## 第15回応用物理学会業績賞受賞記念講演 / 15th JSAP Outstanding Achievement Award Lecture

第15	第15回応用物理学会業績賞受賞記念講演 / 15th JSAP Outstanding Achievement Award Lecture 口頭講演						
	3月11日(水)	14:30 - 15:1	5				
招待	14:30 - 15:15	11p-E1-1	「第15回応用物理学会業績賞(教育業績)受賞記念講演」(45分) ネット時代の応物コミュニケーション	○佐藤 勝昭¹	1.科学技術振興機構		
	3月12日(木)	14:00 - 14:4	5				
招待	14:00 - 14:45	12p-A23-1	「第15回応用物理学会業績賞(研究業績)受賞記念講演」(45分) 大容量メモリ技術の産業展開への貢献と三次元集積化技術の先 駆的研究	〇小柳 光正1	1.東北大学		
	3月12日(木) 16:00 - 16:45						
招待	16:00 - 16:45	12p-A10-8	「第15回応用物理学会業績賞(研究業績)受賞記念講演」(45分) フォトニック結晶工学の進展と今後の展望	〇野田 進 <sup>1</sup>	1.京大		

## 特別シンポジウム

14:25 - 14:50 14a-B2-14

14:50 - 15:00 14a-B2-15

用物理分野で流	舌躍する女性は	幸 −第3回バイオエレクトロニクス編− / Women in /	Applied Physics - Part III: Bioelec	tronics -			
3月13日(金) 9:00 - 12:00							
9:00 - 9:05	13a-B3-1	趣旨説明	○高井 まどか¹	1.東京大学			
9:05 - 9:10	13a-B3-2	会長挨拶	○河田 聡□	1.大阪大学			
9:10 - 9:30	13a-B3-3	金属微粒子二次元シートによるバイオインターフェイスの高分解能 蛍光観察	○玉田 薫¹	1.九州大学			
9:30 - 9:50	13a-B3-4	プラズモニックチップを用いた高感度蛍光検出法のバイオイメージン グとバイオセンシングへの応用	○田和 圭子1	1.産業技術総合研究所			
9:50 - 10:00	13a-B3-4.1	休憩					
10:00 - 10:40	13a-B3-5	我が国の科学技術イノベーション政策 ~ 若手・女性活躍によるイノ ベーション創出~	○久間 和生¹	1.総合科学技術・イノベーション会議			
10:40 - 11:00	13a-B3-6	神経細胞の機能計測とナノテクノロジ	○河西 奈保子¹	1.NTT			
11:00 - 11:20	13a-B3-7	シリコン微細加工で創る脂質二分子膜イオンチャネルチップ	○平野 愛弓¹	1.東北大学			
11:20 - 11:30	13a-B3-7.1	休憩					
11:30 - 12:00	13a-B3-8	バネル討論	〇高井 まどか¹, 永松 愛子², 南谷 英美², 住 友 弘二², 山田 明⁴	1.東京大学, 2.宇宙航空研究開発機構, 3.NTT, 4.東京工業大学			

フォノンエンジニアリング:ナノスケール熱制御のための新しい材料科学、理論・シミュレーション、計測技術、およびこれによるデバイス革新

/ PHONON ENGINEERING: material science, theory/simulation and measurement technologies for Nano-scale thermal management

and devic	and device innovation						
3月14日(土) 8:45 - 15:00							
8:45 - 8:55	14a-B2-1	はじめに	○粟野 祐二¹	1.慶大理工			
8:55 - 9:20	14a-B2-2	ナノ構造や界面によるフォノン輸送制御	○塩見 淳一郎1.2	1.東大工, 2.JSTさきがけ			
9:20 - 9:45	14a-B2-3	最低熱伝導率の観点に基づく低熱伝導率材料の候補物質	○桂 ゆかり¹, 高木 英典¹², 押山 淳¹	1.東大工, 2.MPI 固体研			
9:45 - 10:10	14a-B2-4	フォノンの波動性を利用した熱伝導制御	○野村 政宏1.2	1.東大生研, 2.東大ナノ量子機構			
10:10 - 10:35	14a-B2-5	摂動分子動力学法による複雑結晶構造酸化物の格子熱伝導の数 値解析	○吉矢 真人 <sup>1,2</sup> , 藤井 進 <sup>1</sup> , 宮内 洋平 <sup>1</sup> , 多田 昌浩 <sup>1</sup> , 柳樂 知也 <sup>1</sup> , 安田 秀幸 <sup>1,3</sup>	1.大阪大工, 2.ファインセラミックスセンタ ー, 3.京都大工			
10:35 - 11:00	14a-B2-6	ポーラス Si 薄膜の熱伝導	○宮崎 康次¹	1.九州工大工			
11:00 - 11:25	14a-B2-7	バルス光加熱サーモリフレクタンス法でみる薄膜および界面での熱 伝導	○八木 貴志¹, 竹歳 尚之¹, 馬場 哲也¹	1.産総研			
11:25 - 11:50	14a-B2-8	材料の観点から、熱電材料	○森 孝雄 <sup>1,2</sup>	1.物材機構, 2.筑波大学			
11:50 - 12:15	14a-B2-9	NEMS技術とフォノンエンジニアリング	○水田 博 <sup>1,2</sup> , Manoharan Muruganathan <sup>1</sup> , 小矢野 幹夫 <sup>1</sup> , 土屋 良重 <sup>2</sup>	1.北陸先端大, 2.サザンプトン大			
12:15 - 13:00	14a-B2-9.1	昼食					
13:00 - 13:10	14a-B2-10	ナノスケール熱制御によるデバイス革新	○馬場 寿夫¹	1.JST-CRDS			
13:10 - 13:35	14a-B2-11	抵抗変化メモリ ReRAM におけるナノスケール熱制御	○秋永 広幸¹, 島 久¹	1.産総研			
13:35 - 14:00	14a-B2-12	表面プラズモンを利用した熱アシスト磁気記録	○中川 活二¹, 芦澤 好人¹, 塚本 新¹	1.日大理工			
14:00 - 14:25	14a-B2-13	熱配慮設計によるデバイス高性能化・高機能化戦略	○内田 建1.2, 高橋 綱己1.2	1.慶大理工, 2.JST-CREST			

○畠山 友行¹, 石塚 勝¹

○丸山 茂夫1

1.富山県立大工

1.東大工

フォノンエンジニアリングの電子機器実装への応用

まとめ

	世界行きたい科学広場in 東海大学湘南キャンパス 第一部:シンポジウム / Science Square in Shonan Campus of Tokai University Part 1 symposium							
3月14日(土)	3月14日(土) 9:00 - 10:50							
9:50 - 9:55	14a-F1-1	開会の言葉	○岡田 工¹, 内田 晴久¹	1.東海大				
9:55 - 10:05	14a-F1-2	今回のシンポジウムについて	○葛生 伸¹	1.福井大院工				
10:05 - 10:20	14a-F1-3	学生による子ども向けの体験実験教室	○四方 周輔¹	1.東海大理				
10:20 - 10:35	14a-F1-4	これからのリフレッシュ理科教室について?フェーズチェンジの試みー	○平松 信康¹	1.福岡大				
10:35 - 10:50	14a-F1-5	これからの理科教育が抱える課題	○滝川 洋二¹	1.東海大				

世界	世界行きたい科学広場in 東海大学湘南キャンパス 第二部:科学広場と科学ショー / Science Square in Shonan Campus of Tokai University Part 2 Science Square and Science Shows						
3月14日(土) 11:00 - 15:00							
	11:00	14a-E1-1	科学広場開場				
	12:00 - 13:00	14a-E1-2	「実に面白い実験ショー」青色発光ダイオードの ひみつ~青色LED とノーベル賞~	○滝川 洋二1	1.東海大		
	15:00	14a-E1-3	閉場				
	15:00 - 15:30	14a-E1-4	質疑討論				

かな	かながわ発! スマートエネルギー革命 / Smart Energy Revolution form KANAGAWA							
	3月12日(木) 13:00 - 16:45							
	13:00 - 13:10	12a-E1-1	シンポジウム開催イントロダクトリートーク	○木村 英樹¹	1.東海大工学部・チャレンジセンター			
	13:10 - 13:40	12a-E1-2	スマートエネルギー社会へ! かながわの挑戦	○松浦 治美¹	1.神奈川県産業労働局エネルギー部			
	13:40 - 14:10	12a-E1-3	太陽電池が拓くスマート社会	○羽賀 孝裕¹	1.パナソニックグループ エコソリューションズ社			
	14:10 - 14:40	12a-E1-4	水素がもたらすスマート社会の未来	○中村 博□	1.水素エネルギー製品研究試験センター			
	14:40 - 14:55	12a-E1-4.1	休憩					
	14:55 - 15:25	12a-E1-5	FCEVとEV開発の最前線	○荒井 孝之1	1.日産自動車株式会社総合研究所			
	15:25 - 15:55	12a-E1-6	水素エネルギーの大規模貯蔵運搬技術	○岡田 佳巳1	1.千代田化工建設株式会社			
	15:55 - 16:25	12a-E1-7	水素エネルギーの普及で動き出すスマート社会とエネルギー革命	○内田 裕久¹	1.東海大学工学部			
	16:25 - 16:45	12a-E1-8	総合討論・質疑応答・クロージングリマーク	○杉山 正和1	1.東京大学工学部・応用物理学会エネル ギーシステム研究会			

	産学協働研究会設立シンポジウム-日本のモノづくり再生に向けた産学官共鳴場の創成を目指して- / Kickoff Symposium for Group of Research and Joint-Effort on Industry-Academia Partnership							
3月12日(木)	) 13:30 - 17:3	30						
13:30 - 13:35	12p-B2-1	開会挨拶	○保立 和夫¹	1.東京大学				
13:35 - 13:50	12p-B2-2	産学協働研究会設立の経緯と構想	○末光 眞希¹	1.東北大学				
13:50 - 14:30	12p-B2-3	日本のサイエンス・イノベーション・ファンド政策の根本的な誤り	○山口 栄一1	1.京都大学大学院総合生存学館				
14:30 - 14:50	12p-B2-4	国家財政と科学技術イノベーション-産学連携の観点から-	○片山 健太郎¹	1.財務省主計局文部科学第四係主査				
14:50 - 15:10	12p-B2-5	産学連携の政策的意義	○坂本 修一1	1.文部科学省産業連携地域支援課長				
15:10 - 15:25	12p-B2-5.1	休憩						
15:25 - 15:55	12p-B2-6	半導体産業ビジネス現場から見た産学連携への一考察―化合物半 導体デバイスにおける日米比較から学ぶ―	○乙木 洋平1	1.日立金属				
15:55 - 16:25	12p-B2-7	集積エレクトロニクス領域における産学連携拠点の現状とチャレンジ	○遠藤 哲郎¹	1.東北大学 国際集積エレクトロニクス研 究開発センター センター長				
16:30 - 17:20	12p-B2-8	パネルディスカッション テーマ「産学連携とファンド」						
17:20 - 17:30	12p-B2-9	閉会の挨拶	○堂免 恵¹	1.湧志創造				

# 分科企画シンポジウム / Symposium

3 光	3 光・フォトニクス						
フォ	トニクスと量	子情報技術の融	合へ向けて / Quantum Photonics: Toward a new p	paradigm of quantum information	n technology		
	3月11日(水)	13:30 - 17:1	5				
招待	13:30 - 13:45	11p-B4-1	オープニング	〇根本 香絵 <sup>1</sup>	1.国立情報学研究所		
招待	13:45 - 14:15	11p-B4-2	量子ドットを用いた量子情報素子の現状と期待	〇荒川 泰彦 <sup>1,2</sup>	1.東大ナノ量子機構, 2.東大生研		
招待	14:15 - 14:45	11p-B4-3	光子を用いた量子計測	〇竹内 繁樹 <sup>1</sup>	1.京大工		
招待	14:45 - 15:15	11p-B4-4	量子鍵配送システムとそれを実現するフォトニクス技術	〇南部 芳弘 <sup>1</sup>	1.NECスマエネ研		

	15:15 - 15:30		休憩/Break		
招待	15:30 - 16:00	11p-B4-5	半導体量子ドットによる単一光子および量子もつれ光源	〇熊野 英和1, 中島 秀朗1, 末宗 幾夫1	1.北大電子研
	16:00 - 16:15	奨 11p-B4-6	超伝導磁束量子ビットに結合したNV中心の磁場印加による寿命の 改善	○松崎 雄一郎',シャオポ ズー', 角柳 孝輔', 樋田 啓', 下岡 孝明', 水落 憲和', 根本 香 絵', 仙場 浩一', ムンロー ウィリアム', 山口 浩司', 齊藤 志郎'	1.NTT 物性基礎研, 2.阪大基礎工, 3.国立情報学研究所, 4.情報通信研究機構
	16:15 - 16:30	奨 11p-B4-7	ダイヤモンドスピン縮退キュービットの任意状態生成	○三島 将太¹, 田中 統太¹, 幸村 雄介¹, 関口雄平¹, 新倉 菜恵子¹, 小坂 英男¹	1.横国大院工
招待	16:30 - 17:00	11p-B4-8	ナノエミッタ-ナノフォトニクス結合系における光物質相互作用増強	○納富 雅也1.2	1.NTTナノフォトニクスセンタ, 2.NTT物 性科学基礎研
招待	17:00 - 17:15	11p-B4-9	クロージング	〇岩本 敏 <sup>1</sup>	1.東大生研・ナノ量子機構

6 薄	膜·表面							
斜め			ャドウイングによるナノ形態の制御と評価 cterization of nano-structures prepared with advar	nced shadowing deposition syste	ms			
	3月11日(水	) 13:15 - 17:	:00					
招待	13:15 - 14:00	11p-D9-1	シャドウイングによるナノ形態制御技術の進展と課題	〇鈴木 基史1	1.京大院・工			
招待	14:00 - 14:30	11p-D9-2	3次元ナノテンプレートPLD法による遷移金属酸化物微細構造体 創製	〇服部 梓 <sup>1</sup> , 田中 秀和 <sup>1</sup>	1.阪大産研			
	14:30 - 14:45	11p-D9-3	雰囲気ガスによる表面拡散の制御法の開発と明瞭なAgナノコラム形成への応用	○伊東 孝将¹, 中嶋 薫¹, 木村 健二¹, 鈴 木 基史¹	1.京大院工			
招待	14:45 - 15:15	11p-D9-4	反応性環境下での斜め堆積による化合物薄膜の離散的ナノ柱状構 造形成	〇井上 泰志 <sup>1</sup> , 高井 治 <sup>2</sup>	1.千葉工大工, 2.関東学院大			
	15:15 - 15:30		休憩/Break					
招待	15:30 - 16:00	11p-D9-5	異材界面に挿入したナノ要素集合薄膜の破壊基準	〇澄川 貴志1, 北村 隆行1	1.京大工			
招待	招待 16:00 - 16:30 11p-D9-6 斜め蒸着法を用いた無機光学素子 ○高田 昭夫¹, 小池 伸幸¹, 高橋 英司¹ 1.デクセリアルズ(株)							
招待	16:30 - 17:00	E 11p-D9-7	$WO_3$ -NRs/BiVO $_4$ core-shell nanostructure for enhanced photocatalytic $H_2$ production	OYuriy Pihosh <sup>1</sup> , Kazuma Mawatari <sup>1</sup> , Masahiro Tosa <sup>2</sup> , Takehiko Kitamori <sup>1</sup>	1.University of Tokyo, 2.NIMS			

13 🛱	≚導体						
最先	端CMOS技行	析とその将来	展望 / Advanced CMOS Technology and Its Future S	Scope			
3月11日(水) 13:15 - 17:30							
	13:15 - 13:30	11p-B5-1	最先端CMOS技術とその将来展望	○最上 徹¹	1.PETRA		
招待	13:30 - 14:00	11p-B5-2	3次元構造デバイスにおけるプラズマダメージ層形成モデル	〇江利口 浩二1, 斧 高一1	1.京大院工		
招待	14:00 - 14:30	11p-B5-3	最先端CMOS加工におけるダメージの予測・制御技術	〇久保井 信行1, 深沢 正永1, 辰巳 哲也1	1.ソニー(株)		
	14:30 - 14:45	11p-B5-4	先端電子デバイスエッチング技術とその将来展望	○田中 基裕¹, 安井 尚輝¹, 森本 未知数¹, 伊澤 勝¹	1.日立ハイテク		
	14:45 - 15:00		休憩/Break				
招待	15:00 - 15:30	11p-B5-5	FinFETにおける特性ばらつきと低周波ノイズの抑制技術	〇松川 貴 <sup>1</sup> , 福田 浩一 <sup>1</sup> , 柳 永勛 <sup>1</sup> , 塚田 順一 <sup>1</sup> , 山内 洋美 <sup>1</sup> , 遠藤 和彦 <sup>1</sup> , 大内 真一 <sup>1</sup> , 右田 真司 <sup>1</sup> , 水林 亘 <sup>1</sup> , 森田 行則 <sup>1</sup> , 太田 裕之 <sup>1</sup> , 昌原 明植 <sup>1</sup>	1.産総研		
招待	15:30 - 16:00	11p-B5-6	AC performance improvement by RMG module for 14nm FinFETs and beyond	OMitsuhiro Togo¹, M. Joshi¹, H. V. Meer¹, C. Yong¹, B. Liu¹, X. He¹, X. Wu¹, S. Y. Mun¹, X. Zhang¹, D. Konduparthi², J. Lian¹, G. Bohra¹, W. H. Tong¹, C. Y. Xiao¹, D. Triyoso¹, E. Banghart¹, S. M. Pandey¹, A. Wei¹, R. Pal¹, R. Carter¹, M. H. Nam¹, M. Eller¹, S. Samavedam¹	1.GLOBALFOUNDRIES		
招待	16:00 - 16:30	11p-B5-7	シリコントライゲートナノワイヤトランジスタにおける特性ばらつき・電流ノイズ・閾値電圧シフトの系統的理解	〇齋藤 真澄¹, 太田 健介¹, 田中 千加¹, 松下大介¹, 沼田 敏典¹	1.東芝研開セ		
招待	16:30 - 17:00	11p-B5-8	次世代High-k メタルゲートプロセス	〇吉田 尚美1, アダム ブランド1	1.アプライドマテリアルズ		
招待	17:00 - 17:30	11p-B5-9	Geチャネル High-k/メタルゲートMOSFET向けパッシベーション スキーム	O中村 源志 <sup>1</sup> , Kandabara Tapily <sup>2</sup> , Robert Clark <sup>2</sup> , David O'Meara <sup>2</sup> , Steve Con- siglio <sup>2</sup> , Richard Gaylord <sup>2</sup> , Cory Wajda <sup>2</sup> , Gert Leusink <sup>2</sup> , Tat Ngai <sup>3</sup> , Dmitry Vek- sler <sup>3</sup> , Chris Hobbs <sup>3</sup> , Ken Matthews <sup>3</sup> , David Gilmer <sup>3</sup> , Paul Kirsch <sup>3</sup>	1.東京エレクトロン(株), 2.TEL Technology Center, America, LLC, 3.SEMATECH		

2 放	2 放射線							
放射	線オプティク	ス / Ionizing ra	adiation optics					
	3月12日(木	) 14:00 - 17:1	15					
招待	14:00 - 14:30	12p-A19-1	宇宙X線観測用望遠鏡	〇松本 浩典1	1.名大KMI			
招待	14:30 - 15:00	12p-A19-2	回折格子を用いたX線顕微法の開発	〇矢代 航1	1.東北大多元研			
招待	15:00 - 15:30	12p-A19-3	放射光X線ナノ集光技術の現状と将来展望	〇山内 和人1	1.大阪大学			
	15:30 - 15:45		休憩/Break					
招待	15:45 - 16:15	12p-A19-4	フレネルゾーンプレートを用いたX線顕微イメージング技術の開発	〇竹内 晃久 $^1$ , 鈴木 芳生 $^1$ , 上杉 健太朗 $^1$ , 小田 政利 $^2$	1.JASRI / SPring-8, 2.NTT-AT			
招待	16:15 - 16:45	12p-A19-5	中性子反射光学素子の開発とその応用	〇日野 正裕1	1.京大原子炉			
招待	16:45 - 17:15	12p-A19-6	X線天文・探査衛星に向けたマイクロマシン技術を用いた超軽量X 線望遠鏡	○江副 祐一郎1	1.首都大理工物理			

3 光	・フォトニクス								
レー	レーザーによる3次元造形技術の最先端から実用まで / Advanced and Practical 3D Fabrication Techniques Using Lasers								
	3月12日(木) 13:30 - 18:00								
招待	13:30 - 14:30	12p-B6-1	光造形法の創作時顛末(発明想到経緯・当時の評価・特許4失策)	〇小玉 秀男1	1.快友国際特許事務所				
招待	14:30 - 15:00	12p-B6-2	マイクロ光造形・鋳型技術の進展と応用	〇丸尾 昭二1	1.横国大院工				
	15:00 - 15:15		休憩/Break						
招待	15:15 - 15:45	12p-B6-3	3Dプリンターで注目される粉末床溶融結合技術	○早野 誠治¹	1.株式会社アスペクト				
招待	15:45 - 16:15	12p-B6-4	フェムト秒レーザーを用いた透明固体内部加工	〇松尾 繁樹 <sup>1</sup>	1.芝浦工大工				
招待	16:15 - 16:45	12p-B6-5	除去・付加複合フェムト秒レーザー3次元加工	〇杉岡 幸次¹, Wu Dong¹, Xu Jian¹, Sima Felix¹, 緑川 克美¹	1.理研光量子工学研究領域				
	16:45 - 17:00		休憩/Break						
	17:00 - 17:15	E 12p-B6-6	Flexible electrode patterning in glass microchannels using hybrid femtosecond laser microfabrication for 3D controllable electro-orientation of microorganisms	○Jian Xu¹, Hiroyuki Kawano¹, Dong Wu¹, Katsumi Midorikawa¹, Koji Sugioka¹	1.RIKEN				
	17:15 - 17:30	奨 12p-B6-7	フェムト秒レーザを用いたNi微細構造の還元パターニング特性	○田村 健紀¹, 溝尻 瑞枝², 櫻井 淳平², 秦 誠一²	1.名大工, 2.名大院工				
	17:30 - 17:45	12p-B6-8	レーザー支援エッチングによる多成分ガラス基板への貫通孔形成	○米村 正寿¹, 加藤 覚¹, 長谷川 和男¹, 高 橋 秀知²	1.豊田中研, 2.アイシン精機				
	17:45 - 18:00	12p-B6-9	配向を制御したカーボンナノチューブ/ボリマーコンボジット3次元マイクロ構造のレーザー形成	○庄司 暁¹, 牛場 翔太², 增井 恭子², 河 田 聡²	1.電通大先進理工, 2.阪大院工				

3 光	3 光・フォトニクス							
光量	光量子を自在に操る分極反転光デバイス / Polarity-reversed optical device handling quantum photons							
	3月12日(木)	) 13:15 - 17:0	00					
招待	13:15 - 13:45	12p-D2-1	分極反転デバイスによるもつれ光子対発生	〇岸本 直¹, 曹 博², 陳 切春², 上野 若菜², 薮野 正裕², 三森 康義², 荒平 慎¹, 村井 仁 ¹, 枝松 圭一²	1.沖電気工業, 2.東北大通研			
招待	13:45 - 14:15	12p-D2-2	帯域拡大分極反転デバイスによる量子もつれ光子対	〇田中 陽 <sup>1,2</sup> , 岡本 亮 <sup>1,2,3</sup> , Lim Hwang- Hong <sup>4</sup> , 栗村 直 <sup>4</sup> , 竹内 繁樹 <sup>1,2,3</sup>	1.北大電子研, 2.阪大産研, 3.京大工, 4.物材機構			
招待	14:15 - 14:45	12p-D2-3	低複屈折分極反転デバイスによる量子もつれ光子生成	〇清水 亮介 <sup>1</sup>	1.電通大先端セ			
招待	14:45 - 15:15	E 12p-D2-4	Spontaneous parametric down conversion in adhered slab waveguide based on periodically poled lithium tantalate	OHwan Hong Lim <sup>1</sup> , Sunao Kurimura <sup>1</sup> , Kazufumi Fujii <sup>1</sup> , Masayuki Okano <sup>2</sup> , Shigeki Takeuchi <sup>2,3,4</sup>	1.NIMS, 2.Kyoto Univ., 3.Hokkaido Univ., 4.Osaka Univ.			
	15:15 - 15:30		休憩/Break					
招待	15:30 - 16:00	12p-D2-5	超短パルス発生・制御からみた分極反転デバイスへの期待	〇藤 貴夫 <sup>1</sup>	1.分子研			
招待	16:00 - 16:30	12p-D2-6	広帯域分極反転MgO:LNを用いた緑色レーザ発生	〇正田 史生 <sup>1</sup> , 秋野 陽介 <sup>1</sup> , 山本 修平 <sup>1</sup> , 柳澤 隆行 <sup>1</sup> , 平野 嘉仁 <sup>1</sup>	1.三菱電機			
招待	16:30 - 17:00	12p-D2-7	紫外光発生用新結晶 LBGO	〇廣橋 淳二 <sup>1</sup> , 谷内 哲夫 <sup>2</sup> , 今井 浩一 <sup>1</sup> , 坂 入 光佳 <sup>1</sup> , 竹川 俊二 <sup>1</sup> , 松倉 誠 <sup>1</sup> , 宮澤 信太郎 <sup>1,3</sup> , 古川 保典 <sup>1</sup>	1.オキサイド, 2.東北大学際研, 3.早 大材研			

3 光	3 光・フォトニクス							
散选	散逸ゆらぎ制御ナノ電子フォトン系の理論とデバイス構築 / Theory and Practice of Nanoelectron-photon Interaction via Dissipation and Fluctuations							
	3月12日(木	) 14:00 - 17:	45					
招待	14:00 - 14:30	12p-A12-1	スピンゆらぎの物理基盤とデバイス構築	〇田畑 仁1	1.東大院工			
招待	14:30 - 15:00	12p-A12-2	ナノ環境における揺らぎの下での光誘起ダイナミクスの理論と応用	〇飯田 琢也 <sup>1</sup> , 床波 志保 <sup>2</sup> , 伊都 将司 <sup>3</sup>	1.大阪府大院理, 2.大阪府大ナノ科学・ 材料セ, 3.阪大院基礎工			
招待	15:00 - 15:30	12p-A12-3	ナノ電子フォトン系における機能の基本構造と圏論に基づく描像	〇堀 裕和1	1.山梨大院総研			
招待	15:30 - 16:00	12p-A12-4	天然光合成PSIIに学ぶ水の酸化反応	〇中村 振一郎1	1.理化学研究所			
	16:00 - 16:15		休憩/Break					
招待	16:15 - 16:45	12p-A12-5	フォトクロミック分子材料の最前線	〇入江 正浩 <sup>1</sup>	1.立教大学未来分子センター			
招待	16:45 - 17:15	12p-A12-6	揺律場の科学に向けて	○原 正彦 <sup>1,2</sup>	1.東工大総理工, 2.理研			
招待	17:15 - 17:45	12p-A12-7	綱引きポムベ:全体最適な意思決定器「知的ナノ構造体」に向けて	〇金 成主 <sup>1</sup> , 青野 真士 <sup>2,3</sup> , 成瀬 誠 <sup>4</sup>	1.物材機構, 2.東工大, 3.JST, 4.情 通機構			

3 光	3 光・フォトニクス							
宇宙	宇宙観測・地球観測で活用される光センシング技術 / Optical sensing utilized in space and earth observations							
	3月12日(木	13:30 - 16:	15					
招待	13:30 - 14:00	12p-B3-1	系外惑星直接観測のための高コントラスト撮像光学系	〇西川 淳 <sup>1,2</sup>	1.国立天文台, 2.総研大物			
招待	14:00 - 14:30	12p-B3-2	系外惑星探査のための近赤外ドップラー分光と光周波数コム	〇黒川 隆志 <sup>1,2</sup> , 柏木 謙 <sup>2</sup> , 小谷 隆行 <sup>1</sup> , 西川 淳 <sup>1,4</sup> , 田村 元秀 <sup>1,3</sup>	1.国立天文台, 2.東京農工大, 3.東大, 4.総研大			
招待	14:30 - 15:00	12p-B3-3	大型低温重力波望遠鏡KAGRAとレーザー干渉計技術	〇安東 正樹1,2	1.東大理, 2.国立天文台			
	15:00 - 15:15		休憩/Break					
招待	15:15 - 15:45	12p-B3-4	超小型衛星ほどよし3,4号における光学系とその成果	〇青柳 賢英1, 中須賀 真一1	1.東大工			
招待	15:45 - 16:15	12p-B3-5	人工衛星用光ファイバジャイロ:高精度化のためのキー技術	〇巳谷 真司¹, 水谷 忠均¹, 篠崎 慶亮¹, 佐々木 善信¹	1.JAXA			

6 薄	6 薄膜·表面 9 応用物性							
次世	次世代強誘電体材料の開発指針 / Guidelines for Development of Ferroelectric Materials in the Following Generation							
	3月12日(木)	13:30 - 17:3	30					
招待	13:30 - 14:00	12p-B5-1	チタン酸バリウム系強誘電体の開拓を振り返って	〇秋重 幸邦1	1.島根大教育			
招待	14:00 - 14:30	12p-B5-2	強誘電体エレクトロニクス材料の研究開発動向	○安藤 陽1	1.村田製作所			
招待	14:30 - 15:00	12p-B5-3	強誘電体プローブデータストレージ	〇平永 良臣 $^1$ ,青木 朋徳 $^1$ ,陳 一桐 $^1$ ,長 康雄 $^1$	1.東北大通研			
招待	15:00 - 15:30	12p-B5-4	強誘電体薄膜の圧電MEMS への応用	〇小林 健¹, 牧本 なつみ¹, 岡田 浩尚¹, 高松誠一¹, 鈴木 靖弘¹, 伊藤 寿浩¹, 前田 龍太郎¹	1.産総研			
	15:30 - 15:45		休憩/Break					
招待	15:45 - 16:00	12p-B5-5	「講演奨励賞受賞記念講演」(15分) Hf02基エビタキシャル薄膜の強誘電性	〇清水 荘雄1, 片山 きりは2, 舟窪 浩1.2	1.東工大元素, 2.東工大総理工			
招待	16:00 - 16:30	12p-B5-6	エネルギー変換応用を指向した非鉛強誘電体薄膜の開発	〇吉村 武1, 藤村 紀文1	1.阪府大院工			
招待	16:30 - 17:00	12p-B5-7	KNN非鉛圧電薄膜の開発	〇堀切 文正1, 渡辺 和俊1, 柴田 憲治1	1.日立金属			
招待	17:00 - 17:30	12p-B5-8	酸化物エレクトロニクスと強誘電体 一過去、現在、未来一	○田畑 仁¹	1.東大院工			

6薄	6 薄膜・表面							
スピ	スピン-軌道相互作用が生み出す酸化物の新しい機能性 / New functionality of oxides generated by spin-orbit interaction							
	3月12日(木)	13:15 - 18:3	30					
招待	13:15 - 14:15	12p-D10-1	トポロジカル量子現象の視点とトポロジカル超伝導	〇前野 悦輝1	1.京大院理			
招待	14:15 - 15:00	12p-D10-2	カルコゲナイド系トポロジカル絶縁体の実験研究	〇瀬川 耕司 <sup>1</sup>	1.阪大産研			
招待	15:00 - 15:45	12p-D10-3	トポロジカル絶縁体設計に向けたイリジウム酸化物(111)超格子 の実現	〇平井 大悟郎1	1.東大理物			
	15:45 - 16:00		休憩/Break					
招待	16:00 - 16:45	12p-D10-4	ペロブスカイトハーフメタル/強誘電体へテロ構造のマルチフェロイック特性	〇浅野 秀文 <sup>1</sup> , 蘇 ジョンミン <sup>1</sup> , 許 方舟 <sup>1</sup> , 伊東 和徳 <sup>1</sup> , 羽尻 哲也 <sup>1</sup> , 植田 研二 <sup>1</sup>	1.名古屋大院工			
招待	16:45 - 17:30	12p-D10-5	マルチフェロイックにおけるエレクトロマグノンの電気磁気共鳴	○高橋 陽太郎1,2,3	1.東大工, 2.理研 CEMS, 3.PRESTO JST			
	17:30 - 17:45	12p-D10-6	垂直磁気異方性を誘起したMn酸化物薄膜における異常ホール効果	○中村 優男¹, 森川 大輔¹, 于 秀珍¹, 有馬 孝尚¹², 川﨑 雅司¹², 十倉 好紀¹²	1.理研 CEMS, 2.東大院工			
招待	17:45 - 18:30	12p-D10-7	ナノスケール磁気渦-スキルミオンの直接観察	〇于 秀珍1	1.理研創発			

6 薄	6 薄膜·表面							
二酸	二酸化チタンの最近の動向 / Recent development of titanium dioxide							
	3月12日(木)	13:15 - 17:3	30					
招待	13:15 - 13:30	12p-D9-1	二酸化チタンの最近の動向	○坂間 弘¹	1.上智大理工			
招待	13:30 - 14:00	12p-D9-2	Overview:結晶多形および表面・界面	〇大西 洋 <sup>1</sup>	1.神戸大院理			
招待	14:00 - 14:30	12p-D9-3	二酸化チタン表面の光励起キャリア寿命―光触媒活性を向上させる ためのヒント―	○小澤 健一¹	1.東工大院理工			
招待	14:30 - 15:00	12p-D9-4	色素増感太陽電池における二酸化チタン光電極の役割	〇荒川 裕則 <sup>1</sup>	1.東理大工			
招待	15:00 - 15:30	12p-D9-5	抵抗変化メモリ -メモリ材料としての二酸化チタン-	〇木下 健太郎1,2	1.鳥取大工, 2.TiFREC			
	15:30 - 15:45		休憩/Break					
招待	15:45 - 16:15	12p-D9-6	TiO <sub>2</sub> 系透明導電体の新進展	〇長谷川 哲也1,2,3	1.東大院理, 2.KAST, 3.JST-CREST			
招待	16:15 - 16:45	12p-D9-7	酸化チタン・ナノチューブ複合体の形成とデバイス応用	〇庭野 道夫1	1.東北大通研			
招待	16:45 - 17:15	12p-D9-8	球状多孔質金属酸化物ナノ粒子の一段階合成とその応用	大谷 政孝¹, 〇小廣 和哉¹	1.高知工科大環境理工			
招待	17:15 - 17:30	12p-D9-9	二酸化チタンへの期待	〇佐々木 正洋 <sup>1</sup>	1.筑波大数物			
1110	11.15 11.50	12p 137 7		OE (NEA	1.70112773210			

7ビ	ーム応用								
リソ	グラフィ技術の	の最新動向 / T	he latest trend of the lithography technology						
	3月12日(木)	13:15 - 15:3	30						
招待	13:15 - 14:00	12p-C3-1	リソグラフィ技術の発展とEUVリソグラフィの最新動向	〇岡崎 信次1	1.ギガフォトン(株)				
招待	14:00 - 14:30	12p-C3-2	マルチパターニングによる微細加工の可能性	〇八重樫 英民 $^1$ , 小山 賢 $^{-1}$ , 山内 祥 $^{-1}$ , 原	1.東京エレクトロン				
招待	14:30 - 15:00	12p-C3-3	ジブロックコポリマーを用いた誘導自己組織化プロセスのモデリングと最適化	〇吉元 健治¹, 深渡瀬 健¹, 堀 義宗¹, 銭谷 優佑¹, 大嶋 正裕¹	1.京大				
招待	15:00 - 15:30	12p-C3-4	Nanoimprint systems for high volume semiconductor manufacturing	〇岩本 和徳¹, 酒井 啓太¹, 岩永 武彦¹, 高 林 幸夫¹	1.キヤノン株式会社				

8プ	8 プラズマエレクトロニクス							
微粒	微粒子合成法とその応用最前線 / Synthesizing methods for fine particles and their latest applications							
	3月12日(木)	13:30 - 18:4	15					
招待	13:30 - 13:45	12p-D14-1	プラズマによる微粒子合成法の現状と課題	〇渡辺 隆行 <sup>1</sup>	1.九大工			
招待	13:45 - 14:15	12p-D14-2	熱プラズマプロセスによるナノ粒子の合成とその応用	〇中村 圭太郎1, 上原 浩臣1, 七蔵司 和哉1	1.日清製粉グループ本社			
招待	14:15 - 14:45	12p-D14-3	プラズマによるナノ粒子の合成と凝集・輸送制御	〇白谷 正治 <sup>1</sup> , 古閑 一憲 <sup>1</sup>	1.九大シス情			
招待	14:45 - 15:15	12p-D14-4	金超原子および超原子分子:合成と評価	〇佃 達哉 <sup>1,2</sup>	1.東大院理, 2.京大ESICB			
招待	15:15 - 15:45	12p-D14-5	低圧プラズマによる微粒子表面修飾法	〇永津 雅章 <sup>1</sup>	1.静大創科技院			
	15:45 - 16:00	奨 12p-D14-6	間欠スパッタによるFe微粒子高密度形成	○(DC)小路 紘史¹, 本郷 知紀¹, 楠本 雄司¹, 古田 寛¹², 八田 章光¹²	1.高知工科大院, 2.高知工科大総研ナ ノテクC			

	16:00 - 16:15		休憩/Break		
招待	16:15 - 16:45	12p-D14-7	コロイド化学的手法によるヘテロ構造ナノ粒子の合成	〇前之園 信也 <sup>1</sup>	1.北陸先端大マテリアル
招待	16:45 - 17:15	12p-D14-8	超臨界プラズマによるダイヤモンドモイド合成法	〇寺嶋 和夫 <sup>1</sup> , シュタウス スベン <sup>1</sup> , 占部 継 一郎 <sup>1</sup> , 石井 千佳子 <sup>1</sup> , 大島 郁人 <sup>1</sup> , 加藤 智嗣 <sup>1</sup>	1.東大 新領域
招待	17:15 - 17:45	12p-D14-9	液中プラズマを用いるナノ粒子のグリーンな合成と改質	〇米澤 徹1	1.北大院工
	17:45 - 18:00	12p-D14-10	液体電極を用いた大気圧プラズマによる磁性ナノ粒子生成の検討	〇白井 直機 $^{1}$ , 吉田 健人 $^{1}$ , 内田 $\hat{\mathbf{a}}^{1}$ , 杤久 保 文嘉 $^{1}$	1.首都大
招待	18:00 - 18:30	12p-D14-11	微粒子プロセスの高度化による多機能材料の創製	○目 義雄¹	1.物材機構
招待	18:30 - 18:45	12p-D14-12	まとめと展望	○金子 俊郎1	1.東北大院工

12 本	12 有機分子・バイオエレクトロニクス								
バイ	オインターフ	ェースの可視	化・実用技術の新展開 / Visualization and application	of biointerfaces					
	3月12日(木) 13:15 - 17:15								
招待	13:15 - 13:45	12p-D5-1	バイオインタフェース設計とバイオセンサーの高機能化	〇民谷 栄一1	1.阪大工				
招待	13:45 - 14:15	12p-D5-2	FM-AFMおよび3次元フォースマッピング法による生体分子-溶液 界面構造の可視化	〇山田 啓文1, 小林 圭1,2	1.京大工, 2.京大白眉センター				
招待	14:15 - 14:45	12p-D5-3	水溶液-固体界面における無機イオンの振る舞い	〇赤木 和人1	1.東北大AIMR				
	14:45 - 15:00	12p-D5-4	分子動力学法に基づくdouble-stranded DNA界面の水とイオン挙動	○前川 侑毅¹, 澁田 靖¹, 加治佐 平¹, 坂 田 利弥¹	1.東大院工				
	15:00 - 15:15		休憩/Break						
招待	15:15 - 15:45	12p-D5-5	表面化学修飾による菌の接着制御	〇中野 美紀¹, 三宅 晃司¹, 西村 麻里江²	1.産総研, 2.生物研				
	15:45 - 16:00	12p-D5-6	酸化グラフェン表面に固定したアプタマの分子吸脱着特性	○上野 祐子¹, 古川 一暁¹, 日比野 浩樹¹	1.NTT物性基礎研				
招待	16:00 - 16:30	12p-D5-7	生体不活性特性と界面水分子	〇林 智広1	1.東工大 総理工				
招待	16:30 - 16:45	12p-D5-8	「講演奨励賞受賞記念講演」(15分) 吸着抑制能を有するオリゴエチレングリコール末端SAMの液中 3D-SFM計測	〇稲田 なつみ <sup>1</sup> , 淺川 雅 <sup>2</sup> , 宮澤 佳甫 <sup>1</sup> , 福 間 剛士 <sup>1,2,3</sup>	1.金大院, 2.金大バイオAFMセ, 3.JST ACT-C				
招待	16:45 - 17:15	12p-D5-9	フラグメント分子軌道法でナノ-バイオ界面を見る	〇望月 祐志1.2, 福澤 薫2.3	1.立教大理, 2.東大生産研, 3.日大 松戸歯				

13 <del>-</del>	半導体				
未来			「 ~集積化技術の新たな価値創造を目指して~ e as future scientists? - Innovative value creation。	of integration technology by your	ng generations -
	3月12日(木	) 13:00 - 17	:00		
招待	13:00 - 13:30	12p-A29-1	若き科学者たちよ。未来産業創造にむけて沈みゆく船・日本を救え。	〇山口 栄一 <sup>1</sup>	1.京大院 総合生存
招待	13:30 - 14:00	12p-A29-2	将来の超集積化システムにおける指導原理 ― 学振165委員会の 議論から ―	〇平本 俊郎1	1.東大生研
	14:00 - 14:15	12p-A29-3	自己加熱効果の抑制によるFinFET低消費電力化の検討	○高橋 綱己1.2, 内田 建1.2	1.慶應大理工 電子工, 2.JST CREST
	14:15 - 14:30	12p-A29-4	フォーミングガスアニールがCr/SiOg/Si界面の熱抵抗に与える影響	○熊田 亜理沙¹, 竹内 豪¹, 宮田 耕¹, 高橋 綱己¹², 内田 建¹²	1.慶應大理工 電子工, 2.JST CREST
	14:30 - 14:45	奨 12p-A29-5	金属/Ge界面への高Sn組成Ge $_{1-x}$ Sn $_x$ 層挿入によるショットキー障壁高さの低減	○鈴木 陽洋¹, 柴山 茂久¹², 坂下 満男¹, 竹内 和歌奈¹, 中塚 理¹, 財満 鎖明¹.³	1.名大院工, 2.学振DC, 3.名大エコトピア
	14:45 - 15:00	12p-A29-6	$HfO_2/Al_2O_3/In_{0.55}Ga_{0.47}As$ 界面に対する窒素プラズマクリーニング後の水素アニール効果に関する研究	○袮津 誠晃¹, 金澤 徹¹², 宮本 恭幸¹²	1.東工大工, 2.東工大院理工
	15:00 - 15:15		休憩/Break		
招待	15:15 - 15:45	12p-A29-7	3次元集積化技術が拓くDiversificationの未来 - From LSI of scale to LSI of scope -	O田中 徹 <sup>1</sup>	1.東北大院医工
	15:45 - 16:00	12p-A29-8	三次元集積化における異種材料間の熱膨張係数差がおよぼす影響	○木野 久志¹, 池ヶ谷 俊介², 小柳 光正³, 田中 徽⁴	1.東北大学際研, 2.東北大工, 3.東北大 未来研, 4.東北大院医工
招待	16:00 - 16:30	12p-A29-9	超柔軟有機デバイスによる生体情報計測	〇染谷 隆夫 <sup>1,2</sup>	1.東大工, 2.JST/ERATO
	16:30 - 16:45	12p-A29-10	スパッタ堆積MoS。膜の下地平坦化による電気特性向上	○大橋 匠', 山口 晋平', 松浦 賢太朗', 須田 耕平², 石原 聖也², 澤本 直美², 角嶋 邦之', 杉井 信之', 西山 彰', 片岡 好則', 名取 研二', 筒井 一生', 岩井 洋', 小椋 厚志², 若林 整'	1.東工大, 2.明治大
	16:45 - 17:00	12p-A29-11	VO。薄膜における金属・絶縁体転移を用いた電界効果三端子素子の実証	○矢嶋 赳彬¹², 西村 知紀¹², 鳥海 明¹²	1.東大, 2.JST-CREST

13 半導体									
クル	マ社会の未み	来を支えるセン	シング技術 ~自動運転システムの展望と課題~						
	$/$ Sensing Technologies for the Future of Automobile Society $\sim$ The Prospect and Challenge of Autonomous Driving System $\sim$								
	3月12日(木	) 14:00 - 17:	15						
招待	14:00 - 14:30	12p-D15-1	将来のクルマを支えるセンシング技術; MEMS技術に期待!	○宮田 博司1	1.トヨタテクニカルディベロップメント(株)				
招待	14:30 - 15:00	12p-D15-2	自動運転とADASセンサーがもたらす社会のイノベーション	○野辺 継男¹.²	1.インテル, 2.名古屋大学				
	15:00 - 15:15	奨 12p-D15-3	Sub-1Gから20Gまで検知可能な集積化MEMS加速度センサの検討	〇山根 大輔 $^{1.4}$ , 小西 敏文 $^2$ , 松島 隆明 $^2$ , 年吉 洋 $^{3.4}$ , 町田 克之 $^{1.2.4}$ , 益 一哉 $^{1.4}$	1.東工大, 2.NTT-AT, 3.東大, 4.JST- CREST				
	15:15 - 15:30	12p-D15-4	MEMS3軸加速度センサのマトリックス感度並列計測	○土屋 智由¹, 中野 篤¹, 平井 義和¹, 田畑 修¹, 梅田 章²	1.京大工, 2.ベクトルダイナミックス				
	15:30 - 15:45		休憩/Break						
招待	15:45 - 16:15	12p-D15-5	情報通信技術の観点から見た自動車のセキュリティ	〇黒田 幸明 <sup>1</sup>	1.サイバー創研				
招待	16:15 - 16:45	12p-D15-6	自動車運転支援のための画像認識技術	○岡田 隆三1	1.(株)東芝				

16:45 - 17:00	奨 12p-D15-7	トリリオンセンサ時代に向けた自動ID生成回路	○松永 賢一¹, 大嶋 尚一¹, 美濃谷 直志², 近藤 利彦¹, 森村 浩季¹	1.NTT先デ研, 2.NTTMI研(現NTT テレコン)
17:00 - 17:15	12p-D15-8	室内 $\mathrm{CO}_2$ モニタリングのための波長選択赤外光源	○佐々木 実¹, 熊谷 慎也¹	1.豊田工大

AE	ナッションド	ロイドギャッフ	『ஸんりかと道体材料・デバイフ						
	合同セッションK ワイドギャップ酸化物半導体材料・デバイス 酸化物半道体における価電子メタモルフ+ロジ / Valence-electron metamorphology in oxide semiconductors								
酸化	後化物半導体における価電子メタモルフォロジ / Valence-electron metamorphology in oxide semiconductors								
	3月12日(木) 13:15 - 18:30								
	13:15 - 13:30   12p-D1-1   酸化物半導体における価電子メタモルフォロジ:Introductory Talk   ○川原村 敏幸 <sup>1</sup> , 阿部 友紀 <sup>2</sup> , 宇野 和行 <sup>3</sup>   1.高知コ				1.高知工大, 2.鳥取大, 3.和大				
招待	13:30 - 14:00	12p-D1-2	Stem Technology Initiative for sustainable energy future based on smart chemistry of oxides	〇鯉沼 秀臣1	1.東大				
招待	14:00 - 14:30	12p-D1-3	酸化物半導体における価電子メタモルフォロジの制御	○藤田 静雄¹	1.京大院工				
招待	14:30 - 15:00	12p-D1-4	2価のユウロピウムを含むペロブスカイト型酸化物の磁気的性質	〇田中 勝久1, 藤田 晃司1	1.京大院工				
招待	15:00 - 15:30	12p-D1-5	可視領域でバンドギャップチューニング可能なZnO系新材料の開発 〇板垣 奈穂 <sup>1,2</sup> 、松島 宏一 <sup>1</sup> 、井出 知章 <sup>1</sup> 、山 下 大輔 <sup>1</sup> 、徐 鉉雄 <sup>1</sup> 、古閑 一憲 <sup>1</sup> 、白谷 正治 <sup>1</sup>		1.九大シス情, 2.JSTさきがけ				
招待	15:30 - 16:00	12p-D1-6	鉄系酸化物半導体の価電子制御と光・電気・磁気特性	〇田畑 仁1	1.東大院工				
	16:00 - 16:15		休憩/Break						
	16:15 - 16:30	12p-D1-7	$\beta$ -Ga $_2$ O $_3$ 結晶の透過と反射スペクトルの偏光依存性	○尾沼 猛儀 <sup>1,23</sup> , 齋藤 伸吾³, 佐々木 公平 ³-4, 增井 建和⁴, 山口 智広², 本田 徹², 東 脇 正高³	1.東京高専, 2.工学院大, 3.情通機構, 4.タムラ製作所				
	16:30 - 16:45	12p-D1-8	結晶性OS FETのドレイン電流耐性	○馬場 晴之¹, 鈴木 陽夫¹, 小林 由幸¹, 松田 慎平¹, 齋藤 暁², 早川 昌彦², 山崎 舜平¹.²	1.半エネ研, 2.AFD Inc				
	16:45 - 17:00	奨 12p-D1-9	$Sr_{1x}La_xSnO_3$ 透明導電薄膜の作製	○馬場 枝里奈¹, 菅 大介¹, 島川 祐一¹.²	1.京大化研, 2.JST-CREST				
招待	17:00 - 17:30	12p-D1-10	2次元酸化物ナノシートのメタモルフォロジ	〇長田 実1, 佐々木 高義1	1.物材機構MANA				
招待	17:30 - 18:00	12p-D1-11	ペロプスカイト酸化物薄膜の電子状態を原子空間分解能で明らか にする	〇一杉 太郎1	1.東北大学AIMR				
招待	18:00 - 18:30	12p-D1-12	ワイドバンドギャップ酸化亜鉛における価電子メタモルフォロジ	〇山本 哲也1, 野本 淳一1, 牧野 久雄1	1.高知工科大総研				

15 糸	15 結晶工学									
	進化するパワー半導体・・・シリコンからワイドバンドギャップへ / Progress of power semiconductors, toward wide band-gap materials beyond silicon									
	3月12日(木) 13:15 - 18:15									
招待	13:15 - 13:30	12p-B4-1	イントロダクトリー	〇木本 恒暢 <sup>1</sup>	1.京大					
招待	13:30 - 14:00	12p-B4-2	戦略的イノベーション創造プログラム(SIP)「次世代パワーエレクトロニクス」の取り組み	〇大森 達夫1, 田中 保宣1	1.内閣府					
招待	14:00 - 14:30	12p-B4-3	パワーデバイスの現状と今後の進展について	〇齋藤 渉¹	1.東芝					
招待	14:30 - 15:00	12p-B4-4	パワーデバイス用単結晶の結晶成長	〇柿本 浩一¹, ガオ ビング¹, リュウ キン¹, 中野 智¹, 西澤 伸一², 原田 博文³, 宮村 佳児³, 関口 隆史³, 寒川 義裕²	1.九大応力研, 2.産総研, 3.物質材料機構					
招待	15:00 - 15:30	12p-B4-5	結晶評価の立場から見た各種パワー半導体材料	〇山本 秀和 <sup>1</sup>	1.千葉工大工					
	15:30 - 15:45		休憩/Break							
招待	15:45 - 16:15	12p-B4-6	物性から見たパワーデバイス用半導体材料	〇須田 淳 <sup>1</sup>	1.京大院工					
招待	16:15 - 16:45	12p-B4-7	先進パワーデバイスにおける新規ゲート絶縁膜開発	〇渡部 平司¹, 細井 卓治¹	1.阪大院工					
招待	16:45 - 17:15	12p-B4-8	イオン注入技術の適用の現状	〇加地 徽 <sup>1</sup>	1.豊田中研					
招待	17:15 - 17:45	12p-B4-9	次世代パワー半導体モジュール技術動向	〇高橋 良和1, 中澤 治雄1, 西村 芳孝1	1.富士電機					
招待	17:45 - 18:15	12p-B4-10	パワー半導体デバイスへ要求される特性と現状	〇原 英則 <sup>1</sup>	1.安川電機					

1 応	用物理学一般	投							
衝擊	および重力	場応用の物理	の最前線 / Research forefront of shock wave and h	igh & micro-gravity application s	cience				
	3月13日(金) 9:00 - 13:00								
招待	9:00 - 9:30	13a-D13-1	衝撃分野研究の特異性と将来性	〇三好 仁1, 酒井 正嗣1, 吉江 伸二1	1.衝擊工学研究所				
招待	9:30 - 10:00	13a-D13-2	X線自由電子レーザーによるレーザー衝撃現象の可視化と将来展望	○佐野 雄二1	1.革新的研究開発推進プログラム				
	10:00 - 10:15	13a-D13-3	国際宇宙ステーションを利用した微小重力実験	○夏井坂 誠¹	1.宇宙航空研究開発機構				
招待	10:15 - 10:45	13a-D13-4	微小重力環境を利用した均一組成バルク混晶の育成と地上への 応用	〇木下 恭一1, 荒井 康智1	1.宇宙航空研究開発機構				
	10:45 - 11:00	13a-D13-5	窒素ガス中ガス銃衝突反応によるアミノ酸含有微粒子合成	○三重野 哲¹, 大河内 一輝², 長谷川 直³, 黒澤 耕介⁴	1.静岡大院創造, 2.静岡大院理, 3.JAXA 宇宙研, 4.千葉大惑星セ				
	11:00 - 11:15	13a-D13-6	有機物液体中パルス細線放電法による炭化物超微粒子合成	○末松 久幸¹, 菅島 健太¹, 鈴木 和真¹, 鈴木 常生¹, 中山 忠親¹, 新原 晧一¹	1.長岡技大極限セ				
	11:15 - 11:30		休憩/Break						
招待	11:30 - 12:00	13a-D13-7	高圧合成法による機能性酸化物の探索 ―巨大負熱膨張材料 BiNiO <sub>3</sub> ―	〇東 正樹 <sup>1</sup>	1.東工大応セラ研				
	12:00 - 12:15	13a-D13-8	衝撃圧縮法によるBi系酸化物超伝導体作製における圧力依存性	○(D)亀谷 崇樹¹, 真下 茂¹, Chen Liliang¹, 富岡 成矢², 中村 悟士², 中村 峰大², 毛塚 博史², 鶴岡 誠², 吉村 徹三², 有沢 俊一³	1.熊本大, 2.東京工科大, 3.NIMS				
	12:15 - 12:30	13a-D13-9	強い重力場による酸化物の結晶構造変化	○真下 茂¹, 緒方 裕大¹, Bagum Rabaya¹, 杉山 和正², 杵鞭 義明³, 奥部 真樹⁺, 速水 和正⁵, 富永 昌人⁵, 磯部 博志⁵, 吉朝 朗⁵	1.熊大パルスパワー, 2.東北大金研, 3.産総研, 4.東工大応セラ研, 5.熊大理, 6.熊大工				
	12:30 - 12:45	13a-D13-10	a-Si/Au多層膜の結晶化に対する重力場の影響	○岡本 庸一¹, 緒方 雄大², 徳田 誠², 宮﨑尚¹, 守本 純¹, 真下 茂²	1.防衛大, 2.熊本大				

12:45 - 13:00	13a-D13-11	常磁性状態のGdのバーネット効果	○小野 正雄 <sup>1,4</sup> , 針井 一哉 <sup>1,4</sup> , 岡安 悟 <sup>1,4</sup> , 中堂 博之 <sup>1,4</sup> , 松尾 衛 <sup>1,4</sup> , 家田 淳一 <sup>1,4</sup> , 前川 禎 通 <sup>1,4</sup> , 齊藤 英治 <sup>1,2,3,4</sup>	
			理···,角膝 夹石······	

10 -	10 スピントロニクス・マグネティクス								
10 /	10 メヒントロニクス・マクネティクス								
スピ	スピントロニクスの将来ビジョン ~スピントロニクスはこれから何をするのか?~								
	/ A vision of future spintronics ~What is the next in spintronics?								
	3月13日(金	9:00 - 12:30	)						
招待	9:00 - 9:15	13a-B6-1	スピントロニクスの現状と将来展望	〇田中 雅明 <sup>1</sup>	1.東京大学工学系				
招待	9:15 - 9:45	13a-B6-2	金属スピントロニクスの応用の現状と将来ビジョン	〇湯浅 新治 <sup>1.3</sup> , 薬師寺 啓 <sup>1.3</sup> , 福島 章雄 <sup>1.3</sup> , 久保田均 <sup>1.3</sup> , 野崎 隆行 <sup>1.3</sup> , 塩田陽一 <sup>1.3</sup> , 甲野藤真 <sup>1.3</sup> , 安藤 功兒 <sup>1</sup> , 三輪 真嗣 <sup>2.3</sup> , 鈴木 義茂 <sup>1.2,3</sup>	1.産総研, 2.大阪大, 3.JST				
招待	9:45 - 10:15	13a-B6-3	ナノスピン変換科学研究で目指すもの	O大谷 義近 <sup>1,2</sup>	1.東大物性研, 2.理研CEMS				
招待	10:15 - 10:45	13a-B6-4	ホイスラー合金を用いた磁気抵抗素子の課題と展望	〇宝野 和博 <sup>1</sup> , 高橋 有紀子 <sup>1</sup> , 古林 孝夫 <sup>1</sup> , 桜庭 裕弥 <sup>1</sup>	1.物質材料研究機構				
	10:45 - 11:00		休憩/Break						
招待	11:00 - 11:30	13a-B6-5	トポロジカル絶縁体における薄膜化研究の現状と課題	〇塚崎 敦 <sup>1,2</sup> , 吉見 龍太郎³, ジョセフ チェケルスキー³, 安田 憲司³, 小塚 裕介³,5 ジョセフ ファルソン³,5 高橋 圭 <sup>6</sup> , 永長 直人³,5 川崎 雅司³,5,6 十倉 好紀³,6	1.東北大金研, 2.JSTさきがけ, 3.東大物 エ, 4.MIT, 5.東大QPEC, 6.理研CEMS				
招待	11:30 - 12:00	13a-B6-6	磁壁デバイスの展望	○小野 輝男¹	1.京大化研				
招待	12:00 - 12:30	13a-B6-7	光によるスピン制御の展望	〇宗片 比呂夫 <sup>1</sup>	1.東工大像情報				

11 走	11 超伝導									
巨匠	巨匠が教えてくれた高温超伝導とその未来〜北澤宏一先生・前田弘先生追悼シンポジウム〜 / Memorial Symposium for Prof. K. Kitazawa and Prof. H. Maeda									
	3月13日(金) 9:00 - 11:45									
招待	9:00 - 9:15	13a-B2-1	イントロダクトリートーク	〇下山 淳一 <sup>1</sup>	1.東大院工					
招待	9:15 - 9:45	13a-B2-2	高温超伝導の夜明け	〇岸尾 光二1	1.東大院工					
招待	9:45 - 10:15	13a-B2-3	前田弘先生とビスマス系高温超伝導体の発見	○戸叶 一正1	1.物材機構					
招待	招待 10:15 - 10:45 13a-B2-4 前田弘さんと北澤宏一先生の思い出 O佐藤 謙一 <sup>1</sup> 1.住友電気工業									
招待	10:45 - 11:15	13a-B2-5	走査型トンネル分光の発展と高温超伝導	〇花栗 哲郎 <sup>1</sup>	1.理研CEMS					
招待	11:15 - 11:45	13a-B2-6	Bi2212固有ジョセフソン接合系によるジョセフソンプラズマ励起と THz発振(高温超伝導研究の突破口を拓いた2大巨人:北澤宏一·前 田弘先生の思い出)	○門脇 和男¹	1.筑波大数理物質					
	3月13日(金)	16:15 - 18:4	5							
招待	16:15 - 16:45	13p-B2-1	酸化物超伝導材料の応用として始まった磁気科学研究	〇廣田 憲之1	1.物材機構					
招待	16:45 - 17:15	13p-B2-2	Bi2223超電導材料によるバルク電流リードの開発 -液体ヘリウムフ リー超電導マグネットへの適用-	〇石塚 正之 <sup>1</sup> , 櫻庭 順二 <sup>1</sup> , 淡路 智 <sup>2</sup> , 渡 辺 和雄 <sup>2</sup>	1.住重技研, 2.東北大金研					
招待	17:15 - 17:45	13p-B2-3	STMと固体物性との出会い~北澤先生の夢へと続く道	〇長谷川 哲也 <sup>1</sup>	1.東大院理					
招待	17:45 - 18:15	13p-B2-4	4K冷凍機を用いた伝導冷却式超電導磁石および高温超電導磁 石の開発	〇栗山 透 <sup>1</sup>	1.株式会社東芝					
招待	18:15 - 18:45	13p-B2-5	高温超伝導直流送電と北澤宏一先生	〇山口 作太郎1, 筑本 知子1	1.中部大学超伝導センター					

15糸	吉晶工学 16	5 非晶質・微結晶	3 31		
太陽	電池用バル:	ク結晶シリコン	の成長と評価 / Growth and characterization of bull	k crystalline silicon for photovolt	aic application
	3月13日(金	) 13:15 - 18:	15		
	13:15 - 13:30	13p-C2-1	イントロダクトリートーク 〜結晶成長と結晶評価技術の重要性〜	○沓掛 健太朗¹, 石河 泰明², 大平 圭介³	1.東北大金研, 2.奈良先端大, 3.北陸 先端大
招待	13:30 - 14:00	13p-C2-2	Noncontact crucible methodを用いた太陽電池用の直径比の大きなSiインゴット単結晶の研究開発	〇中嶋 一雄¹, 小野 聖¹, 村井 良多¹, 金 子 弦¹	1.科学技術振興機構
	14:00 - 14:15	奨 13p-C2-3	浮遊キャスト成長法におけるデンドライト結晶を利用した多結晶Siの組織制御と転位密度の低減効果の実証	○(M1C)平松 巧也¹, 高橋 勲¹, 宇佐美 徳 隆¹	1.名大院工
	14:15 - 14:30		休憩/Break		
招待	14:30 - 15:00	13p-C2-4	シードを用いた太陽電池用シリコンの結晶成長	〇柿本 浩一 <sup>1</sup> , ガオ ビング <sup>1</sup> , リュウ キン <sup>1</sup> , 中 野 智 <sup>1</sup> , 原田 博史 <sup>2</sup> , 宮村 佳児 <sup>2</sup> , 関口 隆史 <sup>2</sup> , 寒川 義裕 <sup>1</sup>	1.九大応力研, 2.物質材料機構
招待	15:00 - 15:30	13p-C2-5	Development of High-quality Multi-crystalline Silicon Ingots for Solar Cells	○黄 新明 <sup>1,2</sup>	1.晶澳太阳能, 2.南京工業大
	15:30 - 15:45	奨·E 13p-C2-6	Impact of Grain Boundary Interactions on Grain Structure of Multicrystalline Silicon	○(D)Ronit Prakash¹², Karolin Jiptner², Yoshiji Miyamura², Jun Chen², Hirofumi Harada², Takashi Sekiguchi¹²	1.Tsukuba Univ., 2.NIMS
	15:45 - 16:00		休憩/Break		
招待	16:00 - 16:30	13p-C2-7	フォトルミネッセンスによる太陽電池用Si結晶評価	〇田島 道夫 <sup>1,2</sup> , 加藤 言 <sup>1,2</sup> , 中川 啓 <sup>1,2</sup> , 豊田 裕之 <sup>1</sup> , 小椋 厚志 <sup>2</sup>	1.JAXA 宇宙研, 2.明治大
	16:30 - 16:45	奨 13p-C2-8	顕微PLイメージング:多結晶シリコンウエハ評価法としての可能性	○二宮 駿也¹, 沓掛 健太朗¹², 出浦 桃子¹, 大野 裕¹, 宇佐美 徳隆³, 米永 一郎¹	1.東北大 金研, 2.JSTさきがけ, 3.名 大院工
	16:45 - 17:00	奨 13p-C2-9	偏光PLイメージングによる太陽電池用多結晶Siの欠陥評価	○加藤 言 <sup>1,2</sup> , 田島 道夫 <sup>1,2</sup> , 豊田 裕之 <sup>2</sup> , 小 椋 厚志 <sup>1</sup>	1.明治大, 2.JAXA 宇宙研
	17:00 - 17:15		休憩/Break		
招待	17:15 - 17:45	13p-C2-10	FTIRによるバルク結晶シリコン中の酸素析出の評価	〇小野 春彦 <sup>1,2</sup>	1.神奈川県産技セ, 2.明治大
招待	17:45 - 18:15	13p-C2-11	PVシリコンのライフタイム評価の進展	〇渡辺 正晴¹, Korsos F.², Wilson M.³	1.日本セミラボ, 2.セミラボ, 3.Semilab SDI

### 15 結晶工学

窒化物半導体特異構造の科学 ~成長・プロセスとエレクトロニクス展開~

/ Materials science of singularity in nitride semiconductors-Growth, processing and electronic application-

	_				
3	日1	4 🗆	(+)	8.30	_ 11.45

招待	8:30 - 9:00	14a-B1-1	パルス励起堆積法による特異構造の創製	〇藤岡洋1,2,3, 上野耕平1, 小林篤1, 太	1.東大生研, 2.JST-CREST, 3.JST-AC-
+71 <b>4</b> ±	0.00 0.20	14a-B1-2	国地!!!\( ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** **	田 実雄 <sup>1</sup>	CEL
招待	9:00 - 9:30		周期トレンチ構造を持つGaNトランジスタ	- II-MA FI	1.北大量集センター
	9:30 - 9:45	奨 14a-B1-3	酸性アモノサーマル法によるGaN結晶育成に及ぼす圧力の効果	○栗本 浩平 <sup>1-2</sup> , 包 全喜 <sup>1-2</sup> , 斉藤 真 <sup>1-3</sup> , 富田 大輔 <sup>1</sup> , 伊藤 みずき <sup>1</sup> , 山崎 芳樹 <sup>1</sup> , 小島 一 信 <sup>1</sup> , 鏡谷 勇二 <sup>3</sup> , 茅野 林造 <sup>2</sup> , 石黒 徹 <sup>1</sup> , 秩 父 重英 <sup>1</sup>	1.東北大多元研, 2.日本製鋼所, 3.三菱化学
	9:45 - 10:00	奨 14a-B1-4	PAMBE法によるSiC基板上AIN成長層の貫通転位低減における成長 初期V/III比の重要性	○金子 光顕¹, 木本 恒暢¹, 須田 淳¹	1.京大院工
	10:00 - 10:15	14a-B1-5	III族原料流量変調エビタキシによる窒素極性GaN(000-1)薄膜成 長機構	○赤坂 哲也¹, 林 家弘¹, 山本 秀樹¹	1.NTT物性基礎研
	10:15 - 10:30		休憩/Break		
招待	10:30 - 11:00	14a-B1-6	ナノ構造導入によるLEDの性能向上に関する研究	〇上山 智 <sup>1</sup> , 岩谷 素顕 <sup>1</sup> , 竹内 哲也 <sup>1</sup> , 赤 崎 勇 <sup>1,2</sup>	1.名城大理工, 2.名古屋大赤﨑記念研 究センター
	11:00 - 11:15	14a-B1-7	高成長速度AlInN/GaN多層膜反射鏡を用いた面発光レーザのバルス発振	〇小塚 祐吾 <sup>1</sup> , 池山 和希 <sup>1</sup> , 赤木 孝信 <sup>1</sup> , 岩山章 <sup>1</sup> , 中田 圭祐 <sup>1</sup> , 竹内 哲也 <sup>1</sup> , 上山 智 <sup>1</sup> , 岩谷素顕 <sup>1</sup> , 赤崎 勇 <sup>12</sup>	1.名城大理工, 2.名大・赤崎記念研究 センター
	11:15 - 11:30	14a-B1-8	AlGaN DBR上InGaN MQWナノコラムフォトニック結晶の光励起 発振特性	○(PC)石沢 峻介¹, 本山 界¹, 岸野 克巳¹²	1.上智大理工, 2.上智ナノテク
	11:30 - 11:45	奨 14a-B1-9	ScAIMgO <sub>2</sub> (0001)基板上低歪GaN薄膜を用いたInGaN系可視発光 ダイオードの試作	○(D)尾崎 拓也¹, 船戸 充¹, 川上 養一¹	1.京大院工
	3月14日(土	) 12:45 - 15	5:00		
招待	12:45 - 13:15	14p-B1-1	III-CI・III-CI <sub>3</sub> 混在ハライド気相成長によるIII族窒化物特異構造の 形成	〇熊谷 義直¹, 富樫 理恵¹, ティユ クァン トゥ², 村上 尚¹, Monemar Bo²³, 纐纈 明伯¹	1.東京農工大院工, 2.東京農工大GIRO, 3.Linköping Univ.
招待	13:15 - 13:45	14p-B1-2	ボンドエンジニアリングによる特異構造形成へのアプローチ	〇伊藤 智徳 <sup>1</sup>	1.三重大院工
	13:45 - 14:00	14p-B1-3	混晶化合物半導体の電子状態計算:IQB modelの拡張	○篠塚 雄三¹, 小田 将人¹	1.和歌山大システム工
	14:00 - 14:15	14p-B1-4	時間分解PL測定を用いたAIGaN/AINへテロ構造の臨界膜厚評価	○(D)市川 修平¹, 岩田 佳也¹, 船戸 充¹, 川 上 養一¹	1.京大院工
	14:15 - 14:30	14p-B1-5	深紫外LEDの高出力化	○市川 将嗣 <sup>1,2</sup> , 藤岡 陽¹, 小杉 卓生¹, 遠藤 慎哉¹, 佐川 治信¹, 玉置 寛人¹, 向井 孝志¹, 魚本 幸², 島津 武仁 <sup>2,3</sup>	1.日亜化学, 2.東北大学際研, 3.東北 大通研
招待	14:30 - 15:00	14p-B1-6	特異構造結晶の導入による高効率深紫外デバイスとTHz-QCLの 開発	〇平山 秀樹 <sup>1</sup> , 前田 哲利 <sup>1</sup> , 定 昌史 <sup>1</sup> , 寺嶋 亘 <sup>1</sup> , 豊田 史朗 <sup>1,2</sup> , 鎌田 憲彦 <sup>2</sup>	1.理研, 2.埼玉大

## 公募シンポジウム / Symposium

7	1 3	,	_	
/	$\sim$	- / .	心	ш

最先端の電子・集束イオンビーム装置技術 / State of the art technology in electron and focused-ion-beam apparatuses

	3月11日(水	) 13:15 - 17:	15		
招待	13:15 - 13:30	11p-B3-1	イントロダクトリートーク:荷電粒子ビームの工業への応用	○高岡 義寛1	1.京大光・電子理工センター
招待	13:30 - 14:00	11p-B3-2	走査電子顕微鏡(SEM)の高分解能化の歴史と最新技術	○多持 隆一郎1	1.日立ハイテク
招待	14:00 - 14:30	11p-B3-3	透過型電子顕微鏡(TEM)における最先端技術	〇奥西 栄治 $^1$ , 向井 雅貴 $^1$ , 神保 雄 $^1$ , 沢田 英敬 $^1$	1.日本電子(株)
招待	14:30 - 15:00	11p-B3-4	マスク用電子ビーム描画装置の最新動向	〇竹越 秀和 <sup>1</sup> , 上久保 貴司 <sup>1</sup> , 吉武 俊介 <sup>1</sup> , 斎藤 賢一 <sup>1</sup>	1.ニューフレアテクノロジー
招待	15:00 - 15:30	11p-B3-5	最先端の電子ビーム(EB)直接描画技術	〇小澤 寛司 $^1$ , 桒野 靖久 $^1$ , 星 浩利 $^1$ , 駒 形 正 $^1$	1.日本電子
	15:30 - 15:45		休憩/Break		
招待	15:45 - 16:15	11p-B3-6	FIB技術の最新動向	〇麻畑 達也 <sup>1</sup>	1.日立ハイテクサイエンス
招待	16:15 - 16:45	11p-B3-7	ヘリウムイオン顕微鏡技術による評価と加工	〇小川 真一1	1.産総研
	16:45 - 17:00	11p-B3-8	集束イオンビーム立体ナノ構造形成技術とその高精度化	○米谷 玲皇□	1.東大工
	17:00 - 17:15	11p-B3-9	メタルフリー・反応性負イオンFIBへの応用へ向けたイオン液体イオン源の開発と照射効果の検討	○竹内 光明', 星出 優輝', 龍頭 啓充', 高岡 義寛'	1.京大光電子理工セ

### 13 半導体

化合物薄膜とペロブスカイト太陽電池融合の可能性

/ Feasibility of integration of perovskite semiconductors into multinary compounds solar cells

### 3月11日(水) 9:00 - 11:45

	3/11/1/(V/	•			
	9:00 - 9:15	11a-B6-1	化合物太陽電池の現状・課題とペロブスカイト太陽電池(はじめに)	○今泉 充¹	1.宇宙機構
招待	9:15 - 9:45	11a-B6-2	III-V族半導体高効率多接合太陽電池(Overview)	〇高本 達也 <sup>1</sup>	1.シャープ
	9:45 - 10:00	11a-B6-3	スマートスタック法による多接合太陽電池の検討	○牧田 紀久夫¹, 水野 英範¹, 大島 隆治¹, 菅谷 武芳¹	1.産総研
招待	10:00 - 10:30	11a-B6-4	0100万ルム物々拉人士明示池の1プレリ明改	O. I. III. 1811 2	1 キェナ応用エ 2 キェナロバクログ
	10.00 10.50	11a-D0-4	CIGS系化合物多接合太陽電池のトップセル開発	〇山田 明 <sup>1,2</sup>	1.東工大院理工, 2.東工大PVSEC
	10:30 - 10:45	11a-D0-4	CIGS米化合物多接合本物電池のトップセル開発 体憩/Break	OЩ田 明····	1.泉工大阮理工, 2.泉工大PVSEC

	11:00 - 11:15	E 11a-B6-6	Examination of Cu(In,Ga)Se <sub>2</sub> Films Deposited by Multi-Layer Precursor Method Using Optical Deep Level Transient Spectroscopy	○(PC)Jakapan Chantana¹, Daisuke Hironiwa¹, Zeguo Tang¹, Taichi Watanabe², Seiki Teraji², Takashi Minemoto¹	1.Ritsumeikan Univ., 2.Nitto Denko Corp.
招待	11:15 - 11:45	11a-B6-7	ペロブスカイト型太陽電池:材料純度と物性	O若宮 淳志 <sup>1,2</sup>	1.京大化研, 2.JST さきがけ
	3月11日(水	) 13:15 - 17:0	00		
招待	13:15 - 13:45	11p-B6-1	種々材料の組み合わせによるペロプスカイト太陽電池の多様化とその耐久性向上の検討	〇伊藤 省吾1	1.兵県大工
招待	13:45 - 14:15	11p-B6-2	有機・無機ハイブリッド金属ハロゲン化物ペロプスカイトの構造と 物性制御	〇稲辺 保1, 長谷川 裕之1	1.北大院理
	14:15 - 14:30	奨·E 11p-B6-3	Efficient Semi-transparent Perovskite Solar Cells Prepared by the Hybrid Deposition Method	OShenghao Wang <sup>1</sup> , Luis K. Ono <sup>1</sup> , Mat- thew R. Leyden <sup>1</sup> , Yuichi Kato <sup>1</sup> , Sonia R. Raga <sup>1</sup> , Michael V. Lee <sup>1</sup> , Yabing Qi <sup>1</sup>	1.Okinawa Inst. Sci. Tech. Graduate Univ.
	14:30 - 14:45	11p-B6-4	ベロブスカイト型複酸化物を用いたダブルレイヤー型色素増感太陽 電池の作製	○岡本 裕二¹, 鈴木 義和¹	1.筑波大数理物質
	14:45 - 15:00		休憩/Break		
招待	15:00 - 15:30	11p-B6-5	ベロブスカイト太陽電池一赤外光電変換とPb free ペロブスカイト 太陽電池を目指して—	〇早瀬 修二1	1.九工大
招待	15:30 - 16:00	11p-B6-6	ペロブスカイト太陽電池のデバイスシミュレーション	○峯元 高志¹	1.立命館大
	16:00 - 16:15	奨 11p-B6-7	$Cu_2ZnSn(S,Se)_4$ 太陽電池におけるハイブリッドバッファ層の検討	○松尾 寿大¹, 廣庭 大輔¹, 酒井 紀行², 加藤 拓也², 杉本 広紀², 峯元 高志¹	1.立命大, 2.Solar Frontier社
招待	16:15 - 16:45	11p-B6-8	カルコパイライト系太陽電池の産業化の現状	〇杉本 広紀 <sup>1</sup>	1.ソーラーフロンティア(株)
	16:45 - 17:00	11p-B6-9	化合物薄膜とベロブスカイト太陽電池融合の可能性(おわりに)	○櫻井 岳暁¹	1.筑波大数理

# 1 応用物理学一般 / Interdisciplinary Physics and Related Areas of Science and Technology

1.1 /	応用物理一般	・学際領域 / Ir	nterdisciplinary and General Physics	ポスター講演			
	3月12日(木) 13:30 - 15:30						
		奨 12p-P1-1	アニーリング法による金ナノ微粒子層作成と真空Plasma処理による影響	○藪田 有希¹, 堀江 莉子¹, 近藤 淳¹	1.静岡大工		
		12p-P1-2	高空間分解能な静電気分布計測のためのセンサアレイの開発	○菊永 和也¹, 江頭 正浩¹, 山下 博史¹, 檜枝 龍美¹, 野中 一洋¹	1.産総研		
		12p-P1-3	粉末状の電極を有する誘電エラストマーアクチュエータの特性	○(B)山内 優幸 <sup>1</sup>	1.芝浦工大工		
		12p-P1-4	アルゴン雰囲気中ta-C薄膜の深紫外光照射損傷	○神津 知己 <sup>1,2</sup> , 山口 誠³, 川口 雅弘⁴, 西 田 謙²	1.レニショー株式会社, 2.防衛大学校, 3.秋田大学, 4.都立産技研センター		
		12p-P1-5	回転スクリーンを用いた体積型立体表示-渦巻型スクリーンによるちらつき感の評価-	鈴木 慎之介¹, ○藤川 知栄美¹, 面谷 信¹	1.東海大工		

1.1 /	応用物理一般	ヒ・学際領域 / Ir	nterdisciplinary and General Physics	口頭講演	
	3月13日(金)	16:30 - 19:0	00		
招待	16:30 - 16:45	13p-D12-1	「講演奨励賞受賞記念講演」(15分) 学生プロジェクトによる理科実験授業におけるタブレット端末の活用 方法に関する検討	〇手島 駿¹, 長谷川 誠¹	1.千歳科技大
	16:45 - 17:00	奨 13p-D12-2	多孔質ガラスとフッ素オイルを用いた固体/液体複合撥水材料の作製 とその動的撥水性	○高田 康寛¹, 酒井 宗寿², 磯部 敏宏¹, 松下 祥子¹, 中島 章¹	1.東工大院理工, 2.山口東理大先材研
	17:00 - 17:15	奨 13p-D12-3	固体/液体複合材料における固体表面処理が濡れ性に与える影響	○横山 広大¹, 酒井 宗寿², 磯部 敏宏¹, 松下祥子¹, 中島 章¹	1.東工大理工, 2.山口東京理科大先材研
	17:15 - 17:30	奨 13p-D12-4	回転分裂法を用いた静電浮遊液滴の粘性係数測定	○(M1)綿引 壮真¹, 松本 聡², 金川 哲也¹, 金子 暁子¹, 阿部 豊¹	1.筑波大, 2.JAXA
	17:30 - 17:45	E 13p-D12-5	Highly Accurate Local Pseudopotentials for Large-Scale Materials Simulations with Orbital FreeDensity Functional Theory	○Sergei Manzhos¹, Fleur Legrain¹	1.Natl Univ Singapore
	17:45 - 18:00	13p-D12-6	ウコン色素/n-Si/p-Si接合ダイオードの光応答特性	○兼城 千波¹, 内間 大輔¹, 濱田 泰輔¹	1.沖縄高専
	18:00 - 18:15	奨 13p-D12-7	フレーザー・ウィルコックス錯視のメカニズム検証	○大槻 一博¹, 面谷 信¹	1.東海大学工
	18:15 - 18:30	13p-D12-8	バーゲン錯視のメカニズム解明	○野原 祐一郎¹, 面谷 信¹	1.東海大工
	18:30 - 18:45	奨 13p-D12-9	ヘルムホルツ共振器を用いた平面型音響ノッチフィルター素子	○磯崎 瑛宏¹, 高橋 英俊¹, 田村 洋人¹, 高畑智之¹, 松本 潔¹, 下山 勲¹	1.東大
	18:45 - 19:00	13p-D12-10	ヴァイオリンの胴体内の空気の温度変化による空気共鳴モードA0周 波数のシフト	○松谷 晃宏¹	1.東工大半導体MEMS

1.2 教	女育 / Education	ポスター講演						
	3月13日(金) 16:30 - 18:30							
	13p-P1-1	LEDライトを用いたヤングの干渉実験(II)	○大向 隆三¹, 草薙 栄理子¹, 関川 留都¹, 近藤 一史¹	1.埼玉大教育				
	13p-P1-2	フィルター回路を用いた光電効果信号の高感度検出(II)	○大向 隆三¹, 小林 憲治¹, 國料 樹¹	1.埼玉大教育				
	13p-P1-3	ホロカソードランプを用いた光電効果実験(V)	○松本 龍馬¹	1.埼玉大教育				
	13p-P1-4	相対性理論の数学的破綻の証明	○土田 成能¹	1.ダビンチ研				
	13p-P1-5	セルオートマトンを用いた半導体シミュレータ(2)	○大豆生田 利章¹	1.群馬高専				
	13p-P1-6	ArduinoとLabVIEWを用いた偏光計測実験教材の開発	○大久保 進也¹	1.沼津高専				
	13p-P1-7	マイコンのタッチセンサ機能を用いた微小静電容量の測定	○出口 幹雄¹	1.新居浜高専				

	13p-P1-8	演示用の原子吸収スペクトル装置の開発	○塚林 功¹, 関 一¹, 佐藤 杉弥²	1.いろは理科工房, 2.日本工大
	13p-P1-9	小型水箱を用いた光の屈折の授業プログラムの研究	○千葉 芳明¹, 西條 敏剛², 本田 亮³	1.宫城教大, 2.宫城県白石高, 3.鳴門
3	奨 13p-P1-10	バイポーラ・トランジスタの負性抵抗特性を利用した簡易なLED点 滅回路	○(M1)林田 宗志¹, 小山 英樹¹	教大 1.兵庫教育大院
	13p-P1-11	機関的 霧箱中の飛跡で求めるβ線のエネルギー分布	○足利 裕人¹	1.鳥取環境大学
	13p-P1-12	螺旋プラズマ演示実験装置の開発	○服部 邦彦¹, 塚林 功¹, 佐藤 杉弥¹, 安藤 晃²	1.日本工大, 2.東北大工
:	13p-P1-13	高校生(SSH)の指導による小学生のための科学教室「屈折望遠鏡」	除光² ○鈴木 恒則¹, 中村 春樹², 山田 武範², 藤 城 武彦¹	1.東海大理, 2.東海大高輪台高校
	13p-P1-14	LED位置センサを利用した力学実験装置の改良	○河野 託也¹, 國光 拓実¹	1.岐阜高専
	13p-P1-15	永久磁石の直径を小さくした場合のホール効果	○安森 偉郎¹, 岡田 工², 崔 一媄²	1.東海大教育研, 2.東海大チャレンジャンター
	13p-P1-16	振動発電を使った教材開発(IV)	<ul><li>○木村 花梨¹, 山本 優¹, 川内 つぐみ¹, 八並 愛佳¹, 山田 亜紀¹, 小栗 和也¹</li></ul>	1.東海大 教養
	13p-P1-17	空気の力と浮力に関する小学生向け科学教室の実践	○葛生 伸¹, 香川 喜一郎²	1.福井大院工, 2.ふくい科学学園
	13p-P1-18	幼児に対する科学教育の実践 ~物理分野に興味を持たせる実験教室の考察~	○月僧 秀弥¹, 稲垣 裕介², 早武 真理子², 葛生 伸³	1.坂井市立三国中学校, 2.(公財)日本科 学技術振興財団, 3.福井大院工
3	奨 13p-P1-19	紫キャベツ色素増感型太陽電池を教材とした科学スクールの開催	○奥村 高史¹, 中野 寛之¹, 佐伯 平二 ¹, 森 豪¹	1.爱工大
	13p-P1-20	低コストICTによるリアルタイム教育支援システムの開発	○渡邊 悠¹, 樺澤 匠¹, 湯沢 友之、鶴岡 誠¹	1.東京工科大
	13p-P1-21	2015物理チャレンジ合宿実験研修の教育的効果	〇毛塚 博史 <sup>1</sup> , 中屋敷 勉 <sup>2</sup> , 真梶 克彦 <sup>3</sup> , 興 治 文子 <sup>4</sup>	1.東京工科大, 2.岡山県立一宮高, 3.筑 波大学附属駒場中·高, 4.新潟大教育
	13p-P1-22	シングルボードコンピュータと無線モジュールを利用した物理実験の データ管理システム	○伊多波 正徳¹	1. 茨城大工
	13p-P1-23	『仮説実験講座』における学生スタッフ体験を通じた理科教職課程履 修生のアクティブラーニング	○中村 敏浩¹, 舟橋 春彦¹², 宮地 祐司¹₃	1.大阪電通大工, 2.京大国際高等教育院, 3.NPO楽知ん研究所
	13p-P1-24	中学校理科/技術科教育における電圧電流概念の体験的学習用教材	○改正 清広¹	1.静大教
	13p-P1-25	工学系人材育成のための学校外/家庭学習用教材の開発	○改正 清広¹	1.静大教
	13p-P1-26	学生プロジェクトチームによる科学啓発活動の学生教育効果	○長谷川 誠¹, 手島 駿¹	1.千歳科技大
3	奨 13p-P1-27	砂糖水の旋光による白色LED出射光の透過スペクトルの遷移	○徳光 聖茄¹, 浜松 霞¹, 前田 智美¹, 大川 七海¹, 長谷川 誠¹	1.千歳科技大
	13p-P1-28	イベントでの使用を目的とした銀塩ホログラム撮影システム	○平谷 雄二¹	1.広国大工
	13p-P1-29	小型無線センサーを用いた振動実験教材化II	○鈴木 三男¹, 増田 健二²	1.福島高専, 2.静岡大工
	13p-P1-30	風力で動作するホバークラフトの教材としての検討	○山口 静夫1	1.九共大総研
	13p-P1-31	プロジェクションマッピングの教材への応用	鈴木 施哉¹, 菅原 詩織¹, ○原田 建治¹	1.北見工大情報システム
	13p-P1-32	"見えた!" 〜驚きをやる気に変える教材の提案〜	○菅原 詩織¹, 浅野目 祥¹, 原田 建治¹	1.北見工大
	13p-P1-33	蛍光偏光度測定装置におけるデータ処理プログラムの開発	○東城 裕樹¹, 渡邊 悠¹, 樺澤 匠、古家 竜之輔¹, 湯沢 友之、鶴岡 誠¹	1.東京工科大
	13p-P1-34	電気泳動を用いた科目横断教材の開発(2)	○田島 佳奈¹, 伊藤 光平¹, 小林 かおり¹, 小栗 和也¹	1.東海大 教養
	13p-P1-35	グラスハーブを使用した教材開発(III)	○深澤 里菜¹, 斉藤 沙季¹, 大沼 梨菜¹, 藤居 奈々¹, 小栗 和也¹	1.東海大 教養
	13p-P1-36	創造理工学実験における"ものづくり基礎実験教育"用実験テーマの開発	○伊藤 智幹¹, 岡島 茂樹¹, 柴田 祥一¹, 佐藤 元泰¹. 伊藤 響', 阪田 泉¹, 中山 和也¹, 井筒 潤¹, 大嶋 晃敏¹, 上田 洋征¹, 伊藤 幸雄¹	1.中部大工
	13p-P1-37	米海軍佐世保基地の小学生を対象とした専門英語による理科実験 教室	○柳生 義人', 西口 廣志', 石貫 文子', 中尾 充宏'	1.佐世保高専
	13p-P1-38	リバースエンジニアリングを活用した教育教材の開発	○林 和彦¹, 幾久 健¹, 石本 辰哉¹	1.呉高専
	13p-P1-39	Arduinoを利用した物理教材開発	○佐藤 杉弥¹	1.日本工大
	13p-P1-40	ボルダの振り子における周期の正弦的変化	○近藤 一史¹, 柴崎 健多¹, 石田 卓矢¹, 大向 隆三¹, 津田 俊信¹	1.埼玉大教育

1.3	新技術·複合	新領域 / Nove	I technologies and interdisciplinary engineering	口頭講演	
	3月11日(水	) 13:15 - 17:	00		
招待	13:15 - 13:45	11p-D13-1	「応用物理学一般 分科内招待講演」(30分) MOD法により製作したVOxマイクロボロメータ素子の検出特性	〇内田 貴司 <sup>1</sup> , 立木 隆 <sup>1</sup>	1.防衛大電気電子
	13:45 - 14:00	11p-D13-2	マテリアルキュレーション:材料情報の活用による材料探索例3	○吉武 道子¹	1.物材機構
	14:00 - 14:15	11p-D13-3	ガス浮遊法による酸化物高屈折率ガラスの製造と大型化	○依田 真一1.2, 今井 良二³, Won-Seung Cho⁴	1.熊本大学, 2.JAXA, 3.室蘭工大, 4.仁 荷大学
	14:15 - 14:30	奨 11p-D13-4	超薄膜Pt/Tiを用いたブリッジ型水素センサの開発	○井並 祥太¹, 牛田 祐貴², 武市 修藏², 菅井 良祐², 堺 健司², 紀和 利彦², 塚田 啓二²	1.岡山大工, 2.岡山大自然
	14:30 - 14:45	11p-D13-5	in-situ電気伝導測定による金触媒の反応機構の解析	○前田 泰¹, 飯塚 泰雄¹, 香山 正憲¹	1.産総研
	14:45 - 15:00		休憩/Break		
	15:00 - 15:15	11p-D13-6	トップダウン・ボトムアップ統合アブローチによるポリスチレン四重極 子の作製	○高橋 毅¹, 松谷 晃宏², 庄司 大², 西岡 國 生², 佐藤 美那², 磯部 敏宏¹, 中島 章¹, 松 下 祥子¹	1.東工大院理工, 2.東工大半導体 MEMS
	15:15 - 15:30	11p-D13-7	磁気配列法による微粒子2次元周期配列構造の形成	○青木 画奈¹, 藤井 稔¹	1.神戸大工
	15:30 - 15:45	奨 11p-D13-8	光トラップによる気液界面の付着力の評価	○細田 駿介¹, 高澤 曹¹, 山西 陽子¹.²	1.芝浦工大, 2.JSTさきがけ

. - +<!! ( )- !- ^ +< 4=! |> / . .

15:45 -	- 16:00	11p-D13-9	表面処理を利用した高感度光ファイバーセンサーの開発	○木口 崇彦¹, 伊澤 昂汰², Li Oi Lun²³, 齋藤 永宏¹.²³.4	1.名大未来社会, 2.名大院工, 3.JST COI STREAM, 4.名大グリモ
16:00 -	- 16:15	11p-D13-10	<b>唾液グルコースのためのマウスガード型バイオセンサに関する研究</b>	○仁田 大揮¹, 黒木 祐輔¹, 當麻 浩司¹, 荒川 貴博¹, 三林 浩二¹	1.医科歯科大
16:15 -	- 16:30	11p-D13-11	血糖値制御のための薬物放出システムにおけるグルコース駆動式減 圧機構の高出力化	○栗原 康司 <sup>1</sup> , 佐藤 怜¹, 松浦 佑樹 <sup>1</sup> , ムンフ ジャルガル ムンフバヤル <sup>1</sup> , 當麻 浩司 <sup>1</sup> , 荒川 貴博 <sup>1</sup> , 齊藤 浩一 <sup>2</sup> , 三林 浩二 <sup>1</sup>	1.医科歯科大, 2.東京高専
16:30 -	- 16:45	11p-D13-12	バイオ化学発光を用いた嗅覚カメラによる手掌エタノールガスの可 視化計測	○飯谷 健太¹, 佐藤 敏征¹, 當麻 浩司¹, 荒川 貴博¹, 三林 浩二¹	1.医科歯科大
16:45 -	- 17:00	11p-D13-13	シングルビーム原子磁力計におけるゼロ磁場校正	○佐々木 耀一¹, 大坊 真洋¹	1.岩手大工

3月12日(木)	13:30 - 15:	30		
	奨 12p-P2-1	ボリマー製フォトニック結晶共振器の作製・評価	○前野 権一¹, 安藝 翔馬¹, 末吉 健志¹, 久本 秀明¹, 遠藤 達郎¹	1.阪府大院工
	12p-P2-2	ブリンテッドプラズモニック結晶のラマン分光分析への応用	○遠藤 達郎¹, 梶田 浩志², 末吉 健志¹, 田中 覚², 久本 秀明¹	1.阪府大院工, 2.SCIVAX株
	12p-P2-3	TiO』/ポリマーハイブリッド型2次元フォトニック結晶を用いた面発光蛍 光増強デバイスの開発	○安藝 翔馬¹, 前野 権一¹, 久本 秀明¹, 末吉 健志¹, 遠藤 達郎¹	1.阪府大院工
	12p-P2-4	金堆積ナノインブリンテッドブラズモニック結晶の作製と非標識バイオ センサーへの応用	○西口 輝一¹, 末吉 健志¹, 久本 秀明¹, 遠藤 達郎¹	1.阪府大工
	12p-P2-5	Dee-RIEにより深掘りエッチングされたSiエッチング側面のEDX分析	○佐藤 美那¹, 西岡 國生¹, 庄司 大¹, 松 谷 晃宏¹	1.東工大 半導体MEMSプロセス技 センター
	12p-P2-6	液体定在波を利用した酵母細胞の流路レス凝集パターンの振動周 波数による制御	○松谷 晃宏¹, 髙田 綾子²	1.東工大半導体MEMS, 2.東工大イオ技術
	12p-P2-7	小望遠鏡とデジタル一眼レフカメラによる太陽黒点の温度推定におけ る観測波長領域の影響について	○松谷 晃宏¹	1.東工大半導体MEMS
	12p-P2-8	衝撃圧縮されたポルサイト蛍光体の評価	○(M1)濱田 翔¹, 岸村 浩明¹, 冨永 悠貴¹, 守住 志洋¹, 有賀 敦¹, 松本 仁¹	1.防大材料
	12p-P2-9	衝撃圧縮法による赤色蛍光体Y₂O₃:Eu³+の改質	○岸村 浩明¹, 濱田 翔¹, 守住 志洋¹, 有賀 敦¹, 松本 仁¹	1.防衛大材料
	12p-P2-10	衝撃圧縮法によるBi系酸化物超伝導体結晶粒の育成における圧力依存性及びシード効果	〇中村 峰大¹, 富岡 成矢¹, 中村 悟土¹, 吉村 徹三¹, 毛塚 博史¹, 亀谷 崇樹², Chen Liliang², 真下 茂², 岸村 浩明³, 松本 仁³, 有 沢 俊一¹, 遠藤 和弘⁵	1.東京工科大, 2.熊本大, 3.防衛大, 質材料研究機構, 5.金沢工業大
	12p-P2-11	強い重力場による強磁性炭化物の合成	○緒方 裕大¹, 真下 茂¹, 徳田 誠¹, 吉朝 朗¹	1.熊大

3月11日(	水) 9:30 - 11:30	)		
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	11a-P1-1	レーザー焼成還元金属ナノベーストを用いた熱電変換素子の開発	○(M1)李 妍楠¹, 佐伯 拓¹, 飯田 幸雄¹	1.関西大学 システム理工
	11a-P1-2	二酸化炭素励起用中赤外固体レーザーの開発	○佐藤 篤¹, 那須 祥彦¹, 三宅 良宜¹, 丸 尾 容子¹	1.東北工大工
	11a-P1-3	自己集合性ペプチドと有機金属錯体で形成された化学モーターによるマイクロ発電機	○池添 泰弘 <sup>12</sup> , Fang Justin <sup>2</sup> , Wasik Tomasz L. <sup>2</sup> , 植村 卓 <sup>3,4</sup> , Zheng Yongtai <sup>3,5</sup> , 北川 進 <sup>3,5</sup> , 松井 宏 <sup>2</sup>	1.日工大, 2.NY市大, 3.京大院工 4.CREST-JST, 5.iCeMS
	11a-P1-4	イオン液体を電解液に用いたリチウムイオン電池における黒鉛負極上 の表面皮膜の役割	○岸田 和久1.2, 中川 清晴1.2, 小田 廣和1.2	1.関大理工, 2.HRC
	11a-P1-5	金属元素を担持した活性炭の水素吸蔵能の評価	○田村 知樹¹, 大竹 尚登¹, 赤坂 大樹¹	1.東工大
	11a-P1-6	ひずみイメージングによるリチウムイオン二次電池正極材LiCoO₂のイオン吸蔵放出の非破壊その場計測	○(B)佛願 建太¹	1.関大システム理工
	11a-P1-7	高速充放電Liイオン電池に向けた強誘電体-活物質コンポジット正極	○寺西 貴志¹, 吉川 祐未¹, 佐久間 諒¹, 橋本 英樹¹, 林 秀考¹, 藤井 達生¹, 岸本 昭¹	1.岡山大工
	11a-P1-8	リチウムイオン二次電池のひずみイメージングにおける電圧印加方 法の影響	○(B)大坂 隆馬¹	1.関大システム理工
	11a-P1-9	リチウムイオン二次電池セパレータの熱による構造変化	○松下 友紀¹	1.関大システム理工
	11a-P1-10	シリコンVLSI技術を用いて試作した100×100 ミクロン平方全固体型 リチウムイオン2次電池	○内野 将也¹, 野崎 孝明¹, 栗山 一男¹, 串 田 一雅²	1.法大理工, 2.大阪教育大
	奨·E 11a-P1-11	Study of time-resolved photoluminescence (TR-PL) in ${\rm Cu_2Zn-Sn(S,Se)_4}$ thin films with different Cu/Sn ratio.	OMohammad Abdul Halim¹, Muhammad Monirul Islam¹, Xianjia Luo¹, Takeaki Sakurai¹, Noriyuki Sakai², Takuya Kato², Hiroki Sugimoto², Hitoshi Tampo³, Hajime Shibata³, Shigeru Niki³, Katsuhiro Akimoto¹	1.University of Tsukuba, 2.Sola Frontier, 3.AIST
	11a-P1-12	熱放射スペクトル制御材料を用いた高効率ソーラー熱光起電力発電	○清水 信¹, 小桧山 朝華¹, 酒井 淳¹, 柳澤 邦彦¹, 井口 史匡¹, 湯上 浩雄¹	1.東北大院工
	11a-P1-13	バイオマスからエネルギー調達	○(M2)長島 雄志¹	1.玉川大工
	11a-P1-14	メタンの低温水蒸気改質の実験的研究	○(B)北川 聖¹, 高橋 克己¹, 小原 宏之¹	1.玉川大学TSCP
	11a-P1-15	CNTを用いた微生物燃料電池の試作	○(M1C)倉嶋 一塁¹, 高橋 克己¹, 小原 宏 之¹	1.玉川大学 TSCP

3月12日(木	9:00 - 12:4	5		
9:00 - 9:15	奨 12a-D12-1	熱音響機関のためのリニア発電機の設計および評価	○(M1)大西 紘平¹, 長谷川 真也², 木村 英樹²	1.東海大院工, 2.東海大工
9:15 - 9:30	E 12a-D12-2	Efficient and Stable Solution-Processed Planar Perovskite Solar Cells	○Chuanjiang Qin¹, Toshinori Matsushi- ma¹, Chiahaya Adachi¹	1.Kyushu Univ.
9:30 - 9:45	12a-D12-3	TiO。上に坦持したAgPd@Pd微粒子を用いた高効率ギ酸分解水素 生成	○(PC)服部 真史¹, 永長 久寛², 辻 正治¹	1.九大先導研, 2.九大総理工
9:45 - 10:00	E 12a-D12-4	Amorphous Carbon Is a Promising Material for Sodium Ion Battery Anodes: a Computational Study	○Sergei Manzhos¹, Fleur Legrain¹, Konstantinos Kotsis¹	1.Natl Univ Singapore
10:00 - 10:15	12a-D12-5	マイクロ構造とナノ構造が融合したリチウムイオン電池負極	○山浦 大地¹, 荻野 俊郎¹²	1.横浜国大, 2.CREST/JST
10:15 - 10:30	12a-D12-6	舶用液体水素タンク内部の熱流体解析	○(M2)塚本 博志¹, 武田 実¹	1.神戸大海事
10:30 - 10:45	12a-D12-7	酸素分圧の異なる雰囲気における電子線照射が及ぼすLaNi $_{4,6}$ Al $_{0,4}$ 水素吸蔵合金の電気化学的水素吸収速度への影響	○徳平 真之介¹, 阿部 浩之², 内田 裕久¹	1.東海大応用理学, 2.(独)日本原子 究開発機構
10:45 - 11:00	12a-D12-8	液中プラズマ法を用いたCNT表面へのPt触媒の形成とその燃料電池への応用	○(M1)上野 雄太郎¹, 庄 善之¹	1.東海大工
11:00 - 11:15		休憩/Break		
11:15 - 11:30	12a-D12-9	金属触媒ウエットエッチングによる多結晶固定砥粒シリコンウェーハに 対するテクスチャー	○北垣内 圭二', 熊谷 晃'	1.JET
11:30 - 11:45	奨 12a-D12-10	単色放射に対する太陽電池エネルギー変換効率の波長依存性	○(M1)武澤 港斗¹, 齋藤 輝文¹	1.東北工大院工
11:45 - 12:00	12a-D12-11	太陽光発電バネル上積雪の通電加熱による除雪	○齋藤 輝文1², 柴崎 浩一郎¹, 武澤 港斗², 二田 祐也¹, 初谷 博³, 味原 真穂³, 宍戸 保 曨³, 杉山 丞⁴	1.東北工大工, 2.東北工大院工, 3.保岡, 4.保タニタハウジングウェア
12:00 - 12:15	12a-D12-12	蛍光導波路型ソーラーコレクタにおける変換効率の形状依存性	○(M2)向原 悠香¹, 若木 守明¹, 渋谷 猛久¹, 浅川 久志², 名執 洵子²	1.東海大工, 2.丸茂電機
12:15 - 12:30	12a-D12-13	大電力用電気二重層キャパシター型電池の1提案(II)	○川端 啓介	
12:30 - 12:45	12a-D12-14	ソーラーカーの表面圧力測定に基づく空力性能評価	○(M2)関川 陽¹, 木村 英樹¹, 福田 紘大¹, 春田 憲一¹, 大塚 隆司¹	1.東海大工

1.5 資源·環境 /	1.5 資源·環境 / Resources and environment 口頭講演					
3月11日(水	10:00 - 11:	:30				
10:00 - 10:15	11a-D12-1	溶媒浸漬に伴う両極性NIPAゲルの体積の経時変化	$\bigcirc$ 大庭 崇弘¹, 西本 貴士¹, 日高 芳樹¹, 岡部 弘高¹, 原 一広¹	1.九大院工		
10:15 - 10:30	11a-D12-2	ナノポーラスカーボンの真密度とその分類	○朱 傑¹, 戸田 育民¹, 大塩 茂夫¹, 小松 啓 志¹, 津田 欣範², 齋藤 秀俊¹	1.長岡技科大, 2.ヒューズ・テクノネット		
10:30 - 10:45	11a-D12-3	賦活強度が異なる籾殻由来ナノポーラスカーボンの真密度	○朱 傑¹, 戸田 育民¹, 大塩 茂夫¹, 小松 啓 志¹, 津田 欣範², 齋藤 秀俊¹	1.長岡技科大, 2.ヒューズ・テクノネット		
10:45 - 11:00	11a-D12-4	ナノポーラスカーポンによるCO <sub>2</sub> およびCH <sub>4</sub> 吸着挙動の温度依存性	○石橋 佳国¹, 李 観成¹, 戸田 育民¹, 小松 啓志¹, 大塩 茂夫¹, 津田 欣範², 齋藤 秀俊¹	1.長岡技科大, 2.ヒューズテクノネット		
11:00 - 11:15	11a-D12-5	グラフェンの紙基板への転写とその特性	○大久保 貴雅¹, 奧村 竜二¹, 張 棲岩², 佐藤 利文², 市川 洋¹	1.名古屋工業大学, 2.東京工芸大学		
11:15 - 11:30	11a-D12-6	再利用可能なサファイアフィルタを用いた希少金属の回収	○太子 敏則1.2	1.信大環境エネ研, 2.信大COI		

1.5 資	1.5 資源・環境 / Resources and environment ポスター講演					
	3月12日(木) 13:30 - 15:30					
		奨 12p-P3-1	Ti-Cr-Mn系水素吸蔵合金の作製及び水素吸蔵特性の検討	○Zholdayakova Saule¹, 内田 晴久¹	1.東海大	
		12p-P3-2	汎用性に富むクリーン環境CUSP $\sim$ 太陽電池作製プラットフォームから居住空間応用まで	○石橋 晃1.2, 大橋 美久2	1.北大電子研, 2.シーズテック(株)	
		12p-P3-3	深紫外LEDを用いたオゾン濃度測定装置の開発	○中村 広隆¹, 武田 有志¹, 菅野 裕靖², 阿彦由美², 青柳 克信³	1.都産技研, 2.(有)光電鍍工業所, 3.立 命館大	

1.6 計測技術・計測標準 / Instrumentation, measurement and Metrology ポスター講演							
3月13日(金)	3月13日(金) 9:30 - 11:30						
	13a-P1-1	数値演算による精密な位相雑音と振幅雑音の算出	柳町 真也¹, ○平野 育¹, 池上 健¹, 和田 雅 人¹, 萩本 憲¹, 高見澤 昭文¹	1.産総研			
	13a-P1-2	パラジウム添加セラミックスの反応熱を利用した水素ガス検知	○相沢 宏明¹, 勝亦 徹¹, 小室 修二¹	1.東洋大理工			
	13a-P1-3	搬送波位相衛星双方向測定による仲介水素メーザー不要の光時計 絶対周波数測定	○藤枝 美穂¹, 井戸 哲也¹, 後藤 忠広¹, 瀧口博士¹, 早坂 和弘¹, 豊田 健二², 米垣 賢治², 田中 歌子², 占部 伸二²	1.情通機構, 2.阪大基礎工			
	13a-P1-4	UTCrを用いたUTC(NICT)の高度化	<ul><li>○中川 史丸¹, 花土 ゆう子¹, 今村 國康¹, 伊東 宏之¹</li></ul>	1.情報通信研究機構			

1.6	計測技術·計	測標準 / Instru	mentation, measurement and Metrology	口頭講演		
	3月14日(土) 9:00 - 11:15					
	9:00 - 9:15	14a-D12-1	振動抑制冷凍機を用いた低温サファイア発振器の周波数安定度の 評価	○池上 健¹, 渡部 謙一¹, 柳町 真也¹, 平 野 育¹, 萩本 憲¹, 高見澤 昭文¹, ハートネッ ト ジョン²	1.産総研, 2.アデレード大	
	9:15 - 9:30	14a-D12-2	温度安定型水晶振動子を用いた水素漏洩検知器におけるプリアンプ の 温度特性の影響	○鈴木 淳¹, 北條 久男², 小林 太吉³	1.産総研, 2.バキュームプロダクツ, 3.ブ イピイアイ	
	9:30 - 9:45	奨 14a-D12-3	熱モードスペクトロスコピーを用いた微小試料に対する新しい熱伝導 率計測法の開発	○石原 達也¹, 荻 博次¹, 石田 秀士¹, 平尾 雅彦¹, マリス ハンフリー²	1.阪大院基, 2.ブラウン大	

9:45 - 10:00	14a-D12-4	キャビティリングダウン分光法によるガス中微量水分の自動測定シ ステ	○阿部 恒¹, リサク ダニエル², シガン アガタ², チュレオ ローマン²	1.産総研, 2.コペルニクス大学
10:00 - 10:15	奨 14a-D12-5	アルゴン中微量水分標準の開発	○天野 みなみ¹, 阿部 恒¹	1.産総研
10:15 - 10:30	14a-D12-6	スーパーコンティニュアム光を用いた絶対放射温度計の分光感度 校正	○山口 祐¹, 山田 善郎¹	1.産総研
10:30 - 10:45	14a-D12-7	テラヘルツカロリメータの直線性評価	○飯田 仁志¹, 木下 基¹, 雨宮 邦招¹, 島田 洋蔵¹	1.産総研
10:45 - 11:00	奨 14a-D12-8	核四極共鳴信号計測のためのオートチューニングシステム	○佐藤 晋大¹, 赤羽 英夫¹, 糸崎 秀夫¹	1.阪大院基礎工
11:00 - 11:15	14a-D12-9	量子電圧雑音源を用いた熱雑音の精密測定によるポルツマン定数 の評価	○浦野 千春', 吉田 俊介', 岡崎 雄馬', 山田隆宏', 山澤 一彰', 山森 弘毅', 福山 康弘 ¹, 金子 晋久¹, 丸山 道隆', 堂前 篤志¹, 丹波 純¹, 桐生 昭吾³	1.産総研計測標準, 2.産総研ナノエレ, 3.東京都市大
3月14日(土)	) 13:00 - 14:	15		
13:00 - 13:15	14p-D12-1	液中粒子数濃度測定の不確かさ評価と一次標準の開発	○坂口 孝幸¹	1.産総研
13:15 - 13:30	14p-D12-2	単一微粒子の形状及び分光分布の解析	○星野 鉄哉¹, 伊藤 雅英¹	1.筑波大数物
13:30 - 13:45	14p-D12-3	ウェハ表面パーティクル検査装置校正用の粒子数基準ウェハの開発	○田島 奈穂子¹, 飯田 健次郎¹², 榎原 研正², クンプアン ソマワン¹², 原 史朗¹²	1.ミニマルファブ技術研究組合, 2.産総研
13:45 - 14:00	14p-D12-4	アガロースゲルの誘電特性	岩本 晋司¹, ○飯野 正昭¹	1.千葉工大工
14:00 - 14:15	14p-D12-5	応力発光を介した応力履歴記録ペイント	○寺崎 正¹, 徐 超男¹	1.産業技術総合研究所
	10:00 - 10:15 10:15 - 10:30 10:30 - 10:45 10:45 - 11:00 11:00 - 11:15 3月14日(土 13:00 - 13:15 13:15 - 13:30 13:30 - 13:45 13:45 - 14:00	10:00 - 10:15	ステ 10:00 - 10:15 奨 14a-D12-5 アルゴン中微量水分標準の開発 10:15 - 10:30 14a-D12-6 スーパーコンティニュアム光を用いた絶対放射温度計の分光感度校正 10:30 - 10:45 14a-D12-7 テラヘルツカロリメータの直線性評価 10:45 - 11:00 奨 14a-D12-8 核四極共鳴信号計測のためのオートチューニングシステム 11:00 - 11:15 14a-D12-9 量子電圧雑音源を用いた熱雑音の精密測定によるボルツマン定数の評価 3月14日(土) 13:00 - 14:15 13:00 - 13:15 14p-D12-1 液中粒子数濃度測定の不確かさ評価と一次標準の開発 13:15 - 13:30 14p-D12-2 単一微粒子の形状及び分光分布の解析 13:30 - 13:45 14p-D12-3 ウェハ表面パーティクル検査装置校正用の粒子数基準ウェハの開発 13:45 - 14:00 14p-D12-4 アガロースゲルの誘電特性	2.

1.7	超音波 / Ultr	rasonic	口頭講演		
	3月11日(水)	) 13:15 - 17:	15		
招待	13:15 - 13:30	11p-D12-1	「講演奨励賞受賞記念講演」(15分) 極低温ピコ秒超音波法を用いた異なるキャリア密度のGaNに対する キャリアダイナミクスの観測	〇長久保 白¹, 石原 達也¹, 荻 博次¹, 中村 暢 $(+)$ , 平尾 雅彦¹	1.阪大基礎工
	13:30 - 13:45	奨 11p-D12-2	180°, 90R散乱配置を用いたBrillouin散乱計測によるGaNの弾性定数測定	○市橋 隼人¹, 柳谷 隆彦², 高柳 真司¹, 川部 昌彦¹, 松川 真美¹	1.同志社大, 2.名工大
	13:45 - 14:00	11p-D12-3	$C_{a_3}Ta(Ga_{0.5}Al_{0.5})_3Si_2O_{14}$ 単結晶のAl置換による音響特性への影響の検討	○大橋 雄二¹, 工藤 哲男¹, 横田 有為², 庄子育宏³, 黒澤 俊介¹², 鎌田 圭²³, 吉川 彰¹²³	1.東北大金研, 2.東北大NICHe, 3.C&A
	14:00 - 14:15	11p-D12-4	圧電-誘電体周期構造を用いた音響ダイオードの設計	○岩崎 裕平1, 石川 篤1, 鶴田 健二1	1.岡山大院自然
	14:15 - 14:30	11p-D12-5	骨の超音波誘電磁応答の異方性	○(M1)渡部 翔¹, 山田 尚人¹, 生嶋 健司¹, 新実 信夫², 小島 良績²	1.農工大院工, 2.日本シグマックス(株)
	14:30 - 14:45	奨 11p-D12-6	骨トランスデューサから放射されるMHz域の超音波測定	○(B)松川 沙弥果¹, 常田 裕子¹, 眞野 功¹, 高柳 真司¹, 松川 真美¹	1.同志社大
	14:45 - 15:00	奨 11p-D12-7	音響共鳴現象と超音波バルスエコー法を利用したヒトiPS細胞塊の厚さと音速の実測	○齊藤 崇允¹, 松谷 巌¹, 大沼 清¹, 桑原 敬司¹, 近藤 みずき¹, 井原 郁夫¹	1.長岡技科大工
	15:00 - 15:15	奨 11p-D12-8	超音波速度変化による脂肪肝診断のための組み合わせ型プローブ	〇堀 誠¹, 横田 大輝¹, 真野 和音¹, 谷川 昇平¹, 和田 健司¹, 松中 敏行¹, 堀中 博道¹, 森川 浩安²	1.阪府大工, 2.阪市大医
	15:15 - 15:30		休憩/Break		
	15:30 - 15:45	奨 11p-D12-9	水銀からのマルチバブルソノルミネセンス	○山中 泰智¹, 崔 博坤¹	1.明大理工
	15:45 - 16:00	11p-D12-10	広域加熱・局所冷却による閉じたき裂の超音波フェーズドアレイ映像 化の定量解析	高橋 恒二¹, 猪 慶弘¹, ○小原 良和¹, 山中 一司¹	1.東北大学
	16:00 - 16:15	11p-D12-11	高音速薄膜装荷によるリーキー弾性表面波の低損失化	○垣尾 省司¹, 保坂 桂子¹	1.山梨大院
	16:15 - 16:30	11p-D12-12	宇宙機汚染管理を目的としたQCMアレイセンサの作製と評価	○土屋 佑太¹, 宮崎 英治¹, 美浦 由佳¹, 内田修¹, 鈴木 浩一¹	1.宇宙航空研究開発機構
	16:30 - 16:45	11p-D12-13	ゾルゲルSiOx膜を用いたボールSAW微量水分センサの低ガス流量 における感度	○辻 俊宏', 渡邊 圭', 東出 祐介', 大泉 透', 竹田 宣生', 赤尾 慎吾', 塚原 祐輔', 山中 一司'	1.東北大
	16:45 - 17:00	11p-D12-14	アンダーサンプリングを用いた実用的ボールSAWセンサ	○辻 俊宏¹, 大泉 透¹, 竹田 宣生¹, 赤尾 慎吾¹, 塚原 祐輔¹, 山中 一司¹	1.東北大
	17:00 - 17:15	11p-D12-15	デジタル式マイクロ流体システムを用いた血液凝固測定	大橋 紀之¹, ○近藤 淳¹	1.静岡大

1.7	1.7 超音波 / Ultrasonic		ポスター講演		
	3月11日(水) 9:30 - 11:30				
		奨 11a-P2-1	太陽光を利用した熱音響システムの研究 -円筒管内への光による 熱入力-	○渡 健吾¹, 坂本 眞一², 渡辺 好章¹	1.同志社大, 2.滋賀県立大
		奨 11a-P2-2	Ca、CaOHからのソノルミネセンス	○櫻田 浩樹¹, 崔 博坤¹	1.明大理工
		奨 11a-P2-3	周波数の異なる弾性表面波デバイスを用いた霧化現象の評価	○(M1)杉山 達也¹, 木村 尚史¹, 近藤 淳¹	1.静岡大
		11a-P2-4	弾性表面波による液滴搬送メカニズムの検討	深谷 智彦¹, ○近藤 淳¹	1.静岡大

2.1 放射線物理-	一般・検出器基礎	* / Radiation physics and Detector fundamentals	ポスター講演	
3月12日(木	9:30 - 11:30	)		
	12a-P1-1	Ce <sup>3+</sup> を添加したCaB <sub>2</sub> O <sub>4</sub> 結晶の熱蛍光及び輝尽蛍光特性	○藤本 裕¹, 柳田 健之², 越水 正典¹, 浅 井 圭介¹	1.東北大, 2.九工大
	12a-P1-2	希土類元素を添加したSiO <sub>2</sub> ガラスの放射線応答特性	$\bigcirc$ 藤本 裕 $^1$ ,柳田 健之 $^2$ ,越水 正典 $^1$ ,浅 井 圭介 $^1$	1.東北大, 2.九工大
	12a-P1-3	無添加LuVO <sub>4</sub> 結晶のシンチレーション特性	○藤本 裕¹, 柳田 健之², 小島 孝広³, 越水 正典¹, 浅井 圭介¹	1.東北大, 2.九工大, 3.オキサイド
	12a-P1-4	Ce:LiCaAIF。におけるシンチレーションの立ち上がり	○越水 正典¹, 柳田 健之², 福田 健太郎³, 藤本 裕¹, 浅井 圭介¹	1.東北大院工, 2.九工大, 3.トクヤマ
	12a-P1-5	$Ce:Gd_2Si_2O_7$ におけるエネルギー移動過程の解析	○越水 正典¹, 柳田 健之², 藤本 裕¹, 浅 井 圭介¹	1.東北大院工, 2.九工大
	12a-P1-6	Biドーププラスチックシンチレータの高エネルギーX線検出特性	○越水 正典¹, Bertrand Guillaume², Hamel Matthieu², 岸本 俊二³, 春木 理恵³, 錦戸 文 彦⁴, 柳田 健之⁵, 藤本 裕¹, 浅井 圭介¹	1.東北大院工, 2.CEA Saclay, 3.KEK, 4.放医研, 5.九工大
	12a-P1-7	高圧合成法を用いたZnOセラミックスのシンチレーション特性	○渡邊 慶¹, 越水 正典¹, 柳田 健之², 滝澤 博胤¹, 藤本 裕¹, 浅井 圭介¹	1.東北大工, 2.九工大
	12a-P1-8	Cs <sub>3</sub> BiCl <sub>6</sub> 及びCs <sub>3</sub> Bi <sub>2</sub> Br <sub>9</sub> 単結晶のX線に対する検出特性評価	○清水 真, 越水 正典', 岸本 俊二², 春木 理絵², 錦戸 文彦³, 柳田 健之⁴, 藤本 裕¹, 浅井 圭介¹	1.東北大工, 2.KEK, 3.放医研, 4.九工大
	12a-P1-9	$Cs_{3}Bi_{2}Br_{9}$ 単結晶のシンチレーション特性及びドーバントによる影響	○清水 真¹, 越水 正典¹, 柳田 健之², 藤本裕¹, 浅井 圭介¹	1.東北大工, 2.九工大
	12a-P1-10	Hfナ/粒子含有プラスチックシンチレータの高エネルギーX線検出 特性評価	○近野 唯!, 越水 正典!, 錦戸 文彦², 春木 理恵³, 岸本 俊二³, 柳田 健之⁴, 藤本 裕¹, 孫 彦¹, 浅井 圭介¹	1.東北大, 2.放医研, 3.KEK, 4.九工大
	12a-P1-11	ハフニアナノ粒子含有プラスチックシンチレータのX線検出特性	○(B)平田 智之¹, 野口 多紀郎¹, 越水 正典¹, 岸本 俊二², 春木 理恵², 錦戸 文彦³, 柳田健之⁴, 藤本 裕¹, 相田 穷¹, 高見 誠一¹, 阿尻雅文¹, 浅井 圭介¹	1.東北大学工, 2.KEK, 3.放医研, 4.九 工大
	12a-P1-12	中性子検出用Li含有型プラスチックシンチレータの開発	○(B)小田切 泰海¹, 越水 正典¹, 藤本 裕¹, 柳田 健之², 浅井 圭介¹	1.東北大工, 2.九工大
	12a-P1-13	CsClおよびCsBr結晶におけるシンチレーション特性の比較	○佐伯 啓一郎¹, 越水 正典¹, 柳田 健之², 藤本 裕¹, 浅井 圭介¹	1.東北大, 2.九工大
	12a-P1-14	Eu添加CsBr及びCsCl結晶のシンチレーション特性	○佐伯 啓一郎¹, 越水 正典¹, 柳田 健之², 藤本 裕¹, 浅井 圭介¹	1.東北大, 2.九工大
	12a-P1-15	CsRbZnCl <sub>4</sub> 結晶シンチレータのオージェフリー発光特性	○佐伯 啓一郎¹, 越水 正典¹, 柳田 健之², 藤本 裕¹, 浅井 圭介¹	1.東北大, 2.九工大
	12a-P1-16	${ m YBa_{_2}Cu_{_3}O}_{_\delta}$ における放射線照射効果の緩和観察	○甲谷 拓也¹, 越水 正典¹, 浅井 圭介¹	1.東北大工
	12a-P1-17	リン酸塩ガラス中のAg濃度とラジオフォトルミネッセンス特性の相関	○(B)田中 宏典¹, 藤本 裕¹, 越水 正典¹, 柳 田 健之², 浅井 圭介¹	1.東北大工, 2.九工大
	12a-P1-18	Cu添加リン酸塩ガラスにおけるラジオフォトルミネッセンス現象の観測	○(B)田中 宏典¹, 藤本 裕¹, 越水 正典¹, 柳 田 健之², 浅井 圭介¹	1.東北大工, 2.九工大
	12a-P1-19	シートタイプ蛍光ガラスを用いた放射線量分布の可視化	〇宮本 由香¹, 図子 直城², 佐藤 文信², 飯田 敏行², 清水 喜久雄², 池口 琢磨³, 南戸 秀 仁³, 井原 陽平¹, 稲田 禎一⁵, 杉山 誠¹, 佐藤 典仁¹, 竹內 宣博', 山本 幸佳¹	1.千代田テクノル, 2.大阪大学, 3.金沢工業大学, 4.EMFジャパン, 5.日立化成
	12a-P1-20	Sn,Mn 共添加ZnO-P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> ガラスにおけるPL,RL 特性	○正井 博和¹, 日野 祐輔¹, 柳田 健之², 藤 本 裕²	1.京大化研, 2.九工大
	12a-P1-21	重粒子線照射場におけるCsI(Tl)シンチレータの放射化	○(M1)鷲尾 知也¹, 若林 源一郎², 納富 昭弘³, 真正 浄光⁴, 古場 裕介⁵	1.近大院, 2.近大原研, 3.九大院医, 4.首 都大, 5.放医研

.1 放射線物理-	-般·検出器基	礎 / Radiation physics and Detector fundamentals	口頭講演	
3月13日(金	9:00 - 12:1	15		
9:00 - 9:15	13a-A19-1	Mg共添加Ce: $\mathrm{Gd_3}(\mathrm{Al},\mathrm{Ga})_5\mathrm{O}_{12}$ シンチレータの大型化とシンチレーション特性評価	○鎌田 圭 <sup>1,2</sup> , 庄子 育宏 <sup>2,3</sup> , 名倉 亜耶 <sup>3</sup> , 黒澤 俊介 <sup>1,3</sup> , 奥村 聡 <sup>4</sup> , 山本 誠一 <sup>4</sup> , V.Kochurikh- in Vladimir <sup>5</sup> , Pejchal Jan <sup>1,6</sup> , 横田 有為 <sup>1</sup> , 大 橋 雄二 <sup>3</sup> , 吉川 彰 <sup>1,2,3</sup>	1.東北大 NICHe, 2.株式会社 C&A, 3.東北大金研, 4.名大院医, 5.General Phys. Inst., 6.Inst.of Phys. AS CR
9:15 - 9:30	13a-A19-2	SrI2(Eu)単結晶の大口径化とその発光のEu濃度依存性	○桜木 史郎¹, 橋本 哲¹, 河相 武利²	1.ユニオンマテリアル, 2.大阪府大
9:30 - 9:45	13a-A19-3	ArF レーザー励起でのpure $\mathrm{SrI}_2$ 及び $\mathrm{SrI}_2$ (Eu) 発光特性	○桜木 史郎¹, 橋本 哲¹, 河相 武利²	1.ユニオンマテリアル, 2.大阪府大
9:45 - 10:00	E 13a-A19-4	Wavelength discrimination of Composite ceramic YAG scintillator	OJIANYONG JIANG¹, Kenji Shimazoe¹, Hiroyuki Takahashi¹, Takayuki Yanagida²	1.The Univ.of Tokyo, 2.Kyushu Inst.
10:00 - 10:15	奨 13a-A19-5	LaBr,:Ce シンチレータにおける波形解析を用いたアルファ線自己放射能除去方法の研究開発	○小川原 亮¹, 石川 正純¹	1.北大医
10:15 - 10:30	13a-A19-6	CeBr、シンチレーション検出器のy線応答のモンテカルロシミュレーションによる検討	○松本 政雄¹, 中路 拓¹, 高階 正彰¹, 井原陽平², 隱岐 圭司²	1.阪大院医, 2.EMF ジャパン(株)
10:30 - 10:45		休憩/Break		
10:45 - 11:00	13a-A19-7	CsIシンチレータの自己放射化にもとづく高感度中性子検出	○納冨 昭弘!, 有吉 容子!, 山内 ももこ!, 木 下 博之!, 本田 宗一郎!, 若林 源一郎!, 福永 淳一 <sup>3</sup> , 赤嶺 寛地 <sup>3</sup> , 梅津 芳幸 <sup>3</sup> , 中村 泰彦 <sup>3</sup>	1.九大医保, 2.近大原研, 3.九大病院
11:00 - 11:15	13a-A19-8	TRUST LiCAFと波長シフトファイバを用いた中性子検出器の特性評価	○(M1)山崎 拓弥¹, 杉本 大¹, 渡辺 賢一¹, 山崎 淳³, 瓜谷 章¹, 井口 哲夫¹, 福田 健太 郎², 石津 澄人², 柳田 健之³	1.名大工, 2.トクヤマ, 3.九工大
11:15 - 11:30	13a-A19-9	Ho添加酸化物結晶の放射線誘起発光特性に関する基礎研究	○熊谷 洋祐¹, 渡辺 賢一¹, 山崎 淳¹, 瓜谷章¹, 柳田 健之²	1.名大工, 2.九工大
11:30 - 11:45	13a-A19-10	分子内エネルギー移動構造を有する液体シンチレータ用有機色素 の開発	○(M1)佐熊 祐大¹, 坂口 幸一¹, 江良 正直¹, 清水 俊彦², 猿倉 信彦²	1.佐賀大院工, 2.阪大レーザー研
11:45 - 12:00	13a-A19-11	銀活性リン酸塩ガラスを用いた三次元線量イメージングのための時間 分解スペクトル測定	○(B)糸井 駿¹, 柳田(宮本) 由香², 黒堀 利夫¹	1.金沢大自然, 2.千代田テクノル

12:00 - 12:15	13a-A19-12	銀活性リン酸塩ガラスの飛跡検出器への応用	○小平 聡¹, 宮本 由香², 小口 靖弘², 四之宫 創³, 花岡 慶祐², 長谷部 信行³, 川嶋 元¹, 蔵野 美恵子¹, 北村 尚¹, 内堀 幸夫¹, 小倉 紘一⁴	1.放医研, 2.千代田テクノル, 3.早大理工研, 4.日大生産工
3月13日(金)	14:00 - 16:	00		
14:00 - 14:15	13p-A19-1	TlBr検出器の電子正孔対生成エネルギーの測定Ⅱ	○人見 啓太朗¹, 小野寺 敏幸², 金 聖潤¹, 庄司 忠良², 石井 慶造¹	1.東北大, 2.東北工大
14:15 - 14:30	13p-A19-2	CdTe系検出器におけるSCP過渡電流波形	○鈴木 和彦¹, 瀬戸 悟², 澤田 孝幸¹	1.北科大工, 2.石川高専
14:30 - 14:45	13p-A19-3	HBr系エッチング液によるCdTe検出器の表面処理の検討	○神野 悟史 <sup>1</sup> , 鈴木 悠太 <sup>1</sup> , 高井 紀明 <sup>1</sup> , 塚本 雄大 <sup>1</sup> , 松本 雅彦 <sup>1</sup> , 伊藤 祐葵 <sup>1</sup> , 杉本 宗一郎 <sup>1</sup> , 山崎 大輔 <sup>1</sup> , 北川 翔三 <sup>1</sup> , 小島 將弘 <sup>1</sup> , 安形 保則 <sup>1</sup> , ニラウラ マダン <sup>1</sup> , 安田 和人 <sup>1</sup>	1.名工大
14:45 - 15:00	奨 13p-A19-4	CVD合成ダイヤモンドを用いた高エネルギー重イオン飛跡の検出	○(M1)春山 盛善 <sup>1,2</sup> , 小野田 忍 <sup>2</sup> , 寺地 徳之 ³, 磯谷 順一 <sup>4</sup> , 加田 渉 <sup>1</sup> , 大島 武 <sup>2</sup> , 花泉 修 <sup>1</sup>	1.群大理工, 2.原子力機構, 3.物材機構 4.筑波大学
15:00 - 15:15	13p-A19-5	耐放射線性を有するSi-MOSFETの開発	○中田 智成¹, 秋山 周哲¹, 渡辺 温¹, 相 沢 淳², 大塚 正志², 石井 邦尚², 吉沢 勝美 ², 持木 幸一³	1.パイオニア(株), 2.パイオニアマイクロテクノロジー(株), 3.東京都市大学
15:15 - 15:30	13p-A19-6	Fe-55によるTESのベンチマーク試験	○佐藤 泰',福田 大治',田中 啓一',神代 晓',平山 文紀',山森 弘毅',永沢 秀一',佐藤 昭',日高 睦夫',畠山 修一³,入松川 知 也¹³,大野 雅史³,高橋 浩之³	1.産総研, 2.日立ハイテクサイエンス, 3.東大院
15:30 - 15:45	13p-A19-7	Si吸収体を有する超伝導トンネル接合検出器を用いたkeV領域のイオン計測	○志岐 成友¹, 藤井 剛¹, 浮辺 雅宏¹, 小池 正記¹, 大久保 雅隆¹	1.産総研
15:45 - 16:00	13p-A19-8	超伝導転移端検出器アレイのためのマイクロ波読出	○入松川 知也¹, 平山 文紀², 佐藤 昭², 山森 弘毅², 永沢 秀一², 福田 大治², 日高 睦夫², 神代 晓², 大野 雅史¹, 高橋 浩之¹	1.東大工, 2.産総研

2.2 検出器開発	2.2 検出器開発 / Detection systems 口頭講演					
3月11日(	水) 16:15 - 18	:00				
16:15 - 16:30	11p-A19-9	走査透過型電子顕微鏡搭載用TES型マイクロカロリメータEDSシステムの開発	○前畑 京介¹, 原 徽², 満田 和久³, 日高 睦 夫⁴, 田中 啓一⁵, 山中 良浩⁵	1.九大院工, 2.NIMS, 3.JAXA, 4.産総研, 5.日立ハイテクサイエンス, 6.大陽日酸		
16:30 - 16:45	11p-A19-10	STEM-EDS用64素子TES型X線マイクロカロリメータアレイの開発	○林 佑!, 永吉 賢一郎!, 村松 はるか!, 満田 和久!, 山崎 典子!, 本間 敬之², 齋藤 美紀子 ³, 前畑 京介¹, 原 徹⁵	1.ISAS/JAXA, 2.早大先進理工, 3.早大 NTRC, 4.九大工, 5.NIMS		
16:45 - 17:00	11p-A19-11	走査透過型電子顕微鏡搭載のための TES 型 X 線マイクロカロリメータアレイ読み出し系の開発	○千葉 旭', 酒井 和広', 永吉 賢一郎', 山本 亮', 林 佑', 村松 はるか', 満田 和久', 山崎 典子', 竹井 洋', 永沢 秀一², 日高 睦夫², 前 畑 京介³, 原 徹*	1.JAXA, 2.AIST, 3.九大工, 4.NIMS		
17:00 - 17:15	11p-A19-12	走査型電子顕微鏡搭載のためのTES型X線マイクロカロリメータアレイ実装技術の開発	○永吉 賢一郎', 千葉 旭', 林 佑', 村松 はるか', 酒井 和広', 山本 亮', 満田 和久', 山崎 典子', 竹井 洋', 前畑 京介', 原 徹'	1.宇宙航空研究開発機構, 2.九大工, 3.物質·材料研究機構		
17:15 - 17:30	11p-A19-13	1keV以下の特性線取得効率向上に向けたTESシステムの開発	○田中 啓一¹, 永田 篤士¹, 中山 哲¹, 茅根 一夫¹, 前畑 京介², 満田 和久³, 原 徽⁴	1.日立ハイテクサイエンス, 2.九大工, 3.JAXA, 4.NIMS		
17:30 - 17:45	11p-A19-14	走査透過型電子顕微鏡 EDS 用ポリキャビラリーのX線伝送特性測定	○高野 彬¹, 前畑 京介¹, 伊豫本 直子¹, 原 徹², 満田 和久³, 山崎 典子³, 田中 啓一⁴	1.九大工, 2.NIMS, 3.JAXA, 4.日立ハイ テクサイエンス		
17:45 - 18:00	11p-A19-15	走査透過型電子顕微鏡搭載用小型無冷媒³He-⁴He希釈冷凍機の 開発	○前畑 京介¹, 山中 良浩², 伊藤 琢司², 原徽³, 満田 和久⁴, 田中 啓─⁵	1.九大院工, 2.大陽日酸, 3.NIMS, 4.JAXA, 5.日立ハイテクサイエンス		

2.2 検出器開発 /	2.2 検出器開発 / Detection systems ポスター講演					
3月12日(木)	9:30 - 11:30					
	12a-P2-1	$Tm$ ドープ $CaF_2$ 蛍光体の光刺激ルミネッセンス	○(M1)中川 涼太¹, 平澤 一樹¹, 竹井 義法¹, 南戸 秀仁¹, 柳田 健之², 藤本 裕³, 宮本 由 香⁴, 福田 健太郎⁵, 黒堀 利夫⁶	1.金沢工大, 2.九州工大, 3.東北大, 4.千 代田テクノル, 5.株式会社トクヤマ, 6.金 沢大		
	12a-P2-2	液相エピタキシャルInSb放射線検出器におけるキャリア捕獲に関する研究	○飯村 隆介¹, 濱口 拓¹, 神野 郁夫¹	1.京大院工		
	12a-P2-3	塗布技術を用いた中性子検出器の試作	○内田 智久 <sup>1,3</sup> , 池野 正弘 <sup>1,3</sup> , 身内 賢太郎 <sup>2</sup> , 島崎 昇一 <sup>1,3</sup> , 田中 真伸 <sup>1,3</sup> , 田中 秀治 <sup>1</sup>	1.KEK素核研, 2.神戸大理, 3.Open-It		
	12a-P2-4	第三世代コンピュータ断層撮影に対応する電流測定・エネルギー分解 X線検出器の開発	○(M2)叶井 絵梨¹, 神野 郁夫¹, 山下 良樹¹, 小川 剛史¹, 真正 浄光²	1.京大院工, 2.首都大学東京		
	奨 12a-P2-5	エネルギー分解X線コンピュータ断層撮影法による造影剤量低減の可能性	○伊良皆 拓¹, 桑原 潤一², 神野 郁夫¹, 伊藤 秋男¹, 中村 光宏³, 平岡 真寛³	1.京大院工, 2.京大病院放射線部, 3.京 大院医		
	奨 12a-P2-6	熱蛍光素子BeO:Na(UD-170A)のグロー成分解析と線量依存性の 検討	○(M2)大坪 圭介¹, 眞正 浄光¹, 古場 裕介 ², 若林 源一郎³	1.首都大放, 2.放医研, 3.近大原研		
	12a-P2-7	荷電粒子線用グラファイトカロリーメータの開発	○田中 隆宏¹, 清水 森人¹, 森下 雄一郎¹, 黒澤 忠弘¹, 加藤 昌弘¹, 齋藤 則生¹	1.産総研 計測標準		
	奨 12a-P2-8	PET用3次元位置検出器X'tal Cubeの開発:(0.8mm)³分解能への挑戦	○新田 宗孝¹², 稲玉 直子², 平野 祥之², 錦戸 文彦², 吉田 英治², 田島 英朗², 河合 秀幸¹, 山谷 泰賀²	1.千葉大学, 2.放医研		
	12a-P2-9	TRUST LiCAFと波長シフトファイバを使用した中性子イメージング 検出器の開発	○杉本 大¹, 山崎 拓弥¹, 渡辺 賢一¹, 山崎淳¹, 瓜谷 章¹, 井口 哲夫¹, 福田 健太郎², 石津 澄人², 柳田 健之³	1.名大工, 2.トクヤマ, 3.九工大		
	12a-P2-10	健康診断における癌のスクリーニングを目的とした低被ばくX線コンピュータ断層撮影法の開発	○(M2)船引 綾乃¹, 山内 一輝¹, 神野 郁夫¹, 大高 雅彦², 橋本 周², 荒 邦章², 尾鍋 秀明³	1.京大院工, 2.原子力機構, 3.レイテック		
	12a-P2-11	リバース型アバランシェフォトダイオードのシングルイベント効果のシミュレーション研究	○(M2)荻田 竜平¹, 片寄 祐作¹, 大島 武², 小野田 忍², 牧野 高紘²	1.横国大工, 2.原子力機構		
	E 12a-P2-12	Characterization of Cubic $\mathrm{SrI}_2(\mathrm{Eu})$ Scintillators for Array Detectors	○Yang Tian¹, Kenji Shimazoe¹, Hiroyuki Takahashi¹, Shiro Sakuragi², Yasushi Yamasaki³	1.Tokyo Univ., 2.Union Materials, 3.Leading Edge Algorithms		

	3月13日(金)	16:15 - 19:0	00		
3待	16:15 - 16:45	13p-A19-9	「放射線 分科内招待講演」(30分) 原子核乾板自動解析技術の開発とその応用	〇森島 邦博 <sup>1</sup>	1.名大
3待	16:45 - 17:00	13p-A19-10	「講演奨励賞受賞記念講演」(15分) シンチレーティングGlass GEM の炭素線に対する応答	〇古場 裕介 <sup>1</sup> , 藤原 健 <sup>2</sup> , 松藤 成弘 <sup>1</sup> , 高橋 浩之 <sup>2</sup>	1.放医研, 2.東大工
	17:00 - 17:15	13p-A19-11	極微小シンチレータと光ファイバを用いた透視に映らない診断X線用 線量計の開発	○石川 正純¹, 中川 啓治², 五十嵐 俊之², 古畑 優³	1.北大院医, 2.太宝電子㈱, 3.アクロバイオ㈱
	17:15 - 17:30	奨 13p-A19-12	即発OSLによる蛍光強度測定及び線量率線形性の評価	○上野 克宜¹, 富永 和生¹, 田所 孝広¹, 石澤 幸治², 高橋 良知²	1.目立日研, 2.日立GE
	17:30 - 17:45		休憩/Break		
	17:45 - 18:00	奨 13p-A19-13	Scintillating Glass GEMの開発とその応用	○藤原 健¹, 三津谷 有貴¹, 古場 祐介², 高橋 浩之¹, 上坂 充¹	1.東大工, 2.放医研
	18:00 - 18:15	13p-A19-14	PADC検出器中重イオントラック内に形成されるヒドロキシル基の役割	○楠本 多聞¹, 森 豊¹, 金崎 真聡¹, 小田 啓 二¹, 小平 聡², 北村 尚², 山内 知也¹	1.神戸大院海事, 2.放医研
	18:15 - 18:30	13p-A19-15	Xeイオン(290 MeV/n), Krイオン(400 MeV/n)を照射したポリイミドの損傷構造	○池永 龍之介¹, 松川 兼也¹, 小田 啓二¹, 山内 知也¹, 小平 聡², 北村 尚², 小西 輝昭²	1.神大院海事, 2.放医研
	18:30 - 18:45	13p-A19-16	高閾値飛跡検出器としてのポリイミド樹脂の研究	〇安田 修一郎¹, 松川 兼也¹, 小田 啓二¹, 小平 聡², 北村 尚², 蔵岡 孝治¹, 山内 知也¹	1.神大院海事, 2.放医研
	18:45 - 19:00	13p-A19-17	重イオン成分を含む混成場への固体飛跡検出器群の適用	○山内 知也!、 ムハンマド エリワ!、 楠本 多聞, 田尾 陽!, 池永 龍之か! 安田 修一郎 「, 小田 啓二!, 小平 聡², 北村 尚', 西内 満美子³, 榊 泰直³, 金崎 真聡³, 福田 裕仁³, 近藤 公伯³	1.神戸大院海事, 2.放医研, 3.原子力機構関西
	3月14日(土)	9:00 - 12:15	5		
	9:00 - 9:15	14a-A19-1	腹腔鏡用単眼コンプトンプローブイメージングに関する研究	○(M1)小山 晃広¹, 中村 泰明¹, 島添 健次¹, 高橋 浩之¹	1.東大工
	9:15 - 9:30	奨 14a-A19-2	無人へり搭載散乱エネルギー認識型高位置分解能ガンマカメラの 開発	○島添 健欠¹, Jiang Jianyong¹, 高橋 浩之¹, 志風 義明², 島居 建男³, 西澤 幸康², 吉田 真美², 黒澤 俊介, 鎌田 圭², 吉川 彰³, 吉野 特生¹, 加藤 翔³, 伊藤 繁記¹, 遠藤 貴範¹, 堤浩輔², 佐藤 浩樹¹, 薄 善行⁴	1.東大工, 2.原子力機構, 3.東北大, 4. 河機械金属
	9:30 - 9:45	E 14a-A19-3	Electron Track Recognition with SOI sensor for Advanced Compton Imaging	○(M2)Fairuz Atiqah¹, Yuri Yoshihara¹, Kenji Shimazoe¹, Hiroyuki Takahashi¹, Ay- aki Takeda², Takeshi Tsuru², Yasuo Arai³⁴	1.Univ. of Tokyo, 2.Kyoto Univ., 3.KEK, 4.OIST
	9:45 - 10:00	14a-A19-4	SOI技術を用いた放射線イメージセンサーの最近の進展	○三好 敏喜¹, 新井 康夫¹, 三井 真吾¹, 西村 龍太郎²	1.KEK素核研, 2.総研大
	10:00 - 10:15	14a-A19-5	大面積CdTeビクセル検出器開発の現状と今後の計画	〇豊川 秀訓', 川瀬 守弘', 呉 樹奎', 佐治 超爾', 大端 通', 梶原 堅太郎', 佐藤 眞直', 広野 等子², 菖蒲 敬久³, 城 鮎美³, 末永 敦 士⁴, 池田 博一⁵	1.JASRI/SPring-8, 2.ポン大学, 3.原子機構, 4.豊和産業, 5.ISAS/JAXA
	10:15 - 10:30	奨 14a-A19-6	次世代CTを目指した高精細カラー放射線イメージセンサの開発 (I)	○大鳥 翼', 片岡 淳', 岸本 彩', 藤田 卓 也', 呉井 洋太', 西山 徹', 山本 誠一², 尾 川 浩一³	1.早大理工, 2.名大医, 3.法大理工
	10:30 - 10:45		休憩/Break		
	10:45 - 11:00	14a-A19-7	PMT, APD, MPPCを用いたSrI <sub>2</sub> (Eu)シンチレータの限界性能評価	○(D)岸本 彩¹, 片岡 淳¹, 櫻木 史郎², 山 嵜 康司³	1.早大理工, 2.ユニオンマテリアル, 3. ーディングエッジアルゴリズム
	11:00 - 11:15	E 14a-A19-8	Effect of Photoluminescence Position in Crystal on the Spectrum of Detected Photons	○Amin Choghadi¹, Kenji Shimazoe¹, Hiroyuki Takahashi¹, Masao Yoshino²	1.The Univ. of Tokyo, 2.Furukawa CO LTD
	11:15 - 11:30	奨 14a-A19-9	比例モードSi-APDを用いたX線シンチレーション検出器の開発(2)	○井上 圭介¹, 岸本 俊二¹²	1.総研大, 2.高エネ研
	11:30 - 11:45	14a-A19-10	重イオンマイクロビームを利用した4H-SiCショットキーバリアダイオード中の欠陥評価	○(M1C)神林 佑哉¹², 安藤 裕士¹, 加田 涉¹, 小野田 忍², 牧野 高紘², 星乃 紀博², 土田秀一³, 花泉 修¹, 神谷 富裕², 大島 武²	1.群馬大, 2.原子力機構, 3.電中研
	11:45 - 12:00	14a-A19-11	荷電粒子誘起電荷解析法を利用したダイヤモンド検出器内部の欠 陥準位計測	○加田 涉¹, 神林 佑哉¹², 小野田 忍², 牧野高紘², 安藤 裕士¹, 梅沢 仁³, 李野 由明³, 鹿田 真一³, 花泉 修¹, 神谷 富裕², 大島 武²	1.群馬大, 2.原子力機構, 3.産総研
	12:00 - 12:15	14a-A19-12	Coplanar電極を用いた希ガス電離箱の開発III	○草野 広樹¹, 吉村 亮¹, 川端 修¹, 粟田 光 紀¹, 岩崎 健太¹, 宮島 光弘¹, 柴村 英道¹, 長 谷部 信行¹	1.早大理工研

放射線応用・	発生装置·新	技術 / Application, radiation generators, new techno	ology 口頭講演	
3月11日(水	9:00 - 11	:45		
9:00 - 9:15	11a-A19-1	300keV小型イオンマイクロビーム装置で形成されたビーム径の縮小化	○石井 保行¹, 大久保 猛¹	1.原子力機構高崎研
9:15 - 9:30	11a-A19-2	焦電結晶を用いたX線発生器の動作特性(Ⅱ)	〇内藤 雅之¹, 長谷部 信行¹, 草野 広樹¹, 長岡 央¹, 久野 治義¹, 柴村 英道¹, José A. Matias Lopes²	1.早稲田大学, 2.Univ. of Coimbra
9:30 - 9:45	11a-A19-3	慣性静電閉じ込め放電における陰極内部電圧の分光測定	○金岩 潤一郎', 大村 航太', 友清 彰大', 前 田 涉吾', 青田 英悟', 内海 倫明', 千葉 雅 美', 藤井 政俊', 進藤 春雄'	1.東海大, 2.首都大理工, 3.島根大医
9:45 - 10:00	11a-A19-4	コンクリート内部を可視化する後方散乱X線装置の開発	○豊川 弘之¹, 平 義隆¹, 萬代 新一², 瓜谷章³, 渡辺 賢一³, 藤原 健⁴	1.産総研, 2.(株) BEAMX, 3.名古屋学, 4.東京大学
10:00 - 10:15	11a-A19-5	1および2インチ径La-GPS単結晶のシンチレーション特性評価	〇黒澤 俊介 $^{12}$ , 庄子 育宏 $^{13}$ , 村上 力輝斗 $^{1}$ , 山路 晃広 $^{1}$ , Pejchal Jan $^{24}$ , 大橋 雄二 $^{1}$ , 横田 有為 $^{2}$ , 鎌田 圭 $^{23}$ , 吉川 彰 $^{123}$	1.東北大金研, 2.東北大NICHe, 3.杉 会社C&A, 4.チェコ物理研
10:15 - 10:30		休憩/Break		
10:30 - 10:45	11a-A19-6	携帯型コンプトンカメラによる3次元ガンマイメージ再構成	○(D)岸本 彩¹, 片岡 淳¹, 西山 徹¹, 多屋 隆 紀¹, 株木 重人², 西尾 禎治³	1.早大理工, 2.東海大医, 3.国立がん 究センター
10:45 - 11:00	11a-A19-7	散乱線による放射性物質の3次元深度分布推定法	○(B)岩本 康弘¹, 片岡 淳¹, 岸本 彩¹, 西山 徹¹, 藤田 卓也¹, 多屋 隆紀¹, 大河内 博¹, 緒方 裕子¹	1.早大理工

11:00 - 11:15	11a-A19-8	キャビティーリングダウン分光に基づく放射性炭素同位体分析システムの開発	○寺林 稜平', 富田 英生', Volker Sonnen- schein', 弘津 嵩大', 揺詰 聡士', 金 磊', 山 中 真仁', 西澤 典彦', 佐藤 淳史², 大森 茜², 井手野 晃², 大原 利成², 井口 哲夫'	1.名古屋大学, 2.積水メディカル薬物動 態研究所
11:15 - 11:30	11a-A19-9	重粒子線照射野イメージングのための二重リング式OpenPET実証 機開発	○山谷 泰賀!, 吉田 英治!, 田島 英朗!, 稲玉 直子!, 錦戸 文彦!, 品地 哲弥!, 新田 宗孝!, 中島 靖紀!, Mohammadi Akram!, 脇坂 秀 克!, M. Ahmed Abdella!, 稲庭 拓', 北川 敦 志', 增田 圭介², 清水 啓司²	1.放医研, 2.浜松ホトニクス
11:30 - 11:45	11a-A19-10	1リング試作機を用いたRFコイル一体型頭部用PET/MRI装置のイメージング性能評価	○錦戸 文彦¹, 田島 英朗¹, 稲玉 直子¹, 清水 浩大², 菅 幹生², 小畠 隆行¹, 吉田 英治¹, 山谷 秦賀¹	1.放医研, 2.千葉大
3月11日(水	) 14:00 - 16	5:00		
14:00 - 14:15	11p-A19-1	位置有感型比例計数箱PS-TEPCフライトモデルの開発(II)	○岸本 祐二¹, 佐々木 慎一¹, 高橋 一智¹, 齋藤 宪¹, 寺沢 和洋², 身内 賢太郎³, 布施 哲人¹, 永松 爱子¹, 勝田 真参³, 伊藤 裕一⁴, 松本 晴久¹, 森 國城², 谷森 遼³, 窪 秀利², 内堀 幸夫⁵, 北村 尚⁵, 道家 忠義³	1.KEK, 2.慶応大, 3.神戸大, 4.JAXA, 5.京大, 6.放医研, 7.早大
14:15 - 14:30	11p-A19-2	有人宇宙船内における最適な遮蔽材料と遮蔽厚の検討	○島田健 <sup>1</sup> , 永松愛子 <sup>2</sup> , 佐藤 達彦 <sup>3</sup> , 北城 圭一 <sup>1</sup> , 坂根 小百合 <sup>1</sup> , 武田 和雄 <sup>4</sup> , 安田 仲 宏 <sup>2</sup> , 伊藤 剛 <sup>2</sup>	1.㈱エイ・イー・エス, 2.宇宙航空研究開発機構, 3.日本原子力研究開発機構, 4.高度情報科学技術研究機構
14:30 - 14:45	11p-A19-3	放射線治療時のリアルタイム線量モニタ実現に向けた近赤外発光Ti 添加ガーネット酸化物シンチレータ結晶の開発	○(DC)山路 晃広¹, 黒澤 俊介¹², 北浦 守³, 村上 力輝斗¹, Pejchal Jan¹, 大橋 雄二¹, 鎌 田 圭², 横田 有為², 大西 彰正³, 吉川 彰¹²	1.東北大金研, 2.東北大NICHe, 3.山 形大理
14:45 - 15:00	11p-A19-4	月周回衛星による月ガンマ線及び中性子の線量空間分布	○林田 陵佑¹, 長岡 央¹, 長谷部 信行¹, 草野 広樹¹, 小平 聡²	1.早大理, 2.放医研
15:00 - 15:15	11p-A19-5	放射性核種の微小部位イメージングに向けたCsレーザー共鳴イオン 化スキームの開発	○古田 雄仁¹, 高松 峻英¹, 富田 英生¹, 坂本 哲夫², 大石 乾詞², 能任 琢真¹, 中村 敦¹, 井 口 哲夫¹, クラウス ベント³	1.名古屋大工, 2.工学院大工, 3.ヨハネ グーテンベルグ大
15:15 - 15:30	11p-A19-6	CR-39 を用いた $\alpha$ 線オートラジオグラフィによるMOX 燃料の品質評価への応用	○小平 聡¹, 藏野 美恵子¹, 細金 達哉², 石川 文隆², 影山 十三男², 佐藤 光弘², 茅野 雅志 ², 安田 仲宏³	1.放医研, 2.原子力機構, 3.福井大
15:30 - 15:45	E 11p-A19-7	Lithium silicate crystals for neutron scintillators	OJan Pejchal <sup>1,2</sup> , Alena Beitlerova <sup>2</sup> , Shunsu- ke Kurosawa <sup>3</sup> , Yuui Yokota <sup>1,3</sup> , Martin Nikl <sup>2</sup> , Akira Yoshikawa <sup>1,3</sup>	1.NICHe, Tohoku Univ., 2.Inst. Phys. AS CR, 3.IMR, Tohoku Univ.
15:45 - 16:00	E 11p-A19-8	Luminescence properties of $\mathrm{Srl}_2$ single crystals doped with s²-group ions grown by modified micro-pulling-down method	○(P)Robert Kral <sup>1,2</sup> , Karel Nitsch², Jan Pejchal <sup>2,3</sup> , Vitezslav Jary², Shunsuke Kuro- sawa¹, Yuui Yokota³, Martin Nikl², Akira Yoshikawa¹ <sup>1,3</sup>	1.Institute for Materials Research, Tohoku University, 2.Institute of Phys ics AS CR, Czech Republic, 3.New Industry Creation Hatchery Center, Tohoku University

2.3 放射線応用・発生装置・新技術 / Application, radiation generators, new technology ポスター講演					
3月12日(木) 9:30 - 11:30					
	12a-P3-1	焦電性結晶を用いたX線発生の強度安定性に及ぼす結晶形状の影響に関する研究	○(M1)小川 友輔¹, 佐藤 祐喜¹, 吉門 進三¹, 伊藤 嘉昭²	1.同志社大院理工, 2.京大化研	
	12a-P3-2	垂直磁気異方性CoFeB-MgO磁気トンネル接合の高速中性子耐性 評価	○成田 克¹, 早尾 貴史¹, 高橋 豊¹, 伊藤 正 俊², 酒見 泰寛², 小林 大輔³, 廣瀬 和之³, 石 川 慎也⁴, Enobio Eli Christopher⁴, 佐藤 英 夫⁵, 池田 正二⁵, 遠藤 哲郎⁵.6, 大野 英男⁴.5.6.7		
	12a-P3-3	荷電粒子検出器となる薄膜型単結晶CVDダイヤモンド上での細胞 培養の試み	○加田 渉¹, 酒井 真理², Pomorski Michal², Grilj Veljko¹, Skukan Natko¹, 神林 佑哉ध², 牧野 高紘⁵, Jakšić Milko⁴, 小野田 忍⁵, 大島 武⁵, 神谷 富裕⁵, 花泉 修¹	1.群馬大, 2.群馬大重粒子, 3.CEA- LIST, 4.RBI, 5.原子力機構	

# 3 光・フォトニクス / Optics and Photonics

3月13日(金	9:00 - 11:1	5		
9:00 - 9:15	E 13a-A15-1	Separation of Intermolecular Motions in Liquids with Polarization Dependent Stimulated Raman Spectroscopy	○(P)Stefan Funkner¹, Gudrun Niehues¹, Shun Nakae¹, Takashi Furuya¹, Kohji Yamamoto¹, Masahiko Tani¹	1.FIR Center, Univ. of Fukui
9:15 - 9:30	獎·E 13a-A15-2	Low Temperature-Grown GaAs Carrier Lifetime Measurements Using "Double Pump" Terahertz Time-Domain Spectroscopy Setup	○(D)Valynn Magusara¹, Stefan Funkner¹, Gudrun Niehues¹, Elizabeth Ann Prieto², Armando Somintac², Elmer Estacio², Arnel Salvador², Kohiji Yamamoto¹, Muneaki Hase³, Masahiko Tani¹	1.FIR-Univ. of Fukui, 2.NIP Univ. of Phils., 3.Univ. of Tsukuba
9:30 - 9:45	E 13a-A15-3	Exploring the Fano resonance of dolmen structures in near field by PEEM	○(D)Yu Han¹, Sun Quan¹, Ueno Kosei¹, Matsuo Yasutaka¹, Kubo Atsushi², Misawa Hiroaki¹	1.RIES-Hokkaido Univ., 2.Inst. Phy Univ. Tsukuba
9:45 - 10:00	E 13a-A15-4	Design of Perfect Absorber Based on Spiral Architecture Meta- material for Near-Infrared Spectral Range	○IHAR FANIAYEU¹², IGOR SEM- CHENKO², VYGANTAS MIZEIKIS¹	1.Shizuoka Univ., 2.Gomel State Un
10:00 - 10:15	E 13a-A15-5	Exciton Quenching of Thermally Activated Delayed Fluorescence Molecules	○(P)SANGARANGE SANDANAYAKA¹, Toshinori Matsushima¹, Chihaya Adachi¹	1.OPERA Kyushu University, JST ERATO
10:15 - 10:30	E 13a-A15-6	Light absorption via discrete states in AlGaAs solar cell embedded with Er complex	○(D)ChaoYu Hung¹, Tomah Sogabe¹, Ryo Tamaki¹, Naoya Miyashita¹, Akio Ogura¹, Yoshitaka Okada¹	1.RCAST, The Univ. of Tokyo
10:30 - 10:45	E 13a-A15-7	Optical Feedback Sensitivity of InAs/GaAs Quantum Dot Lasers	(D)Timothy Rae¹, Katsuaki Tanabe¹, Kenichiro Yashiki², Kazuhiko Kurata², Satoshi Iwamoto¹, Yasuhiko Arakawa¹	1.NanoQuine, IIS, Univ. Tokyo, 2.PETRA
10:45 - 11:00	E 13a-A15-8	Experimental Investigation of Four-Wave Mixing Effect in Quantumn-Dot Semiconductor Optical Amplifier Physics	Guo-Wei LU², Danshi Wang³, Cheng Wang³, Jun Qin³, ○Takahide Sakamoto¹, Kouichi Akahane¹, Naokatsu Yamamoto¹, Hongxiang Wang³, Min Zhang³, Tetsuya Kawanish¹¹, Shigeru Yamaguchi²	1.NICT, 2.Tokai univ., 3.BUPT

11:00 - 11:15 E 13a-A15-9 Multiplexed SOI Ring Resonators for Biosensing Applications	○(D)Manuel Mendez-Astudillo¹, Matthias Jager², Danny Volkmann², Hirochika Nakajima¹	1.Waseda Univ., 2.TU Berlin
---	---	-----------------------------

3.1	3.1 光学基礎・光学新領域 / Basic optics and frontier of optics ポスター講演						
	3月13日(金) 9:30 - 11:30						
		13a-P2-1	光渦を用いたレーザートラッピング法によるグリシン結晶成長制御		○パリダン アルキン¹, Lee Jun Hyung¹, 曲澤 学¹, 宮本 克彦¹, 尾松 孝茂¹²	1.千葉大, 2.JST_CREST	
		13a-P2-2	液晶光学素子による量子化ラゲールガウスビームの生成と伝搬特性(II)		〇小川 賀代 <sup>1</sup> , 齊藤 彩 <sup>1</sup> , 惟村 百合子 <sup>1</sup> , 田 辺 綾乃 <sup>2</sup> , 栗原 誠 <sup>2</sup> , 横山 正史 <sup>2</sup> , 松本 健志 <sup>2</sup> , 橋本 信幸 <sup>2</sup>	1.日本女子大理, 2.シチズンホールディン グス(株)開発部	

3月14日(土	) 9:00 - 12:0	0		
9:00 - 9:15	14a-A12-1	フェムト秒ダブルバルストレインによるナノ粒子の光トラッピングおよび 放出ダイナミクス(3)粒子アブレーションと放出過程	○村松 正康¹, 沈 則甫¹, 江 威逸¹, Usman Anwar², 增原 宏¹	1.国立交通大理, 2.アブドラ科技大
9:15 - 9:30	14a-A12-2	ラゲール・ガウスビーム中における粒子の円運動の原理	○茨田 大輔 <sup>1,2,4</sup> , 川田 重夫 <sup>1,2</sup> , 谷田貝 豊彦 <sup>2</sup> , 尾松 孝茂 <sup>3,4</sup>	1.宇大院工, 2.宇大CORE, 3.千葉 融合, 4.JST-CREST
9:30 - 9:45	14a-A12-3	光渦の散乱力により形成された単結晶シリコンピラー	〇高橋 冬都', 滝澤 隼', 藤原 穂波', 宮本 克彦', 比田井 洋史', 森田 隆二 <sup>2,3</sup> , 尾松 孝茂 <sup>1,3</sup>	1.千葉大院, 2.北大院工, 3.JST-CR
9:45 - 10:00	14a-A12-4	テラヘルツベクトルビームの制御II	○若山 俊隆 <sup>1</sup> , 東口 武史 <sup>2-3</sup> , 及川 大基 <sup>2</sup> , 坂 上 和之 <sup>1</sup> , 鷲尾 万一 <sup>4</sup> , 米村 元喜 <sup>1</sup> , 吉澤 徹 <sup>5</sup> , タイヨ スコット <sup>6</sup> , 大谷 幸利 <sup>3</sup>	1.埼玉医大, 2.宇大, 3.宇大CORE, 大, 5.三次元工学会, 6.アリゾナ大学
10:00 - 10:15	14a-A12-5	テラヘルツビームの偏光検出:ベクトル渦解析 III	○若山 俊隆¹, 東口 武史²³, 及川 大基², 坂 上 和之⁴, 鷲尾 方一⁴, 米村 元喜¹, 吉澤 徹⁵, タイヨ スコット ⁶, 大谷 幸利³	1.埼玉医大, 2.宇大, 3.宇大CORE, 大, 5.三次元工学会, 6.アリゾナ大学
10:15 - 10:30	14a-A12-6	高次径偏光ビームのスーパーオシレーション集光	○小澤 祐市¹, 松永 大地¹, 佐藤 俊一¹	1.東北大多元研
10:30 - 10:45		休憩/Break		
10:45 - 11:00	奨 14a-A12-7	高次径偏光ビームのスーパーオシレーション特性による共焦点レーザー顕微鏡の空間分解能の向上	○松永 大地¹, 小澤 祐市¹, 佐藤 俊一¹	1.東北大多元研
11:00 - 11:15	14a-A12-8	螺旋型フレネルゾーンプレートによるX線光渦生成と集光点近傍の 波面決定	○香村 芳樹¹, 武井 大¹, 鈴木 芳生²	1.理研SPring-8センター, 2.JASRI
11:15 - 11:30	奨 14a-A12-9	タイコグラフィー位相回復法による光渦の波面計測	○齋藤 貴宏¹, 竹尾 陽子¹, 三村 秀和¹	1.東京大工
11:30 - 11:45	奨 14a-A12-10	ナノ流体による太陽光の光熱変換	○石井 智1.2, 長尾 忠昭1.2	1.物材機構, 2.JST-CREST
11:45 - 12:00	奨 14a-A12-11	コアシェル型高屈折率誘電体ナノ構造の可視域電磁場応答制御	○土本 悠太¹, 矢野 隆章¹², 林 智広¹², 原 正彦¹²	1.東工大総理工, 2.理研
3月14日(土	) 13:00 - 14:	15		
13:00 - 13:15	14p-A12-1	3次元疑似スペクトル時間領域(PSTD)法のGPGPUによる高速化	○水谷 彰夫¹, 菊田 久雄¹	1.阪府大工
13:15 - 13:30	14p-A12-2	局在モードを制御した新規ランダムレーザーの発振状態解析	○煮雪 亮¹, 石川 善恵², 越崎 直人³, 辻 剛 志⁴, 中村 俊博³, 藤原 英樹¹, 笹木 敬司¹	1.北大電子研, 2.産総研, 3.北大院 4.島大総理工, 5.群馬大院理工
13:30 - 13:45	14p-A12-3	異方性光学結晶で光完全密閉箱は構成できるか?	○(M2)芝崎 勝也¹, 小林 哲郎², 兼松 泰男², 岡村 康行¹	1.阪大基礎工, 2.阪大 e-square
13:45 - 14:00	14p-A12-4	透過光スペクトルによるナノファイバーセンサーの評価	○山本 和広¹, 山口 堅三², 横山 士吉¹, 大 友 明³	1.九大先導研, 2.香川大, 3.情通機構
14:00 - 14:15	14p-A12-5	紫外線発光ダイオードとブラスチックターゲットを用いた人工衛星搭載 用推進機の開発	○(M1)小山 拓実¹, 山崎 泰史¹, 堀澤 秀之¹	1.東海大工

3.2	3.2 材料·機器光学 / Equipment optics and materials 口頭講演						
	3月12日(木)	) 14:00 - 17:	15				
	14:00 - 14:15	12p-A13-1	赤外イメージングシステムによる塗抹文字検出	○菅原 滋¹	1.科警研		
	14:15 - 14:30	12p-A13-2	液晶レンズの応答特性(I)	○千田 誠¹, 田村 賢介¹, 河村 希典¹, 佐 藤 進²	1.秋田大院工, 2.液晶レンズ研		
	14:30 - 14:45	12p-A13-3	焦点可変液晶レンズを用いたサーモグラフィカメラによる撮像システムの構成	佐藤 翔吾¹, ○河村 希典¹, 佐藤 進²	1.秋田大院工, 2.液晶レンズ研		
	14:45 - 15:00	12p-A13-4	酸化バナジウムで形成したメゾフレーク膜の光学特性	○垣内田 洋¹, 吉村 和記¹, 田澤 真人¹	1.産総研		
	15:00 - 15:15	12p-A13-5	0.02 以上の屈折率変調を有する有機ナノ微粒子-ポリマーコンポジット体積ホログラフィック格子	○富田 康生 <sup>1</sup> , 浦野 寛史 <sup>1</sup> , 西村 直也 <sup>2</sup> , 大 土井 啓祐 <sup>2</sup>	1.電通大院先進理工, 2.日産化学工業 (株)		
	15:15 - 15:30	12p-A13-6	高濃度半導体CdSe 量子ドット分散ポリマーナノコンポジット中における高屈折率変調Bragg 格子の形成	○山上 龍一¹, 秦泉寺 貴章¹, 富田 康生¹	1.電気通信大		
	15:30 - 15:45		休憩/Break				
	15:45 - 16:00	奨 12p-A13-7	動的光重合により作製した回折格子の光学物性	○相沢 美帆¹, 久野 恭平¹, 赤松 範久¹, 宍 戸 厚¹²	1.東工大資源研, 2.JSTさきがけ		
	16:00 - 16:15	奨 12p-A13-8	ブルー相液晶を用いた円偏光選択分波光素子	○アヌチャー コンカノック¹, 河田 優人¹, 田中秀¹, 吉田 浩之¹, 尾崎 雅則¹	1.阪大院工		
	16:15 - 16:30	奨 12p-A13-9	水中油滴型エマルションを利用した貴金属ナノ粒子自己組織化膜 の作製	○(M1)香川 龍恭¹, 武安 伸幸¹, 金田 隆¹	1.岡大院自然		
	16:30 - 16:45	E 12p-A13-10	Low temperature synthesis of mechanoluminescent material	OKenji Murakami², Manoj Ranasinghe¹, Gamini Rajapakse³, Oliver Illeperuma³	1.GSST, Shizuoka Univ., 2.GSE, Shizuoka Univ., 3.Univ. Peradeniya		
	16:45 - 17:00	12p-A13-11	高Tgメタクリレート系EOポリマーの長期安定性	○大友 明¹, 青木 勲¹, 山田 千由美¹, 山田 俊樹¹	1.情通機構		
	17:00 - 17:15	12p-A13-12	深紫外光励起によるAIN結晶の吸収スペクトル変化	○(B)久保 雄紀¹	1.宇大 CORE		

3.2	3.2 材料・機器光学 / Equipment optics and materials ポスター講演						
	3月13日(金)	9:30 - 11:30					
		13a-P3-1	偏光板を利用しない液晶レンズの結像におけるノイズ除去	○葉 茂¹, 崔 春暉¹, 包 瑞¹, 郁 樹達¹	1.超多維		
		13a-P3-2	宇宙光通信用小型デュブリケート光学系の汎用化に向けた検討	○中山 朋子¹, 高山 佳久², 藤川 知栄美¹, 小 舘 香椎子³	1.東海大工, 2.情報通信研究機構, 3.電 通大		
		13a-P3-3	コロナ放電選択堆積によるガラスホログラム	○酒井 大輔¹, 神成 邦弘¹, 氏家 健太郎¹, 原 田 建治¹, 原 悠一郎¹, 池田 弘², 西井 準治³	1.北見工大, 2.九大産学連携センター, 3.北大電子研		
		13a-P3-4	液体金属を用いたフレキシブルな反射型回折格子	橋本 拓也¹, ○斉藤 光徳¹, 山田 逸成², 西 井 準冶³	1.龍谷大, 2.滋賀県立大, 3.北大		
		13a-P3-5	四角形状電極を有する液晶マイクロレンズアレイの3次元液晶分子配向シミュレーション	○河村 希典¹, 中村 剣登¹, 佐藤 進²	1.秋田大院工, 2.液晶レンズ研		
		13a-P3-6	偏光感受性材料中での偏光選択型バイナリホログラムの記録特性	○宮内 大功¹, 江本 顕雄¹, 大谷 直毅¹, 福 田 隆史²	1.同志社大理工, 2.産総研		
		E 13a-P3-7	Hybrid-aligned dye-doped polymer network liquid crystal showing self-focusing effect	○Jing Wang¹, Yosuke Aihara¹, Motoi Kinoshita², Atsushi Shishido¹.³	1.Tokyo Tech., 2.Saitama Tech., 3.PRESTO, JST		
		13a-P3-8	PDMS上でのスチルベン誘導体の結晶形成	○望月 博孝¹, 園田 与理子¹, 佐々木 史雄¹, 阿澄 玲子¹, 周 英¹	1.産総研電子光		
		13a-P3-9	$\operatorname{Gd}_2\operatorname{O}_3$ : Yb³+, $\operatorname{Er}^{3+}$ の下方変換発光におけるエネルギー伝達機構	○植田 史郎¹, 有本 聖吾¹, 佐俣 博章¹, 小澤 忠司²	1.神戸大海事, 2.物材機構		
		13a-P3-10	$\operatorname{Gd_2O_3}:\operatorname{Er^{3+}},\operatorname{Yb^{3+}},\operatorname{Li^+}$ のアップコンバージョン特性	○埴岡 正史¹, 有本 聖吾¹, 佐俣 博章¹, 小澤 忠司²	1.神戸大海事, 2.物材機構		

3.3	3.3 情報フォトニクス・画像工学 / Information photonics and image engineering 口頭講演						
	3月13日(金) 16:30 - 17:30						
	16:30 - 16:45	13p-A11-1	事例ベース超解像技術を用いた光学顕微鏡	○石川 慎二¹, 早崎 芳夫¹	1.宇大オプティクス		
	16:45 - 17:00	奨 13p-A11-2	画素限界条件下のDepth-from-defocus における瞳位相変調を用いた奥行き分解能の向上	○新原 隆広¹, 堀崎 遼一¹, 清野 光宏², 柳井 謙一², 谷田 純¹	1.阪大院情, 2.デンソー		
	17:00 - 17:15	13p-A11-3	タンパク質を用いた受容野型フィルター素子による画像処理	○向井 貴之¹, 本井 拓馬¹, 春山 喜洋², 笠井 克幸², 岡田 佳子¹	1.電通大先進理工, 2.情報通信研究機構		
	17:15 - 17:30	13p-A11-4	複眼画像システムによるプリンタ画線の偏角多段露光観察	〇赤尾 佳則¹, 東川 佳靖¹, 谷田 純²	1.科警研, 2.阪大院情報		

3.3 情報フォトニク	ス・画像工学/	Information photonics and image engineering	ポスター講演					
3月13日(金)	3月13日(金) 9:30 - 11:30							
	13a-P4-1	ディジタルホログラフィにおけるフレネル領域フィルタリング法に適し た物体光条件	○井邊 真俊¹, 野村 孝徳¹, Naughton Thomas J.²	1.和歌山大院システム工, 2.アイルランド 国立大メイヌース校				
	13a-P4-2	ディジタルホログラフィック顕微鏡による血液凝固過程の動的観察	熊谷 泰志¹, ○船水 英希¹, 相津 佳永¹	1.室工大院				
	13a-P4-3	矩形開口シフト法によるディジタルホログラフィの画質向上と合焦位置 検出応用の検討	○(D)森 裕¹, 福岡 隆彦¹, 野村 孝徳¹	1.和歌山大院システム工				
	13a-P4-4	スペックル照明を用いたカラーディジタルホログラフィック顕微鏡の分 光透過率推定	得能 友太¹, ○船水 英希¹, 相津 佳永¹	1.室工大院				
	奨 13a-P4-5	多色光再生法を用いた偏光ホログラフィックメモリーの再生信号特性	○(B)吉田 竜¹, 志村 努², 黒田 和男¹, 藤村 隆史¹	1.宇大CORE, 2.東大生研				
	13a-P4-6	キノフォーム可変焦点レンズを用いた多層記録ホログラフィックメモリ	○(D)信川 輝吉¹, 野村 孝徳¹	1.和歌山大院システム工				
	13a-P4-7	長周期グレーティング装荷SOAによる全光2R再生デバイスにおける縦型と横型方向性結合器による特性比較	<ul><li>○益本 佳奈¹, 徐 イツロク¹, 松島 裕一¹, 宇 高 勝之¹</li></ul>	1.早大理工				

.3 情報フォトニ	クス・画像工学	/ Information photonics and image engineering	口頭講演	
3月14日(土	) 9:00 - 12:1	5		
9:00 - 9:15	14a-A11-1	AIRRによる空中LEDスクリーン上での手振り復号型ステガノグラフィー	○高橋 昌史¹, 山本 裕紹¹²	1.宇大オプト, 2.JST, CREST
9:15 - 9:30	14a-A11-2	誤差拡散法に基づく難視認性投影パターンの生成	○生源寺 類□	1.静大院工
9:30 - 9:45	14a-A11-3	車用ヘッドアップディスプレイにおける合わせガラス二重像の精密 測定	○富田 保士¹, 久保田 重夫¹	1.オキサイド
9:45 - 10:00	14a-A11-4	直交ミラーアレイによって収束された音波の波形	○久次米 亮介¹, 宮本 康平¹, 陶山 史朗¹, 山本 裕紹¹²	1.徳島大学, 2.宇都宮大学
10:00 - 10:15	14a-A11-5	視域走査型全周立体ホログラム表示に用いるホログラム計算法	○井上 達晶¹, 高木 康博²	1.農工大工, 2.農工大院工
10:15 - 10:30	14a-A11-6	波面回転光学系を用いた全水平方向から観測可能なホログラフィック 3D ディスプレイの時分割数の削減	○山東 悠介123, 茨田 大輔12, 谷田貝 豊彦1	1.宇大CORE, 2.宇大院工, 3.大阪府 産技研
10:30 - 10:45		休憩/Break		
10:45 - 11:00	14a-A11-7	水平走査型カラーホログラフィーに適した誤差拡散法	中島 竜海¹, ○高木 康博¹	1.農工大院工
11:00 - 11:15	14a-A11-8	コントラストとDuty比を用いた1次元空間光変調素子によるフルカラーホログラフィックディスプレイの画素構造設計	上野 文華¹, 仁田 功一¹, ○的場 修¹	1.神戸大院シス情
11:15 - 11:30	奨 14a-A11-9	ホログラフィック並列光アクセスと多層蛍光スクリーンを用いたボリュ ームディスプレイ	○熊谷 幸汰¹, 長谷川 智士¹, 早崎 芳夫¹	1.宇大オプト
11:30 - 11:45	14a-A11-10	2次元位相格子を用いたホログラフィックメモリのための複素振幅変調技術	○(D)信川 輝吉¹, 野村 孝徳¹	1.和歌山大院システム工
11:45 - 12:00	14a-A11-11	複素振幅マスクを用いたバイナリーページデータの高密度化方法	○茨田 大輔1-2, 川田 重夫1-2, 谷田貝 豊彦2	1.宇大院工, 2.宇大CORE
12:00 - 12:15	奨 14a-A11-12	位相多値ホログラフィックメモリーにおけるクロストークノイズの解析	○(B)染谷 和希¹, 茨田 大輔², 志村 努³, 藤 村 隆史¹	1.宇大CORE, 2.宇大院工, 3.東大生

3月14日(土) 13:15 - 14:30					
13:15 - 13:30	奨 14p-A11-1	16パルス縮退光パラメトリック発振器系を用いたコヒーレント計算機	○高田 健太 <sup>1,2,3</sup> , Marandi Alireza <sup>2,4</sup> , 丸尾 大貴 <sup>1,2,3</sup> , 坂口 潤将 <sup>1,2,3</sup> , 宇都宮 聖子 <sup>2</sup> , 山 本 喜久 <sup>1,2,3,4</sup>	1.東大情理, 2.国立情報学研, 3.理研, 4.スタンフォード大	
13:30 - 13:45	14p-A11-2	蛍光共鳴エネルギー移動に基づく分子論理回路の光制御	○西村 隆宏¹, 藤井 亮¹, 小倉 裕介¹, 谷 田 純¹	1.阪大院情	
13:45 - 14:00	14p-A11-3	3波長同一パターンを生成する回折光学素子の設計	○柿内 孝介¹, 市川 裕之¹	1.愛媛大院理工	
14:00 - 14:15	14p-A11-4	全干渉型3次元イメージング分光法のにおける双曲面型体積インターフェログラムの計測の検討	○(D)橋本 哲弥¹, 小笠原 早紀¹, 平井 亜紀子², 吉森 久¹	1.岩大院工, 2.産総研	
14:15 - 14:30	14p-A11-5	統計手法を用いた高速格子パターン投影三次元計測法	○安井 裕紀¹, 吉川 宣一¹	1.埼玉大学大学院理工学研究科	

3.4 生体·医用光:	学 / Biomedica	ll optics ポスター講演		
3月12日(木)	9:30 - 11:30			
	12a-P4-1	レーザー光散乱場によるナノ粒子挙動の制御: 数値計算による特性 考察	○横井 直倫¹, 相津 佳永²	1.旭川高専, 2.室蘭工大院
	12a-P4-2	ハイパースペクトル画像を用いたヒト皮膚PSF の検討	奥塚 太一¹, 稲垣 雄太¹, 船水 英希¹, 前田 貴章², ○相津 佳永¹	1.室工大院, 2.釧路高専
	12a-P4-3	局部変化領域を有するヒト皮膚モデルにおける光線追跡計算	佐々木 瞭¹, 前田 貴章², 船水 英希¹, 西舘 泉 ³, ○相津 佳永¹	1.室工大院, 2.釧路高専, 3.東京農工大
	12a-P4-4	9層構造皮膚モデルにおける拡散反射光分布のモンテカルロ解析	吉田 貴之¹, 石山 吉紀¹, 船水 英希¹, 前田 貴章², ○相津 佳永¹	1.室工大院, 2.釧路高専
	12a-P4-5	多波長InAs量子ドットSLD光源を用いたSD-OCTによる植物サンプ ル断層画像取得	○(M2)柴田 弘¹, 保田 拓磨¹, 尾崎 信彦¹, 大河内 俊介², 池田 直榭³, 大里 啓孝³, 渡辺 英一郎³, 杉本 喜正³, 古城 健司⁴, 宮地 邦男 ⁴, Hogg Richard⁵	1.和歌山大シスエ, 2.NEC, 3.物材機構, 4.シンクランド(株), 5.シェフィールド大
	奨 12a-P4-6	波長0.8-1.9 um帯におけるOCTイメージングの波長依存性の評価	○川越 寛之¹, 山中 真仁¹, 西澤 典彦¹	1.名大院工
	12a-P4-7	iPS細胞の多能性評価に向けた非線形分光イメージング	○(M1C)米山 弘亮¹, 瀬川 尋貴², 西村 健³, 福田 綾³, 久武 幸司³, 加納 英明¹	1.筑波大·数理, 2.東大院·理, 3.筑波 大·医
	12a-P4-8	生体親和性酸化亜鉛微粒子への金担持と光学特性2	○藤井 政俊¹, 橋本 英樹², 藤田 恭久³	1.島根大医, 2.島根大戦略研究推進セ, 3.島根大院総合理工
	12a-P4-9	蛍光顕微鏡による珪藻の被殻と細胞骨格の可視化	○堀内 友貴¹, 堀田 純一¹	1.山形大院理工

4 生体・医用光	学 / Biomedic	al optics      口頭講演		
3月14日(土	9:30 - 11:4	5		
9:30 - 9:45	14a-A10-1	差分計測を利用した飽和励起顕微鏡:信号対雑音比の向上	○米丸 泰央¹, スミス ニコラス², 河田 聡¹, 藤田 克昌¹	1.阪大工, 2.阪大iFReC
9:45 - 10:00	奨 14a-A10-2	近赤外発光・カソードルミネッセンスによるマルチスケール生体観察	○(DC)福島 昌一郎,新岡 宏彦!,一宮 正義º,三宅淳!,芦田 昌明!,荒木 勉!,橋 本守!	1.阪大基, 2.滋賀県立大
10:00 - 10:15	奨 14a-A10-3	微小CL光源による非染色細胞の高分解能イメージング	○福田 真大¹, 金森 聡¹, 古川 太一², 名和靖矩³, 居波 涉³⁴, 林 升⁴, 川田 善正³⁴	1.静大院工, 2.阪大ナノサイエンスデ ザイン教育センター, 3.静大電子研, 4.JST-CREST
10:15 - 10:30	14a-A10-4	マルチモーダル多光子顕微鏡を用いたラット眼組織の分子イメージ ング	○(M1C)秋山 敏宏¹, 瀬川 尋貴², 加治 優一³, 大鹿 哲郎³, 加納 英明¹	1.筑波大·数理, 2.東大院·理, 3.筑波 大·医
10:30 - 10:45	E 14a-A10-5	Broadband noise suppression for fiber-laser-based video-rate stimulated Raman scattering spectral microscopy.	OMichio Ishikawa <sup>1</sup> , Naoki Kohara <sup>1</sup> , Yuki Yonetani <sup>1</sup> , Akira Yamamoto <sup>1</sup> , Chidane Ouchi <sup>1</sup> , Masanobu Hasegawa <sup>1</sup>	1.Canon Inc.
10:45 - 11:00	14a-A10-6	高感度・高解像フォトサーマル顕微鏡による生体組織の3次元イメ ージグ	○宮崎 淳¹, 川角 洸史¹, 小林 孝嘉¹	1.電通大先端レーザー
11:00 - 11:15	14a-A10-7	ショートマルチモードファイバープローブを用いたFFOCTの基礎特性	○関根 雄樹¹, 高橋 俊博¹, 西館 泉², 佐 藤 学¹	1.山形大, 2.東京農工大
11:15 - 11:30	14a-A10-8	プラスチック光ファイババンドルを用いた細胞の蛍光イメージング	○櫻井 孝司¹, 夏目 三男², 鯉田 孝和¹	1.豊橋技科大EIIRIS, 2.電興社
11:30 - 11:45	E 14a-A10-9	Capillary flow reactor synthesis of upconversion colloidal nano- particles	OThangaraju Dheivasigaman <sup>1</sup> , Mortier Michel <sup>2</sup> , Karthikeyan Rajan <sup>1</sup> , Prakash Natarajan <sup>1</sup> , Tadanobu Koyama <sup>1</sup> , Yasuhiro Hayakawa <sup>1</sup>	1.RIE Shizuoka Univ, 2.Chimie ParisTech
3月14日(土	) 13:00 - 14:	:30		
13:00 - 13:15	14p-A10-1	Continuous and noninvasive characterization of liquid sample based on continuous-wave photoacoustic technique: accuracy improvements with linear fitting.	OSerge Camou <sup>1</sup> , Yujiro Tanaka <sup>1</sup> , Yuichi Higuchi <sup>1</sup> , Hiroshi Koizumi <sup>1</sup>	1.Device Techn. Labs., NTT Corp
13:15 - 13:30	奨 14p-A10-2	CW光音響法を応用した非侵襲血糖モニタの高精度化に向けた2次 多項式近似アルゴリズム	○田中 雄次郎¹, 樋口 雄一¹, カム セルジュ¹	1.NTT先デ研
13:30 - 13:45	14p-A10-3	レーザー走査法による模擬血管の動態観測	○(M1)篠永 直輝¹, 岩井 俊昭¹	1.東京農工大 BASE
13:45 - 14:00	14p-A10-4	心臓拍動研究のためのインキュベーター内自動録画システム	○三井 祐司1	1.青学大理工
14:00 - 14:15	14p-A10-5	画像解析を用いた心臓組織片による拍動の伝播と同期化の研究	○(B)新井 晋¹, 高橋 伴典¹, 三井 祐司¹, 石 田 研太郎¹, 三井 敏之¹	1.青学大理工
14:15 - 14:30	14p-A10-6	心臓組織片による同期化のメカニズムの研究	〇高橋 伴典', 新井 晋', 三井 祐司', 石田 研太郎', 山崎 将吾², 金子 智行², 三井 敏之'	1.青学大, 2.法政大

3.5	3.5 レーザー装置・材料, 3.14 光制御デバイス・光ファイバーのコードシェアセッション 口頭講演						
	3月13日(金) 9:00 - 11:15						
招待	9:00 - 9:15	13a-A13-1	「講演奨励賞受賞記念講演」(15分) 中赤外(9-12µm)光渦レーザーにおける符号制御	〇堀川 マイケル知樹 <sup>1</sup> , 尾川 あずさ <sup>1</sup> , 古城 健司 <sup>1</sup> , 宮本 克彦 <sup>1</sup> , 尾松 孝茂 <sup>1,2</sup>	1.千葉大融合, 2.JST-CREST		
	9:15 - 9:30	奨·E 13a-A13-2	Widely tunable optical vortex parametric laser	○(D)ABULIKEMU AIZITIAILI¹, Taximaiti Yusufu¹², Katsuhiko Miyamoto¹, Takashige Omatsu¹.²	1.Chiba Univ, 2.JST-CREST		
	9:30 - 9:45	13a-A13-3	マイクロチップレーザー励起中赤外光パラメトリック発生の検討	○石月 秀貴¹, 平等 拓範¹	1.分子研		
	9:45 - 10:00	奨 13a-A13-4	CsLiB6O10結晶を用いた非同軸位相整合方式の高効率 355nm 紫 外光発生	○(D)曲 晨¹, 吉村 政志¹, 高橋 義典¹, 森 勇介¹	1.阪大院工		
	10:00 - 10:15	奨 13a-A13-5	金属/液体電極を用いた電圧印加によるMgO:LiNbO <sub>3</sub> 周期分極反転 構造の作製と緑色光第二高調波発生	○沖野 行佑¹, 栖原 敏明¹	1.阪大院工		
	10:15 - 10:30	奨 13a-A13-6	接合イオンスライスLiNbO、結晶におけるプロトン交換増速エッチング によるリッジ光導波路の作製	○田中 圭祐¹, 栖原 敏明¹	1.阪大院工		
	10:30 - 10:45	奨 13a-A13-7	MgO(8mol%)添加c-LiTaO <sub>3</sub> アニールプロトン交換導波路の作製	○岡 寿治¹, 栖原 敏明¹	1.阪大院工		
	10:45 - 11:00	13a-A13-8	AlGaAs/AlOx 高屈折率差U字導波路における第二高調波発生の 位相整合特性	○中村 勇貴¹, 松下 智紀¹, 近藤 高志¹	1.東大工		
	11:00 - 11:15	奨 13a-A13-9	周期空間反転AlGaAsのAs₂を用いたMBE成長	○楢崎 亮太¹, 松下 智紀¹, 近藤 高志¹	1.東大工		

3.5 レーザー装置	置・材料 / Laser	system and materials ポスター講	演	
3月12日(木	9:30 - 11:30	)		
	12a-P5-1	光アイソレーターを用いた遠赤外レーザー励起用 $\mathrm{CO}_2$ レーザーの安定化	○中山 和也¹, 岡島 茂樹¹, 秋山 毅志², 田中 謙治², 川端 一男²	1.中部大工, 2.核融合研
	12a-P5-2	青色InGaN半導体レーザ励起可視受動モード同期Pr:YLFレーザ	○狩山 了介¹, 田中 裕樹¹, 飯島 功大¹, 神成 文彦¹	1.慶大理工
	12a-P5-3	高出力バルス動作Ybファイバーレーザーシステムの開発(7)	○吉田 英次!, 山村 健 <sup>24</sup> , 椿本 孝治!, 藤田 尚徳!, 宮永 憲明!, 塚本 雅裕3, 酒川 友一 <sup>24</sup> , ハイク コスロービアン <sup>25</sup> , 谷口 誠治 <sup>25</sup> , 藤田 雅之 <sup>25</sup> , 井澤 靖和 <sup>25</sup>	1.阪大レーザー研, 2.ALPROT, 3.阪大接合研, 4.片岡製作所, 5.レーザー総研
	12a-P5-4	重力波検出器KAGRAの発振周波数安定化レーザーシステム	○土井 康平¹, KAGRA コラボレーション	, 1.東大
	12a-P5-5	放電の空間的制御を用いた高繰り返し軸方向放電励起N <sub>2</sub> レーザー	○市來 秀平', 對馬 弘明', 宇野 和行', 秋津哲也', 實野 孝久²	1.山梨大工, 2.阪大レーザー研
	E 12a-P5-6	Tiled Aperture Coherent Combining of Multiple Beams using Bernoulli Algorithm	○Haik Chosrowjan¹, Toshiyuki Kitamura², Mitsuru Musha², Masayuki Fujita¹, Yasu- kazu Izawa¹	1.ILT, 2.Inst. for Laser Science, Univ. of Electro-Commun.
	12a-P5-7	太陽光励起用Ce/Cr/Nd:YAGセラミックレーザーにおけるNdイオン蛍 光寿命の温度依存特性	○(M1)中町 崇人¹, 佐伯 拓¹, 林 考則¹, 藤 岡 加奈², 古瀬 裕章³, 本田 能之², 本越 伸 二⁴, 藤本 靖², 中塚 正大²⁴, 飯田 幸雄¹	1.関西大学システム理工, 2.大阪大学レーザーエネルギー学研究センター, 3.北 見工業大学, 4.レーザー技術総合研究所

3月13日(金	16:30 - 18	:45		
16:30 - 16:45	奨 13p-A13-1	高速スキャナーを用いた利得分布制御による高次Laguerre-Gaussモードビームの直接発振	○佐藤 拓海¹, 小澤 祐市¹, 佐藤 俊一¹	1.東北大工
16:45 - 17:00	13p-A13-2	金リングバターンを持つNd:YVO <sub>4</sub> レーザー結晶の熱レンズ効果の 検討	○角 剛¹, 小澤 祐市¹, 佐藤 俊一¹	1.東北大多元研
17:00 - 17:15	13p-A13-3	安定な光混合を目的としたビコ秒バルス光源の開発	○山垣 美恵子¹, 奥山 大輔¹, 澤田 久¹, 折井 庸亮¹, 岡田 穣治¹	1.スペクトロニクス
17:15 - 17:30	奨 13p-A13-4	1 $\mu$ m帯利得スイッチング半導体レーザビコ秒光パルスの光増幅における自然放出光ノイズの入力光パワー依存性	○茶木 智大 <sup>1,2</sup> , 草間 裕太 <sup>2</sup> , 房 宜澂 <sup>1,2</sup> , 山田博仁 <sup>1,2</sup> , 横山 弘之 <sup>1,2</sup>	1.東北大院工, 2.東北大未来研
17:30 - 17:45	E 13p-A13-5	Multi-hundreds-kW-peak-power picosecond-light-pulse source based on a 1060-nm-band gain-switched laser diode	○(D)YICHENG FANG <sup>1,2</sup> , Tomohiro Cha- ki <sup>1,2</sup> , Kusama Yuta <sup>1</sup> , Hirohito Yamada <sup>1,2</sup> , Hiroyuki Yokoyama <sup>1,2</sup>	1.NICHe, Tohoku Univ., 2.Grad. of Eng., Tohoku Univ.
17:45 - 18:00	13p-A13-6	利得スイッチング半導体レーザに基づく同期制御2波長パルス光源	○草間 裕太¹, 房 宜澂¹, 根本 知己², 横山 弘之¹	1.東北大 未来研, 2.北海道大 電子
18:00 - 18:15	13p-A13-7	1.1μm帯量子ドット波長可変レーザの開発	○山野井 俊雄¹, 友松 泰則¹, 遠藤 尚¹, 山本直克², 赤羽 浩一², 川西 哲也²	1.光伸光学工業(株), 2.情報通信码 究機構
18:15 - 18:30	13p-A13-8	波長可変LDの線輻狭窄化に向けた検討	○原口 英介¹, 望月 敬太¹, 上野 雄鋭¹, 長谷川 清智¹, 安藤 俊行¹	1.三菱電機(株)
18:30 - 18:45	13p-A13-9	$1 \mu m$ 帯における広帯域テーパーアンプの開発	○(M1)丸茂 大樹¹	1.千葉大院理
3月14日(土	9:30 - 12:0	00		
9:30 - 9:45	奨 14a-A13-1	共振器内高次高調波発生のためのリング型共振器Yb:YAG Thin Diskモード同期レーザー	○神田 夏輝 <sup>12</sup> , アマニ イランル <sup>1</sup> , 今鉾 友 洋 <sup>3</sup> , 住吉 哲実 <sup>3</sup> , 鍋川 康夫 <sup>1</sup> , 五神 真 <sup>2,4</sup> , 緑 川 克美 <sup>1,4</sup>	1.理研, 2.東大光量子, 3.サイバー1 ー, 4.東大フォトンサイエンス機構
9:45 - 10:00	奨 14a-A13-2	二周波数注入同期連続発振Ti: Sapphireレーザーの出力安定化	○(M1)吉崎 諒¹, Gavara Trivikramarao¹, 藤 村 祐希¹, 桂川 眞幸¹	1.電通大先進理工
10:00 - 10:15	14a-A13-3	LD直接励起モード同期Cr+:YAG単結晶ファイバーレーザー	○石橋 茂雄¹	1.NTT先端集積デバイス研究所
10:15 - 10:30	奨 14a-A13-4	サファイアエンドキャップNd:YVO <sub>4</sub> スラブバウンス増幅器を用いた 高 効率・高出力ピコ秒レーザー	○鴻和 真弥¹, 阿部 将士¹, 宮本 克彦¹, 尾 松 孝茂¹.²	1.千葉大融合, 2.JST CREST
10:30 - 10:45	奨 14a-A13-5	青色InGaN 半導体レーザ 励起高出力Pr³:YLF レーザ及び受動Q スイッチ動作	○飯島 功大¹, 狩山 了介¹, 田中 裕樹¹, 神成 文彦¹	1.慶大理工
10:45 - 11:00	奨 14a-A13-6	緑色InGaN半導体レーザ2台励起モード同期Ti:sapphireレーザ	○澤田 亮太¹, 田中 裕樹¹, 狩山 了介¹, 神成 文彦¹	1.慶大理工
11:00 - 11:15	14a-A13-7	GaN Blue LD励起 Pr³+YLF Laserの赤色2W連続発振	○川瀬 宏海¹, 大内 幹夫¹, 折井 庸亮²	1.東京電機大, 2.スペクトロニクス
11:15 - 11:30	14a-A13-8	常温接合を用いたNd:YAG/ダイヤモンド複合構造レーザーの発振 特性	○奥山 洋平¹, 山内 太貴¹, 恩田 友美¹, 庄司 一郎¹	1.中大理工
11:30 - 11:45	14a-A13-9	レーザーグレードYb:FAP異方性セラミックスにおける光増輻特性の 確認	○佐藤 庸一¹, 秋山 順¹, 平等 拓範¹	1.分子研

11:45 - 12:00	14a-A13-10	Sn <sup>2+</sup> 添加リン酸塩ガラス及びホウ酸塩ガラスの可視蛍光飽和特性	○川本 拓也1.3, 時田 茂樹1, 正井 博和2, 田	1.阪大レーザー研, 2.京大化研, 3.摂
			口 俊弘3, 河仲 準二1	南大理工

0 1	4		trashort-pulse and high-intensity lasers	口頭講演	
	3月12日(木)	9:45 - 12:30			
	9:45 - 10:00	12a-A15-1	フッ化物多層膜鏡による受動共振器利用VUV 高調波のアウトブットカップリング	和久井 健太郎¹, 早坂 和弘¹, ○井戸 哲也¹	1.情通機構
	10:00 - 10:15	12a-A15-2	ブラズマミラーを用いた周波数分解光ゲート法による真空紫外波形 計測	○板倉 隆二¹, 熊田 高之¹, 中野 元善¹, 赤木 浩¹	1.原子力機構・関西研
	10:15 - 10:30	12a-A15-3	多光子イオン化質量分析における深紫外フェムト秒光パルス幅のオンサイト簡易測定	○今坂 智子¹, 濱地 彬文², 奥野 智也², 今 坂 藤太郎².3	1.九大院芸工, 2.九大院工, 3.九大未 来化セ
	10:30 - 10:45	12a-A15-4	ガス媒質中でのフィラメンテーションを利用した可視域 6.5 フェムト 秒バルスの発生	○金島 圭佑¹, 石井 順久¹, 板谷 治郎¹	1.東大物性研
	10:45 - 11:00	12a-A15-5	BIBO-OPCPAによるサブ2サイクルミリジュール赤外バルス発生	〇石井 順久¹, 金島 圭佑¹, 金井 輝人¹, 渡部 俊太郎², 板谷 治郎¹	1.東大物性研, 2.東理大
	11:00 - 11:15		休憩/Break		
寺	11:15 - 11:30	12a-A15-6	「光・フォトニクス 分科内招待講演」(15分) 12 GHzフェムト秒モード同期レーザーを用いた光パルスフーリエ 合成	O(D)遠藤 護 <sup>1,2</sup> , 谷 峻太郎 <sup>1,2</sup> , 小林 洋平 <sup>1,2</sup>	1.東大物性研, 2.JST ERATO
	11:30 - 11:45	12a-A15-7	広帯域フェムト秒レーザを用いたType-I差周波混合中赤外バルス 波形整形	○(M1)伊佐 文宏¹, 藤井 令央¹, 鈴木 敬和¹, 廣澤 賢一¹, 神成 文彦¹	1.慶大理工
	11:45 - 12:00	12a-A15-8	全ファイバー型自己相似 Er ファイバー増幅システムによる 41 fs バルス発生	○吉富 大¹, 鳥塚 健二¹	1.産総研
	12:00 - 12:15	12a-A15-9	共振器内フィルタを有する高速波長可変ピコ秒モード同期ファイバ レーザ	○(B)田代 大悟¹, 小関 泰之¹	1.東大工
	12:15 - 12:30	12a-A15-10	1.06-µm帯利得スイッチング駆動DFB-LD光バルスのジッタ低減の 検討	○(M1)徳永 京也¹, 房 宜澂², 草間 裕太², 横山 弘之², 小関 泰之¹	1.東大院工, 2.東北大NICHe
	3月12日(木)	14:00 - 17:4			
	14:00 - 14:15	奨 12p-A15-1	バルス捕捉現象による非線形光ルーブミラーを用いた全光サンブリ ング	○白木 英二¹, 西澤 典彦²	1.岐阜高専, 2.名大
	14:15 - 14:30	奨 12p-A15-2	非線形偏波回転とカーボンナノチューブフィルムを用いたハイブリッド モード同期Er添加ファイバーレーザーの特性評価	○(M1)野々部 和樹¹, 金 磊¹, 榊原 陽一², 面 田 恵美子², 片浦 弘道², 西澤 典彦¹	1.名大院工, 2.産総研
	14:30 - 14:45	12p-A15-3	光制御型光コム	<ul> <li>○稲場 肇¹, 大久保 章¹, シュラム マルテ¹,</li> <li>郡司 謙汰¹², 洪 鋒雷³, 保坂 一元¹, 大苗 敦¹</li> </ul>	1.産総研, 2.筑波大, 3.横国大
	14:45 - 15:00	奨 12p-A15-4	2f-3f自己参照干渉計によるCEO周波数の安定性評価	〇日達 研一¹, 石澤 淳¹, 忠永 修², 增子 拓紀¹, 西川 正³, 寒川 哲臣¹, 後藤 秀樹¹	1.NTT物性研, 2.NTT先デ研, 3.東 電機大
	15:00 - 15:15	12p-A15-5	トロイド共振器において発生した光カーコムの時間波形測定及び 雑音評価	○岡部 悠介¹, 鈴木 良¹, 陳 哲倫¹, 長野 拓 真¹, 小畠 知也¹, 田邉 孝純¹	1.慶大理工
	15:15 - 15:30	奨 12p-A15-6	シミラリトン増幅器によるオクタープスパンスーパーコンティニューム光 のコヒーレンス性の評価	○(M1)野村 佳孝¹, 榊原 陽一², 面田 恵美子², 片浦 弘道², 西澤 典彦¹	1.名大院工, 2.産総研
	15:30 - 15:45	12p-A15-7	オンチップスーパーコンティニューム光スペクトルとシリコン導波路人 射パルス波形の関係	○(M1)後藤 貴大 <sup>1,2</sup> , 石澤 淳¹, 高 磊³-4, 土澤 秦³-4, 松田 信幸 <sup>1,3</sup> , 日達 研一·, 西川 正², 山 田 浩治³-4, 寒川 哲臣¹, 後藤 秀樹¹	1.NTT物性研, 2.東京電機大, 3.NT NPC, 4.NTT先デ研
	15:45 - 16:00		休憩/Break		
	16:00 - 16:15	12p-A15-8	IRドップラー観測用光周波数コムの広帯域化	○森 貴宏¹, 奥山 康志¹, 柏木 謙¹, 田中 洋 介¹, 黒川 隆志¹², 小谷 隆行², 西川 淳², 田 村 元秀²³	1.東京農工大, 2.国立天文台, 3.東大
	16:15 - 16:30	12p-A15-9	電気光学変調器ベース光周波数コムを用いた低位相雑音ミリ波発生	〇石澤 淳¹, 西川 正², 後藤 貴大¹², 日達 研一¹, 寒川 哲臣¹, 後藤 秀樹¹	1.NTT物性研, 2.東京電機大
	16:30 - 16:45	奨 12p-A15-10	気体中高強度サブサイクル光バルス発生	○貴田 祐一郎¹, 今坂 藤太郎¹²	1.九大院工, 2.九大未来化セ
	16:45 - 17:00	奨 12p-A15-11	チャーブバルスアップコンバージョンを用いた中赤外領域の時間分 解分光	○(B)畑 秀文¹², 中村 亮介¹, 濱田 格雄¹, 神村 共住²	1.阪大, 2.大工大
	17:00 - 17:15	奨 12p-A15-12	コヒーレント結合系を用いて生成された超短径偏光バルスの拡張スト ークスパラメータによる定量的解析	○(DC)鈴木 雅人¹, 山根 啓作¹², 岡 和彦¹, 戸田 泰則¹², 森田 隆二¹²	1.北大院工, 2.JST CREST
	17:15 - 17:30	12p-A15-13	軸対称偏光ビームの空間位相解析	〇山根 啓作 <sup>1.2</sup> , 横瀬 尚也 <sup>1</sup> , 鈴木 雅人 <sup>1</sup> , 戸 田 泰則 <sup>1.2</sup> , 森田 隆二 <sup>1.2</sup>	1.北大工, 2.JST-CREST
	17:30 - 17:45	12p-A15-14	光電場再生に基づいた光渦のラゲールガウスモード展開	○山根 啓作 <sup>1,2</sup> , 中嶌 奨太 <sup>1</sup> , 鈴木 雅人 <sup>1</sup> , 戸 田 泰則 <sup>1,2</sup> , 森田 隆二 <sup>1,2</sup>	1.北大工, 2.JST-CREST
	3月13日(金)	16:30 - 19:0	00	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
	16:30 - 16:45	13p-A15-1	X線+近赤外2色レーザー励起による共鳴オージェ過程の光学制御	Chatterjee Souvik¹, ○中嶋 隆¹	1.京大エネ研
	16:45 - 17:00	13p-A15-2	1,2-ブタジエンにおける超高速緩和ダイナミクスの研究	○(M1)飯窪 亮¹, 藤原 丈久¹, 関川 太郎¹, 原渕 祐², 武次 徹也², 萱沼 洋輔³	1.北大院工, 2.北大院理, 3.東工大応 セラ研
	17:00 - 17:15	13p-A15-3	シクロヘキサジエン開環反応における基底状態生成物の観測	○足立 俊輔1.2, 佐藤 元樹1, 鈴木 俊法1.2	1.京大理, 2.理研
	17:15 - 17:30	13p-A15-4	90nm真空紫外パルスによる液体の超高速光電子分光	佐藤 元樹 <sup>1</sup> , ○足立 俊輔 <sup>1,2</sup> , 鈴木 俊法 <sup>1,2</sup>	1.京大理, 2.理研
	17:30 - 17:45	13p-A15-5	レーザーによる固体電子励起過程のためのKeldysh理論の再構築	〇乙部 智仁¹, 篠原 康², 佐藤 駿丞³, 矢 花 一浩³	1.原子力機構, 2.マックスプランク, 3. 波大
	17:45 - 18:00		休憩/Break		
	18:00 - 18:15	13p-A15-6	カルコゲナイド半導体薄膜の超高速相変化ダイナミクス	大庭 航¹, 片山 郁文¹, 南 康夫¹, 桑原 正史², 斎木 敏治³, ○武田 淳¹	1.横浜国大院工, 2.産総研, 3.慶大理
	18:15 - 18:30	13p-A15-7	アルカンチオール鎖の銀ナノ粒子吸着状態のコヒーレント超高速振動分光	○首藤 健一¹, 杉山 夏輝¹, 片山 郁文¹, 北島 正弘¹.²³, 武田 淳¹	1.横浜国立大学, 2.株式会社ルクスレイ, 3.防衛大
	18:30 - 18:45	13p-A15-8	ッカル 波形整形中赤外パルスによる反応制御に向けた試み:K <sub>2</sub> [RuCl <sub>5</sub> (NO)] 重水溶液のNO伸縮振動ラダークライミング		1.東大生研
	18:45 - 19:00	13p-A15-9	波形整形中赤外パルスによる液相分子の2振動自由度コヒーレン	○若林 直樹¹, 田山 純平², 芦原 聡²	1.農工大工, 2.東大生研

3.6 超高速・高強度レーザー / Ultrashort-pulse and high-intensity lasers ポスター講演					
3月13日(金	9:30 - 11:30	)			
	13a-P5-1	正常分散型モード同期Ybファイバーレーザーの開発とその動作解析	○山中 紀幸¹, 芦原 聡²	1.農工大工, 2.東大生研	

3.6	超高速・高強	度レーザー / し	Ultrashort-pulse and high-intensity lasers	口頭講演	
	3月14日(土	) 9:15 - 12:0	0		
	9:15 - 9:30	E 14a-A15-1	Scalings of High-Order Harmonics from Relativistic Electron Spikes	OAlexander Pirozhkov¹, Masaki Kando¹, Timur Esirkepov¹, Tatiana Pikuz², Anatoly Faenov², Koichi Ogura¹, Yukio Hayashi¹, Hideyuki Kotaki¹, Eugene Ragozin³, David Neely¹, Hiromitsu Kiriyama¹, Manabu Tanoue¹, Yoshiki Nakai¹, Masahiro Okamoto¹, Kazuhiro Torimoto¹, Shuji Kondo¹, Shuhei Kanazawa¹, James Koga¹, Yuji Fukuda¹, Masaharu Nishikino¹, Takashi Imazono¹, Noboru Hasegawa¹, Tetsuya Kawachi¹, Hiroyuki Daido¹, Yoshiaki Kato⁵, Sergei Bulanov¹, Kiminori Kondo¹	1.JAEA, 2.Osaka Univ., 3.Lebedev Phys. Inst., 4.CLF RAL, 5.GPI
	9:30 - 9:45	14a-A15-2	レーザー駆動イオン加速のための水素クラスターターゲットの生成と その評価	○神野 智史¹, 田中 宏尭²³, 金崎 真聡³, 榊 泰直³, 近藤 公伯³, 松井 隆太郎³⁴, 岸本 泰 明⁴, 福田 祐仁²³	1.東大院工, 2.九大総理工, 3.原子力機 構関西, 4.京大エネ科
	9:45 - 10:00	奨 14a-A15-3	クラスターターゲットを用いたレーザー駆動イオン加速における背景 ガスイオンの加速	○金崎 真聡', 神野 智史', 榊 泰直', Faenov A. Ya.¹, Pikuz T. A.¹, 西內 満美子', 桐山 博光', 神門 正城, 近藤 公伯', 松井 隆太 郎², Scullion C.³, Smyth A. G.³, Aaron A.³, Doria D.³, Borghesi M.³, 小田 啓二⁴, 山内 知也⁴, 岸本 泰明², 福田 祐仁¹	1.原子力機構関西研, 2.京大エネ科, 3.QUB, 4.神大院海事
	10:00 - 10:15	奨 14a-A15-4	配列した二酸化炭素分子から発生する高次高調波強度の楕円率 依存性	○(M2)中川 桂¹, 峰本 紳一郎¹, 酒井 広文¹	1.東大院理
	10:15 - 10:30	奨 14a-A15-5	硫化カルボニル分子の多チャンネル解離性イオン化における角度 依存性	○酒見 悠介¹, 峰本 紳一郎¹, 長野 晃士¹, 酒井 広文¹	1.東大院理
	10:30 - 10:45	奨 14a-A15-6	状態選別した分子のフィールドフリーな配列および配向制御	○文 堤會¹, 夏 沛宇¹, 峰本 紳一郎¹, 酒 井 広文¹	1.東大院理
	10:45 - 11:00		休憩/Break		
招待	11:00 - 11:15	14a-A15-7	「講演奨励賞受賞記念講演」(15分) フェムト秒時間分解電子線回折法の開発:トポロジカル絶縁体の光 誘起構造ダイナミクスの観測	〇羽田 真毅 <sup>1,2</sup> ,則松 桂 <sup>1,3</sup> ,田中 誠一 <sup>4</sup> , Keskin Sercan <sup>5</sup> , 鶴田 哲也 <sup>1,3</sup> ,五十嵐 九 四郎 <sup>1</sup> ,石川 忠彦 <sup>4</sup> , 萱沼 洋輔 <sup>1,3</sup> , Miller R. J. Dwayne <sup>5,6</sup> ,笹川 崇男 <sup>1</sup> ,恩田 健 <sup>2,4</sup> ,腰原 伸 也 <sup>3,4</sup> ,中村 一隆 <sup>1,3</sup>	1.東工大応セラ研, 2.JST-さきがけ, 3.JST-CREST, 4.東工大理工, 5.マックス・プランク研, 6.トロント大
	11:15 - 11:30	奨 14a-A15-8	トポロジカル絶縁体Bi <sub>2</sub> Te <sub>3</sub> の光励起電子・格子ダイナミクス	○則松 桂 <sup>1,2,3,4</sup> 、羽田 真毅 <sup>1,5</sup> 、鶴田 哲也 <sup>1,3,4</sup> 、 五十嵐 九四郎 <sup>1,3</sup> ,田中 誠一 <sup>6</sup> ,恩田 健 <sup>5,6</sup> ,笹 川 崇男 <sup>1,3</sup> ,中村 一隆 <sup>1,3,5</sup>	1.東工大応セラ研, 2.JSPS, 3.東工大総理工, 4.JST-CREST, 5.JST-さきがけ, 6.東工大理工
	11:30 - 11:45	奨 14a-A15-9	広帯域線形周波数チャーブバルスを用いた全光学超高速イメージング	○(B)鈴木 敬和', 藤井 令央', 伊佐 文宏', 廣澤 賢一', 神成 文彦'	1.慶大理工
	11:45 - 12:00	奨 14a-A15-10	気体を用いたチャーブバルス上方変換による中赤外ポンプ・プロー ブ分光	○(PC)白井 英登¹, 葉 恬恬², 野村 雄高¹, 羅 志偉², 藤 貴夫¹	1.分子研, 2.台湾交通大
	3月14日(土	) 13:00 - 15:	00		
招待	13:00 - 13:30	14p-A15-1	「第16回光・量子エレクトロニクス業績賞(宅間宏賞)受賞記念講演」(30分) コンパクトSASE型X線自由電子レーザーSACLA	〇石川 哲也 <sup>1</sup> , 新竹 積 <sup>2</sup> , 北村 英男 <sup>1</sup>	1.理化学研究所, 2.沖縄科技大
	13:30 - 13:45	14p-A15-2	単一アト秒バルス用回折限界集光システムの開発	澤田 和寬'², 森 哲³, 田丸 裕基'⁴, 豊田 光 紀³, ○高橋 栄治', 神成 文彦², 須田 亮¹, 緑 川 克美¹, 柳原 美廣³	1.理研, 2.慶応大, 3.東北大多元研, 4.東京理科大
	13:45 - 14:00	14p-A15-3	アト秒バルス列によって生成された振動波束の非自明な位相変調	○鍋川 康夫¹, 古川 裕介¹, 沖野 友哉¹, アマニ イランル¹, 高橋 栄治¹, 山内 薫², 緑川 克美¹	1.理研光量子, 2.東大院理
	14:00 - 14:15	14p-A15-4	高強度レーザー中の多電子ダイナミクス: 時間依存・多配置自己無撞 着場法の原子のための実装	○佐藤 健¹, 石川 顕一¹	1.東大院工
	14:15 - 14:30	14p-A15-5	Multi Resolution TDSE / MCTDHFの開発	○澤田 亮人¹, 佐藤 健¹, 石川 顕一¹	1.東大院工
	14:30 - 14:45	E 14p-A15-6	Time-Dependent Multiconfiguration Study of High Harmonic Generation from Multielectron Atoms	○(M2)Iliya Tikhomirov¹, Takeshi Sato¹, Ryohto Sawada¹, Kenichi Ishikawa¹	1.University of Tokyo
	14:45 - 15:00	14p-A15-7	シリコンのコヒーレントフォノンの発生起源に関する実験的考察	○加藤 景子¹, 小栗 克弥¹, 後藤 秀樹¹	1.NTT物性研

レーザープロ	1セシング / L	aser processing        口頭講演		
3月11日(水	9:30 - 12	:30		
9:30 - 9:45	11a-A11-1	プラズモン援用フェムト秒レーザナノ還元の偏波依存性制御	○西山 宏昭¹, 大関 透典¹	1.山形大院理工
9:45 - 10:00	11a-A11-2	汎用グリーンレーザーを用いた紫外透過性フッ素ポリマーの微細加 工技術開発	○(B)小川 達也¹, 及川 良太¹, 花田 修賢¹²	1.弘前大学, 2.理研
10:00 - 10:15	11a-A11-3	短バルスレーザーを利用した材料表面改質による水素吸蔵合金の 吸蔵能変化	○阿部 浩之¹, 德平 真之介², 下村 柘也³, 島田 幸洋³, 竹仲 祐介³, 古山 雄太³, 西村 昭彦³, 大道 博行³, 内田 裕久², 大島 武¹	1.原子力機構量子ビーム, 2.東海大学 応理, 3.原子力機構レーザー共研
10:15 - 10:30	11a-A11-4	時間分解反射率の振動から探る高分子材料のフェムト秒レーザーア ブレーションにおける非熱効果の研究	○熊田 高之¹, 赤木 浩¹, 板倉 隆二¹, 乙部智仁¹, 横山 淳¹	1.原子力機構関西
10:30 - 10:45	11a-A11-5	第一原理計算によるレーザー損傷閾値及び深さの解析	○佐藤 駿丞¹, 矢花 一浩¹, 篠原 康², 乙部 智仁³, 李 畊旻⁴, G.F. Bertsch⁵	1.筑波大, 2.Max-Planck Inst., 3.JAI 関西, 4.韓国CoReLS, 5.ワシントン大
10:45 - 11:00	11a-A11-6	イットリア安定化ジルコニア表面への短バルスレーザー誘起周期的 構造形成	○欠端 雅之¹, 屋代 英彦¹, 大矢根 綾子², 伊藤 敦夫³, 鳥塚 健二¹	1.産総研 電子光技術, 2.産総研 ナノ システム, 3.産総研 ヒューマンライフ クノロジー
11:00 - 11:15		休憩/Break		
11:15 - 11:30	11a-A11-7	シリコン表面におけるフェムト秒レーザサブミクロン加工形状へのリッ ブル形成の影響	○八木 隆志¹, 菅原 諒¹, 曽根 有紀¹, 関口 翔大¹, 門井 慎¹, 林 竜生¹	1.東海大理

	11:30 - 11:45	11a-A11-8	ラジアルおよびアジミューサル偏光ベッセルビームによるSiおよびAlの 微細加工パターン形成メカニズムの研究	○八木 隆志¹, 関口 翔大¹, 曽根 有紀¹, 菅原 諒¹, 北原 俊一¹, 鈴木 貴士¹, 牧野 渉¹	1.東海大理
	11:45 - 12:00	11a-A11-9	四角穴加工のための分割構造複屈折素子	○菊池 弘¹, 安西 雄祐¹, 水谷 彰夫¹, 菊田 久雄¹, 平井 義彦¹, 川田 博昭¹	1.大阪府立大院工
	12:00 - 12:15	11a-A11-10	大規模並列フェムト秒レーザー加工	○長谷川 智士¹, 早崎 芳夫¹	1.宇都宮大オプティクス
	12:15 - 12:30	11a-A11-11	多点同時フェムト秒レーザー照射による単結晶内部の過渡応力分布	○坂倉 政明¹, 岡田 拓郎², 福田 直晃¹, 下間	1.京大産連本部, 2.京大工, 3.京大院工
	3月11日(水)	14:00 - 18:0	の変調と亀裂進展への影響	靖彦³, 三浦 清貴³	
+刀(土				〇松士 #1 四廿 立禾1 工服 健一1 深目	1 六十 10 丁
加切	14:00 - 14:15	11p-A11-1	「講演奨励賞受賞記念講演」(15分) 水中レーザー誘起プレークダウン分光法における蒸発速度差を考慮 した組成比の補正	○松本 歩 <sup>1</sup> , 田村 文香 <sup>1</sup> , 天野 健一 <sup>1</sup> , 深見 一 弘 <sup>1</sup> , 西 直哉 <sup>1</sup> , 作花 哲夫 <sup>1</sup>	1.永入阮工
	14:15 - 14:30	奨 11p-A11-2	レーザー駆動EUV光による物質アプレーションにおけるイオン膨張 に関する研究	○出口 亮¹, 田中 のぞみ², 増田 将也¹, 砂原 淳², 村上 匡且¹, 余語 覚文¹, 西村 博明¹	1.阪大レーザー研, 2.レーザー総研
	14:30 - 14:45	奨 11p-A11-3	フェムト秒パルスレーザーが誘起する気泡生成過程の高時間分解 計測	○(DC)水嶋 祐基¹, 齋藤 隆之²	1.静大創科院, 2.静大グリーン研
	14:45 - 15:00	奨 11p-A11-4	フェムト秒レーザー誘起衝撃力が微小物体に及ぼす作用ダイナミク スの定式化	○(M1)山川 健¹, 丸山 彰大¹, 飯野 敬矩¹, 細川 陽一郎¹	1.奈良先端大物質
	15:00 - 15:15	奨 11p-A11-5	フェムト秒レーザー照射による周期的微細構造形成がチタン基板上の 細胞伸展に与える効果	○河 拓弥¹, 塚本 雅裕², 篠永 東吾², 原 一之¹, 宮川 和也¹, 徐 賢先³, 陳 鵬⁴, 永井 亜 希子⁴, 塙 隆夫⁴	1.阪大院工, 2.阪大接合研, 3.阪大工, 4.東医歯大生材工研
	15:15 - 15:30		休憩/Break		
	15:30 - 15:45	奨 11p-A11-6	フェムト秒レーザ直接還元描画法におけるCuOナノ粒子の還元特性評価	○溝尻 瑞枝¹, 荒金 駿¹, 櫻井 淳平¹, 秦 誠一¹	1.名大院工
	15:45 - 16:00	奨 11p-A11-7	フェムト秒レーザーアブレーションにおけるタングステン剥離薄膜形状 の局所強度依存性	○井筒 類¹, 江山 剛史¹, 柿本 直也¹, 富田 卓朗¹, 長谷川 登², 錦野 将元², 南 康夫³, 馬 場 基芳³, 河内 哲哉², 山極 満², 未元 徹²	1.徳島大院ソシオ, 2.原子力機構関西研3.東大物性研
	16:00 - 16:15	奨 11p-A11-8	$\mathrm{CO}_2$ レーザーによる熱的効果を付与したガラス内部への超短光パルスマイクロ加工	○浅田 拓斗¹, 玉木 隆幸¹	1.奈良高専
	16:15 - 16:30	奨 11p-A11-9	ナノ秒レーザーを用いたCFRPの切断加工と熱的影響領域の雰囲気 ガス依存性I	○松岡 史浩¹, 塚本 雅裕², 山下 顕資³, 佐藤雄二², 升野 振一郎², 高橋 謙次郎²	1.阪大院工, 2.阪大接合研, 3.阪大工学
	16:30 - 16:45	奨 11p-A11-10	液中レーザー溶融法生成粒子に及ぼすバルス波形の影響	○榊 祥太¹, 越崎 直人¹, 池上 浩², 辻 剛志 ³, 石川 善恵⁴	1.北大工, 2.九大工, 3.島根大工, 4.産 総研
	16:45 - 17:00		休憩/Break		
	17:00 - 17:15	奨 11p-A11-11	垂直配向ZnOナノウォールアレイの作製とランダムレージング	○(M1)高橋 将大¹, 原田 浩輔², 中尾 しほみ¹, 東畠 三洋¹, 池上 浩¹, 中村 大輔¹, 中田 芳樹², 岡田 龍雄¹	1.九大大学院 シス情, 2.阪大 レーザー研
	17:15 - 17:30	奨 11p-A11-12	大気中レーザーアブレーションによるドープZnOマイクロスフィアの 作製	○(M1)田中 稔伸¹, 永嵜 史明¹, 藤原 優輝¹, 東畠 三洋¹, 中村 大輔¹, 岡田 龍雄¹	1.九大シス情
	17:30 - 17:45	奨 11p-A11-13	光励起ZnOマイクロ球の紫外レーザー発振における周囲媒質の影響	○植山 健史¹, 佐藤 雄太¹, 東畠 三洋¹, 中村 大輔¹, 池上 浩¹, 岡田 龍雄¹	1.九大シス情
	17:45 - 18:00	奨 11p-A11-14	ZnOバッファ層の四光東干渉UVレーザー照射によるパターン加工と ZnO微小結晶の作製	○(DC)下垣 哲也', 川原 裕貴', 中尾 しほみ', 東畠 三洋', 池上 浩', 中村 大輔', 中田 芳樹', 岡田 龍雄'	1.九州大学, 2.大阪大学
	3月12日(木)	9:30 - 11:30			
	9:30 - 9:45	12a-A11-1	窒化チタン粉末を用いた液中レーザー溶融法による球状粒子の作製	○川添 晃佑¹, 石川 善恵², 越崎 直人³, 矢野哲司⁴, 小田原 修¹, 和田 裕之¹	1.東工大院総理工, 2.産総研, 3.北大院 工, 4.東工大院理工
	9:45 - 10:00	12a-A11-2	液中レーザーアプレーションによる金属微粒子生成ダイナミクスの高 速度レーザーストロボビデオ撮影: 気泡内部観察の試み	○勝部 孝行¹, 倉田 修吾¹, 田辺 里枝¹, 伊藤 義郎¹	1.長岡技大機械
	10:00 - 10:15	12a-A11-3	各種材料におけるフェムト秒レーザーの透過特性	○佐野 秀¹, 橋新 裕一¹²	1.近大理工, 2.近大院総理研
	10:15 - 10:30		休憩/Break		
	10:30 - 10:45	12a-A11-4	フェムト秒レーザーを用いた植物単細胞への巨大分子の導入	○(M1)片桐 大輔¹, 坂口 さやか¹, 米田 新², 出村 拓², 細川 陽一郎¹	1.奈良先端大物質創成, 2.奈良先端 大バイオ
	10:45 - 11:00	12a-A11-5	フェムト秒レーザー衝撃力と原子間力顕微鏡による疑似細胞組織の 振動解析	○(M1)宮本 敏男¹, 福嶋 亮介¹, 飯野 敬矩¹, 藪 浩², 細川 陽一郎¹	1.奈良先端大物質, 2.東北大多元研
招待	11:00 - 11:30	E 12a-A11-6	[Invited lecture of overseas researcher] (30min.) Intracellular molecular manipulation by femtosecond laser triggering	OHe Hao¹	1.Shanghai Jiaotong University
	3月13日(金)	9:30 - 12:30	)		
	9:30 - 9:45	13a-A11-1	高圧ガス中レーザー蒸発法によるスズ/炭素コアシェルナノワイヤー の形成	○冨田 裕誉¹, 小塩 明¹, 小海 文夫¹	1.三重大院工
	9:45 - 10:00	13a-A11-2	高圧ガス中レーザー蒸発法による酸化ケイ素ナノワイヤー形成と直 径制御	○澤田 直樹¹, 小塩 明¹, 小海 文夫¹	1.三重大院工
	10:00 - 10:15	13a-A11-3	銅ナノ粒子薄膜へのレーザー直接描画による銅グリッドバターンの 形成	○渡辺 明¹, Qin Gang¹, Cai Jinguang¹	1.東北大多元研
	10:15 - 10:30	13a-A11-4	数密度に依存した奇異なナノバブル成長過程の観測	Wang Xiaolong¹, Chatterjee Souvik¹, 作花哲夫², ○中嶋 隆¹	1.京大エネ研, 2.京大工
	10:30 - 10:45	13a-A11-5	中赤外自由電子レーザーを用いたユウキハクマクの相変化観測II -膜質の改善と薄膜温度の評価-	溝端 圭介¹, Maurya Sandeep¹, ○中嶋 隆¹, 全 炳俊¹, 紀井 俊輝¹, 大垣 英明¹	1.京大エネ研
	10:45 - 11:00		休憩/Break		
	11:00 - 11:15	13a-A11-6	高温ステンレス試験片に付着した塩分のレーザアブレーションによる プラズマ発光の特徴	○江藤 修三¹, 藤井 隆¹	1.電中研
	11:15 - 11:30	13a-A11-7	F <sub>2</sub> レーザーを用いたバルスレーザー推積法によるポーラスSiO <sub>2</sub> 膜の 形成	〇谷山 大地¹, 池上 浩¹, 大久保 智幸¹, 中村 大輔¹, 岡田 龍雄¹	1.九大シス情
	11:30 - 11:45	13a-A11-8	フッ素レーザーによる鉄薄膜表面への微細周期構造の形成(3)	○大越 昌幸¹, 山下 嗣人²	1.防衛大, 2.関東学院大
	11:45 - 12:00	13a-A11-9	ナノ秒レーザーを用いたCFRPの切断加工と熱的影響領域の雰囲気	○(PC)佐藤 雄二¹, 塚本 雅裕¹, 松岡 史浩²,	1.阪大接合研, 2.阪大院工, 3.阪大工
	11.10 12.00		ガス依存性Ⅱ	山下 顕資³, 高橋 謙次郎¹, 升野 振一郎¹	

12:15	- 12:30	13a-A11-11	レーザ光スキャンシステムを用いたQFP-ICはんだ付け	○(D)土屋 均 <sup>1,2</sup> , 本間 哲哉 <sup>1</sup>	1.芝浦工業大学大学院, 2.東芝生産技
					術センター

3.7 レーザープロセシング / Laser processing ポスター講演						
3月13日(金) 16:30 - 18:30						
	13p-P2-1	プラズモニックバブルの光学顕微鏡とAFMによるハイブリッド観察	○柳谷 伸一郎¹, 堀内 加奈¹, 橋本 修一¹, 後藤 信夫¹	1.徳島大工		
	13p-P2-2	溶融塩中レーザーアブレーションによるナノ粒子作成	○谷口 誠治¹, 中島 信昭¹²	1.レーザー総研, 2.大市大		
	13p-P2-3	軟X線レーザーの集光照射による表面ナノ加工	〇石野 雅彦 <sup>1</sup> , 圓山 桃子 <sup>1</sup> , 長谷川 登 <sup>1</sup> , 錦野 捋元 <sup>1</sup> , 保 智己 <sup>2</sup> , Faenov Anatoly <sup>3,4</sup> , Pikuz Tatiana <sup>3,4</sup> , 河内 哲哉 <sup>1</sup> , 山極 満 <sup>1</sup>	1.原子力機構, 2.奈良女大, 3.大阪大, 4.ロシア科学アカデミー		
	E 13p-P2-4	Photo-reduced Graphene Oxide with Tunable Properties by Femtosecond Laser Irradiation	OMuttaqin Muttaqin <sup>1</sup> , Takahiro Nakamura <sup>1</sup> , Yuta Nishina <sup>2</sup> , Shunichi Sato <sup>1</sup>	1.IMRAM, Tohoku Univ., 2.Okayama Univ.		

		measurement, instrumentation, and sensor	口頭講演	
3月11日(水	9:00 - 12:3	0		
9:00 - 9:15	11a-A14-1	微粒子レーザー回折像の画像処理による粒径測定	○額田 祐輔¹, 北村 卓仁¹, 椿 光太郎¹	1.東洋大総合情報
9:15 - 9:30	11a-A14-2	偏光回折素子を利用した2次元複屈折プロファイラーの位相差定量 評価	○江本 顕雄¹, 中島 亮平¹, 大谷 直毅¹, 福 田 隆史²	1.同志社大理工, 2.産総研
9:30 - 9:45	11a-A14-3	分光光度計による半導体薄膜の屈折率の算出	宮崎 卓幸¹, ○(B)松原 良典¹, 安達 定雄¹	1.群馬大院理工
9:45 - 10:00	11a-A14-4	テラヘルツバルス波を用いた膜厚計測の高分解能化	○落合 孝典¹, 高橋 一雄¹	1.パイオニア
10:00 - 10:15	奨 11a-A14-5	2色法を用いた高温環境下高精度距離計測	○針山 達雄¹, 笠井 啓晃¹, 谷口 敦史¹, 渡 辺 正浩¹	1.日立製作所
10:15 - 10:30	E 11a-A14-6	Accuracy of optical frequency comb profilometry using a single pixel camera for different frequency selections	○(P)Quang Duc Pham¹, Yoshio Hayasaki¹	1.Utsunomiya University Center for Optical Research and Educat (CORE)
10:30 - 10:45	11a-A14-7	ファイバー光コム共振器の外乱/RF周波数変換機能を用いたひずみ 計測に関する基礎研究	○小倉 隆志¹, 中嶋 善晶²³, 山岡 禎久⁴, 美 濃島 薫²³, 安井 武史¹.³	1.徳島大, 2.電通大, 3.JST-ERATO 4.京都府立医大
10:45 - 11:00	奨 11a-A14-8	ファイバ型光コム干渉計による光路長走査範囲の拡大	○中嶋 善晶1², 美濃島 薫1.2	1.電通大 先進理工, 2.JST, ERAT 光シンセサイザ
11:00 - 11:15		休憩/Break		
11:15 - 11:30	11a-A14-9	1156 nm半導体レーザーを用いたYb光格子時計のための時計遷移励起用レーザー	○保坂 一元 <sup>1</sup> , 赤松 大輔 <sup>1</sup> , 小林 拓実 <sup>2</sup> , 安田 正美 <sup>1</sup> , 稲場 肇 <sup>1</sup> , 大久保 章 <sup>1</sup> , 田邊 健彦 <sup>1</sup> , 大 苗 敦 <sup>1</sup> , 洪 鋒雷 <sup>1,2</sup>	1.産総研, 2.横国大理工
11:30 - 11:45	奨 11a-A14-10	光周波数コムを用いたイッテルビウム原子の $^{1}$ P $_{1}$ 遷移の絶対周波数測定	○田邊 健彦', 赤松 大輔', 小林 拓実 <sup>12</sup> , 安 田 正美 <sup>1</sup> , 稲場 肇', 大久保 章', 大苗 敦', 洪 鋒雷 <sup>12</sup> , 保坂 一元 <sup>1</sup>	1.産総研, 2.横浜国大
11:45 - 12:00	11a-A14-11	Ti原子a³F₂-y³F₂におけるg因子の評価	○小林 慎治', 西宮 信夫', 鈴木 正夫'	1.工芸大
12:00 - 12:15	11a-A14-12	周期的な光バルス列を用いた近赤外離散フーリエ変換分光	○大久保 章 <sup>1,2</sup> , 謝 宜達 <sup>2,3</sup> , 稲場 肇 <sup>1,2</sup> , 大苗 敦 <sup>1,2</sup> , 保坂 一元 <sup>1,2</sup> , 橋本 守 <sup>4</sup> , 安井 武史 <sup>2,3,4</sup>	1.産総研, 2.美濃島ERATO, 3.徳. 工, 4.阪大基礎工
12:15 - 12:30	奨 11a-A14-13	波長計を用いたCRDSによるガス中微量水分の高感度スペクトル測定	○橋口 幸治¹, Lisak Daniel², Cygan Agata², 阿部 恒¹	1.産総研, 2.ニコラス・コペルニクス
3月11日(水	) 14:00 - 18:	00		
14:00 - 14:15	11p-A14-1	相互相関に基づく蛍光寿命イメージング法の提案	○水野 孝彦¹, 水谷 康弘¹², 岩田 哲郎¹²	1.徳島大, 2.JST-ERATO
14:15 - 14:30	11p-A14-2	蛍光 LIDAR によるストレス条件下における植物蛍光寿命計測	○冨田 孝幸², 梅田 隼¹, 小林 一樹², 斉藤 保典²	1.信州大学 理工, 2.信州大学 工
14:30 - 14:45	11p-A14-3	酸素Aバンドを利用した植物蛍光の分光画像計測	○栗山 健二¹, 斉藤 隼人², 眞子 直弘², 久世 宏明²	1.静岡大工, 2.千葉大CEReS
14:45 - 15:00	11p-A14-4	広帯域多波長画像の組み合わせによる植物健康診断システム	〇片岡 圭司', 川本 章博', 冨田 孝幸', 大谷 武志', 小林 一樹', 斉藤 保典', 小平 計美', 丸山 次郎 <sup>2</sup>	1.信州大工, 2.アールエフ
15:00 - 15:15	11p-A14-5	水中レーザーリモートセンシングに向けた海水溶存ガスのラマン分光	○染川 智弘¹, 藤田 雅之¹²	1.レーザー総研, 2.阪大レーザー研
15:15 - 15:30	11p-A14-6	近赤外差分吸収分光法を利用した都市域大気中における二酸化炭 素及び水蒸気濃度計測	○(DC)齊藤 隼人¹, 眞子 直弘¹, 栗山 健二², 久世 宏明¹	1.千葉大学CEReS, 2.静岡大学工
15:30 - 15:45	11p-A14-7	小型 $1.6\mu m$ DIALによる下層大気中の ${ m CO}_2$ 濃度分布計測	○柴田 泰邦¹, 長澤 親生¹, 阿保 真¹	1.首都大院シスデザ
15:45 - 16:00	11p-A14-8	PANDAドップラーライダーの風測定精度検証 - GPSゾンデおよび超音波風速計測定との比較 -	○青木 誠¹, 岩井 宏徳¹, 中川 勝広¹, 水谷 耕平¹	1.情報通信研究機構
16:00 - 16:15		休憩/Break		
16:15 - 16:30	11p-A14-9	航空機搭載植生ライダー	○水谷 耕平¹, 石井 昌憲¹, 浅井 和弘², 佐藤 篤¹²	1.情通機構, 2.東北工大
16:30 - 16:45	11p-A14-10	可搬LIFSライダを用いたエアロゾルの種類判別と立体計測	○(M1)西澤 直人¹, 冨田 孝幸², 小林 一樹², 齊藤 保典²	1.信大理工, 2.信大工
16:45 - 17:00	11p-A14-11	浮遊火山灰濃度測定のためのパーティクルカウントライダー	○阿保 真¹, 茂木 達也¹	1.首都大院シスデザ
17:00 - 17:15	11p-A14-12	ヘテロダインレーザ干渉計用新方式デジタル位相差計測法	○穀山 涉¹, 野里 英明¹, 大田 明博¹	1.産総研 計測標準
17:15 - 17:30	11p-A14-13	新しいサブナノ秒過渡吸収測定手法、RIPT 法	○中川 達央¹, 岡本 基土¹, 花田 啓明¹, 加 藤 隆二²	1.ユニソク, 2.日本大学
17:30 - 17:45	11p-A14-14	周波数領域単一ショット任意光波形計測の基礎検討	○宮本 貴幸¹, 塩田 達俊¹	1.埼玉大理工
17:45 - 18:00	11p-A14-15	二波長同時ヘテロダイン検波法を用いた並列同時分散計測システム	○春日 海秀¹, 宮本 貴幸¹, 塩田 達俊¹	1.埼玉大工

3.8 光計測技術・	3.8 光計測技術・機器 / Optical measurement, instrumentation, and sensor ポスター講演					
3月13日(金	3月13日(金) 9:30 - 11:30					
	13a-P6-1	医療応用を目指したGPUとCPUを併用した光散乱シミュレーション の高速化	○大槻 荘一¹	1.産総研健康工学		
	13a-P6-2	異方性媒質における旋光性と円二色性の同時測定法	○(D)中川 鉄馬¹, 中村 洸太¹, 朝日 透¹²	1.早大先進理工, 2.早大科健機構		
	13a-P6-3	無限遠補正光学系を用いた共通光路位相シフト干渉顕微鏡	○佐藤 貴則¹, 冨川 望¹, 陳 軍¹	1.東京工芸大工		
	13a-P6-4	シングルスリットによる回折光の偏光特性	金 蓮花¹, ○(B)丹沢 貴之¹	1.山梨大工		
	13a-P6-5	LiNbO3結晶の電気光学係数 r22の波長分散の計測	金 蓮花¹, ○(B)奈良 晃兵¹, 滝澤 國治²	1.山梨大工, 2.浜松ホトニクス中央研		
	13a-P6-6	GPS周波数標準にトレースした光周波数コムとその周波数安定性	○韋 冬¹, 明田川 正人¹	1.長岡技大工		
	13a-P6-7	可視光広帯域光源を用いたμm-OCTの半導体微細加工プロセス への応用	〇西 剛史¹, 尾崎 信彦¹, 大里 啓考², 渡辺 英一郎², 池田 直樹², 杉本 喜正²	1.和歌山大学シスエ, 2.物質・材料研 究機構		
	13a-P6-8	ハニカム構造を有するマイクロホログラムアレイを用いたホログラフィックShack-Hartmann波面センサーによる波面計測	○最田 裕介¹, 神藤 宏伸¹, 野村 孝徳¹	1.和歌山大システム工		
	13a-P6-9	シリコンフォトダイオード応答非直線性の波長依存性要因の実験的・ 理論的検証 III	○田辺 稔¹, 雨宮 邦招¹, 沼田 孝之¹, 福 田 大治¹	1.産総研		

3月14日(土	9:00 - 11:3	0		
9:00 - 9:15	14a-A14-1	配向方向の異なる長球状マイクロレンズアレイを用いた広ダイナミック レンジShack-Hartmann波面センサー	○神藤 宏伸¹, 最田 裕介¹, 野村 孝徳¹	1.和歌山大院システム工
9:15 - 9:30	奨 14a-A14-2	薄明視野顕微鏡法を用いた40 n m 金ナノ粒子の3 次元位置計測	○(M1)後藤 和史¹, 早崎 芳夫¹	1.宇都宮大学オプティクス教育研ンター
9:30 - 9:45	14a-A14-3	偏光無依存な垂直共鳴型屈折率センサ	〇山下 大輔¹, 水谷 彰夫¹, 菊田 久雄¹, 平井 義彦¹, 川田 博昭¹	1.大阪府立大院工
9:45 - 10:00	E 14a-A14-4	Brillouin Optical Correlation Domain Reflectometry with Lock-in Detection Scheme	○(DC)Yuguo Yao¹, Masato Kishi¹, Kazuo Hotate¹	1.the Univ. of Tokyo
10:00 - 10:15	奨 14a-A14-5	無人航空機搭載を目指した超小型軽量中赤外分光イメージング装置	○(BC)西藤 翼¹, 斉 威¹, 佐藤 俊¹, 藤原 大¹, 石丸 伊知郎¹	1.香川大学工学部
10:15 - 10:30		休憩/Break		
10:30 - 10:45	14a-A14-6	位相変調された光による干渉信号を用いた振動変位計測一大振幅三 角波変調による自動較正	○木村 亮祐¹, 伊藤 孝優¹, 田中 洋介¹, 黒 川 隆志¹	1.農工大工
10:45 - 11:00	14a-A14-7	シングルショット形状計測測定範囲のSPM入射角依存性	○小堺 崇也¹, バントゥアン¹², 塩田 達俊¹	1.埼玉大, 2.セブンシックス株式会
11:00 - 11:15	E 14a-A14-8	Improvement of the zoomable single-shot tomography and pro- filometry using a low-dense groove spatial phase modulator	○(P)Tuan Banh <sup>1,2</sup> , Tatsutoshi Shioda <sup>1</sup>	1.Saitama University, 2.Sevensis
11:15 - 11:30	E 14a-A14-9	Temporal phase measurements using a pixelated polarization phase shifting interferometer	○(P)David Serrano¹, Yukitoshi Otani¹	1.Utsunomiya Univ.
3月14日(土	) 13:00 - 15:	00		
13:00 - 13:15	14p-A14-1	準ニュートン法を用いたエリプソメトリー計測の窓補正	金 蓮花¹, ○(B)春日 翔貴¹, 近藤 英一¹	1.山梨大工
13:15 - 13:30	14p-A14-2	VIPAコム干渉を用いたシングルショット2次元断層計測および形状 計測	○宮岡 拓実¹, 塩田 達俊¹	1.埼玉大工
13:30 - 13:45	14p-A14-3	単一露光ワイドフィールドOCTによる屈折率測定	○木村 暁¹	1.山形大工
13:45 - 14:00	14p-A14-4	光学干渉計による多層膜吸収試料の層毎のスペクトル計測	○(B)大仁田 竜馬¹, 塩田 達俊¹	1.埼玉大工
14:00 - 14:15	14p-A14-5	低コヒーレンス動的光散乱法における多重散乱光の影響	○泉谷 悠介¹-², 岩井 俊昭¹	1.東京農工大BASE, 2.大塚電子
14:15 - 14:30	奨 14p-A14-6	半導体レーザを用いたスペックルシアリング干渉計	○平岡 幹基¹, 押田 至啓¹, 岩橋 善久²	1.奈良高専, 2.大阪産大
14:30 - 14:45	奨·E 14p-A14-7	Ultra short-term growth behaviour of plants under the influence of Cadmium using a highly sensitive interferometric technique, SIT	○(D)KanchanaMuthumali Kokge <sup>1,2</sup> , Hirofumi Kadono¹, Kokyo Oh³	1.Saitama Univ., 2.Univ. of Ruh 3.CESS
14:45 - 15:00	14p-A14-8	機能的OCTによる塗膜の乾燥モニタリング	○(DC)深井 俊宏 <sup>1,2</sup> , 門野 博史 <sup>1</sup>	1.埼玉大, 2.東洋精機製作所

3.9 テラ	ヘルツ全般 / Terahertz	z technologies ポスター講演		
3月	11日(水) 16:00 - 18:	00		
	奨 11p-P3-1	ボウタイアンテナを集積したテラヘルツ波源における放射特性の構造依存性解析	○山倉 裕和', 斉藤 光史', 須原 理彦'	1.首都大院理工
	11p-P3-2	テラヘルツ帯周波数コム放射用広帯域集積デバイスの構造設計	○加藤 優斗¹, 浅川 澄人¹, 斉藤 光史¹, 須 原 理彦¹	1.首都大院理工
	11p-P3-3	テラヘルツ帯ゼロバイアス検波用レクテナにおける出力側集積構 造設計	○(B)徳岡 岳海¹, 山倉 裕和¹, 斉藤 光史¹, 須原 理彦¹	1.首都大学東京
	11p-P3-4	有機非線形光学結晶DAST及びBNAを用いたE-O変調に関する 研究	○野竹 孝志¹, 縄田 耕二¹, 瀧田 佑馬¹, 時実悠¹, 岡安 雄一², 冨澤 宏光², 南出 泰亜¹	1.理研・光量子工学研究領域, 2.高輝度 光科学研究センター
	11p-P3-5	ダブルクラッドYb添加ファイバー増幅器を使ったDAST結晶からの高 出力THz波発生	○浜崎 淳一¹, 関根 徳彦¹, 笠松 章史¹, 寶 迫 巌¹	1.情通機構
	奨 11p-P3-6	結合二重上位準位構造を用いた差周波発生テラヘルツ量子カスケー ドレーザ光源の室温動作	○日高 正洋¹, 藤田 和上¹, 伊藤 昭生¹, 枝村 忠孝¹, 山西 正道¹	1.浜松ホトニクス
	11p-P3-7	テラヘルツ量子カスケードレーザの水平横モードに対する光制御	○酒瀬川 洋平¹, 齋藤 伸吾¹, 関根 徳彦¹, 笠 松 章史¹, 芦田 昌明², 寶迫 巌¹	1.情報通信研究機構, 2.阪大基礎工
	奨 11p-P3-8	分布実効屈折率0 <n<1をホールアレーにより制御した金属スリットレンズアンテナの設計と実験< td=""><td>○佐藤 竜也¹, 古謝 望², 鈴木 健仁¹²</td><td>1. 茨城大工, 2. 茨城大院理工</td></n<1をホールアレーにより制御した金属スリットレンズアンテナの設計と実験<>	○佐藤 竜也¹, 古謝 望², 鈴木 健仁¹²	1. 茨城大工, 2. 茨城大院理工
	奨 11p-P3-9	非対称ペアカットワイヤーによる負の分布屈折率を有するフレキシブル 薄フィルムレンズの設計	○梅原 一樹¹, 佐藤 竜也¹, 石原 功基¹, 竹林 佑記², 鈴木 健仁¹²	1.茨城大工, 2.茨城大院理工
	奨 11p-P3-10	フレキシブル薄フィルム上2層構造カットワイヤーによるテラヘルツ波用 1/4波長板の設計と評価	○大内 隆嗣¹, 鈴木 健仁¹	1.茨城大院理工

11p-P3-11	THz帯における45度反射を用いた無参照反射分光の検討	○大野 誠吾¹, 石原 照也¹	1.東北大院理
奨 11p-P3-12	テラヘルツ波を利用した非接触温度・気圧センサーに関する研究	○(M1)駒井 翔伍 <sup>1</sup>	1.首都大院シスデザ
11p-P3-13	YBCO超伝導体のテラヘルツ吸収スペクトルの評価	○安田 新¹, 中島 伸陽¹, 佐々木 哲朗²	1.鶴岡高専制御情報工, 2.静岡大電研
11p-P3-14	高感度テラヘルツ光伝導検出器とバンドパスフィルタによるテラヘル ツマルチスペクトル分光イメージング	○青木 誠¹, 廣本 宣久²	1.情報通信研究機構, 2.静大院工
11p-P3-15	テラヘルツケミカルイメージングシステムを用いた錠剤中の医薬品成分の擬似結晶形転移の拡散過程の解析	○坂本 知昭¹, 佐々木 哲朗², 香取 典子¹, 合田 幸広¹	1.国立衛研, 2.静岡大電研
奨 11p-P3-16	$RuO_2$ ナノシートのテラヘルツ応答	○(B)楠本 雅志¹, 中田 陽介¹, 宮丸 文章¹, 杉本 涉¹, 武田 三男¹	1.信州大
11p-P3-17	外部共振器を用いた高周波数確度CWテラヘルツ分光システムの 開発	○飯塚 悠円¹, 安藤 慶一¹, 音 賢一¹, 室 清 文², 中嶋 誠³	1.千葉大院理, 2.Spectra Quest Lab., 3.阪大レーザー研

.9 -	アフヘルツ全	段 / Terahertz	z technologies 口頭講演				
	3月12日(木)	9:15 - 12:1	5				
	9:15 - 9:30	12a-A14-1	時間-周波数解析によるテラヘルツバルス波からの構造情報の抽 出(3)	○高橋 功将 <sup>1</sup> , 深澤 亮一 <sup>1</sup> , 碇 智文 <sup>1</sup> , 大島 誉寿 <sup>2</sup> , 水谷 義弘 <sup>2</sup>	1.スペクトルデザイン, 2.東工大		
	9:30 - 9:45	奨 12a-A14-2	グラフェンのテラヘルツ帯における運動量緩和時間の実験的導出	○(M1)若生 洋由希¹, 佐藤 昭¹, ヴィクトール リズィー¹, 河原 憲治³, 吾郷 浩樹³, 河野 淳 一郎², 尾辻 泰一¹	1.東北大学通研, 2.ライス大学, 3.九大 先導研		
	9:45 - 10:00	12a-A14-3	p 型GaInP におけるフォノン・電子系量子干渉バラメータの評価	○坂本 裕則¹, 馬 蓓¹, 森田 健¹, 石谷 善博¹	1.千葉大工		
	10:00 - 10:15	奨 12a-A14-4	高強度THz波が誘起する金ナノ構造薄膜における非線形電気伝導	○吉岡 克将¹, 南 康夫¹, 首藤 健一¹, Thang Duy Dao <sup>2,2,4</sup> , 長尾 忠昭 <sup>2,3</sup> , 北島 正弘 <sup>1,2,2,5</sup> , 武田 淳¹, 片山 郁文¹	1.横浜国大工, 2.物材機構WPI-MAI 3.CREST JST, 4.奈良先端大, 5.ルク スレイ		
	10:15 - 10:30	12a-A14-5	超広帯域赤外時間領域分光によるInSbにおける光誘起拡張ドルー デ応答	○松原 英—1.², 森本 智英², 永井 正也², 芦 田 昌明²	1.阪歯大物理, 2.阪大基礎工		
待	10:30 - 10:45	12a-A14-6	「講演奨励賞受賞記念講演」(15分) スプリットリング共振器の高強度テラヘルツ近接磁場による非線形 反強磁性共鳴励起	〇向井 佑¹, 廣理 英基².3.4, 山本 隆文⁵, 陰山 洋².5, 田中 耕一郎¹.2.4	1.京大院理, 2.京大iCeMS, 3.JST-PRESTO, 4.JST-CREST, 5 大院工		
	10:45 - 11:00		休憩/Break				
	11:00 - 11:15	12a-A14-7	非対称二重格子ゲート構造を有するグラフェントランジスタにおける プラズマ不安定性	○小関 勇気¹, リズィー ヴィクトール¹, 尾辻 泰一¹, ポポフ ヴィアチェスラフ², 佐藤 昭¹	1.東北大通研, 2.IREE ロシア		
	11:15 - 11:30	12a-A14-8	THz帯量子カスケードレーザの高温動作のための半導体材料	○安田 浩朗¹	1.情報通信研究機構		
	11:30 - 11:45	12a-A14-9	共鳴トンネルダイオードの真性遅延削減による1.86 THz基本波発振及 び真性遅延と外部遅延削減による高周波化の見積もり	○(D)金谷 英敏¹, 前川 猛¹, 鈴木 左文², 浅 田 雅洋¹	1.東工大 総理工, 2.東工大 理工		
	11:45 - 12:00	奨 12a-A14-10	共鳴トンネルダイオードテラヘルツ周波数可変発振器の多素子集積化による580-900GHz広範囲周波数掃引	○北川 成一郎¹, 鈴木 左文², 浅田 雅洋¹	1.東工大 総理工, 2.東工大 理工		
	12:00 - 12:15	12a-A14-11	負の屈折率媒質による電子ビームからの電磁波放射	○李 大治¹, 高野 恵介², 中嶋 誠², 宮本 修治³	1.レーザー総研, 2.阪大レーザー研, 3.兵庫大		
	3月12日(木) 13:30 - 17:00						
	13:30 - 13:45	奨 12p-A14-1	光注入型THz波バラメトリック光源の広帯域化	○(M2)村手 宏輔¹, 今山 和樹¹, 林 伸一郎², 川瀬 晃道¹²	1.名大院工, 2.理研		
	13:45 - 14:00	12p-A14-2	バラメトリック過程を用いた高ダイナミックレンジテラヘルツ波分光器 の開発	○今山 和樹¹, 村手 宏輔¹, 林 伸一郎², 南出泰亜², 川瀬 晃道¹²	1.名大院工, 2.理研		
	14:00 - 14:15	12p-A14-3	LiNbO <sub>3</sub> リッジ導波路における高出力広帯域テラヘルツ波発生	○南 翼¹, 岡野 紘世¹, 竹家 啓¹, 川瀬 晃道¹²	1.名大院工, 2.理研		
	14:15 - 14:30	12p-A14-4	(113)B基板上のInAs量子ドットを有するGaAs/AlAs結合共振器へのフェムト秒パルス照射によるテラヘルツ帯差周波発生 (II)	○大柄根 斉宣¹, 高本 俊昭¹, 盧 翔孟¹, 熊谷直人¹, 北田 貴弘¹, 井須 俊郎¹	1.徳島大院フロンティア		
	14:30 - 14:45	奨 12p-A14-5	超短バルスレーザー励起による金ナノロッドからのテラヘルツ波放射	○(M2)浅井 基希¹, 込山 英秋², 彌田 智 —²³, 田所 譲¹, 高野 恵介¹, 中嶋 誠¹, 萩 行 正憲¹	1.大阪大レーザー研, 2.JST-ERATC 3.東工大資源化学		
	14:45 - 15:00	12p-A14-6	両性不純物添加したGaSe液相成長	○佐藤 陽平¹, 鈴木 康平², 前田 健作², 小山 裕²	1.東北大工, 2.東北大院工		
	15:00 - 15:15	12p-A14-7	高温超伝導テラヘルツ光源における偏光制御	吉岡 佑介¹, 辻本 学¹, 中川 裕也¹, ○掛 谷 一弘¹	1.京大院工		
	15:15 - 15:30		休憩/Break				
	15:30 - 15:45	12p-A14-8	光ファイバ経由のテラヘルツ周波数基準信号伝送とその応用	○熊谷 基弘¹, 長野 重夫¹, 入交 芳久¹, 諸 橋 功¹, 川上 彰¹, 伊東 宏之¹, 花土 ゆう子 ¹, 寶迫 巌¹	1.情報通信研究機構		
	15:45 - 16:00	12p-A14-9	低損失な光学結合方式によるテラヘルツ波バラメトリック発生およ び検出	○瀧田 佑馬¹, 野竹 孝志¹, 縄田 耕二¹, 時実悠¹, 林 伸一郎¹, 南出 泰亜¹	1.理研		
	16:00 - 16:15	12p-A14-10	非対称二重格子ゲートHEMTによるテラヘルツ波検出の周波数特性	○佐藤 昭', Stephane Boubanga Tombet <sup>1</sup> , 渡辺 隆之 <sup>1</sup> , 川崎 鉄哉 <sup>1</sup> , 糟合 文月 <sup>1</sup> , 末 光 哲也 <sup>1</sup> , Denis V. Fateev <sup>2</sup> , Vyacheslav V. Popov <sup>2</sup> , 南出 泰亜 <sup>3</sup> , 伊藤 弘昌 <sup>3</sup> , Dominiq- ue Coquillat <sup>4</sup> , Wojciech Knap <sup>4</sup> , Guillaume Ducournau <sup>3</sup> , Yahya Meziani <sup>5</sup> , 尾辻 泰一 <sup>1</sup>	1.東北大, 2.IREE, 3.理研仙台, 4.モ リエ第2大, 5.IEMN, 6.サラマンカフ		
	16:15 - 16:30	12p-A14-11	MEMS両持ち梁構造を用いた室温テラヘルツ光検出の可能性	○渡辺 康行¹.², 吉田 健治¹.², 平川 一彦¹.²	1.東大生研, 2.ナノ量子機構		
	16:30 - 16:45	12p-A14-12	量子ドット光伝導スイッチのメサ加工による暗電流の抑制	○村雲 圭佑¹, 山岡 裕也¹, 熊谷 直人¹, 北田 貴弘¹, 井須 俊郎¹	1.徳島大院フロンティア		
	16:45 - 17:00	奨 12p-A14-13	BaTiO <sub>3</sub> 結晶を用いたTHz波のヘテロダインEOサンプリング	○東 奨悟', 小澤 慎平', 堀 貴陽', シュテファンフンクナー', グドルンニフース!, 岩前 敦', 山本 晃司', 古屋 岳², エルマー エスタシオ³, マイケル バクノフ', 谷 正彦'	1.福井大遠赤セ, 2.福井大工, 3.フィン大, 4.ニジニノブゴロド大		

9:00 - 9:15	13a-A14-1	テラヘルツ帯金属薄膜サブ波長格子構造偏光子の金属膜厚分布と 光学特性の金属種依存性	○村木 兼吾¹, 諏訪 翔也¹, 山本 浩輔¹, 白 石 和男¹	1.宇都宮大工
9:15 - 9:30	13a-A14-2	MEMS可変スパイラルメタマテリアルのテラヘルツ応答	○菅 哲朗¹, 磯崎 琰宏¹, 神田 夏輝¹², 根 本 夏紀¹, 小西 邦昭¹, 五神 真¹, 松本 潔 ¹, 下山 勲¹	1.東京大学, 2.理研
9:30 - 9:45	奨 13a-A14-3	テラヘルツ領域における分割リング共振器の構造と共鳴周波数の シフト	○(B)五味 蔵酒', 森田 博紀', 西田 翼', 中田 陽介', 中西 俊博', 宮丸 文章', 武田 三男'	1.信大, 2.京大
9:45 - 10:00	奨 13a-A14-4	Berry位相を用いた光渦生成テラヘルツメタ表面	○(B)平良 優大¹, 中田 陽介¹, 宮丸 文章¹, 武田 三男¹	1.信大
10:00 - 10:15	奨 13a-A14-5	自己補対近傍チェッカーボードバターンのテラヘルツ応答	○田中 翼', 高野 恵介', Abdallah Chahadih², Abbas Ghaddar², Xiang-Lei Han², François Vaurette², Tahsin Akalin², 宮丸 文章³, 中嶋 誠', 萩行 正憲¹	1.阪大レーザー研, 2.IEMN, Lille Univ, 3.信州大理
10:15 - 10:30	13a-A14-6	V溝(テーバつき伝送線路)によるsub-THz電磁波集束のアバーチャを用いた評価	○森川 治¹, 山本 晃司², 谷 正彦², 栗原 一 嘉², 桒島 史欣³	1.海保大, 2.福井大, 3.福井工大
10:30 - 10:45		休憩/Break		
10:45 - 11:00	13a-A14-7	集積型 光·THz 信号直接変換素子の設計	○安井 章雄¹, 雨宮 智宏², 西山 伸彦¹, 荒 井 滋久¹.²	1.東工大, 2.量子ナノエレクトロニク 究センター
11:00 - 11:15	13a-A14-8	グラフェンを電極に用いたランダム配向液晶セルによるテラヘルツ波 の位相制御	○佐々木 友之¹, 野田 浩平¹, 川月 喜弘², 小野 浩司¹	1.長岡技科大, 2.兵庫県立大
11:15 - 11:30	奨 13a-A14-9	グラフェンチャネルFETのサブテラヘルツ帯ミキサ応用	○菅原 健太¹, 川崎 鉄哉¹, Binti Hussin Mastura¹, 玉虫 元¹, 未光 眞希¹, 吹留 博一¹, 可児 淳一², 寺田 純², 桑野 茂², 岩月 勝美³, 末光 哲也¹³, 尾辻 泰一¹.³	1.東北大通研, 2.NTTAS研, 3.東 気通信研究機構
11:30 - 11:45	E 13a-A14-10	Improvement of THz imager with hybridization system of metamaterial and cholesteric liquid crystal	○(P)Boyoung Kang¹, Tomohiro Nishika- wa¹, Yuzuru Tadokoro¹, Keisuke Takano¹, Makoto Nakajima¹	1.Institute of Laser Engineering University
11:45 - 12:00	奨 13a-A14-11	サブ波長銅球集団における高電場テラヘルツ誘起コヒーラー	○田所 譲¹, 西川 智啓¹, 高野 恵介¹, 中嶋 誠¹, 萩行 正憲¹	1.阪大レーザー研
12:00 - 12:15	13a-A14-12	中赤外マイクロストリップ線路の位相定数評価	○川上 彰¹, 堀川 隼世¹², 兵頭 政春³, 田中 秀吉¹, 武田 正典⁴, 島影 尚²	1.情通機構, 2.茨城大院, 3.金沢大岡大院
3月13日(金	16:15 - 19	:00		
16:15 - 16:30	奨 13p-A14-1	テラヘルツ波ケミカル顕微鏡を用いた液中イオンの同時検出	○秋宗 広祐¹, 大川 裕貴¹, 紀和 利彦¹, 堺健司¹, 塚田 啓二¹	1.岡山大自然
16:30 - 16:45	奨 13p-A14-2	テラヘルツ波ケミカル顕微鏡によるD-(+)-マンノースの非標識検出	○小川 真寬¹, 中村 彰宏¹, 紀和 利彦¹, 堺 健司¹, 塚田 啓二¹	1.岡山大自然
16:45 - 17:00	13p-A14-3	低コヒーレンスサブテラヘルツ波による煙越しのイメージング	○清水 直文¹, 内田 英建², 松山 賢²	1.NTT 先デ研, 2.東理大 火災科 究センター
17:00 - 17:15	奨 13p-A14-4	ビデオレートテラヘルツ電場ベクトルイメージング装置の構築	○高井 茉佑子¹, 渡邉 紳一¹	1.慶大理工
17:15 - 17:30	E 13p-A14-5	THz wavefront measurement using 2D electro-optic imaging combined with Hartmann sensor principle	OHarsono Cahyadi¹, Jerome Degert², Eric Freysz², Takeshi Yasui¹, Emmanuel Abraham²	1.Tokushima Univ., 2.Bordeaux
17:30 - 17:45	13p-A14-6	カーボンブラック分散体のテラヘルツ分光特性	○能勢 秀俊¹, 児島 孝則¹, 次田 浩¹, 門脇 信傑¹, 奧野 雅史¹, 小林 正樹¹	1.協和ファインテック
17:45 - 18:00		休憩/Break		
18:00 - 18:15	13p-A14-7	テラヘルツ波を用いたガスハイドレートの研究	○高橋 亮平¹, 竹家 啓¹, 川瀬 晃道¹	1.名大院工
18:15 - 18:30	13p-A14-8	光注入型テラヘルツ波バラメトリック発生器を用いた遮蔽物内試薬 の透過分光	○山崎 良¹, 加藤 三樹矢¹, 村手 宏輔¹, 今山 和樹¹, 川瀬 晃道¹²	1.名古屋大学, 2.理研
18:30 - 18:45	13p-A14-9	テラヘルツ電場波形の高速シングルショット検出	○(B)小林 真隆¹, Johnson Jeremy¹.², 南 康夫¹, 武田 淳¹, 片山 郁文¹	1.横浜国大, 2.Brigham Young University
18:45 - 19:00	13p-A14-10	全室温動作連続波GaPテラヘルツ信号発生・検出システムの性能	○佐々木 哲朗¹, 田邉 匡生², 西澤 潤一³	1.静岡大電研, 2.東北大多元研, 3 北大

3.10	光量子物理	·技術 / Optica	al quantum physics and technologies	口頭講演		
3月11日(水) 9:15 - 12:00						
	9:15 - 9:30	11a-A17-1	アレイ導波路回折格子を用いた高次元量子もつれ状態生成	○松田 信幸 <sup>1,2</sup> , Karkus Peter <sup>2</sup> , 西 英隆 <sup>1,3</sup> , 土 澤 泰 <sup>1,3</sup> , 山田 浩治 <sup>1,3</sup> , 武居 弘樹 <sup>2</sup>	1.NTT NPC, 2.NTT物性基礎研, 3.NTT先端集積デバイス研	
	9:30 - 9:45	11a-A17-2	時間分解同時測定による高明瞭度のHong-Ou-Mandel干渉実験	○(M1)田中 元基¹, 逵本 吉郎, 杉浦 幸大¹, 生田 力三¹, 三木 茂人², 山下 太郎², 寺井弘高², 藤原 幹生², 山本 俊¹, 小芦 雅斗³, 佐々木 雅英², Zhen Wang², 井元 信之¹	1.阪大基礎工, 2.情通機構, 3.東大工	
	9:45 - 10:00	E 11a-A17-3	Separable Schmidt modes generation by using a Hong-Ou-Mandel interference	ORuibo Jin¹, Ryosuke Shimizu², Mikio Fujiwara¹, Ryota Wakabayashi¹³, Masahiro Takeoka¹, Masahide Sasaki¹	1.NICT, 2.Univ. of Electro-Comm., 3.Waseda Univ.	
	10:00 - 10:15	11a-A17-4	フォトニックメタマテリアルを用いたエンタングルメント蒸留実験	○浅野 元紀¹, Muriel Bechu², Mark Tame³, Sahin Kaya Ozdemir⁴, 生田 力三¹, Durdu O Guney⁵, 山本 俊¹, Lan Yang⁴, Martin Wegener², 井元 信之¹	1.阪大基礎工, 2.カールスルーエ大, 3.ク ワズール・ナタール大, 4.ワシントン大, 5.ミシガン工科大	
	10:15 - 10:30	11a-A17-5	単一光子源を用いたサイドチャンネルフリー量子暗号	○南部 芳弘¹	1.NECスマエネ研	
	10:30 - 10:45	11a-A17-6	エラーレート揺らぎを考慮した現実的想定下における DPS-QKD の 性能	○(M1)生田 拓也¹, 井上 恭¹	1.阪大工	
	10:45 - 11:00		休憩/Break			
	11:00 - 11:15	11a-A17-7	微弱光の自己ヘテロダインビートの測定	○大川 洋平¹, 大岡 佳生¹, 大村 史倫¹, 安武 裕輔¹², 深津 晋¹	1.東大院総合, 2.JST さきがけ	
	11:15 - 11:30	11a-A17-8	高効率単一光子検出へ向けたSPADクエンチング抵抗に関する一 考察	○(M2)高野 晃¹, 行方 直人¹, 井上 修一郎¹	1.日大量科研	
	11:30 - 11:45	11a-A17-9	スペクトルフィルタリングされた場に対する光子統計の簡易計算法と その応用	○上出 健仁¹, 岩本 敏¹², 荒川 泰彦¹²	1.東大ナノ量子機構, 2.東大生研	

11:45 - 12:00	奨 11a-A17-10	対称ファイバ干渉計を用いた光子数スクイーズド光の生成	○保坂 有杜¹, 廣澤 賢一¹, 澤田 亮太¹, 神成 文彦¹	1.慶大理工
3月11日(水	) 14:00 - 16:4	<b>1</b> 5		
14:00 - 14:15	11p-A17-1	カオス駆動半導体レーザにおける周期成分の低減	○近藤 博文¹, 大坪 順次¹	1.静大院工
14:15 - 14:30	11p-A17-2	直交偏光戻り光のある面発光半導体レーザの矩形波発振	○近藤 弘基¹, 大坪 順次¹	1.静大院工
14:30 - 14:45	11p-A17-3	スター型結合半導体レーザにおけるカオス同期特性	○松本 卓也¹, 大坪 順次¹	1.静大院工
14:45 - 15:00	奨 11p-A17-4	戻り光量子ドット半導体レーザの変調特性解析	○加藤 雅史¹, 大坪 順次¹	1.静大工
15:00 - 15:15	11p-A17-5	半導体レーザの相互結合多数リングにおけるカオス同期	○南部 真志¹, 大坪 順次¹	1.静大工
15:15 - 15:30		休憩/Break		
15:30 - 15:45	11p-A17-6	不均一な注入電流を有するプロードエリア半導体レーザにおける時空 カオスの数値解析	○野澤 隆宏¹, 荒幡 真也¹, 森勝 進一朗¹, 内田 淳史¹	1.埼玉大
15:45 - 16:00	奨 11p-A17-7	ブロードエリア半導体レーザの空間モード間の反位相ダイナミクス の 数値計算	○荒幡 真也¹, 内田 淳史¹	1.埼玉大
16:00 - 16:15	11p-A17-8	「ナノカオス」の乱数性と複雑性	○金 成主¹, 成瀬 誠², 青野 真士³.⁴, 堀 裕和⁵	1.物材機構, 2.情通機構, 3.東工大, 4.JST, 5.山梨大
16:15 - 16:30	11p-A17-9	Penrose unilluminable room共振器の波動伝機解析	○福嶋 丈浩¹, 板谷 諒介¹, 篠原 晋², 砂田 哲³, 原山 卓久⁴, 坂口 浩一郎¹, 徳田 安紀¹	1.岡山県立大, 2.NTT CS研, 3.金沢大, 4.早稲田大
16:30 - 16:45	11p-A17-10	レーザーカオスと金属V溝導波路を用いた高効率THz時間領域 分光法	○桑島 史欣', 白尾 拓也', 岸端 俊宏', 赤峰 勇佑', 谷 正彦', 栗原 一嘉', 山本 晃司', 長 島 健', 荻行 正憲'	1.福井工大, 2.福井大遠赤セ, 3.福井大 教育, 4.摂南大, 5.阪大レーザー研

3	3.10 光量子物理・技術 / Optical quantum physics and technologies ポスター講演						
	3月12日(木) 9:30 - 11:30						
		12a-P6-1	PPLN導波路を用いた大規模時分割多重光パラメトリック発振器	○武居 弘樹¹, 稲垣 卓弘¹, 梅木 毅同², 忠永修², 竹ノ内 弘和²	1.NTT物性研, 2.NTT先デ研		
		12a-P6-2	利得変調半導体レーザーの時間ジッター計測に関する数値計算Ⅱ	〇松山 哲也', 山上 雄基', 松倉 聖', 北川 直昭', 田中 天翔', 和田 健司', 堀中 博道'	1.阪府大院工		
		12a-P6-3	半導体レーザーの周波数雑音を利用した測距法に関する検討	○土井 康平 <sup>1</sup> , 新井 秀明 <sup>2</sup> , 齋藤 高大 <sup>2</sup> , 前原 進也 <sup>2</sup> . 大平 泰牛 <sup>2</sup> . 坂本 秀一 <sup>2</sup> . 佐藤 孝 <sup>2</sup>	1.東大, 2.新潟大		

フォトニック	構造·現象, 13	.7 超薄膜・量子ナノ構造のコードシェアセッション	口頭講演	
3月12日(木	9:00 - 12:3	0		
9:00 - 9:15	奨 12a-A10-1	有機ヒ素を用いたMOVPE法によるフォトニック結晶の埋め込み成長	○河崎 正人 <sup>1,3</sup> , 吉田 昌宏¹, 石崎 賢司¹, Menaka De Zoysa <sup>1,2</sup> , 北村 恭子 <sup>1,2</sup> , 野田 進¹	1.京大院工, 2.京大白眉, 3.三菱電 先端総研
9:15 - 9:30	12a-A10-2	$(Sc, Er)_2O_3$ 薄膜におけるサイト選択励起でのエネルギー移動とアップコンバージョン	○川上 欣洋¹, 俵 毅彦²³, 尾身 博雄²³, 鍜治 怜奈¹, 足立 智¹	1.北大院工, 2.NTT物性基礎研, 3. ナノフォトニクスセンタ
9:30 - 9:45	12a-A10-3	(ErSc)2O3 薄膜におけるアップコンバージョン発光とフォトニックバン ドギャップによる抑制	○俵 毅彦¹², Thomas McManus¹³, 川上 欣 洋⁴, 尾身 博雄¹², Adel Najar¹, 鍛治 怜奈⁴, 足立 智⁴, 後藤 秀樹¹	1.NTT物性研, 2.NTTナノフォトニック, 3.バース大, 4.北大
9:45 - 10:00	奨 12a-A10-4	InP(311)B基板上InAs量子ドットからの単一光子発生とその温度特性	○(M2)細井 響子¹, 高熊 亨¹, 黒澤 裕之³, 中島 秀朗³, 赤羽 浩一², 熊野 英和³, 末宗 幾夫³, 早瀬 潤子³	1.慶大理工, 2.情通機構, 3.北大電
10:00 - 10:15	12a-A10-5	(111)A 面上量子ドットにおける励起子微細構造分裂の高精度評価	○中島 秀朗¹, 熊野 英和¹, 劉 祥明², 間野高明², 黒田 隆², 末宗 幾夫¹	1.北大電子研, 2.物材機構
10:15 - 10:30	E 12a-A10-6	Entangled photon emission at temperatures up to 60 K from droplet epitaxial quantum dots	○(P)Xiangming Liu¹, Takashi Kuroda¹, Takaaki Mano¹, Hideaki Nakajima², Hide- kazu Kumano², Ikuo Suemune², Yoshiki Sakuma¹, Kazuaki Sakoda¹	1.NIMS, 2.RIES Hokkaido Univ.
10:30 - 10:45	12a-A10-7	量子ドット-ナノ共振器強結合系における光散逸経路間干渉	〇太田 泰友¹, 太田 竜一², 熊谷 直人¹, 岩本 敏¹², 荒川 泰彦¹.²	1.東大ナノ量子機構, 2.東大生研
10:45 - 11:00	奨 12a-A10-8	走査型電子顕微鏡による量子ドットの位置検出とナノ共振器との結 合状態評価	○車 一宏¹, 太田 泰友², 高宮 大策¹, 角田 雅弘², 岩本 敏¹², 荒川 泰彦¹²	1.東大生研, 2.東大ナノ量子機構
11:00 - 11:15		休憩/Break		
11:15 - 11:30	12a-A10-9	ウエハ接合界面での光損失を低減した量子ドット結合共振器の作製	○北田 貴弘¹, 原山 千穂¹, 太田 寛人¹, 前川 知久¹, 盧 翔孟¹, 熊谷 直人¹, 井須 俊郎¹	1.徳島大院フロンティア
11:30 - 11:45	12a-A10-10	一次元フォノニック結晶導波路におけるフォノン伝搬のバンド構造依 存性	○畑中 大樹¹, ドデル アモリ¹, マブーブ イム ラン¹, 小野満 恒二¹, 山口 浩司¹	1.NTT物性研
11:45 - 12:00	奨 12a-A10-11	多モード干渉を利用した表面プラズモンポラリトン交差導波路	○太田 雅¹, 福原 誠史¹, 住村 あさひ¹, 伊藤 基¹, 相原 卓磨¹, 石井 佑弥¹, 福田 光男¹	1.豊技大
12:00 - 12:15	奨 12a-A10-12	グラフェン装荷型プラズモニクス導波路における光吸収の増強	○(M1)常川 雅人 <sup>1,2</sup> , 小野 真証 <sup>1,3</sup> , 納富 雅 也 <sup>1,2,3</sup>	1.NTT物性研, 2.東工大理工, 3.N Tナノフォトニクスセンタ
12:15 - 12:30	奨 12a-A10-13	プラズモニック導波路のSi細線導波路への結合	○小野 真証 <sup>12</sup> , Hao Xu <sup>12</sup> , 倉持 栄一 <sup>12</sup> , 野 崎 謙悟 <sup>12</sup> , 谷山 秀昭 <sup>12</sup> , 常川 雅人 <sup>23</sup> , 納 富 雅也 <sup>1,23</sup>	1.NTTナノフォトニクスセンタ, 2.N'性科学基礎研, 3.東工大理工

3.11	3.11 フォトニック構造・現象 / Photonic structures and phenomena ポスター講演						
	3月11日(水) 9:30 - 11:30						
		11a-P3-1	GPU の総和計算アルゴリズムによるFDTD の高速化	○谷山 秀昭1.2, 納富 雅也1.2	1.NTT NPC, 2.NTT物性基礎研		
		11a-P3-2	ナノインブリントと干渉フォトリソグラフィを用いた三次元周期多孔構 造体の作製	○鷲田 一博¹, 三宅 正男¹, 池之上 卓己¹, 平藤 哲司¹	1.京都大エネ科		
		11a-P3-3	フォトニック結晶バンド端共振器とナノ金属共振器の相互作用	○李 潤植¹, 北村 恭子¹², 浅野 卓¹, 石崎 賢司¹, 野田 進¹	1.京大院工, 2.京大白眉		
		11a-P3-4	3次元フォトニック結晶における並列水平導波路の結合特性解析(II)	○(D)権平 皓¹, 石崎 賢司¹, 北野 圭輔¹, 浅 野 卓¹, 野田 進¹	1.京大院工		

11a-P3-5	熱光発電のための赤外透明基板の熱輻射スペクトルの評価	○堤 達紀¹, 末光 真大², 橋本 康平¹, 浅野卓¹, De Zoysa Menaka³, 野田 進¹	1.京大院工, 2.大阪ガス, 3.京大白眉
11a-P3-6	AlGaAsフォトニック結晶スラブ導波路による和周波発生	○小田 久哉¹, 夛田 量宏¹, 山中 明生¹, 尾崎 信彦², 池田 直樹³, 杉本 喜正³	1.千歳科技大, 2.和歌山大, 3.物材研

.11	. フォトニック	構造・現象 / P	hotonic structures and phenomena	口頭講演	
3月12日(木) 14:00 - 18:45					
	14:00 - 14:15	12p-A10-1	ダブルホール格子点をもつフォトニック結晶レーザの作製	○渡辺 明佳 <sup>1,3</sup> , 廣瀬 和義 <sup>1,3</sup> , 杉山 貴浩 <sup>1,3</sup> , 梁 永 <sup>2,3</sup> , 北川 均 <sup>2,3</sup> , 野田 進 <sup>2,3</sup>	1.浜ホト, 2.京大院工, 3.ACCEL JST
	14:15 - 14:30	E 12p-A10-2	Observation of plasmonic Fabry-Perot modes in a GaAs nanowire embedding multi-stacked InGaAs/GaAs quantum dots	O(D)Jinfa Ho¹, Jun Tatebayashi¹, Sylvain Sergent¹, Chee Fai Fong¹, Satoshi Iwamo- to¹², Yasuhiko Arakawa¹²	1.Nanoquine, Univ. of Tokyo, 2.IIS, Univ. of Tokyo
	14:30 - 14:45	12p-A10-3	InGaAs/GaAs量子ドットを有するナノワイヤレーザの室温発振	○館林 潤¹, 加古 敏¹², Ho Jinfa², 太田 泰友¹, 岩本 敏¹², 荒川 泰彦¹²	1.東大ナノ量子機構, 2.東大生研
	14:45 - 15:00	12p-A10-4	フォトニック結晶レーザにおける不均一ポンピング効果の理論解析	○北川 均 <sup>1,2</sup> , 梁 永 <sup>1,2</sup> , 中川 翔太 <sup>1,2</sup> , Gelleta John <sup>1,2</sup> , 野田 進 <sup>1,2</sup>	1.京大院工, 2.ACCEL JST
	15:00 - 15:15	E 12p-A10-5	Theoretical analysis of nanolaser with a few quantum dot gain	O(M2)VINCENT ELFVING <sup>12</sup> , YAS- UTOMO OTA <sup>12</sup> , KENJI KAMIDE <sup>12</sup> , SATOSHI IWAMOTO <sup>1,23</sup> , YASUHIKO ARAKAWA <sup>1,23</sup>	1.Univ. of Tokyo, 2.IIS, 3.NanoQuin
	15:15 - 15:30	12p-A10-6	フォトニック結晶レーザにおける空間ホールバーニング現象の理論 解析	○北川 均 <sup>1,2</sup> , 梁 永 <sup>1,2</sup> , 中川 翔太 <sup>1,2</sup> , Gelleta John <sup>1,2</sup> , 野田 進 <sup>1,2</sup>	1.京大院工, 2.ACCEL JST
	15:30 - 15:45	12p-A10-7	単一モード位相アレイフォトニック結晶レーザ	○新家 昭彦1², 野崎 謙悟1², 倉持 栄一1.², 谷山 秀昭1², 納富 雅也1²	1.NTTナノフォトセンタ, 2.NTT物性 基礎研
	15:45 - 16:00		休憩/Break		
待	16:00 - 16:45	12p-A10-8	「第15回応用物理学会業績賞(研究業績)受賞記念講演」(45分) フォトニック結晶工学の進展と今後の展望	〇野田 進 <sup>1</sup>	1.京大
	16:45 - 17:00	奨 12p-A10-9	2次元ビーム走査のための変調フォトニック結晶レーザの動作特性	○(M1)安田 大貴¹, 北村 恭子¹², 李 潤植¹, 野田 進¹	1.京大院工, 2.京大白眉
	17:00 - 17:15	奨 12p-A10-10	共振器共鳴励起によるナノレーザの自然放出係数増大	○高宮 大策¹, 太田 泰友², 渡邉 克之², 角田 雅弘², 岩本 敏¹², 荒川 泰彦¹²	1.東大生研, 2.東大ナノ量子機構
	17:15 - 17:30	E 12p-A10-11	Coupled-wave analysis for photonic-crystal surface-emitting lasers –Effect of multiple external reflectors on threshold gain–	○John Gelleta <sup>1,2</sup> , Yong Liang <sup>1,2</sup> , Hitoshi Kitagawa <sup>1,2</sup> , Susumu Noda <sup>1,2</sup>	1.Kyoto Univ., 2.ACCEL JST
	17:30 - 17:45	12p-A10-12	円偏光ビームを出射するフォトニック結晶レーザ構造の検討	○(M1)前川 享平¹, 西本 昌哉¹, 石崎 賢司¹, 北村 恭子¹-², 野田 進¹	1.京大院工, 2.京大白眉
	17:45 - 18:00	奨 12p-A10-13	半導体三次元カイラルフォトニック結晶の偏光バンド端における量子 ドットからの高純度円偏光の発光	○高橋 駿¹, 田尻 武義², 太田 泰友¹, 館林 潤¹, 岩本 敏¹², 荒川 泰彦¹²	1.東大ナノ量子機構, 2.東大生研
	18:00 - 18:15	奨 12p-A10-14	3次元フォトニック結晶内部の極薄空隙面における光伝搬の観測	○北野 圭輔¹, 石崎 賢司¹, 権平 皓¹, 野 田 進¹	1.京大院工
	18:15 - 18:30	12p-A10-15	Q ~ 60,000を有する三次元フォトニック結晶ナノ共振器	○高橋 駿¹, 田尻 武義², 太田 泰友¹, 渡邉 克之¹², 岩本 敏¹², 荒川 泰彦¹²	1.東大ナノ量子機構, 2.東大生研
	18:30 - 18:45	奨 12p-A10-16	プレート差込型積層方式を用いた三次フォトニック結晶 ~提案と 作製~	○田尻 武義¹, 高橋 駿², 太田 泰友², 舘林 潤², 岩本 敏¹², 荒川 泰彦¹²	1.東大生研, 2.ナノ量子機構
	3月13日(金)	9:00 - 12:1	5		
待	9:00 - 9:15	13a-A10-1	「講演奨励賞受賞記念講演」(15分) 離れた光ナノ共振器間の任意タイミングでの断熱的光転送の実現	〇鴻池 遼太郎 <sup>1</sup> , 中川 遥之 <sup>1</sup> , 浅野 卓 <sup>1</sup> , 田中 良典 <sup>1</sup> , 野田 進 <sup>1</sup>	1.京大院工
	9:15 - 9:30	13a-A10-2	無点欠陥/少数点欠陥ナノ光共振器の超高Q値設計	○倉持 栄一 <sup>1,2</sup> , Duprez Hadrien <sup>2</sup> , 谷山 秀昭 <sup>1,2</sup> , 角倉 久史 <sup>1,2</sup> , 野崎 謙悟 <sup>1,2</sup> , 新家 昭彦 <sup>1,2</sup> , 納富 雅也 <sup>1,2</sup>	1.NTT NPC, 2.NTT物性基礎研
	9:30 - 9:45	奨 13a-A10-3	マイクロヒータの集積による結合光ナノ共振器の離調制御	○中川 遥之¹, 鴻池 遼太郎¹, 浅野 卓¹, 田中 良典¹, 野田 進¹	1.京大院工
	9:45 - 10:00	奨 13a-A10-4	超精密切削加工による結晶材料WGM共振器の作製および熱光学機 械振動の共振器サイズ依存性についての検討	○糸部 大貴¹, 中川 陽介¹, 莇 駿也¹, 柿沼 康弘¹, 田邉 孝純¹	1.慶大理工
	10:00 - 10:15	奨 13a-A10-5	ナノファイバを用いたフォトニック結晶導波路上での高Q値共振器 形成	○鐵本 智大¹, 大岡 勇太¹, 伏見 亮大¹, 田 邉 孝純¹	1.慶大理工
	10:15 - 10:30	奨 13a-A10-6	SiCナノビームフォトニック結晶共振器の設計(3)	○山口 祐樹¹, 田 昇愚¹, 宋 奉植¹², 浅野 卓¹, 田中 良典¹, 野田 進¹	1.京大院工, 2.成均館大
	10:30 - 10:45		休憩/Break		
	10:45 - 11:00	13a-A10-7	L3 型Ge フォトニック結晶ナノビーム共振器における共振器モード (Q>1,300)の観測	○黒木 理宏¹, 加古 敏¹, 石田 悟己¹, 小田 克矢², 井戸 立身², 岩本 敏¹, 荒川 泰彦¹	1.東大生研/ナノ量子機構, 2.日立中の
	11:00 - 11:15	13a-A10-8	InGaAsP埋込みヘテロ構造をもつフォトニック結晶ナノ共振器による 微小光変調器	○野崎 謙悟 <sup>1,2</sup> ディヌレスク シルビウ <sup>2</sup> , 松尾 慎治 <sup>1,3</sup> 藤井 拓郎 <sup>1,3</sup> ,武田 浩司 <sup>1,3</sup> ,倉持 栄 − <sup>1,2</sup> ,納富 雅也 <sup>1,2</sup>	1.NTT NPC, 2.NTT物性基礎研, 3.NTT先端集積デバイス研
	11:15 - 11:30	奨 13a-A10-9	フォノニック結晶共振器を用いた光弾性変調器の特性解析	○金 仁基¹, 岩本 敏¹², 荒川 泰彦¹²	1.東大生研, 2.東大ナノ量子機構
	11:30 - 11:45	13a-A10-10	フォトニック結晶光ディテクタと変調器の連結による波長変換回路の 構成	○野崎 謙悟1.2, 松尾 慎治1.3, 納富 雅也1.2	1.NTT NPC, 2.NTT物性基礎研, 3.NTT先端集積デバイス研
	11:45 - 12:00	奨 13a-A10-11	表面にフォトニック結晶を形成したmc-Si太陽電池の理論解析	○川本 洋輔¹, 田中 良典¹, 石崎 賢司¹, De Zoysa Menaka¹², 梅田 尚実¹, 基平 暉人¹, 藤田 奨也¹, 浅野 卓¹, 野田 進¹	1.京大院工, 2.京大白眉
	12:00 - 12:15	13a-A10-12	フォトニック結晶µc-Si太陽電池の作製―表面層のみへのフォトニック 結晶形成効果の検討ー	○梅田 尚実¹, 元平 暉人¹, 石崎 賢司¹, De Zoysa Menaka¹², 田中 良典¹, 川本 洋輔¹, 藤田 奨也¹, 野田 進¹	1.京大院工, 2.京大白眉

	3月13日(金	16:30 - 18:4	45		
招待	16:30 - 17:00	13p-A10-1	「第5回女性研究者研究業績・人材育成賞(小舘香椎子賞)受賞記念講演」(30分) フォトニック結晶レーザによる新奇集光ビームの生成とその応用	〇北村 恭子1	1.京大
	17:00 - 17:15	13p-A10-2	Design of Super-Robust All-Dielectric Zero Index Material	OShota Kita <sup>1</sup> , Yang Li <sup>1</sup> , Philip Munoz <sup>1</sup> , Orad Reshef <sup>1</sup> , Daryl Vulis <sup>1</sup> , Bobby Day <sup>1</sup> , Charles Lieber <sup>1</sup> , Eric Mazur <sup>1</sup> , Loncar Marko <sup>1</sup>	1.Harvard Univ.
	17:15 - 17:30	13p-A10-3	Demonstration of Super-Robust All-Dielectric Zero Index Material	OShota Kita <sup>1</sup> , Yang Li <sup>1</sup> , Philip Munoz <sup>1</sup> , Orad Reshef <sup>1</sup> , Daryl Vulis <sup>1</sup> , Bobby Day <sup>1</sup> , Charles Lieber <sup>1</sup> , Eric Mazur <sup>1</sup> , Loncar Marko <sup>1</sup>	1.Harvard Univ.
	17:30 - 17:45	奨 13p-A10-4	フォトニック結晶スローライト導波路での光誘起ドップラーシフト	○近藤 圭祐¹, 馬場 俊彦¹	1.横国大院工
	17:45 - 18:00	13p-A10-5	広帯域低分散スローライトを発現するシリカクラッドフォトニック結晶導 波路のメカニズムの考察と最適化	○田村 卓也¹, 近藤 圭祐¹, 馬場 俊彦¹	1.横国大院工
	18:00 - 18:15	13p-A10-6	マイクロキャビティ構造からの波長選択性熱ふく射スベクトル狭帯 域化	○(DC)小桧山 朝華¹, 清水 信¹, 井口 史匡¹, 湯上 浩雄¹	1.東北大院工
	18:15 - 18:30	13p-A10-7	低消費電力・狭帯域熱輻射光源の開発	○井上 卓也¹, De Zoysa Menaka¹², 浅野卓¹, 野田 進¹	1.京大院工, 2.京大白眉
	18:30 - 18:45	13p-A10-8	狭帯域近赤外Siフォトニック結晶熱輻射光源の検討(VI)	○末光 真大², 橋本 康平¹, 浅野 卓¹, 堤 達 紀¹, De Zoysa Menaka³, 野田 進¹	1.京大院工, 2.大阪ガス, 3.京大白眉

3.12	ナノ領域光	科学・近接場光	学 $/$ Nanoscale optical science and near-field option $/$	cs      口頭講演	
	3月11日(水	9:00 - 12:3	0		
召待	9:00 - 9:15	11a-A12-1	「講演奨励賞受賞記念講演」(15分) 金ナノロッドによる中赤外超短パルス電場の共鳴増強と光電界放出	○草 史野 <sup>1,2</sup> , エヒテルンカンプ カタリナ³, ロパース クラウス³, 芦原 聡 <sup>2</sup>	1.農工大院工, 2.東大生研, 3.ゲッティ ンゲン大
	9:15 - 9:30	11a-A12-2	A nanoscale vacuum-tube diode triggered by few-cycle laser pulses	○(P)Higuchi Takuya¹, Hommelhoff Peter¹	1.University of Erlangen-Nuremberg
	9:30 - 9:45	11a-A12-3	中赤外光スロットアンテナによる光増強効果の垂直方向依存性(II)	○(M1)國近 祐太¹, 川野 貴裕¹, 宮田 純一¹, 山本 悠人¹, 西村 悠希¹, 笠原 健一¹, 家路豊成², 池田 直樹³, 大里 啓考³, 杉本 喜正³	1.立命館大理工, 2.立命館大 SR センター, 3.物質・材料研究機構
	9:45 - 10:00	11a-A12-4	Alの異方性アノードエッチングにもとづいた熱放射制御構造の放射 波長制御	近藤 敏彰¹, ○長谷川 駿¹, 木村 直史², 吉岡 文孝², 豊永 隆², 益田 秀樹¹	1.首都大都市環境, 2.オキツモ
	10:00 - 10:15	11a-A12-5	大面積プラズモニックメタ表面における共鳴調整と界面改質	〇岩長 祐伸¹, 崔 峯碩¹, 宮崎 英樹¹, 杉本喜正¹, 迫田 和彰¹	1.物材機構
	10:15 - 10:30	奨 11a-A12-6	プラズモニック結晶キャビティによる発光の制御	○斉藤 光¹, 山本 直紀¹	1.東工大
	10:30 - 10:45		休憩/Break		
	10:45 - 11:00	11a-A12-7	近接場光顕微鏡を用いた中赤外ログスパイラルアンテナの解析	○藤村 直紀¹, 石川 昴¹, 陸 昴義¹, 小田 俊 理¹, 河野 行雄¹	1.東工大量子ナノ研セ
	11:00 - 11:15	11a-A12-8	GaAs/Ti ストライプ構造における LO フォノン周波数での赤外光吸収	○(B)竹内 映人¹, 石谷 善博¹, 森田 健¹, 馬 蓓¹	1.千葉大工
	11:15 - 11:30	奨 11a-A12-9	湾曲金ナノロッドダイマー構造とV字型金ナノダイマー構造の光学特性の比較	○横田 幸恵¹, 田中 拓男¹²	1.理研, 2.北大電子研
	11:30 - 11:45	11a-A12-10	テラヘルツ帯域に共鳴を有する光アンテナ構造の分光特性と分子計 測への応用	○上野 貢生¹, 野澤 翔¹, 三澤 弘明¹	1.北大電子研
	11:45 - 12:00	11a-A12-11	プラズモニック結晶のリング状欠陥 - 四重極子モード -	○酒井 恭輔¹, 山本 岳明¹, 大村 竜矢¹, 笹木 敬司¹	1.北大 電子研
	12:00 - 12:15	11a-A12-12	メタマテリアルレンズアレーを実装した超解像光学顕微鏡	○岩長 祐伸¹	1.物材機構
	12:15 - 12:30	11a-A12-13	力検出を用いた近接場光イメージングの高さ依存性観測	○山西 絢介¹, 徳山 貴士¹, 内藤 賀公¹, 李 艶君¹, 菅原 康弘¹	1.阪大院工
	3月11日(水	14:00 - 18:	00		
召待	14:00 - 14:15	11p-A12-1	「講演奨励賞受賞記念講演」(15分) 深紫外プラズモニクスにおけるインジウムとアルミニウムの利用	〇熊本 康昭 <sup>1</sup> , 齊藤 結花 <sup>2</sup> , 田口 敦清 <sup>2</sup> , 本田 光裕 <sup>2</sup> , 河田 聡 <sup>1,2</sup>	1.理研, 2.阪大院工
	14:15 - 14:30	奨·E 11p-A12-2	Characterization of Step, Ridge, and Crack Submicro/Nano- structure on Epitaxial Graphene using Tip-enhanced Raman Spectroscopy	○(D)Sanpon Vantasin¹, Yoshito Tanaka¹, Ichiro Tanabe¹, Toshiaki Suzuki¹, Tamitake Itoh², Yasunori Kutsuma¹, Koji Ashida¹, Tadaaki Kaneko¹, Yukihiro Ozaki¹	1.Kwansei Gakuin Univ., 2.AIST
	14:30 - 14:45	11p-A12-3	TERS顕微鏡のためのマルチグレインプローブ	○田口 敦清1.2, 河田 聡1.2	1.阪大工, 2.理研
	14:45 - 15:00	11p-A12-4	表面増強ラマン散乱法を用いたブラズモニック光化学反応の追跡	○(PC)山本 裕子 <sup>1,2</sup> , 茅野 優也 <sup>1</sup> , 伊藤 民武 <sup>3</sup> , 中西 俊介 <sup>1</sup>	1.香川大工, 2.学振RPD, 3.産総研四
	15:00 - 15:15	11p-A12-5	単一SERSホットスポットにおけるスペクトル変化分析	○伊藤 民武¹, 山本 裕子², 田丸 博晴³, バス デバンピライ ビジュ¹, 脇田 慎一¹	1.産総研健工, 2.香大工, 3.東大院工
	15:15 - 15:30	11p-A12-6	アンチストークス近接場蛍光を使ったナノ領域の温度測定	○山本 賢¹, 藤村 隆史¹, 梶川 浩太郎¹	1.東工大総理工
	15:30 - 15:45		休憩/Break		
	15:45 - 16:00	11p-A12-7	ドレスト光子利用波長変換フィルムによる結晶シリコン太陽電池の 高効率化	○川添 忠¹, 雨海 千秋¹, 大津 元一¹	1.東大工
	16:00 - 16:15	11p-A12-8	ドレスト光子フォノン援用アニールで作製されたSi-LED中のドーバント分布の特徴	○川添 忠¹, 大津 元一¹	1.東大工
	16:15 - 16:30	奨 11p-A12-9	フォトンブリーディング効果によるSi-LEDの偏光制御	○西岡 克紘¹, 川添 忠¹, 大津 元一¹	1.東大工
	16:30 - 16:45	奨 11p-A12-10	レーザードーピングによる可視発光 Si-LED の開発	〇山口 真生¹, 西岡 克紘¹, 川添 忠¹, 大津 元一¹	1.東大院工
	16:45 - 17:00	奨 11p-A12-11	ドレスト光子を用いた増幅型のSi青-紫外光検出器	○(M1)池川 晶貴¹, 川添 忠¹, 大津 元一¹	1.東大院工
	17:00 - 17:15	11p-A12-12	ドレスト光子を利用したSiレーザー導波路の光増輻利得の評価	○田中 肇¹, 川添 忠¹, 大津 元一¹, 赤羽 浩 一², 山本 直克²	1.東大工, 2.情通機構
	17:15 - 17:30	奨 11p-A12-13	ドレスト光子フォノン援用過程を用いたGaP LEDスペクトルの加工 条件依存性	○(D)金 俊亨¹, 川添 忠¹, 大津 元─¹	1.東大院工
	17:30 - 17:45	11p-A12-14	ドレスト光子フォノンエッチングによる半導体の表面損傷の修復	○野村 航¹, 川添 忠¹, 八井 崇¹, 大津 元一¹	1.東大院工

17:45 - 18:00	11p-A12-15	DPPエッチングを利用したナノダイヤモンドの発光制御	○南雲 亮佑¹, Brandenburg Felix¹, 八井 崇	1.東京大, 2.ウルム大
			1, Ermakova Anna², Jelezko Fedor²	1.朱尔人, 2.7 ルム人
3月12日(木	9:00 - 12:1	5		
9:00 - 9:15	12a-A12-1	Theory of the Single Susceptibility equally associated with Non-radiative and Radiative Fields in Optics IV	○Itsuki Banno¹	1.Univ. of Yamanashi
9:15 - 9:30	12a-A12-2	3Dプリンター造形バフ研磨エバネッセント光原子ファネル	○横山 雄大¹, 吉田 貴広¹, 佐川 研太¹, 伊藤 治彦¹	1.東工大総理工
9:30 - 9:45	12a-A12-3	近接場光原子センシング用ナノスリットのエッジ急峻化	○(M2)永井 弥夕¹, 鈴木 匠¹, 伊藤 治彦¹	1.東工大総理工
9:45 - 10:00	12a-A12-4	金属ナノスリットを用いた可変回折レンズの開発	山中 裕貴¹, 大津 朋也¹, 石井 智², ○山 □ 堅三¹	1.香川大工, 2.物材機構
10:00 - 10:15	奨 12a-A12-5	石英基板上での単結晶銀ナノ粒子の作製と評価	○森 智博 <sup>1,2</sup> , 田中 康弘¹, 須崎 嘉文¹, 山 口 堅三¹	1.香川大工, 2.和歌山工技セ
10:15 - 10:30	奨 12a-A12-6	銀ナノ石畳構造を利用した新規反射防止構造	○安田 英紀¹, 松野 亮², 谷 武晴¹, 納谷 昌之¹	1.富士フイルム先端研, 2.富士フイ 産技術センター
10:30 - 10:45	12a-A12-7	FDTD計算による多層積層銀ナノ粒子シートの紫外・可視吸収機構 の解明	〇田中 大輔 <sup>1</sup> , 出川 亮 <sup>2</sup> , Li Xinheng <sup>2</sup> , 岡本 晃一 <sup>2</sup> , 玉田 薫 <sup>2</sup>	1.大分高専, 2.九大先導研
10:45 - 11:00		休憩/Break		
11:00 - 11:15	12a-A12-8	金ナノ粒子を介した金薄膜の光透過	藤井 一輝¹, 藤村 隆史¹, 下条 雅幸², ○梶 川 浩太郎¹	1.東工大総合理工, 2.芝浦工大工
11:15 - 11:30	12a-A12-9	固体表面に担持した金属ナノクラスターの光吸収	○飯田 健二¹, 野田 真史¹, 信定 克幸¹	1.分子研
11:30 - 11:45	12a-A12-10	金属ナノ粒子分散液晶メタマテリアルにおけるDyakonov表面波	○松井 龍之介1.2	1.三重大院工, 2.三重大極限ナノコ
11:45 - 12:00	12a-A12-11	蓮の葉をバイオテンプレートに使った黒体メタマテリアル	○海老原 佑亮¹, 下条 雅幸², 梶川 浩太郎¹	1.東京工大, 2.芝浦工大
12:00 - 12:15	12a-A12-12	反射光検出型LSPRガスセンサの検討	○加沢 エリト¹, 紋川 亮¹	1.都産技研
3月13日(金	9:00 - 12:3	0		
9:00 - 9:15	奨 13a-A12-1	表面プラズモンを介した光ビート信号による電子回路の動作	○酒井 宏基¹, 岡久 真也¹, 相原 卓磨¹, 福原 誠史¹, 石井 佑弥¹, 福田 光男¹	1.豊技大
9:15 - 9:30	13a-A12-2	高分子系有機EL素子の薄膜化とそれに伴う表面プラズモンの散乱 特性	○乾 貴大¹, 川瀬 博人¹, 溝口 雄太¹, 米田 拓也¹, 笠原 健一¹, 池田 直樹², 大里 啓孝 ², 杉本 喜正²	1.立命大理工, 2.物質·材料研究機
9:30 - 9:45	13a-A12-3	金属ナノ構造中の局在プラズモン場の高空間分解分光イメージング	○安田 有輝¹, 藤原 英樹¹, 酒井 恭輔¹, 石田 周太郎¹, 田中 嘉人², 笹木 敬司¹	1.北大電子研, 2.関西学院大
9:45 - 10:00	奨 13a-A12-4	非同径ポンプ・プローブレーザー励起顕微鏡法による局所励起表面プラズモン波束のフェムト秒時間分解映像	○加藤 佳祐¹, 久保 敦¹	1.筑波大物理
10:00 - 10:15	奨 13a-A12-5	金属ナノブリッジにおける表面プラズモン伝搬	○(M1)長崎 裕介¹, 宮田 将司¹, 高原 淳一¹.2	1.阪大院工, 2.阪大フォトニクスセ
10:15 - 10:30	13a-A12-6	Gap plasmon resonance in a film-coupled floating gold nanowire	○(DC)宮田 将司¹, Aaron Holsteen², 長崎裕介¹, Mark L. Brongersma², 高原 淳一¹.3	1.阪大院工, 2.GLAM, Stanford U 3.阪大フォトニクセ
10:30 - 10:45	13a-A12-7	陽極酸化ポーラスアルミナにもとづいた同軸ナノケーブルアレーの形成と集光デバイスへの応用	○近藤 敏彰¹, 堀 龍太郎¹, 柳下 崇¹, 益 田 秀樹¹	1.首都大都市環境
10:45 - 11:00		休憩/Break		
11:00 - 11:15	13a-A12-8	銀溥膜の表面プラズモンによる酸化亜鉛の可視発光増強:銀膜厚 依存性	○(M2)肖 貴宝¹, 中村 俊博¹, 安達 定雄¹	1.群馬大院理工
11:15 - 11:30	13a-A12-9	銀ナノキューブ担持酸化チタンの非対称な光学挙動およびその制御	○齋藤 滉一郎¹, 田邉 一郎¹, 立間 徹¹	1.東大生研
11:30 - 11:45	13a-A12-10	プラズモニック多層ナノ粒子によるアップコンバージョン増強(I)	〇山本 薫¹, 大瀬 昌明¹, 今北 健二¹, 藤 井 稔¹	1.神戸大院工
11:45 - 12:00	13a-A12-11	金ナノ粒子-シリコンナノ結晶複合体の発光特性(I)	〇井上 飛鳥¹, 杉本 泰¹, 今北 健二¹, 藤 井 稔¹	1.神戸大工
12:00 - 12:15	13a-A12-12	シリカで被覆したポリスチレン@Auコアシェル粒子の2光子励起蛍光 増大への応用	○志野木 駿伍¹, 加藤 徳剛¹	1.明大理工
	奨 13a-A12-13	局在増強電場下での量子干渉効果と高効率2光子上方変換	○(D)逢坂 良樹¹, 余越 伸彦¹, 中谷 正俊	1.阪府大院工

3.12	ナノ領域光科学・近	妾場光学 $/$ Nanoscale optical science and near-field o	ptics ポスター講演	
	3月13日(金) 16:3	0 - 18:30		
	13p-P3-	遠紫外表面プラズモンセンサーの開発	○田中 嘉人¹, 領木 貴之¹, 田邉 一郎¹, 後藤 剛善¹, 黄川田 昌和², 居波 涉²³, 川田 善正 ²³, 尾崎 幸洋¹	1.関西学院大理工, 2.静大院工, 3.JST- CREST
	13p-P3-	導波路クレッチマン型SPRセンサの高感度化・広測定範囲化の検記	付 ○(M2)日高 直哉¹, 黒田 康彰¹, 松島 裕一², 石川 浩¹, 宇高 勝之¹	1.早大理工, 2.GCS研究機構
	13p-P3-	一次元金属回折格子を用いた伝搬型表面プラズモンセンサーによ 高屈折率媒質の検出	る ○水戸 慎也¹, 元垣内 敦司¹², 三宅 秀人¹², 平松 和政¹²	1.三重大院工、2.三重大極限ナノエレセンター
	13p-P3-	金属ナノスリットを用いた可変回折レンズの機構設計	○山口 堅三', 山中 裕貴', 大津 朋也', 石井 智²	1.香川大工, 2.物材機構
	13p-P3-	石英基板上での銀成膜段階における結晶粒成長機構	○森 智博 <sup>1,2</sup> , 田中 康弘 <sup>1</sup> , 須崎 嘉文 <sup>1</sup> , 山 口 堅三 <sup>1</sup>	1.香川大工, 2.和歌山工技セ
	13p-P3-	金属ナノ構造との相互作用検証のための蛍光微小球配置技術の限	開発 ○田崎 俊¹, 谷口 敏規¹, 齋藤 蘭¹, 岡本 敏 弘¹, 原口 雅宣¹	1.徳島大院
	13p-P3-	金ナノロッド/非線形光学ポリマー複合型非線形光学素子のポリマ 積層条件による最適化	一 ○棚倉 悠史¹, 平林 拓磨¹, 二橋 俊介¹, 小野 篤史¹, 川田 善正¹, 杉田 篤史¹	1.静岡大工
	13p-P3-	ナノロッドアレイによる赤外域での電場増強と表面増強赤外吸収	○竹上 明伸 <sup>1,2</sup> , 草 史野 <sup>1,2</sup> , 生嶋 健司 <sup>1</sup> , 芦 原 聡 <sup>2</sup>	1.農工大工, 2.東大生研
	13p-P3-	近赤外域に共鳴をもつ金ナノロッドの合成とその非線形光学応答の 評価	D ○萬 大輔', 草 史野', 田山 純平², 西 弘泰², 立間 徹², 芦原 聡²	1.農工大(工), 2.東大生研
	13p-P3-	金 / 銀 / 銅合金系の複素誘電率と結晶構造の評価	○橋本 佳和¹, 西島 喜明¹, Gediminas Seniutinas², Saulius Juodkazis², Lorenzo Rosa²	1.横国大院工, 2.スインバーン工科大学
	13p-P3-	1 Pt薄膜上へのPtコート極細糸の配置によるPt複素屈折率の変化の 可能性	○但馬 文昭¹, 西山 善郎¹	1.横国大教

13p-P3-12	ルビジウム原子2光子遷移スペクトルの励起レーザーパワー依存性	○(M2)真下 太郎¹, 伊藤 拓馬¹, 小林 豊¹, 柴田 康介¹, 東條 賢¹	1.中央大理工
13p-P3-13	レーザー冷却原子観測のための高解像度測定の実現	○(M2)須永 裕司¹, 柴田 康介¹, 東條 賢¹	1.中央大理工
13p-P3-14	近接場マルチプローブ顕微鏡による半導体量子井戸内の励起輸送 観察(V)	○三輪 嘉彦!, 大久保 領!, 酒井 優!, 東海林 篤!, 內山 和治!, 小林 潔!, 松本 俊!, 岸野 克巳², 堀 裕和!	1.山梨大院医工, 2.上智大理工
13p-P3-15	二重トンネル接合された金ナノロッド系における近接場光分布と電流- 電圧特性の相関	○西川 直樹¹, 内山 和治¹, 久保田 悟¹, 小林 潔¹, 堀 裕和¹	1.山梨大工
13p-P3-16	金属ナノ構造体における超高速プラズモン場の時空間制御のモデ ル計算	○(B)小島 康裕¹, 正木 雄太¹, 藤間 一憲¹, 神成 文彦¹	1.慶大理工
13p-P3-17	フェムト秒レーザ波形整形による回折格子結合超高速表面プラズモン バルス及び非線形放射制御	○正木 雄太¹, 藤間 一憲¹, 廣澤 賢一¹, 神成 文彦¹	1.慶大理工
13p-P3-18	金属マルチスリットを組み込んだLED構造による表面プラズモンポラリトン発生素子の検討	○大正谷 皓司¹, 村中 隆二¹, 原口 雅宣¹, 岡本 敏弘¹, 井須 俊郎¹, 福井 萬壽夫¹	1.徳島大工
13p-P3-19	高効率熱光発電のためのNiW熱輻射光源の分光計測	○穴澤 勇人¹, 那 順², 岩見 健太郎², 梅 田 倫弘²	1.農工大工, 2.農工大院工
13p-P3-20	高効率吸収材料とプラズモニクスを融合した光熱発電モデルの構築	○小松 諒祐', 山村 拓也', 西島 喜明', GEDIMINAS SENIUTINAS², SAULIUS JUODKAZIS²	1.横国大院工, 2.スインバーン工科大学
13p-P3-21	プラズモン共振器を含むトレンチ型導波路の透過特性解析	○岡本 浩行¹, 目下 晃佑¹, 山口 堅三², 原口 雅宣³, 岡本 敏弘³	1.阿南高専, 2.香川大工, 3.徳島大院
13p-P3-22	プラズモニック導波路を用いた温度計測デバイスの検討	○日下 晃佑¹, 岡本 浩行¹, 山口 堅三², 原口 雅宣³, 岡本 敏弘³	1.阿南高専, 2.香川大工, 3.徳島大学院
13p-P3-23	ハーフコアシェルMIM構造による磁気共鳴	○藤井 鐘多¹, 藤村 隆史¹, 梶川 浩太郎¹	1.東工大総理工
13p-P3-24	TERS探針先端における増強電場のFDTD計算解析	北濱 康孝¹, 鈴木 利明², 尾崎 幸洋³, ○伊藤 民武¹	1.産総研健工, 2.ユニソク, 3.関学理工
奨 13p-P3-25	V型溝を組み合わせたAuアバーチャーアンテナによるナノ円偏光生成 の波長依存性	○(DC)蔡 永福¹, 池田 壮志¹, 中川 活二², 菊池 宏³, 清水 直樹³, 石橋 隆幸¹	1.長岡技科大, 2.日大理工, 3.NHK技研
13p-P3-26	格子構造近傍における局所偏光場の空間プロファイルのFDTD解析	清水 健史¹, 大平 泰生¹, ○岡 寿樹²	1.新潟大工, 2.新潟大超域
13p-P3-27	2次元空間におけるメタマテリアルの検討	○日野 湧也¹, 市川 裕之¹	1.愛媛大院理工
13p-P3-28	局在光と分子振動の相互作用	○岩佐 豪¹, 武次 徹也¹	1.北大院理

3月12日(木	9:00 - 13:0	0		
9:00 - 9:15	12a-A17-1	バイオテンプレート極限加工を用いたGeナノディスクの作製と光学 特性	○藤井 拓也 <sup>1,2</sup> , 磯田 大河 <sup>3,5</sup> , シェンティエル モハメッド タハール <sup>1,4</sup> , 遠藤 広考 <sup>2</sup> , 伊藤 公 平 <sup>3,5</sup> , 寒川 誠二 <sup>1,4,5</sup>	1.東北大·流体研, 2.本田技術研究所, 3.慶應大·理工, 4.東北大WPI-AIMR, 5.JST-CREST
9:15 - 9:30	E 12a-A17-2	Change in Photo Induced Minority Carrier Lifetime of PN Junction with Bias Voltage	○(B)Takayuki Motoki¹, Keisuke Yasuta¹, Shousuke Saitou¹, Hidenao Suzuki¹, Shousuke Kimura¹, Tomohiko Nakamura¹, Masahiko Hasumi¹, Toshiyuki Samesima¹	1.TUAT
9:30 - 9:45	12a-A17-3	電力置換法による太陽電池エネルギー変換効率の測定	○齋藤 輝文¹², 阿部 大和¹, 佐藤 宏樹¹, 武澤 港斗²	1.東北工大工, 2.東北工大院工
9:45 - 10:00	12a-A17-4	${\rm Ga\ _2O\ _3}/{\rm CuInGaSe\ _2}$ ヘテロ接合ダイオードにおける光電流増 倍現象	○菊地 健司¹, 為村 成亨¹, 宮川 和典¹, 大竹浩¹, 久保田 節¹, 中田 時夫²	1.NHK技研, 2.東理大総研
10:00 - 10:15	12a-A17-5	近接障壁層の構造変化よる量子ドット赤外線検出器の検知波長制御	○各務 惣太 <sup>1,2</sup> , 田中 朋 <sup>1</sup> , 角田 雅弘 <sup>2</sup> , 渡 邉 克之 <sup>3</sup> , 山本 剛 <sup>1,2</sup> , 白根 昌之 <sup>1,2</sup> , 萬 伸一 <sup>1,2</sup> , 荒川 泰彦 <sup>2,3</sup>	1.NECスマエネ研, 2.東大ナノ量子機構 3.東大生研
10:15 - 10:30	12a-A17-6	プラズモニックナノギャップアンテナを利用した電荷敏感型赤外光子 検出器(CSIP)	○金 鮮美¹, 小宮山 進²³, 佐藤 崇¹, パトラシン ミハイル³, 梶原 優介¹	1.東大生研, 2.東大総文, 3.情通研
10:30 - 10:45	12a-A17-7	テーパー構造を有する電界制御型分岐比可変多モード干渉カプラー の損失低減の検討	○金子 慎¹, 川崎 直道¹, 盧 柱亨¹, 荒川 太郎¹	1.横国大院工
0:45 - 11:00	12a-A17-8	マイクロリング装荷型マッハツェンダー2×2光スイッチの設計	○堀 健人¹, 西村 真樹¹, 荒川 太郎¹, 國 分 泰雄¹	1.横国大院工
11:00 - 11:15	12a-A17-9	EOポリマ/TiO $_2$ 多層薄膜スロット導波路光変調器におけるバリア層とクラッド層による電気光学係数の増強	○中村 英弘¹, Jouane Youssef¹, Luo J.², Jen Alex K-Y.², 榎波 康文¹	1.高知工科大学, 2.ワシントン大学
11:15 - 11:30		休憩/Break		
11:30 - 11:45	12a-A17-10	混晶化法を用いたAIAs選択酸化に関する基礎実験	○魏 徹¹, 宮本 智之¹	1.東工大·精研
11:45 - 12:00	E 12a-A17-11	Fabrication of SiC Membrane High Contrast Grating Using Nanoimprint Lithography	(D)YingYu Lai <sup>1,2</sup> , Shunya Inoue <sup>1</sup> , Tien- Chang Lu <sup>2</sup> , Shing-Chung Wang <sup>2</sup> , Fumio Koyama <sup>1</sup>	1.TIT, 2.NCTU
12:00 - 12:15	奨 12a-A17-12	横方向複合共振器面発光レーザのVernier効果による横モード制御	○(PC)中濱 正統¹, 小林 拓貴¹, 丸山 彰¹, 坂口 孝浩¹, 松谷 晃宏², 小山 二三夫¹	1.東工大精研, 2.半導体MEMSプロセニ 技術センター
12:15 - 12:30	12a-A17-13	励起準位を用いたVCSELの動作温度範囲拡大	○(M2)角田 健¹, 松谷 晃宏², 宮本 智之¹	1.東工大 精研, 2.東工大 技術部
12:30 - 12:45	E 12a-A17-14	Chirp Reduction Along with Modulation Bandwidth Enhancement Utilizing Coupled Cavity VCSEL	○(M1)Shanting Hu¹, Fumio Koyama¹	1.Titech
12:45 - 13:00	E 12a-A17-15	Fabrication and photoluminescence characterization of cap- sule-shaped metallic InP/InGaAs cavity structures	○(D)Baifu Zhang¹, Takuya Okimoto¹, Takuo Tanemura¹, Yoshiaki Nakano¹	1.The Univ. of Tokyo

召待	14:00 - 14:15	12p-A17-1	「講演奨励賞受賞記念講演」(30分)	〇川端 祐斗¹, 財津 優¹, 種村 拓夫¹, 中	1.東大院工
			ハーフリッジ型導波路構造を用いたInPモノリシック偏波変調器の 試作と実証	野 義昭1	
	14:15 - 14:30	奨 12p-A17-2	Optical interconnection between III-V chips on Si by using photonic wire bonding	○(M2)ZhiChen Gu¹, Tomohiro Amem- iya²³, Atsushi Ishikawa³, Yuki Atsumi⁴, JoonHyun Kang¹, Takuo Hiratani¹, Nobuhiko Nishiyama¹, Takuo Tanaka³, Shigehisa Arai¹²	1.Tokyo Tech, 2.QNERC, 3.RIKEN, 4.AIST
	14:30 - 14:45	12p-A17-3	スポットサイズ変換器集積GaAs基板上量子ドットレーザ	○植竹 理人', 高林 和雅', 木村 徳治', 山本剛之', 山口 正臣², 高田 幹², 武政 敬三², 菅原 充², 荒川 泰彦³	1.富士通研, 2.QDレーザ, 3.東大ナノ 量子機構
	14:45 - 15:00	12p-A17-4	近赤外広帯域光源を目指したInAs 量子ドットLD の発光特性[2]	○沢渡 義規¹, 吉沢 勝美¹, 赤羽 浩一², 山 本 直克²	1.パイオニアマイクロテクノロジー㈱, 2.情通機構
	15:00 - 15:15	12p-A17-5	1.1μm帯広帯域量子ドットリッジ導波路型LDの開発	○吉沢 勝美¹, 沢渡 義規¹, 赤羽 浩一², 山 本 直克²	1.パイオニアMTC, 2.情報通信研究機構
	15:15 - 15:30	12p-A17-6	p 変調ドーブInAs/InP ダブルキャップ量子ドット構造の電流注入特性	○(M1)鋤柄 俊樹¹, 山元 雄太¹, 西山 哲央¹, 下村 和彦¹	1.上智大理工
	15:30 - 15:45	12p-A17-7	(775)B InP 基板上にMBE成長したInGaAs層のコラゲーションと光学的特性のIn組成依存性	○松田 晃賢¹, 下村 哲¹, 森貞 俊¹	1.愛媛大院理工
	15:45 - 16:00	12p-A17-8	ウエハ接合で形成した量子ドット結合共振器による二波長面発光レ ーザ構造の作製	原山 千穂¹, ○太田 寛人¹, 前川 知久¹, 盧 翔孟¹, 熊谷 直人¹, 北田 貴弘¹, 井須 俊郎¹	1.徳島大院フロンティア
	16:00 - 16:15	12p-A17-9	InAs/InGaAsP歪み量子ドット構造半導体の量子準位の解析	○山口 萌花¹, 新井 暢子¹, 結女 井出¹, 今 井 元¹	1.日女大理
	16:15 - 16:30		休憩/Break		
	16:30 - 16:45	奨 12p-A17-10	BJB構造を有する半導体薄膜分布反射型レーザの室温連続動作	○平谷 拓生¹, 井上 大輔¹, 冨安 高弘¹, 厚地 祐輝¹, 雨宮 智宏², 西山 伸彦¹, 荒井 滋久¹²	1.東工大, 2.東工大量子ナノ
	16:45 - 17:00	奨 12p-A17-11	GaInAsP/InP半導体薄膜レーザの低電圧動作	○厚地 祐輝¹, 福田 快¹, 平谷 拓生¹, 井上 大輔¹, 雨宮 智宏², 西山 伸彦¹, 荒井 滋久¹²	1.東工大電電, 2.量子ナノ
	17:00 - 17:15	12p-A17-12	直接貼付InP/Quartz基板上GaInAs/InP MQW LEDの電流注入 動作	○松本 恵一¹, 高巣 誠¹, 金谷 佳則¹, 岸川 純也¹, 下村 和彦¹	1.上智大理工
	17:15 - 17:30	12p-A17-13	直接貼付InP/Si基板における接合状態評価	○(M1)岸川 純也¹, 松本 恵一¹, 金谷 佳則¹, 下村 和彦¹	1.上智大理工
	17:30 - 17:45	奨 12p-A17-14	急速加熱処理により作製したGeSn-on-quartz構造のフォトルミネッセンス測定	○(M1)天本 隆史¹, 冨永 幸平¹, 梶村 恵子¹, 細井 卓治¹, 志村 孝功¹, 渡部 平司¹	1.阪大院工
	17:45 - 18:00	12p-A17-15	III-V-OI基板上における量子井戸インターミキシングの検討	○高島 成也 <sup>1,2</sup> , 一宮 佑希 <sup>1,2</sup> , 竹中 充 <sup>1,2</sup> , 高 木 信一 <sup>1,2</sup>	1.東大院工, 2.JST-CREST
	18:00 - 18:15	12p-A17-16	Fイオン注入と熱処理によるGaAsP 歪量子井戸選択的無秩序化を用いた導波光伝搬損失低減	奥田 真也¹, ○上向井 正裕¹, 栖原 敏明¹	1.阪大院工
	18:15 - 18:30	12p-A17-17	高効率動作を目的とした共振点シフトDFB-LDの提案と解析	○(M1)市川 敬一郎¹	1.立命館大理工
	18:30 - 18:45	12p-A17-18	Spin-LEDにおける円偏光へリシティーの高速切替え実験	○青山 政樹¹, 西沢 望¹, 西林 一彦¹, 宗 片 比呂夫¹	1.東工大像情報
	18:45 - 19:00	12p-A17-19	265nm深紫外LEDの光取出し効率向上による90mW高出力動作 の実証	○井上 振一郎¹, 溜 直樹¹², 谷口 学¹, 中屋 晃成¹, 木下 亨², 小幡 俊之², 柳 裕之²	1.情報通信研究機構, 2.トクヤマ

3.13 半導体光デバイス / Semiconductor optical devices ポスター講演							
	3月13日(金)	3月13日(金) 16:30 - 18:30					
		13p-P4-1	高密度InAs歪量子ドットを活性層に含むリッジレーザの作製と評価	○伴 龍太郎¹, 菅原 宏治¹, 赤羽 浩一², 山 本 直克²	1.首都大SD, 2.情通機構		
		13p-P4-2	非対称結合量子井戸における励起子吸収を考慮したフォトダイオード の光応答特性シミュレーション	○坂口 浩一郎¹, 船木 洸希¹, 福嶋 丈浩¹, 徳田 安紀¹	1.岡山県立大		
		13p-P4-3	三角障壁フォトトランジスタによる高感度赤外光検出	○大森 雅登¹, 杉村 和哉¹, 小嶋 友也¹, 加戸作成¹, 野田 武司², Vitushinskiy Pavel¹, 岩田 直高¹, 榊 裕之¹²	1.豊田工大, 2.物材研		

3.5 レーザー装置・材料, 3.14 光制御デバイス・光ファイバーのコードシェアセッション 口頭講演								
3月13日(金) 9:00 - 11:15								
招待	9:00 - 9:15	13a-A13-1	「講演奨励賞受賞記念講演」(15分) 中赤外(9-12μm)光渦レーザーにおける符号制御	〇堀川 マイケル知樹 <sup>1</sup> , 尾川 あずさ <sup>1</sup> , 古城 健司 <sup>1</sup> , 宮本 克彦 <sup>1</sup> , 尾松 孝茂 <sup>1,2</sup>	1.千葉大融合, 2.JST-CREST			
	9:15 - 9:30	奨·E 13a-A13-2	Widely tunable optical vortex parametric laser	(D)ABULIKEMU AIZITIAILI¹, Taximaiti Yusufu¹², Katsuhiko Miyamoto¹, Takashige Omatsu¹²	1.Chiba Univ, 2.JST-CREST			
	9:30 - 9:45	13a-A13-3	マイクロチップレーザー励起中赤外光パラメトリック発生の検討	○石月 秀貴¹, 平等 拓範¹	1.分子研			
	9:45 - 10:00	奨 13a-A13-4	CsLiB6O10結晶を用いた非同軸位相整合方式の高効率 355nm 紫 外光発生	○(D)曲 晨¹, 吉村 政志¹, 高橋 義典¹, 森 勇介¹	1.阪大院工			
	10:00 - 10:15	奨 13a-A13-5	金属/液体電極を用いた電圧印加によるMgO:LiNbO。周期分極反転 構造の作製と緑色光第二高調波発生	○沖野 行佑¹, 栖原 敏明¹	1.阪大院工			
	10:15 - 10:30	奨 13a-A13-6	接合イオンスライスLiNbO。結晶におけるプロトン交換増速エッチングによるリッジ光導波路の作製	○田中 圭祐¹, 栖原 敏明¹	1.阪大院工			
	10:30 - 10:45	奨 13a-A13-7	MgO(8mol%)添加c-LiTaO <sub>3</sub> アニールプロトン交換導波路の作製	○岡 寿治¹, 栖原 敏明¹	1.阪大院工			
	10:45 - 11:00	13a-A13-8	AlGaAs/AlOx 高屈折率差U字導波路における第二高調波発生の 位相整合特性	○中村 勇貴¹, 松下 智紀¹, 近藤 高志¹	1.東大工			
	11:00 - 11:15	奨 13a-A13-9	周期空間反転AlGaAsのAs <sub>2</sub> を用いたMBE成長	○楢崎 亮太¹, 松下 智紀¹, 近藤 高志¹	1.東大工			

3.14	光制御デバイ	イス・光ファイバ	— / Optical control devices and optical fibers	口頭講演		
	3月11日(水)	9:15 - 12:30	)			
	9:15 - 9:30	11a-A13-1	中赤外光アンテナの干渉効果による反射率低減	○(M1)川野 貴裕', 國近 祐太', 西村 悠希 ', 宮田 純一', 山本 悠人', 笠原 健一', 家路 豊成², 池田 直樹³, 大里 啓孝³, 杉本 喜正³	1.立命館大理工, 2.立命館大SRセンター, 3.物質・材料研究機構	
	9:30 - 9:45	11a-A13-2	中赤外用用金属薄膜サブ波長多重格子構造偏光子の挿入損失低 減化	○樋口 翔吾¹, 柿沼 洋¹, 清水 淳¹, 白石 和男¹, 依田 秀彦¹, 六本木 誠¹	1.宇都宮大工	
	9:45 - 10:00	11a-A13-3	非対称・金属/Ge/金属構造を有する光素子の試作と特性評価	○(M1)前蔵 貴行¹, 山本 圭介², 王 冬¹, 中 島 寛²	1.九大総理工, 2.九大産セ	
	10:00 - 10:15	11a-A13-4	スローライト導波路フェイズドアレイフェーズドアレイを用いた二次元ビ ーム掃引に向けた研究の検討	○森 裕之¹, 顧 暁冬¹, 小山 二三夫¹	1.東工大 精研	
	10:15 - 10:30	11a-A13-5	光導波路とエバネッセント結合したGdFe薄膜の磁気光学応答	○岩崎 大和¹, 西林 一彦¹, 松谷 晃宏², 佐藤 美那², 久我 淳³, 宗片 比呂夫¹	1.東工大·像情報, 2.東工大·半導体 MEMS, 3.NHK放送技研	
	10:30 - 10:45	奨 11a-A13-6	フェムト秒レーザーによるYIG光磁気造形を利用した磁気光学回路	○雨宮 智宏 <sup>1,3</sup> , 顧 之琛 <sup>2</sup> , 石川 篤 <sup>3,4</sup> , 庄司 雄哉 <sup>2</sup> , ファム ナムハイ <sup>2</sup> , 田中 雅明 <sup>3</sup> , 水本 哲 弥 <sup>2</sup> , 田中 拓男 <sup>3,6</sup> , 荒井 滋久 <sup>1,2</sup>	1.東工大量子ナノ, 2.東工大院工, 3.理研, 4.岡大院工, 5.東大院工, 6.北大電子研	
	10:45 - 11:00		休憩/Break			
	11:00 - 11:15	奨 11a-A13-7	外部制御を用いない偏波整列素子に関する検討	○阪本 隼志¹, 佐藤 昇男², 山口 城治¹, 橋 本 俊和¹	1.NTT 先端集積デバイス研, 2.NTTデ バイスイノベーションセンタ	
	11:15 - 11:30	奨 11a-A13-8	液晶素子におけるリタデーション電圧依存性導出の高精度化	○(B)寺島 康平¹, 若生 一広¹	1.仙台高専	
	11:30 - 11:45	11a-A13-9	有機マイクロワイヤリングによるWGMレーザー出力結合	平川 昇¹, 中野 光浩¹, 吉岡 宏晃¹, 〇興 雄司¹	1.九大シス情	
	11:45 - 12:00	11a-A13-10	ドナー電子増強型FTC系EOポリマーを用いたマッハ・ツェンダー干渉 計型光デバイスの試作		1.住友大阪セメント, 2.九大先導研, 3.日 産化学工業, 4.NICT	
	12:00 - 12:15	11a-A13-11	光側帯波の偏光操作による6逓倍信号の生成	○赤松 洋介¹, 千葉 明人¹, 高田 和正¹	1.群馬大工	
	12:15 - 12:30	11a-A13-12	Non-uniform distortion in optical QAM receiver	○Takahide Sakamoto¹, Guo-Wei Lu¹, Tetsuya Kawanishi¹	1.NICT	
	3月11日(水)	14:00 - 16:4	15 15	,		
	14:00 - 14:15	11p-A13-1	(Pb,La)(Zr,Ti)O <sub>3</sub> (PLZT)薄膜を用いた25Gb/s光変調器	○原 英生¹, 增田 伸¹, 阿部 峻佑¹	1.アドバンテスト研究所	
	14:15 - 14:30	11p-A13-2	光強度の時間制御によるLN位相変調器を用いたSSB変調	○大村 史倫¹, 浅場 智也¹, 安武 裕輔¹², 深津 晋¹	1.東大院総合(駒場), 2.JST さきがけ	
	14:30 - 14:45	11p-A13-3	8角柱KTN可変焦点レンズの最適化検討	○川村 宗範¹, 今井 欽之¹, 宮津 純¹, 阪本 匡¹	1.NTTデバイスイノベーションセンタ	
	14:45 - 15:00	11p-A13-4	球面湾曲モデルによるKTN光偏向器の透過波面の解析	○今井 欽之¹, 川村 宗範¹, 宮津 純¹, 阪本 匡¹	1.NTTデバイスイノベーションセンタ	
	15:00 - 15:15		休憩/Break			
	15:15 - 15:30	奨 11p-A13-5	高周波動作へ向けた新構造KTN平面光偏向器	○辰己 韶子¹, 佐々木 雄三¹, 豊田 誠治¹, 今 井 欽之¹, 小林 潤也¹, 阪本 匡¹	1.日本電信電話株式会社, NTTデバイス イノベーションセンタ	
	15:30 - 15:45	11p-A13-6	KTN高速光スキャナの光路長制御による偏向角増大	○豊田 誠治¹, 饗場 悠太², 上野 雅浩¹, 佐々木 雄三¹, 坂本 尊¹, 小林 潤也¹, 阪本 匡¹	1.日本電信電話株式会社 NTT デバイスイノベーションセンタ, 2.東京工業大学院 理工学研究科	
	15:45 - 16:00	11p-A13-7	PPLN導波路を用いた中赤外光源によるホルムアルデヒドの検出	○遊部 雅生', 林 書都', 松谷 雄平', 竹宮 勇太郎', 青木 輝世', 加藤 明', 染谷 竜太', 登倉 明雄', 竹ノ内 弘和', 山口 滋'	1.東海大, 2.NTT 先端集積デバイス研	
	16:00 - 16:15	11p-A13-8	EO効果による位相変調を用いた光PLLにおける信号品質の検討	○中村 一貴¹, 入野 辰夫¹, 藤沢 涼平¹, 曽我 俊太¹, 遊部 雅生¹, 梅木 毅伺², 竹ノ内 弘和²	1.東海大工, 2.NTT先端集積デバイス研	
	16:15 - 16:30	奨 11p-A13-9	複数PPLN集積素子を用いた第二高調波励起波長変換の帯域特性	○風間 拓志¹, 梅木 毅同¹, 遊部 雅生², 竹 ノ内 弘和¹	1.NTT, 2.東海大学	
	16:30 - 16:45	11p-A13-10	熱光学効果を用いた直接接合PPLN導波路の擬似位相整合特性 制御	○梅木 毅伺¹, 風間 拓志¹, 圓佛 晃次¹, 忠永修¹, 遊部 雅生², 竹ノ内 弘和¹	1.NTT先デ研, 2.東海大	
	3月12日(木) 9:00 - 11:45					
	9:00 - 9:15	12a-A13-1	一点露光法による長周期ファイバグレーティングの製作条件	○川崎 啓太¹, 笠原 啓暉¹, 田村 祐起¹, 村上 巧磨¹, 桐山 拓也², 神村 共住², 西 壽巳²	1.阪工大, 2.阪工大院	
	9:15 - 9:30	12a-A13-2	ねじれファイバに形成したマイクロベンド誘起LPFGの偏光特性	○木舩 拓也¹, 原田 智弘¹, 坂田 肇¹	1.静岡大工	
	9:30 - 9:45	12a-A13-3	逆結合型LPFGの光入射方法	○(B)笠原 啓暉¹, 中野 剛司², 西 壽巳²	1.阪工大, 2.阪工大院	
	9:45 - 10:00	12a-A13-4	光導波型マイクロホンにおけるダンビング効果の考察	○老川 仁志¹, 大河 正志², 佐藤 孝²	1.新潟大学大学院, 2.新潟大学	
	10:00 - 10:15	12a-A13-5	シリコン基板光導波型加速度センサにおけるおもりサイズと位相感 度の関係	○坂部 亮¹, 大河 正志², 佐藤 孝²	1.新潟大学大学院, 2.新潟大学	
	10:15 - 10:30		休憩/Break			
	10:30 - 10:45	奨 12a-A13-6	有線・無線を統合したWDM方式光給電型ファイバセンサ網	○杉山 裕亮¹, 小林 周平¹, 塩道 明優¹, 田中 洋介¹, 黒川 隆志¹	1.東京農工大学	
	10:45 - 11:00	12a-A13-7	ブラノコンベックス型レンズドファイバの集光特性の改善	○斎藤 矯¹, 鈴木 裕太¹, 白石 和男¹, 依 田 秀彦¹	1.宇都宮大工	
	11:00 - 11:15	奨 12a-A13-8	ブラスチック光ファイバを用いたブリルアン光相関領域反射計の簡 素化	〇(D)林 寧生¹, 水野 洋輔¹, 中村 健太郎¹	1.東工大 精研	
	11:15 - 11:30	奨 12a-A13-9	外部熱源を用いないブラスチック光ファイバのテーバ加工法の提案	○(B)氏原 大希¹, 林 寧生¹, 皆川 和成¹, 田 原 麻梨江¹, 水野 洋輔¹, 中村 健太郎¹	1.東工大 精研	
	11:30 - 11:45	12a-A13-10	Tmファイバリング共振器へのCNT挿入によるQスイッチ発振	○高橋 紀人¹, 金原 健太¹, 坂田 肇¹	1.静岡大工	

3.14 光制御デバ	イス・光ファイバ	— / Optical control devices and optical fibers	ポスター講演	
3月13日(金	9:30 - 11:30			
	13a-P7-1	カスケード型チャープ長周期光ファイバグレーティングを用いたひず みおよび温度計測	○(M1)ゴ タン トゥン¹, 月田 統¹, 田中 哲¹, 内村 良太郎¹, 和田 篤¹, 高橋 信明¹	1.防衛大学校
	13a-P7-2	可視光励起によるエルビウム添加光ファイバーの蛍光特性	○(M2)加藤 康平', 大友 一槻', 古瀬 裕章', 本越 伸二², 本田 能之³, 藤本 靖³, 曽根 宏靖'	1.北見工大, 2.レーザー総研, 3.阪大レーザー研
	13a-P7-3	二次元4×4ポリマー光スイッチの特性	○若松 果奈¹, 小林 久也¹, 木村 優一¹, 宇高勝之¹, 松島 裕一², 石川 浩¹	1.早大理工, 2.GCS機構
	13a-P7-4	3次元光インターコネクション用ポリマー2層構造4×4光スイッチの作製	○木村 優一¹, 小林 久也¹, 若松 果奈¹, 松島 裕一², 石川 浩¹, 宇高 勝之¹	1.早大基幹理工, 2.GCS機構
	13a-P7-5	3次元光接続用ポリマー3層構造3×3光スイッチの作製	○小林 久也¹, 木村 優一¹, 若松 果奈¹, 松島 裕一², 石川 浩¹, 宇高 勝之¹	1.早大, 2.GCS機構
	13a-P7-6	全光論理ゲート素子に向けた多重積層量子ドットのイオン注入と熱処 理による組成拡散の検討	○武井 勇樹¹, 尾崎 太斎¹, 松本 敦², 赤羽 浩一², 松島 裕一¹, 石川 浩¹, 宇髙 勝之¹	1.早大理工, 2.情報通信研究機構
	13a-P7-7	液晶を用いたシリコン細線マッハツェンダー光スイッチ	○(M2)宮崎 哲男 <sup>1,2</sup> , 渥美 祐樹 <sup>2</sup> , 岡野 誠 <sup>2</sup> , 武井 亮平 <sup>2</sup> , 三浦 登 <sup>1</sup> , 森 雅彦 <sup>2</sup> , 榊原 陽一 <sup>2</sup>	1.明大院理工, 2.産業技術総合研究所
	13a-P7-8	磁気光学材料 $Bi_sFe_sO_{12}$ を用いた $Si$ リング共振器光スイッチの磁場方位依存性	○岡田 一也¹, 平田 智士¹, 野田 和希¹, 雨宮 嘉照¹, 田部井 哲夫¹, 横山 新¹	1.広大ナノデバ
	13a-P7-9	磁気光学材料を用いたフォトニック結晶光共振器の研究	○野田 和希¹, 千日 拓馬¹, 本澤 圭太¹, 岡田 一也¹, 雨宮 嘉照¹, 田部井 哲夫¹, 横山 新¹	1.広大ナノデバイス

シリコンフォ	トニクス / Sili	icon photonics 口頭講演		
3月11日(水	) 14:00 - 17	:00		
14:00 - 14:15	11p-A16-1	窒化シリコン光導波路の分散制御	○古澤 健太郎¹, 関根 徳彦¹, 笠松 章史¹	1.情通機構
14:15 - 14:30	奨 11p-A16-2	$SiD_4$ を用いたECRプラズマCVD法による低損失 $SiN$ 導波路作製	○岡崎 功太 <sup>1,2</sup> , 西 英隆 <sup>1,2</sup> , 土澤 泰 <sup>1,2</sup> , 山本剛 <sup>2</sup> , 山田 浩治 <sup>1,2</sup>	1.NTTナノフォトニクスセンタ, 2.N 端集積デバイス研
14:30 - 14:45	11p-A16-3	波長405/488nm領域におけるSiON導波路の光学特性	○高 磊 <sup>1-2</sup> , 土澤 秦 <sup>1-2</sup> , 岡崎 功太 <sup>1-2</sup> , 井上 鈴代 <sup>2</sup> , 上野 祐子 <sup>3</sup> , 開 達郎 <sup>1-2</sup> , 山本 剛 <sup>2</sup> , 山 田 浩治 <sup>1-2</sup>	1.NTT ナノフォトセンタ, 2.NTT 先 積デバイス研, 3.NTT 物性科学基
14:45 - 15:00	11p-A16-4	TiO <sub>2</sub> 微粒子ポリマを用いたシリコン細線光導波路のアサーマル化	○北智洋¹, 眞坂 美江子², タン フレディ², 山田 博仁¹, 井上 大介³, 山下 逹弥³, 各務 学³, 杉原 興浩²	1.東北大工, 2.宇都宮大, 3.豊田中
15:00 - 15:15	11p-A16-5	合成石英基板上水素化アモルファスシリコン細線導波路	○岡野 誠¹, 面田 恵美子¹, 前神 有里子¹, 渥 美 裕樹¹, 榊原 陽一¹, 亀井 利浩¹, 森 雅彦¹	1.産総研
15:15 - 15:30		休憩/Break		
15:30 - 15:45	11p-A16-6	シングルモードファイバ直結用編波無依存2段テーバスポットサイズ 変換器	○高橋 博之¹, 岡山 秀彰¹, 小野 英輝¹, 八重 樫 浩樹¹, 佐々木 浩紀¹	1.沖電気
15:45 - 16:00	11p-A16-7	Siの結晶異方性エッチングを利用したスポットサイズ変換器	○宮村 悟史!, 小野 英輝!, 岡部 豊!, 太縄陽介!, 八重樫 浩樹!, 堀川 剛¹², 平山 直紀², 佐々木 浩紀¹	1.PETRA, 2.産総研
16:00 - 16:15	11p-A16-8	SiO <sub>2</sub> スペーサ付スポットサイズ変換器:スペーサ膜厚依存性評価	○前神 有里子¹, 岡野 誠¹, 武井 亮平¹, 面田 恵美子¹, 天野 建¹, 森 雅彦¹, 榊原 陽一¹, 亀井 利浩¹	1.産総研
16:15 - 16:30	11p-A16-9	非対称導波路の方向性結合を利用した導波路型光アイソレータの 設計	○細田 昌志¹, 佐藤 譲¹, ダニシュ アブドゥル ワヒド¹, 服部 貴也¹, 清水 大雅¹	1.農工大工
16:30 - 16:45	11p-A16-10	非相反結合を利用したSi導波路プラズモン光アイソレータの設計	○福田 登¹, 梅津 沙緒里¹, 貝原 輝則¹, 清 水 大雅¹	1.農工大工
16:45 - 17:00	11p-A16-11	TE-TMモード変換器を集積したSi干渉導波路型光アイソレータ	○藤江 彰裕¹, 庄司 雄哉¹, 水本 哲弥¹	1.東工大工
3月12日(木	9:30 - 12:3	30		
9:30 - 9:45	12a-A16-1	狭間隔スロットリング共振器型MEMS光学素子の検討	○雨宮 嘉照¹, 岡田 一也¹, 本澤 圭太¹, 野田 和希¹, 千日 拓馬¹, 福山 正隆¹, 横山 新¹	1.広島大
9:45 - 10:00	12a-A16-2	EOポリマーを用いたプラズモン変調器の構造検討	○北條 直也¹, 雨宮 智宏², 西山 伸彦¹, 荒 井 滋久¹²	1.東工大, 2.量子ナノエレクトロニク 究センター
10:00 - 10:15	12a-A16-3	小型低損失8x8シリコン光スイッチモジュール	○中村 滋¹, 柳町 成行¹, 竹下 仁士¹, 田島 章雄¹, 樋野 智之¹, 加藤 友章¹, 福知 清¹	1.NEC グリーンプラットフォーム研
10:15 - 10:30	12a-A16-4	偏波ダイバーシティー4×4 光スイッチの作製	○鈴木 恵治郎¹, Kim Sang-Hun¹, 谷澤 健¹, Cong Guangwei¹, 池田 和浩¹, 並木 周¹, 河島 整¹	1.産総研
10:30 - 10:45	12a-A16-5	櫛形pn接合を搭載したフォトニック結晶小型シリコンQPSK変調器	○北條 惠子¹, 寺田 陽祐¹, 雛倉 陽介¹, 矢澤 直哉¹, 渡邊 友彦¹, 馬場 俊彦¹	1.横国大·院工
10:45 - 11:00	12a-A16-6	Siフォトニック結晶変調器のドーピング分布最適化による変調速度 向上	○竹内 萌江¹, 寺田 陽祐¹, 馬場 俊彦¹	1.横国大院工
11:00 - 11:15		休憩/Break		
11:15 - 11:30	12a-A16-7	Siフォトニック結晶光変調器の周波数特性	○寺田 陽祐¹, 竹内 萌江¹, 馬場 俊彦¹	1.横国大院工
11:30 - 11:45	12a-A16-8	Siフォトニック結晶マッハツェンダー光変調器における広い波長範囲で の25 Gbps動作の検証	○雛倉 陽介¹, 寺田 陽祐¹, 馬場 俊彦¹	1.横国大·院工
11:45 - 12:00	12a-A16-9	歪SiGeインターリープPN接合型光変調器の検討	○(B)武内 和治¹, 金 栄現¹, 竹中 充¹, 高 木 信一¹	1.東大工
12:00 - 12:15	12a-A16-10	Si光変調器に向けた歪SiGe成長に関する検討	○野口 将高¹, 韓 在勲², 藤方 潤一¹, 中村 隆宏¹, 竹中 充²	1.PETRA, 2.東大
12:15 - 12:30	12a-A16-11	歪SiGe層を用いた空乏化型Si光変調器の検討	○藤方 潤一¹, 野口 将高¹, 金 栄現², 高橋 重樹¹, 中村 隆宏¹, 竹中 充²	1.光電子融合基盤技術研究所, 2.9

14.00 14.15	10 4161	Q (6:Q = -₩A → *= · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	(P) 수도 사고! 로비 보호! 및 노현?? 및	1 ± 1. = 0 3 mm 4 44 45 45 -0 0 2
14:00 - 14:15	12p-A16-1	Ge/SiGeヘテロ接合アバランシェフォトダイオード	○(B)宮坂 祐司 <sup>1</sup> , 石川 靖彦 <sup>1</sup> , 開 達郎 <sup>23</sup> , 岡崎 功太 <sup>23</sup> , 武田 浩太郎 <sup>23</sup> , 土澤 秦 <sup>23</sup> , 山田 浩治 <sup>23</sup> , 和田 一実 <sup>1</sup>	1.東大工, 2.NTT先端集積デバイ 3.NTTナノフォトニクスセンタ
14:15 - 14:30	12p-A16-2	残留歪とマイクロ構造を用いたSOI上Ge成長膜の2軸伸張歪の増強	○石田 悟己¹, 加古 敏¹², 小田 克矢³, 井戸 立身³, 岩本 敏¹², 荒川 泰彦¹²	1.東大生研・先端研, 2.東大ナノ量 構, 3.日立中研
14:30 - 14:45	奨 12p-A16-3	熱酸化を用いた表面不活性化による引っ張り歪みGe on Siの発光 強度増大	○(M2)高林 昂紀¹, 徐 学俊¹, 澤野 憲太郎¹, 丸泉 琢也¹	1.都市大総研
14:45 - 15:00	12p-A16-4	伸張歪ゲルマニウムにおける間接Lバレー端の円偏光蛍光	○松下 智昭¹, 安武 裕輔¹², 揖場 聡³, 齋藤 秀和³, 湯浅 新治³, 深津 晋¹	1.東大院総合, 2.JST さきがけ, 3.
15:00 - 15:15	12p-A16-5	Geの顕微フォトルミネセンスにおける励起光強度密度の影響	○(B)東垂水 直樹¹, 石川 靖彦¹	1.東大工
15:15 - 15:30	E 12p-A16-6	Study of Thermal Annealing Effect on Smartcut Ge-on-Insulator Substrate	○Jian Kang <sup>1,2</sup> , Xiao Yu <sup>1,2</sup> , Mitsuru Takena-ka <sup>1,2</sup> , Shinichi Takagi <sup>1,2</sup>	1.Tokyo Univ., 2.JST-CREST
15:30 - 15:45	12p-A16-7	SOI上直接成長Geを用いたマイクロディスク共振器の作製と光学 評価	○加古 敏 <sup>1,2</sup> , 石田 悟己 <sup>1</sup> , 小田 克矢 <sup>3</sup> , 斎藤 慎一 <sup>4</sup> , 井戸 立身 <sup>3</sup> , 荒川 泰彦 <sup>1,2</sup>	1.東大生研・先端研, 2.東大ナノ量 構, 3.日立中研, 4.サザンプトン大
15:45 - 16:00	12p-A16-8	Si(111)基板上化学修飾ゲルマネンの作製	○安武 裕輔1², 深津 晋1	1.東大院総合, 2.JSTさきがけ
16:00 - 16:15		休憩/Break		
16:15 - 16:30	E 12p-A16-9	Ridge-Type InAs/GaAs Quantum Dot Lasers on Silicon-on-Insulator Substrates by Metal-Stripe Bonding	○(D)YuanHsuan Jhang¹, Katsuaki Tanabe², Satoshi Iwamoto¹², Yasuhiko Arakawa¹²	1.IIS, Univ. Tokyo, 2.NanoQuin Univ. Tokyo
16:30 - 16:45	12p-A16-10	Si細線上へのInP系埋込みヘテロ構造の集積	○藤井 拓郎 <sup>1,2</sup> , 武田 浩司 <sup>1,2</sup> , 西 英隆 <sup>1,2</sup> , 長 谷部 浩一 <sup>1,2</sup> , 硴塚 孝明 <sup>1,2</sup> , 山本 剛 <sup>1</sup> , 山田 浩治 <sup>1,2</sup> , 松尾 慎治 <sup>1,2</sup>	1.NTT先端集積デバイス研, 2.ナ. トニクスセンタ
16:45 - 17:00	12p-A16-11	SOI光導波路上III-Vリングレーザ/光検出器の集積(I) 〜周回モード制御〜	○飯塚 紀夫¹, 大平 和哉¹, 上村 紘崇¹, 吉 田 春彦¹, 江崎 瑞仙¹, 上村 浩¹, 栗田 洋一郎¹, 古山 英人¹	1.PETRA
17:00 - 17:15	12p-A16-12	SOI光導波路上III-Vリングレーザ/光検出器の集積(II)〜反射戻り 光制御〜	○吉田 春彦¹, 大平 和哉¹, 上村 紘崇¹, 飯塚 紀夫¹, 江崎 瑞仙¹, 上村 浩¹, 栗田 洋一郎', 古山 英人¹	1.PETRA
17:15 - 17:30	12p-A16-13	InAs量子ドット光増幅器を用いた1.2mm帯シリコンフォトニック波長 可変レーザ	〇北 智洋¹, 山本 直克², 川西 哲也², 山田 博仁¹	1.東北大工, 2.NICT

3.15 シリコンフォ	トニクス / Silic	on photonics ポスター講演		
3月13日(金)	9:30 - 11:30			
	E 13a-P8-1	Bio Sensor Using Photonic Crystal Multi-Resonator	○(DC)Amrita Kumar Sana¹, Keita Honzawa¹, Yoshiteru Amemiya¹, Shin Yokoyama¹	1.Hiroshima Univeristy
	奨 13a-P8-2	グラフェン集積シリコンリング共振器の方向性結合率調整による透 過率向上	○小林 弓月¹, 高 磊²³, 土澤 泰²³, 井上 鈴 代³, 上野 祐子⁴, 日比野 浩樹⁺, 山本 剛³, 山 田 浩治²³, 中島 啓幾¹	1.早大先進理工, 2.NTT ナノフォトセンタ, 3.NTT 先端集積デバイス研, 4.NTT 物性科学基礎研
	13a-P8-3	Siリング共振器を用いた1Portグレーテイング光導波路屈折率センサー	○(M1)筒井 誠貴¹, 高久 寛基¹, 岡山 秀彰 ¹², 中島 啓幾¹	1.早大先進理工, 2.沖電気工業
	13a-P8-4	主/副リング共振器を用いたグレーティング結合型Si光導波路屈折 率センサー	○高久 寛基¹, 筒井 誠貴¹, 岡山 秀彰¹², 中 島 啓幾¹	1.早大先進理工, 2.沖電気工業
	13a-P8-5	Si細線導波路による偏波変換Braggグレーティングにおける1次モード 回折に関する検討	○岡山 秀彰¹, 太縄 陽介¹, 佐々木 浩紀¹, 八 重樫 浩樹¹	1.沖電気
	13a-P8-6	Si細線導波路干渉器素子における多領域構造による特性設定の検討	○岡山 秀彰¹, 八重樫 浩樹¹, 佐々木 浩紀¹	1.沖電気
	13a-P8-7	組み合わせリング共振器を用いたCバンド帯における狭帯域フィルタの解析	○横井 裕人¹, 三橋 頼人¹, 松島 裕一², 石川 浩¹, 宇高 勝之¹	1.早大理工, 2.GCS機構
	13a-P8-8	浅いメサ導波路からなるシリコン反射交差導波路型2x2光スイッチ の検討	○(M1)嶋田 裕介¹, 藤原 裕士¹, 松本 敦³, 松島 裕一², 石川 浩¹, 宇髙 勝之¹	1.早大 理工, 2.早大 GCS機構, 3.情報 通信研究機構
	13a-P8-9	波長可変なシリコンフォトニクス波長多重送信回路	○伊藤 寛之¹, 寺田 陽祐¹, 馬場 俊彦¹	1.横浜国大

# 6 薄膜·表面 / Thin Films and Surfaces

6.1	強誘電体薄膜	/ Ferroelectri	ic thin films ポスター講演		
	3月11日(水)	16:00 - 18:0	00		
		11p-P4-1	PLD法によるBiFeO3-LaAlO3系薄膜の作製とその誘電特性	○泉 宏和¹, 吉村 武², 藤村 紀文²	1.兵庫工技セ, 2.阪府大院工
		11p-P4-2	RFマグネトロンスパッタ法による(100)BiFeO $_{\rm 3}$ /(100)LaNiO $_{\rm 3}$ へテ構造の作製	□ ○堂安 豪¹, 苅谷 健人¹, 荒牧 正明¹, 吉村 武¹, 藤村 紀文¹	1.阪府大工
		11p-P4-3	BiFeO <sub>3</sub> 薄膜に用いる新規下部電極の検討	○荒牧 正明¹, 苅谷 健人¹, 堂安 豪¹, 吉村 武¹, 藤村 紀文¹	1.府大院工
		11p-P4-4	ZnO単結晶基板上でのBiFeO <sub>3</sub> 薄膜の成長	$\bigcirc$ (M1)小前 智也¹, 山田 裕明¹, 吉村 武¹, 藤村 紀文¹	1.阪府大工
		11p-P4-5	${ m BiFeO_3}$ 薄膜のドメインウォール幅( ${ m II}$ )	坂本 広太¹, $\bigcirc$ 藤沢 浩訓¹, 中嶋 誠二¹, 清水 勝¹	1.兵庫県大工
		11p-P4-6	アルコール系インクによるチタン酸ビスマス薄膜の作成	○柿元 信利¹, 山口 正樹¹	1.芝浦工大工
		11p-P4-7	強相関系強誘電体YMnO <sub>3</sub> 薄膜の光誘起電流と分極反転の相関	宇賀 洋志¹, ○張 楽駿¹, 芦田 淳¹, 古川 喜 彬², 中山 正昭², 藤村 紀文¹	1.阪府大, 2.阪市大
		11p-P4-8	ハーフメタル/ $\mathrm{Ba_{x}Sr_{1-x}TiO_{3}}$ 〜テロ積層構造における歪み効果と簡的特性	電気 ○ソ ジョンミン¹, 許 方舟¹, 伊東 和徳¹, 羽尻 哲也¹, 植田 研二¹, 浅野 秀文¹	1.名大院工
		11p-P4-9	PZT薄膜の縦方向圧電定数 $\mathbf{d}_{_{33,f}}$ と横方向圧電定数 $\mathbf{d}_{_{31}}$ の比較	○牧本 なつみ <sup>1</sup> , 竹下 俊弘 <sup>2</sup> , 前田 龍太郎 <sup>1</sup> , 小林 健 <sup>1</sup>	1.産総研, 2.九州大
		11p-P4-10	圧電応答顕微鏡を用いたP(VDF-TrFE)のナノスケール分極操作	「○宝田 隼」,佐藤 宙樹」,古川 昭雄」	1.東理大理工

3月13日(金	) 9:00 - 12:3	ric thin films		
9:00 - 9:15	13a-A21-1	Ptナノコロイドを分散させた不均一Pb(Zr,Ti)O <sub>3</sub> 薄膜の微細組織と 圧電特性	○松平 佳巳¹, 橋爪 洋一郎¹, 中嶋 宇史¹, 飯島 高志², 岡村 総一郎¹	1.東理大理, 2.産総研
9:15 - 9:30	13a-A21-2	圧电行性 Pb過剰(Pb,La)(Zr,Ti)O <sub>3</sub> 薄膜の結晶粒巨大化とその電気特性評価	□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □	1.東理大理, 2.防衛大, 3.産総研
9:30 - 9:45	奨 13a-A21-3	Zr/(Zr+Ti)比によるPb(Zr,Ti)O <sub>3</sub> 薄膜のドメイン制御	○一ノ瀬 大地¹, 中島 崇明¹, 江原 祥隆¹, 及 川 貴弘¹, 清水 荘雄¹, 山田 智明²³, 舟窪 浩¹	1.東工大, 2.名大, 3.PRESTO
9:45 - 10:00	奨 13a-A21-4	急冷法によってc軸配向させたSi基板上のPMnN-PZT単結晶薄膜 の高温特性	○半澤 弘明¹, 吉田 慎哉¹, 和佐 清孝², 田中 秀治¹	1.東北大, 2.横浜市立大
10:00 - 10:15	13a-A21-5	Pb(Hf,Ti)O <sub>3</sub> 薄膜の作製と圧電特性評価	○西尾 正悟¹, 黒川 文弥¹, 肥田 博隆¹, 神野 伊策¹	1.神大院工
10:15 - 10:30		休憩/Break	N V A	
10:30 - 10:45	13a-A21-6	チタン酸バリウムナノキューブ規則配列マイクロバターン集積体の作 製と評価	○三村 憲一¹, 加藤 一実¹	1.産総研
10:45 - 11:00	13a-A21-7	(111) $\mathrm{Ba}_{\mathrm{l}_{\mathrm{x}}}\mathrm{Ca}_{\mathrm{x}}\mathrm{TiO}_{\mathrm{y}}/\mathrm{ZnO}$ ヘテロ構造の作製とその電気的特性	○山田 裕明¹, 吉村 武¹, 藤村 紀文¹	1.阪府大院工
11:00 - 11:15	E 13a-A21-8	Development of 400° C operational relaxor ferroelectric based thin-film capacitor with exceptionally high stability	OKumaragurubaran Somu <sup>1</sup> , Takahiro Nagata <sup>1</sup> , Kenichiro Takahashi <sup>1,2</sup> , Sung-Gi Ri <sup>1,2</sup> , Yoshifumi Tsunekawa <sup>1,2</sup> , Setsu Suzuki <sup>1,2</sup> , Toyohiro Chikyow <sup>1</sup>	1.NIMS, 2.COMET Inc.
11:15 - 11:30	13a-A21-9	化学溶液法により合成した $\mathrm{Bi}_{0.5}\mathrm{Na}_{0.5}\mathrm{TiO}_{_3}$ 強誘電体薄膜の特性に対する $\mathrm{Mn}$ ドープの影響	○坂本 渉¹, 牧野 成道¹, 飯島 高志², 余 語 利信¹	1.名大エコトピア研, 2.産総研つく
11:30 - 11:45	13a-A21-10	巨大なc/a比を有するBiFe $_{\rm l_x}$ Co $_{\rm x}$ O $_{\rm 3}$ 薄膜の結晶構造と圧電特性の関係	○清水 啓佑¹, 北條 元¹, 東 正樹¹	1.東工大応セラ研
11:45 - 12:00	13a-A21-11	新規非鉛強誘電体Bi <sub>z</sub> ZnTi <sub>1x</sub> Mn <sub>x</sub> O <sub>e</sub> 薄膜の育成	○富永 健¹, 北條 元¹, 清水 啓佑¹, 松田 奈 瑠美¹, 東 正樹¹	1.東工大応セラ
12:00 - 12:15	奨 13a-A21-12	単一ドメインBiFeO。薄膜の電気的特性にMn及びZnドーブが及ぼす影響(III)	○(M1)重松 晃二¹, 中嶋 誠二¹, 藤沢 浩訓 ¹, 清水 勝¹	1.兵庫県大工
12:15 - 12:30	13a-A21-13	$SrTiO_3$ バイクリスタル基板上への $BiFeO_3$ 薄膜の作製	○瀬戸 翔太¹, 中嶋 誠二¹, 藤沢 浩訓¹, 清水 勝¹	1.兵庫県大工
3月13日(金	) 16:15 - 18:	30		
16:15 - 16:30	13p-A21-1	化学溶液堆積法によるHfO₂-ZrO₂極薄膜の作製と特性評価	阿部 千穂子¹, 塩川 真里奈¹, 白石 貴久², 清水 荘雄², 舟窪 浩², ○内田 寛¹	1.上智大, 2.東工大
16:30 - 16:45	13p-A21-2	斜方晶相を含むエピタキシャル $\mathrm{HfO}_2$ 基薄膜の結晶構造解析	〇片山 きりは¹, 清水 荘雄², 横内 達彦¹, 白石 貴久¹, 及川 貴弘¹, 木口 賢紀³, 赤間 章裕³, 今野 豊彦³, 内田 寛⁴, 舟窪 浩¹²	1.東工大総理工, 2.東工大元素, 3 大金研, 4.上智大理工
16:45 - 17:00	13p-A21-3	電子強誘電体YbFe $_2$ O $_4$ エピタキシャル薄膜のキャリア伝導特性	○樫本 涼¹, 吉村 武¹, 芦田 淳¹, 藤村 紀文¹	1.阪府大工
17:00 - 17:15	奨 13p-A21-4	ハードディスクドライブ型強誘電体記録装置における更なる高密度化 とビット列の実時間再生	○青木 朋徳¹, 平永 良臣¹, 長 康雄¹	1.東北大 通研
17:15 - 17:30	13p-A21-5	強誘電体プローブデータストレージ用PZT薄膜媒体の表面層のXPS 測定	○平永 良臣¹, 陳 一桐¹, 長 康雄¹	1.東北大通研
17:30 - 17:45	奨 13p-A21-6	圧電MEMSのためのスパッタ堆積による大口径Si基板上へのYSZバッファ層のエピタキシャル成長	○西澤 信典 <sup>1</sup> , 吉田 慎哉 <sup>1</sup> , 和佐 清孝 <sup>2</sup> , 田 中 秀治 <sup>1</sup>	1.東北大学, 2.横浜市立大学
17:45 - 18:00	13p-A21-7	有機強誘電体イミダゾールのプレードコート法による薄膜作製と物性	○(PC)野田 祐樹 <sup>12</sup> , 山田 寿一 <sup>1</sup> , 賀川 史敬 <sup>23</sup> , 小林 賢介 <sup>4</sup> , 熊井 玲児 <sup>24</sup> , 堀内 佐智雄 <sup>12</sup> , 長谷川 達生 <sup>1,25</sup>	1.産総研FLEC, 2.JST-CREST, 3. CEMS, 4.KEK物構研PF, 5.東大
18:00 - 18:15	13p-A21-8	PVDF系共重合高分子を用いた高誘電率・低損失コンデンサフィルム	○安藤 正彦¹, 吉本 尚起¹, 吉武 勇一郎 ², 加藤 修治², 児玉 秀和³, 古川 猛夫³, 田代 孝二⁴	1.日立中研, 2.日立日研, 3.小林理 4.豊田工大
18:15 - 18:30	13p-A21-9	高分子強誘電体VDF/TeFE共重合体薄膜の分極反転特性	〇中川 佑太¹, 橋爪 洋一郎¹, 中嶋 宇史¹, 岡村 総一郎¹	1.東理大理
3月14日(土	9:00 - 12:0	00		
9:00 - 9:15	E 14a-A21-1	Theoretical Analysis of Nonlinear Response in Vibrational Energy Harvesters	OAli Mohamed Eltanany <sup>12</sup> , Takeshi Yoshimura <sup>1</sup> , Norifumi Fujimura <sup>1</sup> , Nour Zaki Elsayed <sup>2</sup> , Mohamed Refat Ebeid <sup>2</sup> , Mohamed Galal Sayed Ali <sup>2</sup>	1.Osaka Pref. Univ., 2.Minia Un
9:15 - 9:30	奨 14a-A21-2	自励振動を利用した圧電薄膜気流振動発電素子	○辻浦 裕一¹, 諏訪 英作¹, 黒川 文弥¹, 肥田博隆¹, 神野 伊策¹	1.神大院工
9:30 - 9:45	14a-A21-3	水熱合成(K,Na)NbO $_3$ 膜を用いたフレキシブル圧電素子の作製と特性評価	○白石 貴久¹, 金子 祈之¹, 黒澤 実¹, 内田 寛², 鈴木 靖弘³, 小林 健³, 舟窪 浩¹	1.東工大院, 2.上智大, 3.産総研
9:45 - 10:00	14a-A21-4	複数梁構造を有する圧電MEMS振動発電素子の振動解	○苅谷 健人¹, 吉村 武¹, 村上 修一², 藤村 紀文¹	1.阪府大工, 2.阪府産技研
10:00 - 10:15	14a-A21-5	PVDF圧電ポリマーによるエレクトロクロミックセルの駆動	○鳥山 真¹, 中嶋 宇史¹, 橋爪 洋一郎¹, 岡村 総一郎¹	1.東理大理
10:15 - 10:30		休憩/Break		
10:30 - 10:45	奨 14a-A21-6	強誘電体光起電力効果の増強に向けた界面設計 -BiFeO。系キャバシタを例に-	○(D)松尾 拓紀¹, 北中 佑樹¹, 井上 亮太郎¹, 野口 祐二¹, 宮山 勝¹	1.東大
10:45 - 11:00	14a-A21-7	SrTiO <sub>3</sub> 基板上に成長した単一ドメインBiFeO <sub>3</sub> 薄膜の異常光起電力 効果	○(B)高山 幸太¹	1.兵庫県立大工
11:00 - 11:15	14a-A21-8	(Bi,Pr)(Fe,Mn)O <sub>3</sub> 強誘電体薄膜の分極誘起光起電力効果	○川畑 創¹, 川江 健¹, 森本 章治¹	1.金沢大
11:15 - 11:30	14a-A21-9	強相関系強誘電体YMnO₃薄膜の光吸収および発光特性と それらの 光誘起電流との相関	○宇賀 洋志¹, 芦田 淳¹, 吉村 武¹, 古川 喜 彬², 中山 正昭², 藤村 紀文¹	1.阪府大工, 2.阪市大工
11:30 - 11:45	奨 14a-A21-10	UV-LED光駆動の圧電薄膜アクチュエータの作製	〇黒川 文弥¹, 大地 優平¹, 佐段田 温朗¹, 辻浦 裕一¹, 肥田 博隆¹, 神野 伊策¹	1.神大院工
11:45 - 12:00	14a-A21-11	強誘電体薄膜における電気熱量効果の直接測定の検討	○松下 裕司', 吉村 武', 藤村 紀文'	1.阪府大

3月11日(水	) 13:15 - 18:	00		
13:15 - 13:30	11p-C1-1	ブラズマCVDを用いたダイヤモンド単結晶成長における基板温度変 化と窒素添加効果	○山田 英明¹, 茶谷原 昭義¹, 杢野 由明¹	1.産総研
13:30 - 13:45	11p-C1-2	(001)面高濃度ボロンドーブダイヤモンド成長のオフ角依存性	○(DC)川島 宏幸 <sup>1,2,3</sup> , 加藤 宙光 <sup>2,3</sup> , 小倉 政 彦 <sup>2,3</sup> , 牧野 俊晴 <sup>2,3</sup> , 竹内 大輔 <sup>2,3</sup> , 山崎 聡 <sup>1,2,3</sup>	1.筑波大, 2.産総研, 3.JST/CRE
13:45 - 14:00	奨 11p-C1-3	X線回折法を用いたボロンドーブ超伝導ダイヤモンド薄膜の臨界膜 厚評価	○(B)柴田 将暢¹, 蔭浦 泰資¹, 山口 尚秀², 高野 義彦², 川原田 洋¹	1.早大理工, 2.物材機構
14:00 - 14:15	11p-C1-4	高濃度リンドープn型ダイヤモンド薄膜の評価	○(PC)大谷 亮太¹, 山本 卓¹, 小泉 聡¹	1.物材機構
14:15 - 14:30	11p-C1-5	シンクロトロンX線トポグラフィーによる(110)高温高圧合成ダイヤモン ド単結晶の観察	○嘉数 誠¹, 村上 竜一¹, 桝谷 聡士¹, 植松 卓也¹, 角谷 均²	1.佐賀大院工, 2.住友電工
14:30 - 14:45	奨·E 11p-C1-6	Direct observation and mechanism for enhanced electron emission sites in Pt ion implanted/post-annealed ultra nanocrystalline diamond films	○(PC)Kalpataru Panda¹, Eiichi Inami¹, K. J Sankaran², Yoshiaki Sugimoto¹, N-H Tai², I-Nan Lin³	1.Osaka Univ., 2.NTHU, 3.Tam Univ.
14:45 - 15:00		休憩/Break		
15:00 - 15:15	奨 11p-C1-7	格子状核発生領域を用いたダイヤモンドのヘテロエビタキシャル成長	○市川 公善¹, 児玉 英之¹, 鈴木 一博², 澤 邊 厚仁¹	1.青学大理工, 2.トウプラスエンジ リング
15:15 - 15:30	11p-C1-8	ダイヤモンド/立方晶窒化ホウ素(c-BN)薄膜ヘテロ構造成長	○平間 一行¹, 谷保 芳孝¹, 狩元 慎一¹, 山 本 秀樹¹	1.NTT物性研
15:30 - 15:45	11p-C1-9	CVDダイヤモンド表面伝導層のバンドダイヤグラム:表面直下の下向きバンド曲がりの再確認	○河野 省三¹, 竹内 大輔², 児玉 英之¹, 澤 邊 厚仁¹	1.青山学院大理工, 2.産総研
15:45 - 16:00	奨 11p-C1-10	ダイヤモンド基板の表面制御によるアプタマーを用いたATP検出	○(B)楢村 卓朗¹, スアエバ エヴィ¹, 明道 三 穂¹, 小林 幹典¹, 稲葉 優文¹, 平岩 篤¹, 川 原田 洋¹	1.早大理工
16:00 - 16:15		休憩/Break		
16:15 - 16:30	11p-C1-11	(111)基板上へのアンサンブルNVセンターを含むダイヤモンド薄膜 合成	○小澤 勇斗¹, 岩崎 孝之¹², 田原 康佐¹, 古山 聡子¹, 清水 麻希¹², 波多野 睦子¹²	1.東工大, 2.CREST
16:30 - 16:45	11p-C1-12	ホモエピタキシャルダイヤモンド(111)薄膜中に形成されたNVセンターの配向度と極性	○寺地 徳之¹, Michl Julia², Zaiser Sebas- tian², Yakobi Ingmar², Waldherr Gerald², Dolde Florian², Neumann Philipp², Doherty Marcus³, Manson Neil³, Isoya Junichi⁴, Wrachtrup Jorg²	1.物材機構, 2.シュツットガルト大, ストラリア国立大, 4.筑波大
16:45 - 17:00	11p-C1-13	ダイヤモンド(111)基板における窒素-空孔複合欠陥の配向整列機構	○宮崎 剛英 <sup>1,2</sup> , 宮本 良之 <sup>1,2</sup> , 牧野 俊晴 <sup>1,3</sup> , 加藤 宙光 <sup>1,3</sup> , 山崎 聡 <sup>1,3</sup> , 福井 貴大 <sup>1,4</sup> , 土 井 悠生 <sup>1,4</sup> , 徳田 規夫 <sup>5</sup> , 波多野 睦子 <sup>1,6</sup> , 水 落 憲和 <sup>1,4</sup>	1.JST-CREST, 2.産総研ナノシス 3.産総研エネルギー技術, 4.大阪 礎工, 5.金沢大理工, 6.東工大院
17:00 - 17:15	11p-C1-14	リンドナーによるダイヤモンド NV 中心の電荷状態制御	○土井 悠生!, 福井 貴大!, 加藤 宙光²³, 牧 野 俊晴²³, 山崎 聡³³, 田嶌 俊之!, 森下 弘 樹', 三輪 真嗣', Jelezko Fedor¹, 鈴木 義茂 ¹, 水落 憲和¹³	1.阪大基礎工, 2.産総研, 3.CRES ルム大
17:15 - 17:30	11p-C1-15	ダイヤモンドJFETの内部電界測定に向けたNVセンターの形成	○成木 航 <sup>1</sup> , 田原 康佐 <sup>1</sup> , 岩崎 孝之 <sup>13</sup> , 加藤 宙光 <sup>23</sup> , 牧野 俊晴 <sup>23</sup> , 小倉 政彦 <sup>23</sup> , 竹内 大 輔 <sup>23</sup> , 山崎 聡 <sup>23</sup> , 波多野 睦子 <sup>1,3</sup>	1.東工大, 2.産総研, 3.CREST
17:30 - 17:45	11p-C1-16	ダイヤモンド選択成長によるNVセンターの集光率向上	〇古山 聡子¹, 岩崎 孝之¹², 清水 麻希¹², 矢板 潤也¹, 小寺 哲夫¹², 波多野 睦子¹²	1.東工大, 2.CREST-JST
17:45 - 18:00	11p-C1-17	イオン注入によるCVDダイアモンド膜へのSiVセンターの導入	○小副川 裕太¹, 中尾 基¹, 坪田 敏樹¹, 長町 信治²	1.九州工業大学, 2.株式会社長町 エンスラボ

5.2 カーボン系落	轉膜 / Carbon-b	pased thin films ポスター講演		
3月11日(7	k) 9:30 - 11:3	0		
	11a-P4-1	高品質ダイヤモンド膜合成用廉価マイクロ波ブラズマCVD装置の 開発	○宮田 昌和¹, 毎田 修¹, 南光 正平², 伊藤 利道¹	1.阪大院工, 2.ニッシン
	11a-P4-2	{111}リンドープダイヤモンド薄膜成長のオフ角依存性	○(PC)山本 卓¹, 小泉 聡¹	1.物材機構
	11a-P4-3	高濃度ホウ素ドープ縮退ダイヤモンド薄膜における縮退領域の局在クラスター化とその積層	○田渕 智大¹, 毎田 修¹, 伊藤 利道¹	1.阪大院工
	11a-P4-4	簡易リソプロセスを用いた $\approx 1 \mu m$ 径の高品質柱状ダイヤモンド周期構造の作製とその粒子検出器への応用	○清水 彰人¹, 毎田 修¹, 伊藤 利道¹	1.阪大院工
	11a-P4-5	Si基板上への高配向ボロンドーブ・ダイヤモンドの選択成長	○(M1C)小宮 一輝¹, 市川 直斗¹, 小島 隆平¹, 相馬 勇治¹, 一色 秀夫¹	1.電通大院先進理工
	11a-P4-6	ホウ素ドープCVDダイヤモンド薄膜における 過渡光容量法による結晶欠陥評価	○堀 敬憲¹, 毎田 修¹, 伊藤 利道¹	1.阪大院工
	11a-P4-7	電子線誘起電流(EBIC)法によるダイヤモンドの欠陥位置の視覚化	○河野 省三¹, 寺地 徳之², 児玉 英之¹, 澤 邊 厚仁¹	1.青山学院大理工, 2.物材機構
	奨·E 11a-P4-8	Role of the oxygen interlayer on electrical properties of WC/p-diamond Schottky diodes	○(PC)Alexandre FIORI¹, Tokuyuki TER- AJI¹, Jose PINERO², Daniel ARAUJO², Yasuo KOIDE¹	1.NIMS, 2.University of Cadiz
	11a-P4-9	原子状Si誘起核発生により形成したナノ・ダイヤモンドからのSi-V中心発光	○小島 隆平¹, 市川 直斗¹, 小宮 一輝¹, 相馬 勇治¹, 一色 秀夫¹	1.電通大院先進理工
	11a-P4-10	ダイヤモンドへの銀コーティング(2)	○(M1)井山 年明¹, 大島 龍司¹, 飯塚 完司¹	1.日工大
	11a-P4-11	種々の炭化水素を原料として極低温合成したa-C:Hの物性評価	○齋藤 登之¹, 内藤 瑛慈¹, 小林 直樹¹, 佐藤 哲也¹	1.山梨大医工総研
	奨 11a-P4-12	X線反射率法を用いたRFプラズマCVD成膜におけるDLC膜界面 の分析	○針谷 達 <sup>1</sup> , 安岡 佑起 <sup>1</sup> , 古田 寬 <sup>1,2</sup> , 八田 章光 <sup>1,2</sup>	1.高知工科大, 2.高知工科大ナノテクセンター
	11a-P4-13	アモルファス炭素膜の電気的特性に及ぼす安定同位体の影響	○鈴木 裕太郎¹, 鈴木 常生², 神田 一浩³, 大 竹 尚登¹, 赤坂 大樹¹	1.東工大, 2.長岡技科大, 3.兵庫県立大
	奨 11a-P4-14	Excel上で動作するsp²/(sp²+sp³)比算出のためのDLC薄膜のC-K端 NEXAFSスペクトル用シミュレーションプログラムの開発	○高松 大樹1.2	1.兵庫県立大工, 2.高度研
	11a-P4-15	極低温合成a-C:F膜のマイクロスクラッチ試験による密着性評価	○曽我 遥華¹, 山井 孝太¹, 森川 恭兵¹, 佐藤 哲也¹, 中川 清和¹	1.山梨大院医工総研
	11a-P4-16	PBII法により作製したヨウ素添加アモルファスカーボン薄膜への熱 処理効果	○(M2)溝上 知広¹, 中尾 節男², 岸 直希¹, 曽我 哲夫¹	1.名工大, 2.産総研

11a-P4-17	Arのマイクロ波放電フローにおける有機ケイ素化合物の解離励起 反応解析	○(M1)佐伯 駿介¹, 熊倉 基起¹, 伊藤 治彦¹	1.長岡技科大工
奨 11a-P4-18	アモルファス窒化炭素薄膜の光誘起体積変化における長時間光照 射の影響	○原田 人萌¹, 青野 祐美¹, 北沢 信章¹, 渡邉 芳久¹	1.防大材料

	3月12日(木)	9:00 - 11:4	5		
	9:00 - 9:15	奨 12a-C1-1	ダイヤモンド上SiO <sub>2</sub> ゲート絶縁膜の形成と評価	○(B)原 壮志¹, 袴田 知宏¹, 小野 和子¹, 瀬 下 裕志¹, 林 佑哉¹, 平岩 篤¹, 川原田 洋¹	1.早大理工
	9:15 - 9:30	奨 12a-C1-2	耐圧 $1600$ Vを超える高温ALD- $Al_2$ O。絶縁膜を用いた水素終端ダイヤモンドMOSFET	(B)北林 祐哉¹, 山田 哲也¹, 許 德琛¹, 坪 井 秀俊¹, 斎藤 俊輝¹, 齊藤 達也¹, 松村 大 輔, 平岩 篤, 川原田 洋¹	1.早大理工
Ī	9:30 - 9:45	奨 12a-C1-3	原子層堆積Al <sub>2</sub> O <sub>2</sub> -MOSキャバシタの高温電気的絶縁性に対するゲート電極材質の影響	〇松村 大輔¹, 齊藤 達也¹, 平岩 篤¹, 川 原田 洋¹	1.早大理工
	9:45 - 10:00	奨 12a-C1-4	トレンチチャネルを有する C-H ダイヤモンド MOSFET	○斎藤 俊輝', 小林 幹典', 山田 哲也', 許 徳琛', 北林 祐哉', 松村 大輔', 坪井 秀俊', 稲葉 優文', 平岩 篤', 川原田 洋'	1.早大
	10:00 - 10:15	奨 12a-C1-5	(001)ダイヤモンド上MBE薄膜AINのIn-Plane X線回折法による評価	○(B)林 佑哉¹, 小野 和子¹, 袴田 知宏¹, 平岩 篤¹, 川原田 洋¹	1.早大理工
	10:15 - 10:30		休憩/Break		
	10:30 - 10:45	奨 12a-C1-6	(111)基板上の{1-10}面を接合面としたダイヤモンド横型p-n接合の作製	○佐藤 一樹¹, 岩崎 孝之¹²³, 清水 麻希¹³, 加藤 宙光³¹, 牧野 俊晴³₄, 小倉 政彦³⁴, 竹 内 大輔³⁴, 山崎 聡³⁴, 波多野 睦子¹²²	1.東工大, 2.ALCA, 3.CREST, 4.産総
	10:45 - 11:00	奨 12a-C1-7	ダイヤモンド横型p-n接合についてケルビンプロープフォース顕微鏡に よる 表面電位評価と内部構造との相関	○白田 和也 <sup>1.2</sup> , 竹内 大輔², 牧野 俊晴², 加藤 宙光², 小倉 政彦², 山崎 聡 <sup>1.2</sup>	1.筑波大学数理, 2.産総研
	11:00 - 11:15	12a-C1-8	ダイヤモンドJFETのノーマリーオフ動作	○諏訪 泰介!, 岩崎 孝之1 <sup>23</sup> , 佐藤 一樹!, 加藤 宙光 <sup>34</sup> , 牧野 俊晴 <sup>34</sup> , 小台 政彦 <sup>34</sup> , 竹内 大輔 <sup>34</sup> , 山崎 聡 <sup>34</sup> , 波多野 睦子 <sup>1,23</sup>	1.東工大, 2.ALCA, 3.CREST, 4.産紅
	11:15 - 11:30	12a-C1-9	ホッピング伝導層を用いたダイヤモンドp*-i-n*接合の電気特性	○牧野 俊晴 <sup>1-2</sup> , 桑原 大輔 <sup>1-2,3</sup> , 加藤 宙光 <sup>1-2,4</sup> 竹内 大輔 <sup>1-2,4</sup> , 小倉 政彦 <sup>1-2,4</sup> 大串 秀世 <sup>1-2,4</sup> 山崎 聡 <sup>1,2,3</sup>	1.産総研エネ部門, 2.CREST/JST, 3 波大
	11:30 - 11:45	奨 12a-C1-10	ダイヤモンドLEDにおける励起子発光の温度依存性	○(D)桑原 大輔 <sup>1,23</sup> , 牧野 俊晴 <sup>2,3</sup> , 加藤 宙 光 <sup>2,3</sup> , 竹內 大輔 <sup>2,3</sup> , 小倉 政彦 <sup>2,3</sup> , 大串 秀世 <sup>2,3</sup> , 山崎 聡 <sup>2,3</sup>	1.筑波大, 2.産総研, 3.CREST/JST
	3月12日(木)	13:15 - 19:	00		
	13:15 - 13:30	12p-C1-1	ラマン解析より求めたダイヤモンドライクカーボンの形成要素	○鷹林 捋¹, 楊 猛³, 高桑 雄二³, 高萩 隆行²	1.東北大·通研, 2.広島大·先端研, 3 北大·多元研
	13:30 - 13:45	12p-C1-2	ダイヤモンドライクカーボン薄膜の耐熱性向上に関する分光学的解析	○鷹林 捋¹, 高萩 隆行²	1.東北大·通研, 2.広島大·先端研
	13:45 - 14:00	12p-C1-3	高周波マグネトロンスパッタリング法により推積したアモルファス状炭 素膜の構造と光学定数	○荒川 悟 <sup>1</sup> , 中谷 恭之 <sup>1</sup> , 周 小龍 <sup>1</sup> , トゥンミ ー サラユット <sup>1</sup> , 小松 啓志 <sup>1</sup> , 大塩 茂夫 <sup>1</sup> , 齋 藤 秀俊 <sup>1</sup>	1.長岡技科大
	14:00 - 14:15	E 12p-C1-4	The chemical information evaluation of hydrogenated amorphous carbon films by XPS and NEXAFS at different thicknesses	O(D)Sarayut Tunmee <sup>1</sup> , Ratchadaporn Supruangnet <sup>2</sup> , Hideki Nakajima <sup>2</sup> , Xiaolong Zhou <sup>1</sup> , Yasuyuki Nakaya <sup>1</sup> , Satoru Arakawa <sup>1</sup> , Keiji Komatsu <sup>1</sup> , Shigeo Ohshio <sup>1</sup> , Kazuhiro Kanda <sup>3</sup> , Hidetoshi Saitoh <sup>1</sup>	1.Nagaoka Univ. Tech., 2.SLRI, 3.I TI, Univ. of Hyogo
	14:15 - 14:30	12p-C1-5	熱CVDアモルファスカーボンの低温成膜技術	○北村 昌幸¹, 水永 覚¹, 清水 亮¹, 柿本 明修¹, 早川 欣延², 濱田 康弘³	1.東京エレクトロン東北, 2.東京エレロン宮城, 3.東京エレクトロン
	14:30 - 14:45	奨 12p-C1-6	フィルタードアーク蒸着においてDCバイアスで成膜したDLC膜の 諸特性	○藤井 裕真', 今井 貴大', 宮本 優', 須田 善行', 滝川 浩史', 田上 英人², 神谷 雅男 ³, 瀧 真, 長谷川 祐史', 辻 信広', 金子 智 ⁵, 安井 治之°, 國次 真輔", 川口 雅弘 <sup>8</sup> , 三 浦 健一 <sup>9</sup>	1.豊橋技科大, 2.北九州高専, 3.伊康学, 4.オンワード技研, 5.神奈川県産 6.石川工試, 7.岡山県工技セ, 8.東京 産技研, 9.大阪府産技研
Ì	14:45 - 15:00		休憩/Break	III IAE	
	15:00 - 15:15	E 12p-C1-7	Formation of popcorn-like nanostructure in $C_{60}$ -incorporated DLC by exposing to $H_2O$ vapor	○(DC)Wei Xie¹, Aiko Kawahito¹, Takashi Yanase¹, Taro Nagahama², Toshihiro Shimada²	1.Graduate School of Chemical Sciences and Engineering, Hokkaid University, 2.Hokkaido University
	15:15 - 15:30	12p-C1-8	変調SiO2基板上へのグラフェン成膜と特性評価に関する研究	○今村 友紀¹, 伊崎 貴生¹, 西口 博樹¹, 松尾 経太¹, 松川 誠也¹, 吉岡 昌雄², 久保田 弘¹²	1.熊大院自, 2.熊大工
	15:30 - 15:45	奨 12p-C1-9	ホットメッシュ堆積法によるペンタセン系有機膜の形成	○(M1)平野 竣¹, 部家 彰¹, 松尾 直人¹	1.兵庫県立大院工
	15:45 - 16:00	12p-C1-10	硬質炭素膜のSRV摩擦摩耗試験機を用いたはく離特性評価に及ぼ す膜厚の影響	○大花 継頼¹, 間野 大樹¹, 中村 挙子¹	1.産総研
	16:00 - 16:15	12p-C1-11	酸素プラズマ処理によるDLCの表面改質	○(B)河内 佑太¹, 大越 康晴¹, 本間 章彦¹, 平栗 健二¹, 荒船 龍彦¹, 野口 展士¹	1.東京電機大
	16:15 - 16:30	奨 12p-C1-12	軟X線照射によるSi合有水素化DLC膜の体積変化	〇田中 祥太郎¹, 今井 亮¹, 岡田 真¹, 松井 真二¹, 神田 一浩¹	1.兵庫県大高度研
	16:30 - 16:45		休憩/Break		
Ť	16:45 - 17:45	12p-C1-13	「薄膜・表面 分科内招待講演」(60分) DLC膜の現在と将来展望	〇大竹 尚登 <sup>1</sup>	1.東工大
†	17:45 - 18:00	12p-C1-14	N <sub>2</sub> とアセトニトリルの混合気体マイクロ波放電フローで生成する a-CN <sub>2</sub> :H薄膜の窒素源	○(M1)茂木 紳令¹, 津留 紘樹¹, 伊藤 治彦¹	1.長岡技科大工
	18:00 - 18:15	奨 12p-C1-15	アモルファス窒化炭素薄膜の柱状構造がガス応答性に及ぼす影響	○田村 尚之¹, 青野 祐美¹, 北沢 信章¹, 渡 邉 芳久¹	1.防大材料
	18:15 - 18:30	12p-C1-16	スーパーマグネトロンブラズマによる電界放出用a-CNx:H/Al膜の 作製	○木下 治久¹, 鈴木 昌¹, 田口 亮平¹, 竹 内 宏樹¹	1.静大院工
t	18:30 - 18:45	奨 12p-C1-17	グアニジン炭酸塩を用いたグラファイト状窒化炭素薄膜の合成とその基礎的評価	○藤田 詩織¹, 羽渕 仁恵¹, 髙木 俊作¹, 滝川 浩史²	1.岐阜高専, 2.豊橋技科大
	18:45 - 19:00	E 12p-C1-18	Large area synthesis of hexagonal boron nitride (hBN) with	○(D)Subash Sharma¹, Golap Kalita¹, Masaki Tanemura¹	1.Nagoya Inst of Tech

	3月11日(水)	9:00 - 11:4	5		
	9:00 - 9:15	11a-D10-1	対向ターゲット反応性スパッタ法によるp形NiO薄膜作製とCdTe太 陽電池応用	○古谷 靖明¹, 荒木 涼一¹, 小川 洋平², 細野 藍響², 野本 隆宏¹, 石川 亮佑¹, 保 岡本², 望 坪井¹	1.新潟大学, 2.木更津高専
	9:15 - 9:30	11a-D10-2	RFリアクティブスパッタ堆積したLi添加NiO薄膜の正孔濃度制御	〇中井 洋志¹, 前田 亮¹, 小笠原 愛理¹, 森山和眞¹, 川出 大佑¹, 秩父 重英², 杉山 睦¹	1.東京理科大学 理工学部/総合研究标構, 2.東北大学 多元物質科学研究所
	9:30 - 9:45	11a-D10-3	熱酸化p形Cu <sub>2</sub> Oシートの電気的特性に対するNa添加の影響	○宮田 俊弘¹, 西 祐希¹, 南 内嗣¹	1.金沢工大
	9:45 - 10:00	11a-D10-4	P形Na添加Cu <sub>2</sub> Oベースヘテロ接合太陽電池	○西 祐希¹, 宮田 俊弘¹, 南 内嗣¹	1.金沢工大 OEDS R&D センター
	10:00 - 10:15	11a-D10-5	複合ターゲットスパッタリングによるMgO単結晶基板を用いた Ni <sub>x</sub> Mg <sub>1x</sub> O系紫外線フォトコンダクタの作製と評価	○西谷 拓樹¹	1.関大シス理
	10:15 - 10:30		休憩/Break		
	10:30 - 10:45	11a-D10-6	電気化学堆積法による $\mathrm{Cu_2O/GaN}$ ~テロ構造の形成と特性評価	○熊崎 祐介¹, 近江 沙也夏¹, 谷田部 然治¹, 佐藤 威友¹	1.北大量集セ
	10:45 - 11:00	11a-D10-7	TiO₂超微粒子の軟X線照射によるNEXAFSスペクトル形状の回復	○新部 正人¹, 佐野 桂治¹, 川上 烈生², 中野 由崇³	1.兵庫県大高度研, 2.徳島大院工, 3. 部大工
	11:00 - 11:15	11a-D10-8	酸化鉄ナノチューブアレイを用いた気相メタノール光触媒分解	太田 貴洋¹, ○野田 啓¹	1.慶應大理工
	11:15 - 11:30	11a-D10-9	光触媒チタンアバタイトによる液相中有機物の吸着分解	○穴澤 俊久¹, 若村 正人¹, 今中 佳彦¹, 塚 田 峰春¹	1.富士通研
	11:30 - 11:45	11a-D10-10	Modulation of band gap in SnO by controlling interlayer Sn-Sn lone pair interaction	○梅澤 直人¹	1.物材機構
	3月11日(水)	13:15 - 17:	45		
待	13:15 - 13:30	11p-D10-1	「講演奨励賞受賞記念講演」(15分)	〇藤田 貴啓1, 佐野 航1, 打田 正輝1, 小塚 裕	
	13:30 - 13:45	奨 11p-D10-2	パイロクロア型Ir酸化物の磁気ドメイン境界における磁気輸送現象 パイロクロア型Ir酸化物薄膜の磁気ドメイン制御と局所輸送特性	介¹, 塚崎 敦²³, 有馬 孝尚⁴⁵, 川崎 雅司¹.⁵ ○小川 翔平¹, 藤田 貴啓¹, 打田 正輝¹, 小塚	け, 4.東大新領域, 5.理研CEMS 1.東大院工, 2.東北大金研, 3.JSTさき
		,		裕介1, 塚崎 敦2.3, 有馬 孝尚4.5, 川崎 雅司1.5	け, 4.東大新領域, 5.理研CEMS
	13:45 - 14:00	奨 11p-D10-3	ダブルベロブスカイト型Sr <sub>2</sub> CoRuO <sub>6</sub> の薄膜合成と物性	○渡会 啓介¹, 吉松 公平¹, 大島 孝仁¹, 大友 明¹²	1.東工大院理工, 2.元素戦略
	14:00 - 14:15	奨 11p-D10-4	トボタクティック酸化・還元法によるAサイト秩序型ベロブスカイト $YBaCo_2O_x$ $(x=4.5-6)$ エビタキシャル薄膜の作製	○(DC)片山 司¹, 近松 彰¹², 福村 知昭¹², 長谷川 哲也¹²₃	1.東大院理, 2.JST-CREST, 3.KAST
	14:15 - 14:30	奨 11p-D10-5	スピネル型フェライト(Fe,Ti)。O <sub>4</sub> 薄膜のキャリア極性制御	〇山原 弘靖¹, 足立 真輝¹, 高橋 雅尚¹, 関宗俊¹, 堀場 弘司², 組頭 広志², 田畑 仁¹	1.東大工, 2.高エネ研
	14:30 - 14:45	奨 11p-D10-6	フタロシアニン系金属錯体を用いた遷移金属酸化物薄膜のMBE 合成	○清水 亮太¹, 白木 捋¹, 一杉 太郎¹²	1.東北大AIMR, 2.JST-さきがけ
	14:45 - 15:00	奨 11p-D10-7	マルチフェロイックBiFe $_{1-x}$ Co $_x$ O $_3$ 薄膜のスピン構造変化	○川邊 諒', 北條 元', 山本 孟', 清水 啓佑', 壬生 攻², 東 正樹'	1.東京工業大学応セラ, 2.名工大工
	15:00 - 15:15	奨 11p-D10-8	$Ca_xSm_{l,x}TiO_3$ エピタキシャル薄膜の作製と電気特性評価	○(B)岡部 宏和¹, 吉松 公平¹, 大島 孝仁¹, 大友 明¹²	1.東工大院理工, 2.元素戦略
	15:15 - 15:30	奨 11p-D10-9	有機金属ガス源分子線エピタキシー法による $\mathrm{Eu_{l,x}La_xTiO_3}$ 薄膜の高移動度化と異常ホール効果	○(M2C)村田 智城¹, 高橋 圭², 松原 雄也²³, 打田 正輝¹, 小塚 裕介¹, 川崎 雅司¹²	1.東大院工, 2.理研CEMS, 3.東北大 金研
	15:30 - 15:45		休憩/Break		
	15:45 - 16:00	11p-D10-10	パルスレーザー蒸着法を用いた $\mathrm{Nd_3Fe_5O_{12}}$ 薄膜作製とその磁気特性	○那須 英和¹, 足立 真輝¹, 山原 弘靖¹, 関 宗俊¹, 田畑 仁¹	1.東大工
	16:00 - 16:15	11p-D10-11	P型透明酸化物半導体Si:FeOのエピタキシャル薄膜の形成	○関 宗俊', シャモハディアミン <sup>1</sup> , 高橋 雅 尚', 足立 真輝', 那須 英和', 山原 弘靖 <sup>1</sup> , 田畑 仁 <sup>1</sup>	1.東大工
	16:15 - 16:30	11p-D10-12	$\text{Lu}_{_3}\text{Fe}_{_{5:2x}}\text{Co}_{_x}\text{Si}_{_x}\text{O}_{_{12}}$ 薄膜におけるリエントラントクラスターグラス特性	○足立 真輝¹, 那須 英和¹, 山原 弘靖¹, 関宗俊¹, 松井 裕章¹, 田畑 仁¹	1.東大院工
	16:30 - 16:45	11p-D10-13	$SrRu_{0,5}Cr_{0,5}O_3$ エピタキシャル薄膜の作製及び物性評価	○山田 佳補¹, 近松 彰¹², 重松 圭¹, 福村 知昭¹², 長谷川 哲也¹²³	1.東大理, 2.JST-CREST, 3.KAST
	16:45 - 17:00	11p-D10-14	強磁性金属/r面配向Cr <sub>2</sub> O <sub>3</sub> 積層膜の磁気特性	○隅田 貴士¹, 橋本 浩介¹, 中村 拓未¹, 渡 部 雄太¹, 永田 知子¹, 高瀬 浩一¹, 山本 寛 ¹, 岩田 展幸¹	1.日大理工
	17:00 - 17:15	11p-D10-15	BiFe, Mn O。擬ペロプスカイト系薄膜および人工超格子の結晶構造と電気的磁気的特性	○稲葉 隆哲', 渡部 雄太', 大島 佳祐', 及川 貴大', 王 春', 宋 華平', 永田 知子', 橋本 拓也², 高瀬 浩一', 山本 寛', 岩田 展幸'	1.日大理工, 2.日大文理
	17:15 - 17:30	11p-D10-16	酸化物-金属界面結合予測ソフト: InterChemBond	○吉武 道子¹	1.物材機構
	17:30 - 17:45	11p-D10-17	有機金属熱分解(MOD)法によるLa $M$ nO $_3$ 薄膜の作製とその電気 伝導特性	〇祐本 美久¹, 牧野 壱¹, 小堀 裕己¹, 山崎 篤志¹, 谷口 年史², 清水 哲夫³	1.甲南大理工, 2.阪大院理, 3.産総研
	3月12日(木)	9:00 - 11:4	5		
	9:00 - 9:15	12a-D10-1	Niプルシャンブルー類似体における高速インターカレーション	○(PC)柴田 恭幸¹, 濱口 純¹, 守友 浩¹²	1.筑波大数理, 2.筑波大CiRfSE
	9:15 - 9:30	12a-D10-2	P2型Na¸CoO¸薄膜電極の放電曲線のレート依存性	○柳田 歩¹, 柴田 恭幸¹, 小林 航¹², 守 友 浩¹²	1.筑波大数理, 2.筑波大 CiRfSE
	9:30 - 9:45	12a-D10-3	全固体リチウム電池の酸化物電解質/電極界面におけるイオン伝導 特性	○白木 捋¹, 春田 正和², 鈴木 竜¹, 高木 由 貴¹, 清水 亮太¹, 一杉 太郎¹	1.東北大AIMR, 2.同志社大
	9:45 - 10:00	奨 12a-D10-4	酸化物ヘテロ界面における室温近傍での酸素イオン伝導	○平井 慧¹, 菅 大介¹, 市川 能也¹, 麻生 亮 太郎¹, 倉田 博基¹², 島川 祐一¹²	1.京大化研, 2.JST-CREST
	10:00 - 10:15	奨 12a-D10-5	2元スパッタリング法で作製したInSiO系チャネル材料の電気特性	へゆ・, 月田   日本・, 18月   竹一・2 ○(M1)栗島 一徳1-, 生田目 俊秀 <sup>2</sup> , 三苫 伸 彦 <sup>2</sup> , 木津 たきお <sup>2</sup> , 塚越 一仁 <sup>2</sup> , 澤田 朋実 <sup>2</sup> , 大井 暁彦 <sup>2</sup> , 山本 逸平 <sup>2-3</sup> , 大石 知司 <sup>3</sup> , 知京 豊裕 <sup>2</sup> , 小椋 厚志 <sup>2</sup>	1.明治大, 2.物材機構 WPI-MANA, 3.芝浦工大
	10:15 - 10:30		休憩/Break		
	10:30 - 10:45	奨 12a-D10-6	高移動度 $\beta\text{-Ga}_{2}\text{O}_{3}(\overline{2}01)$ 単結晶を用いたショットキーバリアダイオードの作製	○(B)古賀 優太¹, 原田 和也¹, 大石 敏之¹, 嘉数 誠¹	1.佐賀大院工
	10:45 - 11:00	奨 12a-D10-7	ワイドバンドギャップ半導体ZnInONをi層に用いたpin太陽電池の 作製	〇松島 宏一¹, 清水 僚太¹, 井手 智章¹, 山下 大輔¹, 徐 鉉雄¹, 古閑 一憲¹, 白谷 正治¹, 板垣 奈穂¹²	1.九州大学, 2.JSTさきがけ

11:00 - 11:15	奨 12a-D10-8	配向を制御した $\alpha$ -Fe $_2$ O $_3$ 溥膜のインビーダンス測定評価	○(D)增子 尚徳¹, 吉松 公平¹, 大島 孝仁¹, 大友 明¹²	1.東工大院理工, 2.元素戦略
11:15 - 11:30	奨 12a-D10-9	パルスレーザー堆積法による $\alpha$ -PbO/SrTiO $_3$ エピタキシャルヘテロ接合の作製と光電子物性	○真島 英司¹, 小塚 裕介¹, 打田 正輝¹, 川 﨑 雅司¹²	1.東大院工, 2.理研CEMS
11:30 - 11:45	12a-D10-10	強誘電抵抗スイッチングにおける終端表面依存性	○山田 浩之1², 福地 厚¹, 小林 正起³, 長井 拓郎⁴, 豊崎 喜精¹, 組頭 広志³, 澤 彰仁¹	1.産総研, 2.JSTさきがけ, 3.KEK, 4.NIMS
3月13日(金	9:00 - 11:4	15		
9:00 - 9:15	13a-D10-1	SrTiO <sub>3</sub> ーイオン液体界面におけるキャリア蓄積のメカニズム	○清水 直¹, 小野 新平¹², 畑野 敬史³, 岩佐 義宏¹⁴, 十倉 好紀¹⁴	1.理研 CEMS, 2.電中研, 3.名大工 4.東大工
9:15 - 9:30	奨 13a-D10-2	様々な電解液を用いたSrTiO <sub>3</sub> の電場誘起金属絶縁体転移	○佐藤 洋平¹, 土井 聖将¹, 上野 和紀¹	1.東大院総合
9:30 - 9:45	E 13a-D10-3	Electrostatic Carrier Doping to KTaO <sub>3</sub> Using Organic Parylene-C/ High-k Oxide Hybrid Gate Insulator	○TINGTING WEI¹², Kohei Fujiwara¹, Hidekazu Takana¹	1.ISIR Osaka Univ., 2.Kunming S Tech Univ
9:45 - 10:00	奨 13a-D10-4	ベロブスカイト型WO <sub>3</sub> 薄膜の作製とキャリアドービング	○西早 辰一¹, 打田 正輝¹, 小塚 裕介¹, 岩佐 義宏¹², 川崎 雅司¹²	1.東大工, 2.理研CEMS
10:00 - 10:15	奨 13a-D10-5	電気化学的 $\text{Li}$ 挿入による $\text{WO}_3$ エピタキシャル薄膜の金属化	○相馬 拓人¹, 吉松 公平¹, 丹羽 三冬¹, 大島孝仁¹, 大友 明¹²	1.東工大院理工, 2.元素戦略
10:15 - 10:30		休憩/Break		
10:30 - 10:45	13a-D10-6	全固体エレクトロクロミック $WO_3$ 薄膜トランジスタ	○廣野 未沙子¹, 片瀬 貴義², 太田 裕道²	1.北大工, 2.北大電子研
10:45 - 11:00	13a-D10-7	全固体SrCoO <sub>3-a</sub> 強磁性薄膜トランジスタ	○鈴木 雄喜¹, 片瀬 貴義², 太田 裕道²	1.北大工, 2.北大電子研
11:00 - 11:15	13a-D10-8	サイドゲート型トランジスタを用いた電界効果によるVO <sub>2</sub> ナノワイヤへの 水素イオンドーブと拡散の時空間解析	○(M2)佐々木 翼¹, 神吉 輝夫¹, 田中 秀和¹	1.阪大産研
11:15 - 11:30	13a-D10-9	TiO <sub>2</sub> 固体絶縁膜を用いたVO <sub>2</sub> モットトランジスタの動作機構の研究	○矢嶋 赳彬¹², 西村 知紀¹², 鳥海 明¹²	1.東大, 2.JST-CREST
11:30 - 11:45	13a-D10-10	$LaVO_xN_y$ エピタキシャル薄膜の電気輸送特性及び光学特性	○佐野 真仁 <sup>1,3</sup> , 廣瀬 靖 <sup>1,2,3</sup> , 中尾 祥一郎 <sup>2,3</sup> , 福村 知昭 <sup>1,2,3</sup> , 長谷川 哲也 <sup>1,2,3</sup>	1.東大院理, 2.JST-CREST, 3.KAS
3月13日(金	) 16:30 - 19	:00		
16:30 - 16:45	13p-D10-1	酸化物界面双極子を用いた $\operatorname{Pt/anatase}\ \operatorname{TiO_2}$ ショットキー障壁の制御	○疋田 育之¹, 立川 卓¹², 簑原 誠人¹³, ベルクリストファー¹⁴, ファン ハロルド¹.⁵	1.SLAC, 2.東大新領域, 3.高エネ研リストル大, 5.スタンフォード大
16:45 - 17:00	奨 13p-D10-2	スピントロニクス応用に向けた遷移金属/Nb:SrTiO $_{_3}$ 界面の接触抵抗制御	○(D)井上 悠¹, Adrian Swartz¹, 立川 卓²³, 疋田 育之², Harold Hwang¹²	1.スタンフォード大, 2.SLAC国立加研, 3.東大新領域
17:00 - 17:15	13p-D10-3	LaNiO <sub>3</sub> /SrTiO <sub>3</sub> における界面ダイポールを用いたポテンシャル変調	○坂井 延寿¹, 堀場 弘司¹, 小林 正起¹, 簔原 誠人¹, 北村 未歩¹, 組頭 広志¹	1.KEK-PF
17:15 - 17:30	奨 13p-D10-4	ペロプスカイト酸化物 $\operatorname{LaMnO_{3}}/\operatorname{LaNiO_{3}}$ ヘテロ界面における電荷移動	○(DC)北村 未歩1², 堀場 弘司², 小林 正起², 坂井 延寿², 簑原 誠人², 三橋 太一², 藤森淳³, 藤岡 洋¹, 組頭 広志²	1.東大生研, 2.高エネ研, 3.東大院
17:30 - 17:45	奨 13p-D10-5	バルスレーザー堆積法による新物質( $[Bi_2O_2]_pRhO_2$ )単結晶薄膜の作製	○大羽 健太¹, 打田 正輝¹, 大内 祐貴¹, 小塚 裕介¹, 川崎 雅司¹²	1.東大院工, 2.理研CEMS
17:45 - 18:00	奨 13p-D10-6	バイアススパッタ法による $\mathrm{VO_2/Al_2O_3}$ (001)の転移特性制御と特異成長モードの発現	○(D)ヌルーハニス ピンティアズハン <sup>1</sup> , 沖 村 邦雄 <sup>1</sup> , 蘇 魁 <sup>1</sup> , ムスタファ ザグリウィ <sup>2</sup> , 坂 井 穣 <sup>2</sup>	1.東海大院理工, 2.トゥール大GRE
18:00 - 18:15	奨 13p-D10-7	${ m VO}_2/{ m TiN/Si}$ 積層構造デバイスにおける ${ m MHz}$ 帯発振	○(D)モハメッド シュルズ <sup>1</sup> , 沖村 邦雄 <sup>1</sup> , 坂 井 穣 <sup>2</sup>	1.東海大院理工, 2.トゥール大GRE
18:15 - 18:30	13p-D10-8	リン酸を用いたMgO基板の結晶異方性エッチング	○(M2)山崎 翔太¹, 神吉 輝夫¹, ベリグリー ノルカ², マンカ ニコラ²³, マレー ダニエル ²³, 田中 秀和¹	1.阪大産研, 2.CNR-SPIN, 3.Gend Univ.
18:30 - 18:45	13p-D10-9	高い絶縁破壊電界強度を持ったナノ構造セラミックス成膜技術	○渕田 英嗣¹, 時崎 栄治¹, 小澤 英一¹	1.有限会社渕田ナノ技研
18:45 - 19:00	13p-D10-10	白色発光を伴う化合物半導体/酸化物複合ナノワイヤの作製	○石川 史太郎¹, 日比 秀昭², 山本 直紀³	1.愛媛大院理工, 2.阪大院工, 3.東 大院理工

6.3 酸化物エレク	'トロニクス / O:	xide electronics ポスター講演		
3月13日(金	) 16:30 - 18:3	30		
	13p-P5-1	Nd:YAGレーザーの第4次高調波を用いたSrTiO <sub>3</sub> 薄膜の低温成長	○石川 竜介¹, 和田 雄太¹, 小野里 尚記¹, 中村 基訓¹, 篁 耕司¹	1.旭川高専
	13p-P5-2	極薄 $\mathrm{Ta_2O_5}$ 膜の抵抗変化型メモリへの適用	○大野 武雄1.2, 寒川 誠二1.3	1.東北大WPI-AIMR, 2.JSTさきがけ, 3.東北大流体研
	13p-P5-3	マイクロ波励起プラズマを用いた $\mathrm{WO}_3$ の形成と抵抗変化メモリへの応用	○(M1)高木 翔太¹, 荒井 哲司¹, 有元 圭介¹, 山中 淳二¹, 中川 清和¹, 高松 利行²	1.山梨大学, 2.株式会社SST
	13p-P5-4	抵抗変化メモリ(ReRAM)の導電性パス生成機構の検討 ~ NiOの 様々な面方位の第一原理電子状態解析 ~	○(D)森山 拓洋 <sup>1,4</sup> , 山崎 隆浩 <sup>2</sup> , 大野 隆央 <sup>2,3</sup> , 岸田 悟 <sup>1,4</sup> , 木下 健太郎 <sup>1,4</sup>	1.鳥取大工, 2.物材機構, 3.東大生産研 4.TiFREC
	13p-P5-5	可視光透過型太陽電池の作製と評価	○佐藤 和弥¹, 山口 竜典¹, 金 相澈¹, 小室 修二², 趙 新為¹	1.東理大理, 2.東洋大理工
	13p-P5-6	${ m IrO}_2$ 薄膜における結晶性と電気抵抗率	○侯 秀一¹, 高橋 竜太¹, Lippmaa Mikk¹	1.東大物性研
	13p-P5-7	ReRAMの発熱挙動観察	○上沼 睦典¹, 浦岡 行治¹	1.奈良先端大
	13p-P5-8	p-Cu <sub>2</sub> O/AlO <sub>x</sub> /n-SiC pnダイオード構造の抵抗変化型不揮発性メモリ	○土屋 充沙¹, 山下 敦史¹, 塚本 貴広¹, 須 田 良幸¹	1.東京農工大
	13p-P5-9	Au/CuO <sub>x</sub> /NiO <sub>x</sub> /n-Si 2層金属酸化物構造の抵抗変化型不揮発性 メモリ	○岩佐 太陽¹, 塚本 貴広¹, 須田 良幸¹	1.東京農工大院工
	13p-P5-10	Pt担持TiO <sub>2</sub> ハイブリッド薄膜を用いたリソグラフィプロセスⅡ	猪岡 航介¹, ○前田 篤志¹, 松田 厚範²	1.府大高専, 2.豊橋技科大
	13p-P5-11	可視光透過型太陽電池に向けたGZO薄膜の作製と評価III	○金 相ちょり¹, 山口 竜典¹, 小室 修二², 趙 新為¹	1.東理大理, 2.東洋大理工
	13p-P5-12	CdSe量子ドットを吸着した逆オバール構造TiO₂電極の光電変換特性・周期依存性・	○(B)廣中 基記 <sup>1</sup> , 常 進 <sup>1,3</sup> , 秋元 正哉 <sup>1</sup> , 豊田 太郎 <sup>1,3</sup> , 尾込 裕平 <sup>2,3</sup> , 早瀬 修二 <sup>2,3</sup> , 沈 青 <sup>1,3</sup>	1.電通大先進理工, 2.九工大生命体工, 3.JST CREST
	13p-P5-13	増感型太陽電池への応用を目的とした水熱合成による単結晶TiO <sub>2</sub> ナノロッド電極の作製と評価	○(B)梶 知史¹, 常 進¹³, 秋元 正哉¹, 豊田 太郎¹³, 尾込 裕平²³, 早瀬 修二²³, 沈 青¹³	1.電通大先進理工, 2.九工大生命体工 3.JST CREST
	13p-P5-14	銅酸化物多孔膜とポリビロールの複合膜の構造制御と光蓄電池へ の応用	○(M1C)前田 大輝¹, 野見山 輝明¹, 堀 江 雄二¹	1.鹿児島大

13	3p-P5-15	ベロブスカイト型酸窒化物光触媒ATa ${\rm O_2N}({\rm A=Ca,Mg})$ における電子状態の構造依存性	○(M2)久保 綾子¹, Giacomo Giorgi¹, 山下 晃一¹.²	1.東京大学大学院, 2.JST-CREST
13	3p-P5-16	$\operatorname{Fe_3O_4}$ 薄膜の $\operatorname{Dewetting}$ プロセスの観察	○正能 大起 <sup>1</sup> , 高橋 竜太 <sup>1</sup> , 小沼 碧海 <sup>2</sup> , 丸 山 伸伍 <sup>2</sup> , 松本 祐司 <sup>2</sup> , Jahangir Solmaz <sup>3</sup> , Nagarajan Valanoor <sup>3</sup> , Lippmaa Mikk <sup>1</sup>	1.東大物性研, 2.東北大院工, 3.UNSW

3月14日(土	9:30 - 11:4	5		
:30 - 9:45	14a-D10-1	RFバイアス三極スパッタ法におけるイオン照射を利用したO面, Zn面, a面およびm面ZnO薄膜の形成	○橋本 亮介¹, 高柳 真司¹, 柳谷 隆彦², 松 川 真美¹	1.同志社大学, 2.名工大
9:45 - 10:00	14a-D10-2	RFマグネトロンスパッタ法におけるZnOターゲット温度がc軸平行配向 ZnO膜の形成に及ぼす影響	○高田 千裕¹, 高柳 真司¹, 柳谷 隆彦², 松 川 真美¹	1.同志社大, 2.名工大
0:00 - 10:15	14a-D10-3	ZnO/grapheneナノ複合体の作製とその電気的特性	○奥村 竜二¹, 高田 直也¹, 大久保 貴雅¹, 近藤 祐太¹, 市川 洋¹	1.名工大
0:15 - 10:30	14a-D10-4	グラフェン上へのZnOナノロッドの直接成長	○奥村 竜二¹, 高田 直也¹, 大久保 貴雅¹, 近藤 祐太¹, 市川 洋¹	1.名工大
0:30 - 10:45	14a-D10-5	抵抗変化メモリの低抵抗状態における残留抵抗の起源	○(D)森山 拓洋 <sup>1,2</sup> , 榎本 雄太郎 <sup>1</sup> , 岸田 悟 <sup>1,2</sup> , 木下 健太郎 <sup>1,2</sup>	1.鳥取大工, 2.TiFREC
0:45 - 11:00	14a-D10-6	溶媒置換によるHfO <sub>2</sub> 導電性ブリッジメモリのスイッチング特性制御 2	○(M2)吉原 正人¹, 原田 晃典¹, 伊藤 敏幸¹, 岸田 悟¹², 木下 健太郎¹²	1.鳥取大工, 2.TiFREC
1:00 - 11:15	14a-D10-7	電子ビーム吸収電流(EBAC)法によるReRAMのメモリ動作領域の 解析	○島 久¹, 秋永 広幸¹	1.産総研ナノエレ部門
1:15 - 11:30	14a-D10-8	MOD法BaTiO <sub>3</sub> 薄膜の抵抗変化型メモリ特性向上の検討	○杉江 敏幸¹, 橋本 修平¹, 張 子洋¹, 山下馨¹, 野田 実¹	1.京工繊工芸
1:30 - 11:45	14a-D10-9	抵抗変化メモリ用MOD法BaTiO <sub>3</sub> 薄膜作製時焼成雰囲気が薄膜特性に与える影響	○橋本 修平¹, 杉江 敏幸¹, 張 子洋¹, 山下 馨¹, 野田 実¹	1.京工繊工芸
8月14日(土	.) 13:00 - 14	45		
3:00 - 13:15	E 14p-D10-1	Effects of the Oxide Film Density on the Resistive Switching Characteristics of Atomic Switches	○(P)Cedric Mannequin¹, Tohru Tsuruo- ka¹, Tsuyoshi Hasegawa¹, Masakazu Aono¹	1.NIMS-WPI-MANA
3:15 - 13:30	14p-D10-2	高分子電解質を用いた原子スイッチ動作の温度依存性	○鶴岡 徹¹, モハパトラ ソーミャ¹, クリシュナン カーティック¹, 長谷川 剛¹, 青野 正和¹	1.物材機構
3:30 - 13:45	奨 14p-D10-3	AlFeO。エピタキシャル薄膜における抵抗スイッチング特性および負性抵抗現象	○(M2)韓 業飛¹, 濵嵜 容丞¹, 安井 伸太郎¹, 谷山 智康¹, 伊藤 満¹	1.東工大応セラ研
3:45 - 14:00	14p-D10-4	ノンボーラ型抵抗変化メモリの構造非対称性がリセット特性に及ぼ す影響	○(M1)木村 康平¹, 小石 遼介¹, 河野 公紀¹, 岸田 悟¹², 木下 健太郎¹²	1.鳥大工, 2.TiFREC
4:00 - 14:15	奨 14p-D10-5	ブレーナー型四端子抵抗変化メモリ(ReRAM)を用いたフィラメント 物性の解析	○(M1)澤居 優圭¹, 高 相圭¹, 青木 智宏¹, 岸田 悟¹², 木下 健太郎¹²	1.鳥取大工, 2.TiFREC
4:15 - 14:30	奨 14p-D10-6	NiOを用いたReRAMのセミフォーミング後におけるコンダクタンスの 温度依存性	○篠倉 弘樹¹, 西 佑介¹, 木本 恒暢¹	1.京大院工
4:30 - 14:45	E 14p-D10-7	Active dislocations for resistance switching in SrTiO <sub>3</sub>	OJUN CHEN¹, JIANYONG LI², SHUN ITO³. SEKIGUCHI TAKASHI¹	1.NIMS, 2.JST, 3.Tohoku Unvi

<b></b>	/ Thin films a	nd New materials 口頭講演		
3月11日(水	9:00 - 11:4	45		
9:00 - 9:15	11a-D8-1	(CH) ポリマーと ${ m Al_2O_3}(0001)$ との反応による ${ m Al_4C_3}$ のエピタキシャル成長	大見 浩輔¹, 長谷川 幸樹², 柳瀬 隆², 長浜 太郎², ○島田 敏宏²	1.北大総化, 2.北大工
9:15 - 9:30	11a-D8-2	イオン液体ナノ薄膜における伝導度の温度依存性	○丸山 伸伍¹, 鳥屋部 果穂¹, 松本 祐司¹	1.東北大院工
9:30 - 9:45	11a-D8-3	Pulsed laser deposition法を用いたLiH薄膜成長	○大口 裕之¹, 白木 将², 桑野 博喜¹, 折茂 慎一²³, 一杉 太郎²	1.東北大院工, 2.東北大AIMR, 3.東 北大金研
9:45 - 10:00	11a-D8-4	Si(100)基板上の複合面方位CeO\$_2\$領域間の分離	○井上 知泰¹, 信田 重成¹	1.いわき明星大科学技術
10:00 - 10:15	11a-D8-5	斜め入射堆積Ti薄膜の熱酸化による酸化チタン薄膜の作製	○星陽一1,小林信一1,北原直人1,澤田豊1	1.東京工芸大工
10:15 - 10:30		休憩/Break		
10:30 - 10:45	11a-D8-6	二次元非熱平衡プラズマを利用した $\mathrm{SnO}_{_2}$ 薄膜の形成	金指 翔大¹, 花井 利通¹, 丹 祐人¹, ○奥 谷 昌之¹.²	1.静岡大院工, 2.静岡大グリーン研
10:45 - 11:00	11a-D8-7	非平衡プラズマを用いたTiO₂膜の作成における雰囲気制御の影響	○増田 優貴¹, 丹 祐人¹, 金指 翔大¹, 奥 谷 昌之¹.²	1.静岡大院工, 2.静岡大グリーン研
11:00 - 11:15	11a-D8-8	Mg-Sn薄膜作製に及ぼすガラス基板表面の効果	○横山 達己 <sup>1</sup> , 西谷 幹彦 <sup>2</sup> , 森田 幸弘 <sup>2</sup> , 倉 敷 哲生 <sup>1</sup>	1.大阪大学, 2.パナソニック株式会社
11:15 - 11:30	11a-D8-9	室温でガラス化硬化するSiO2膜の封止スペース内形成	○歸山 敏之	
11:30 - 11:45	11a-D8-10	金属-EDTAの原料粒径を制御して合成した酸化物膜	白井 友之¹, 淡 エンキン¹, ○小松 啓志¹, 中村 淳¹², 大塩 茂夫¹, 齋藤 秀俊¹	1.長岡技科大, 2.中部キレスト
3月12日(木	9:00 - 11:4	45		
9:00 - 9:15	12a-D8-1	$Sr_2SiO_4$ ターゲットで作製した $Sr_2SiO_4$ 膜組成のアニール温度依存性	○(M1)今西 啓司 <sup>1</sup> , 谷脇 将太 <sup>1</sup> , 馬野 光博 <sup>1</sup> , 堀田 育志 <sup>1,2</sup> , 吉田 晴彦 <sup>1,3</sup> , 新船 幸二 <sup>1,3</sup> , 小 掠 厚志 <sup>2,3</sup> , 佐藤 真一 <sup>1,3</sup>	1.兵庫県立大, 2.明治大, 3.JST-CRES
9:15 - 9:30	12a-D8-2	2種類のHigh-k材料とSiO <sub>x</sub> を用いた三色超構造の作製	〇三宅 省三¹, 豊嶋 祐樹¹, 上岡 聡史¹, 堀田 育志¹³, 吉田 晴彦¹³, 新船 幸二¹³, 小椋 厚志²³, 佐藤 真一¹³	1.兵庫県立大, 2.明治大, 3.JST-CRES
9:30 - 9:45	12a-D8-3	${ m YAIO_3}(001)$ 基板上での ${ m Cr_2O_3}$ 薄膜成長及び結晶構造解析	○橋本 浩佑¹, 隅田 貴士¹, 林 佑太郎¹, 中村 拓未¹, 永田 知子¹, 山本 寛¹, 岩田 展幸¹	1.日大理工
9:45 - 10:00	12a-D8-4	[CaFeO <sub>x</sub> /LaFeO <sub>3</sub> ]人工超格子の電気的磁気的特性	○大島 佳祐¹, 渡部 雄太¹, 及川 貴大¹, 稲葉 隆哲¹, 王 春¹, 宋 華平¹, 永田 知子¹, 高瀬 浩一¹, 橋本 拓也², 山本 寬¹, 岩田 展幸¹	1.日大理工, 2.日大文理
10:00 - 10:15	12a-D8-5	SmFe, 薄膜のエピタキシーと窒化処理による磁気特性変化	○楠森 毅¹, 藤田 麻哉¹, 尾崎 公洋¹	1.産総研中部
10:15 - 10:30		休憩/Break		

	10:30 - 10:45	12a-D8-6	PLD法を用いたサマリウム単酸化物薄膜の作製	○内田 悠¹, 神永 健一¹, 福村 知昭¹², 長谷 川 哲也¹²	1.東大理化, 2.JST-CREST
	10:45 - 11:00	12a-D8-7	高耐熱抵抗材料を目指した $\operatorname{Fe_3O_4}$ 膜の合成と評価	○藤原 宏平¹, 坪田 智司¹, 田中 秀和¹	1.阪大産研
	11:00 - 11:15	12a-D8-8	PLD法によるSi基板上へのLaVO <sub>3</sub> 薄膜の作製	○(M1)稲垣 遼¹, 近成 将¹, 堀田 育志¹, 佐 藤 真一¹	1.兵庫県立大
	11:15 - 11:30	12a-D8-9	パイアス印加スパッタ法による $\mathrm{VO}_{_2}(\mathrm{B})$ 及び $\mathrm{VO}_{_2}(\mathrm{M})$ の選択成長	○蘇 魁¹, NurulHanis BinitAzhan¹, 沖 村 邦雄¹	1.東海大院工
	11:30 - 11:45	12a-D8-10	$(\mathrm{Ti}_{0,4}\mathrm{V}_{0,6})\mathrm{O}_2$ 薄膜におけるスピノーダル分解	○村岡 祐治¹, 大塚 翼¹, 寺嶋 健成¹, 脇田 高徳¹, 横谷 尚睦¹	1.岡山大院自然
	3月12日(木	) 13:15 - 18:3	30		
招待	13:15 - 13:30	E 12p-D8-1	[Young Scientist Presentation Award Speech] (15min.) Thermoplasmonic control of Marangoni flow around a micro bubble	OKyoko Namura <sup>1,2</sup> , Kaoru Nakajima <sup>1</sup> , Kenji Kimura <sup>1</sup> , Motofumi Suzuki <sup>1</sup>	1.Kyoto Univ., 2.J S P S Research Fellow
	13:30 - 13:45	E 12p-D8-2	Nanoscale measurements of the work function in nanocrystalline TiN and amorphous films by multimode scanning probe microscopy and spectroscopy	○Leonid Bolotov¹, Takashi Matsukawa¹, Koichi Fukuda¹, Meishoku Masahara¹, Tetsuya Tada¹	1.AIST
	13:45 - 14:00	E 12p-D8-3	Measurements of absolute densities of Cu, Zn, Sn and S atoms in magnetron sputtering plasma employing a Cu <sub>2</sub> ZnSnS <sub>4</sub> target	○Nayan Nafarizal <sup>1,2</sup> , Koichi Sasaki <sup>1</sup>	1.Hokkaido Univ., 2.Univ. Tun Hussein Onn Malaysia
	14:00 - 14:15	E 12p-D8-4	Characterization of Thick AlN Templates Grown on Micro-circle Patterned-Si Substrates	○(P)Tinh Tran¹, Noritoshi Maeda¹, Shiro Toyoda¹, Hideki Hirayama¹	1.RIKEN
	14:15 - 14:30	E 12p-D8-5	Low-temperature fabricating uniform and controllable ZnO Nanorods	○(DC)Shengwen Hou¹, Miyuki Nishino¹, Chaoyang Li¹	1.Kochi Univ. Tech.
	14:30 - 14:45	E 12p-D8-6	Influence of $N_2O$ doped buffer layer on the properties of ZnO thin films on glass substrates grown by catalytic-reaction-assisted chemical vapor deposition	Yuuki Ishidzuka¹, Yuuki Ohashi¹, Hironori Katagiri², Koichiro Oishi², Yasuhiro Tama- yama¹, Takahiro Kato¹, ○Kanji Yasui¹	1.Nagaoka Univ. Technol., 2.Nagaoka. Nat. Coll. Technol.
	14:45 - 15:00	E 12p-D8-7	Spinel Oxide Flexible Film Thermistors	○Tomohiko Nakajima¹, Tetsuo Tsuchiya¹	1.AIST
	15:00 - 15:15	奨·E 12p-D8-8	Electron Transport Mechanism of Oxygen-doped Zinc Nitride Thin Films	○(D)Xiang Cao¹, Atsushi Sato¹, Yoshihiko Ninomiya¹, Naoomi Yamada¹	1.Chubu Univ.
	15:15 - 15:30		休憩/Break		
招待	15:30 - 15:45	奨 12p-D8-9	「薄膜·表面 分科内招待講演」(15分) 透明強磁性鉄薄膜	〇千原 真志 $^1$ , 角谷 直紀 $^1$ , 藤本 亮祐 $^1$ , 中村 伊吹 $^1$ , 畑野 敬史 $^1$ , 飯田 和昌 $^1$ , 生田 博志 $^1$	1.名大工
	15:45 - 16:00	奨 12p-D8-10	ストロンチウム置換ハイドロキシアパタイト薄膜の作製	○(B)齋藤 絢香¹, 橋本 典也², 西川 博昭¹	1.近大生物理工, 2.大阪歯科大
	16:00 - 16:15	奨 12p-D8-11	バルスレーザ堆積法においてレーザビームの強度分布がハイドロキシ アバタイト薄膜の化学組成に及ぼす影響	○(M1)長谷川 司¹, 橋本 典也², 西川 博昭³	1.近大院生物理工, 2.大阪歯科大, 3.近大生物理工
	16:15 - 16:30	奨 12p-D8-12	浸渍離膜すくい上げ法による多孔基板上への自立Au薄膜の作製	○宮本 優', 山野 将史', 藤井 裕真', 須田 善行', 滝川 浩史', 田上 英人², 西内 満美子 ³, 榊 泰直³, 近藤 公伯°	1.豊橋技科大, 2.北九州高専, 3.原子 力機構
	16:30 - 16:45	奨 12p-D8-13	一軸圧縮下の熱処理による機能性酸化物薄膜の固相結晶化挙動	<ul><li>○野沢 靖久¹, 譚 ゴオン¹, 船迫 友之¹, 金子智², 松田 晃史¹, 吉本 護¹</li></ul>	1.東工大 総理工, 2.神奈川県産技セ
	16:45 - 17:00	奨 12p-D8-14	化学気相蒸着法による六角形 ${ m NbS}_2$ フレークの合成	○柳瀬 隆¹, 渡邊 翔¹, 翁 夢婷¹, 長浜 太郎¹, 島田 敏宏¹	1.北大工
	17:00 - 17:15	奨 12p-D8-15	金属メッシュ配線への窒化AI系光吸収薄膜の応用検討	○志田 陽子¹, 越智 元隆¹, 後藤 裕史¹, 釘宮 敏洋¹, 奥野 博行², 金丸 守賀²	1.(株)神戸製鋼所, 2.(株)コベルコ科研
	17:15 - 17:30		休憩/Break		
	17:30 - 17:45	12p-D8-16	ミスト CVD 法による光透過性銅薄膜の作製	○上野 仁希¹, 池之上 卓己¹, 三宅 正男¹, 平藤 哲司¹	1.京大院エネ科
	17:45 - 18:00	12p-D8-17	TiO₂光学薄膜の機械的特性	○羽尾 衛¹, 室谷 裕志¹	1.東海大工
	18:00 - 18:15	12p-D8-18	アクリル基板上へ形成した光学薄膜の密着性の研究	○田島 直弥¹, 室谷 裕志¹, 松本 繁治², 本 多 博光²	1.東海大工, 2.(株)シンクロン
	18:15 - 18:30	12p-D8-19	ランタンとチタンの複合酸化物(H4)光学薄膜の内部応力の経時変化	○中野 良太¹, 室谷 裕志¹	1.東海大院工

6.4	薄膜新材料 /	Thin films an	d New materials ポスター講演		
	3月13日(金)	) 16:30 - 18:3	30		
		奨·E 13p-P6-1	Flexible flow through transition metal doped $\mathrm{TiO}_{\scriptscriptstyle 2}$ nanotubular film for photocatalytic applications	○(DC)Amir Abidov¹², Bunyod Al- labergenov¹, Feiyi Xiao¹, Cuili Chu¹, Xing Jin¹, Yong Bae Kim², Min Kyu Song⁴, Cho-Hyun Jeon⁴, Hitoshi Habuka², Sungjin Kim¹	1.Kumoh Nat. Inst. Tec, 2.Gumi Elec. Res. Inst, 3.Yokohama univ., 4.Korea Tex. Dev. Inst
		E 13p-P6-2	Comprehensive study about ZnO film growth on (001) Si substrate by rf-sputtering	$\bigcirc$ Dongcheol Oh¹, Kangbok Kim¹, Sooman Lee¹	1.Defense Sci. & Tech. Hoseo University
		E 13p-P6-3	Electron transport of ZnO films on semi-insulating, p-type, and n-type (001) Si substrates	$\bigcirc$ Dongcheol Oh <sup>1</sup> , Sooman Lee <sup>1</sup> , Kangbok Kim <sup>1</sup>	1.Defense Sci. & Tech. Hoseo University
		13p-P6-4	ベチーニ法で作製した ${ m BiFeO}_{_{x}}$ ターゲットを用いて成膜した ${ m BiFeO}_{_{3}}$ 薄膜の作製と評価	○王春¹, 大島 佳祐¹, 稲葉 隆哲¹, 宋 華平¹, 渡部 雄太¹, 永田 知子¹, 橋本 拓也², 高瀬浩一¹, 山本 寬¹, 岩田 展幸¹	1.日大理工, 2.日大文理
		13p-P6-5	MoSi <sub>2</sub> -Si複合体薄膜の抵抗率とHall係数の温度依存性	木谷 僚介¹, ○下薗 宏祐¹, 佐藤 祐喜¹, 吉 門 進三¹	1.同志社大学理
		13p-P6-6	金属-EDTA錯体由来の急速加熱冷却に耐えうる $Y_2O_3$ 膜の合成	外山 歩 <sup>1</sup> , 白井 友之 <sup>1</sup> , 佐藤 彰紀 <sup>1</sup> , 淡 エン キン <sup>1</sup> , ○小松 啓志 <sup>1</sup> , 中村 淳 <sup>1</sup> <sup>2</sup> , 戸田 育民 <sup>1</sup> , 大塩 茂夫 <sup>1</sup> , 村松 寛之 <sup>1</sup> , 齋藤 秀俊 <sup>1</sup>	1.長岡技科大, 2.中部キレスト

3月11日(水)	9:00 - 12:0	0		
9:00 - 9:15	11a-D9-1	GaN系半導体を用いたNEA半導体フォトカソードの開発	○佐藤 大樹¹, 西谷 智博³, 本田 善央¹, 天 野 浩¹²	1.名大院工, 2.名大ARC, 3.名大SR
9:15 - 9:30	11a-D9-2	コンパクト半導体フォトカソード電子銃の研究・開発	○西谷 智博 <sup>1</sup> , 佐藤 大樹 <sup>2</sup> , 天野 浩 <sup>2</sup> , 本田 善央 <sup>2</sup> , 田渕 雅夫 <sup>1</sup> , 岡田 育夫 <sup>1</sup>	1.名大SRC, 2.名大院工
9:30 - 9:45	11a-D9-3	スピン偏極準安定原子線を用いた放出電子顕微鏡	○山内 泰¹, 倉橋 光紀¹, 鈴木 拓¹, 孫 霞², Pratt Andrew³, 張 晗¹, 吉武 道子¹	1.物材機構, 2.中国科技大, 3.York
9:45 - 10:00	11a-D9-4	針状試料の先端開き角度を活用したアトムプローブにおける像の再 構築	○湯川 豪', 森田 真人', 唐澤 正信', 間山 憲仁³, 石村 聡³, 内田 博³, 河村 踊子⁴, 伊藤 公平⁴, 尾張 真則¹²	1.東大生研, 2.東大環セ, 3.東芝ナ/ リシス, 4.慶大理工
10:00 - 10:15	11a-D9-5	透過型電子顕微鏡で触媒反応を可視化する	○田中 崇之1.3, 山本 直紀2.3, 高柳 邦夫2.3	1.名城大理工, 2.東工大院理工, 3.J CREST
10:15 - 10:30		休憩/Break		
10:30 - 10:45	11a-D9-6	色素増感太陽電池のための酸化チタン表面の硫黄処理	○下村 勝 <sup>1,2</sup> , 太田 紘志 <sup>1</sup> , Ariyasinghe D.M.B.P. <sup>2</sup> , Rajapakse R.M.G. <sup>3</sup>	1.静岡大院工, 2.静岡大院創造, 3.デニア大学
10:45 - 11:00	奨 11a-D9-7	In situ真空電気化学測定による イオン液体 / ${\rm TiO_2}(110)$ 界面の特性評価	○渡邉 光¹, 丸山 伸伍¹, 松本 祐司¹	1.東北大院工
11:00 - 11:15	11a-D9-8	水酸化した鉄表面と $H_2$ Oの第一原理計算シミュレーション	○布村 紀男¹, 砂田 聡²	1.富山大情セ, 2.富山大院理工
11:15 - 11:30	11a-D9-9	ガラスナノビベットにおける希ガスの真空コンダクタンス	○高見 知秀¹, 西本 究², 後藤 忠彦², 小川 修一², 高桑 雄二²	1.広大クロマチン, 2.東北大多元研
11:30 - 11:45	11a-D9-10	ぬれ性の測定に用いる微小Ga粒形成法	○(M2)大宮 佑介¹, 松下 浩一¹, 奥山 澄雄¹	1.山形大工
11:45 - 12:00	11a-D9-11	二次元超薄膜への可逆的非破壊電気コンタクト	〇吉武 道子¹, 柳生 進二郎¹, 知京 豊裕¹, 渡 辺 英二郎¹	1.物材機構
3月12日(木)	13:15 - 17:	00		
13:15 - 13:30	12p-D13-1	複数の金属ナノ構造における局在プラズモンの理論	○市川 昌和1	1.東大院工
13:30 - 13:45	奨 12p-D13-2	表面増強ラマン分光法を活用した1,4-ベンゼンジチオール単分子接合 の電子輸送特性の解明	○金子 哲¹, 村井 大午¹, 小本 祐貴¹, 塚越 一仁², 木口 学¹	1.東工大院理工, 2.物材機構
13:45 - 14:00	12p-D13-3	「バンド分散への歪み効果」測定システムにおけるUHV高分解能ラマン分光の開発	○武田 さくら¹, 久米田 晴香¹, 前田 昂平¹, 桃野 浩樹¹, 竹内 克行¹, 中尾 敏臣¹, Ang Artoni K. R.¹, 坂田 智裕¹, 大門 寛¹	1.奈良先端大物質創成
14:00 - 14:15	奨 12p-D13-4	Pb及びIn吸着Ge(001)表面における表面近傍の電子状態	○坂田 智裕¹, 武田 さくら¹, 入江 広一郎 ¹, 大門 寛¹	1.奈良先端大 物質創成
14:15 - 14:30	12p-D13-5	最表面原子層のPt原子の価電子帯構造のオージェスペクトルによる評価	○石塚 知明¹, 松林 信行², 多田 哲也¹, 富 江 敏尚¹	1.産総研ナノエレ, 2.産総研計測フロンティア
14:30 - 14:45	12p-D13-6	AFMとXPSを用いたMgO(100)単結晶表面の溶解の解析	○笹原 亮¹, 村上 達也¹, 富取 正彦¹	1.北陸先端大
14:45 - 15:00	奨 12p-D13-7	走査トンネル顕微鏡を用いて作製された単一銀ナノ粒子の形状制御	○(M1)寶槻 雅樹¹	1.東北大通研
15:00 - 15:15		休憩/Break		
15:15 - 15:30	12p-D13-8	X線光電子分光法によるGoethite表面におけるCesiumの吸着形態 の観察	〇山田 智之¹, 石塚 裕介¹, 宮内 直弥¹, 高 木 祥示¹	1.東邦大理
15:30 - 15:45	12p-D13-9	${ m TiO_2}(110)$ -1×1基板上の吸着層形成過程のSTM観察	○眞銅 雅子¹, 間仲 智洋¹, 内山 真伸², 首 藤 健一¹.²	1.横国大院工, 2.理研
15:45 - 16:00	奨 12p-D13-10	超高真空中におけるSiC上へのSi $_4$ O $_5$ N $_3$ 層の形成	○松尾 ともみ¹, 白濵 順哉¹, 竹嶋 祐城¹, 竹 尾 隆善¹, 中川 剛志¹, 水野 清義¹, 徐 超男¹	1.九大総理工
16:00 - 16:15	12p-D13-11	鉄シリサイド核/Siを用いた鉄酸化物のエピタキシャル成長	〇松井 秀紀¹, 中村 芳明¹, 中本 悠太¹, 竹内 正太郎¹, 酒井 朗¹	1.阪大院基礎工
16:15 - 16:30	12p-D13-12	$SiO_2/Si(001)$ 界面酸化プロセスにおける熱歪みの寄与	○小川 修一¹, 唐 佳芸¹, 吉越 章隆², 石塚 眞治³, 寺岡 有殿², 高桑 雄二¹	1.東北大, 2.原子力機構, 3.秋田高
16:30 - 16:45	12p-D13-13	Ge(100)表面の大気酸化物の放射光光電子分光分析	○吉越 章隆¹, 岡田 隆太², 岩井 優太郎³, 寺岡 有殿¹.³, 山田 洋一², 佐々木 正洋²	1.原子力機構, 2.筑波大学, 3.兵県
16:45 - 17:00	12p-D13-14	Si(113)表面における酸化メカニズムの解析	○田中 一馬¹, 大野 真也¹, 小玉 開¹, 吉越 章隆², 寺岡 有殿², 田中 正俊¹	1.横国大院工, 2.原子力機構

6.5	表面物理・真空 / Surfa	ce Physics, Vacuum ポスター講演		
	3月13日(金) 16:30 -	18:30		
	13p-P7-1	Ni/Si(111)-√19×√19再構成表面における空孔湧出過程	○(M1)今津 研太¹, 武良 光太郎¹, 木谷 哲¹, 小花 絃暉¹, 橋本 修一郎¹, 神岡 武文², 渡邉 孝信¹	1.早大理工, 2.豊田工大
	13p-P7-2	Si(001)表面に吸着したCOの透過FT-IRによる解析	○大野 真也¹, 田中 一馬¹, 田中 正俊¹, 吉信 淳²	1.横国大院工, 2.東大物性研
	13p-P7-3	電界放出微小電子源を用いた低速電子回折	千原 佑太¹, 達城 裕樹¹, 高田 賢哉¹, 中川剛志¹, ○水野 清義¹	1.九大総理工
	13p-P7-4	Cs吸着したGaAs(001)熱処理表面におけるSTM観察 $\sim$ 表面形状と量子効率の関係 $\sim$	○矢崎 貴紀¹, 山中 大地¹, 山崎 颯¹, 飯島 北斗¹, 目黒 多加志¹	1.東理大
	13p-P7-5	4H-SiC 表面のπ-結合鎖模型の安定性についての第一原理解析	○金子 智昭 <sup>1,2</sup> , 山崎 隆浩 <sup>1,2</sup> , 田島 暢夫 <sup>1,2</sup> , 大野 隆央 <sup>1,2,3</sup>	1.物質・材料研究機構, 2.高効率電デバコンソ, 3.東大生産研
	13p-P7-6	GaAsにおけるNEA活性化表面過程の面方位依存性	○稲垣 雄大¹, 早瀬 和哉¹, 飯島 北斗¹, 目 黒 多加志¹	1.東理大
	13p-P7-7	NEA GaAs フォトカソードのための針構造の作成	○田中 翔太¹, 平尾 昌幸¹, 松尾 和俊¹, 飯島 北斗¹, 塩川 高雄², 目黒 多加志¹	1.東理大, 2.理研
	13p-P7-8	Ge(110)表面におけるPt/Auナノワイヤー単一ドメインの作製	○渡邉 貴弘¹, 石津 友康¹, 山田 洋一¹, 佐々木 正洋¹	1.筑波大数物
	13p-P7-9	超音速希ガス原子線を用いたPt(111)上のgrapheneとh-BNの状態 計測	○生津 達也¹, 金城 厚¹, 國原 淳¹, 山田 洋一¹, 佐々木 正洋¹	1.筑波大数物
	13p-P7-10	滑液性表面における防霜性能の検証	○(B)守谷 赳夫¹, 真部 研吾¹, 白鳥 世明¹	1.慶大理工
	13p-P7-11	セルロース繊維への生体適合性材料による耐摩耗性片面超撥水 機能	○(B)佐々木 開地¹, 天神林 瑞樹¹, 真部 研吾¹, 白鳥 世明¹	1.慶大理工

	奨 13p-P7-12	動的Shirley法を活用したXPS定量分析の安定性向上	○(B)松本 凌¹, 田中 博美¹, 吉川 英樹², 田	1.米子高専, 2.物材機構, 3.オミクロンナ	
	_		沼 繁夫², 吉原 一紘³	ノテクノロジージャパン	

6.6	プローブ顕微	対鏡. 12.2 評価・	基礎物性のコードシェアセッション	口頭講演	
		) 9:00 - 12:0		· i->cni3/>c	
	9:00 - 9:15	奨 13a-D14-1	多段階光強度のLM-STSによるP3HT:PCBM系有機薄膜太陽電池の局所測定	○落合 貴大¹², 安田 剛³, 加藤 洋和¹, 小林 祐貴¹, 吉田 昭二¹, 武内 修¹, 重川 秀実¹	1.筑波大数理物質, 2.タカノ(株), 3.物質・材料研究機構
	9:15 - 9:30	奨 13a-D14-2	動作中の有機トランジスタにおける過渡的キャリア分布のナノスケール可視化	○山岸 裕史¹, 木村 知玄¹, 小林 圭¹², 野田 啓³, 山田 啓文¹	1.京大院工, 2.京大白眉セ, 3.慶應大 理工
	9:30 - 9:45	13a-D14-3	時間分解静電気力顕微鏡による有機半導体グレインへの電荷注入・ 排出過程の可視化	○木村 知玄¹, 山岸 裕史¹, 小林 圭¹², 山 田 啓文¹	1.京大工, 2.京大白眉セ
	9:45 - 10:00	奨 13a-D14-4	探針増強ラマン散乱分光測定における金属探針の温度評価と熱拡 散手法	○(DC)望月 誠仁¹, 小口 真弘¹, 角井 杏帆¹, 矢野 隆章¹, 原 正彦¹, 林 智広¹	1.東工大総理工
	10:00 - 10:15	13a-D14-5	液中FM-AFMによる免疫グロブリンM(IgM)の抗原結合評価	○黄 雲飛¹, 木南 裕陽¹, 小林 圭¹², 山 田 啓文¹	1.京大工, 2.京大白眉セ
	10:15 - 10:30	奨 13a-D14-6	自己検知型カンチレバーを用いた液中における単一吸着細胞の剥 離力測定	○橋本 重孝¹, 安達 誠¹, 岩田 太¹²	1.静岡大院工, 2.静岡大電研
	10:30 - 10:45		休憩/Break		
招待	10:45 - 11:00	13a-D14-7	「講演奨励賞受賞記念講演」(15分) ポルフィリン-TbIIIダブルデッカー型単分子磁石のSTMによるパター ニングと近藤状態の評価	〇猪瀬 朋子 <sup>1</sup> , 田中 大輔 <sup>1</sup> , Liu Jie <sup>2</sup> , 梶原 美珠 <sup>2</sup> , 米田 忠弘 <sup>2</sup> , 小川 琢治 <sup>1</sup>	1.阪大院理, 2.東北大多元研
	11:00 - 11:15	奨 13a-D14-8	単一分子伝導における分子形状効果の3次元計測	○片山 智貴¹, 中村 美紀¹, 吉田 昭二¹, 武内修¹, 重川 秀実¹	1.筑波大数理
	11:15 - 11:30	奨 13a-D14-9	CuPc追加蒸着によるPCBMの配列構造の変化	○(M1)桝井 茜¹, 坂上 弘之¹, 高萩 隆行¹, 鈴木 仁¹	1.広島大院先端研
	11:30 - 11:45	奨 13a-D14-10	力検出による近接場光の高分解能観測	○山西 絢介¹, 徳山 貴士¹, 内藤 賀公¹, 李 艶君¹, 菅原 康弘¹	1.阪大院工
	11:45 - 12:00	13a-D14-11	電気化学FM-AFMを用いたイオン液体/ルプレン(001)界面における 探針誘起ナノリソグラフィー	○坂東 賢一!,原 援又!,森野 裕介!, 岡田 悠悟²,今西 哲士!, 横田 泰之!, 植村 隆文², 竹谷 純一², 福井 賢一!	1.阪大院基礎工, 2.東大院新領域

6.6	6.6 プローブ顕微鏡 / Probe Microscopy 口頭講演						
	3月12日(木) 10:00 - 11:45						
	10:00 - 10:15	奨 12a-D9-1	非接触走查型非線形誘電率顕微鏡を用いた酸素吸着Si(100)-2×1表面における電気双極子モーメント分布の観察	○鈴木 将敬¹, 山末 耕平¹, 長 康雄¹	1.東北大通研		
	10:15 - 10:30	奨 12a-D9-2	走査型トンネル/マイクロ波顕微鏡の開発と低温応用	○(DC)高橋 英幸¹, 今井 良宗¹, 前田 京剛¹	1.東大院総合		
	10:30 - 10:45	奨 12a-D9-3	ルチル型Ti ${ m O_2}(110)$ 表面上の局所接触電位差のFM-AFM/KPFM同時測定	○末貞 昌英¹, 温 煥飛¹, 神林 良佑¹, 内藤 賀公¹, 李 艷君¹, 菅原 康弘¹	1.阪大院工		
	10:45 - 11:00	奨 12a-D9-4	高分解能SSRM測定におけるプローブ接触半径の影響評価	○原田 一範¹, 広田 潤², 中居 司², 藪原 秀彦¹	1.東芝生産技術センター, 2.東芝S&S社		
	11:00 - 11:15	奨 12a-D9-5	マイクロ波照射機構を備えた極低温光てこ原子間力顕微鏡の開発	○有馬 英司¹, 徳田 郁実¹, 内藤 賀公¹, 李 艶君¹, 菅原 康弘¹	1.阪大院工		
	11:15 - 11:30	奨 12a-D9-6	フィードバックなしのKPFMを用いたPd原子の接触電位差測定	○横山 弘尭¹, 渡邉 友啓¹, 内藤 公賀¹, 李 艶君¹, 菅原 康弘¹	1.阪大院工		
	11:30 - 11:45	奨 12a-D9-7	3次元走査型力顕微鏡とMDシミュレーションを用いたカルサイト/水 界面の水和構造観察機構の解明	○宮澤 佳甫!, 小林 成貴², Bernhard Reischl³, Peter Spijker⁴, Fillippo Federici Canova⁵, Adam S. Foster⁴, 福間 剛士¹.6	1.金大院, 2.埼玉大, 3.ヘルシンキ大, 4.アールト大, 5.東北大, 6.ACT-C		

6.6 プローブ顕	6.6 プローブ顕微鏡 / Probe Microscopy ポスター講演						
3月12日(	木) 13:30 - 15:	:30					
	12p-P4-1	炭素質ガス吸着膜における表面電位の過渡現象	○須田 順子 <sup>1</sup> , 杉本 岩雄 <sup>1</sup> , 村松 宏 <sup>2</sup> , 高 橋 和彦 <sup>3</sup>	1.東京工科大学CS学部, 2.東京工科大 学BS学部, 3.同志社大学理工学部			
	12p-P4-2	STM探針径制御	○阿部 巧¹, 山田 豊和¹	1.千葉大院融合			
	12p-P4-3	酸化Ga/Si(111)表面の熱処理過程のSTM観察	○苗代迫 拓也¹, 岡田 有史¹, 西村 慶也¹, 吉村 雅満², 角野 広平¹	1.京工繊大, 2.豊田工大			
	12p-P4-4	${ m MoS}_2$ 上シリコンナノシートの電子状態評価	○重原 正明¹, 大村 良輔¹, 久家 隆太郎¹, 田畑 博史¹, 久保 理¹, 片山 光浩¹	1.阪大院工			
	12p-P4-5	非接触AFMを用いたGa/MgAl $_2\mathrm{O}_4(111)$ の吸着初期過程の観察	○西村 慶也¹, 岡田 有史¹, 苗代迫 拓也¹, 吉村 雅満², 角野 広平¹	1.京工繊大, 2.豊田工大			
	12p-P4-6	バイモーダルAFMによる金属内包フラーレンの室温での高分解能分 子内構造観察	○山下 貴裕¹, 野田 晃浩¹, 小林 圭¹², 山田 啓文¹	1.京大工, 2.京大白眉セ			
	12p-P4-7	導電性ナノ粒子インクのSTMポテンショメトリー	○茂木 裕幸¹, 甲山 智規¹, 三成 剛生², 武内修¹, 重川 秀実¹	1.筑波大院数理物質, 2.NIMS			
	12p-P4-8	Ag (110) 上シリセンナノリボン上の電子状態密度分布	大村 良輔', ○久保 理', 中島 規晴', 重原 正明', 田畑 博史', 森 伸也', 片山 光浩'	1.阪大院工			
	12p-P4-9	ポルフィリン系分子の超高真空昇華制御	○島崎 幹朗¹, 山田 豊和¹	1.千葉大院融合			
	12p-P4-10	チタン酸リチウムLi $_4{\rm Ti}_{\rm s}{\rm O}_{\rm 12}(111)$ 表面のイオン液体中FM-AFM観察	○(M1)內田 辰徳¹, 橘田 晃宜², 一井 崇¹, 宇都宮 徹¹, 杉村 博之¹	1.京大院工, 2.産総研			
	12p-P4-11	STMに適したPt(111)基板の作成	○田中 裕行¹, 谷口 正輝¹	1.阪大産研			
	奨 12p-P4-12	走査トンネル顕微鏡によるグラフェンオキサイドの表面ナノ構造観察	○(M1)魏 濤¹, 片野 諭¹, 上原 洋一¹	1.東北大通研			

3日13日(全	:鏡/Probe M ) 16:30 - 19			
5月13日(並 16:30 - 16:45	13p-D9-1	原子間力顕微鏡を用いたナノスペース間の原子操作	○杉本 宜昭 <sup>1</sup> , Yurtsever Ayhan <sup>2</sup> , 平山 直樹 <sup>1</sup> , 阿部 真之 <sup>3</sup> , 森田 清三 <sup>2</sup>	1.阪大院工, 2.阪大産研, 3.阪大陸工
16:45 - 17:00	13p-D9-2	室温で動作する鉛クラスタースイッチの組立	○(PC)稲見 栄一¹, 濱田 幾太郎², 上田 啓 市¹, 阿部 真之³, 森田 清三⁴, 杉本 宜昭¹	1.阪大院工, 2.物材研, 3.阪大院基 4.阪大産研
17:00 - 17:15	13p-D9-3	原子操作による人工二次元電子系の創成	○南任 真史¹, 石橋 幸治¹	1.理研
17:15 - 17:30	E 13p-D9-4	Damping on Quantum Interference by single molecules and single atoms	ONazriq Nana <sup>1</sup> , Toyo Kazu Yamada <sup>1</sup>	1.Chiba Univ.
17:30 - 17:45	13p-D9-5	非接触原子間力顕微鏡/カ分光法によるNH <sub>3</sub> 反応Si(111)-(7x7) 表面上のNH <sub>3</sub> とH吸着基の識別	○坂野 友樹¹, 稲村 竜¹, 富取 正彦², 新 井 豊子¹	1.金沢大, 2.北陸先端大
17:45 - 18:00		休憩/Break		
18:00 - 18:15	13p-D9-6	非接触原子間力顕微鏡におけるSi探針上の水素終端膜によるエネルギー散逸量への影響	○稲村 竜¹, 坂野 友樹¹, 富取 正彦², 新 井 豊子¹	1.金沢大, 2.北陸先端大
18:15 - 18:30	13p-D9-7	磁場計測方向を制御可能な超常磁性探針を用いた交番磁気力顕微 鏡によるFePt永久磁石厚膜の表面近傍磁場イメージング	中山 翔太¹, 江川 元太¹³, 木下 幸則²³, 吉村哲¹³, ○齊藤 準¹³	1.秋田大院工資, 2.秋田大VBL, 3 先端計測
18:30 - 18:45	13p-D9-8	STM/STSによるFe(001)ウィスカ上のMg超薄膜の酸化研究	○(M1C)坂口 雄基¹, Gerhard Lukas², 山 田 豊和¹	1.千葉大院融合, 2.カールスルーン 工科大
18:45 - 19:00	13p-D9-9	1次元系ハロゲン架橋有機錯体における電荷密度波-モットハバード 相転移のSTM観察	○細見 友香¹, 吉田 昭二¹, 高石 慎也², 山下 正廣², 吉田 健文², 武内 修¹, 重川 秀実¹	1.筑波大学, 2.東北大学
19:00 - 19:15	13p-D9-10	室温FM-AFMによる金属内包フラーレンの分子内構造観察	○野田 晃浩¹, 小林 圭¹², 山田 啓文¹	1.京大工, 2.京大白眉セ
19:15 - 19:30	13p-D9-11	モアレ構造を利用したGraphene/Pt(111)上での鉄フタロシアニン 成長	○小幡 誠司¹, 斉木 幸一朗¹	1.東大新領域
3月14日(土)	9:00 - 12:0			
9:00 - 9:15	14a-D9-1	マイカ基板上に形成されるStreptavidin 2次元結晶の液中FM-AFM 高分解能構造観察	○崔 子鵬¹, 宮本 眞之¹, 木南 裕陽¹, 小林 圭¹², 平田 芳樹³, 山田 啓文¹	1.京大工, 2.京大白眉セ, 3.産総研
9:15 - 9:30	14a-D9-2	2探針AFMによる塗布成膜高結晶性有機薄膜の局所電気伝導評	○清水 太一¹, 山岸 裕史¹, 小林 圭¹², 山 田 啓文¹	1.京大工, 2.京大白眉セ
9:30 - 9:45	14a-D9-3	水素フリー超硬質DLC薄膜に接する混合有機溶媒の構造:FM-AFM と中性子反射率による解析	水光 俊介¹, 藤井 裕真², 滝川 浩史², 平山 朋子³-⁴, ○大西 洋¹	1.神戸大理, 2.豊橋技科大工, 3.同 大理工, 4.JSTさきがけ
9:45 - 10:00	14a-D9-4	ナノ電気化学セル顕微鏡: 有機ゲルビベットを用いた局所電気化学 測定条件の検討	○熊谷 明哉¹, 高橋 康史¹²³, 猪又 宏貴², 白木 捋¹, 山本 邦子¹, 春田 正和¹, 伊野 浩介², 珠玖 仁², 一杉 太郎¹, 末永 智一¹²	1.東北大AIMR, 2.東北大院, 3.JS きがけ
10:00 - 10:15	E 14a-D9-5	Study on the Bottom Tracking Technique for Chemical Contrast Imaging.	○(PC)Damiron Denis¹², Pierre E. Allain¹², Yuta Miyazaki², Dai Kobayashi², Naruo Sasaki³, Hideki Kawakatsu¹²	1.LIMMS/IIS Tokyo Univ, 2.IIS Univ., 3.Electro-Com. Univ
10:15 - 10:30	14a-D9-6	ピコ秒レーザーにより誘起されるSb <sub>2</sub> Te <sub>3</sub> の電子状態ダイナミクス	○上原 洋一¹, 桑原 正史², 片野 諭¹	1.東北大通研, 2.産総研
10:30 - 10:45		休憩/Break		
10:45 - 11:00	14a-D9-7	走査型非線形誘電率ポテンショメトリによる自発分極誘起電位の選 択的測定	○山末 耕平¹, 長 康雄¹	1.東北大通研
11:00 - 11:15	14a-D9-8	NC-AFMに組み込んだチャージアンプと電流アンプ出力の同時計測	○野上 真¹, 新井 豊子², 笹原 亮¹, 富取 正彦¹	1.北陸先端大, 2.金沢大
11:15 - 11:30	E 14a-D9-9	Simultaneous measurement of local contact potential difference and density of state on Au/TiO $_2(110)$ surface by KPFM/STM	○(D)HUANFEI WEN¹, Ryosuke Kan- bayashi¹, Masahide Suesada¹, Yanjun Li¹, Yasuhiro Sugawara¹	1.Osaka Univ
11:30 - 11:45	14a-D9-10	容量補償回路を用いたNC-AFM用検出回路の低雑音化	大江 弘晃¹, ○藤居 幹大¹, 新井 豊子¹	1.金沢大
11:45 - 12:00	E 14a-D9-11	A passive THz near-field microscope with a helium-free cryostat	○KuanTing Lin¹, Susumu Komiyama², Sunmi Kim¹, Ken-ichi Kawamura³, Yusuke Kajihara¹	1.Institute of Industrial Science, Tokyo, 2.Department of Basic S Univ. Tokyo, 3.Tokyo Instrumer
3月14日(土)	) 13:00 - 15	i:00		
13:00 - 13:15	14p-D9-1	大規模シミュレーションによるAFMのエネルギー減衰の解明	○仙田 康浩¹, 嶋村 修二¹, ブロンクビスト ヤンネ², ニエミネン リスト²	1.山口大工, 2.アールト大
13:15 - 13:30	14p-D9-2	周波数変調原子間力顕微鏡によるNaCl(001)表面の大気中原子分 解能観察	○阿部 晃平¹, 新井 豊子¹	1.金大院
13:30 - 13:45	14p-D9-3	イオン液体/固体界面に形成される層構造の厚み評価: フォースカー ブ測定における周波数シフト信号及び撓み信号の同時測定	○横田 泰之¹, 大坂 法紀¹, 今西 哲士¹, 福 井 賢一¹	1.阪大院基礎工
13:45 - 14:00	14p-D9-4	ブルッカイト型 ${ m TiO}_2$ ナノ粒子の液中原子分解能 ${ m FM-AFM}$ 計測	○山村 俊貴¹, 淺川 雅¹, 横野 照尚²³, 福 間 剛士¹.³	1.金大, 2.九工大, 3.ACT-C/JST
14:00 - 14:15	14p-D9-5	アルカリハライド結晶のステップ周辺における水和構造評価(2)	○長谷川 俊¹, 小林 圭¹², 山田 啓文¹	1.京大工, 2.京大白眉セ
14:15 - 14:30	14p-D9-6	FM-AFMによる界面活性剤分子集合体構造の形成過程評価 (3)	○鈴木 一博¹, 小林 圭¹², 山田 啓文¹	1.京大工, 2.京大白眉セ
14:30 - 14:45	14p-D9-7	液中動作FM-AFMを用いたイオン液体の局所溶媒和構造と表面構造/電荷との相関に関する研究	○(PC)梅田 健一¹, 小林 圭¹², 山田 啓文¹	1.京大工, 2.京大白眉セ
14:45 - 15:00	14p-D9-8	液中AFM用フローセルの開発とCu配線腐食過程の直接観察	○北川 拓弥¹, 尾形 奨一郎¹, 福永 明², 嶋	1.金沢大理工, 2.荏原製作所, 3.金

# 7 ビーム応用 / Beam Technology and Nanofabrication

.1 X線技術 / X	-ray technolog	gies       口頭講演		
3月11日(水	3) 13:15 - 17:	30		
13:15 - 13:30	11p-A26-1	画像接続によるX線位相コントラスト顕微鏡の視野の拡大	○渡辺 紀生¹, 円谷 雄二¹, 島田 晃広¹, 青木 貞雄¹	1.筑波大数物
13:30 - 13:45	11p-A26-2	X線Talbot-Lau干渉計によるスキャン方式位相イメージ装置の開発	○百生 敦', Bachche Shivaji', 阿部 航', 野々口 雅弘², 加藤 光一², 影山 将史², 小池崇文², 栗林 勝²	1.東北大, 2.リガク
13:45 - 14:00	11p-A26-3	非標準縞走査法を用いたX線顕微鏡の位相回復アルゴリズム	○廉 松哲¹, 楊 海圈¹	1.緑野リサーチ
14:00 - 14:15	11p-A26-4	埋め込みX線ターゲットを用いた自己像直接検出型2次元Talbot-Lau 干渉計の光学設計とその検証	○(DC)森本 直樹', 藤野 翔', 伊藤 康浩', 山崎 周', 佐野 壱成', 細井 卓治', 渡部 平 司', 志村 考功'	1.阪大院工
14:15 - 14:30	奨 11p-A26-5	埋め込みターゲットによる透過型X線撮影法の高分解能化の検討	○佐野 壱成¹, 森本 直樹¹, 細井 卓治¹, 渡部 平司¹, 志村 考功¹	1.阪大院工
14:30 - 14:45	11p-A26-6	$LiTaO_3$ 単結晶による発生 $X$ 線の温度差に対する変化	○花元 克巳¹, 片岡 隆浩¹, 山岡 聖典¹	1.岡山大院保
14:45 - 15:00	11p-A26-7	高エネルギーX線集光用石英ガラス製屈折レンズの開発	○木村 滋¹, 今井 康彦¹	1.高輝度光科学研セ
15:00 - 15:15	11p-A26-8	軸対称多段斜入射ミラー光学系の設計と試作	○青木 貞雄¹, 渡辺 紀生¹, 浅見 博¹, 島 田 晃広¹	1.筑波大数理物質
15:15 - 15:30		休憩/Break		
15:30 - 15:45	奨 11p-A26-9	点回折干渉計によるEUV対物ミラーのサブnm精度波面測定	○砂山 諒¹, 豊田 光紀¹, 柳原 美廣¹	1.東北大多元研
15:45 - 16:00	11p-A26-10	EUV リソグラフィ光源プラズマの光学厚さの最適化	○細田 達矢¹, 松隈 啓¹, 吉田 健祐¹, 藤岡 慎介¹, 余語 覚文¹, 西村 博明¹	1.阪大レーザー研
16:00 - 16:15	奨 11p-A26-11	レーザー駆動EUV光源プラズマにおける先行膨張の最適化	○(PC)松隈 啓¹, 吉田 健祐¹, 細田 達矢¹, 藤岡 慎介¹, 余語 覚文¹, 西村 博明¹	1.阪大レーザー研
16:15 - 16:30	11p-A26-12	プリバルスレーザー照射時のドロップレットの挙動III	○砂原 淳¹, 竹内 靖¹, 佐々木 明³, 西原 功修²	1.レーザー総研, 2.阪大レーザー研, 3.原 研関西研
16:30 - 16:45	11p-A26-13	自己組織化ラグランジメッシュを用いた流体コードによるEUV光源ターゲット分散過程のモデル化	○佐々木 明¹, 砂原 淳², 西原 功修³	1.原子力機構, 2.レーザー総研, 3.阪大 レーザー研
16:45 - 17:00	11p-A26-14	120 mW 出力「水の窓」軟 X 線の連続発生	○天野 壯¹	1.兵庫県大高度研
17:00 - 17:15	11p-A26-15	ゲルマニウム多価イオンの EUV 放射特性	○(M1)原 広行 <sup>1</sup> , デン タン フン <sup>2</sup> , 大橋 隼人 <sup>3</sup> , 坂上 裕之 <sup>4</sup> , 鈴木 千尋 <sup>4</sup> , 加藤 太治 <sup>4</sup> , 村上 泉 <sup>4</sup> , 東口 武史 <sup>12</sup>	1.宇都宮大院工, 2.宇都宮大オプト, 3.覧山大工, 4.核融合研
17:15 - 17:30	11p-A26-16	高輝度 EUV 光源の放射特性	○(M1)荒居 剛己¹, 原 広行¹, ヂン タンフン², 砂原 淳³, 三浦 泰祐⁴, 遠藤 彰⁴, 東口 武史¹²	1.宇都宮大院工, 2.宇都宮大オプト, 3.レ ーザー総研, 4.HiLASE Center

7.1	7.1 X線技術 / X-ray technologies		es ポスター講演		
3月11日(水) 9:30 - 11:30					
		11a-P5-1	非走査型蛍光X線/XAFS イメージングのS/B 比向上	○桜井 健次 <sup>1,2</sup> , Zhao Wenyang <sup>1,2</sup> , 岩元 め ぐみ <sup>1</sup>	1.物材機構, 2.筑波大数理

	3月12日(木	) 13:30 - 19	·00		
召待	-/3(1	12p-A11-1	「講演奨励賞受賞記念講演」(15分) グラフェンのステップ成長のその場TEM観察	〇狩野 絵美1.2, 橋本 綾子1.2, 竹口 雅樹1.2	1.筑波大数理, 2.NIMS
	13:45 - 14:00	12p-A11-2	アルカリハライドを触媒とした電子線励起による炭素ケージの生成	○舘 昌志 <sup>1,2</sup> , 村上 勝久 <sup>1,2</sup> , 竹口 雅樹 <sup>3</sup> , 藤 田 淳一 <sup>1,2</sup>	1.筑波大数理, 2.TIMS, 3.物質·材料 研究機構
	14:00 - 14:15	12p-A11-3	ナトリウムを吸蔵したチタン酸リチウムの高分解能電子顕微鏡観察	○橘田 晃宜¹, 香山 正憲¹, 秋田 知樹¹	1.産総研
	14:15 - 14:30	奨 12p-A11-4	反射電子エネルギー損失分光法を用いたリチウム化合物の評価	○田口 昇¹, 橘田 晃宜¹, 栄部 比夏里¹, 秋 田 知樹¹	1.産総研
	14:30 - 14:45	12p-A11-5	金微粒子-チタン酸ストロンチウム界面構造の電子顕微鏡観察	○秋田 知樹¹, 前田 泰¹, 香山 正憲¹	1.産総研ユビキタス
	14:45 - 15:00	12p-A11-6	電子ビーム照射による絶縁体薄膜帯電のバイアス電圧依存性	○半田 勇希¹, 東海 昌司¹, 小寺 正敏¹	1.大阪工大
	15:00 - 15:15	12p-A11-7	アウトレンズ型低エネルギー二次電子検出器の開発と像観察	○関口 隆史¹, 岩井 秀夫¹	1.物材機構
	15:15 - 15:30	12p-A11-8	低加速電子線偏向法による高空間分解能電界可視化	○吉田 木の実 <sup>1,2</sup> , 粟飯原 有輝 <sup>1,2</sup> , 村上 勝久 <sup>1,2</sup> , 藤田 淳一 <sup>1,2</sup>	1.筑波大数理, 2.TIMS
	15:30 - 15:45	12p-A11-9	強度輸送方程式による長周期位相情報の取得	○三石 和貴¹, 雷 丹¹, 下条 雅幸², 竹口 雅樹¹	1.物材機構, 2.芝工大
	15:45 - 16:00	12p-A11-10	環状明視野位相法による像コントラストの信号対雑音比の改善	○(D)石田 高史¹, 川崎 忠寛².3.⁴, 丹司 敬義².⁴, 生田 孝⁵	1.名大院工, 2.名大エコ, 3.JFCC, 4.GREEN, 5.大阪電通大
	16:00 - 16:15	12p-A11-11	ホローコーンTEMによる軽元素カラムの可視化	○川崎 忠寛1.24, 石田 高史34, 丹司 敬義2.4	1.JFCC, 2.名大エコトピア, 3.名大院工, 4.GREEN
	16:15 - 16:30	12p-A11-12	環境電子顕微鏡用の液体セルの開発(2)	○今枝 紀裕¹, 川﨑 忠寬²¾, 丹司 敬義¾	1.名大院工, 2.JFCC, 3.名大エコトピア科 学研究所, 4.ナノ材料科学環境拠点
	16:30 - 16:45	12p-A11-13	ナノポアおよび電場を利用した水溶液中のナノ粒子操作	○星野 隆行¹, 満渕 邦彦¹	1.東大情理
	16:45 - 17:00		休憩/Break		
	17:00 - 17:15	12p-A11-14	電界放出誘起成長ナノ電子源の計算機シミュレーションによる輝度 評価	○中原 仁¹, 伊藤 真一¹, 齋藤 弥八¹	1.名大院工
	17:15 - 17:30	12p-A11-15	p型シリコンフィールドエミッタからの光支援電子放射(II)	○嶋脇 秀隆¹, 長尾 昌善², 根尾 陽一郎³, 三 村 秀典³, 若家 冨士男⁴, 高井 幹夫⁴	1.八戸工大工, 2.産総研, 3.静岡大, 4.大阪大
	17:30 - 17:45	12p-A11-16	GaAs負性電子親和力カソードの活性化過程とその分光感度特性	○(B)光野 圭悟¹, 增澤 智昭¹, 畑中 義式¹, 根尾 陽一郎¹, 三村 秀典¹	1.静岡大

17:45 - 18:00	12p-A11-17	表面をプラズマ処理した窒化ハフニウム薄膜の仕事関数の評価	藤原 将¹, 辻 博司¹, ○後藤 康仁¹	1.京大院工
18:00 - 18:15	奨 12p-A11-18	第一原理計算を用いた転写モールド法エミッタ用導電性セラミック材料の電子状態(IV)	○(M2)石川原 俊夫¹, 中本 正幸¹	1.静岡大院工
18:15 - 18:30	12p-A11-19	スピン方向を制御可能な電界放出型偏極電子源に向けたW(001)面上に堆積されたCr薄膜の結晶構造の観察	○阪井 那央哉¹, 永井 滋一¹², 岩田 達夫¹², 梶原 和夫¹², 畑 浩一¹²	1.三重大院工, 2.三重大極限ナノセレセ
18:30 - 18:45	12p-A11-20	エタノール浸漬処理したタングステンエミッタの電界放射顕微鏡および 電界イオン顕微鏡観察	○入場 紀明¹, 辻 博司¹, 後藤 康仁¹	1.京大院工
18:45 - 19:00	12p-A11-21	スピント型エミッタの放射線耐性の評価	○長尾 昌善¹, 後藤 康仁², 佐藤 信浩³, 秋吉 優史², 高木 郁二²	1.産総研, 2.京大院工, 3.京大原子炉

7.2 電子ビーム	7.2 電子ビーム応用 / Applications and technologies of electron beams ポスター講演							
3月12日(木) 9:30 - 11:30								
	E 12a-P7-1	Measurement of interfacial potential using transport of intensity equation	○(P)Xiaobin Zhang <sup>1,2</sup> , Yoshifumi Oshima <sup>2,3</sup>	1.Tokyo Institute of Technology, 2.JST-CREST, 3.JAIST				
	奨 12a-P7-2	TiO。を蒸着したカーポンナノチューブからの電界電子放出のTEM その場観察	○松田 薫洋¹, 中原 仁¹, 安坂 幸師¹, 齋 藤 弥八¹	1.名大院工				
	12a-P7-3	先鋭化したシャープペンシル芯からの電界電子放出	○明神 拓真¹, 麻薙 健¹, 堀江 翔太¹, 山田 洋一¹, 佐々木 正洋¹	1.筑波大数物				
	12a-P7-4	メッシュ型フィラメントによる電子雲の生成	○(B)金森 圭太¹, 溝口 亜優¹, 粕谷 俊郎¹, 和田 元¹	1.同志社大理工				

7.3 {	微細パターン	・微細構造形成	成技術 / Micro/Nano patterning and fabrication	口頭講演	
	3月11日(水	9:00 - 11:4	45		
	9:00 - 9:15	11a-B2-1	デスクトップ型液晶マトリックス投影露光装置の最適Fナンバの検討	○堀内 敏行¹, 小山 宗一郎¹, 小林 宏史¹	1.東京電機大工
	9:15 - 9:30	11a-B2-2	ビルトインレンズマスクリソグラフィによる3次元露光の検討Ⅱ	上田 直樹', 田中 利樹', 菊田 久雄', 川田博昭', 笹子 勝', ○平井 義彦'	1.大阪府立大
	9:30 - 9:45	11a-B2-3	半導体露光用ArFエキシマレーザにおけるチャンバ構造とガス流速の 最適化による消費電力の低減	○池田 宏幸!, 諏訪 輝!, 勝海 久和!, 對馬 弘朗!, 熊崎 貴仁!, 黒須 昭彦!, 太田 毅!, 柿 崎 弘司 <sup>1</sup> , 松永 隆 <sup>1</sup> , 溝口 計 <sup>1</sup>	1.ギガフォトン
	9:45 - 10:00	11a-B2-4	表面増強ラマン分光測定のための放射光光化学反応によるAuナノ 粒子合成	○山口 明啓¹, 松元 健¹, 岡田 育夫², 櫻井 郁也², 內海 裕一¹	1.兵庫県大高度研, 2.名古屋大学
	10:00 - 10:15	奨 11a-B2-5	高次高調波を用いたコヒーレントスキャトロメトリー顕微鏡によるバタン欠陥観察(II)	○藤野 貴大¹, 田中 祐輔¹, 原田 哲男¹, 永田豊², 渡邊 健夫¹, 木下 博雄¹	1.兵庫県立大学, 2.理化学研究所
	10:15 - 10:30	奨 11a-B2-6	EUVコレクターミラー用の高精度反射率測定法の開発	○井口 晴貴1	1.兵庫県立大
	10:30 - 10:45		休憩/Break		
	10:45 - 11:00	11a-B2-7	ポリフッ化ビニリデン表面への陽子線照射効果	○西川 宏之¹, 松岡 北斗¹, 佐野 遼¹, 林 英 臣¹, 前川 康成²	1.芝浦工大工, 2.原子力機構
	11:00 - 11:15	奨 11a-B2-8	新規ポリマー型高感度電子線ネガレジストの露光特性	○高山 智寛¹, 池田 紳悟¹, 岸村 由紀子¹, 浅田 裕法¹, 津川 直樹², 赤鹿 洋介², 星野 亮一³	1.山口大学, 2.ナード研究所, 3.グルー オンラボ
	11:15 - 11:30	奨 11a-B2-9	PMMAレジストの現像過程における溶解挙動	○誉田 明宏¹, 山本 洋揮¹, 光安 將騎¹, 古澤 孝弘¹, 吉武 秀介²	1.阪大産研, 2.NuFlare Technology
	11:30 - 11:45	11a-B2-10	ポリスチレンに対する高選択比PMMAエッチング	○下向 主真¹, 川田 博昭¹, 安田 雅昭¹, 平 井 義彦¹	1.大阪府大工
	3月11日(水	) 13:15 - 16	5:30		
3待	13:15 - 13:45	11p-B2-1	「ビーム応用 分科内招待講演」(30分) 易液化ガスPFPを用いたナノインプリント	〇廣島 洋 <sup>1</sup>	1.産総研
	13:45 - 14:00	11p-B2-2	ラジカル重合型光硬化樹脂薄膜の表面弾性率のナノ不均一性	○(B)矢野 春菜¹, 久保 祥一¹, 中川 勝¹, 梁 暁斌², 藤波 想², 中嶋 健²	1.東北大多元研, 2.東北大WPI-AIM
	14:00 - 14:15	11p-B2-3	誘導自己組織化リソグラフィへ向けたPS-b-PMMAのミクロ相分離構造の高速形成挙動	○廣芝 伸哉¹, 大窪 諒¹, 服部 梓², 田中 秀和², 中川 勝¹	1.東北大多元研, 2.阪大産研
	14:15 - 14:30	11p-B2-4	熱アニール法によるポリスチレンとポリジメチルシロキサンからなるプロック共重合体のランダム配向面内シリンダ構造の形成(2)	○山口 徹¹, 藤原 聡¹	1.NTT物性基礎研
	14:30 - 14:45		休憩/Break		
	14:45 - 15:00	11p-B2-5	ナノインプリントにおける離型力のモールド側壁傾斜角依存性I	植村 公亮', 藤井 一緒', ミカロフスキ マーチン', ○(MIC) 栩野 貴充', 中村 直人', 川田博昭', リムザ ジグムント', 平井 義彦'	1.大阪府大院工, 2.ワルシャワ工科大
	15:00 - 15:15	奨 11p-B2-6	ナノインプリントにおける離型力のモールド側壁傾斜角依存性Ⅱ	○(M1C)栩野 貴充¹, 藤井 一緒¹, ミカロフス キマーチン², 植村 公売¹, 川田 博昭¹, リム ザ ジグムント², 平井 義彦¹	1.大府大院工, 2.ワルシャワ工科大
	15:15 - 15:30	11p-B2-7	連続UVナノインブリントにおける離型層の耐久性の検討	○伊吉 就三¹, 岡田 真¹, 春山 雄一¹, 松 井 真二¹	1.兵庫県立大学 高度産業科学技術 研究所
	15:30 - 15:45	11p-B2-8	液晶高分子へのナノインブリントグラフォエビタキシー	○岡田 真¹, 細田 理沙², 谷口 雄亮², 春山雄一¹, 小野 浩司³, 川月 喜弘², 松井 真二¹	1.兵県大高度研, 2.兵県大工, 3.長岡 技科大
	15:45 - 16:00	11p-B2-9	光ナノインブリント成形体の残膜厚均一化に向けたスクリーン印刷法 による光硬化性組成物の吐出量制御	○(M1)田辺 明¹, 上原 卓也¹, 永瀬 和郎², 池戸 裕明², 廣芝 伸哉¹, 中川 勝¹	1.東北大多元研, 2.ミノグループ
	16:00 - 16:15	11p-B2-10	sub-20 nmの孔径を有する炭素被覆モールドを用いた光硬化性組成物の充填に関する研究	○中川 勝¹, 中谷 顕史¹, 干川 康人¹, 京 谷 隆¹	1.東北大多元研
	16:15 - 16:30	11p-B2-11	光ナノインプリント-原子層堆積法によるナノ造形 (II) ~ALD装置の構築と樹脂表面への成膜検討~	○(B)畔柳 志帆¹, 廣芝 伸哉¹, 中川 勝¹	1.東北大多元研

7.3	3 微細パターン	·微細構造形成	技術 / Micro/Nano patterning and fabrication	ポスター講演	
3月12日(木) 9:30 - 11:30					
		12a-P8-1	電子線リソグラフィの分子シミュレーション(3)	○人見 洋¹, 道下 勝司¹, 安田 雅昭¹, 川田 博昭¹, 平井 義彦¹	1.大阪府大工

7.4 量子ビーム界	7.4 量子ビーム界面構造計測 / Buried interface sciences with quantum beam ポスター講演						
3月13日(金) 16:30 - 18:30							
	13p-P8-1	高圧水蒸気熱処理によるメソ多孔体薄膜の膜質改善	○田尻 恭之¹, 関 将吾¹, 古賀 玲奈¹, 香 野 淳¹	1.福岡大理			
	13p-P8-2	硬X線光電子分光測定における電子・イオン同時照射を用いた帯電 中和	○吉木 昌彦¹, 細井 慎², 尾角 英毅², 稲葉 雅之², 久保 優吾², 林 利彦³, 野口 真一², 磯 村 典武*, 川村 朋晃°, 松本 匡史¹º, 黒岡 和 巳¹¹, 上田 和浩²², 野村 健二¹³, 清井 明¹⁴, 梅 本 慎太郎¹⁵	1.東芝, 2.ソニー, 3.川崎重工, 4.神戸製 鋼, 5.住友電工, 6.関西電力, 7.電中研, 8.豊田中研, 9.日亜, 10.日産, 11.バナソ ニック, 12.日立, 13.富士通, 14.三菱電 機, 15.スプリングエイトサービス			
	13p-P8-3	金薄膜/希硫酸水溶液界面電気二重層の中性子反射率測定	○水沢 まり <sup>1,2</sup> , 桜井 健次 <sup>2</sup> , 武田 全康 <sup>3</sup> , 山 﨑 大 <sup>3</sup> , 宮田 登 <sup>1</sup>	1.CROSS 東海, 2.物材機構, 3.原子力機 構, J-PARCセンター			
	13p-P8-4	X線反射率法によるデルタ層を有する多層膜構造の評価	○東 康史¹, 黒河 明¹	1.産総研計測標準			
	13p-P8-5	X線反射率による多層膜解析の改良	○藤居 義和¹	1.神戸大			

20140/1	) 0.00 101	20		
3月14日(土	2) 9:00 - 12:0	30		
9:00 - 9:15	奨 14a-A16-1	シード型自由電子レーザーを用いたGdFeCoのM殻共鳴磁気光学効果による超高速磁化反転機構の研究	○(D)山本 真吾¹², 田口 宗孝³, 染谷 隆史¹², 久保田 雄也¹², 伊藤 俊¹², 和達 大樹¹², 藤澤 正美², Capotondi Flavio⁴, Pedersoli Emanuele⁴, Manfredda Michele⁴, Casolari Francesco⁴, Kiskinova Maya¹, 藤井 純², Moras Paolo⁵, 中村 哲也²⁶, 加藤 剛志⁻, 岩田 聡⁵, 辛 埴², 松田 厳¹²	1.東大理, 2.物性研, 3.奈良先端大, 4.FERMI, 5.ELETTRA, 6.JASRI, 古屋大工, 8.名古屋大エコトピア科 研究所
9:15 - 9:30	14a-A16-2	時間分解共鳴軟X線散乱で見た $\mathrm{La}_{1/3}\mathrm{Sr}_{2/3}\mathrm{FeO}_3$ 薄膜における磁気秩序の超高速融解	津山 智之 <sup>1</sup> , 伊藤 俊 <sup>1</sup> , Pontius Niko <sup>2</sup> , Schussler-Langeheine Christian <sup>2</sup> , 松田 厳 <sup>1</sup> , 蓑原 誠人 <sup>3</sup> , 組頭 広志 <sup>3</sup> , 山崎 裕一 <sup>45</sup> , 中尾 裕則 <sup>3</sup> , 村上 洋一 <sup>3</sup> , ○和達 大樹 <sup>1</sup>	1.東大物性研, 2.HZB BESSYII, 3. PF, 4.東大工, 5.理研CEMS
9:30 - 9:45	14a-A16-3	水素吸蔵特性をもつAg-Rh合金ナノ粒子の価電子帯スペクトル観測	○坂田 修身¹,楊 安麗¹,草田 康平²,屋山 巴³,吉川 英樹¹,石元 孝佳³,古山 通久³,小 林 浩和²,北川 宏²	1.物材機構, 2.京大, 3.九大
9:45 - 10:00	E 14a-A16-4	Hard X-ray photoelectron spectroscopy of epitaxially grown $M_{_X}Ni_{_{1:x}}O\ (M=Li,Mg)$	○(P)Rosantha Kumara¹, Anli Yang¹, Osami Sakata¹², Ryosuke Yamauchi², Mun- etaka Taguchi³, Satoshi Ishimaru¹, Akifumi Matsuda², Mamoru Yoshimoto²	1.NIMS/SPring-8, 2.Tokyo Tech., 3.NAIST
10:00 - 10:15	14a-A16-5	バルスレーザーメルティング法を用いたマンガン過飽和ドープシリコン の作製と結晶構造	○香野 淳¹, 溝上 諒¹, 田尻 恭之¹	1.福岡大·理
10:15 - 10:30	14a-A16-6	化学溶液堆積法を用いたLa置換チタン酸ビスマス薄膜の作製における膜厚と結晶相の制御	○香野 淳¹, 斉田 浩一¹, 田尻 恭之¹	1.福岡大理
10:30 - 10:45		休憩/Break		
10:45 - 11:00	14a-A16-7	一枚の位相型回折格子を用いたGIUSAXS実空間イメージング	○矢代 航¹, 加藤 宏祐², 池田 進³, 和田 恭雄³, 鈴木 芳生⁵, 竹内 晃久⁵	1.東北大多元研, 2.東北大院工, 3. 大原子分子, 4.慶大理工, 5.JASRI
11:00 - 11:15	14a-A16-8	ナノ物質の構造・元素分析に向けたX線支援非接触原子間力顕微鏡 (XANAM)の開発	○鈴木 秀士¹, 向井 慎吾², 田 旺帝³, 野村 昌治⁴, 朝倉 清高²	1.名大院工, 2.北大触媒セ, 3.ICU, 4.KEK-PF
11:15 - 11:30	14a-A16-9	放射光X線回折によるSiC熱分解表面のその場観察法の開発	○(P)吉田 雅洋 <sup>1²</sup> , 河邉 文哉¹, 久津間 保徳¹, 堂島 大地¹, 重政 英史¹, 大和田 謙二², 稲見 俊哉², 玉井 尚登¹, 大谷 昇¹, 金子 忠昭¹, 水木 純一郎¹	1.関学大理工, 2.原子力機構
11:30 - 11:45	14a-A16-10	J-PARC/MLF BL17偏極中性子反射率計「写楽」の現状	○宮田 登 <sup>1</sup> , 武田 全康 <sup>2</sup> , 山崎 大 <sup>2</sup> , 阿久津 和宏 <sup>1</sup> , 水沢 まり <sup>1</sup> , 笠井 聡 <sup>1</sup> , 野島 建大 <sup>2</sup> , 久 保田 正人 <sup>2</sup> , 鈴木 淳市 <sup>1</sup> , 曽山 和彦 <sup>3</sup>	1.総合科学研究機構東海事業セン: ー, 2.原子力機構量子ビーム, 3.J-P. センター
11:45 - 12:00	14a-A16-11	中性子反射投影による埋もれた界面の可視化技術の検討	○桜井 健次 <sup>1,2</sup> , Jiang Jinxing <sup>1,2</sup> , 水沢 まり <sup>1,3</sup> , 伊藤 崇芳 <sup>3</sup> , Li Dan <sup>1,2</sup> , 阿久津 和宏 <sup>3</sup> , 宮田 登 <sup>3</sup>	1.物材機構, 2.筑波大数理, 3.CRO 東海

7.5 /	原子·分子線:	elated new technologies	口頭講演				
	3月13日(金) 10:30 - 12:00						
招待	10:30 - 11:15	13a-A16-1	「ビーム応用 分科内招待講演」(45分) ナノクラスタービーム技術の新展開	〇中嶋 敦 <sup>1,2</sup>	1.慶大理工, 2.JST-ERATO		
	11:15 - 11:30	奨 13a-A16-2	Cu <sub>3</sub> Au(111)合金表面の耐酸化保護膜形成	○津田 泰孝¹, 岡 耕平¹, 牧野 隆正¹, Lehmuskoski Johannes¹, 岡田 美智雄¹, Dino Wilson¹, 笠井 秀明¹, 吉越 章隆², 寺 岡 有殿²	1.阪大, 2.原子力機構		
	11:30 - 11:45	13a-A16-3	超低軌道宇宙環境模擬のためのレーザーデトネーションビーム装置	〇横田 久美子¹, 井出 健太¹, 大平 淳貴¹, 渡邉 大樹¹, 山崎 勇希¹, 初田 光嶺¹, 守本 郁¹, 田川 雅人¹	1.神戸大工		
	11:45 - 12:00		休憩/Break				

7.5	原子·分子線>	ポスター講演			
3月13日(金) 16:30 - 18:30					
		13p-P9-1	電子ビーム照射下の単層二次元SiCのダイナミクス解析	○多田 和広¹, 和泉 遼¹, 安田 雅昭²	1.富山高専, 2.大阪府大院工

7.6 イ	オンビームー	-般 / Ion bean	ns ポスター講演				
3	3月13日(金) 16:30 - 18:30						
		13p-P10-1	Li窒化物とGaNのプロトンビームを用いたラザフォード後方散乱法による組成比決定	○竹内 優作¹, 山下 大輝¹, 栗山 一男¹, 串田 一雅²	1.法大大学院理工, 2.大阪教育大		
		13p-P10-2	集束陽子ビーム加工によるPDMS薄膜内包型光スイッチング素子の開発	○川端 駿介', 猿谷 良太', 加藤 聖', 新木 潤', 三浦 健太', 加田 渉', 佐藤 隆博 <sup>3</sup> , 江 夏 昌志', 石井 保行 <sup>3</sup> , 神谷 富裕 <sup>3</sup> , 西川 宏 之 <sup>2</sup> , 花泉 修 <sup>1</sup>	1.群馬大, 2.芝浦工大, 3.原研		
		13p-P10-3	低周波交流放電からの水素負イオンビーム引き出し	○(B)山本 瞬¹, 岡野 祐樹¹, 宮本 直樹¹, 粕谷 俊郎¹, 和田 元¹	1.同大理工		
		13p-P10-4	高周波イオン源による金属イオンビームの引き出し	○(B)渡辺 悠太¹, 神田 将摩¹, 粕谷 俊郎¹, 和田 元¹	1.同大理工		
		13p-P10-5	電子線回折による水クラスターの構造解析	中川 穣¹, 飼沼 徹¹, ○竹内 光明¹, 龍頭 啓 充¹, 高岡 義寛¹	1.京大光電子理工セ		

3月14日(十	9:00 - 12:	00		
9:00 - 9:15	14a-C1-1		○ 惠士 登略」 編士 和土」 松尺 一郎	1 カナエ
9:00 - 9:15	14a-C1-1	MARLOWE二体衝突シミュレータのプリ・ポストプロセス	○青木 学聡¹, 瀬木 利夫¹, 松尾 二郎¹	1.京大工
9:15 - 9:30	14a-C1-2	高出力インパルスマグネトロンスパッタリングを用いた金属クラスター イオン源の開発	○(M1)水内 勇¹, 秋元 健吾¹, 山本 宏晃², 戸名 正英², 塚本 恵三¹², 中野 元善¹, 大下 慶次郎¹, 美齊津 文典¹	1.東北大院理, 2.(株)アヤボ
9:30 - 9:45	14a-C1-3	共鳴イオン化(RIMS)法を用いた放射性セシウムイメージング装置 の開発	○(PC)大石 乾詞¹, 坂本 哲夫¹², 川上 勇², 奧村 丈夫³	1.工学院大工, 2.阿藤工務店, 3. 性子光学
9:45 - 10:00	奨 14a-C1-4	ビスマスクラスターSIMS法による有機材料分析に関する研究	○藤井 麻樹子¹, 宍戸 理恵², 鈴木 茂², 松 尾 二郎¹	1.京大院工, 2.東北大多元研
10:00 - 10:15	14a-C1-5	ガスクラスターイオンビームを用いた 有機材料の三次元質量イメージ ング技術の開発	〇若本 恵佑¹, 中川 駿一郎¹, 瀬木 利夫¹, 青木 学聡¹, 松尾 二郎¹	1.京大院工
10:15 - 10:30		休憩/Break		
10:30 - 10:45	14a-C1-6	ガスクラスターイオンビームによる極薄膜の非接触硬度評価	○林 雅祐¹, 豊田 紀章¹, 山田 公¹	1.兵庫県立大工
10:45 - 11:00	14a-C1-7	低真空下におけるArクラスターイオンビームの輸送特性	○鈴木 敢士¹, 瀬木 利夫¹, 青木 学聡¹, 松 尾 二郎¹	1.京大工
11:00 - 11:15	14a-C1-8	CIF <sub>3</sub> 中性クラスタービームによる微細パターンエッチング	○瀬木 利夫¹, 山本 洋揮², 古澤 孝弘², 吉野 裕³, 妹尾 武彦³, 小池 国彦³, 青木 学聡¹, 松尾 二郎¹	1.京大院工, 2.阪大産研, 3.岩谷
11:15 - 11:30	14a-C1-9	Ni表面へのGCIB照射による炭素膜の低温形成	○中山 大地¹, 魚住 裕樹¹, 豊田 紀章¹, 山田 公¹	1.兵庫県立大工
11:30 - 11:45	14a-C1-10	希ガス混合下における電界電離イオン種の混在比の電界依存性	○小牧 啓介¹, 永井 滋一¹², 岩田 達夫¹², 梶原 和夫¹², 畑 浩一¹²	1.三重大院工, 2.三重大極限ナノ
11:45 - 12:00	14a-C1-11	走査型へリウムイオン顕微鏡を用いた電圧印加時のコンデンサの電位 分布オペランド計測	○酒井 智香子¹, 石田 暢之¹, 増田 秀樹¹, 永 野 聖子¹, 藤田 大介¹	1.物材機構
3月14日(土	) 13:00 - 15	5:00		
13:00 - 13:15	14p-C1-1	シリコン酸化膜へのゲルマニウム負イオン注入と熱処理で形成した Geナノ粒子の酸化状態評価	○辻 博司¹, 加藤 幹雄², 佐々木 智一², 野村 英一³, 後藤 康仁¹	1.京大院工, 2.東芝ナノアナリシン 発受託21
13:15 - 13:30	14p-C1-2	真空エレクトロスプレーにより得られる帯電液滴ビームの特性	○二宮 啓¹, 境 悠治², チェン リーチュイン ¹, 平岡 賢三²	1.山梨大総合, 2.山梨大クリーン
13:30 - 13:45	14p-C1-3	炭化水素多原子分子イオンビームによる固体及び液体表面へのイ オン照射	○長山 功論¹, 林 恭平¹, 竹内 光明¹, 龍頭 啓充¹, 高岡 義寛¹	1.京大光電子理工セ
13:45 - 14:00	14p-C1-4	イオン液体EMIM-DCAイオンビームのスパッタリング特性	○星出 優輝 <sup>1</sup> , 竹内 光明 <sup>1</sup> , 龍頭 啓充 <sup>1</sup> , 高 岡 義寛 <sup>1</sup>	1.京大光電子教育研究セ
14:00 - 14:15	14p-C1-5	イオン液体ビーム照射による有機系試料の二次イオン質量分析 (SIMS)	○藤原 幸雄¹, 齋藤 直昭¹	1.産総研
14:15 - 14:30	14p-C1-6	重イオンビームを用いたTOF-ERDA測定	○安田 啓介¹, 石神 龍哉², 中田 吉則², 日 比 章五³	1.京都府大, 2.若狭湾エネ研セ, 田中研
14:30 - 14:45	14p-C1-7	液体中イオンビーム照射による材料表面への白金微粒子担持	○(M1)松林 洋太¹, 小林 知洋², 寺井 隆幸¹, 鈴木 晶大¹	1.東京大, 2.理研
14:45 - 15:00	14p-C1-8	大気圧分析を目指した高速重イオンプローブによる二次イオン質量 分析法の開発	○草刈 将一¹, 藤井 麻樹子¹, 瀨木 利夫¹, 青木 学聡¹, 松尾 二郎¹	1.京大院工

# 8 プラズマエレクトロニクス / Plasma Electronics

8.0 Plasma Elec	ctronics Englisl	n Session 口頭講演		
3月12日(木	9:00 - 10:4	5		
9:00 - 9:15	E 12a-D14-1	Time-resolved Curling Probe Measurement of Plasma Modulated at High Frequency	○(D)Anil Pandey¹, Sakakibara Wataru², Hiroyuki Matsuoka², Keiji Nakamura¹, Hideo Sugai¹	1.Chubu Univ., 2.DOWA Thermotech
9:15 - 9:30	E 12a-D14-2	In-situ Monitoring of GaN Film in Process Plasma	○DAISUKE OGAWA¹, YOSHITAKA NAKANO¹, KEIJI NAKAMURA¹	1.Chubu University
9:30 - 9:45	12a-D14-3	パーフルオロエーテルの解離過程	〇石川 健治¹, 林 俊雄¹, 近藤 祐介¹, 宮脇 雄大¹, 竹田 圭吾¹, 近藤 博基¹, 関根 誠¹, 堀 勝¹	1.名古屋大学
9:45 - 10:00	奨·E 12a-D14-4	ROS/RNS generation by various discharge plasma	OKazuhiro Takahashi¹, Kohki Satoh¹, Hidenori Itoh¹, Hideki Kawaguchi¹, Igor Timoshkin², Martin Given², Scott MacGregor²	1.Muroran I. T., 2.Univ. of Strathclyde
10:00 - 10:15	E 12a-D14-5	Production Efficiency of RONS in Plasma Activated Water Improved by Atmospheric-Pressure Microplasma Jet	○(PC)JunSeok Oh <sup>1,2</sup> , Maito Kakuta <sup>1</sup> , Hiroshi Furuta <sup>1,2</sup> , Akimitsu Hatta <sup>1,2</sup>	1.Kochi Univ. Technol., 2.Cetner for Nanotech
10:15 - 10:30	E 12a-D14-6	Advanced Microwave Antenna by Addition of Plasma Components	○Osamu Sakai¹, Akinori Iwai², Keiko Saito¹	1.Univ. Shiga Pref., 2.Kyoto Univ.

招待 10	0:30 - 10:45		[Young Scientist Presentation Award Speech] (15min.) Non-thermal plasma synthesis of silicon nanoparticles and its optical, electrical and photovoltaic properties	OYi Ding <sup>1</sup> , Shu Zhou <sup>1</sup> , Sugaya Michihi- ro <sup>1</sup> , Nozaki Tomohiro <sup>1</sup>	1.Titech
-------	--------------	--	--	---	----------

8.0	Plasma Elect	tronics English	Session ポスター講演		
	3月13日(金)	9:30 - 11:30			
E 13a-P9-1 Study of Temporal Behavior of M nation Plasma		Study of Temporal Behavior of Microwave sheath-Voltage conation Plasma	nbi- (P)Satyananda Kar¹, Hiroyuki Kousaka¹	1.Nagoya Univ.	

8.1 プラズマ生成・制御 / Plasma production and control ポスター講演							
3月12日(木) 16:00 - 18:00							
	E 12p-P9-1	Plasma Production and Stability in Electron Cyclotron Resonance Source	○(D)Camille Romero¹, Motoi Wada¹	1.Doshisha University			
	12p-P9-2	絶縁管内での水中プラズマの発生機構	○前原 常弘¹, 松友 真哉², 田中 彩果¹, 向笠 忍¹, 川嶋 文人¹	1.愛媛大, 2.新居浜高専			
	12p-P9-3	大気圧マイクロ波ラインプラズマにおけるプラズマ挙動シミュレーション	○鈴木 陽香¹, 中野 優¹, 伊藤 仁²³, 関根 誠¹², 堀 勝¹², 豊田 浩孝¹²	1.名大工, 2.名大工プラズマナノ, 3.東京 エレクトロン			
	12p-P9-4	バルスマイクロ波プラズマを用いたインライン溶液処理装置における 処理性能のDuty比依存性	○伊藤 美智子 <sup>1,3</sup> , 高島 成剛 <sup>3</sup> , 野村 記生 <sup>4</sup> , 北川 富則 <sup>4</sup> , 豊田 浩孝 <sup>1,2</sup>	1.名大工, 2.名大プラズマナノ, 3.プラズマ技術産業応用センター, 4.三進製作所			
	奨 12p-P9-5	水-アルコール混合溶液中ソリューションプラズマ反応場の解明: 気/ 液界面への水素結合の影響	○簾 智仁¹, 上野 智永¹⁴, 齋藤 永宏¹²²³⁴	1.名大院工, 2.名大グリモ, 3.未来社会創 造機構, 4.JST-CREST			

3月13日(金	) 16:30 - 19	:00		
16:30 - 16:45	13p-A28-1	同軸ケーブル置換型ECRプラズマスパッタ装置	○赤沢 方省¹, 小野 俊郎²	1.NTT DIC, 2.弘前大理工
16:45 - 17:00	13p-A28-2	Si製スロットアンテナを用いたマイクロ波励起水中気泡プラズマによる レジスト除去プロセスの開発	○伊藤 卓也¹, 石島 達夫¹, 田中 康規¹, 上杉 喜彦¹, 西山 聖², 堀邊 英夫²	1.金沢大, 2.大阪市大
17:00 - 17:15	13p-A28-3	電子サイクロトロン共鳴イオン源プラズマからの多種多様なイオンビーム電流向上のための電極改良	○今井洋太¹, 熊倉翔¹, 西岡田 卓也¹, 長家知生¹, 萩野尚吾¹, 上田和綱¹, 村松正幸², 佐藤文信¹, 加藤裕史¹, 北川敦志², 飯田敏行¹	1.阪大院工, 2.放医研
17:15 - 17:30	13p-A28-4	ECR多価イオン源プラズマの画像計測と共鳴現象との対応	○西岡田 卓也!, 今井 洋太!, 熊倉 翔!, 長家 知生!, 上田 和輝!, 萩野 尚吾!, 佐藤 文信!, 加藤 裕史!, 飯田 敏行!	1.阪大院工
17:30 - 17:45	13p-A28-5	ECR多価イオン源の電子エネルギー分布関数の空間分布と磁力線 との対応	○熊倉 翔', 今井 洋太', 長家 知生', 西岡田卓也', 上田 和輝', 萩野 尚吾', 佐藤 文信', 加藤 裕史', 飯田 敏行'	1.阪大院工
17:45 - 18:00	13p-A28-6	タンデム型ECRイオン源第1ステージプラズマへの蒸発源設置による 影響とステージ間のビーム輸送	〇長家 知生', 今井 洋太', 熊倉 翔', 西岡田卓也', 上田 和輝', 萩野 尚吾', 佐藤 文信', 加藤 裕史', 飯田 敏行'	1.阪大院工
18:00 - 18:15	奨 13p-A28-7	大面積マイクロ波プラズマの円筒キャビティ励起の最適化II	○(B)長谷川 雄一¹, 小川 大輔¹, 中村 圭二¹, 小林 理², 菅井 秀郎³	1.中部大工, 2.アプライドマテリアル 3.名産研
18:15 - 18:30	奨 13p-A28-8	メタマテリアル効果を用いたマイクロ波プラズマでの高調波生成の 効率化(II)	○岩井 亮憲¹, 中村 嘉浩¹, 酒井 道¹.²	1.京都大院工, 2.滋賀県立大工
18:30 - 18:45	13p-A28-9	マイクロ波を用いた大気圧ラインプラズマの生成	○宮田 弘志¹, 内田 雅人², 山口 健志¹, 進藤 春雄¹, 桑畑 周司¹, 磯村 雅夫¹	1.東海大院工, 2.東海大工
18:45 - 19:00	13p-A28-10	RFマグネトロンスバッタにおけるACカソードバイアス印加の効果	○秋元 隆宏¹, 進藤 春雄¹, 磯村 雅夫¹	1.東海大院工
3月14日(土	9:00 - 11:4	15		
9:00 - 9:15	14a-A28-1	狭ギャップ電極系用いた大気圧非平衡プラズマの生成と診断	○中野 俊樹¹, 北嶋 武¹	1.防衛大学校
9:15 - 9:30	14a-A28-2	絶縁管内における純水中の高周波ブラズマ	○田中 彩果¹, 前原 常弘¹	1.愛媛大理工
9:30 - 9:45	奨 14a-A28-3	液体と接する大気圧グロー放電によって誘起される液中反応プロセ スの検討	〇二戸 愛仁¹, 白井 直機¹, 内田 諭¹, 杤久 保 文嘉¹	1.首都大院理工
9:45 - 10:00	奨 14a-A28-4	高圧気体・超臨界流体中における密度揺らぎのスケール依存性を考慮した放電モデルの構築	○(DC)宗岡 均 <sup>1,2</sup> , 占部 継一郎 <sup>1,2</sup> , シュタウス スヴェン <sup>1</sup> , 寺嶋 和夫 <sup>1</sup>	1.東大院新領域, 2.学振特別研究員
10:00 - 10:15	14a-A28-5	3次元PIC/MC法による矩形マグネトロンスパッタカソードのエロージョン形状の解析	○矢部 裕¹, 小寺 恭介¹, 吉田 武史¹, 久保 信一¹, 高橋 理¹, 南部 健一²	1.昭和真空, 2.東北大流体研
10:15 - 10:30		休憩/Break		
10:30 - 10:45	14a-A28-6	非平衡大気圧Heプラズマ基礎特性に及ぼす水蒸気の影響	○(M2)坂下 准哉¹, 小田 昭紀¹	1.千葉工大
10:45 - 11:00	奨 14a-A28-7	二重接地DBDプラズマアクチュエータの作動メカニズムに関する 数値解析	○(B)中野 朝¹, 西田 浩之¹, 白石 朋巳¹	1.農工大
11:00 - 11:15	14a-A28-8	PIC/MCC法によるマイクロECRプラズマスラスタの数値解析	○(M1)上野 佳祐¹, 森 大輔¹, 鷹尾 祥典¹, 江利口 浩二¹, 斧 高一¹	1.京大院工
11:15 - 11:30	奨 14a-A28-9	針対平板電極における高気圧非平衡Neプラズマのシミュレーション	○元島 一樹¹, 白井 直機¹, 内田 諭¹, 杤久 保 文嘉¹	1.首都大院理工
11:30 - 11:45	14a-A28-10	プラズマブロセス中の基板温度制御のための熱流束モデルの解析	○(DC)堤 隆嘉¹, 福永 祐介¹, 石川 健治¹, 竹田 圭吾¹, 近藤 博基¹, 太田 貴之², 伊藤	1.名大院工, 2.名城大理工

8.2	プラズマ診断	·計測 / Plasm	a measurements and diagnostics	口頭講演			
	3月11日(水) 14:00 - 18:00						
	14:00 - 14:15	11p-A27-1	RF印加電圧波形解析と中性粒子ビーム加速機構のモデル化2	○榊原 康明¹, 菊地 良幸¹², 寒川 誠二²	1.東京エレクトロン、2.東北大学		
	14:15 - 14:30	11p-A27-2	禁則遷移を用いた超高感度レーザー吸収分光法による 酸素原子数 密度測定	○松井 信¹, 森田 陵¹	1.静大工		
	14:30 - 14:45	11p-A27-3	分子性ガスを含むアルゴンプラズマにおける電子密度計測への飽和 吸収分光法の応用	○西山 修輔¹, 王 恵民¹, 佐々木 浩一¹	1.北大院工		
	14:45 - 15:00	E 11p-A27-4	Spectroscopic Measurement and Number Density Calculation of NO (B, C) excited states in $\rm N_2\text{-}O_2$ mixture microwave discharge	○(D)HAO TAN¹, Atsushi Nezu¹, Haruaki Matsuura¹, Hiroshi Akatsuka¹	1.Titech		

8	8.2 プラズマ診断・計測 / Plasma measurements and diagnostics				ポスター講演	
		3月13日(金)	9:30 - 11:30			
			13a-P10-1	吸収分光法によるArパルスマイクロ波プラズマのガス温度時分解 測定	○瀬高 健太¹, 豊田 浩孝¹²	1.名大工, 2.名大プラズマナノ工学研究センター
			13a-P10-2	フローティングプローブ法による電子温度の測定	○納富 聡士¹, 佐藤 修一¹, 大内 幹夫¹	1.東京電機大

8.3 プラズマ成膜	8.3 プラズマ成膜・表面処理 / Plasma deposition of thin film and surface treatment ポスター講演							
3月12日(木	3月12日(木) 16:00 - 18:00							
	12p-P10-1	粉体ターゲットプロセスによる機能性薄膜作製~成膜速度~	○川崎 仁晴¹, 大島 多美子¹, 柳生 義人¹, 猪原 武士¹, 田中 雪¹, 須田 義昭¹	1.佐世保高専				
	12p-P10-2	ターゲット有効利用のための様々な形状の磁化プラズマ生成と評価	○大津 康徳¹, 鶴田 昇平¹, 井手 翼¹, 田原 竜夫², 秋山 守人²	1.佐大院工, 2.産総研九州センター				
	12p-P10-3	リング状ホロー電極型高密度容量結合プラズマの溝深さの影響	○大津 康徳¹, 松本 直樹¹	1.佐大院工				
	奨 12p-P10-4	メゾプラズマCVDによる高速横方向エピタキシャルオーバー成長	○小谷野 哲郎¹, 今村 雄将¹, 神原 淳¹	1.東大院工				
	12p-P10-5	吸引プラズマによるポリイミド表面の親水性処理	○狩野 諒¹, 菅 洋志¹, 高橋 賢², 白山 裕也², 新堀 俊一郎², 清水 哲夫³	1.千葉工大, 2.三友製作所, 3.産総研				
	12p-P10-6	マイクロ波プラズマを用いた熱電子発電器用半導体エミッタの表面 処理	○(M1)井上 健吾¹, 荻野 明久¹, 渡邉 孝俊²	1.静大院工, 2.静大工				
	12p-P10-7	a-Si:H:Fの極低温合成とレーザーアニーリングによる結晶化	○坂巻 直¹, 佐藤 哲也¹, 中川 清和¹	1.医工総研				
	12p-P10-8	プラズマ支援原子層堆積法によるa-TiN <sub>x</sub> 薄膜の低温合成	○柳 炳學¹, 関 渓太¹, 佐藤 哲也¹	1.山梨大				

プラズマ成膜	v·表面処理 / P	Plasma deposition of thin film and surface treatme	nt      口頭講演	
3月13日(金	9:00 - 12:3	0		
9:00 - 9:15	13a-A27-1	VHF-DC重畳マグネトロンスパッタにおける成膜速度評価	○福井 崇史¹, 福岡 侑士¹, 高田 昇治², 笹井 建典¹, 豊田 浩孝¹.³	1.名大工, 2.名大技術部, 3.名大プラ ナノ工学研究センター
9:15 - 9:30	13a-A27-2	ハイブリッド対向スパッタによるPETフィルム上へのITO透明導電膜 の作製	○諸橋 信一¹, 谷本 司¹, 辻田 圭佑¹, 荒川 俊也¹, 原田 直幸¹, 村田 卓也¹	1.山口大工
9:30 - 9:45	13a-A27-3	高周波マグネトロンスパッタリングにおける基板位置がタングステン薄膜の結晶配向性に及ぼす影響	○藤原 裕史¹, 辻 博士¹, 後藤 康仁¹	1.京大院工
9:45 - 10:00	13a-A27-4	DCマグネトロンカーボンスパッタリングプラズマ中の励起Ar原子の 挙動	○(M1)佐郷 友亮¹, 太田 貴之¹, 小田 昭紀², 上坂 裕之³	1.名城大理工, 2.千葉工大, 3.名大阪工機械
10:00 - 10:15	13a-A27-5	異なる粒子サイズのTi粉体ターゲットを用いたスパッタリング堆積	○大島 多美子¹, 前田 堯¹, 田中 雪¹, 川崎 仁晴¹, 柳生 義人¹, 猪原 武士¹, 須田 義昭¹	1.佐世保高専
10:15 - 10:30	13a-A27-6	スパッタを用いた低温高速層交換Ge結晶成長に対する基板温度 の効果	○古閑 一憲¹, 市田 大樹¹, 橋本 慎史¹, 徐 鉉雄¹, 山下 大輔¹, 板垣 奈穂¹², 白谷 正治¹	1.九大, 2.JST PRESTO
10:30 - 10:45	13a-A27-7	水素化アモルファスシリコン薄膜中Si-H <sub>2</sub> 結合生成に対するクラスタ混入とラジカル表面反応の寄与	○古閑 一憲¹, 都甲 捋¹, 鳥越 祥宏¹, 毛屋 公孝¹, 徐 鉉雄¹, 板垣 奈穂¹², 白谷 正治¹	1.九大, 2.JST PRESTO
10:45 - 11:00		休憩/Break		
11:00 - 11:15	奨 13a-A27-8	誘導結合プラズマ支援型多重磁極マグネトロンスパッタ法によりABS 樹脂上に作製したNi薄膜物性の膜厚依存性	○諏訪 智巳¹, 宮下 翔¹, 幸田 龍典¹, 森久 英¹, 豊田 宏¹	1.広島工大
11:15 - 11:30	13a-A27-9	プラズマ支援反応性スパッタリング法を用いたアモルファスIGZO薄膜の低温形成とその特性評価	節原 裕一¹, 中田 慶太郎¹, 陶山 悠太郎¹, ○ 竹中 弘祐¹, 内田 儀一郎¹, 江部 明憲²	1.阪大接合研, 2.イー・エム・ディー
11:30 - 11:45	奨 13a-A27-10	ラジカル注入型プラズマ励起化学気相堆積法で成長したアモルファ スカーボン膜の膜構造及び電子物性に対するイオン照射効果	○杉浦 啓嗣¹, 賈 凌雲¹, 徐 達¹, 中村 将之¹, 近藤 博基¹, 石川 健治¹, 竹田 圭吾¹, 関根 誠¹, 堀 勝⁵	1.名大院工
11:45 - 12:00	13a-A27-11	CH <sub>4</sub> およびSiH <sub>4</sub> の解離過程	○林 俊雄¹, 石川 健治¹, 関根 誠¹, 堀 勝¹	1.名大
12:00 - 12:15	13a-A27-12	窒素・水素プラズマ照射によるポリスチレン表面アミノ基生成プロセ スの解析	○(M1)後藤 健作¹, 斉宮 大¹, 礒部 倫郎¹, 杉本 敏司¹, 浜口 智志¹	1.大阪大工
12:15 - 12:30	奨 13a-A27-13	$Ar/O_2$ プラズマ処理によるプラズマインジケータの変色	○宮崎 裕司¹, 菱川 敬太¹, 山川 裕¹, 采山 和弘¹, 井上 浩¹	1.サクラクレパス

8.4	プラズマエッラ	チング / Plasm	a etching	ポスター講演			
	3月13日(金) 9:30 - 11:30						
		13a-P11-1	フルオロカーボンプラズマによりエッ おける化学組成分析	チングされたHfO <sub>2</sub> 基板最表面に	○大村 俊輔¹, 高橋 和生¹	1.京都工芸繊維大	
		13a-P11-2	HプラズマによるSi表面エッチングに ク上・表面H拡散の影響-	おける温度依存性の解析 -バル	○稲垣 耕司1.2, 森川 良忠1, 安武 潔1.2	1.阪大院工, 2.JST-CREST	

3月14日(土	.) 9:00 - 13:0	0		
9:00 - 9:15	14a-A27-1	COクラスター照射による磁性体エッチング反応 (2)	○唐橋 一浩¹, 瀬木 利夫², 松尾 二郎², 浜 口 智志¹	1.阪大院工, 2.京大院工
9:15 - 9:30	奨 14a-A27-2	透明電極材料のエッチング反応における水素ラジカル照射効果	○李 虎¹, 唐橋 一浩¹, 深沢 正永², 長畑 和 典², 辰巳 哲也², 浜口 智志¹	1.阪大院工, 2.ソニー
9:30 - 9:45	E 14a-A27-3	InGaAs quantum dot fabrication by a top-down approach for optical devices applications: effect of nanoscale etching mask	OCedric Thomas <sup>1,4</sup> , Chang-Yong Lee <sup>1</sup> , Akio Higo <sup>2</sup> , Naofumi Okamoto <sup>3</sup> , Ichiro Yamashita <sup>3,4</sup> , Seiji Samukawa <sup>1,2,4</sup>	1.Tohoku Univ., 2.WPI-AIMR, Tol Univ., 3.Nara Inst. of Info. and Te nol., 4.JST-CREST
9:45 - 10:00	奨 14a-A27-4	有機膜エッチングにおける側壁保護作用の基板温度依存性	○福永 裕介¹, 堤 隆嘉¹, 竹田 圭吾¹, 石川 健治¹, 近藤 博基¹, 関根 誠¹, 堀 勝¹	1.名大院工
10:00 - 10:15	奨 14a-A27-5	ハイドロフルオロカーボン(HFC)プラズマによるSiNエッチングにおける水素反応効果:分子動力学シミュレーション解析	○(M1)村上 雄一¹, 礒部 倫郎¹, 三宅 啓太 ¹, 深沢 正永², 長畑 和典², 辰巳 哲也², 浜口 智志¹	1.阪大工, 2.ソニー(株)
10:15 - 10:30	14a-A27-6	酸素中性粒子ビームによる酸化及び錯体反応を用いた遷移金属エッチングメカニズム(2)	○久保田 智広¹, 菊地 良幸¹, 寒川 誠二¹²	1.東北大流体研, 2.東北大WPI-AIM
10:30 - 10:45	14a-A27-7	シースコントロールプレートを用いた基板表面へのイオン斜入射とリップル形成	○(D)中崎 暢也¹, 園部 蒼馬¹, 初瀬 巧¹, 松 本 悠¹, 江利口 浩二¹, 斧 高一¹	1.京大院工
10:45 - 11:00	14a-A27-8	Cl。プラズマSiエッチングにおける表面ラフネスの解析: 初期表面ラフネスの影響	○(M1)松本 悠¹	1.京大院工
11:00 - 11:15		休憩/Break		
11:15 - 11:30	14a-A27-9	$1/\mathrm{C}^2$ 法による $\mathrm{H}_2$ およびHeプラズマ誘起ダメージ層構造の解析	○江利口 浩二¹, 深沢 正永², 長畑 和典², 辰巳 哲也², 斧 高一¹	1.京大院工, 2.ソニー(株)
11:30 - 11:45	奨 14a-A27-10	光学定数を用いたプラズマ誘起Si基板ダメージの面方位依存性	○(B)岡田 行正¹, 江利口 浩二¹, 斧 高一¹	1.京大院工
11:45 - 12:00	14a-A27-11	Cu配線Layoutに依存した新たなLow-kプラズマダメージモデル	○池田 太郎¹, 江利口 浩二², 谷原 聡¹, 山本 伸彦¹, 河西 繁¹, 斧 髙一²	1.東京エレクトロン山梨, 2.京大院工
12:00 - 12:15	奨 14a-A27-12	マイクロ波加熱によるシリコン表面近傍のブラズマ誘起欠陥修復	○岩井 隆晃¹, 江利口 浩二³, 山内 祥平², 野呂 尚孝¹, 北川 淳一¹, 斧 髙一³	1.東京エレクトロン山梨, 2.東京エレロン, 3.京大院工
12:15 - 12:30	14a-A27-13	ウエハ面内入射イオンエネルギー分布制御によるエッチングレート分 布制御技術の開発	○荒巻 徹¹, 森本 未知数¹, 池田 紀彦¹	1.日立ハイテク
12:30 - 12:45	奨 14a-A27-14	ミニマルファブ用 TSV ブラズマエッチング装置におけるフッ素ラジカルの発光強度依存性	○本村 大成 <sup>12</sup> , 高橋 和貴 <sup>3</sup> , 笠嶋 悠司 <sup>1</sup> , 上 杉 文彦 <sup>1</sup> , 安藤 晃 <sup>3</sup> , 小木曽 久人 <sup>12</sup> , クンプア ン ソマワン <sup>12</sup> , 原 史朗 <sup>12</sup>	1.産総研, 2.ミニマルファブ技術研究 合, 3.東北大
12:45 - 13:00	奨 14a-A27-15	プラズマエッチング中の剥離パーティクルの突発的多量発生	○笠嶋 悠司¹, 本村 大成¹, 上杉 文彦¹	1.産総研

8.5	8.5 プラズマナノテクノロジー / Plasma nanotechnology 口頭講演						
	3月13日(金)	16:30 - 18:4	15				
	16:30 - 16:45	E 13p-A27-1	Semiconducting silicon-tin quantum dots as environmentally friendly material for carrier multiplication solar cell at low cost	OSvrcek Vladimir¹, Mickael Lozach¹, Davide Mariotti², Noboru Ohashi³, Tetsuhiko Miyadera¹, Koji Matsubara¹	1.AIST-Tsukuba, 2.Univ. of Ulster UK, 3.Tohoku University		
	16:45 - 17:00	奨 13p-A27-2	TiO <sub>2</sub> ナノ粒子生成中の誘導熱プラズマトーチ内における原料粉体蒸発およびTiO分子生成過程に対する考察	○兒玉 直人¹, 北 健太郎¹, 田中 康規¹, 上杉喜彦¹, 石島 達夫¹, 渡邉 周², 中村 圭太郎²	1.金沢大院自然, 2.日清製粉グルー プ本社		
	17:00 - 17:15	13p-A27-3	大気圧Ar/NH $_{_3}$ プラズマプロセスによる $\rm N_{_2}H_{_4}$ を用いた銀粒子パターンの作製(II)	○木原 直也¹, Blanquet Ella¹², 平岡 悠¹, 酒井 道¹²	1.京都大院工, 2.滋賀県大工		
	17:15 - 17:30	13p-A27-4	プラズマ化学輸送法によるh-BN原子層の形成	○北嶋 武¹, 中野 俊樹¹	1.防大電気		
	17:30 - 17:45	13p-A27-5	リモートプラズマを用いたグラフェンの作製	○東松 真和¹, 平松 美根男¹, 近藤 博基², 堀 勝²	1.名城大理工, 2.名大工		
	17:45 - 18:00	奨 13p-A27-6	ナノ膜厚Ni/Cu積層触媒を用いたMPCVD法によるグラフェン合成	○(M1)楠本 雄司¹, 西森 俊作¹, 宮地 弘樹¹, 針谷 達¹, 古田 寬¹², 八田 章光¹²	1.高知工科大, 2.高知工科大総研ナ ノテクC		
	18:00 - 18:15	奨 13p-A27-7	液中プラズマで合成したナノグラフェンを用いた燃料電池用白金触媒 電極における酸素還元特性	○(M2)天野 智貴¹, 近藤 博基¹, 竹田 圭吾¹, 石川 健治¹, 太田 貴之², 伊藤 昌文², 平松 美根男², 加納 浩之³, 関根 誠¹, 堀 勝¹	1.名大院工, 2.名城大理工, 3.NUエコ		
	18:15 - 18:30	奨 13p-A27-8	白金微粒子担持カーボンナノウォールの耐久性能および劣化機構 の解明	○今井 駿¹, 近藤 博基¹, 石川 健治¹, 平松 美根男², 関根 誠¹, 堀 勝¹	1.名大院工, 2.名城大理工		
	18:30 - 18:45	奨 13p-A27-9	カーボンナノウォールを用いた固体高分子型燃料電池の評価 〜カーボンナノウォールの構造の影響〜	○(M1)大慶 亮佑¹, 太田 貴之¹, 伊藤 昌文¹, 平松 美根男¹, 近藤 博基², 堀 勝²	1.名城大理工, 2.名大院理工		

8.5 プラズマナノ	8.5 プラズマナノテクノロジー / Plasma nanotechnology ポスター講演							
3月13日(金)	3月13日(金) 9:30 - 11:30							
	奨 13a-P12-1	プラズマCVDによるグラフェンナノリボンの架橋合成機構	○鈴木 弘朗¹, 加藤 俊顕¹, 金子 俊郎¹	1.東北大院工				
	奨 13a-P12-2	プラズマ誘起ミクロ液相反応による酸化亜鉛ナノ粒子合成	○妻木 正尚¹, 清水 禎樹², 伊藤 剛仁¹	1.阪大院工, 2.産総研				
	13a-P12-3	大気中でのナノ粒子連続合成に向けた大気圧プラズマプロセスの 開発	○清水 禎樹¹, 川口 建二¹	1.産総研ナノシステム				
	13a-P12-4	斜め堆積反応性スパッタリングにおける原料質量数の影響	○仲尾 昌浩¹, 枡川 尊重¹, 井上 泰志¹, 高 井 治²	1.千葉工大工, 2.材料・表面工学研究所				
	13a-P12-5	離散的ナノ柱状構造化InN薄膜の非水電解質におけるEC繰返し耐久性	○(M1)枡川 尊重¹, 石井 万紀也¹, 小林 正樹¹, 姫松 克成¹, 井上 泰志¹, 高井 治²	1.千葉工大工, 2.関学材料·表面工研				

8.6 プラズマライ	フサイエンス / F	Plasma life sciences	ポスター講演		
3月12日(木) 16:00 - 18:00					
	12p-P11-1	大腸菌コロニーへのFEDBD照射が遺伝子発現に与	える影響	○柳生 義人¹, 畑山 雄大¹, 松本 直樹¹, 川崎 仁晴¹, 大島 多美子¹, 猪原 武士¹, 山崎 隆志 ¹, 須田 義昭¹, 林 信哉²	1.佐世保高専, 2.九大総理工
	12p-P11-2	酸素プラズマガスのバブリングによる水中殺菌		○吉木 宏之¹, 石川 福人¹, 菅原 哲也²	1.鶴岡高専, 2.山形県工業技術センター
	12p-P11-3	ラットに皮下投与したInナノ粒子の体内輸送		○古閑 一憲¹, 天野 孝昭¹, 平田 美由紀², 田中 昭代², 白谷 正治¹	1.九大シス情, 2.九大医
	12p-P11-4	気液界面を介した大気圧非平衡プラズマ照射が液体 与える影響	中のアミノ酸へ	○竹中 弘祐¹, 内田 儀一郎¹, 川端 一史¹, 中島 厚¹, 阿部 浩也¹, 節原 裕一¹	1.阪大接合研

8.6	プラズマライフ	フサイエンス /	Plasma life sciences 口頭講演		
	3月13日(金)	9:00 - 12:1	5		
	9:00 - 9:15	奨 13a-A28-1	酸素ラジカル照射した血清含有培地の線維芽細胞の増殖能への 影響	○(M1)森 洋介¹, 村田 富保¹, 堀 勝², 伊 藤 昌文¹	1.名城大学, 2.名古屋大学
	9:15 - 9:30	奨 13a-A28-2	定期的酸素ラジカル照射による出芽酵母細胞の増殖効果	○(M1)小林 潤¹, 正岡 祐輝¹, 橋爪 博司², 太田 貴之¹, 堀 勝², 伊藤 昌文¹	1.名城大理工, 2.名古屋大学
	9:30 - 9:45	奨 13a-A28-3	酸素ラジカル定量照射溶液中の活性種計測	○小林 剛士¹, 唐渡 卓也¹, 橋爪 博司², 太田 貴之¹, 石川 健治², 掘 勝², 伊藤 昌文¹	1.名城大理工, 2.名大
	9:45 - 10:00	13a-A28-4	殺菌剤としてのブラズマ処理水	○北野 勝久¹, 井川 聡², 中島 陽一², 谷 篤史³	1.阪大工, 2.大阪産技研, 3.阪大理
	10:00 - 10:15	13a-A28-5	乳腺由来細胞を用いたブラズマ照射培養液による選択的細胞死の 検討	○橋爪 博司 <sup>1</sup> , 田中 宏昌 <sup>1</sup> , 中村 香江 <sup>1</sup> , 吉 川 史隆 <sup>1</sup> , 石川 健治 <sup>1</sup> , 加納 浩之 <sup>2</sup> , 水野 正 明 <sup>1</sup> , 堀 勝 <sup>1</sup>	1.名古屋大, 2.NU eco
	10:15 - 10:30	奨 13a-A28-6	大気圧プラズマ活性培養液の抗腫瘍効果作用機構の解析	○(M1) 倉家 尚之¹, 田中 宏昌¹, 石川 健治¹, 中村 香江², 梶山 広明², 吉川 史隆², 近藤隆³, 水野 正明², 竹田 圭吾¹, 近藤 博基¹, 関根 誠', 堀 勝¹	1.名大院工, 2.名大医, 3.富山大
	10:30 - 10:45		休憩/Break		
招待	10:45 - 11:00	13a-A28-7	「講演奨励賞受賞記念講演」(15分) 大気圧プラズマ照射による水溶性高分子の細胞膜透過性促進	〇佐々木 涉太 <sup>1</sup> , 保苅 雄太郎 <sup>1</sup> , 神崎 展 <sup>2</sup> , 金子 俊郎 <sup>1</sup>	1.東北大院工, 2.東北大院医工
	11:00 - 11:15	13a-A28-8	リポソームを用いたプラズマ遺伝子導入機構の解明	〇相原 大二郎', 永岩 秀憲', 木戸 祐吾'², 池田 善久', 本村 英樹', 佐藤 晋'³, 神野 雅 文', 橘 邦英 <sup>4</sup>	1.愛媛大院理工, 2.バール工業, 3.ワイ'ズ, 4.大阪電通大工
	11:15 - 11:30	13a-A28-9	ラジカルがプラズマ遺伝子導入に及ぼす影響	○立花 宏紀', 木村 真徳', 池田 洋平', 木戸 祐吾'², 池田 善久', 本村 英樹', 佐藤 晋'³, 神野 雅文', 橘 邦英'	1.愛媛大学, 2.バール工業, 3.ワイズ, 4.大阪電通大学
	11:30 - 11:45	13a-A28-10	脂質二重膜への誘電体バリア放電処理による拡散係数の変化	○山下 龍舞!, 須田 善行!, 滝川 浩史!, 手 老 龍吾!	1.豊橋技科大
	11:45 - 12:00	奨 13a-A28-11	マルチブレックスコヒーレントアンチストークスラマン散乱(CARS)顕微 鏡を用いたプラズマ誘起生体反応機構の解明	○(B)古田 凌¹, 野村 多加博², 橋爪 博司¹, 竹田 圭吾¹, 近藤 博基¹, 石川 健治¹, 太田 貴之², 伊藤 昌文², 関根 誠¹, 堀 勝¹	1.名大工, 2.名城大
	12:00 - 12:15	13a-A28-12	大気圧プラズマ照射による経皮吸収改善の基礎検討	○清水 一男 <sup>1,2</sup> , 林田 健太郎 <sup>1</sup> , マリウス ブ ラジャン <sup>2</sup>	1.静大院, 2.静大イノベーション

		分野 / Plasma phenomena, emerging area of plas	mas and their new applications	口頭講演
3月11日(水	) 14:00 - 18:	00		
14:00 - 14:15	11p-A28-1	液相レーザーアブレーション誘起キャビテーション気泡周辺での放 電現象	○(M1)高橋 裕太¹, 佐々木 浩一¹	1.北大工
14:15 - 14:30	11p-A28-2	気液界面プラズマによる液相過酸化水素生成機構	石橋 直人¹, ○竹内 希¹	1.東工大
14:30 - 14:45	11p-A28-3	大気圧プラズマにより生成された液中活性種の対流輸送数値シミュ レーション	○幾世 和将¹, 浜口 智志¹	1.大阪大工
14:45 - 15:00	11p-A28-4	AC励起大気圧Arプラズマの培養液照射中における気相活性種の 計測	梁 思潔¹, ○竹田 圭吾¹, 熊倉 匠¹, 近藤 博 基¹, 石川 健治¹, 関根 誠¹, 堀 勝¹	1.名大院工
15:00 - 15:15	11p-A28-5	気液二相スラグ流内における放電プラズマの形成と発光特性	○(B)間野 翔¹, 林 祐衣¹, 高田 昇治¹, 神田 英輝¹, 後藤 元信¹	1.名大工
15:15 - 15:30	奨 11p-A28-6	ナノスケール針状電極を用いた液中放電の機構解明	○青山 智成¹, 藤田 英理², 佐藤 岳彦², 金 子 俊郎¹	1.東北大院工, 2.東北大流体研
15:30 - 15:45	11p-A28-7	大気圧プラズマジェット放電特性に及ぼす放電電圧バルス幅の効果	○内田 儀一郎¹, 竹中 弘祐¹, 川端 一史¹, 節原 裕一¹	1.阪大接合研
15:45 - 16:00	奨 11p-A28-8	H <sub>2</sub> O vapour中の電子輸送特性	○(M2)川口 悟¹, 佐藤 孝紀¹, 伊藤 秀範¹	1.室蘭工大
16:00 - 16:15		休憩/Break		
16:15 - 16:30	奨 11p-A28-9	超臨界流体を用いた擬似微小重力環境下ダストプラズマの創製	○松林 康仁¹, 占部 継一郎¹, シュタウス スヴェン¹, 寺嶋 和夫¹	1.東大院新領域
16:30 - 16:45	11p-A28-10	プラズマ誘起流の時間分解測定	○志村 尚彦¹, 雨森 清行¹, 田中 元史¹, 安 井 祐之¹	1.(株)東芝
16:45 - 17:00	奨 11p-A28-11	光電子制御タウンゼント放電Arブラズマの空間電位分布	$\bigcirc$ (M1)小谷川 祐貴¹, 阿加 賽見¹, 小川 修 $-$ ¹, 高桑 雄二¹	1.東北大学
17:00 - 17:15	E 11p-A28-12	Effect of Radicals on Inactivation of Spore-forming Microorganisms Studied with Porous Ceramic Plate in $\rm N_2/\rm O_2$ Surface-wave Plasma	○(D)Xiaoli Yang¹, Syuhei Hamajima¹, Reitou Tei¹, Masaaki Nagatsu¹	1.Shizuoka Univ.
17:15 - 17:30	奨 11p-A28-13	直流コロナ放電照射による水中のROS生成	○杉山 豪¹, 佐藤 孝紀¹, 伊藤 秀範¹, 川口 秀樹¹, Timoshkin Igor², Given Martin², MacGregor Scott²	1.室蘭工大, 2.ストラスクライド大
17:30 - 17:45	11p-A28-14	ミスト・気体混合媒質中での放電プラズマ解析	○井上 翔太¹, 劉 舒涵¹, 池田 善久¹, 本村 英樹¹, 神野 雅文¹	1.愛媛大院理工
17:45 - 18:00	11p-A28-15	水-誘電体多層電極を用いた立体形状大気圧プラズマの殺菌特性	○三沢 達也¹, 三島 朋子², 高井 雄一郎², 西岡 輝美²	1.佐賀大工, 2.大阪府立環境農水桶

8.7	プラズマ現象	・新応用・融合名	分野 / Plasma phenomena, emerging area of plasi	mas and their new applications	ポスター講演
	3月13日(金)	16:30 - 18:3	30		
		13p-P11-1	マイクロ波プラズマを用いた無電極紫外ランプの開発	○西川 拓¹, 豊田 浩孝1²	1.名大工、2.名大プラズマナノ工学研究センター
		13p-P11-2	超臨界流体レーザー誘起プラズマによる二酸化炭素変換	○後藤 拓¹, 小泉 仁人¹, Mark A. Cappelli², 伊藤 剛仁¹	1.阪大院工, 2.スタンフォード大
		奨 13p-P11-3	バルス放電照射による水中のROS/RNS生成	○中井 基嗣¹, 佐藤 孝紀¹, 伊藤 秀範¹, 川 □ 秀樹¹, Timoshkin Igor², Given Martin², MacGregor Scott²	1.室蘭工大, 2.ストラスクライド大
		奨 13p-P11-4	AC バルス放電による気液界面プラズマ発光の時空間分解計測	○(M2)林 祐衣¹, 神田 英輝¹, 高田 昇治¹, 佐々木 浩一²	1.名大院工, 2.北大院工
		奨 13p-P11-5	Comsol*による低温プラズマ中に存在する液滴の蒸発の計算	○森山 誠¹, 堀田 将也¹, 中村 圭二¹, 小 川 大輔¹	1.中部大工
		13p-P11-6	大気圧グロー放電における電流密度が放電と水質に与える影響	○佐藤 修一¹, 神田 兼二郎¹, 大内 幹夫¹	1.東京電機大
		13p-P11-7	流通式液中放電プラズマによる溶液中の難分解性有機物の分解	○石田 猛¹, 小原 賢信¹, 甲田 公良²	1.日立中研, 2.日立ハイテクサイエンス
		13p-P11-8	自己組織化単分子膜と液中プラズマの相互作用の赤外分光解析	○篠原 正典¹, 吉田 裕太¹, 丸野 尚紀¹, 中野 大和¹, 谷口 雄二郎¹, 伊東 和樹¹, 松田 良 信¹, 藤山 寛¹	1.長崎大院工
		13p-P11-9	プラズマによる硝酸溶液肥料を用いた花のまちづくり	藤井 栄人¹, 渡邊 直弥¹, 饒村 修¹, ○池 澤 俊治郎¹	1.中部大工
		13p-P11-10	プラズマによるアンモニアストリッピング法の効率	藤井 栄人¹, 渡邊 直弥¹, 饒村 修¹, ○池 澤 俊治郎¹	1.中部大工
		13p-P11-11	バリア放電を用いた揮発性化学兵器用剤分解装置の開発と性能 評価	○井上 裕貴¹, 宇都宮 嘉孝¹, 岩井 貴弘², 長島 央行², 名児耶 友樹², 宮原 秀一¹, 瀬戸康雄², 沖野 晃俊¹	1.東工大院総理工, 2.科警研
		13p-P11-12	アルミ蒸着薄膜への大気圧プラズマジェット照射	○桑畑 周司¹, 山口 健志¹	1.東海大院工
		13p-P11-13	大気圧プラズマジェットの高速度カメラ観察	○山口 健志¹, 磯村 雅夫¹, 桑畑 周司¹	1.東海大院工
		13p-P11-14	水素ラジカルによるW、Niの選択加熱を用いたa-Siの固相成長法と TFTの作製	○(M1)上村 和貴¹, 荒井 哲司¹, 有元 圭介¹, 山中 淳二¹, 佐藤 哲也¹, 中家 大希¹, 中川清和¹, 高松 利行², 澤野 憲太郎³	1.山梨大, 2.株式会社SST, 3.東京都市大
		13p-P11-15	大気圧プラズマジェットの照射によるジャガイモの萌芽防止	○(B)鈴木 崇久¹, 西山 修輔¹, 佐々木 浩一¹	1.北大工
		13p-P11-16	低圧プラズマ照射による病原性細菌の不活化	○内田 詳平¹, 中村 研太¹, 小野 大帝¹, 林 信哉¹	1.九大総理工

8.8	8.8 プラズマエレクトロニクス分科内招待講演 口頭講演					
	3月12日(木) 11:00 - 11:30					
招待	11:00 - 11:30	12a-D14-8	「プラズマエレクトロニクス 分科内招待 プラズマを学び科学・技術の最先端に		〇石井 彰三	1.東工大

プ	プラズマエレクトロニクス賞授賞式 / Plasma Electronics Award Ceremony 口頭講演					
	3月12日(火) 11:30 - 11:45					
	11:30 - 11:45	12a-D14-9	「プラズマエレクトロニクス賞授賞式」(15分)			

## 9 応用物性 / Applied Materials Science

	9.1 誘電材料・誘電体 / Dielectrics, ferroelectrics ポスター講演						
3月11日(水) 16:00 - 18:00							
		11p-P5-1	$KSr_2Nb_5O_{15}$ セラミックスの比誘電率温度依存性におの影響	よぼす熱処理	○岩井 裕¹, 味方 陵¹, 星 啓佑¹	1.長岡高専	
		11p-P5-2	ポーラス非鉛系圧電セラミックスの作製		○(M1)馬場 亮佑¹, 唐木 智明¹, 藤井 正¹	1.富山県立大学	

9.1	9.1 誘電材料·誘電体 / Dielectrics, ferroelectrics 口頭講演							
	3月12日(木) 9:00 - 12:30							
	9:00 - 9:15	奨 12a-B5-1	$LaAlO_3$ のフォトルミネセンスに与える熱処理の影響	$\bigcirc$ (M1)針間 正幸¹, 森本 貴明¹², 大木 義路¹.³	1.早大先進理工, 2.学振DC2, 3.早大 材研			
	9:15 - 9:30	奨 12a-B5-2	YSZにおける酸素空孔に起因するフォトルミネセンス	○黒田 康裕¹, 金子 昇司¹, 森本 貴明¹³, 大 木 義路¹²	1.早大先進理工, 2.早大材研, 3.学振 DC2			
	9:30 - 9:45	奨 12a-B5-3	YSZ中の酸素空孔による発光の励起・緩和機構	○(DC)森本 貴明 <sup>1,3</sup> , 金子 昇司 <sup>1</sup> , 大木 義 路 <sup>1,2</sup>	1.早大先進理工, 2.早大材研, 3.学振 DC2			
	9:45 - 10:00	12a-B5-4	K(Nb, Ta)O <sub>3</sub> 固溶及び放電プラズマ焼結による(Bi $_{0.5}$ K $_{0.5}$ )TiO $_3$ -BiFeO $_3$ 強誘電体の特性改善と結晶・電子構造	○宮崎 浩輔¹, 石田 直哉¹, 井手本 康¹, 北 村 尚斗¹	1.東理大理工			
	10:00 - 10:15	奨 12a-B5-5	$SrTiO_3$ を置換した $BaTiO_3$ - $Bi(Mg_{1/2}Ti_{1/2})O_3$ セラミックスの誘電特性	○西川 佳佑¹, 青柳 倫太郎¹, 鈴木 一行²	1.名工大工, 2.産総研			
	10:15 - 10:30	12a-B5-6	コンポジット構造を持つNaNbO <sub>3</sub> -BaTiO <sub>3</sub> セラミックスの作製	○青柳 倫太郎¹, 那須 悠二¹, 坂野 聡一¹, 西川 佳佑¹, 鈴木 一行²	1.名工大工, 2.産総研			
	10:30 - 10:45	12a-B5-7	常誘電相におけるBaTiO <sub>3</sub> 結晶の角度分解偏光ラマン散乱	○塚田 真也¹, 藤井 康裕², 小島 誠治³, 秋 重 幸邦¹	1.島根大教育, 2.立命館大理工, 3.筑 波大数物			
	10:45 - 11:00		休憩/Break					
招待	11:00 - 11:15	12a-B5-8	「講演奨励賞受賞記念講演」(15分) 遠赤外分光エリプソメータを用いた相転移現象の観測	〇金原 一樹 <sup>1</sup> , 保科 拓也 <sup>1</sup> , 武田 博明 <sup>1</sup> , 鶴 見 敬章 <sup>1</sup>	1.東工大院			

招待	11:15 - 11:30	12a-B5-9	「講演奨励賞受賞記念講演」(15分) KTN結晶の電界誘起相転移を用いた光制御	〇稲垣 卓弘 $^1$ , 今井 欽之 $^2$ , 宮津 純 $^2$ , 武居 弘 樹 $^1$ , 小林 潤也 $^2$	1.NTT物性研, 2.NTTデバイスイノベー ションセンタ
	11:30 - 11:45	12a-B5-10	PZTセラミックス、PVDFフィルム、PMN-PT結晶の電気熱量効果	○真岩 宏司¹	1.湘南工大工
	11:45 - 12:00	12a-B5-11 希土類、Nb置換Pb(Zr,Ti) $O_3$ 系強誘電体における強誘電特性と平均、局所、電子構造の関係 手本康! 手本康!		○田村 拓也¹, 石田 直哉¹, 北村 尚斗¹, 井 手本 康¹	1.東理大理工
	12:00 - 12:15	12a-B5-12	$Ca_xBa_{1.x}Nb_2O_6$ 固溶体における強誘電相転移	○符 徳勝¹, 深澤 研介¹	1.静岡大工
	12:15 - 12:30	12a-B5-13	ー軸性リラクサーSBN の常誘電相における電場効果と熱履歴	松本 和也¹, ○小島 誠治¹	1.筑波大数理

・ノワイヤ・ナ	·ノ粒子 / Nan	owires and Nanoparticles       口頭講演	寅	
3月12日(木	9:30 - 12:1	L5		
9:30 - 9:45	奨 12a-A20-1	InAs 量子ドットを埋め込んだ ナノワイヤ構造の Si 基板上成長とその光学特性	○(D)權 晋寛¹, 渡邉 克之¹², 岩本 敏¹², 荒 川 泰彦¹²	1.東大生研, 2.東大ナノ量子
9:45 - 10:00	奨 12a-A20-2	InP/AlGaPコアシェルナノワイヤの結晶構造評価	〇石坂 文哉¹, 平谷 佳大¹, 冨岡 克広¹², 福井 孝志¹	1.北大院情報科学および量子集積セ ー, 2.JST さきがけ
10:00 - 10:15	12a-A20-3	MOVPE選択成長法によるSi(100), SOI基板上のInAsナノワイヤ成長	○冨岡 克広¹², 石坂 文哉¹, 中井 栄治¹, 本 久 順一¹, 福井 孝志¹	1.北大院情報科学および量子集積セ ー, 2.JSTさきがけ
10:15 - 10:30	12a-A20-4	GaAs/InGaAs/GaAs コアマルチシェルナノワイヤ共振器の評価	○(M2)和田 年弘¹, 原 真二郎¹², 本久 順一¹	1.北大院, 2.量子集積研究センター
10:30 - 10:45	12a-A20-5	間隔の広いInP系NWアレイと量子ドットの形成と評価	○(M2)柳瀬 祥吾¹, 原 真二郎¹², 本久 順一¹	1.北大院, 2.量子集積センター
10:45 - 11:00		休憩/Break		
11:00 - 11:15	12a-A20-6	ナノワイヤFET作製におけるインクジェットプリンタとマニビュレータを 用いたナノワイヤ転写精度の改善	○佐々木 智¹, 舘野 功太¹, 章 国強¹, 原田 裕一¹, 齊藤 志郎¹, 藤原 聡¹, 村木 康二¹	1.NTT物性基礎研
11:15 - 11:30	12a-A20-7	InAsP/InPナノワイヤ成長におけるTBAsバルス供給とTBClの効果	○舘野 功太 <sup>1,2</sup> , 滝口 雅人 <sup>1,2</sup> , 章 国強 <sup>1,2</sup> , 後 藤 秀樹 <sup>2</sup>	1.NTT-NPC, 2.NTT物性研
11:30 - 11:45	12a-A20-8	自己触媒VLSナノワイヤにおける軸方向成長速度の均一化	○章 国強¹, 舘野 功太¹, 後藤 秀樹¹	1.NTT 物性研
11:45 - 12:00	12a-A20-9	InAsおよびInPナノワイヤFETにおけるポストアニーリング効果の電極材料依存性	○芦川 耶眞登 <sup>12</sup> , Guoqiang Zhang <sup>1</sup> , 舘野 功太 <sup>1</sup> , 原田 裕一 <sup>1</sup> , 齊藤 志郎 <sup>1</sup> , 藤原 聡 <sup>1</sup> , 村 木 康二 <sup>1</sup> , 佐々木 智 <sup>12</sup>	1.NTT物性基礎研, 2.東北大理
12:00 - 12:15	12a-A20-10	自己触媒VLS法によるInP/GaInAs/InPコアシェルナノワイヤの成長	○(M1)荻野 雄大¹, 朝倉 啓太¹, 下村 和彦¹, 和保 孝夫¹	1.上智大理工
3月12日(木)	) 14:00 - 18	:30		
14:00 - 14:15	奨 12p-A20-1	半導体ナノワイヤの変形ボテンシャル・弾性限界のその場顕微分光 評価	○(PC)渡辺 健太郎¹², 長田 貴弘¹, 若山 裕¹, 関口 隆史¹, フォルク ヤノシュ³	1.物材機構, 2.筑波大学, 3.ハンガリ 学アカデミー
14:15 - 14:30	12p-A20-2	Au触媒GaAsナノワイヤの構造多形メカニズム	○佐々木 拓生¹, 出来 亮太², 高橋 正光¹²	1.原子力機構, 2.兵庫県立大
14:30 - 14:45	E 12p-A20-3	Effects of Fabrication Process of Anodic Aluminum Oxide on Selective Growth of Si Nanowire Arrays	○(P)Hoang Nguyen Van¹², Sergii TUT- ASHKONKO¹², Yusuke HOSHI², Noritaka USAMI¹², Makoto KONAGAI¹³	1.MEXT, FUTURE-PV Innovation Japan Science and Technology Agency, Japan, 2.Graduate School of Engineering, Nagoya University Japan, 3.Graduate School of Science and Engineering, Tokyo Institute of Technology, Japan
14:45 - 15:00	12p-A20-4	Ge/Si コアシェルナノワイヤ作製に向けたナノワイヤ形状に対するSiシェル膜厚依存性の観測	○野口 智弘', 森田 広大', Simanullang Marolop', Xu Zhengyu', 宇佐美 浩一', 河 野 行雄'², 小寺 哲夫², 小田 俊理'¹²	1.東工大量子ナノ研セ, 2.東工大電子物理
15:00 - 15:15	12p-A20-5	Ge/Si コアシェルナノワイヤの熱電特性評価	○森田 広大¹, 野口 智弘¹, 宇佐美 浩一¹, マロロブシマニュラン¹, 河野 行雄¹², 小寺 哲夫², 小田 俊理¹²	1.東工大量子ナノ研セ, 2.東工大電子物理
15:15 - 15:30	奨 12p-A20-6	イオン液体中への金ナノ粒子の合成と結晶学・電気的特性の評価	○松本 雄介¹, 竹内 光明¹, 龍頭 啓充¹, 高 岡 義寛¹	1.京大院工
15:30 - 15:45		休憩/Break		
15:45 - 16:00	12p-A20-7	高密度FePtナノドットスタック構造の電子輸送特性	○(M2)壁谷 悠希¹, 満行 優介¹, 張 海¹, 大 田 晃生¹, 牧原 克典¹, 宮崎 誠一¹	1.名大院工
16:00 - 16:15	12p-A20-8	外部磁場がFePt合金ナノドットへの電子注入特性に及ぼす影響	○満行 優介¹, 壁谷 悠希¹, 張 海¹, 大田 晁 生¹, 牧原 克典¹, 宮崎 誠一¹	1.名大院工
16:15 - 16:30	E 12p-A20-9	Atomic Characterization of Si Nanocrystals Embedded in $\mathrm{SiO}_2$ Matrix by Atom Probe Tomography	○(DC)Bin Han¹, Yasuo Shimizu¹, Koji Inoue¹, Gabriele Seguini², Michele Perego², Yasuyoshi Nagai¹	1.IMR Tohoku Univ., 2.IMM-CNF
16:30 - 16:45	12p-A20-10	${ m CeO}_2$ ナノ粒子上へ選択的結晶成長させたアナターゼ型 ${ m TiO}_2$ の結晶構造	○北條 大介¹, 阿尻 雅文¹	1.東北大WPI-AIMR
16:45 - 17:00	12p-A20-11	シリコンナノ結晶ソリッドにおけるナノ結晶間相互作用(II)	○古田 健太¹, 杉本 泰¹, 今北 健二¹, 藤 井 稔¹	1.神戸大院工
17:00 - 17:15	12p-A20-12	シリコンナノ結晶コロイド塗布薄膜の形成と評価 (II)	○佐々木 誠仁¹, 杉本 泰¹, 加納 伸也¹, 今北 健二¹, 藤井 稔¹	1.神戸大院工
17:15 - 17:30		休憩/Break		
17:30 - 17:45	12p-A20-13	ポストレーザー照射によるナノ結晶 Si コロイドの発光波長制御	○(B)渡邊 幹太¹, 袁 澤¹, 中村 俊博¹, 安 達 定雄¹	1.群馬大理工
17:45 - 18:00	12p-A20-14	シリコン切粉からのシリコンナノバーティクルの作製と応用	○松本 健俊 <sup>13</sup> , 前田 譲章 <sup>13</sup> , 喜村 勝矢 <sup>13</sup> , 松田 真輔 <sup>13</sup> , 小林 悠輝 <sup>13</sup> , 今村 健太郎 <sup>13</sup> , 金谷 弥生 <sup>23</sup> , 肥後 徹 <sup>23</sup> , 小林 光 <sup>13</sup>	1.阪大産研, 2.日新化成, 3.CREST-
18:00 - 18:15	12p-A20-15	自己組織化多孔質誘電体薄膜を用いた周期的孤立ナノ金属構造 の形成	○今里 真之¹, 塚本 新¹	1.日大理工
18:15 - 18:30	12p-A20-16	静電気放電による樹脂系粉体の最小着火エネルギーにバージ用窒素 濃度が及ぼす影響	○崔 光石¹, 西村 浩次郎²	1.安衛研, 2.産業安全技術協会

3月13日	(金) 16:30 - 18	:30		
	13p-P12-1	白色発光を伴う水蒸気酸化GaAs/AlGaAs ヘテロ構造ナノワイヤ	○石川 史太郎¹, 日比 秀昭², 山本 直紀³	1.愛媛大院理工, 2.阪大院工, 3.東 大院理工
	13p-P12-2	Si(111)基板上GaAsBiナノワイヤの分子線エピタキシャル成長	○赤松 良彦¹, 石川 史太郎¹, 下村 哲¹	1.愛媛大院理工
	13p-P12-3	InGaN/InGaN多重積層構造ナノワイヤおよびIn偏析に関する検討	○堤 裕理¹, 木津 良祐¹, 本田 善央¹, 天 野 浩¹²	1.名大工, 2.赤崎記念研究センター
	13p-P12-4	自己触媒VLS法によるInPナノワイヤのTMI供給量依存性	○(B)朝倉 啓太¹, 荻野 雄大¹, 下村 和彦¹, 和保 孝夫¹	1.上智大理工
	E 13p-P12-5	$\boldsymbol{H}_{\!\scriptscriptstyle 2}$ Annealing for Improving of Si Nanowire-based Solar cells	○Wipakorn Jevasuwan¹, Kiyomi Nakaji- ma¹, Yoshimasa Sugimoto¹, Naoki Fukata¹	1.NIMS
	E 13p-P12-6	Structural control of Ge/Si core/shell nanowire	Minke Yu¹.², ○Wipakorn Jevasuwan¹, Naoki Fukata¹	1.NIMS, 2.Univ. of Tsukuba
	13p-P12-7	Auナノ粒子を用いたSiナノコーンの形成と反射率特性の評価	○(M1C)田中 規寬¹, 近藤 彰人¹, 清水 智弘 ¹, 新宮原 正三¹	1.関西大
	13p-P12-8	Siナノワイヤの熱電特性に関する理論的検討: 構造多形の影響	○(M1)菰田 貴都¹, 秋山 亨¹, 中村 浩次¹, 伊藤 智徳¹	1.三重大院工
	13p-P12-9	リチウムイオン電池負極材料に向けた ゲルマニウムナノワイヤ形成法 へのウエットエッチング法の導入	○伊藤 和希¹, 呂 志強¹, 山浦 大地¹, 荻 野 俊郎¹.²	1.横国大, 2.CREST/JST
	13p-P12-10	エレクトロスピニング法によるPolyamide 6極細ナノファイバーの透明 電極への応用	○(B)竹中 一生¹, 真部 研吾¹, 深田 健太¹, 能登屋 桃子¹, 白鳥 世明¹	1.慶大理工
	13p-P12-11	Nb:TiO。ナノファイバを含む原料液を用いた電界紡糸法の開発と色素 増感太陽電池への応用	○郭 世栄¹, 今田 慎二¹, 堀江 雄二¹, 野見 山 輝明¹	1.鹿児島大院理工
	13p-P12-12	${ m TiO_2}$ ナノ粒子/ ${ m WO_3}$ ナノファイバ交互積層法による光蓄電電極の作製	○(M1C)田畑 寿樹¹, 荒川 大樹¹, 野見山 輝明¹, 堀江 雄二¹	1.鹿児島大院理工
	13p-P12-13	微小空間に閉じ込め加熱された金属の挙動解析	○運天 政貴¹, 徳永 智春³, 吉田 弥伸¹, 飯 島 徹¹, 上杉 祐生¹, 西川 亘¹, 山下 善文 ¹, 林 靖彦¹	1.岡山大院自然, 2.名古屋大院工
	13p-P12-14	$ZnAl_2O_4$ ナノ粒子の2液プリカーサーからの水熱合成	○石井 聡¹, 古澤 崇哉¹, 中根 茂行²	1.東京電機大理工, 2.物材機構
	13p-P12-15	真空蒸着法による有機溶媒中での金ナノ粒子の合成	○藤田 朗人¹, 松本 雄介¹, 竹内 光明¹, 龍頭 啓充¹, 高岡 義寛¹	1.京大光電子理工セ
	13p-P12-16	静電吸着法を利用した微粒子集積化II	安東 優輝 <sup>1</sup> , ○前田 篤志 <sup>1</sup> , 武藤 浩行 <sup>2</sup> , 松 田 厚範 <sup>2</sup>	1.府大高専, 2.豊橋技科大

9.3 ナノエレクトロ	9.3 ナノエレクトロニクス / Nanoelectronics ポスター講演						
3月13日(金	16:30 - 18:3	30					
	13p-P13-1	非局所測定法を用いた超伝導Alのスピン拡散長評価	○佐藤 孝幸¹, 滝口 将志¹, 島田 宏¹, 水 柿 義直¹²	1.電通大院 情報理工, 2.CREST-JST			
	奨·E 13p-P13-2	Vertical Phase Separation and Light-Soaking Improvements by Active Layer Spin Coating Initiation Time Control in Air-Pro- cessed Inverted Organic Solar Cells	○(D)Il Jeon¹, Yutaka Matsuo¹	1.The Univ. of Tokyo			
	13p-P13-3	低ダメージGaAs系ナノ構造形成のための高精度ウェットエッチング 技術の開発	○黒田 亮太1.2, 佐藤 将来1.2, 葛西 誠也1.2	1.北大量子集積センター, 2.北大院情報科学			
	13p-P13-4	高温環境下における白金ナノギャップ電極の抵抗値保持特性	○菅 洋志¹, 柏原 翔太¹, 塚越 一仁², 清水 哲夫³, 内藤 泰久³	1.千葉工大, 2.物材機構, 3.産総研			

3月14日(土	) 9:00 - 11:4	5		
	,			
9:00 - 9:15	14a-A20-1	軍隊ガニの挙動に学ぶ単電子論理回路の構造検討	○(M1)浜名 良樹¹, 大矢 剛嗣¹	1.横国大院工
9:15 - 9:30	14a-A20-2	細胞性粘菌に学ぶ単電子情報処理回路	○(B)里見 航汰¹, 大矢 剛嗣¹	1.横国大理工
9:30 - 9:45	14a-A20-3	熱雑音を利用する神経細胞軸索の単電子回路化と評価	○(M1)平島 諒¹, 大矢 剛嗣¹	1.横国大院工
9:45 - 10:00	奨 14a-A20-4	単電子連想記憶回路の設計と評価	○(B)高野 誠¹, 大矢 剛嗣¹	1.横国大理工
10:00 - 10:15	E 14a-A20-5	Stochastic Resonance in Single-Electron Inverter Improved by Attachment of Input Discretizer	○(D)Huong Tran¹, Hiroshi Shimada¹, Yoshinao Mizugaki¹.²	1.The Univ. of Electro-Commun tions, Tokyo, 2.CREST, JST
10:15 - 10:30		休憩/Break		
10:30 - 10:45	E 14a-A20-6	Fabrication and Characterization of Coupled Quantum Dots in Ge/Si Core/Shell Nanowires	○(P)Rui Wang¹, Kenji Wada¹.⁴, Russell S. Deacon¹.², Jun Yao³, Charles M. Lieber³, Koji Ishibashi¹.²	1.RIKEN, 2.RIKEN-CEMS, 3.H. Univ., 4.Chiba Univ.
10:45 - 11:00	14a-A20-7	ダブルLC共振回路を用いた高速FETセンサ	○西口 克彦¹, 山口 浩司¹, 藤原 聡¹, Zant Herre², Steele Gary²	1.NTT物性研, 2.デルフト工科大会
11:00 - 11:15	14a-A20-8	ナノ表面電荷ダイナミクス評価にむけた金属短針によるGaAsナノワイ ヤ表面局所電位変調の基礎的検討	○佐藤 将来 <sup>1,2</sup> , 殷 翔 <sup>1,2</sup> , 黒田 亮太 <sup>1,2</sup> , 井上 慎也 <sup>1,2</sup> , 葛西 誠也 <sup>1,2</sup>	1.北大量集センター, 2.北大院情幸
11:15 - 11:30	14a-A20-9	リアルタイムOSを用いたFCE法によるAuナノワイヤの高精度エレクトロマイグレーション制御による狭窄化	○佐藤 秀亮¹, 金丸 祐真¹, 加藤木 悠¹, 白樫 淳一¹	1.東京農工大院工
11:30 - 11:45	14a-A20-10	FPGAを用いた高速エレクトロマイグレーションによるAuナノワイヤの 狭窄化とコンダクタンスの制御	○加藤木 悠¹, 金丸 祐真¹, 佐藤 秀亮¹, 白樫 淳一¹	1.東京農工大院工
3月14日(土	) 13:00 - 14:	45		
13:00 - 13:15	14p-A20-1	ナノギャップを利用した単電子トランジスタの作製と電気的特性の 検討	○加瀬 捋¹, 森原 康平¹, 岡田 憲昂¹, 白 樫 淳一¹	1.東京農工大学院工
13:15 - 13:30	14p-A20-2	直列に接続されたナノギャップでの通電による単電子トランジスタの 同時一括作製	○岡田 憲昂¹, 森原 康平¹, 加瀬 将¹, 伊藤 光樹¹, 白樫 淳一¹	1.東京農工大学院工
13:30 - 13:45	14p-A20-3	蒸着中エレクトロマイグレーション法を用いた精密ナノギャップ作製	○内藤 泰久¹, 堀川 昌代¹, 石田 敬雄¹	1.産総研ナノシステム
13:45 - 14:00	奨·E 14p-A20-4	Thermoelectric Effect of Thiophene-based Tripodal Molecular Iunctions	○(P)SeeKei Lee <sup>1</sup> , Yutaka Ie <sup>2</sup> , Yoshio Aso <sup>2</sup> , Ryo Yamada <sup>1</sup> , Hirokazu Tada <sup>1</sup>	1.Osaka Univ., 2.ISIR, Osaka Ur

14:00 - 14:15	奨 14p-A20-5	ナノギャップ電極により誘起された高強度THz局所電場と単一分子と の量子的相互作用	○吉田 健治¹, 柴田 憲治², 平川 一彦¹	1.東大生研・ナノ量子機構, 2.東北工大
14:15 - 14:30	14p-A20-6	電極幅の狭いナノギャップ電極の作製	○大沼 悠人¹, 東 康男¹, 真島 豊¹	1.東工大応セラ研
14:30 - 14:45	14p-A20-7	ボルフィリン誘導体保護金ナノ粒子を用いたボトムアップ単電子トラ ンジスタ	○東 康男¹, 坂本 雅典², 寺西 利治², 真 島 豊¹	1.東工大応セラ, 2.京大化研

党電変換 / II	nermoelectric	conversion		
3月12日(木)	9:00 - 12:30			
9:00 - 9:15	12a-A22-1	ポリスチレンマトリックスを用いることによるカーボンナノチューブ膜の 熱電特性の向上	○末森 浩司¹, 渡邉 雄一¹, 星野 聰¹	1.産総研
9:15 - 9:30	12a-A22-2	ボロンカーバイドナノワイヤの構造と熱電特性	○桐原 和大¹, 向田 雅一¹, 清水 禎樹¹	1.産総研ナノシステム
9:30 - 9:45	E 12a-A22-3	Thermal conductivity reduction mechanism in Si 1D phononic crystals at room temperature	○(DC)Jeremie Maire <sup>1,2</sup> , Takuma Hori <sup>3</sup> , Junichiro Shiomi <sup>3</sup> , Masahiro Nomura <sup>1,4</sup>	1.IIS, Univ. of Tokyo, 2.LIMMS, 3.Univ. of Tokyo, 4.Nanoquine
9:45 - 10:00	奨 12a-A22-4	Si中エピタキシャルGeナノドットを用いた熱抵抗制御	○(DC)山阪 司祐人¹, 中村 芳明¹², 上田 智広¹, 竹内 正太郎¹, 酒井 朗¹	1.阪大院基礎工, 2.さきがけ-JST
10:00 - 10:15	12a-A22-5	非対称シリコンナノ構造における熱伝導に関する研究	○鹿毛 雄太¹, 萩野 春俊², 宮崎 康次², Maire Jeremie³, 野村 政宏¹.⁴	1.東大生研, 2.九工大院, 3.東大 LIMMS, 4.東大ナノ量子機構
10:15 - 10:30	12a-A22-6	共ドープナノ構造SOI層のゼーベック係数に関する考察	○鈴木 悠平 <sup>1,2</sup> , ファイズ サレ <sup>1,2</sup> , 下村 勝 <sup>2</sup> , 鎌倉 良成 <sup>3</sup> , 池田 浩也 <sup>1,2</sup>	1.静大電研, 2.静大院工, 3.阪大院
10:30 - 10:45		休憩/Break		
10:45 - 11:00	12a-A22-7	基板貼り合わせ法で作製したp型GOI層のゼーベック係数	○池田 浩也', ベラッパン マニムス', ムスサミオムブラカシュ', 鈴木 悠平', ファイズ サレ', ムカンナン アリバナンドハン', 鎌倉 良成², 早川 泰弘'	1.静大電研, 2.阪大院工
11:00 - 11:15	12a-A22-8	マルチスケールフォノンブロッキングによる熱伝導の低減効果	○野村 政宏 <sup>1,2</sup> , 鹿毛 雄太 <sup>1</sup> , 中川 純貴 <sup>1</sup> , Maire Jeremie <sup>1</sup> , Moser Dominik <sup>3</sup> , Paul Oliver <sup>3</sup>	1.東大生研, 2.東大ナノ量子機構, 3 ライブルク大
11:15 - 11:30	奨 12a-A22-9	スパッタリング法によるCa-Si膜の作製と熱電特性評価	○上原 睦雄', 新井 洋樹', 小川 正太', 秋山 賢輔'², 松島 正明', 内田 寬³, 木村 好里', 舟窪 浩'	1.東工大院, 2.神奈川県産業技術+ 3.上智大
11:30 - 11:45	12a-A22-10	単結晶Si二次元フォノニック結晶における熱伝導率の空隙率依存性	○中川 純貴¹, 鹿毛 雄太¹, Jeremie Maire², 野村 政宏¹.3	1.東大生研, 2.LIMMS, 3.ナノ量子
11:45 - 12:00	奨·E 12a-A22-11	Impact of the phononic structure design on the reduction of thermal conductivity	○(P)Roman Anufriev¹, Masahiro Nomura¹.²	1.IIS, Univ. of Tokyo, 2.Nanoquir Univ. of Tokyo
12:00 - 12:15	12a-A22-12	CoSb <sub>3</sub> の価電子帯の非放物線性に起因するHall因子の強い温度依存性	○梶川 靖友¹	1.島根大総合理工
12:15 - 12:30	奨 12a-A22-13	キャリア運動の有効次元数による熱電特性の評価	〇井上 裕之¹, 大杉 功¹, 小林 隆秀¹, 米 田 征司²	1.テックスイージー, 2.神奈川大学
3月12日(木)	14:00 - 18:0	0		
14:00 - 14:15	12p-A22-1	第一原理計算に基づく半導体のゼーベック係数シミュレーション	○中村 康一1.2	1.京大学際センター, 2.エジプト日本 科技大
14:15 - 14:30	12p-A22-2	バルク熱電材料のゼーベック係数・抵抗率・熱拡散率の同時測定	○(M1)本間 亮英¹, 寺門 宏樹¹, 長谷川 靖 洋', 村田 正行², 山本 淳², 小峰 啓史³, 森 田 寛之⁴	1.埼玉大学, 2.産総研, 3.茨城大学 玉県産総センター
14:30 - 14:45	12p-A22-3	${\rm SrTiO_3}$ 単結晶における光照射下での輸送特性	○(M1)白石 祐芽¹, 岡崎 竜二¹, 谷口 博基¹, 寺崎 一郎¹	1.名大院理
14:45 - 15:00	12p-A22-4	CaTiO <sub>3</sub> の異方性による熱電特性への影	西條 泰紹', 〇白井 光雲'	1.阪大産研
15:00 - 15:15	12p-A22-5	ハーマン法による酸化物材料の熱伝導率測定	○掛本 博文¹, 河野 拓人², 入江 寬¹²	1.山梨大学 クリーンエネルギー研学 ンター, 2.山梨大学 大学院医学工会 合教育部
15:15 - 15:30	12p-A22-6	非対角熱電効果による $Ca_xCoO_2$ 薄膜からのテラヘルツ電磁波発生	○高橋 宏平', 菅野 勉', 酒井 章裕', 玉置 洋正', 草田 英夫', 山田 由佳'	1.パナソニック
15:30 - 15:45	12p-A22-7	Na-Ga-Sn系ジントル化合物の結晶構造と熱電特性評価	○山田 高広¹, 永井 秀明², 山根 久典¹	1.東北大多元研, 2.産総研
15:45 - 16:00		休憩/Break		
16:00 - 16:15	12p-A22-8	シリサイド熱電モジュールの長期耐久性に関する研究	○舟橋 良次¹, 松村 葉子¹, 鈴木 亮輔², 勝山 茂³, Barbier Tristan¹, Combe Emmanuel¹	1.産総研, 2.北大工, 3.阪大工
16:15 - 16:30	12p-A22-9	Chimney-ladder型MnSi <sub>y</sub> 相における遷移金属の微量置換効果	○宮崎 譲', 菊池 祐太', 濱田 陽紀', 林 慶'	1.東北大院工
16:30 - 16:45	12p-A22-10	構成元素MnをReで部分置換した高マンガンシリサイドの熱電物性	○山本 晃生¹, 広石 尚也², 竹内 恒博¹.3	1.豊田工大, 2.名大工, 3.JSTさきが
16:45 - 17:00	12p-A22-11	W を過剰に固溶させた高マンガンシリサイド $\mathbf{MnSi}_{_{\gamma}}$ の熱電物性 II	○竹内 恒博1.2, 広石 尚也3	1.豊田工大, 2.JSTさきがけ, 3.名大
17:00 - 17:15	12p-A22-12	3ω 法を用いたMnSi <sub>γ</sub> リボン状試料の熱伝導率測定	○(D)西野 俊佑¹, 広石 尚也², 宮田 全展¹, 大平 圭介¹, 小矢野 幹夫¹, 竹内 恒博³.⁴	1.北陸先端大, 2.名大工, 3.豊田工 4.JST-さきがけ
17:15 - 17:30	奨·E 12p-A22-13	Effect of silicon nano particles on thermoelectric properties of higher manganese silicide	○(D)Swapnil ghodke¹, Akio yamamoto², Hiroshi Ikuta¹, Tsunehiro Takeuchi².³	1.Nagoya Univ., 2.Toyota Tech. In 3.PRESTO
17:30 - 17:45	E 12p-A22-14	Thermoelectric properties enhancement of a silicon-based compound by synthesis optimization and cationic substitution	○(PC)Tristan Barbier¹, Ryoji Funahashi¹, Emmanuel Combe¹, Tomonari Takeuchi¹, Ryosuke O. Suzuki², Atsuko Kosuga³	1.AIST Kansai, 2.Hokkaido Unive 3.Osaka Prefecture
17:45 - 18:00	12p-A22-15	層状無機有機ハイブリッド単結晶における熱電特性	○田中 寛人¹, 笹川 崇男¹	1.東工大応セラ研
3月13日(金)	9:00 - 12:30			
9:00 - 9:15	13a-A22-1	$Cu_2ZnSnS_4$ の大気中での高温安定性と熱電特性	○小菅 厚子¹, 松沢 美恵¹, 舟橋 良次²	1.阪府大・ナノ, 2.産総研・ユビキタフ
9:15 - 9:30	奨 13a-A22-2	不定比化合物Ag $_{0.37}\mathrm{Cr}_{1.21}\mathrm{X}_2~(\mathrm{X}=\mathrm{S},\mathrm{Se})$ 単結晶の熱電特性	○(DC)矢野 カ三¹, 笹川 崇男¹	1.東工大 応セラ研
9:30 - 9:45	13a-A22-3	Fe置換ウルマナイトの電子物性と第一原理電子状態計算	○(M2)宮田 全展¹, 尾崎 泰助¹², 西野 俊佑¹, 小矢野 幹夫¹	1.北陸先端大, 2.東大物性研
9:45 - 10:00	13a-A22-4	Mg,(Si,Ge,Sn)粉末の低温固相合成とその焼結体の評価	○ブンダリッヒ ビルフリド¹, 浦川 亮一², 鈴木	1.東海大工 材料, 2.東海大工 応用

10:00 - 10:15	奨 13a-A22-5	$Mg_{2+s}Si$ の格子間サイトにおける $Mg$ の定量的評価	○窪内 将隆¹, 小川 陽平¹, 林 慶¹, 髙松 智寿¹, 宮崎 讓¹	1.東北大院工
10:15 - 10:30	13a-A22-6	強い相対論効果を有するMg <sub>3</sub> Bi <sub>2</sub> の単結晶育成と熱電特性評価	○岩橋 直哉¹, 加納 学¹, 笹川 崇男¹	1.東工大応セラ研
10:30 - 10:45	13a-A22-7	層状窒化物 $\operatorname{SrMN}_2(M=Zr,\ Hf)$ の電子状態と熱電輸送特性の $3$ 次元性	○大久保 勇男¹, 森 孝雄¹	1.物材機構
10:45 - 11:00		休憩/Break		
11:00 - 11:15	13a-A22-8	タイプ2構造Snクラスレートの電子状態に対する元素添加効果	○赤井 光治¹, 岸本 堅剛¹, 小柳 剛¹, 山本 節夫¹	1.山口大
11:15 - 11:30	奨 13a-A22-9	type-IIクラスレート化合物 $K_s$ B $a_{1o}$ A $l_{4o}$ S $n_{9o}$ の作製と熱電気的特性	○宇都宮 卓¹, 幸田 翔大¹, 岸本 堅剛¹, 赤井 光治¹, 浅田 裕法¹, 小柳 剛¹	1.山口大院理工
11:30 - 11:45	13a-A22-10	クラスレート化合物を用いたセグメント型素子の熱電発電特性	土谷 陽平¹, 岸本 堅剛¹, 石川 雄基¹, 赤井 光治¹, 浅田 裕法¹, ○小柳 剛¹	1.山口大院理工
11:45 - 12:00	E 13a-A22-11	Improving thermoelectric performances of n-type Bi-Sb alloys by post treatment after pulse electric current sintering (SPS)	○(P)Emmanuel Combe¹, Ryoji Fu- nahashi¹, Tristan Barbier¹, Tomonari Takeuchi¹, Kunio Yubuta²	1.AIST Kansai, 2.Tohoku University
12:00 - 12:15	13a-A22-12	焼結法により作製したBi-Sb合金の磁場中の熱電物性	○村田 正行¹, 山本 淳¹, 長谷川 靖洋², 小 峰 啓史³	1.産業技術総合研究所, 2.埼玉大, 3.茨 城大
12:15 - 12:30	13a-A22-13	Bi <sub>2</sub> Te <sub>3</sub> 熱電微粒子から作製したバルク体の熱電特性	○(M2)大熊 高光', 水谷 慎吾', 林 祐司', 宮田 全展', 西野 俊佑', 小矢野 幹夫', 田中哲史², 福田 克史²	1.北陸先端大, 2.KELK

3月13日(金)	16:30 - 18:	30		
	奨 13p-P14-1	塑性成形法によるカルシウム・コバルト酸化物熱電材料の作製に関する研究	○杉山 泰庸¹, 奥山 剛史¹, 小川 清², 田橋 正浩¹, 高橋 誠¹, 後藤 英雄¹	1.中部大学, 2.オザワ科学株式会社
	奨 13p-P14-2	カルシウム・コバルト酸化物熱電材料の結晶相と熱電特性におよぼ す焼成条件の影響	○鬼頭 知希¹, 奥山 剛¹, 小川 清², 田橋 正浩¹, 高橋 誠¹, 後藤 英雄¹	1.中部大学, 2.オザワ科学株式会社
	奨 13p-P14-3	a-InGaZnO薄膜の熱電特性評価	○(M1)藤本 裕太¹, 上沼 睦典¹, 石河 泰明 ¹, 浦岡 行治¹	1.奈良先端大
	13p-P14-4	BiCuSeOへの二価元素置換効果とその熱電性能	○(M1)水野 州¹, 内藤 智之¹, 藤代 博之¹	1.岩手大工
	13p-P14-5	第一原理計算によるCaMnO <sub>3</sub> の電子状態に及ぼす元素置換の影響	○小杉山 雄基¹, 谷林 慧², 中村 雄一¹, 井 上 光輝¹	1.豊橋技術科学大学, 2.一関高専
	13p-P14-6	バナジウム酸化物ナノワイヤーを用いた塗布型熱電変換素子	○荒木 圭一¹, 樋口 章二¹	1.(株)KRI
	13p-P14-7	ZnOナノ粒子を添加したZn <sub>4</sub> Sb <sub>3</sub> 熱電材料の作製と特性評価	○田橋 正浩¹, 苑 軼², 小川 清³, 高橋 誠¹, 王 強², 後藤 英雄¹	1.中部大学, 2.中国東北大学, 3.オザ 科学株式会社
	13p-P14-8	格子ひずみを負荷したビスマステルライド薄膜の電子輸送特性	○稲本 拓也¹, 高尻 雅之¹	1.東海大工
	13p-P14-9	ビスマステルライド系熱電半導体ナノブレートの製作と評価	○甲斐 真太郎¹, 高杉 壮一², 冨田 恒之³, 高尻 雅之¹	1.東海大工, 2.東海大院総理工, 3.東 海大理
	13p-P14-10	Effect of Phonon Boundary Scattering on Seebeck Coefficient in Silicon Thin Films	○Indra Nur Adisusilo¹, Faiz Salleh², Hiroya Ikeda², Yoshinari Kamakura¹	1.Osaka University, 2.Shizuoka University
	奨 13p-P14-11	$\mathrm{Ba_{s}Al_{16}Si_{30}}$ 系クラスレートにおける同時ドーピング効果	○(M1C)上田 貴大¹, 佐久間 裕教¹, 阿武 宏明¹	1.山口東理大工
	13p-P14-12	$Ba_{s}Al_{16}Si_{30}$ 系クラスレート焼結体の機械的特性	○阿武 宏明¹, 上田 貴大¹, 平田 柊作², 藤田 恒輝¹, 飯田 努². 向後 保雄²	1.山口東理大工, 2.東理大基礎工

3月11日(水	.) 10:00 - 11:4	15		
10:00 - 10:15	奨·E 11a-A20-1	Removal of BTEX Compounds From Concentrated Solutions Using Carbene Generating Gels	○(M1)Brian Omondi¹, Hirotaka Okabe¹, Yoshiki Hidaka¹, Kazuhiro Hara¹	1.Kyushu Univ.
10:15 - 10:30	奨 11a-A20-2	帯電膜上における液滴のエレクトロウェッティング動作	○田頭 健司¹, 大西 慶治¹, 金子 由利子¹, 石川 貴之¹, 表 篤志¹	1.パナソニック先端研究本部
10:30 - 10:45	奨 11a-A20-3	二層構造を有する新規熱放射材料の開発	○伊藤 真紀¹, 石井 利昭¹, 真田 和昭²	1.日立研, 2.富山県立大
10:45 - 11:00	11a-A20-4	リモート水素プラズマ支援によるTaナノドットの高密度一括形成	○王 亜萍¹, 牧原 克典¹, 大田 晃生², 竹内 大智¹, 宮崎 誠一¹	1.名大院工, 2.名大VBL
11:00 - 11:15	11a-A20-5	金ナノ粒子配列における赤外吸収増大スペクトルのシミュレーション	○中嶋 洋¹, 碇 亜紀彦², 石郷 侑汰², 津島 将導², 熊谷 遊太³, 島田 透³, 鈴木 裕史¹	1.弘前大院理工, 2.弘前大理工, 3.弘 前大教育
11:15 - 11:30	11a-A20-6	Ag形ゼオライトの励起光依存Photoluminescence	○成田 翔¹, 鈴木 裕史¹, 宮永 崇史¹, 中村 敦¹	1.弘前大理工
11:30 - 11:45	奨·E 11a-A20-7	Study of Adsorption and Desorption of Cs <sup>+</sup> Ions on Chitosan-Grafted Magnetic Bentonite	○(DC)Shubin Yang <sup>1,2</sup> , Naoya Okada <sup>1</sup> , Nagatsu Masaaki <sup>1</sup>	1.Shizuoka University, 2.IPP, CAS, China
3月11日(水	.) 14:00 - 16:3	30		
14:00 - 14:15	11p-A20-1	固体電解質 $A_a$ LiTa $_s$ ZrSi $_4$ O $_{2a}$ ( $A=$ Sr, $Ba$ )中でのLi拡散経路の第一原理計算による解析	○池田 稔¹, 大野 隆央¹, 相見 晃久², 稲熊 宜之², 森 大輔²	1.物質材料研究機構, 2.学習院大理
14:15 - 14:30	奨 11p-A20-2	トポロジカル絶縁体カルコゲナイド薄膜のスパッタ法による高配向 成膜	○齊藤 雄太¹, 富永 淳二¹, 牧野 孝太郎¹, Paul Fons¹, Alexander V. Kolobov¹, 中野 隆志¹	1.産総研
14:30 - 14:45	11p-A20-3	$GeTe/Sb_2Te_3$ 相変化材料の赤外線・ $THz$ 波検出器応用に向けた研究	○牧野 孝太郎¹, 齊藤 雄太¹, 富永 淳二¹, 中野 隆志¹	1.産総研
14:45 - 15:00	11p-A20-4	P2型Na <sub>x</sub> MO <sub>2</sub> の結晶構造の温度依存性	赤羽 隆弘¹, 柳田 歩¹, ○小林 航¹², 守 友 浩¹²	1.筑波大数理, 2.学際物質科学研究-ンター
15:00 - 15:15		休憩/Break		
15:15 - 15:30	11p-A20-5	$\operatorname{Gd}_{{}_{x}Y_{1_{x}}H_{2}}(0 \ll x \ll 1)$ のホール抵抗および磁気抵抗	○工藤 駆¹, 酒井 政道¹, 桜庭 琢士¹, 春山 翔太¹, 北島 彰², 大島 明博², 樋口 宏二², 長 谷川 繁彦²	1.埼大院理工, 2.阪大産研
15:30 - 15:45	11p-A20-6	$\operatorname{Gd}_{\mathbf{x}} \mathbf{Y}_{1:\mathbf{x}} \mathbf{H}_{2} (0 \leq \mathbf{x} \leq 1)$ における磁性の $\operatorname{Gd}$ 濃度依存性	〇桜庭 琢士¹, 酒井 政道¹, 本多 善太郎¹, 工藤 駆¹, 樋口 宏二², 北島 彰², 大島 明博², 長谷川 繁彦², 中村 修³	1.埼大院理工, 2.阪大産研, 3.岡山理 科大

15:45 - 16:00	11p-A20-7	スカンジウム二水素化物(ScH <sub>2</sub> )の作製とホール効果	〇松永 智善 <sup>1</sup> , 酒井 政道 <sup>1</sup> , 樋口 宏二 <sup>2</sup> , 北島 彰 <sup>2</sup> , 大島 明博 <sup>2</sup> , 長谷川 繁彦 <sup>2</sup>	1.埼大院理工, 2.阪大産研
16:00 - 16:15	11p-A20-8	高保磁力層状コバルト水酸化物の磁性と構造	○穴井 克樹', 中村 哲也', 萩原 政幸', 木 田 孝則', 奧谷 顕', 香取 浩子', 太田 寛人 <sup>3</sup> , 酒井 政道', 福田 武司', 鎌田 憲彦', 本 多 善太郎'	1.埼玉大学院理工学, 2.阪大先端強磁場, 3.東京農工大院工
16:15 - 16:30	11p-A20-9	金属フタロシアニンを基にした磁性炭素材料の合成と磁性	〇佐藤 峻¹, 武藤 祐太¹, 萩原 政幸², 木田孝則², 酒井 政道¹, 福田 武司¹, 鎌田 憲彦¹, 本多 善太郎¹	1.埼玉大院理工, 2.阪大先端強磁場

9.5	9.5 新機能材料・新物性 / New functional materials and new phenomena ポスター講演					
	3月12日(木) 13:30 - 15:30					
		12p-P5-1	3元タリウム化合物における光誘起変形の照射光スポット形状効果	○(M1)今西 慎¹, 沈 用球¹, 脇田 和樹², Mamedov Nazim³	1.阪府大院工, 2.千葉工大工, 3.アゼル バイジャン科学アカデミー	
		12p-P5-2	エアロゾルデポジション法によるゼオライト膜の作製	○飯塚 一智¹, 湯澤 修孝¹, 加藤 栄¹, 廣瀬 伸吾², 明渡 純², 松本 泰治¹	1.栃木産技セ, 2.産総研	
		12p-P5-3	熱制御用マンガン酸化物結晶のバンド・フィリング制御	○村上 良明¹, 太刀川 純孝³, 齋藤 智彦², 桑原 英樹¹	1.上智大理工, 2.東理大理, 3.ISAS/ JAXA	

ピントロニク	ス・マグネティ	クス / Spintronics and Magnetics	ポスター講演	
3月11日(水)	13:30 - 15:3	30		
	E 11p-P1-1	Magnetic tunnel junctions with alloys of Fe and 4f rare-earth metals	○(M1)Kazuhito Tanaka¹, Shinji Miwa¹, Norikazu Mizuochi¹, Yoshishige Suzuki¹	1.Osaka Univ.
	11p-P1-2	Voltage induced magnetic anisotropy change in FePt	○(M1)松田 健彰¹, 三輪 真嗣¹, 野崎 隆行², 湯浅 新治², 水落 憲和¹, 鈴木 義茂¹²	1.阪大院基礎工, 2.産総研ナノスピン
	E 11p-P1-3	Fabrication of MTJ array for bio-magnetic field sensor	⊙Mikihiko Oogane¹, Sabri Cakir¹, Daiki Kato¹, Kosuke Fujiwara¹, Hiroshi Naganu- ma¹, Yasuo Ando¹	1.Tohoku Univ.
	11p-P1-4	磁場センサ型MTJ実現のためのピン層IrMn膜厚および熱処理温 度最適化	○木村 豪¹, 藤原 耕輔¹, 大兼 幹彦¹, 永沼博¹, 安藤 康夫¹	1.東北大院工
	E 11p-P1-5	Magnetic Tunnel Junctions with Amorphous CoFeSiB Free Layer for Highly Sensitive Magnetic Field Sensor Devices	○Daiki Kato¹, Mikihiko Oogane¹, Kosuke Fujiwara¹, Junichi Jouno², Hiroshi Naganu- ma¹, Hiroyuki Katsurada², Yasuo Ando¹	1.Tohoku Univ., 2.Konicaminolta
	E 11p-P1-6	Magnetic tunnel junction with perpendicularly magnetized sensing layer for magnetic sensor with small nonlinearity and large sensing range	○(D)Takafumi Nakano¹, Mikihiko Oogane¹, Hiroshi Naganuma¹, Yasuo Ando¹	1.Tohoku Univ.
	奨·E 11p-P1-7	Resistive Switching induced Multi-State Tunnel Magneto-Resistance in Wurtzite-MgZnO MTJs	○(PC)Mohamed Belmoubarik¹, Muftah Al-Mahdawi¹, Hideyuki Sato¹, Tomohiro Nozaki¹, Masashi Sahashi¹	1.Tohoku Univ.
	11p-P1-8	800 °Cでアニーリングされた $In_{0.8}Ga_{0.2}As_{0.45}P_{0.55}$ におけるスピン緩和の観測	○ショウ サンウ <sup>1</sup> , 原澤 遼 <sup>1</sup> , 安江 雄也 <sup>1</sup> , Wu Hao <sup>1</sup> , 有竹 貴紀 <sup>1</sup> , Lu Shulong <sup>2</sup> , Ji Lian <sup>2</sup> , 竹内 淳 <sup>1</sup>	1.早大先進理工, 2.中国科学院
	奨 11p-P1-9	$GaIn_{0.36}N_{0.006}AsSb_{0.015}/GaN_{0.01}AsSb_{0.11}/GaAs量子井戸のスピン緩和$	○浅川 将輝 <sup>1</sup> , 本多 一輝 <sup>1</sup> , 山本 直輝 <sup>1</sup> , Lianhe Li <sup>2</sup> , Harmand Jean-Christoph <sup>3</sup> , Shulong Lu <sup>4</sup> , 竹内 淳 <sup>1</sup>	1.早大理工, 2.Leeds Univ., 3.LPN-CNRS, 4.SINANO-CAS
	E 11p-P1-10	Effect of growth conditions on carrier and spin lifetimes in (001) GaAs/AlGaAs quantum wells	○Satoshi Iba¹, Hidekazu Saito¹, Ken Watanabe², Yuzo Ohno², Shinji Yuasa¹	1.AIST, 2.Univ. of Tsukuba
	E 11p-P1-11	Investigation of gate controllability in InGaAs/InAlAs double quantum wells towards the spin-filter application	OTakashi Yamashige <sup>1</sup> , Atsushi Sawada <sup>1</sup> , Shoichiro Yokota <sup>1</sup> , Hang Chen <sup>1</sup> , Bolin Liu <sup>1</sup> , Hiroki Sugiyama <sup>2</sup> , Yoshiaki Sekine <sup>3</sup> , Takaaki Koga <sup>1</sup>	1.GSIST Hokkaido Univ., 2.NTT D vice Technology Laboratories, 3.NT Basic Research Laboratories
	E 11p-P1-12	Simulation of Holographic Imaging based on Magneto-Optical Spatial Light Modulator	○(P)Roman Antos¹², Eva Jesenska¹², Martin Veis², Kenji Machida³, Daisuke Kato³, Hiroshi Kikuchi³, Naoki Shimidzu³, Takayuki Ishibashi¹	1.Nagaoka Univ. of Tech., 2.Charles Univ., 3.NHK Sci. & Tech. Res. Lab
	11p-P1-13	InP基板上に成長したInMnAs薄膜の評価	○林 伸一郎¹, 吉沢 勇人¹, 豊田 英之¹, 中村 新一², 内富 直隆¹	1.長岡技術科学大学, 2.青山学院大学
	11p-P1-14	Ce添加によるSi上Ge三次元ドット成長プロセスの変化	○植野 和也¹, 宮田 祐輔¹, 吉村 武¹, 芦田淳¹, 藤村 紀文¹	1.大阪府大院工
	E 11p-P1-15	The effect of B co-doping on the surface morphology and transport characteristics of Si:Ce films	○(D)Yusuke Miyata¹, Ueno Kazuya¹, Yoshimura Takeshi¹, Ashida Atsushi¹, Fujimura Norifumi¹	1.Osaka Pref. Univ.
	奨 11p-P1-16	強磁性電極 $\text{La}_{0.67}\text{Sr}_{0.32}\text{MnO}_{g}$ 有機物界面のトンネル異方性磁気抵抗効果におけるアニール処理の効果	○宮原 千紘¹, 神谷 建¹, 森田 稜也¹, 夛 田 博一¹	1.阪大基礎工
	E 11p-P1-17	Magnetotransport properties of graphene directly grown on permalloy in CPP configuration	○Shiro Entani¹, Hiroshi Naramoto¹, Seiji Sakai¹	1.JAEA
	E 11p-P1-18	Electronic Structure of Ferromagnetic Semiconductor $Ge_{1\alpha}Fe_{\kappa}$ Studied by Soft X-ray Angle Resolved Photoemission Spectroscopy	○(M2)Shoya Sakamoto¹, Yuki Wakabayas- hi¹, Yukiharu Takeda², Shin-ichi Fujimori², Hakuto Suzuki¹, Hiroshi Yamagami²³, Masaaki Tanaka¹, Shinobu Ohya¹, Atsushi Fujimori¹	1.the Univ. of Tokyo, 2.JAEA, 3.Kyo Sangyo Univ.
	11p-P1-19	全光型磁化反転形成磁区のGdFeCo薄膜隣接層構成依存性	○吉川 大貴¹, 佐藤 哲也¹, 塚本 新¹	1.日大理工
	E 11p-P1-20	Spin-dependent transport property of organic-ferromagnetic hybrid junctions using [6]cyclo-2,7-naphthylenes	OKazuya Suzuki¹, Xiao Xhang¹, Sugihara Atsushi¹, Sato Sota¹.²⁴, Izumi Tomoo²³, Taka Hideo²³, Isobe Hiroyuki¹.²⁴, Mizukami Shigemi¹	1.Tohoku Univ.WPI-AIMR, 2.JST ERATO, 3.Konica Minolta, 4.Tohok Univ. Dept. of Chemistry
	11p-P1-21	Fe酸化物挿入によるMgO上超薄膜FeおよびCo層の磁気特性改善	○野崎 隆行 <sup>1.4</sup> , 大久保 忠勝 <sup>3</sup> , 塩田 陽一 <sup>1.4</sup> , 久保田均 <sup>1.4</sup> , 福島 章雄 <sup>1.4</sup> , 宝野 和博 <sup>2</sup> , 鈴木 義茂 <sup>3.4</sup> , 湯浅 新治 <sup>1.4</sup>	1.産総研, 2.物材機構, 3.阪大基礎工, 4.JST-CREST
	奨·E 11p-P1-22	Fabrication of perpendicular magnetized spin filter junctions	○Hiroki Kajita¹, Takashi Yanase¹, Taro Nagahama¹, Toshihiro Shimada¹	1.Hokkaido Univ.
	奨·E 11p-P1-23	Influence of oxygen pressure on electrical and magnetic properties of $CoFe_2O_4$ thin film	○Masato Araki¹, Takashi Yanase¹, Taro Nagahama¹, Toshihiro Shimada¹	1.Hokkaido Univ.

奨 11p-P1-24	MOD法によりガラス基板上へ作製した $\mathrm{Nd_{05}Bi_{25}Fe_{5y}Ga_{y}O_{12}}$ $(y=0$ ~1) 薄膜の磁気異方性	○婁 庚健¹, 佐々木 教真¹, 加藤 剛志², 岩田 聡², 石橋 隆幸¹	1.長岡技科大, 2.名古屋大
E 11p-P1-25	Magnetocrystalline Anisotropy in $Co_2(Fe_xMn_{1:x})Si$ Heusler Thin Films	OTakeshi Seki <sup>1,2</sup> , Tatsuya Yamamoto <sup>1</sup> , Takahide Kubota <sup>1</sup> , Koki Takanashi <sup>1</sup>	1.IMR, Tohoku Univ., 2.JST-PRESTO
E 11p-P1-26	Heusler ferrimagnetic multilayer with perpendicular magnetic anisotropy	Qinli Ma¹, Xianmin Zhang¹, Terunobu Miyazaki¹, ○Shigemi Mizukami¹	1.WPI-AIMR, Tohoku Univ.
E 11p-P1-27	Exchange bias in bilayers using anti-ferromagnetic $\mathrm{Ni}_2\mathrm{MnAl}$ Heusler alloy thin film	○Tomoki Tsuchiya¹, Tomoko Sugiyama¹, Takahide Kubota¹, Koki Takanashi¹	1.IMR, Tohoku Univ.
11p-P1-28	垂直磁化磁気抵抗素子形成のためのMn <sub>s</sub> Geエピタキシャル薄膜の 表面平坦化	○(PC)杉原 敦¹, 鈴木 和也¹, 宮﨑 照宣¹, 水上 成美¹	1.東北大WPI-AIMR
E 11p-P1-29	Temperature dependence of electric field effect on Magnetic Anisotropy in Pd/Co/Pt system	○(M1)Yuki Hibino¹, Aya Obinata¹, Tomo- hiro Koyama¹, Kazumoto Miwa², Shimpei Ono², Daichi Chiba¹	1.The Univ. of Tokyo, 2.CRIEPI
E 11p-P1-30	Dependence of Curie temperature on Pt underlayer thickness in Co/Pt system	OTomohiro Koyama <sup>1</sup> , Aya Obinata <sup>1</sup> , Yuki Hibino <sup>1</sup> , Atsuhumi Hirohata <sup>2</sup> , Balati Kuer- banjiang <sup>2</sup> , Vlado Lazalov <sup>2</sup> , Daichi Chiba <sup>1</sup>	1.The Univ. of Tokyo, 2.The Univ. of York
11p-P1-31	MOD法によるMgO(100)基板上に作製したCoフェライト薄膜の評価	○佐々木 教真!, 二宮 南!, 鶴井 隆雄!, 篠 崎 健二!, 小松 高行!, 柳原 英人², 喜多 英 治², 石橋 隆幸!	1.長岡技科大, 2.筑波大
E 11p-P1-32	Electric field effect on magnetic moment in Co/Pt using electric double layer capacitor structure	OAya Obinata¹, Daichi Hayakawa¹, Kazumoto Miwa², Shimpei Ono², Tomohiro Koyama¹, Daichi Chiba¹	1.The Univ. of Tokyo, 2.CRIEPI
11p-P1-33	逆ペロブスカイト窒化物交換結合膜における電流誘起磁化スイッ チング	榊原 英樹¹, ○黒木 庸次¹, 安藤 弘紀¹, 河合 俊介¹, 羽尻 哲也¹, 植田 研二¹, 浅野 秀文¹	1.名大院工
11p-P1-34	逆ペロプスカイトCo <sub>3</sub> FeN溥膜の異方性磁気抵抗効果とスピン分極率	○安藤 弘紀¹, 河合 俊介¹, 榊原 英樹¹, 黒木庸次¹, 羽尻 哲也¹, 植田 研二¹, 浅野 秀文¹	1.名大院工
11p-P1-35	形状制御したMn-Znフェライトの高周波特性	○星 和志¹, 茂木 光¹, 福長 隆之², 鈴木 宏輔¹, 古澤 伸一¹, 櫻井 浩¹	1.群馬大理工, 2.東京パーツ工業
11p-P1-36	Fe/MgO接合における磁気緩和の電界効果の第一原理計算	○三浦 良雄¹, 辻川 雅人²³, 白井 正文²₃	1.京都工繊大, 2.東北大通研, 3.東北 大CSIS
E 11p-P1-37	Implementation of phase locked loop using spin torque oscillator as a voltage controlled oscillator	OShingo Tamaru¹, Bochong Wang¹, Hitoshi Kubota¹, Kay Yakushiji¹, Akio Fukushima¹, Shinji Yuasa¹	1.AIST
11p-P1-38	電流誘起磁化反転における電子散乱過程に関する非平衡第一原 理計算	○洗平 昌晃¹, 山本 貴博², 白石 賢二¹	1.名大院工, 2.東理大工
E 11p-P1-39	Effect of High Substrate Temperature Fabrication on Spin Pumping in Polycrystalline Structured Co Films	○Shinji Isogami¹, Shintaro Hinata²	1.Fukushima NCT., 2.Tohoku Univ.
E 11p-P1-40	Study of spin injection into few-layer graphene	○(M2)Dinh Hiep Duong¹, Muruganathan Manoharan¹, Hiroshi Mizuta¹.²	1.JAIST, 2.Univ. of Southampton
E 11p-P1-41	Composition- and cap-layer-dependence of electric-current-in- duced dynamics of bubble domains in TbFeCo wires	○Masaaki Tanaka¹, Hiroki Kanazawa¹, Sho Sumitomo¹, Syuta Honda², Ko Mibu¹, Hiroyuki Awano³	1.Nagoya Inst. of Tech., 2.Univ. of Tsukuba, 3.Toyota Tech. Inst.
11p-P1-42	TbFeCoを電極とした $YH_2$ チャネルの磁気電気伝導特性	○高尾 啓', 松永 智善', 飯笹 圭太郎', 西間木 誠', 酒井 政道', 樋口 宏二², 北島 彰², 大島 明博², 長谷川 繁彦², 兼平 冬馬³, 粟野 博之³	1.埼玉大院理工, 2.阪大産研, 3.豊田 工大
E 11p-P1-43	Temperature dependence of magneto-transport properties in ${\rm Co_2Fe(Ga_{0.5}Ge_{0.5})/Cu}$ lateral spin valves	(D)Ikhtiar Ikhtiar <sup>1,3</sup> , Shinya Kasai <sup>3</sup> , Aki- hide Itoh <sup>2,3</sup> , Yukiko Takahashi <sup>3</sup> , Tadakatsu Ohkubo <sup>2,3</sup> , Seiji Mitani <sup>1,3</sup> , Kazuhiro Hono <sup>1,3</sup>	1.Univ. of Tsukuba, 2.Tokyo Univ.of Science, 3.NIMS
奨 11p-P1-44	新規3端子スピン軌道トルク素子の動作実証	○姉川 哲朗¹, 張 超亮¹, 深見 俊輔²³, 大 野 英夫¹.².³.⁴	1.東北大通研, 2.東北大CSIS, 3.東北大 CIES, 4.東北大WPI-AIMR
E 11p-P1-45	High speed spin dynamics in CoFeB/Ta/CoFeB investigated by optical pump-probe technique	OTatsuya Ito¹, Yuta Sasaki², Shinji Miwa¹, Kohei Nawaoka¹, Tashima Toshiyuki¹, Yoi- chi Shiota¹, Yosuke Wakatake¹, Katsunori Konishi¹, Hiroyuki Tomita¹, Norikazu Mizuochi¹, Shigemi Mizukami², Yoshishige Suzuki¹	1.Osaka Univ., 2.Tohoku Univ., 3.WPI-Tohoku Univ.
E 11p-P1-46	Magnetic resonance of Fe thin-films investigated by the anomalous Hall effect	○Shinji Miwa¹, Norikazu Mizuochi¹, Yoshishige Suzuki¹	1.Osaka Univ.
11p-P1-47	外部磁場中のスピンホール効果に関する古典的運動方程式	○酒井 政道¹	1.埼玉大院理工
11p-P1-48	MOD法により作製したNd系磁性ガーネット薄膜における縦型スピンゼーベック効果	○桑原 惇¹, 浅田 裕法¹, 婁 庚健², 石橋 隆幸², 岸本 堅剛¹, 小柳 剛¹	1.山口大院理工, 2.長岡技科大工
11p-P1-49	スピンゼーベック熱電変換素子の作製と評価	○平田 智士¹, 野田 和希¹, 岡田 一也¹, 雨宮 嘉照¹, 田部井 哲夫¹, 横山 新¹	1.広島大学ナノデバイス・バイオ融合科 学研究所
11p-P1-50	補償組成近傍TbFeCo垂直磁気異方性薄膜の異常ネルンスト効果	○安藤 亮¹, 加藤 健¹, 飯村 修志¹, 小峰 啓 史², 長谷川 靖洋³	1.茨城県工業技術センター, 2.茨城大学, 3.埼玉大学
11p-P1-51	Py薄膜における励起スピン波の磁化方向依存性	○中山 真伎¹, 田島 摩百合¹, 葛西 伸哉², 三 谷 誠司², 真砂 卓史¹	1.福岡大理, 2.物材機構
11p-P1-52	静磁表面波の減衰長の磁性層厚依存性	○太田 雅己¹, 葛西 伸哉², 三谷 誠司², 眞 砂 卓史¹	1.福岡大理, 2.物材機構
11p-P1-53	強磁性トンネル接合素子の非破壊検査への応用	○(M1)阿部 雅彦¹, 大兼 幹彦¹, 藤原 耕輔¹, 遠藤 基¹, 永沼 博¹	1.東北大院工
11p-P1-54	Study on Magnetic Separation Applied to Remove Micro Particles in Boiler Feed Water.	○(M2)今村 健太郎¹, 岡田 秀彦², 安藤 努¹, 廣田 憲之², 西嶋 茂宏³	1.日大院生産工, 2.物材機構, 3.阪大工
11p-P1-55	磁場中コロイドプロセスによるREBa <sub>2</sub> Cu <sub>3</sub> O <sub>3</sub> 配向体の作製	○堀井 滋¹, 松浦 瞬¹, 土井 俊哉¹, 下山 淳 一², 岸尾 光二²	1.京大院エネ科, 2.東大院工
奨·E 11p-P1-56	Crystallization of taurine by LLIP method in high magnetic fields	○(B)tetsuya onotou¹	1.YNU
獎·E 11p-P1-57	Crystallization of Ice by LLIP Method under Magnetic Field	○(M1)yuta kimura¹	1.YNU
11p-P1-58	磁場配向グアニン結晶による光散乱強度の濃度依存性	○宮下 惟人1.2, 岩坂 正和1.3	1.広島大, 2.JSPS, 3.JST

3月11日(水)	) 15:45 - 18:3	30		
15:45 - 16:00	E 11p-D11-1	$\label{eq:magnetic} Magnetoresistance of the Group-IV Ferromagnetic Semiconductor $Ge_{1,y}Fe_y/Ge:B/Ge_{1,x}Fe_x$ Trilayer Heterostructures$	○Yoshisuke Ban¹, Ryosho Nakane¹, Masaaki Tanaka¹	1.Univ. Tokyo
16:00 - 16:15	E 11p-D11-2	Study on the onset of photo-excited precession of magnetization in Co/Pd multilayers	○Takashi Matsuda¹, Kazuhiro Nishibayas- hi¹, Hiro Munekata¹	1.Tokyo Inst. Tech.
16:15 - 16:30	11p-D11-3	種々の基板に成長したCo/Pd結晶性多層膜の光誘起磁化歳差運動	○(M1)高橋 克典¹, 西沢 望¹, 西林 一彦¹, 松田 喬¹, 岩崎 大和¹, 北本 仁孝², 宗片 比呂夫¹	1.東工大像情報, 2.東工大物質科学
16:30 - 16:45	11p-D11-4	Co/Pd 多層積層膜における磁化才差運動の局所的光励起・検出	○堀江 慧¹, 南 不二雄¹, 西林 一彦¹, 宗 片 比呂夫¹	1.東工大
16:45 - 17:00	11p-D11-5	$\operatorname{Co}_{\mathbf{x}} \operatorname{Mn}_{\mathbf{+x}} \mathbf{N}$ エピタキシャル薄膜の飽和磁化と垂直磁気異方性の評価	○伊藤 啓太1²³, 安富 陽子¹, 鹿原 和樹², 具志 俊希¹, 東小薗 創真¹, 都甲 薫¹, 角田 匡清², 末益 崇¹	1.筑波大数理物質, 2.東北大工, 3.气
17:00 - 17:15	11p-D11-6	MBE法による $\alpha$ "-Fe $_{16}$ N $_2$ 薄膜のエピタキシャル成長	○(B)東小薗 創真¹, 伊藤 啓太¹.²³, 安富 陽子¹, 具志 俊希¹, 都甲 薫¹, 末益 崇¹	1.筑波大 数理物質, 2.東北大 工, 3
17:15 - 17:30	11p-D11-7	負のスピン分極率を有するFe <sub>4</sub> N強磁性細線の磁壁形成位置の制御	○具志 俊希¹, 伊藤 啓太¹²³, 安富 陽子¹, 東小薗 創真¹, 都甲 薫', 大里 啓孝⁴, 杉本 喜正⁴, 浅川 潔³, 太田 憲雄¹, 本多 周太¹, 末益 崇¹	1.筑波大数理物質, 2.東北大工, 3.4 4.物材機構
17:30 - 17:45	E 11p-D11-8	High-frequency magnetic resonance in strained rare-earth iron garnet thin films	⊙Masaki Adachi¹, Hidekazu Nasu¹, HIroyasu Yamahara¹, Munetoshi Seki¹, Hiroaki Matsui¹, Hitoshi Tabata¹	1.Univ. of Tokyo
17:45 - 18:00	奨·E 11p-D11-9	Fabrication of Ga doped Gadolinium Iron Garnet Thin Films by Metal Organic Decomposition and their Magneto-optics Characterizations	○Jo Sato¹, Abdul Wahid Danish¹, Takaya Hattori¹, Hiromasa Shimizu¹	1.Tokyo Univ. of Agri. & Tech
18:00 - 18:15	E 11p-D11-10	Optical and magneto-optical properties of Bi substituted yttrium iron garnets prepared by metal organic decomposition	○(D)Eva Jesenska¹², Tomohiko Yoshida¹, Lukas Beran², Roman Antos², Martin Veis², Takayuki Ishibashi¹	1.Nagaoka Univ. of Tech., 2.Charl Univ.
18:15 - 18:30	11p-D11-11	スピン量子十字デバイス創製に向けた ${ m Co}$ と ${ m Ni}_{75}{ m Fe}_{25}$ 薄膜の磁気特性	〇森 澄人', 三澤 貴浩', 笠 晴也', 阿部 太郎', 海住 英生', 西井 準治'	1.北大電子研
3月12日(木)	9:00 - 11:4	5		
9:00 - 9:15	E 12a-D11-1	Crystal structure characterization of $\alpha$ -Cr <sub>2</sub> O <sub>3</sub> layer of Pt/Co/ $\alpha$ -Cr <sub>2</sub> O <sub>3</sub> film possessing different exchange anisotropy energy	○Yu Shiratsuchi¹, Yuuta Nakano¹, Nobu- hito Inami², Tetsuro Ueno³, Kanta Ono², Reiji Kumai², Ryoko Sagayama², Chiharu Mitsumata, Tetsuya Nakamura⁴, Ryoichi Nakatani¹	1.Osaka Univ, 2.KEK, 3.NIMS, 4. RI/SPring-8
9:15 - 9:30	E 12a-D11-2	Isothermal switching of perpendicular exchange anisotropy in Pt/ $\text{Co}/\alpha\text{-Cr}_2\text{O}_3/\text{Pt}$ layered structure by pulsed voltage	○Yu Shiratsuchi¹, Kentaro Toyoki¹, Atsushi Kobane¹, Chiharu Mitsumata², Ryoichi Nakatani¹	1.Osaka Univ, 2.NIMS
9:30 - 9:45	奨·E 12a-D11-3	Antiferromagnetic anisotropy of buffered Cr <sub>2</sub> O <sub>3</sub> thin films	○Tomohiro Nozaki¹, Naoki Shimomura¹, Satya Prakashi Pati¹, Masashi Sahashi¹	1.Tohoku Univ.
9:45 - 10:00	奨·E 12a-D11-4	Ir-doping effect on Morin temperature of alpha-Fe $_{\rm 2}{\rm O}_{\rm 3}$ (0001) thin film	(P)Satya Prakash Pati <sup>1</sup> , N. Shimomura <sup>1</sup> , Y. Hoshino <sup>1</sup> , T. Nozaki <sup>1</sup> , K. Mibu <sup>2</sup> , M. Sahashi <sup>1</sup>	1.Tohoku University, 2.Nagoya Institute of Technology
10:00 - 10:15	奨·E 12a-D11-5	Effect of off-stoichiometry on the half-metallic character of Heusler alloy $\mathrm{Co_2}(\mathrm{Mn,Fe})\mathrm{Si}$ thin films	○(DC)Kidist Ayele¹, Yusuke Honda¹, Tetsuya Uemura¹, Masafumi Yamamoto¹, Yoshio Miura², Masafumi Shirai³	1.Division of Electronics for Inforics, Hokkaido Univ., 2.Mathematic and Physical Science, Kyoto Instit of Tech., 3.Research Institute of Etrical Communication, Tohoku University
10:15 - 10:30	E 12a-D11-6	Improvement of $\mathrm{L2}_{_{1}}$ -ordering in half-metallic Heusler compounds by Ag-doping	Subrojati Bosu¹, ○Yuya Sakuraba¹, Taisu- ke Sasaki¹, Songtian Li¹, Kazuhiro Hono¹	1.NIMS
10:30 - 10:45	12a-D11-7	$\mathrm{L1}_{a}$ オーダーを制御した FePt 薄膜の Pt $\mathrm{L}_{2,3}$ 吸収端 X 線磁気円 二色性	〇石上 啓介', 芝田 悟朗', 関 剛斎', 坂本 祥哉', 野中 洋亮', 鈴木 基寛', 高梨 弘毅 ', 藤森 淳'	1.東大理, 2.東北大金研, 3.JASRI
10:45 - 11:00	E 12a-D11-8	Observation of perpendicular magnetization in Cu layer inserted between Co and Pt layers	OJun Okabayashi <sup>1</sup> , Tomohiro Koyama <sup>2</sup> , Daichi Chiba <sup>2</sup>	1.School of Science, Univ. of Toky 2.School of Engineering, Univ. of Tokyo
11:00 - 11:15	12a-D11-9	Extended Study on Perpendicular Magnetic Anisotropy in Fe/MgO interfaces	具 正祐 <sup>1,2</sup> , 向 清懿 <sup>1,2</sup> , 温 振超 <sup>2</sup> , 介川 裕章 <sup>2</sup> , ○三谷 誠司 <sup>1,2</sup>	1.筑波大数理, 2.物材機構
11:15 - 11:30	E 12a-D11-10	Magnetic properties of Co ultra-thin film deposited directly on polar ZnO substrates	○Daichi Chiba¹, Naoya Shibata², Atsushi Tsukazaki³	1.Dep. of Appl. Phys., The Univ. Tokyo, 2.IEI, The Univ. of Tokyo, 3.IMR, Tohoku Univ.
11:30 - 11:45	E 12a-D11-11	Anomalous Nernst effect in heavy elements-doped Fe films	○Yuya Sakuraba¹, Yohei Kinoshita², Taisuke Sasaki¹, Mamoru Ishikiriyama²,	1.NIMS, 2.TOYOTA

10.2	スピントルク	'・スピン流・回路	各·測定技術 / Spin torque, spin current, circuits, a	nd measurement technologies	口頭講演	
	3月12日(木) 13:15 - 18:30					
	13:15 - 13:30	奨 12p-D11-1	垂直磁気異方性CoFeB-MgO磁気トンネル接合における閾値電流の 温度依存性	○(M2)竹内 祐太朗 <sup>1.2</sup> , エノビオ エライクリストファー <sup>2</sup> , 佐藤 英夫 <sup>3.4</sup> , 深見 俊輔 <sup>3.4</sup> , 池田正二 <sup>2.3.4</sup> , 松倉 文礼 <sup>1.2.3</sup> , 大野 英男 <sup>1.2.3.4</sup>	1.東北大 WPI-AIMR, 2.東北大 通研 ナ ノスピン実験施設, 3.東北大 CSIS, 4.東 北大 CIES	
	13:30 - 13:45	奨 12p-D11-2	NCMR-Trilayer-STO素子を用いた低磁場での高Q値発振	○塩川 陽平 <sup>1</sup> , 戸田 裕介 <sup>1</sup> , Al-Mahdawi Muftah K.O <sup>1</sup> , 佐橋 政司 <sup>1</sup>	1.東北大工	
	13:45 - 14:00	奨·E 12p-D11-3	Spin Torque Oscillator Based on a Point-Contact Geometry with Highly Spin-Polarized Co <sub>2</sub> (Fe, Mn)Si	○(D)Tatsuya Yamamoto¹, Takashi Seki¹², Takahide Kubota¹, Hitomi Yako¹, Koki Takanashi¹	1.IMR, Tohoku Univ., 2.JST-PRESTO	
	14:00 - 14:15	奨·E 12p-D11-4	Universality classes for current- and field-induced domain wall creep in a Ta/CoFeB/MgO/Ta wire	O(D)Samik Duttagupta¹, Shunsuke Fukami²³, Chao Liang Zhang¹, Hideo Sato²³, Michihiko Yamanouchi¹², Fumihiro Matsukura¹²⁴, Hideo Ohno¹²³³4	1.RIEC, Tohoku Univ., 2.CSIS, Tohoku Univ., 3.CIES, Tohoku Univ., 4.WPI-AIMR, Tohoku Univ.	
	14:15 - 14:30	奨·E 12p-D11-5	Device size dependence of switching current for magnetization reversal induced by spin-orbit torque in Ta/CoFeB/MgO structures down to 30 nm	OChaoliang Zhang¹, Shunsuke Fukami²³, Hideo Sato²³, Fumihiro Matsukura¹²⁴, Hideo Ohno¹².3.4	1.RIEC, Tohoku Univ., 2.CSIS, Tohoku Univ., 3.CIES, Tohoku Univ., 4.WPI- AIMR, Tohoku Univ.	
	14:30 - 14:45	E 12p-D11-6	Controlling spin transmission and the Dzyaloshinskii-Moriya interaction at interfaces in magnetic heterostructures	○Masamitsu Hayashi¹, Jacob Torrejon,- Junyeon Kim,Peng Sheng,Seiji Mitani	,1.NIMS	

14:45 - 15:00	E 12p-D11-7	Layer thickness dependence of spin orbit torques and fields in Pt/Co/AlO trilayer structure	○(B)Minsik KONG¹, Tim Yang¹, Makoto Kohda¹, Takeshi Seki², Koki Takanashi², Junsaku Nitta¹	1.Tohoku Univ., 2.Tohoku Univ. IMR
15:00 - 15:15	E 12p-D11-8	Spin orbit interaction depending on crystal structures of Ta thin films	○Hiromu Gamou¹, Jeongchun Ryu¹, Rento Ohsugi¹, Makoto Kohda¹, Junsaku Nitta¹	1.Tohoku Univ.
15:15 - 15:30	E 12p-D11-9	Critical current of magnetization dynamics excited by spin-Hall torque in the presence of transverse magnetic field	○Tomohiro Taniguchi¹, Seiji Mitani², Masamitsu Hayashi²	1.AIST, 2.NIMS
15:30 - 15:45	12p-D11-10	低融点ガラスに挟まれたCo薄膜の磁気特性評価とスピン注入デバイスへの応用	○三澤 貴浩¹, 森 澄人¹, 阿部 太郎¹, 笠 晴也¹, 海住 英生¹, 西井 準治¹	1.北大電子研
15:45 - 16:00		休憩/Break		
16:00 - 16:15	12p-D11-11	2端子 $Co_2$ FeSiスピン注入による巨大純スピン流の生成	○黒川 孝幸¹, 沖 宗一郎¹, 山田 晋也¹, 金島岳¹, 浜屋 宏平¹²	1.阪大基礎工, 2.JST-CREST
16:15 - 16:30	E 12p-D11-12	Generation and detection of pure spin currents through epitaxial Ge/Fe $_3$ Si heterostructures	OMakoto Kawano <sup>1</sup> , Kohei Santo <sup>1</sup> , Soichiro Oki <sup>1</sup> , Shinya Yamada <sup>1</sup> , Takeshi Kanashima <sup>1</sup> , Kohei Hamaya <sup>1,2</sup>	1.Osaka Univ., 2.JST-CREST
16:30 - 16:45	E 12p-D11-13	Large spin accumulation signal in a lateral spin valve with nondegenerate Si channel	OYuichiro Ando <sup>1</sup> , Hayato Koike <sup>2</sup> , Takayuki Tahara <sup>1</sup> , Makoto Kameno <sup>3</sup> , Tomoyuki Sasaki <sup>2</sup> , Yoshishige Suzuki <sup>3</sup> , Masashi Shiraishi <sup>1</sup>	1.Kyoto Univ., 2.TDK Corporation, 3.Osaka Univ
16:45 - 17:00	E 12p-D11-14	Highly efficient spin pumping from a single-crystalline $\mathrm{Fe_3Si}$ layer into a Si channel	OYuichiro Ando¹, Kouki Ichiba², Shinya Yamada², Teruya Shinjo¹, Kohei Hamaya², Masashi Shiraishi¹	1.Kyoto Univ., 2.Osaka Univ.
17:00 - 17:15	E 12p-D11-15	Observation of Joule-heating-induced spin injection and transport in highly-doped n-type Si	O(DC)Makoto Kameno <sup>1,2</sup> , Hayato Koike <sup>3</sup> , Yuichiro Ando <sup>2</sup> , Teruya Shinjo <sup>2</sup> , Tomoyuki Sasaki <sup>3</sup> , Yoshishige Suzuki <sup>1</sup> , Masashi Shiraishi <sup>2</sup>	1.Osaka Univ., 2.Kyoto Univ., 3.TDK Co.
17:15 - 17:30	奨·E 12p-D11-16	Dynamical spin injection into n-type 4H-SiC	○(B)Ei Shigematsu¹, Yuuichiro Ando¹, Gaku Eguchi¹, Teruya Shinjo¹, Tsunenobu Kimoto¹, Masashi Shiraishi¹	1.Kyoto Univ.
17:30 - 17:45	E 12p-D11-17	Ferromagnetic resonance induced electrical signals in $\mbox{Pt/}(\mbox{Ga,Mn})$ As	OHiroyasu Nakayama¹, Lin Chen², Hsiao Wen Chang¹³, Fumihiro Matsukura¹.².⁴, Hideo Ohno¹.².⁴	1.LNS, RIEC, Tohoku Univ., 2.WPI-AIMR, Tohoku Univ., 3.National Sun Yat-Sen Univ., 4.CSIS, Tohoku Univ.
17:45 - 18:00	奨·E 12p-D11-18	Fe impurity contribution to Spin-Seebeck effect in Pt thin film	○Jeongchun Ryu¹, Kotaro Mizunuma², Yuta Saiga², Yasushi Kono², Makoto Kohda¹, Junsaku Nitta¹	1.Tohoku univ., 2.DENSO CORPORATION
18:00 - 18:15	E 12p-D11-19	Spin-Seebeck effect in CuPt thin films with different Pt concentration	Ohiroshi ono¹, Jeong Chun Ryu¹, Yuta Saiga², Kotaro Mizunuma², Yasushi Kono², Makoto Kohda¹, Junsaku Nitta¹	1.Tohoku Univ, 2.DENSO CORPORATION
18:15 - 18:30	E 12p-D11-20	Composition dependence of anomalous Nernst effect in $Mn_{_\chi}\text{-}Ga_{_{1:\chi}}$ epitaxial thin films	○Masaki Inoue¹, Masaki Mizuguchi¹, Shigemi Mizukami², Koki Takanashi¹	1.IMR, Tohoku Univ., 2.WPI-AIMR, Tohoku Univ.

10.3	GMR·TMR	·磁気記録技術	/ Giant magnetoresistance (GMR), tunnel magne	toresistance (TMR) and magnet 口頭講演	ic recording technologies
	3月13日(金)	16:15 - 18:1	15		
	16:15 - 16:30	奨·E 13p-D11-1	A theoretical study of thermally activated magnetization switching under microwave assistance	○Hirofumi Suto¹, Kiwamu Kudo¹, Tazumi Nagasawa¹, Taro Kanao¹, Koichi Mizushi- ma¹, Rie Sato¹, Satoshi Okamoto², Nobuaki Kikuchi², Osamu Kitakami², Takehito Shimatsu²	1.Toshiba R&D Center, 2.Tohoku Univ.
	16:30 - 16:45	E 13p-D11-2	Resonant magnetization switching induced by spin-torque-driven oscillations	○Kiwamu Kudo¹, Hirofumi Suto¹, Nagasawa Tazumi¹, Mizushima Koichi¹, Sato Rie¹	1.Toshiba Corporation
	16:45 - 17:00	E 13p-D11-3	High-output microwave detector using voltage-induced ferromagnetic resonance	OYoichi Shiota <sup>1,2,3</sup> , Shinji Miwa <sup>2,3</sup> , Shingo Tamaru <sup>1</sup> , Takayuki Nozaki <sup>1,3</sup> , Hitoshi Kubota <sup>1,3</sup> , Akio Fukushima <sup>1,3</sup> , Yoshishige Suzuki <sup>1,2,3</sup> , Shinji Yuasa <sup>1,3</sup>	1.AIST Spintronics RC, 2.Osaka Univ. 3.JST-CREST
	17:00 - 17:15	13p-D11-4	dc Bias Voltage Dependence of Magnetic Anisotropy in CoFeB/ MgO Investigated by Electric Field-Induced Ferromagnetic Resonance	○金井 駿 <sup>1,3</sup> , Gajek Martin², Worledge Daniel², 松倉 文礼 <sup>1,3,4</sup> , 大野 英男 <sup>1,3,4</sup>	1.東北大学通研, 2.IBM TJ Watson Research Center, 3.東北大学CSIS, 4.東 北大学WPI-AIMR
	17:15 - 17:30	奨·E 13p-D11-5	rf power dependence of homodyne-detected ferromagnetic resonance spectra of a CoFeB/MgO magnetic tunnel junction	OEriko Hirayama¹, Shun Kanai¹, Jun-ichiro Ohe², Hideo Sato³.⁴, Fumihiro Matsukura¹.³.⁵, Hideo Ohno¹.².٨.⁵.	1.Laboratory for Nanoelectronics and Spintronics, RIEC, Tohoku Univ., 2.Department of Physics, Toho Univ., 3.CSIS, Tohoku Univ., 4.CIES, Tohoku Univ., 5.WPI-AIMR, Tohoku Univ.
	17:30 - 17:45	E 13p-D11-6	Effects of Transition Metal Oxide on Voltage Control of Magnetic Anisotropy of ${\rm CoFeB/MO_x}$ Stacks	○Ryusuke Oishi¹, Kazuki Segawa¹, Koji Kita¹	1.The Univ. of Tokyo
	17:45 - 18:00	奨·E 13p-D11-7	Highly (001) textured $\rm L1_{\rm o}^{-}CoPt/TiN$ multilayer films with perpendicular magnetic anisotropy	○(DC)HONGYU AN¹	1.Titech
	18:00 - 18:15	E 13p-D11-8	Effect of oxygen exposure at Co <sub>2</sub> FeSi/MgO interfaces on perpendicular magnetic anisotropy of Co <sub>2</sub> FeSi layer	○Kouki Shinohara¹, Takahiro Suzuki¹, Yota Takamura¹, Shigeki Nakagawa¹	1.Dept. of Phys. Electron., Tokyo Tech.
	3月14日(土)	13:00 - 15:0	00		
招待	13:00 - 13:30	14p-D11-1	「第5回女性研究者研究業績・人材育成賞(小舘香椎子賞)受賞記念講演((30分) 垂直通電型巨大磁気抵抗効果増大の開発 ~スピントロニクス産業へ向けて~	○湯浅 裕美1	1.東芝
	13:30 - 13:45	E 14p-D11-2	Bias voltage dependence in magnetic tunnel junctions with a spinel Mg-Al-O barrier	○Hiroaki Sukegawa¹, Koichiro Inomata¹, Seiji Mitani¹	1.NIMS
	13:45 - 14:00	E 14p-D11-3	Enhancement of CPP-GMR by a CuZn alloy spacer layer	○Takao Furubayashi¹, Yukiko Takahashi¹, Taisuke Sasaki¹, Kazuhiro Hono¹	1.NIMS
	14:00 - 14:15	E 14p-D11-4	Current-perpendicular-to-plane giant magnetoresistance effect in $Co_2(Fe-Mn)Si/Ag-Mg/Co_2(Fe-Mn)Si \ junctions$	Hiroyuki Narisawa¹, ○Takahide Kubota¹, Koki Takanashi¹	1.IMR, Tohoku Univ.
	14:15 - 14:30	E 14p-D11-5	Polycrystalline CPP-GMR devices using <001> textured Co $_2$ Fe(-Ga $_0$ $_5$ Ge $_{_5}$ ) Heusler alloy layer and conductive Mg $_{0.5}$ Ti $_{0.5}$ O $_x$ buffer layer	(D)YE DU <sup>12</sup> , Takao Furubayashi <sup>2</sup> , Yukiko Takahashi <sup>2</sup> , Yuya Sakuraba <sup>2</sup> , Kazuhiro Hono <sup>1,2</sup>	1.Univ. of Tsukuba, 2.NIMS
	14:30 - 14:45	奨·E 14p-D11-6	Temperature dependence of spin-dependent tunneling resistances of Co <sub>2</sub> MnSi and Co <sub>2</sub> (Mn,Fe)Si MTJs showing high tunneling magnetoresistances	○(D)Bing Hu¹, Takeshi Kawami¹, Kidist Moges¹, Tetsuya Uemura¹, Masafumi Yamamoto¹	1.Hokkaido Univ.

14:45 - 15:00	奨·E 14p-D11-7	Crystal orientation dependence in all-B2-trilayer current-perpen-	○(D)Jiamin CHEN <sup>1,2</sup> , Takao Furubayas-	1.NIMS, 2.Tsukuba Univ.
	_	dicular-to-plane giant magnetoresistance pseudo spin-valves using	hi1, Yukiko Takahashi1, Taisuke Sasaki1,	
		Co <sub>2</sub> Fe(Ge <sub>0.5</sub> Ga <sub>0.5</sub> ) Heusler alloy and NiAl spacer	Kazuhiro Hono <sup>1,2</sup>	

.0.4			ントロニクス / Semiconductors, organic, optical, an	d quantum spiritionics	口頭講演
	3月14日(土	9:00 - 12:00	0		
召待	9:00 - 9:30	14a-D2-1	「第5回化合物半導体エレクトロニクス業績賞(赤﨑勇賞)受賞記念 講演」(30分) AllnAs/GalnAsから強磁性半導体GaMnAsまで	○大野 英男¹	1.東北大学
召待	9:30 - 9:45	E 14a-D2-2	[Young Scientist Presentation Award Speech] (15min.) Electrical modulation of ferromagnetism via controlling the wavefunction in n-type ferromagnetic semiconductor (In,Fe)As quantum wells	ODuc Anh Le <sup>1</sup> , Nam Hai Pham <sup>1,2</sup> , Yuichi Kasahara <sup>1,3</sup> , Yoshihiro Iwasa <sup>1,4</sup> , Masaaki Tanaka <sup>1</sup>	1.The University of Tokyo, 2.Tokyo Institute of Technology, 3.Kyoto University, 4.RIKEN Center for Emergent Matter Science
	9:45 - 10:00	奨·E 14a-D2-3	Temperature dependent direction of in-plane uniaxial magnetic anisotropy in (Ga,Mn)As codoped with Li	OShohei Miyakozawa¹, Lin Chen², Fumi- hiro Matsukura²³, Hideo Ohno¹²²³	1.LNS-RIEC, Tohoku Univ., 2.WPI-AIMR, Tohoku Univ., 3.CSIS, Tohok Univ.
	10:00 - 10:15	奨·E 14a-D2-4	Room-temperature local ferromagnetism and its nanoscale domain growth in the ferromagnetic semiconductor $Ge_{1\alpha}Fe_{\alpha}$	○(D)Yuuki Wakabayashi¹, Shoya Sakamo- to¹, Keisuke Ishigami¹, Yukio Takahashi¹, Yukiharu Takeda², Yuji Saitoh², Hiroshi Yamagami², Atushi Fujimori¹, Masaaki Tanaka¹, Shinobu Ohya¹	1.Univ. of Tokyo, 2.JAEA
	10:15 - 10:30	奨·E 14a-D2-5	Fabrication and evaluation of a GaMnAs-based three-terminal magnetoresistance-modulation device	○Toshiki Kanaki¹, Hirokatsu Asahara², Shinobu Ohya¹, Masaaki Tanaka¹	1.The Univ. of Tokyo, Graduate School, 2.The Univ. of Tokyo
	10:30 - 10:45		休憩/Break		
	10:45 - 11:00	奨·E 14a-D2-6	The dependence on carrier density, Co content, and thickness of magnetic domain structure in anatase $(Ti,Co)O_2$ thin films	○(D)Thantip Krasienapibal¹, Tomoteru Fukumura¹.².³, Tetsuya Hasegawa¹.².³	1.University of Tokyo, 2.JST-CREST 3.KAST
	11:00 - 11:15	奨·E 14a-D2-7	Intrinsic spectrum of reflection magnetic circular dichroism of GaMnAs thin films	○Hiroshi Terada¹, Shinobu Ohya¹, Masaaki Tanaka¹	1.The Univ. of Tokyo
	11:15 - 11:30	奨·E 14a-D2-8	Band structure of GaMnAs near the Fermi level studied by time-resolved light-induced reflectivity measurements	○(M2)Tomoaki Ishii¹, Tadashi Kawazoe¹, Yusuke Hashimoto², Hiroshi Terada¹, Iriya Muneta¹, Motoichi Ohtsu¹, Masaaki Tanaka¹, Shinobu Ohya¹	1.The Univ. of Tokyo, 2.Radboud Univ. Nijmegen
	11:30 - 11:45	E 14a-D2-9	The effect of F-doping on magnetism in diluted magnetic semi-conductor (Zn,Co)O thin films	○(M2)Ryo Ishikawa¹, Shinji Kuroda¹, Hironori Ofuchi²	1.Grad. School of Pure & Appl. Sci., Univ. Tsukuba, 2.JASRI/SPring-8
	11:45 - 12:00	奨·E 14a-D2-10	Magneto-optical and magneto-transport characteristics of heavily Fe-doped ferromagnetic semiconductor (Ga,Fe)Sb	○Thanh Tu Nguyen¹, Pham Nam Hai¹², Le Duc Anh¹, Masaaki Tanaka¹	1.Tokyo Univ., 2.Tokyo Tech Inst.
	3月14日(土	.) 13:00 - 15:0	00		
	13:00 - 13:15	E 14p-D2-1	A phenomenological model for the helicity dependent photocurrent in a ferromagnet – insulator – semiconductor junction	○(D)Ronel Roca¹, Nozomi Nishizawa¹, Takashi Matsuda¹, Hiro Munekata¹	1.Tokyo Tech.
	13:15 - 13:30	奨·E 14p-D2-2	Electrical detection of the ratio of Rashba and Dresselhaus spin orbit interactions in InGaAs/InAlAs quantum wires	○Kohei Yoshizumi¹, Makoto Kohda¹, Junsaku Nitta¹	1.Tohoku Univ.
	13:30 - 13:45	E 14p-D2-3	Spatial mapping of spin polarization in InGaAs quantum wells at high temperature using Monte Carlo simulation	ORYOTA KUROSAWA¹, KEN MORITA¹, YOSHIHIRO ISHITANI¹	1.Chiba Univ.
	13:45 - 14:00	E 14p-D2-4	Electrical control of drifting spin coherence in GaAs quantum well	○Yoji Kunihashi¹, Haruki Sanada¹, Hideki Gotoh¹, Koji Onomitsu¹, Makoto Kohda², Junsaku Nitta², Tetsuomi Sogawa¹	1.NTT BRL, 2.Tohoku Univ.
	14:00 - 14:15	奨·E 14p-D2-5	Electric-Field Dependence of Coherence Time of the Electron Spin in the Diamond Nitrogen-Vacancy Center	OSatoshi Kobayashi <sup>12</sup> , Hiroki Morishita <sup>1</sup> , Shinji Miwa <sup>1</sup> , Yoshishige Suzuki <sup>1</sup> , Norikazu Mizuochi <sup>1,2</sup>	1.Osaka Univ., 2.CREST
	14:15 - 14:30	奨·E 14p-D2-6	Electrical detection of nuclear magnetic resonance in GaAs using Heusler alloy Co <sub>2</sub> MnSi	○Takafumi Akiho¹, Yuya Ebina¹, Mas- afumi Yamamoto¹, Tetsuya Uemura¹	1.Grad. School of Information Scien and Technology, Hokkaido Univ.
	14:30 - 14:45	E 14p-D2-7	Dynamical spin injection into solution-processed Carbon-nano-tubes	○(B)Hiroshi Nagano¹, Yuichiro Ando¹, Teruya Shinjo¹, Hiromichi Kataura², Take- shi Tanaka², Masashi Shiraishi¹	1.Kyoto Univ., 2.AIST
	14:45 - 15:00	14p-D2-8	シリコン上酸化マグネシウム薄膜中の常磁性欠陥評価	○林 寛¹, 松村 佳人¹, 森下 弘樹¹, 小池 勇 人², 三輪 真嗣¹, 水落 憲和¹, 鈴木 義茂¹	1.大阪大学, 2.TDK

3月14日(土	9:00 - 12:00	0		
9:00 - 9:15	14a-D11-1	バルスならびに定常磁場を用いたCoO反強磁性相のバリアント再 配列	○寺井 智之¹, 掛下 知行¹, 徳永 将史², 赤 木 暢³	1.阪大工, 2.東大物性研, 3.阪大理先端強磁場
9:15 - 9:30	14a-D11-2	銅磁気電析のキラル界面形成への添加剤の影響	○茂木 巖¹, 青柿 良一², 渡辺 和雄¹	1.東北大金研, 2.職業大
9:30 - 9:45	14a-D11-3	光触媒反応磁場効果モデルの検討	○奧村 英之¹, 遠藤 晋¹, 山末 英嗣¹, 石原 慶一¹	1.京大エネ科
9:45 - 10:00	14a-D11-4	Magnetic manipulation of light reflection and mirror angle for the organic crystal mirror in minute solution	○(D)水川 友里 <sup>1,2</sup> , 岩坂 正和 <sup>1,3</sup>	1.広島大院, 2.日本学術振興会, 3.科特技術振興機構
10:00 - 10:15	14a-D11-5	強磁場中回転容器内の非定常流れが配向粒子に及ぼす影響	○(M2)井上 真生¹, 安藤 努¹, 廣田 憲之²	1.日大院生産工, 2.物材機構
10:15 - 10:30		休憩/Break		
10:30 - 10:45	奨 14a-D11-6	強磁場中におけるBi-Mn合金の巨視的変化の観察	○(B)宮崎 泰樹', 平 敦志', 三井 好古', ア ベ松 賢一', 高橋 弘紀', 宇田 聡 <sup>2</sup> , 渡辺 和 雄 <sup>2</sup> , 小山 佳一 <sup>1</sup>	1.鹿大理, 2.東北大金研
10:45 - 11:00	奨·E 14a-D11-7	Crystal Growth of NaCl by LLIP Method under Magnetic Fields II	○(M1)Ryusei Semba¹, Ryosuke Yoshida¹, Taku Arashiro¹, Shun Ozawa¹, Isao Yamamoto¹	1.Yokokoku Univ.
11:00 - 11:15	奨·E 14a-D11-8	Optical Properties of $C_{60}NW$ Precipitated in Magnetic Fields	○Taku Arashiro¹, Kazuki Kanei¹, Syun Ozawa¹, Isao Yamamoto¹	1.YNU
11:15 - 11:30	E 14a-D11-9	Observation of Insulating Particle Motion in Electrically Conductive Fluid under Oscillating Electromagnetic Field	○Asuka Maruyama¹, Iwai Kazuhiko¹	1.Hokkaido Univ.
11:30 - 11:45	E 14a-D11-10	Magnetic Phase Transition for Supercooled Liquid of Bi-Mn II	○Rio Murase¹, Shun Ozawa¹, Isao Yamamoto¹	1.Yokohama Nat'l Univ.

11:45 - 12:00	E 14a-D11-11	Detection of Magnetic Nanoparticles Using Magnetically-assisted	○BagusTrisnanto Suko¹, Yoshitaka	1.Tokyo Inst. of Tech.
		Impedance Spectroscopy	Kitamoto <sup>1</sup>	

11 超伝導 / S	uperconduc	ctivity		
11 超伝導 / Supe	erconductivity	ポスター講演		
3月12日(木)	9:30 - 11:30			
	12a-P9-1	グラファイト表面にアルカンを接触させることによる室温超伝導を引き 起こすプロトン生成の証拠	○川島 康¹	1.東海大工
	12a-P9-2	d波層状超伝導体におけるc軸方向パラ伝導率の理論的評価	青葉 知弥¹, 古瀬 京介², 今成 一雄², ○森 夏樹², 臼井 友洋³, 足立 伸太郎³, 渡辺 孝夫 ³, 末松 久幸¹	1.長岡技科大, 2.小山高専, 3.弘前大学
	12a-P9-3	MOD法による非c軸配向BSCCO薄膜の作製(II)	○山田 靖幸¹, 羽根田 海生¹, 松崎 亮博¹, 森 夏樹¹, 渥美 太郎¹, 加藤 孝弘², 石橋 隆幸²	1.小山高専, 2.長岡技科大
	12a-P9-4	改良型母材粉砕法によるBi系高温超伝導ウィスカーの育成	○田中 博美¹, 西尾 知美¹, 小西 那奈¹, 吉川 英樹², 岸田 悟³	1.米子高専, 2.物材機構, 3.鳥大院工
	12a-P9-5	固有ジョセフソン接合を用いたテラヘルツ波発振素子の放射特性 の解析(II)	○立木 隆¹, 内田 貴司¹	1.防衛大·電気電子
	12a-P9-6	NaOH-KOHフラックス法を用いて成膜したEu123, Eu124膜の特性評価	○宮地 優悟¹, 奥西 亮太¹, 舩木 修平¹, 山田 容士¹	1.島根大学
	奨 12a-P9-7	KOHフラックス法を用いたREB $\mathbf{a}_2$ C $\mathbf{u}_3$ O $_y$ 膜作製時の酸素分圧制御によるRE/B $\mathbf{a}$ 置換の抑制	○舩木 修平¹, 奥西 亮太¹, 宮地 優悟¹, 山田 容士¹	1.島大総理工
	12a-P9-8	KOH flux法で合成したRE123相の酸素分圧の制御によるRE/Ba置 換の制御	○奥西 亮太¹, 舩木 修平¹, 宮地 優悟¹, 山田 容士¹	1.島大総理工
	12a-P9-9	部分的に立方体集合組織を有するニッケル平角線の作製	○山崎 裕文¹, 山口 巖¹	1.産総研
	12a-P9-10	圧延と熱処理によるYBCOテーブ用金属基板の作製(3)	○岡井 大祐 <sup>1.4</sup> , 信川 和毅 <sup>1</sup> , 山本 厚之 <sup>1</sup> , 土 井 俊哉 <sup>2.4</sup> , 堀井 滋 <sup>2.4</sup> , 一瀬 中 <sup>3.4</sup>	1.兵庫県立大工, 2.京大エネ科, 3.電中研, 4.JST-ALCA
	12a-P9-11	配向銅テープ上におけるNbドープSrTiO <sub>3</sub> 薄膜の作製条件の検討	○橋本 真幸¹, 中 順平¹, 内間 貴之¹, 堀井 滋¹², 土井 俊哉¹²	1.京大院エネ科, 2.JST-ALCA
	12a-P9-12	単結晶基板を用いたY系超伝導体の縦磁界下における臨界電流特性	○木戸 竜馬¹, 秀島 匡彦¹, 木内 勝¹, 小田部 荘司¹, 松下 照男¹, 佐藤 迪夫², 三浦 正志²	1.九工大情報工, 2.成蹊大理工
	12a-P9-13	多種形状MgB <sub>2</sub> 超電導バルク磁石の捕捉磁場分布	○石原 篤¹, 赤坂 友幸¹, 富田 優¹, 山本 明 保²³, 岸尾 光二²	1.鉄道総研, 2.東大院工, 3.さきがけ
	12a-P9-14	冷凍機冷却による多層リング状バルク超電導体の性能評価	○赤坂 友幸¹, 石原 篤¹, 福本 祐介¹, 富田 優¹, 禹 泰城², 関野 正樹², 大崎 博之²	1.鉄道総研, 2.東大
	12a-P9-15	超伝導線材を用いた液体水素液面計に関する理論的考察	渡邉 紗良 <sup>1,2</sup> , ○馬渡 康徳 <sup>2</sup> , 石田 茂之 <sup>2</sup> , 土屋 佳則 <sup>2</sup> , 吉田 良行 <sup>2</sup> , 西尾 太一郎 <sup>1</sup>	1.東理大, 2.産総研
	E 12a-P9-16	Observation of inhomogeneous profiles of current density in BSCCO and YBCO tapes from residual magnetic field measurement	○(D)Mohamed Tallouli¹, Jian Sun¹, Yuri Ivanov¹, Mirofumi Watanabe¹, Makoto Hamabe¹, Noriko Chikumoto¹, Satarou Yamaguchi¹, Oleg Shyshkin², Samia Charfi-Kaddour³	1.Chubu Univ., 2.Kharkiv National Univ., 3.Univ. of El Manar
	12a-P9-17	Al層の追加によるNb/Al/AlOx/Nb接合のリーク電流の低減	○(M1)池谷 瑞基¹, 酒井 剛¹, 小嶋 崇文 ², 野口 卓²	1.電気通信大学, 2.国立天文台
	12a-P9-18	TiNパッファー層上のNbNトンネル接合の作製と評価	○牧瀬 圭正¹, 寺井 弘高¹	1.情通機構
	12a-P9-19	2並列非対称ナノブリッジの特性	○伊藤 雄記¹, 井上 真澄², 藤巻 朗¹	1.名大院工, 2.名城大理工
	12a-P9-20	単一磁束量子回路の高温動作化に向けたNbTiN配線のシートインダ クタンスの温度依存特性評価	坂本 隼也¹, ○宗本 健太郎¹, 赤池 宏之¹, 藤巻 朗¹	1.名大院工
	12a-P9-21	単結晶NbTiN薄膜の超伝導カイネティックインダクタンス非線形性	○武田 正典¹, 小嶋 崇文², 齊藤 敦³, 牧瀬 圭正⁴, 鵜澤 佳徳⁴, 齋藤 伸吾⁴, 島影 尚⁵	1.静大院工, 2.国立天文台, 3.山形大院工, 4.情通機構, 5.茨城大工
	12a-P9-22	700 MHz NMR用超伝導検出コイルの開発 ~サファイアプレートを 用いた共振周波数シフト~	○越田 和磨¹, 北島 慶太¹, 今野 正貴¹, 山田 貴大¹, 高橋 雅人², 齊藤 敦¹, 大嶋 重利¹	1.山形大院理工, 2.理研
	12a-P9-23	1000素子アレイ化に向けての3次元構造STJ-X線検出器の開発(3)	○藤井 剛¹, 浮辺 雅宏¹, 大久保 雅隆¹	1.産総研
	12a-P9-24	量子効率100%のパラレル型超伝導ストリップイオン検出器	○全 伸幸¹, 志岐 成友¹, 藤井 剛¹, 浮辺 雅 宏¹, 小池 正記¹, 大久保 雅隆¹	1.産総研
	12a-P9-25	光ファイバ自己整合型構造を用いた高効率超伝導光子数識別器の 開発	藪野 正裕 <sup>12</sup> , 布川 裕真 <sup>12</sup> , ○田辺 稔 <sup>2</sup> , 沼 田 孝之 <sup>2</sup> , 吉澤 明男 <sup>2</sup> , 土田 英実 <sup>2</sup> , 枝松 圭 一 <sup>1</sup> , 福田 大治 <sup>2</sup>	1.東北大学, 2.産総研
	E 12a-P9-26	Broadening of Superconducting Transition in NbTiN Nanowires on Si-substrate	○Wei Qiu¹, Saburo Imamura¹, Shigehito Miki¹, Kazumasa Makise¹, Hirotaka Terai¹	1.NICT
	12a-P9-27	N/I/S トンネル接合型固体冷凍素子の開発III	○柏谷 聡¹, 柏谷 裕美¹, 小柳 正男¹	1.産総研
	12a-P9-28	溝によって分離されたゲート電極をもつYBa $_2$ Cu $_3$ O $_{7-\delta}$ ナノチャネル素子において観測された電界効果	○守屋 雅隆¹, 新夕 智啓¹, 河原木 槙二¹, 水 柿 義直¹²	1.電通大, 2.CREST, JST

11.1 基礎物性 /	Fundamental	l properties      口頭講演				
3月11日(水) 14:00 - 16:45						
14:00 - 14:15	11p-A2-1	グラフェンを用いた交差アンドレーエフ反射検出器の作製	○上保 淳敬¹, 津村 公平¹, 高柳 英明¹²	1.東理大応, 2.物材機構MANA		
14:15 - 14:30	11p-A2-2	グラフェン/超伝導体接合の輸送特性に対する光照射効果のゲー ト電圧変化	○津村 公平¹, 古川 直紀¹, 伊藤 宙陛³, 渡辺 英一郎², 津谷 大樹², 高柳 英明¹.3	1.東理大, 2.NIMS微細加工PF, 3.NIMS-MANA		
14:30 - 14:45	11p-A2-3	$\mathrm{Bi}_{2}\mathrm{Sr}_{2x}\mathrm{La}_{x}\mathrm{CaCu}_{2}\mathrm{O}_{8+\delta}$ における固有ジョセフソン特性	○野村 義樹¹, 温 一凡¹, 神原 仁志¹, 掛 谷 一弘¹	1.京大院工		
14:45 - 15:00	11p-A2-4	大面積固有ジョセフソン接合のリトラッピング特性	○村田 健一郎¹, 赤坂 圭司¹, 八巻 和宏¹, 入江 晃亘¹	1.宇都宮大工		
15:00 - 15:15	11p-A2-5	バルス電流印加法を用いたメサ型固有接合の発熱評価	○(BC)岩塚 紳矢¹, 及川 大¹, 室谷 英彰¹, 杉 浦 藤虎¹, 安藤 浩哉¹, 塚本 武彦¹	1.豊田高専		
15:15 - 15:30		休憩/Break				

	15:30 - 15:45	11p-A2-6	塩酸改質法により作製した固有ジョセフソン接合テラヘルツ波発振 素子	○赤坂 圭司¹, 倉成 友理¹, 八巻 和宏¹, 入 江 晃亘¹	1.宇都宮大工
	15:45 - 16:00	11p-A2-7	両面加工法で作製したBi系固有接合スタックの発振特性と温度分布評価	○加藤 孝弘¹, 西方 翼¹, 小瀧 侑央¹, 安井 寛治¹, 未松 久幸¹, 石橋 隆幸¹, 王 華兵², 羽 多野 毅², 川上 彰³	1.長岡技大, 2.物材機構, 3.情報通信 研究機構
	16:00 - 16:15	11p-A2-8	希塩酸法で作製された $\mathrm{Bi}_{z}\mathrm{Sr}_{z}\mathrm{CaCu}_{z}\mathrm{O}_{y}$ スタックの電磁波放射特性の幾何学的依存性	○小瀧 侑央¹, 加藤 孝弘², H.B. Wang³, 羽 多野 毅³, 川上 彰⁴, 鈴木 常生¹, 中山 忠親 ¹, 新原 晧─¹	1.長岡技大極限センター, 2.長岡技大 電気系, 3.物材研, 4.情報通信研究機構
	16:15 - 16:30	11p-A2-9	LaドープBi <sub>2</sub> Sr <sub>2</sub> CaCu <sub>2</sub> O <sub>8+δ</sub> によるテラヘルツ波発振	○(M1)温 一凡¹	1.京都大工
	16:30 - 16:45	11p-A2-10	${ m Bi}_2{ m Sr}_2{ m CaCu}_2{ m O}_{8+\delta}$ 薄膜固有ジョセフソン接合テラヘルツ波発振デバイスの 液体窒素温度動作	○竹野 智史¹, 渡辺 祥吾¹, 木村 涉¹, 山田博信¹, 立木 隆², 内田 貴司², 中島 健介¹	1.山形大, 2.防衛大
	3月12日(木)	) 13:30 - 18:0	00		
招待	13:30 - 13:45	12p-A2-1	「講演奨励賞受賞記念講演」(15分) 高フッ素濃度単結晶SmFeAsO1-xFxの合成とFIB を用いた微小結 晶への4端子電極作製プロセス	〇藤岡 正弥 <sup>1</sup> , Denholme Saleem <sup>1</sup> , 田 中 将嗣 <sup>1</sup> , 鈴木 皓司 <sup>1,2</sup> , 原 裕 <sup>1,2</sup> , 山木 拓馬 <sup>1,2</sup> , 山下 愛智 <sup>1,2</sup> , 山口 尚秀 <sup>1</sup> , 竹屋 浩幸 <sup>1</sup> , 高 野 義彦 <sup>1,2</sup>	1.物材機構, 2.筑波大学
	13:45 - 14:00	12p-A2-2	SmFeAs(O,F)の相生成および超伝導特性に対するSn添加効果	○(B)林 功輔¹, 获野 拓¹, 焼田 裕之¹, 岡田 朋之¹, 山本 明保¹, 岸尾 光二¹, 下山 淳一¹	1.東大工
	14:00 - 14:15	12p-A2-3	(Ca,RE)FeAs <sub>2</sub> の超伝導特性のRE依存性	○焼田 裕之¹, 荻野 拓¹, サラ アルベルト¹², 岡田 朋之¹, 山本 明保¹, 岸尾 光二¹, 伊豫 彰², 永崎 洋², 下山 淳一¹	1.東大院工, 2.産総研
	14:15 - 14:30	12p-A2-4	ペアレンツ・アロイングによる $\mathrm{BaFe_2}(\mathrm{As,P})_2$ 多結晶体の合成	○辻岳 千里¹, 山本 明保¹², 荻野 拓¹, 下山淳一¹, 岸尾 光二¹	1.東大院工, 2.JSTさきがけ
	14:30 - 14:45	12p-A2-5	Co添加BaFe $_2$ As $_2$ エピタキシャル薄膜における特異な圧力効果	○佐藤 光 <sup>1</sup> , 平松 秀典 <sup>1,2</sup> , 神谷 利夫 <sup>1,2</sup> , 細野 秀雄 <sup>1,2,3</sup>	1.東工大 応セラ研, 2.東工大 元素戦略 研, 3.東工大 フロンティア研
	14:45 - 15:00	奨 12p-A2-6	層間長の大きな新規インターカレーション超伝導体 ${\rm Li}_{x}({\rm C_6H_{16}N_2})$ $_y{\rm Fe}_{2x}{\rm Se}_2$ の合成	○細野 祥平¹, 野地 尚¹, 畑田 武宏¹, 川股 隆行¹, 加藤 雅恒¹, 小池 洋二¹	1.東北大院工
	15:00 - 15:15	12p-A2-7	$CaF_z$ 基板を用いた $FeSe_{1x}Te_x$ エピタキシャル薄膜の作製と相分離の抑制	○今井 良宗¹, 澤田 雄一¹, 鍋島 冬樹¹, 前田 京剛¹	1.東大院総合
	15:15 - 15:30	奨 12p-A2-8	相分離を抑制したFeSe <sub>1-x</sub> Te <sub>x</sub> 薄膜の磁場中輸送特性	○澤田 雄一¹, 鍋島 冬樹¹, 今井 良宗¹, 前田 京剛¹	1.東大院総合
	15:30 - 15:45	12p-A2-9	$FeSe_{1x}Te_{x}$ 薄膜における臨界電流密度特性の評価	○花輪 雅史¹, 塚田 一郎¹, 鍋島 冬樹², 今 井 良宗², 前田 京剛², Tarantini Chiara³, Polyanskii Anatolii³, Larbalestier David³	1.電中研, 2.東大総合文化, 3.ASC/ NHMFL/フロリダ州立大
	15:45 - 16:00		休憩/Break		
	16:00 - 16:15	12p-A2-10	Hg系超伝導銅酸化物のアンダードーブ状態における高圧効果	〇山本 文子¹, 竹下 直², 寺倉 千恵子¹, 十 倉 好紀¹	1.理研創発物性センター, 2.産総研電 子光部門
	16:15 - 16:30	12p-A2-11	RE247相の簡便な合成方法と超伝導特性	○下山 淳一¹, 堀井 滋², 岸尾 光二¹	1.東大院工, 2.京大院エネ科
	16:30 - 16:45	12p-A2-12	回転変調磁場下における $(Y_{1x}Er_x)Ba_2Cu_3O_y$ の配向挙動	○藤岡 祥太郎¹, 堀井 滋¹, 松浦 瞬¹, 土井 俊哉¹, 木村 史子², 木村 恒久²	1.京大院エネ科, 2.京大院農
	16:45 - 17:00	12p-A2-13	マティアスルール適用によるSrBi <sub>3</sub> の超伝導転移温度上昇	○伊豫 彰', 柳 陽介'², 金城 達也'², 西尾 太一郎'³, 長谷 泉', 柳澤 孝', 石田 茂之 ¹, 鬼頭 聖', 竹下 直', 岡 邦彦', 吉田 良行 ¹, 永崎 洋¹	1.産総研, 2.イムラ材研, 3.東理大
	17:00 - 17:15	12p-A2-14	トポタクティック合成した $\mathrm{Bi}_{_{2}}(\mathrm{O,F})\mathrm{S}_{_{2}}$ の圧力効果	岡田 朋之¹, ○荻野 拓¹, 下山 淳一¹, 岸 尾 光二¹, 伊豫 彰², 竹下 直², 白川 直樹 ², 永崎 洋²	1.東大院工, 2.産総研
	17:15 - 17:30	12p-A2-15	$LaNO_3$ から $LaNiO_2$ へのトポタクティック変換における $Ni/La$ 組成比依存性	○池田 愛¹, 真部 高明², 内藤 方夫¹	1.農工大, 2.産総研
	17:30 - 17:45	12p-A2-16	O <sub>3</sub> 雰囲気中での銀酸化物薄膜の低温エビタキシャル成長	○七尾 美子¹	1.農工大工
	17:45 - 18:00	12p-A2-17	(Sr,M)-(Mo,Mo')-O系113相酸化物(M = La, Ca; M' = V, Nb)の物性、導電率の組成依存	○福田 大地¹, 石田 直哉¹, 北村 尚斗¹, 井 手本 康¹	1.東理大理工

			口頭講演	
3月12日(木	14:00 - 17	:30		
14:00 - 14:15	12p-A1-1	1次元ピンを導入した高品質EuBa2Cu3O7-δ 薄膜の作製	○高井 洋輔¹, 向田 昌志¹, 三浦 正樹², 一瀬 中³, 末吉 哲郎⁴, 藤吉 孝則⁴	1.九州大工, 2.FANUC, 3.電中研, 4.負本大工
14:15 - 14:30	12p-A1-2	YBCO薄膜における多層膜法によるハイブリッドAPCの導入	○堀出 朋哉¹, 坂本 宜優¹, 石丸 学¹, 一瀬中², 松本 要¹	1.九工大, 2.電中研
14:30 - 14:45	E 12p-A1-3	Tuning the angular variation of $J_{\rm c}$ of YBCO thin films by incorporating different combinations of hybrid APCs	(P)Alok Jha¹, Kaname Matsumoto¹, Tomoya Horide¹, Shrikant Saini², Paolo Mele², Yutaka Yoshida³, Satoshi Awaji⁴	1.Kyushu Instt Technol, 2.Hiroshima Univ., 3.Nagoya Univ., 4.Tohoku Un
14:45 - 15:00	12p-A1-4	APC導入REBCO 薄膜のJc角度依存性の解析モデル	○松本 要¹, ジャー アロク¹, 堀出 朋哉¹	1.九工大工
15:00 - 15:15	12p-A1-5	エピタキシャルHg系超伝導薄膜の不可逆磁場特性	○松本 要¹, 加藤 拓¹, 堀出 朋哉¹, 吉田 隆², 淡路 智³, 高野 義彦⁴	1.九州工業大学, 2.名古屋大学, 3.東 大学, 4.物材機構
15:15 - 15:30	12p-A1-6	無限層超伝導 $\mathrm{Sr}_{\mathrm{l},\mathrm{x}}\mathrm{La}_{\mathrm{x}}\mathrm{CuO}_{2}$ a軸成長膜における歪効果	○伊藤 雅崇¹,何 軼倫¹,羽尻 哲也¹,植田研二¹,浅野 秀文¹	1.名大院工
15:30 - 15:45		休憩/Break		
15:45 - 16:00	12p-A1-7	薄膜結晶成長シミュレーションによるREBCO薄膜中BMOの自己組織化メカニズムの検討	○一野 祐亮¹.², 吉田 隆²	1.名大エコ研, 2.名大工
16:00 - 16:15	12p-A1-8	格子不整合性界面における中間層の結晶配向のメカニズム(II)	○一瀬 中 <sup>1.3</sup> , 中 順平 <sup>2</sup> , 内間 貴之 <sup>2</sup> , 堀井 滋 <sup>2.3</sup> , 土井 俊哉 <sup>2.3</sup>	1.電中研, 2.京大院エネ科, 3.JST-ALC
16:15 - 16:30	12p-A1-9	昇温速度がTFA-MOD $(Y_{0.77}Gd_{0.23})Ba_2Cu_3O_y$ 線材の結晶性及び超伝導特性に及ぼす影響	○丹羽 信博¹, 佐藤 迪夫¹, 三浦 正志¹, 高木裕司², 中岡 晃一², 吉積 正晃², 和泉 輝郎²	1.成蹊大, 2.超工研
16:30 - 16:45	12p-A1-10	酸素アニール温度がTFA-MOD $(Y_{0.77}Gd_{0.29})Ba_2Cu_3O_{7-0}$ 線材の磁場中超伝導特性に及ぼす影響	○関 翼', 丹羽 信博', 佐藤 迪夫', 三浦 正志', 高木 裕司², 中岡 晃一², 吉積 正晃², 和泉 輝郎²	1.成蹊大, 2.超工研
16:45 - 17:00	奨 12p-A1-11	バッファ層の面内配向性がTFA-MOD ( Y <sub>0.77</sub> Gd <sub>0.23</sub> )Ba <sub>2</sub> Cu <sub>3</sub> O <sub>y</sub> 線材の 磁場中超伝導特性に及ぼす影響	○佐藤 迪夫¹, 関 翼¹, 三浦 正志¹, 高木 裕 司², 中岡 晃一², 吉積 正晃², 和泉 輝郎²	1.成蹊大, 2.超工研

17:00 - 17:	15 獎 12p-A1-12	TFA-MOD法を用いた磁場配向REBa <sub>2</sub> Cu <sub>3</sub> O <sub>7-x</sub> の検討	○林 真理子¹, 荒木 猛司¹, 福家 浩之¹	1.東芝研開セ
17:15 - 17:	30 12p-A1-13	TFA-MOD法によるYBa $_{2}$ Cu $_{3}$ O $_{p}$ 膜中のBaHfO $_{3}$ 粒状ピン止め点の微細化	○寺西 亮¹, 堀田 宏志¹, 山田 和広¹, 金子 賢治¹, 吉積 正晃², 和泉 輝郎²	1.九州大工, 2.超電導工研
3月13日	(金) 12:00 - 19	:00		
12:00 - 12:	15 13p-A1-1	さまざまなPLD条件で作製したFe(Te,Se)薄膜のT。機構	○堀出 朋哉¹, 算用子 将弘¹, 一瀬 中², 松 本 要¹	1.九工大, 2.電中研
12:15 - 12:	30 13p-A1-2	$\operatorname{FeSe}_{1x}\operatorname{Te}_x/\operatorname{CaF}_2$ 基板界面の微細構造のx依存性	○塚田 一郎¹, 一瀬 中¹, 鍋島 冬樹², 今井 良宗², 前田 京剛²	1.電中研, 2.東大院総合文化
12:30 - 12:	45 獎 13p-A1-3	鉄カルコゲナイド超伝導体を用いた超格子薄膜の作製とその輸送 特性	○(DC)鍋島 冬樹¹, 澤田 雄一¹, 今井 良宗¹, 花輪 雅史², 一瀬 中², 塚田 一郎², 前田 京剛¹	1.東大院総合, 2.電中研
12:45 - 13:0	00 13p-A1-4	SmFeAs(O,F)薄膜のMBE成長における各種フッ素源の比較	○常木 孝信¹, 迫田 將仁¹, 石井 陽大¹, 渡辺 大樹¹, 内藤 方夫¹	1.農工大
13:00 - 13:	15 13p-A1-5	分子線エピタキシー法を用いて成長した鉄系超伝導体SmFeAs(O,F) の積層膜と接合作製(2)	○迫田 將仁¹, 常木 孝信¹, 石井 陽大¹, 渡辺 大樹¹, 内藤 方夫¹	1.農工大工
13:15 - 13:	30 13p-A1-6	$CaF_2$ バリヤ層を用いた $MgB_2$ ジョセフソン接合の最適化	○目出 和也¹, 迫田 將仁¹, 内藤 方夫¹	1.東京農工大学
13:30 - 13:4	45 13p-A1-7	電子ビーム蒸着法で作製したMgB <sub>2</sub> 薄膜のアニール効果	○竹原 寬人¹, 青木 翔太¹, 堀井 滋¹, 土 井 俊哉¹, 楠 敏明², 山本 明保³, 下山 淳一 ³, 岸尾 光二³	1.京大院エネ科, 2.日立製作所, 3.東 大院工
13:45 - 14:0	00 13p-A1-8	コロネン熱分解でナノカーボンコートした硼素粉末により作製した MgB。線材	○熊倉 浩明¹, 葉 術軍¹, 松本 明善¹, 長 谷川 明¹	1.物材機構

3月11日(水	.) 14:00 - 18	3:00		
14:00 - 14:15	11p-A1-1	$BaHfO_3 添加SmBa_2 Cu_3 O_3 薄膜の低磁場磁束ピン止めモデルと不可逆磁場曲線$	○(D)鶴田 彰宏¹, 一野 祐亮¹, 吉田 隆¹, 一 瀬 中², 松本 要³, 淡路 智⁴	1.名大工, 2.電中研, 3.九工大, 4.
14:15 - 14:30	奨 11p-A1-2	$BaHfO_3$ 添加 $SmBa_2Cu_3O_y$ 薄膜の高温領域磁束相図とビニング特性	○(PC)土屋 雄司¹, 淡路 智¹, 渡辺 和雄¹, 三 浦 峻², 一野 祐亮², 吉田 隆²	1.東北大金研, 2.名大工
14:30 - 14:45	11p-A1-3	BHOナノロッド導入Sm123薄膜における相関ビン特性	○淡路 智', 土屋 雄司', 渡辺 和雄', 三浦 峻², 鶴田 彰宏², 一野 祐亮², 吉田 隆², 松本 要³	1.東北大金研, 2.名大工, 3.九工元
14:45 - 15:00	11p-A1-4	高速プロセスで作製した $BaHfO_3$ 人エピン導入 $Eu_1Ba_2Cu_3O_{7.\delta}$ 線材の臨界電流特性	○高崎 建¹, 井上 昌睦¹, 田中 健太¹, 衣斐 顕², 吉田 朋², 吉積 正晃², 和泉 輝郎², 木 須 隆暢¹	1.九大院シス情, 2.超電導工研
15:00 - 15:15	11p-A1-5	成長制御したナノ粒子とYBCOからなる多層膜のJ。特性	○末吉 哲郎¹, 上瀧 哲也¹, 浦口 雄世¹, 牧原 隆博¹, 末永 桃太郎¹, 藤吉 孝則¹	1.熊大工
15:15 - 15:30	11p-A1-6	磁気顕微法とX線CTによる希土類系高温超伝導テープ線材の臨界 電流制限因子の解明	○井上 昌睦¹, 田中 健太¹, 高崎 健¹, 今村 和孝¹, 東川 甲平¹, 吉積 正晃², 和泉 輝郎 ², 木須 隆暢¹	1.九大院シス情, 2.超電導工研
15:30 - 15:45	11p-A1-7	REBCO線材のI <sub>c</sub> 統計分布に対する試料長ならびに空間解像度の 影響	○木須 隆暢1², 東川 甲平1, 井上 昌睦1	1.九大院シス情, 2.iSTERA
15:45 - 16:00		休憩/Break		
16:00 - 16:15	11p-A1-8	$MgB_z$ 薄膜モデルを用いた磁束運動の数値解析: $J_c$ の粒径、磁場依存性	○菅野 量子¹, 山本 浩之¹, 楠 敏明², 児玉 一宗², 一木 洋太², 田中 秀樹², 山本 明保 ³, 下山 淳一³	1.日立中研, 2.日立日研, 3.東大口
16:15 - 16:30	11p-A1-9	高捕捉磁場MgB₂超伝導バルク磁石の開発	杉野 翔¹, ○山本 明保¹³, 下山 淳一¹, 岸尾 光二¹, 石原 篤², 赤坂 友幸², 富田 優²	1.東大, 2.鉄道総研, 3.JSTさきがし
16:30 - 16:45	11p-A1-10	HIP法で作製したMgB₂ベルク超伝導体の磁束ビン止め特性と微細組織観察	○内藤 智之¹, 吉田 卓史¹, 望月 豪彦¹, 藤 代 博之¹	1.岩手大工
16:45 - 17:00	11p-A1-11	高性能超伝導直流ケーブルの電流容量の検討	○松下 照男¹, ビアトキン ウラジミール¹, 木内 勝¹, 小田部 荘司¹	1.九工大
17:00 - 17:15	11p-A1-12	テストベンチを用いた直流超伝導ケーブルシステム向けベルチェ電流 リードの性能評価と過電流試験	○宮田 成紀¹, 吉原 幸夫¹, 渡邉 裕文¹, 山内 健吾¹, 牧野 圭志¹, 山口 作太郎¹	1.中部大
17:15 - 17:30	11p-A1-13	有限要素法を用いた縦磁界中における超伝導体内の磁束の動き の評価	○増田 嘉道¹, 小田部 荘司¹, 木内 勝¹, 馬 渡 康徳²	1.九工大, 2.産総研
17:30 - 17:45	11p-A1-14	超伝導体におけるピンニング損失パワー密度	○松下 照男¹	1.九工大
17:45 - 18:00	11p-A1-15	Bi系超伝導線材の臨界電流に関する一考察	○伊豆 文里1	1.拓殖大工

11.4	1アナログ応月	用および関連技	術 / Analog applications and their related technol	logies 口頭講演	
	3月12日(木)	14:00 - 17:0	00		
	14:00 - 14:15	12p-A3-1	Si 細線導波路結合型SSPD の作製	○柴田 浩行 <sup>1,2</sup> 、開 達郎 <sup>1,3</sup> 、土澤 泰 <sup>1,3</sup> 、武居 弘樹 <sup>2</sup> 、清水 薫 <sup>2</sup> 、山本 剛 <sup>3</sup> 、都倉 康弘 <sup>2</sup> 、山 田 浩治 <sup>1,3</sup>	1.NTT NPC, 2.NTT物性研, 3.NTT 先デ研
	14:15 - 14:30	12p-A3-2	可視波長帯超伝導ナノワイヤ単一光子検出器を用いた蛍光相関分 光II	○山下 太郎', 劉 登寬 <sup>2</sup> , 三木 茂人', 山本 条太郎 <sup>3</sup> , 原口 徳子 <sup>1,4</sup> , 金城 政孝 <sup>3</sup> , 平岡 泰 <sup>1,4</sup> , 王 鎮 <sup>1,2</sup> , 寺井 弘高 <sup>1</sup>	1.情通機構, 2.上海微所, 3.北大先端生命, 4.阪大生命機能
	14:30 - 14:45	12p-A3-3	64ピクセル超伝導単─光子検出素子の特性評価Ⅱ	○三木 茂人¹, 山下 太郎¹, 寺井 弘高¹	1.情通機構
	14:45 - 15:00	12p-A3-4	導波路結合型超伝導ナノワイヤ単一光子検出器の開発Ⅲ	〇和木 健太朗 <sup>12</sup> , 山下 太郎 <sup>2</sup> , 井上 振一郎 <sup>23</sup> , 三木 茂人 <sup>2</sup> , 寺井 弘高 <sup>2</sup> , 生田 カ三 <sup>1</sup> , 山 本 俊 <sup>1</sup> , 井元 信之 <sup>1</sup>	1.阪大院基礎工, 2.情通機構, 3.JSTさ きがけ
	15:00 - 15:15	12p-A3-5	シリコン基板の深掘り加工による放射線検出器の感度向上	○宮本 法明¹, 成瀬 雅人¹, 田井野 徹¹, 明 連 広昭¹	1.埼玉大院理工
	15:15 - 15:30	12p-A3-6	ミリ波・サブミリ波オンチップ分光器の開発	○新井 慧一¹, 成瀬 雅人¹, 田井野 徹¹, 明連 広昭¹, 美馬 覚², 大谷 知行²	1.埼大院, 2.理研
	15:30 - 15:45		休憩/Break		
	15:45 - 16:00	12p-A3-7	TESマイクロ波多重読み出しのためのNbN共振特性評価	○平山 文紀', 入松川 知也', 佐藤 昭', 山森 弘毅', 永沢 秀一', 福田 大治', 日高 睦夫', 神代 曉', 大野 雅史', 高橋 浩之'	1.産総研, 2.東大工

16:00 - 16:15	12p-A3-8	TaN薄膜を用いたマイクロ波力学インダクタンス検出器の作製	○山田 博信¹, 小川 裕平¹, 岡 大輝¹, 齊藤 敦¹, 大嶋 重利¹, 有吉 誠一郎², 中島 健介¹	1.山形大, 2.豊橋技科大
16:15 - 16:30	奨 12p-A3-9	積層された2つの電流バイアス運動インダクタンス検出器の同時計測	○(PC)宮嶋 茂之 <sup>1</sup> , 鳴神 吉人 <sup>1</sup> , 山口 裕之 <sup>1</sup> , 中山 弘貴 <sup>1</sup> , 宍戸 寛明 <sup>12</sup> , 藤巻 朗 <sup>3</sup> , 日高 睦夫 <sup>4</sup> , 石田 武和 <sup>12</sup>	1.大阪府大工, 2.大阪府大ナノ研, 3.名古屋大工, 4.産総研
16:30 - 16:45	12p-A3-10	超伝導バルク共振器を用いた 100 Wクラス送信用フィルタの開発	○(M1)鶴井 椋太¹, 齊藤 敦¹, 加藤 知己¹, 齋藤 大暉¹, 手嶋 英一², 大嶋 重利¹	1.山形大理工, 2.新日鐵住金
16:45 - 17:00	12p-A3-11	電圧標準チップの熱応力の数値解析	○山森 弘毅¹, 山田 隆宏¹, 佐々木 仁¹, 高橋 ひかり¹², 丸山 道隆¹, 天谷 康孝¹, 金子 晋 久¹, 神代 暁¹, 桐生 昭吾²	1.産総研, 2.東京都市大
3月14日(土	9:00 - 12:0	00		
9:00 - 9:15	14a-A3-1	超伝導量子干渉素子を用いた24-bitディジタル-アナログ変換器	○中西 正和¹	1.産総研
9:15 - 9:30	奨 14a-A3-2	SQUIDによる電子スピン偏極の検出	○樋田 啓¹, 松崎 雄一郎¹, 角柳 孝輔¹, 根 本 香絵², ウィリアム ムンロー¹, 山口 浩司 ¹, 齊藤 志郎¹	1.NTT物性基礎研, 2.国立情報学研究所
9:30 - 9:45	14a-A3-3	反応性イオンエッチングを用いて作製したマイクロ・ナノSQUIDからなる局所磁場計測システムの開発	○佐久間 大輔¹, 永合 祐輔¹, 石黒 亮輔², 柏 谷 聡³, 髙柳 英明¹.⁴	1.東理大, 2.理研, 3.産総研, 4.物材機構 MANA
9:45 - 10:00	14a-A3-4	STM-SQUIDのための磁束量子の数値シミュレーション	〇立木 実¹, 林 忠之¹², 町田 理³, 大井 修一 ¹.⁴, 平田 和人¹.⁴	1.物材機構, 2.仙台高専, 3.理研, 4.北 大理
10:00 - 10:15	奨 14a-A3-5	HTS-SQUIDを用いた高機能サンプル振動型磁化率計の開発	〇松永 恭曉¹, Mohd Mawardi¹, 日下 瞬¹, 森田 洪爾¹, 堺 健司¹, 紀和 利彦¹, 塚田 啓二¹	1.岡大工
10:15 - 10:30		休憩/Break		
10:30 - 10:45	奨 14a-A3-6	傾斜磁場を用いた磁気粒子イメージングシステムの開発	○森下 学¹, 宮崎 貴東¹, 辻田 裕也¹, 笹山 瑛由¹, 円福 敬二¹	1.九州大学シス情
10:45 - 11:00	奨 14a-A3-7	SQUIDを用いた磁気的液相免疫検査法の高性能化	○浦 正和', 上岡 祐太', 中村 洸太', 笹山 瑛由', 吉田 敬', 円福 敬二'	1.九大システム情報
11:00 - 11:15	14a-A3-8	高温超伝導コイルを用いた鉄板厚さの測定	○石田 智樹¹, 笹山 瑛由¹, 松尾 政晃¹, 円 福 敬二¹	1.九大シス情
11:15 - 11:30	14a-A3-9	高温超伝導rf-SQUIDの共振周波数に対するスリット長依存性	酒井 章¹, 芦塚 拓也¹, ○宮戸 祐治¹, 糸 崎 秀夫¹	1.阪大基礎工
11:30 - 11:45	奨 14a-A3-10	LN, 冷却磁束トランスを用いた超低磁場HTS-SQUID-NMR 装置の検討	○廣瀬 勇野', 山本 将彰', 八田 純一', 有吉 誠一郎', 田中 三郎', 安達 成司², 田辺 圭一²	1.豊橋技科大, 2.超電導工学研究所
11:45 - 12:00	奨 14a-A3-11	高温超伝導SQUIDと磁束トランスを用いた金属異物検査装置の検討	○成田 雄作1	1.豊橋技大工

11.5	接合,回路作	<b>F製プロセスお</b>	らよびデジタル応用 / Junction and circuit fabrication	procresss, digital applications	口頭講演
	3月13日(金	) 16:15 - 17	:45		
	16:15 - 16:30	13p-A2-1	配線包囲型構造による超伝導マイクロストリップライン間の磁気結合 度の評価	○小野美 武¹, 中島 康治¹	1.東北大電通研
	16:30 - 16:45	13p-A2-2	超伝導物理乱数生成器の動作安定のための後処理回路の研究	○(M1)菅田 裕道¹, 山梨 裕希¹, 吉川 信行¹	1.横浜国立大学
	16:45 - 17:00	13p-A2-3	飛行時間型質量分析に向けた超伝導ストリップイオン検出器とSFQ時間測定回路の単一冷凍機内への実装	○佐野 京佑¹, 村松 祐希¹, 下田 知毅¹, 山梨裕希¹, 吉川 信行¹, 全 伸幸², 大久保 雅隆²	1.横浜国大工, 2.産総研
	17:00 - 17:15	13p-A2-4	SFQ 回路と接続したナノワイア O/E 変換器のエラーフリー動作	○梶野 顕明¹, 三木 茂人¹, 山下 太郎¹, 寺 井 弘高¹	1.情通機構
	17:15 - 17:30	13p-A2-5	20 kA/cm <sup>2</sup> Nb/AlO <sub>2</sub> /Nb接合を用いたRSFQ 100 GHzビットシリア ル加算器	○田中 雅光¹, 佐藤 諒¹, 藤巻 朗¹, 永沢 秀一², 日高 睦夫²	1.名大, 2.産総研
	17:30 - 17:45	13p-A2-6	高温超伝導体を用いたランプエッジ型ジョセフソン接合のTEM観察	○安達 成司¹, 塚本 晃¹, 文 裕植¹, 押久保靖夫¹, 田辺 圭一¹	1.超電導工研
	3月14日(土	9:00 - 12:0	00		
招待	9:00 - 9:15	14a-A2-1	「講演奨励賞受賞記念講演」(15分) 磁束量子ラッチを用いたXORゲートの提案と動作実証	〇竹内 尚輝 <sup>1</sup> , 山梨 裕希 <sup>1</sup> , 吉川 信行 <sup>1</sup>	1.横浜国大
	9:15 - 9:30	奨 14a-A2-2	磁性体を用いた超伝導位相シフタによる単一磁束量子回路の多機 能化の検討	〇谷口 壮耶', 伊藤 大', 石川 航太', 黒川 綜太', 津根 彰久', 田中 雅光', 赤池 宏之 ', 藤巻 朗'	1.名大院工
	9:30 - 9:45	14a-A2-3	Quantum Flux Latchの動作マージンの改善	○(B)辻 直樹¹, 竹内 直輝², 山梨 裕希¹, 吉川 信行¹	1.横国大理工, 2.情通機構
	9:45 - 10:00	奨 14a-A2-4	磁性体を用いた再構成可能な磁束量子パラメトロン回路	○黒川 綜太¹, 津根 彰久¹, 伊藤 大¹, 谷口 壮耶¹, 田中 雅光¹, 赤池 宏之¹, 藤巻 朗¹	1.名大院工
	10:00 - 10:15	奨 14a-A2-5	断熱型磁束量子パラメトロン1万ゲート回路の低速動作実証	○奈良間 達也¹, 竹內 尚輝², 山梨 裕希¹, 吉川 信行¹	1.横浜国立大学, 2.情報通信研究機構
	10:15 - 10:30	奨 14a-A2-6	単一磁束量子回路と断熱型磁束量子パラメトロン回路間インターフェ ース回路の設計と評価	○知名 史博¹, Ortlepp Thomas², 山梨 裕希¹, 吉川 信行¹	1.横浜国立大学, 2.CiS研究所
	10:30 - 10:45		休憩/Break		
	10:45 - 11:00	奨 14a-A2-7	SFISジョセフソン接合の磁性層が接合特性に与える影響の検討	○伊藤 大¹, 谷口 壮耶¹, 石川 航太¹, 赤池 宏之¹, 藤巻 朗¹	1.名大院工
	11:00 - 11:15	奨 14a-A2-8	電流比較部を最適化したSFQ 論理ゲートにおけるビットエラーレートの測定	○(M1)朝倉 剣太¹, 山梨 裕希¹, 吉川 信行¹	1.横国大院工
	11:15 - 11:30	奨 14a-A2-9	直列接続多元超伝導検出器アレイの個別読出し	○神谷 恭平¹, 喜多 祐真¹, 上阪 岬¹, Bozbey Ali², 藤巻 朗¹, 田中 雅光¹	1.名古屋大, 2.TOBB UET
	11:30 - 11:45	奨 14a-A2-10	動的な内部リセット機構によるLRバイアス低電力単一磁束量子回路 の高速化	佐藤 紘史¹, ○堤 隆太¹, 山梨 裕希¹, 吉 川 信行¹	1.横国大院工
	11:45 - 12:00	14a-A2-11	CB-KID/SFQモノリシックデバイスの作製プロセス	〇日高 睦夫¹, 永沢 秀一¹, 宮嶋 茂之², 宍戸 寛明², 藤巻 朗³, 石田 武和²	1.産総研, 2.大阪府大工, 3.名大工

## 12 有機分子・バイオエレクトロニクス / Organic Molecules and Bioelectronics

	20110(1)	0.00 10.00			
	-,3(3,	9:00 - 12:00			A THE LAWRENCE OF HILLS AND
	9:00 - 9:15	11a-D2-1	窒素添加LaB。薄膜上に形成したペンタセン薄膜の堆積レート依存性	○前田 康貴¹, 大見 俊一郎¹, 後藤 哲也², 大見 忠弘²	1.東工大総理工, 2.東北大未来研
	9:15 - 9:30	11a-D2-2	Si(111)基板上におけるジアセチレン薄膜成長過程の光学顕微鏡観察	○鎌田 勇人¹, 小幡 誠司¹, 上野 啓司², 斉 木 幸一朗¹	1.東大新領域, 2.埼玉大院理工
	9:30 - 9:45	11a-D2-3	有機薄膜トランジスタの被覆率と電気伝導のその場評価	〇(PC)渡辺 剛¹, 小金澤 智之¹, 菊池 護², 西田 広作², 吉本 則之², 広沢 一郎¹	
	9:45 - 10:00	11a-D2-4	α,ω-クオターチオフェン誘導体薄膜の結晶成長に及ぼす末端アル キル基の効果	〇小鹿 曹汰¹, 小金澤 智之², 山本 秦平³, 鈴木 充朗³, 山田 容子³, 吉本 則之¹	1.岩手大工, 2.高輝度光化学研究セ, 3.奈良先端大物質
	10:00 - 10:15	11a-D2-5	大気圧走査電子顕微鏡を用いた共役高分子のナノバターニング	○樋口 剛志¹, 西山 英利², 須賀 三雄², 陣内 浩³, 高原 淳³.⁴	1.東北大多元研, 2.日本電子, 3.九大 導研, 4.JST, ERATO高原ソフト界面で
	10:15 - 10:30	11a-D2-6	ベロブスカイト酸化物の極性に依存するフタロシアニン極薄層の形成	○小島 峻吾¹, 福村 知昭¹², 神坂 英幸¹², 長谷川 哲也¹²	1.東大院理, 2.JST-CREST
	10:30 - 10:45		休憩/Break		
待	10:45 - 11:00	11a-D2-7	「講演奨励賞受賞記念講演」(15分) インクジェット塗布された異種ミクロ液滴の混合挙動の制御と高度印 刷薄膜製造技術への応用	〇野田 祐樹¹, 峯廻 洋美¹, 山田 寿一¹, 長谷川 達生¹²	1.産総研 FLEC, 2.東大工
	11:00 - 11:15	11a-D2-8	銀ナノワイヤーの電気伝導性と酸化耐性に関する表面結合ポリビニ ルビロリドンの効果	○富岡 明宏¹, 増田 啓宏¹, 波多野 雄亮¹, 前田 善貴¹, 新井 秀治¹, 川畑 公人¹	1.大阪電通大工
	11:15 - 11:30	11a-D2-9	添加剤導入によるP3HT:PCBM混合膜の結晶成長過程のその場観察評価	○新井康司 <sup>1-2</sup> , 柴田陽生 <sup>2</sup> , 伊藤 英輔 <sup>2</sup> , 小 金澤智之 <sup>3</sup> , 宮寺 哲彦 <sup>2-4</sup> , 近松 真之 <sup>2</sup> , 矢 口 裕之 <sup>1</sup>	1.埼玉大工, 2.産総研・太陽光, 3.高績 光科学研究センター, 4.JST さきがけ
	11:30 - 11:45	11a-D2-10	静電噴霧堆積(ESD)法による有機EL材料の積層化	○高久 英明¹, 早川 晴美¹, 青山 哲也¹, 田島 右副¹, 松下 聖志郎¹	1.理研
	11:45 - 12:00	11a-D2-11	多電極型静電塗布法(ナノミスト堆積法)による低分子(CBP:PBD:T-PD:Ir(mppy) <sub>3</sub> ))有機薄膜の成膜特性の検討	○新沼 佳樹¹, 西 大紀¹, 石野 隼一¹, 菊 池 昭彦 <sup>1,2</sup>	1.上智大・理工, 2.上智大学ナノテクセンター
	3月11日(水)	13:15 - 18:0	0		
	13:15 - 13:30	奨 11p-D2-1	尿素オリゴマーを用いた真空蒸着膜の薄膜作製及び構造評価	○(M1)福冨 達也¹, 森本 勝大¹, 小柴 康子¹, 三崎 雅裕¹, 石田 謙司¹	1.神戸大院工
	13:30 - 13:45	奨 11p-D2-2	${ m Fe}_{\circ}{ m O}_4$ ナノ粒子- ${ m C}_{16}$ 混合LB膜を用いたVA-CNTの合成および直径評価	○中村 健太郎¹, 栗山 直樹¹, 高際 翔太¹, 串田 正人¹	1.千葉大工
	13:45 - 14:00	奨 11p-D2-3	Feナノ粒子-シリカナノ粒子混合LB膜から合成した垂直配向カーボンナノチューブの構造評価	○高際 翔太¹, 金杉 治¹, 中村 健太郎¹, 串 田 正人¹	1.千葉大工
	14:00 - 14:15	奨 11p-D2-4	交互間欠静電塗布法を用いたp-nプレンド膜の成膜方法の提案	○鈴木 勝己¹, 戸田 明日来¹, 福田 武司¹, 鎌田 憲彦¹, 本多 善太郎¹	1.埼玉大
	14:15 - 14:30	奨 11p-D2-5	ベンゼンチオール誘導体による修飾表面の濡れと安定性	○鈩 信吾¹, 北村 雅季¹²	1.神戸大院工, 2.東大ナノ量子機構
	14:30 - 14:45	奨 11p-D2-6	液晶性フタロシアニンの加熱スピンコート薄膜における導電性高分 子混合効果	○東 卓也¹, Mihary Fiderana Ramananarivo¹, 大森 雅志¹, 吉田 浩之¹, 藤井 彰彦¹, 尾崎 雅則¹	1.阪大院工
	14:45 - 15:00	奨 11p-D2-7	Auストライプ構造上TIPS petacene単結晶ドメインの分子配向評価	○(M2)大長 規浩¹, 中村 綾斗¹, 小野島 紀夫¹	1.山梨大
	15:00 - 15:15		休憩/Break		
	15:15 - 15:30	奨 11p-D2-8	動的光重合により誘起される分子配向挙動の構造依存性	○(M1)石津 真樹¹, 久野 恭平¹, 宍戸 厚¹²	1.東工大資源研, 2.JST さきがけ
	15:30 - 15:45	奨 11p-D2-9	電気化学キャバシタを指向したハイブリッドマイクロ粒子の作製	○鳥羽 彩伽¹, 早坂 泰史², 松田 圭吾², 増原 陽人²³	1.山形大工, 2.山形大院理工, 3.有機 レクトロニクス研究センター
	15:45 - 16:00	奨 11p-D2-10	プラズモン特性を有するコア-シェル型電子供与体材料作製法の確立	〇宮川 佳奈¹, 渡部 大輝², 内貴 博之³, 雲林 院 宏³, 有田 稔彦¹, 增原 陽人²⁵	1.山形大学工, 2.山形大院理工, 3.ルヴァン・カトリック大, 4.東北大多元研, 5.有機エレ研
	16:00 - 16:15	奨 11p-D2-11	新規製膜手法によるベロプスカイト結晶薄膜の作製	○(B)梅本 和輝 <sup>1</sup> , 早坂 泰史 <sup>2</sup> , 增原 陽人 <sup>2,3</sup>	1.山形大工, 2.山形大院理工, 3.有機 レクトロニクスセンター
	16:15 - 16:30	奨 11p-D2-12	再沈法における貧溶媒選択が $C_{\omega}$ ナノ結晶形成に及ぼす影響の解明	○伊藤 直子1, 志藤 慶治2, 増原 陽人3	1.山形大工, 2.山形大学院理工, 3.有 エレクトロニクス研究センター
	16:30 - 16:45	奨 11p-D2-13	微小液滴中の量子ドットー色素結合体の高速合成及び反応速度の 定量化	○宇高 光', 倉林 智和', 福田 武司', Yoon Dong Hyun², 鎌田 憲彦', 鈴木 美穂', 中原 旭², 関口 哲志², 庄子 習一²	1.埼玉大工, 2.早稲田大理工
	16:45 - 17:00		休憩/Break		
	17:00 - 17:15	E 11p-D2-14	Orientation of conjugated polymers by FTM method	(D)MANISH PANDEY¹, Shuichi Naga- matsu², Shyam S. Pandey¹, Shuzi Hayase¹, Wataru Takashima¹	1.Graduate School of LSSE, Kyushi Institute of Technology, 2.Depatme of Computer Science and Electroni Kyushu Institute of Technology
	17:15 - 17:30	11p-D2-15	ナノ電解法による位置選択的ナノ単結晶作製 ~有機アクセブタ分子 への展開~	○長谷川 裕之1.2	1.北大院理, 2.情報通信研未来
	17:30 - 17:45	11p-D2-16	高ドープされたCu-TCNQ錯体ナノ結晶の構造・物性評価	○廣瀬 嶺央¹, 小野寺 恒信¹, 笠井 均¹, 及 川 英俊¹	1.東北大多元研
	17:45 - 18:00	11p-D2-17	UV光照射による金属フタロシアニンナノ結晶のOne-pot合成	○樋口 剛志¹, 齊藤 祐太¹, 杉森 秀一², 藪 浩¹	1.東北大多元研, 2.(株) KRI
	3月12日(木)	9:00 - 11:30			
	9:00 - 9:15	12a-D2-1	蛍光体の厚膜ベーストを形成するベースト供給方法	○(D)土屋 均¹², 宮内 攻², 本間 哲哉¹	1.芝浦工業大学大学院, 2.東芝生産術センター
	9:15 - 9:30	12a-D2-2	屈折率を制御した光応答性有機無機ハイブリッドの作製と光応答 性評価	○和田 隆佑¹, 多和田 昌弘¹, 成田 麻美子², 渡辺 修²	1.名城大理工, 2.豊田中研
	9:30 - 9:45	12a-D2-3	スプレー交互積層法による水蒸気バリア性を備えた粘土/ポリマー複合膜の検討	○能登屋 桃子¹, 慶 奎弘¹, 藤本 幸司¹, 白 鳥 世明¹	1.慶大院理工
	9:45 - 10:00	12a-D2-4	水熱法による多孔質シリカ中空カプセルの作製とモデル薬物の充填	○(M2)加藤 直¹, 山口 優¹, 加藤 徳剛¹	1.明大理工

10:00 - 10:15	12a-D2-5	表面修飾による多孔質シリカカプセルの細孔封止	○山口優¹,加藤直¹,加藤徳剛¹	1.明大理工
10:15 - 10:30	12a-D2-6	カテコール基含有高分子ナノシート上へのナノ微粒子の吸着制御	○山本 俊介¹, 内山 駿¹, 宮下 徳治¹, 三ツ 石 方也¹	1.東北大多元研
10:30 - 10:45	12a-D2-7	液晶化に支配されたミクロ相分離構造膜の構造形成機構と制御	○小村 元憲¹, 彌田 智一²	1.沼津高専, 2.東工大資源研
10:45 - 11:00	12a-D2-8	高分子/液晶のメゾ相分離と配向秩序形成の制御および熱応答型調 光素子の開発	○垣内田 洋¹, 吉村 和記¹, 荻原 昭文²	1.産総研, 2.神戸高専
11:00 - 11:15	12a-D2-9	ポリビニルイミダゾールのラビング膜における液晶配向特性 -液晶材料の選択的吸着 -	○山口 留美子¹, 長沼 耀太¹, 小舘 輝¹	1.秋田大工
11:15 - 11:30	12a-D2-10	デザインした液晶配向欠陥の形成と3次元コロイド粒子制御	○吉田 浩之¹, 朝倉 啓太¹, 福田 順一², 尾崎 雅則¹	1.阪大院工、2.産総研ナノシステム

12.1	作製·構造制	御 / Fabricatio	ons and Structure Controls ポス	ター講演	
	3月13日(金)	9:30 - 11:30			
		13a-P13-1	超高速真空蒸着による有機薄膜成長とデバイス特性への影響	○松原 亮介¹, 寺岡 拓麻¹, 小島 広孝¹, 中村 雅一¹	1.奈良先端大物質
		13a-P13-2	溶媒離脱効果に起因する高分子半導体膜表面での金属堆積性変調	○(M2)山口 耕司¹, 辻岡 強¹	1.大阪教育大
		13a-P13-3	種々のバラフィン系材料を用いた蒸着膜の作製と評価	○佐藤 慶太¹, 田中 邦明¹, 臼井 博明¹	1.農工大工
		13a-P13-4	ボリイミド上へのイオン化蒸着法による銅シード層の作製と評価	○神野 友樹¹, 田中 邦明¹, 臼井 博明¹	1.農工大工
		13a-P13-5	イオンアシスト蒸着法を用いたポリイミド表面改質層の形成	○河村 拓¹, 田中 邦明¹, 臼井 博明¹	1.農工大工
		13a-P13-6	蒸着重合によるポリイミド膜の作製と配向制御	マハバン チャンヤー <sup>1</sup> , 菊地 亮介 <sup>1</sup> , 田中 邦明 <sup>1</sup> , ○臼井 博明 <sup>1</sup>	1.農工大工
		13a-P13-7	金属薄膜上での気固相反応によるオクタシアノ金属フタロシアニン合成とナノロッド成長	○小柴 康子¹, 三澤 明日香¹, 西本 光穂子¹, 三崎 雅裕¹, 石田 謙司¹	1.神戸大院工
		13a-P13-8	脂肪酸薄膜形成に及ぼす気相中における会合状態の影響	$\bigcirc$ 小林 拓磨¹, 竹田 治生¹, 蓬莱 健一¹, 久 保野 敦史¹	1.静岡大工
		13a-P13-9	バイオマス溶媒を用いた塗布型有機デバイスの作製	○永松 秀一¹, 有馬 幹尋¹, 高嶋 授¹, パンディシャム¹, 早瀬 修二¹	1.九工大
		13a-P13-10	反応性自己組織化膜を用いた陽極/正孔輸送層の界面制御	○小野 爽太郎¹, 田中 邦明¹, 金 性澔¹, Advincula Rigoberto C.², 臼井 博明¹	1.東京農工大工, 2.Case Western大
		13a-P13-11	ダイヤモンドナノ粒子の電気泳動堆積過程のTEM観察	○後藤 洋介¹, 田中 邦明¹, 大石 不二夫², 臼井 博明¹	1.農工大工, 2.神奈川大理
		13a-P13-12	料分散ポリマーコロイドによるフルカラーマイクロレンズアレイのシリコン基板への作製	○櫻井 芳昭', 畠山 冴子², 田中 剛', 佐藤 和郎', 村上 修一', 田中 恒久', 松永 崇', 榎 本 博行², 山村 昌大¹	1.阪府産技研, 2.大阪電通大
		13a-P13-13	エレクトロスピニングを用いた液体滑液膜の作製と評価	○塚本 拓也¹	1.慶大理工院
		13a-P13-14	静電スプレー堆積法によるP3HT/PCBM相互貫入型構造の作製	○石間 康久¹, 高橋 和志¹, 小野島 紀夫¹	1.山梨大
		13a-P13-15	極薄強誘電性高分子膜の作製と物性評価	○関根 智仁¹, 菅野 亮¹, 田代 智也¹, 福田 憲二郎¹², 熊木 大介¹, 時任 静士¹	1.山形大ROEL, 2.JSTさきがけ
		13a-P13-16	光照射による $C_8$ -BTBT薄膜の再結晶化とトランジスタへの応用	○大西 洋輔¹, 飯塚 尚輝¹, 藤枝 一郎¹	1.立命館大理工
		13a-P13-17	Cul層により分子配向制御されたCuPc膜の電気物性と縦型トランジスタへの応用	○篠田 亘1-2, 武藤 隼斗1-2, 中山 健一1-2	1.山形大院理工, 2.山形大ROEL
		13a-P13-18	摩擦転写法によるローバンドギャップポリマーPTB7の配向薄膜	<ul><li>○谷垣 宣孝¹, ヘック クライレ¹, 溝黒 登志子¹, 柴田 陽生², 宮寺 哲彦², 小金澤 智之³</li></ul>	1.産総研ユビキタス, 2.産総研太陽光, 3.JASRI
		13a-P13-19	量子ビームによる有機太陽電池薄膜におけるドメイン構造の研究	○久保田 正人 <sup>1</sup> , 宮寺 哲彦 <sup>2,4</sup> , 櫻井 岳暁 <sup>3,4</sup> , 吉田 郵司 <sup>2</sup>	1.原子力機構, 2.産総研, 3.筑波大, 4.JSTさきがけ
		13a-P13-20	超高真空下での金単結晶上のペンタセンの薄膜形成過程の構造 評価	○小栗 貴文¹, 多田 圭佑¹, 渡辺 剛³, 小金澤 智之³, 菊池 護¹, 谷 正安², 廣沢 一郎³, 吉本 則之¹	1.岩手大工, 2.RSE(株), 3.高輝度光化 学研究セ
		13a-P13-21	エレクトロスビニング法により紡糸した 紫外線硬化型液晶混合ファイ バー近傍のネマティック液晶配向	○渡戸 優介¹, 渡辺 大貴¹, 工藤 幸寛¹, 高 橋 泰樹¹	1.工学院大
		13a-P13-22	シアニン色素-無機層状化合物複合体の作製とその光応答性	○石原 マリ¹, 平瀬 龍二¹, 吉岡 秀樹¹	1.兵庫県工技セ
		13a-P13-23	酸化亜鉛微粒子-ポルフィリン複合体の発光特性V	○(M1)東影 勇介¹, 原村 聡志¹, 西村 浩二², 水野 斎¹, 広光 一郎¹	1.島根大院総合理工, 2.島根大研究 支援セ
		13a-P13-24	$\mathrm{CH(NH_2)_2Pb(I_{1:x}Br_x)_3}$ 薄膜の作製および評価	〇山中 孝紀', 石川 良', 本多 善太郎', 上野 啓司', 白井 肇'	1.埼玉大院理工
		13a-P13-25	TFEPDDとポリイミドを用いた周期構造の作製	○(M2)徳永 裕輔¹	1.明治大理工
		13a-P13-26	規則ナノ細孔を有する多孔質薄膜を用いたナノバブル発生	○齋藤 栄幸¹, 馬 騰¹, 山本 英明².3.4, 平野 愛弓².3, 庭野 道夫¹	1.東北大通研, 2.東北大院医工, 3.CREST, JST, 4.東北大 学際研
		13a-P13-27	主鎖型高分子錯体ナノ結晶の表面を認識した選択的分子吸着	○鈴木 龍樹¹, 小野寺 恒信¹, 笠井 均¹, 及 川 英俊¹	1.東北大多元研

6.6	6プローブ顕微	対鏡, 12.2 評価・	基礎物性のコードシェアセッション	口頭講演	
	3月13日(金	9:00 - 12:00	)		
	9:00 - 9:15	奨 13a-D14-1	多段階光強度のLM-STSによるP3HT:PCBM系有機薄膜太陽電池 の局所測定	○落合 貴大¹², 安田 剛³, 加藤 洋和¹, 小林 祐貴¹, 吉田 昭二¹, 武内 修¹, 重川 秀実¹	1.筑波大数理物質, 2.タカノ(株), 3.物質・材料研究機構
	9:15 - 9:30	奨 13a-D14-2	動作中の有機トランジスタにおける過渡的キャリア分布のナノスケール可視化	○山岸 裕史¹, 木村 知玄¹, 小林 圭¹², 野田 啓³, 山田 啓文¹	1.京大院工, 2.京大白眉セ, 3.慶應大 理工
	9:30 - 9:45	13a-D14-3	時間分解静電気力顕微鏡による有機半導体グレインへの電荷注入・ 排出過程の可視化	○木村 知玄¹, 山岸 裕史¹, 小林 圭¹², 山 田 啓文¹	1.京大工, 2.京大白眉セ
	9:45 - 10:00	奨 13a-D14-4	探針増強ラマン散乱分光測定における金属探針の温度評価と熱拡 散手法	○(DC)望月 誠仁¹, 小口 真弘¹, 角井 杏帆¹, 矢野 隆章¹, 原 正彦¹, 林 智広¹	1.東工大総理工
	10:00 - 10:15	13a-D14-5	液中FM-AFMによる免疫グロブリンM(IgM)の抗原結合評価	○黄 雲飛 <sup>1</sup> , 木南 裕陽 <sup>1</sup> , 小林 圭 <sup>1,2</sup> , 山 田 啓文 <sup>1</sup>	1.京大工, 2.京大白眉セ

	10:15 - 10:30	奨 13a-D14-6	自己検知型カンチレバーを用いた液中における単一吸着細胞の剥離力測定	○橋本 重孝¹, 安達 誠¹, 岩田 太¹.²	1.静岡大院工, 2.静岡大電研
	10:30 - 10:45		休憩/Break		
招待	10:45 - 11:00	13a-D14-7	「講演奨励賞受賞記念講演」(15分) ポルフィリン-TbIIIダブルデッカー型単分子磁石のSTMによるパター ニングと近藤状態の評価	〇猪瀬 朋子 <sup>1</sup> , 田中 大輔 <sup>1</sup> , Liu Jie <sup>2</sup> , 梶原 美珠 <sup>2</sup> , 米田 忠弘 <sup>2</sup> , 小川 琢治 <sup>1</sup>	1.阪大院理, 2.東北大多元研
	11:00 - 11:15	奨 13a-D14-8	単一分子伝導における分子形状効果の3次元計測	〇片山 智貴', 中村 美紀', 吉田 昭二', 武内修', 重川 秀実'	1.筑波大数理
	11:15 - 11:30	奨 13a-D14-9	CuPc追加蒸着によるPCBMの配列構造の変化	○(M1)桝井 茜¹, 坂上 弘之¹, 高萩 隆行¹, 鈴木 仁¹	1.広島大院先端研
	11:30 - 11:45	奨 13a-D14-10	力検出による近接場光の高分解能観測	○山西 絢介¹, 徳山 貴士¹, 内藤 賀公¹, 李 艶君¹, 菅原 康弘¹	1.阪大院工
	11:45 - 12:00	13a-D14-11	電気化学FM-AFMを用いたイオン液体/ルプレン(001)界面における 探針誘起ナノリソグラフィー	○坂東 賢一¹, 原 援又¹, 森野 裕介¹, 岡田 悠悟², 今西 哲士¹, 横田 泰之¹, 植村 隆文², 竹谷 純一², 福井 賢一¹	1.阪大院基礎工, 2.東大院新領域

12.2	評価·基礎物性 / Charac	terization and Materials Physics ಸ	ポスター講演	
3	3月12日(木) 13:30 - 15	i:30		
	12p-P6-1	DNTT多層膜の成長過程の分子レベル観察	○長谷川 友里¹, 山田 洋一¹, 佐々木 正洋¹, 若山 裕²	1.筑波大数理, 2.物材機構WPI-MANA
	12p-P6-2	グラフェンー色素間の蛍光共鳴エネルギー移動の距離依存性	○古川 一暁¹, 上野 祐子¹, 高村 真琴¹, 日 比野 浩樹¹	1.NTT物性基礎研
	12p-P6-3	金基板およびシリコン基板上に作製したフェロセン誘導体 SAM の 分子整流特性	○(M1)鄭 安純¹, 杉浦 慎太郎¹, 一井 崇¹, 宇都宮 徹¹, 杉村 博之¹	1.京大院工
	12p-P6-4	熱刺激電流(TSC)- EFISHG同時測定によるIZO/polyimide/pentacene/Au素子のキャリアトラップ評価	○田口 大¹, 細川 英機¹, 間中 孝彰¹, 岩 本 光正¹	1.東工大
	12p-P6-5	バイアス印加硬X線光電子分光法による有機薄膜トランジスタの電 位観察	○(PC)渡辺 剛¹, 多田 圭佑², 安野 聡¹, 陰地 宏¹, 吉本 則之², 広沢 一郎¹	1.高輝度光科学研究セ, 2.岩手大工
	12p-P6-6	パルスレーザ光照射による大気中光電子放出	○細貝 拓也¹, 松崎 弘幸¹, 古部 昭広¹, 中村 健¹	1.産総研 計測フロンティア
	12p-P6-7	塗布により作成した有機TFT の方形波重み関数電流DLTS 測定	○吉田 友紀¹, 丹羽 弘典¹, 岡本 啓暉¹, 徳田豊¹, 中村 健二², 加藤 哲弥², 片山 雅之²	1.愛知工大, 2.(株)デンソー
	12p-P6-8	バンドダイアグラム測定装置の開発	○柳生 進二郎¹, 吉武 道子¹, 知京 豊裕¹	1.物材機構
	12p-P6-9	電極間距離が及ぼす単分子検出への影響	○谷本 幸枝¹, 森川 高典¹, 有馬 彰秀¹, 筒井 真楠¹, 谷口 正輝¹	1.阪大産研
	12p-P6-10	コンダクタンスと熱起電力の同時計測による単分子接合の電子状態評価	○筒井 真楠¹, 森川 高典¹, 有馬 彰秀¹, 谷 口 正輝¹	1.阪大産研

3月13日(金	e) 16:30 - 19	:00		
16:30 - 16:45	13p-D14-1	固体基板上への逐次担持によるイオン液体薄膜の作製とその界面 構造の評価	○中条 文哉¹, 森野 裕介¹, 横田 泰之¹, 今西哲士¹, 福井 賢一¹	1.阪大院基礎工
16:45 - 17:00	13p-D14-2	光電子分光法による有機発光デバイス材料Be錯体の集合構造と電子状態の相関研究	○高橋 理記', 牧野 凜太朗', 加藤 賢悟', 米澤 恵一朗', 山口 拓真', 須田 洋輔', 鎌田太介', 深川 弘彦', 上野 信雄', 解良 聡''	1.千葉大院融合, 2.東京理科大, 3.NH 技研, 4.分子研
17:00 - 17:15	13p-D14-3	紫外光電子分光によるテトラセン及びルブレンのホール-振動結合	○佐藤 一至¹, 米澤 恵一朗¹, 山口 拓真¹, 須 田 洋輔¹, 解良 聡¹²	1.千葉大院, 2.分子研
17:15 - 17:30	奨 13p-D14-4	超高感度負イオン光電子分光による極性有機薄膜の空準位の直接 観察	○(DC)金城 拓海!, Lim Hyunsoo¹, 大澤 祐介', 佐藤 友哉!, 中光 栄仁', Thanh Luan Nguyen¹, 浦上 裕希¹, 山崎 純暉², 中山 泰生¹, 石井 久夫¹³	1.千葉大院融合, 2.千葉大工学部, 3.年葉大先進
17:30 - 17:45	奨 13p-D14-5	有機半導体のイオン化エネルギーと電子親和力の分子配向依存と四 重極モーメントの影響	○山田 一斗¹, 吉田 弘幸¹, 佐藤 直樹¹	1.京大化研
17:45 - 18:00		休憩/Break		
18:00 - 18:15	13p-D14-6	低エネルギー逆光電子分光法によるHOPG上のシャトルコック型フタロシアニンの鏡像準位の観測	○吉田 弘幸¹, 白石 龍¹, 佐藤 直樹¹	1.京大化研
18:15 - 18:30	13p-D14-7	BCPの電子状態に関する理論的研究	○柳澤 将 <sup>1,2</sup> , 畑田 真之介², 森川 良忠², 吉田 弘幸³	1.琉球大理, 2.阪大院工, 3.京大化研
18:30 - 18:45	13p-D14-8	弱い相互作用に誘起される分子内軌道エネルギー緩和	○米澤 恵一朗', 山口 拓真', 牧野 凜太朗', 須田 洋輔', Kaveenga Rasika Koswattage', 上野 信雄', 解良 聡 <sup>12</sup>	1.千葉大院融合, 2.分子研
18:45 - 19:00	奨 13p-D14-9	有機薄膜/グラファイト界面における電子-格子相互作用:光電子非弾性散乱の観測	〇山口 拓真', Bussolotti Fabio <sup>2</sup> , Yang Jinpeng', 木村 賢太郎', 松波 雅治 <sup>2</sup> , 上野 信雄', 解良 聡 <sup>1,2</sup>	1.千葉大院融合, 2.分子研
3月14日(土	9:00 - 12:0	00		
9:00 - 9:15	奨 14a-D14-1	透過電子顕微鏡を用いたブルー相液晶の格子構造観察	○田中 秀¹, 吉田 浩之¹, 桒原 隆亮², 西 竜 治², 尾崎 雅則¹	1.阪大院工, 2.阪大電顕センター
9:15 - 9:30	奨 14a-D14-2	アルキル鎖長の異なる液晶性フタロシアニンの薄膜X線構造解析	○(M2)大森 雅志¹, 東 卓也¹, 藤井 彰彦¹, 尾崎 雅則¹	1.阪大院工
9:30 - 9:45	E 14a-D14-3	Shear-Induced Conformation Change in $\alpha$ -crystalline Nylon6: a Way to Modulate and Measure Properties	○Sergei Manzhos¹, Saerif Arabnejad¹, Victor Shim¹, Chaobin He¹	1.Natl. Uni. Singapore
9:45 - 10:00	14a-D14-4	赤外分光によるゼラチン薄膜の乾燥過程における結合水の構造変 化の解析	○大塚 由紀子¹, 白樫 了¹, 平川 一彦¹	1.東大生研
10:00 - 10:15	奨 14a-D14-5	表面プラズモン増強電界によるアゾベンゼン光異性化を用いた透過型 表面プラズモン励起特性変化	○(M1)太田 厳之¹, 桑原 尚希¹, 馬場 暁¹, 大平 泰生¹, 新保 一成¹, 加藤 景三¹, 金子 双男¹	1.新潟大学
10:15 - 10:30		休憩/Break		
10:30 - 10:45	14a-D14-6	ポリマーダイオード動作過程の分光計測による評価	○鐘本 勝一¹, 石川 沙樹¹	1.大阪市大院理

10:45 - 11:00	14a-D14-7	有機半導体の構造秩序の乱れが電荷輸送に与える影響— 秩序 パラメーターに基づく相関のあるディスオーダーモデル ―	○大野 玲¹, 新田 武父¹, 高屋敷 由紀子¹, 飯野 裕明¹	1.東工大像情報
11:00 - 11:15	14a-D14-8	インピーダンス分光を用いた有機半導体デバイスの新規キャリア寿 命評価法	○高木 謙一郎¹, 永瀬 隆¹², 小林 隆史¹², 内 藤 裕義¹²	1.大阪府大院工, 2.大阪府大 分子エレク トロニックデバイス研
11:15 - 11:30	奨 14a-D14-9	過渡電流測定及び電界誘起光第二次高調波測定によるMIS構造中 の有機半導体層のキャリア移動度評価	○中村 大二郎¹, 貞方 敦雄¹, 田口 大¹, 間中 孝彰¹, 岩本 光正¹	1.東工大理工
11:30 - 11:45	14a-D14-10	電界誘起光第二次高調波発生法による2層積層(IZO/PMMA/a-NPD/Au)有機ダイオード素子の電界分布と電気伝導機構の解析	○(M2)西 翔平¹, 田口 大¹, 間中 孝彰¹, 岩 本 光正¹	1.東工大院理工
11:45 - 12:00	14a-D14-11	電界注入型マイクロ波共振法による界面における電荷キャリア輸送 評価	○筒井 祐介¹, 崔 旭鎮¹, 櫻井 庸明¹, 佐伯昭紀¹, 関 修平¹	1.阪大院工
3月14日(土)	) 13:00 - 15:0	00		
13:00 - 13:15	奨 14p-D14-1	EFISHG顕微法による有機素子(IZO/polyimide/C <sub>ω</sub> /Al)の絶縁破壊 前駆現象の観察	○田口 大¹, 間中 孝彰¹, 岩本 光正¹	1.東工大
13:15 - 13:30	14p-D14-2	ベンタセン単結晶上へのC <sub>60</sub> のヘテロエピタキシャル成長	○山本 真之¹, 水野 裕太², 金城 拓海¹, 浦上 裕希¹, 細貝 拓也³, 小金澤 智之⁴, 間瀬 一彦 ⁵, Kaveenga Rasika Koswattage⁵, 中山 泰生 ¹²², 石井 久夫¹²²	1.千葉大院融合, 2.千葉大工, 3.産総研, 4.JASRI, 5.KEK 物構研, 6.千葉大先進
13:30 - 13:45	14p-D14-3	金属イオンを介したルテニウム錯体分子多層膜の長距離電子移動能	○大山 真紀子¹, 永嶌 匠², 小澤 寛晃², 芳賀 正明², 石田 敬雄¹	1.産総研ナノシステム, 2.中央大理工
13:45 - 14:00	14p-D14-4	Ni-C <sub>60</sub> -Niスピンバルブ素子の第一原理計算	○大戸 達彦¹, 山田 亮¹, 夛田 博一¹	1.阪大院基礎工
14:00 - 14:15	14p-D14-5	カーボンナノチューブ・ボリ酸ネットワークのニューロン発火特性のカ オス解析	○付 凌翔¹, 田向 権¹, 小川 琢治², 田中 啓文¹.²	1.九州工業大学, 2.大阪大学
14:15 - 14:30	奨 14p-D14-6	単層グラフェンを上部電極に利用した単分子膜素子の作製	〇山口 真理子¹, 生田 昂², 金井 康², 大戸達彦¹, 山田 亮¹, 大野 恭秀²³, 前橋 兼三²⁴, 松本 和彦², 夛田 博一¹	1.阪大院基礎工, 2.阪大産研, 3.徳島大, 4.農工大工
14:30 - 14:45	奨 14p-D14-7	Au/オリゴチオフェン/Au接合の非弾性トンネルスペクトル測定	○下店 隆史¹, Franchi Jimmy², 田中 彰治³, 大戸 達彦¹, 山田 亮¹, 夛田 博一¹	1.阪大院, 2.スウェーデン王立工科大, 3.分子研
14:45 - 15:00	奨 14p-D14-8	アルカンチオール分子接合のTransition voltage spectroscopy における界面準位および非対称性の寄与	○野勢 大輔¹, 佐藤 友哉¹, 土手 宏樹¹, 石井 久夫¹.², 野口 裕³	1.千葉大院融合, 2.千葉大先進, 3.明 治大学

機能材料・	崩芽的アバイス	/ Functional Materials and Novel Devices	口頭講演	
3月11日(水	9:00 - 11:4	5		
9:00 - 9:15	11a-D4-1	薄膜グラファイトを用いた歪みセンサによる指関節運動のモニタリング	○下田 寛¹, 齋藤 孝成¹, 白樫 淳一¹	1.東京農工大学院工
9:15 - 9:30	11a-D4-2	薄膜グラファイト細線を用いた装着型デバイスによる人体動作の観察	○齋藤 孝成¹, 下田 寛¹, 白樫 淳一¹	1.東京農工大院工
9:30 - 9:45	11a-D4-3	カーボンナノチューブ複合体電極を有する高速応答ボリイミド静電容量型湿度センサの作製とガス透過機構に関する検討	○伊東 栄次¹, 高田 明典¹	1.信州大工
9:45 - 10:00	奨 11a-D4-4	ストレッチャブル配線を用いた伸縮計測センサーの開発	○延島 大樹¹, 小笹 健仁¹, 植村 聖¹, 吉田 学¹	1.産総研FLEC
10:00 - 10:15	奨 11a-D4-5	ストレッチャブルな圧力分布計測シートの開発	○延島 大樹¹, 小笹 健仁¹, 吉田 学¹, 植 村 聖¹	1.産総研FLEC
10:15 - 10:30		休憩/Break		
10:30 - 10:45	奨·E 11a-D4-6	Programmable Biosensor Development for the Electrochemical Detection of Metal Ions	○(P)Rahul Bhardwaj¹, Manish Biyani¹, Yuzuru Takamura¹	1.Japan Advanced Institute of Scienard Technology
10:45 - 11:00	奨 11a-D4-7	エレクトロスビニング法で作製したボリ乳酸ファイバー膜が有する圧 電的挙動の解析	○(P)延島 大樹¹, 石井 佑弥², 酒井 平祐 ³, 植村 聖¹	1.産総研FLEC, 2.豊橋技科大, 3.北 先端大
11:00 - 11:15	奨 11a-D4-8	高導電性ハイドロゲルの合成と力学特性	○久保田 智章¹, 岩下 加奈¹, 奧崎 秀典¹	1.山梨大院
11:15 - 11:30	奨 11a-D4-9	PEDOT/PSS/ポリグリセリン複合フィルムの作製と電気力学特性	○(M1)佐藤 正樹¹, 谷川 諒¹, 久保田 智章 ¹, 奧崎 秀典¹	1.山梨大院
11:30 - 11:45	奨 11a-D4-10	熱応答性ポリマーを用いた無電源アクチュエータ	〇山本 祐輝', 金尾 顕一朗', 有江 隆之', 秋 田 成司', 竹井 邦晴'	1.大阪府大工
3月11日(水	() 13:15 - 17:	45		
13:15 - 13:30	11p-D4-1	ポリチオフェンナノファイバーとPEDOT:PSS積層膜の熱電変換特性評価	○涌井 純馬¹, 樋浦 翔悟¹, 下村 武史¹	1.農工大院
13:30 - 13:45	11p-D4-2	イオン液体添加による単層カーボンナノチューブ熱電変換特性の増 強効果	○堀家 匠平¹, 小柴 康子¹, 三崎 雅裕¹, 斎藤 毅², 石田 謙司¹	1.神戸大院工, 2.産総研
13:45 - 14:00	11p-D4-3	巨大ゼーベック係数を示すフラーレンの回転運動と熱物性との相関性	○小島 広孝¹, 阿部 竜¹, 藤原 史弥¹, 伊藤 光洋¹, 橋爪 拓也¹, 松原 亮介¹, 中村 雅一¹	1.奈良先端大物質
14:00 - 14:15	11p-D4-4	温度変調に伴うキャリア伝導機構変化を利用した新奇有機熱電材料の探索(III):巨大ゼーベック効果の特異性と普遍性	阿部 竜', 藤原 史弥', 高橋 功太郎', 小島 広孝', 松原 亮介', 葛原 大軌', 山田 容子 ', 山本 達也², 薬師寺 秀典², 池田 征明², 〇 中村 雅一'	1.奈良先端大物質, 2.日本化薬
14:15 - 14:30	奨 11p-D4-5	ポリフッ化ビニリデンナノ粒子からなるコロイド結晶の構築とβ相化	○岡田 大地¹, 古海 誓一², 竹口 雅樹³, 山本 洋平¹	1.筑波大院数理物質, 2.東京理科大 3.物質材料機構
14:30 - 14:45	奨·E 11p-D4-6	Tailored hierarchical architectures based on POSS-crystallization kinetics driven self-assembly	○(P)Jinguang Cai¹, Akira Watanabe¹	1.IMRAM, Tohoku Univ.
14:45 - 15:00	11p-D4-7	van der Waals 相互作用エネルギーが乾燥模様に及ぼす影響 II	○大森 豊司¹, 増田 貴史¹, 下田 達也¹²	1.北陸先端大、2.グリーンデバイス研
15:00 - 15:15	11p-D4-8	ジチオール置換銀微粒子単層膜の作製と評価	○龍崎 奏¹, 斎藤 昴¹, 岡本 晃一¹, 玉田 薫¹	1.九大先導研
15:15 - 15:30	11p-D4-9	メタルコートされた異方的半球配列構造の反射光学特性	○福田 隆史¹, 江本 顕雄²	1.産総研 電子光技術, 2.同志社大理
15:30 - 15:45		休憩/Break		
15:45 - 16:00	11p-D4-10	液晶素子を用いたレーザースペックルノイズの低減	○石川 隼¹	1.東理大院基礎工
16:00 - 16:15	11p-D4-11	強度変調と偏光変調が混在した2光波干渉紫外光の一度露光による TN及びホモジニアス配向が混在したベクトル回折格子液晶セル形成	○河合 孝太郎¹, 佐々木 友之¹, 野田 浩平¹, 川月 喜弘², 小野 浩司¹	1.長岡技科大, 2.兵庫県立大
16:15 - 16:30	11p-D4-12	光架橋性高分子液晶を用いたファブリベロー構造を有するホログラフィックベクトル格子の回折特性	〇山口春樹¹,河合孝太郎¹,佐々木友之¹,野田浩平¹,川月喜弘²,小野浩司¹	1.長岡技科大, 2.兵庫県立大
16:30 - 16:45	11p-D4-13	光架橋性高分子液晶を用いた回折格子液晶セル形成と回折特性の キラル分子添加効果	〇志村 礼 <sup>1</sup> , 河合 孝太郎 <sup>1</sup> , 佐々木 友之 <sup>1</sup> , 野田 浩平 <sup>1</sup> , 川月 喜弘 <sup>2</sup> , 小野 浩司 <sup>1</sup>	1.長岡技科大, 2.兵庫県立大

	16:45 - 17:00	奨 11p-D4-14	高分子安定化ブルー相液晶における電気光学カー効果の異方性	○河田 優人¹, 吉田 浩之¹, 菊池 裕嗣², 尾	1.阪大院工, 2.九大先導研
		-	の検討	崎 雅則1	
	17:00 - 17:15	奨 11p-D4-15	分子配向性ネマティックマイクロ粒子の液晶中における電界応答	○今村 弘毅¹, 片山 満吉¹, 吉田 浩之¹, 尾 﨑 雅則¹	1.阪大院工
	17:15 - 17:30	奨 11p-D4-16	基板レス液晶ディスプレイの実現に向けた液晶・高分子配向複合膜 の相分離制御	○佐々木 大介¹, 石鍋 隆宏¹, 藤掛 英夫¹	1.東北大工
	17:30 - 17:45	奨 11p-D4-17	<b>塗布・剥離形成基板を用いたフレキシブル液晶デバイスの作製</b>	○生内 友輔¹, 石鍋 隆宏¹, 藤掛 英夫¹	1.東北大工
	3月12日(木)	9:00 - 11:30			
	9:00 - 9:15	12a-D4-1	ずりを用いて作製された基板面内に螺旋軸を持つコレステリック液晶	○井上 曜¹, 森武 洋¹	1.防衛大電気情報
	9:15 - 9:30	12a-D4-2	3つの応答成分を持つ面内螺旋配向コレステリック液晶の電気光 学効果	○井上 曜¹, 森武 洋¹	1.防衛大電気情報
	9:30 - 9:45	12a-D4-3	強誘電性液晶の一様垂直配向セルの作製	○(M1C)大塚 正志¹, 鈴木 裕二¹, 岡 真一郎², 小林 真一², 古江 広和¹	1.東理大院基礎工, 2.ジャパンディスプレイ
	9:45 - 10:00	12a-D4-4	PSCOF構造を有する液晶セルの作製条件	○原田 拓明¹	1.東理大院基礎工
	10:00 - 10:15	12a-D4-5	PSV-FLCD作製のための添加モノマー種の検討	○宿岡 真¹	1.東理大基礎工
	10:15 - 10:30		休憩/Break		
	10:30 - 10:45	12a-D4-6	光配向性複合体液晶への偏光露光と光配向特性	〇小歩 岳史¹, 佐々木 友之¹, 野田 浩平¹, 川 月 喜弘², 後藤 浩平³, 小野 浩司¹	1.長岡技科大, 2.兵庫県立大, 3.日産 化学工業
	10:45 - 11:00	12a-D4-7	アルキルアミン蒸気処理時間とボリイミド光配向膜の面内異方性と の関係	○坂本 謙二1	1.物材機構
	11:00 - 11:15	12a-D4-8	アルキルスルホン化ボリイミド薄膜のライオトロビック液晶性により誘起 された規則構造とプロトン伝導性の相関	○後藤 崚介¹, 原 光男¹, 長尾 祐樹², 永 野 修作³	1.名大院工, 2.JAIST, 3.名大VBL
	11:15 - 11:30	12a-D4-9	糖脂質系グルコシド液晶の磁場・電場誘起相転移現象	○杉村 明彦¹, 浜砂 大地¹, H.S. Nguan², M. Rahman², R. Hashim², H. Zimmermann³	1.阪産大, 2.マラヤ大, 3.マックスプラ ンク研
	3月12日(木)	13:15 - 17:4	5		
	13:15 - 13:30	12p-D4-1	バルビツール酸誘導体Ni錯体ディスコチック液晶中の正孔移動特性	○(M2)横山 昌憲¹, 向後 潤一¹, Gorecka Ewa², 石川 謙¹	1.東工大院, 2.ワルシャワ大
	13:30 - 13:45	12p-D4-2	バーフルオロアルキル基を持つ有機半導体の光電子分光法により得られる仕事関数の特異性	夫 恒範¹, ソーサ-ヴァルガス リディア¹, 池原成拓², 熊田 泰士², 奥田 大樹¹³, 三宅 康雄¹², 藤井 彰彦², 尾崎 雅則², ○清水 洋¹	1.産総研ユビキタス, 2.阪大院工, 3.龍 谷大理工
	13:45 - 14:00	12p-D4-3	液晶性ジアルキルチエニルナフタレンとP3HTの2成分系におけるキャリヤ移動特性	川野 倖暉¹², 縄本 眞三¹, 西川 浩矢¹², 物部 浩達¹, ○清水 洋¹	1.産総研ユビキタス, 2.龍谷大理工
	14:00 - 14:15	12p-D4-4	銀ナノ粒子-酸化チタン複合フィルムの光電導	○山崎 健輝¹, 石田 拓馬¹, 武者 拓人¹, 藤野 正家¹, 片桐 裕則², 河村 剛³, 松田 厚範³	1.群馬高専, 2.長岡高専, 3.豊橋技科大
	14:15 - 14:30	12p-D4-5	ポリ(3-ヘキシルチオフェン)の基板界面近傍の分子配向	○水野 佑¹, 大野 慶太¹, 原 光生¹, 永野 修作², 関 隆広¹	1.名大院工, 2.名大VBL
	14:30 - 14:45	12p-D4-6	混合膜系のp型およびn型導電性高分子の分子配向	○大野 慶太¹, 水野 佑¹, 原 光生¹, 永野 修作², 関 隆広¹	1.名大院工, 2.名大VBL
	14:45 - 15:00		休憩/Break		
招待	15:00 - 15:15	12p-D4-7	「講演奨励賞受賞記念講演」(15分) 自己組織化π共役高分子マイクロ球体からのWGM発光	〇田畑 顕一¹, Daniel Braam², 櫛田 創¹, 童 亮¹, 桑原 純平¹, 神原 貴樹¹, Axel Lorke², 山本 洋平¹.³	1.筑波大数理物質, 2.デュイスブルグ-エッセン大学物理, 3.筑波大TIMS
	15:15 - 15:30	奨 12p-D4-8	高発光性π共役高分子球体によるWGM発光とエネルギー捕集	○櫛田 創¹, ブラーム ダニエル², 田畑 顕一¹, 柴崎 浩輔¹, タン ダオ³, 石井 智³, 長尾 忠昭³, 桑原 純平¹, 神原 貴樹¹, 木島 正志¹, ロルケ アクセル², 山本 洋平¹	1.筑波院数理, 2.Duisburg-Essen大物理, 3.NIMS, MANA
	15:30 - 15:45	奨 12p-D4-9	有機薄膜への酸素の導入によるSinglet-Triplet Annihilationの抑制	○井上 棟智¹, 松島 敏則¹², 安達 千波矢¹²	1.九州大 OPERA, 2.JST ERATO
	15:45 - 16:00	奨 12p-D4-10	結晶化制御による光導電性増強とその汎用化の検討	○(D)辻村 翔¹², 藤原 隆²³, 佐々 高史², 木 梨 憲司¹, 坂井 亙¹, 石橋 幸治², 堤 直人¹	1.京工繊大院, 2.理研, 3.九州先端研
	16:00 - 16:15	奨 12p-D4-11	高分子ナノシートから作製したSiO <sub>2</sub> 超薄膜の抵抗変化動作	○北中 孝尚¹, 山本 俊介¹, 宮下 徳治¹, 三 ツ石 方也¹	1.多元研
	16:15 - 16:30	12p-D4-12	TPCO結晶マイクロキャビティの角度分解および時間分解レーザー 特性	田中 庸介¹, 後藤 要², 山下 兼一², 山雄 健 史², 堀田 収², 佐々木 史雄³, ○柳 久雄¹	1.奈良先端大物質, 2.京工繊大院工芸, 3.産総研電子光技術
	16:30 - 16:45	12p-D4-13	サイズ制御したp-sexiphenyl単結晶キャビティの発光増幅特性	田村 健次¹, 佐々木 史雄², ○柳 久雄¹	1.奈良先端大物質, 2.産総研電子光技術
	16:45 - 17:00	12p-D4-14	有機色素J会合体を用いたマイクロキャビティの光学特性	○水野 斎¹, 谷尻 尚之¹, 川西 有輝¹, 石墨 淳², 柳 久雄², 廣光 一郎¹	1.島根大総合理工, 2.奈良先端大物質
	17:00 - 17:15	12p-D4-15	有機・無機層状ペロブスカイト光共振器の強結合モードを介した発光	○高田 徳幸¹	1.産総研
	17:15 - 17:30	12p-D4-16	シアニン色素薄膜におけるエネルギー移動による励起子緩和時間 の制御	○長内 順平¹, 小島 磨¹, 喜多 隆¹, 沈 用球²	1.神戸大院工, 2.阪府大院工
	17:30 - 17:45	12p-D4-17	温度変調法による電子型強誘電体 a-(BEDT-TTF) <sub>2</sub> L <sub>3</sub> の焦電流観測	○山本 薫¹, 川島 大樹¹, 横山 直¹	1.岡山理大理
	3月13日(金)	9:00 - 11:00			
	9:00 - 9:15	奨 13a-D4-1	ポリビニルカルバゾールナノファイバーの作製と光導波	○里園 翔太¹, 石井 佑弥¹, 上ノ瀬 亮平¹, 福	1.豊技大
	9:15 - 9:30	奨 13a-D4-2	PEDOT/PSSを用いたアルミ固体電解コンデンサの作製	田 光男 <sup>1</sup> ○竹澤 裕美 <sup>1</sup> , 勝沼 将人 <sup>1</sup> , 奧崎 秀典 <sup>1</sup>	1.山梨大院
	9:30 - 9:45	奨 13a-D4-3	1000 S/cmを超えるPEDOT/PSSの合成と電気特性	○雨宮 裕希¹, 堀井 辰衛¹, 奥崎 秀典¹	1.山梨大院
	9:45 - 10:00	13a-D4-4	n型導電性高分子の安定性について -アルキル化(p-ビリジルビ	○小野田 光宣¹	1.兵庫県立大院工
	10:00 - 10:15	13a-D4-5	ニレン) - 熱刺激電流測定法及び電気光学定数測定法による有機電気光学ポ	○(M2)池本 龍馬¹, 田口 大¹, 間中 孝彰¹,	1.東工大理工, 2.情報通信研究機構
招待	10:15 - 11:00	13a-D4-6	リマーの熱安定性の評価 「有機分子・バイオエレクトロニクス 分科内招待講演」(45分)	岩本 光正¹, 山田 俊樹², 大友 明² 〇彌田 智一¹	1.東工大
			分子回路工学をめざした分子グリッド配線技術		

3月13日(金	) 16:30 - 18	8:30		
	13p-P15-1	ハイブリッド配向型液晶偏光回折格子における高次回折特性	○(B)高橋 夏輝¹, 本間 道則¹, 能勢 敏明¹	1.秋田県立大学
	13p-P15-2	液晶偏光マスクによる液晶光配向バターンの形成	○(B)安藝 諭宇馬¹, 本間 道則¹, 能勢 敏明¹	1.秋田県立大学
	13p-P15-3	ナノファイバー/液晶複合素子の立ち下がり時間のファイバー密度 依存性	○Duong Toan¹, 尾崎 良太郎², 井上 曜 ¹, 森武 洋¹	1.防衛大電気情報, 2.愛媛大院理工
	13p-P15-4	高分子安定化ブルー相液晶セルの電気光学応答に与える高分子の 影響に関する研究	○松本 崇裕¹, 木村 宗弘¹	1.長岡技科大
	13p-P15-5	スリット電極型液晶シリンドリカルレンズアレイによる光偏向効果(II)	○内田 勝¹, 梁瀬 智¹, 王 濱¹	1.秋田産技センター
	13p-P15-6	横電界駆動 TNLC によるフレクソエレクトリック係数評価	○(M2)FILZAHBINTI ZAINALARIF¹, 松 本 紘希¹, 木村 宗弘¹, 赤羽 正志¹	1.長岡技術科学大学
	13p-P15-7	マイクロストリップライン電極構造におけるn形液晶の分子配向特性	○永澤 雅!, 小室 匠¹, 笹森 崇行¹, 磯田 陽 次!, 渡辺 猛², 伊藤 謙二², 伊東 良太¹, 本間 道則¹, 能勢 敏明¹	1.秋田県大システム, 2.由利工業(株
	13p-P15-8	導波管測定による多孔質PMMAフィルムにおける液晶分子配向効 果の検討	○大野 真之介¹, 伊東 良太¹, 本間 道則¹, 能勢 敏明¹	1.秋田県大システム
	13p-P15-9	±45° TN液晶セルの偏光回転効果におけるセル厚依存性の検討	○(M1)竹内 亨', 伊東 良太', 本間 道則', 藤田 直子², 岡野 桂樹², 村田 純², 村口 元², 尾崎 紀昭², 能勢 敏明'	1.秋田県大システム, 2.秋田県大生物
	13p-P15-10	厚いネマティック液晶層を有するデバイスの高分子安定化による応 答改善	<ul><li>○ブイバオ¹, 樋口 博紀², 菊池 裕嗣², 井上曜¹, 森武 洋¹</li></ul>	1.防衛大, 2.九大先導研
	13p-P15-11	Uniform Standing Helixモード液晶素子の基礎研究	○小野寺 郁也¹	1.長岡技科大院工
	13p-P15-12	低電圧駆動型液晶レンズの高速駆動における解像度特性	○近藤 祐治¹, 王 濱¹, 石井 雅樹², 梁瀬 智¹, 高橋 慎吾¹	1.秋田産技センター, 2.秋田県大
	13p-P15-13	第3電極を持つ液晶シリンドリカルレンズの2D/3D切り替え特性	○梁瀬 智¹, 内田 勝¹, 王 濱¹	1.秋田産技センター
	13p-P15-14	$TCF-CF_3$ アクセプターを含むNLO色素の合成	○(M1)鈴木 亮太¹, 北川 顕磨¹, 間瀬 暢之¹, 鳴海 哲夫¹, 杉田 篤史¹	1.静岡大工
	13p-P15-15	ナノインプリントを用いたポリチオフェン誘導体の結晶構造制御	○塚田 涼太¹, 串 聡志¹, 下村 武史¹	1.農工大院
	13p-P15-16	有機ナノファイバーコンポジットフィルムの半導体特性	○八木 杜仁¹, 下村 武史²	1.農工大工, 2.農工大院工
	13p-P15-17	ポリチオフェン誘導体のナノファイバー形成メカニズム	○伊藤 大樹¹, 下村 武史², 三浦 俊明³	1.農工大工, 2農工大院工, 3.産総
	13p-P15-18	有機層にπ共役系高分子を導入した臭化鉛系層状ベロブスカイト有機・無機超格子Langmuir-Blodgett膜の作製	○(B)白鳥 武¹, 早田 皓一¹, 坂口 幸一¹, 江 良 正直¹	1.佐賀大理工
	13p-P15-19	ポリジアセチレンナノ結晶の薄膜化と非線形光学応答のサイズ依存性	○(M1)真木 晴季¹, 小野寺 恒信¹, Sato Rodrigo², 武田 良彦², 笠井 均¹, 及川 英俊¹	1.東北大多元研, 2.物材機構
	13p-P15-20	色素添加ポリマー光ファイバーの垂直応力下での出射光解析	○(B)溝呂木 大地¹, 牧野 建志¹, 西村 亮一², 塚田 賢治², 二瓶 栄輔², 古川 怜¹	1.電気大情報学先進古研, 2.慶應大工学物理二研
	13p-P15-21	ポリマーダイオードにおける電気容量の磁場効果	○中嶋 敬幸¹, 鐘本 勝一¹	1.阪市大院理
	13p-P15-22	溶液塗布法による有機強誘電体薄膜(PVDF薄膜)の成膜	○中山 貴裕¹, 今井 裕司², 馬 騰¹, 山本 英明³.4, 平野 愛弓³.4, 庭野 道夫¹	1.東北大通研, 2.仙台高専, 3.東北ナ 医工, 4.CREST,JST
	13p-P15-23	アゾ・カルバゾール色素における光誘起屈折率格子の形成VII	○夛田 量宏¹, 今井 敏郎¹, 川辺 豊¹	1.千歳科技大
	13p-P15-24	アゾビナフチル分散PMMA膜における光誘起屈折率変化の機構	○佐々 高史¹, 清水 智樹¹², 藤原 隆¹³, 川本益揮¹, 礒島 隆史¹, 木下 岳司², 石橋 幸治¹	1.理研, 2.慶大理工, 3.九州先端研
	13p-P15-25	ジアリールエテン/銅複合膜における電流双安定性	○(B)信長 賢輝¹, 土肥 愛実¹, 辻岡 強¹	1.大阪教育大
	13p-P15-26	ジアリールエテン膜のキャリア注入異性化反応を用いたメモリ素子 の動作原理	○(M1)山本 一樹¹, 辻岡 強¹	1.大阪教育大
	13p-P15-27	(TTF)(TCNQ)蒸着膜における抵抗率とゼーベック係数の温度依存性	○佐藤 諒之介¹, 角屋 智史¹, 川本 正¹, 森 健彦¹	1.東工大院理工
	13p-P15-28	THz波センサ応用にむけた有機電界効果トランジスタの作製とTHz 波光伝導度測定	○木元 鴻太郎¹, 鈴木 諒¹, 羽田 正雄¹, 李世光², 小島 広孝¹, 松原 亮介¹, 中村 雅一¹	1.奈良先端大物質, 2.西安理工大
	13p-P15-29	酸化亜鉛微粒子とアントラセン誘導体間のエネルギー移動	○水野 斎¹, 垣内 君斗¹, 東影 東影¹, 石墨淳², 柳 久雄², 廣光 一郎¹	1.島根大総合理工, 2.奈良先端大物
	13p-P15-30	微細金属ワイヤへのポリピロール薄膜形成	○出村 洋智¹, 永吉 浩¹	1.東京高専
	13p-P15-31	GZO/有機半導体/MoO $_{ m y}$ /Au構造における抵抗変化型write onceメモリ効果の発現	○長谷川 純也¹, 永瀬 隆¹², 小林 隆史¹², 内藤 裕義¹²	1.大府大工, 2.大阪府立大分子エレロニックデバイス研
	13p-P15-32	シアノ置換TPCO誘導体結晶を用いたマイクロキャビティの発光特性	○畑野 良太¹, 田中 庸介¹, 山下 兼一², 山雄 健史², 堀田 収², 佐々木 史雄³, 柳 久雄¹	1.奈良先端大物質, 2.京工繊大院工 3.産総研電子光技術
	13p-P15-33	メタルコートされた球・半球構造における反射光学特性の比較	○江本 顕雄¹, 川井 優也¹, 大谷 直毅¹, 福 田 隆史²	1.同志社大理工, 2.産総研
	13p-P15-34	バイオミメティック匂いセンサ(BMOS)の最適ホスト材料の探索	○上野 陽佑¹, 小島 大樹¹, 三田地 成幸¹	1.東京工科大
	13p-P15-35	スメクチック液晶におけるキラリティと分子ゆらぎ	○平岡 一幸¹, 川崎 良太¹, 山本 愛実¹, 小宮 研一郎¹	1.東京工芸大工
	13p-P15-36	金属アルコキシドを用いた有機無機ハイブリッド薄膜太陽電池の高 効率化	○加藤 岳仁¹, 梅壽 光大¹, 伊澤 悟¹, 田中 好一¹, 萩原 直樹², 加藤 有行³	1.小山高専, 2.アシザワ・ファインテッ株), 3.長岡技大

12.	4 有機EL・トラ	シンジスタ / Org	anic light-emitting devices and organic transistor	s 口頭講演		
	3月11日(水) 9:30 - 11:45					
	9:30 - 9:45	11a-D3-1	高効率白色リン光有機ELデバイスの開発	○宇田川 和男¹, 笹部 久宏¹², 五十嵐 史彬¹, 城戸 淳二¹²	1.山形大院理工, 2.山形大有機エレ研セ	
	9:45 - 10:00	11a-D3-2	95 lm W-1 超の電力効率を示す低駆動電圧緑色TADF有機ELデバイスの開発	猪股 晋¹, ○清野 雄基¹, 笹部 久宏¹², 夫 勇 進¹², 城戸 淳二¹²	1.山形大院理工, 2.山形大有機エレ研セ	
	10:00 - 10:15	11a-D3-3	酸化亜鉛透明導電膜を用いた逆構造有機発光ダイオードの作製と 評価	○高田 誠¹, 永瀬 隆¹², 小林 隆史¹², 内 藤 裕義¹²	1.大阪府立大, 2.大阪府立大分子エレクトロニックデバイス研	

10:15 - 10:30	奨 11a-D3-4	塗布マルチフォトンエミッション型有機EL素子	○千葉 貴之¹, 夫 勇進¹, 井手田 一茂¹, 高橋 省吾¹, 相澤 直矢¹, 引地 達也¹, 城戸 淳二¹	1.山形大院理工
10:30 - 10:45	奨 11a-D3-5	低屈折率電子輸送層を用いた有機EL素子における表面プラズモン 損失の低減とその光学解析	○垣添 勇人¹, 米原 健矢¹, 澤部 智明¹, 杉 啓司¹, 加藤 大望¹, 真常 泰¹, 小野 富男 ¹, 中井 豊¹	1.(株)東芝 研究開発センター
10:45 - 11:00	11a-D3-6	熱活性化遅延蛍光材料の光誘導吸収の励起光強度依存性	○丹羽 顕嗣¹, 高木 絢生¹, 小林 隆史¹², 永 瀬 隆¹², 合志 憲一³⁴, 安達 千波矢³⁴, 内 藤 裕義¹²	1.大阪府大工, 2.大阪府大RIMED, 3 大OPERA, 4.九大WPI-I2CNER
11:00 - 11:15	11a-D3-7	有機EL膜の界面混合状態とその動的挙動に関するエリブソメトリー分析	○横山 大輔1.2.3, 柴田 真希¹, 酒井 義也²	1.山形大院理工, 2.山形大工, 3.山形 有機エレ研究センター
11:15 - 11:30	11a-D3-8	スピンコートにおける低分子及び高分子有機EL材料の膜形成過程 の観察	○硯里 善幸1.2, 井上 晴夫2	1.山形大有機イノベ, 2.首都大院都市環境
11:30 - 11:45	奨·E 11a-D3-9	Horizontal molecular orientation in solution-processed organic light-emitting diodes based on an oligofluorene derivative	○(D)Li Zhao¹, Takeshi Komino¹².²³, Munetomo Inoue¹, Ju-Hyung Kim¹, Jean- Charles Ribierre¹³, Chihaya Adachi¹².²³	1.Center for Organic Photonics and Electronics Research (OPERA) Kyushu University, Japan, 2.Educatic Center for Global Leaders in Mo- lecular System for Devices, Kyushu University, Japan, 3.Japan Science at Technology Agency (JST), ERATO, Adachi Molecular Exciton Engineeri Project, Japan
3月11日(水)	13:15 - 18:0	00		
13:15 - 13:30	11p-D3-1	積層型有機ELにおける界面蓄積電荷に関するラマン分光研究	○唐津 勇作¹, 古川 行夫¹, 大畑 浩², 宮口 敏², 筒井 哲夫²	1.早稲田大先進理工, 2.次世代化学校 評価技術研究組合
13:30 - 13:45	奨 11p-D3-2	ナノ微細構造OLEDを用いたSinglet-Polaron Annihilationの抑制	○(B)新田 篤志¹, 桑江 博之²³, 吉田 巧 ¹, 井上 棟智¹, 松島 敏則¹², 水野 潤²³, 安 達 千波矢¹²	1.九大OPERA, 2.JST ERATO, 3.早
13:45 - 14:00	11p-D3-3	ドーブ層を持つ有機EL素子の配向分極による深いトラップの観測	○石野 竜太¹, 中光 栄仁¹, 金 炯濬¹, 野口 裕², 石井 久夫¹³	1.千葉大融合, 2.明治大理工, 3.千葉 大先進
14:00 - 14:15	奨 11p-D3-4	EFISHGおよびLBIC測定による二層積層有機EL素子内のキャリア 挙動解析	○貞方 敦雄¹, 田口 大¹, 間中 孝彰¹, 岩 本 光正¹	1.東工大·理工
14:15 - 14:30	奨 11p-D3-5	デバイスシミュレータによるCuPc/正孔輸送層の電導解析	○坂井田 雅人¹, 光崎 茂松¹, 雷 丙尤¹, 古橋 秀夫¹, 森 竜雄¹	1.愛知工大
14:30 - 14:45		休憩/Break		
14:45 - 15:00	11p-D3-6	ケルビンプローブフォース顕微鏡によるペンタセン薄膜トランジスタの 局所活性化エネルギー評価	○黄 子玲¹, 木村 知玄¹, 小林 圭¹², 山 田 啓文¹	1.京大工, 2.京大白眉セ
15:00 - 15:15	奨 11p-D3-7	化学修飾金電極がベンタセン薄膜トランジスタに及ぼす影響の数値 的検討	○長浜 陽生¹, 野田 啓¹, 和田 恭雄¹, 鳥 谷部 達²	1.慶應大理工, 2.東洋大
15:15 - 15:30	11p-D3-8	CNT-電極間の接触抵抗解析	○殿内 規之¹, 松本 翼¹, 二瓶 史行¹, 遠藤 浩幸¹	1.日本電気
15:30 - 15:45	11p-D3-9	キャリアコヒーレンスに起因する有機半導体移動度のトランスファー 積分符号依存性	○松井 弘之¹, 岡本 敏宏¹, 三津井 親彦¹, 山岸 正和², 佐藤 寛泰³, 山野 昭人³, 竹谷 純一¹	1.東大新領域, 2.富山高専, 3.リガク
15:45 - 16:00	E 11p-D3-10	Development of solvent-free tunable and flexible liquid organic semiconductor lasers	OJeanCharles Ribierre <sup>1,2</sup> , Ju-Hyung Kim <sup>1</sup> , Munetomo Inoue <sup>1</sup> , Li Zhao <sup>1</sup> , Takeshi Komino <sup>1,2,3</sup> , Chihaya Adachi <sup>1,2,3</sup>	1.OPERA, Kyushu Univ., 2.JST ER TO, 3.Kyushu Univ.
16:00 - 16:15	11p-D3-11	BP3T単結晶の光増幅特性におけるポーラロン効果	○宮崎 真澄¹, 坂上 知¹, 高橋 亘¹, 堀田 収², 竹延 大志¹	1.早大先進, 2.京都工繊大
16:15 - 16:30		休憩/Break		
16:30 - 16:45	11p-D3-12	二種類の蛍光ポリマーを混合した発光電気化学セルにおける活性層 組成と発光色の相関	<ul><li>○瀧澤 大介¹, 西出 宏之¹, 錦谷 禎範¹, 内田 聡一², 矢崎 さなみ², 西村 涼²</li></ul>	1.早大理工, 2.JX日鉱日石エネルギー(株)
16:45 - 17:00	11p-D3-13	ホスホニウム系イオン液体を用いた青色発光電気化学セル	○松本 慶太¹, 酒井 平祐¹, 村田 英幸¹	1.北陸先端大マテリアル
17:00 - 17:15	11p-D3-14	イオン液体を用いた電気化学トランジスタにおける導電性高分子の薄膜構造と電気伝導特性	○(M2)原田 知典¹, 伊東 裕¹, 安藤 良洋¹, 田中 久暁¹, 黒田 新一¹	1.名大院工
17:15 - 17:30	11p-D3-15	PBTTT/イオン液体有機トランジスタのキャリヤー解析と電流電圧特性に関する研究	○古川 行夫¹, 秋山 浩太郎¹, 山本 潤¹	1.早大先進理工
17:30 - 17:45	11p-D3-16	Au / DNTT / Al ショットキーダイオードの伝導特性	○林 稔晶¹, 志立 錬², 横田 知之², 藤原 聡¹, 染谷 隆夫²³	1.NTT物性研, 2.東京大学, 3.ERAT
17:45 - 18:00	11p-D3-17	有機薄膜の電流電圧曲線および薄膜中の電荷分布に対する解析 的な理論	○関和彦¹	1.産業技術総合研究所
3月12日(木)	9:00 - 11:45			
9:00 - 9:15	12a-D3-1	スライドボート法によるダブルヘテロ構造有機結晶薄膜作製	○佐々木 史雄¹, 望月 博孝¹, 柳 久雄², 堀 田 lbr³	1.産総研電子光技術, 2.奈良先端大学
9:15 - 9:30	12a-D3-2	p型変調による縦型面状発光トランジスタの発光効率改善	田 收 <sup>3</sup> ○小賀坂 直樹 <sup>1</sup> , 武藤 隼斗 <sup>1</sup> , 中山 健一 <sup>1,2</sup>	質, 3.京工繊大院工芸 1.山形大院理工, 2.山形大ROEL
9:30 - 9:45	奨 12a-D3-3	赤色燐光材料ドーブ層を有するフルオレン系積層有機発光トランジス タの作製と発光特性	○原 三喜雄¹, 梶井 博武¹, 大森 裕¹	1.阪大院工
9:45 - 10:00	奨 12a-D3-4	乳酸イオンを検出可能な延長ゲート有機トランジスタ型酵素センサ の開発	○南 豪 <sup>1,2</sup> , 佐藤 翼 <sup>1,2</sup> , 南木 創 <sup>1,2</sup> , 福田 憲二 郎 <sup>1,2</sup> , 熊木 大介 <sup>1,2</sup> , 時任 静士 <sup>1,2</sup>	1.山形大院理工, 2.山形大ROEL
10:00 - 10:15	奨 12a-D3-5	ポリマーを用いた高感度温度センサの生体・医療デバイス応用	○横田 知之 <sup>1,2</sup> , 井上 雄介 <sup>1,2</sup> , Reeder Jonathan <sup>1,3</sup> , Ware Taylor <sup>3</sup> , Voit Walter <sup>3</sup> , 関野 正 樹 <sup>1,2</sup> , 関谷 毅 <sup>2,4</sup> 染谷 隆夫 <sup>1,2</sup>	1.東京大学, 2.JST, ERATO, 3.The University of Texas, 4.阪大産研
10:15 - 10:30		休憩/Break	四,四日双,不甘性人	
10:30 - 10:45	12a-D3-6	印刷銀電極を用いたRFID回路用整流ダイオードの作製と評価	○FAIZ ADI¹, 岡部 羊平¹, 横澤 晃二²³, 秦 典 竹田²³, 福田 憲次郎²³, 熊木 大介²³, 時 任 翰-+²³	1.サトーホールディングス, 2.山形大院 工, 3.山形大 ROEL
10:45 - 11:00	12a-D3-7	印刷型超短チャネル有機薄膜トランジスタの変調特性改善	任 静士 <sup>2.3</sup> ○竹田 泰典 <sup>1.2</sup> , 吉村 悠大 <sup>1.2</sup> , 岡本 朋子 <sup>3</sup> , 儘田 正史 <sup>1.5</sup> , 福田 憲二郎 <sup>1.2,4</sup> , 熊木 大介 <sup>1.2</sup> , 片山 嘉則 <sup>3</sup> , 時任 静士 <sup>1.2</sup>	1.山形大院理工, 2.山形大 ROEL, 3.DIC株式会社, 4.JST さきがけ, 5.山 大 INOEL
		塗布型有機単結晶トランジスタを用いたCMOS集積回路	○山村 祥史¹, 添田 淳史¹, 境 駿希¹, 岸村	1.東大新領域, 2.阪府産技研, 3.パイ:

11:15 - 11:30	奨 12a-D3-9	印刷型有機トランジスタの閾値電圧制御と回路応用	〇塩飽 黎', 吉村 悠大', 竹田 泰典', 福 田 貴', 福田 憲二郎' <sup>1,3,4</sup> , 熊木 大介 <sup>1,4</sup> , 時 任 静士 <sup>1,4</sup>	1.山形大院理工, 2.東ソー, 3.JST さきがけ, 4.山形大ROEL
11:30 - 11:45	12a-D3-10	メタルベース有機トランジスタを用いたエミッタフォロワ回路	○上妻 嵩季¹, 武藤 隼斗¹, 小賀坂 直樹¹, 中山 健一¹.²	1.山形大院理工, 2.山形大ROEL

		ganic light-emitting devices and organic transistor	s ポスター講演	
月12日(木	(1) 16:00 - 18	:00		
	12p-P12-1	スカイブルー発光を示す熱活性化遅延蛍光材料の緩和過程の解析	○(B)長谷山 翔太¹, 高木 絢生¹, 丹羽 顕嗣¹, 小林 隆史¹², 永瀬 隆¹², 合志 憲一³⁴, 安達 千波矢³⁴, 内藤 裕義¹²	1.大阪府大工, 2.大阪府大分子 トロニックデバイス研, 3.九大 O 4.九大 WPI-I2CNER
	12p-P12-2	高次の三重項励起状態を考慮したTADF材料の緩和モデルの検討	○高木 絢生 <sup>12</sup> , 丹羽 顕嗣 <sup>12</sup> , 小林 隆史 <sup>12</sup> , 永瀬 隆 <sup>12</sup> , 合志 憲一 <sup>3,4</sup> , 安達 千波矢 <sup>3,4</sup> , 内 藤 裕義 <sup>1,2</sup>	1.大阪府大工, 2.RIMED,, 3.九; OPERA, 4.九大 WPI-I2CNER
	12p-P12-3	電子注入層としてPEIEを用いた逆構造透明有機EL素子	○佐野 弘尚¹, 中 茂樹¹, 岡田 裕之¹²	1.富山大・院理工, 2.富山大・自 究支援センター
	12p-P12-4	(チオフェン/フェニレン)コオリゴマー誘導体積層膜を用いた有機EL 素子	○土器屋 翔平¹, 佐々木 史雄², 堀田 収³, 柳 久雄¹	1.奈良先端大物質, 2.産総研電術, 3.京工繊大院工芸
	12p-P12-5	プラズマ重合法による有機EL素子用アントラセン薄膜の作製	○(M1)宮本 勝成¹, 佐藤 祐喜¹, 吉門 進三¹	1.同志社大院理工
	12p-P12-6	スパッタ法による酸化モリブデンをホール注入層とした有機EL素子	○慈幸 範洋¹, 三木 綾¹, 志田 陽子¹, 越智 元隆¹, 釘宮 敏洋¹	1.神戸製鋼所
	12p-P12-7	導電性高分子材料PEDOT:PSSを用いた二層積層有機ELのキャリア挙動解析	○大塚 貴子¹, 貞方 敦雄¹, 田口 大¹, 間中 孝彰¹, 岩本 光正¹	1.東工大·理工
	12p-P12-8	ポリマーFETの印刷製造とキャリア注入層の挿入効果の検討	○金森 暉¹, 伊東 栄次¹	1.信州大工
	12p-P12-9	紫外線重合したポリシルセスキオキサンゲート絶縁膜を用いたベンタ セン薄膜トランジスタ	○芝尾 秀人¹, 中原 佳夫¹, 宇野 和行¹, 田 中 一郎¹	1.和歌山大システム工
	12p-P12-10	高移動度および高耐熱性を有する有機電界効果トランジスタ	○阿部 正宏 <sup>1,2</sup> , 森 崇充 <sup>2</sup> , 尾坂 格 <sup>2</sup> , 瀧 宮 和男 <sup>2</sup>	1.日本化薬株式会社, 2.理研CE
	12p-P12-11	有機半導体薄膜のインクジェット印刷形成のMD計算による検討	○米谷 慎¹, 峯廻 洋美¹, 山田 寿一¹, 長谷 川 達生¹.²	1.産総研, 2.東大
	12p-P12-12	C <sub>12</sub> -BTBT OFETの作製と評価	○中道 諒介¹, 永瀬 隆¹², 小林 隆史¹², 貞光 雄一³, 内藤 裕義¹²	1.大阪府立大学, 2.分子エレクト デバイス研, 3.日本化薬(株)
	E 12p-P12-13	Basic Study on Organic Thin-Film Transistors with Various Kinds of Interfacial Layers	○(DC)BINTISHAARI SAFIZAN¹, Hiroyuki Okada¹, Shigeki Naka¹	1.University of Toyama
	12p-P12-14	アルキル置換酸素架橋N字型有機半導体の固体物性と塗布プロセス性の検証	○(M1)田中 翔太1², 三津井 親彦², 井原 将司², 山岸 正和³, 田中 佑治¹, 矢野 将文¹, 佐藤 寛泰⁴, 山野 昭人⁴, 竹谷 純一², 岡 本 敏宏125	1.関西大院理工, 2.東大新領域, 高専, 4.リガク, 5.JSTさきがけ
	12p-P12-15	塗布プロセスによる高移動度n型有機電界効果トランジスタ	○末永 悠¹, 永瀬 隆¹², 小林 隆史¹², 内 藤 裕義¹²	1.大阪府大工, 2.大阪府大分子。 ロニックデバイス研
	12p-P12-16	有機フレキシブルTFTにおける繰り返し曲げの効果	○山口 祥平¹, 佐々木 達彦¹, 林 潤郎¹, 酒井 正俊¹, 国吉 繁一¹, 山内 博¹, 貞光 雄一², 品 村 祥司², 工藤 一浩¹	1.千葉大院工, 2.日本化薬
	12p-P12-17	光焼成法による銀ナノ粒子を使った印刷電極の高速焼成プロセス の検討	○熊木 大介 <sup>1,2</sup> , 原田 敦 <sup>1,2</sup> , 後藤 芳政 <sup>1,2</sup> , 福 田 憲二郎 <sup>1,2</sup> , 時任 静士 <sup>1,2</sup>	1.山大院理工, 2.山大ROEL
	12p-P12-18	電解質ゲート有機トランジスタを用いたヒスタミン検出	○橋間 裕貴¹, 南 豪²³, 南木 創²³, 熊木 大 介²³, 時任 静士²³	1.山形大工, 2.山形大院理工, 3. 大ROEL
	12p-P12-19	延長ゲート有機トランジスタ型免疫センサによる非標識ヒトIgA検出	○(B)佐々木 由比¹, 南 豪²³, 南木 創²³, 栗 田 僚二⁴, 丹羽 修⁴, 脇田 慎一⁴, 福田 憲二 郎²³, 熊木 大介²³, 時任 静士²³	1.山形大工, 2.山形大院理工, 3. ROEL, 4.産総研
	12p-P12-20	強誘電性高分子層の熱処理温度による強誘電体ゲート有機薄膜トランジスタのメモリ特性改善	○菅野 亮 <sup>1,2</sup> , 関根 智仁 <sup>1,2</sup> , 福田 憲二郎 <sup>1,2,3</sup> , 熊木 大介 <sup>1,2</sup> , 時任 静士 <sup>1,2</sup>	1.山形大理工, 2.山形大 ROEL, さきがけ
	12p-P12-21	有機半導体を用いたフレキシブル温度センサとCMOS読出回路	〇中山 健吾 <sup>1</sup> , 車 溥相 <sup>1</sup> , 金岡 祐介 <sup>12</sup> , 宇 野 真由美 <sup>12</sup> , 三津井 親彦 <sup>2</sup> , 岡本 敏宏 <sup>2,3</sup> , 竹 谷 純 $^{-1.2}$	1.阪府産技研, 2.東大新領域, 3. きがけ
	12p-P12-22	フルオレン系高分子配向薄膜を用いた積層有機面発光トランジスタ の偏光発光特性	○(M1)大友 隆弘¹, 田中 仁¹, 橋本 和弥¹, 梶井 博武¹, 大森 裕¹	1.阪大院工
	12p-P12-23	半導体レーザ励起による有機VCSELの室温バルス発振	〇谷沢 元春 <sup>1</sup> , 高橋 良平 <sup>1</sup> , 丸山 武男 <sup>1</sup> , 飯山 宏一 <sup>1</sup>	1.金沢大理工

12.4	l 有機EL・トラ	ンジスタ / Org	anic light-emitting devices and organic transistor	s 口頭講演			
	3月13日(金) 9:00 - 11:45						
	9:00 - 9:15	奨 13a-D3-1	グラフェン電極を用いたポリチオフェン誘導体の伝達特性評価	○生田 昂¹, 丹波 俊輔', 金井 康¹, 大野 恭 秀¹², 前橋 兼三¹³, 井上 恒一¹, 家 裕隆¹, 安 蘇 芳雄¹, 松本 和彦¹	1.阪大産研, 2.徳島大, 3.農工大		
	9:15 - 9:30	奨 13a-D3-2	斜方蒸着を用いた電荷発生型有機電界効果トランジスタのオンオフ比改善	○田村 英継¹, 皆川 正寛², 馬場 暁¹, 新保 一成¹, 加藤 景三¹, 金子 双男¹	1.新潟大学, 2.長岡高専		
	9:30 - 9:45	13a-D3-3	圧縮粉末を用いた有機トランジスタ	○松島 敏則1.2, 江崎 有1, 安達 千波矢1.2	1.九大OPERA, 2.JST ERATO		
	9:45 - 10:00	13a-D3-4	圧縮配向化による高移動度ポリマートランジスタの作製とバンド伝導 性の評価	〇山下 侑', 添田 淳史', 鶴見 淳人', 岡田 悠悟', 松井 弘之', 尾坂 格³, 瀧宮 和男³, 竹谷 純一¹	1.東大新領域, 2.阪大工, 3.理研		
	10:00 - 10:15	13a-D3-5	EFI-SHG 法による高配向高分子半導体薄膜の注入および輸送異方性評価	○(M2)安部 健太郎¹, 松原 幸平¹, 間中 孝彰¹, 岩本 光正¹	1.東工大·理工		
	10:15 - 10:30		休憩/Break				
	10:30 - 10:45	13a-D3-6	分子ドービングしたポリマー薄膜のバターン電極を用いた全有機型ト ランジスタの作製	○但木 大介¹, 馬 騰¹, 木村 康男², 庭野 道夫¹	1.東北大通研, 2.東京工科大		
	10:45 - 11:00	13a-D3-7	超音波溶融法による低耐熱基板上への有機薄膜の形成	○佐々木 達彦¹, 高 徳幸¹, 山口 祥平¹, 林 潤郎¹, 山崎 陽太¹, 酒井 正俊¹, 山内 博³, 国吉繁一¹, 貞光 雄一², 品村 祥司², 工藤 一浩¹	1.千葉大院工, 2.日本化薬		
	11:00 - 11:15	13a-D3-8	印刷銅電極を用いた塗布型有機TFTの高性能化	○(M1)乗田 翔平¹, 松浦 陽², 福田 貴³, 福 田 憲二郎¹⁴, 熊木 大介¹⁴, 時任 静士¹.⁴	1.山形大院理工, 2.山形大工, 3.東ソー, 4.山形大ROEL		

11:15 - 11:30	13a-D3-9	電荷変調イメージング法による有機薄膜トランジスタの劣化機構解析	○堤 潤也¹, 松岡 悟志¹, 山田 寿一¹, 長谷 川 達生 <sup>1,2</sup>	1.産総研, 2.東大工
11:30 - 11:45	13a-D3-10	三端子容量-電圧測定による有機発光トランジスタのキャリア挙動の 観測	○山本 紘平¹, 田中 仁², 梶井 博武², 大森 裕², 野口 裕³, 石井 久夫¹.4	1.千葉大院融合, 2.阪大院工, 3.明大理工, 4.千葉大先進
3月14日(土)	9:15 - 12:0	0		
9:15 - 9:30	14a-D3-1	V字型有機半導体分子の理論的研究: 分子間相互作用	○下位 幸弘¹, 都築 誠二¹, 岡本 敏宏²³, 三 津井 親彦², 竹谷 純一², 佐藤 寛泰⁴, 山 野 昭人⁴	1.産総研ナノシステム, 2.東大院新領域, 3.JST さきがけ, 4.リガク
9:30 - 9:45	14a-D3-2	フェナセン系有機薄膜電界効果トランジスタの形成と論理回路応用	○三上 隆弘¹, 下 侑馬¹, 村上 寬虎¹, 浜尾 志乃¹, 後藤 秀徳¹, 久保園 芳博¹, 林 靖彦¹	1.岡山大院自然
9:45 - 10:00	14a-D3-3	[8]フェナセン単結晶を用いた高性能電界効果トランジスタの作製	○(M1C)下 侑馬¹, 三上 隆弘¹, 村上 寛虎¹, 浜尾 志乃¹, 後藤 秀徳¹, 岡本 秀毅¹, 郷田慎², 佐藤 かおり², 林 靖彦¹, 久保園 芳博¹	1.岡山大院自然, 2.ナード研究所
10:00 - 10:15	14a-D3-4	ビチアゾールテトラチオン骨格を用いた大気安定n型有機トランジスタ	Agathe Filatre-Furcate¹, Dominique Lorcy¹, ○東野 寿樹², 森 健彦²	1.レンヌ第一大学, 2.東工大院理工
10:15 - 10:30	14a-D3-5	新規有機半導体 DTBDT の結晶薄膜形成過程の解析	○福田 貴¹, 山川 浩¹, 渡辺 真人¹, 古川 博章¹, 福田 憲二郎²³, 熊木 大介²³, 時任 静士²³	1.東ソー株式会社, 2.山形大院理工, 3.1 形大ROEL
10:30 - 10:45		休憩/Break		
10:45 - 11:00	奨 14a-D3-6	可溶性アルキルピセンを用いた単結晶トランジスタの特性	○小池 優作 <sup>1</sup> , 門崎 正樹 <sup>2</sup> , 岡本 一男 <sup>2</sup> , 功 刀 義人 <sup>1</sup>	1.東海大院工, 2.ウシオケミックス(株)
11:00 - 11:15	14a-D3-7	モノアルキル置換Ph-BTBT誘導体を用いたFETの作製と特性評価―アルキル鎖長依存性―	○飯野 裕明¹, 岡村 寿¹, 臼井 孝之¹, 半 那 純一¹	1.東工大像情報
11:15 - 11:30	14a-D3-8	Ph-BTBT-10多結晶薄膜を用いたBottom-gate Bottom-contact型 FETの作製と特性評価	○飯野 裕明¹, 臼井 孝之¹, 半那 純一¹	1.東工大像情報
11:30 - 11:45	14a-D3-9	高溶解性アルキル置換セレン架橋V字型有機半導体材料の固体物性とデバイス特性	○岡本 敏宏 <sup>1,2</sup> , 三津井 親彦 <sup>1</sup> , 岸 柾之 <sup>1</sup> , 山岸 正和 <sup>3</sup> , 吉本 和美 <sup>1</sup> , 佐藤 寛泰 <sup>1</sup> , 山野 昭人 <sup>4</sup> , 竹谷 純一 <sup>1</sup>	1.東大院新領域, 2.JSTさきがけ, 3.富山 高専, 4.リガク
11:45 - 12:00	奨 14a-D3-10	新規塗布型低分子半導体の高分子材料との混合による有機TFTの 特性向上	○(M2)鈴木 達也¹, 福田 貴², 福田 憲二郎 ¹.3.4, 熊木 大介¹.3, 時任 静士¹.3	1.山形大学院理工, 2.東ソー, 3.山形大 ROEL, 4.JSTさきがけ
3月14日(土)	13:00 - 14:	45		
13:00 - 13:15	14p-D3-1	ボトムコンタクト型ペンタセンOFETのL/W比依存性	○Fadli Ondi¹, Nithi Atthi¹, 大見 俊一郎¹	1.東工大総理工
13:15 - 13:30	14p-D3-2	n型低分子半導体/絶縁性高分子の混合インクを用いた有機薄膜トランジスタの高性能化	○(M2)青塚 晟¹, 垣田 一成², 島 秀好², 米 田 康洋², 田中 康裕², 儘田 正史¹³, 福田 憲 二郎¹⁴, 熊木 大介¹⁴, 時任 静士¹⁴	1.山形大院理工, 2.宇部興産, 3.山形大INOEL, 4.山形大ROEL
13:30 - 13:45	14p-D3-3	短チャネル・短コンタクト長全印刷型トランジスタ	○福田 憲二郎 <sup>123</sup> , 岡本 朋子 <sup>4</sup> , 儘田 正史 <sup>1.5</sup> , 熊木 大介 <sup>1,2</sup> , 片山 嘉則 <sup>4</sup> , 時任 静士 <sup>1,2</sup>	1.山形大院理工, 2.山形大ROEL, 3.JS' さきがけ, 4.DIC株式会社, 5.山形大 INOEL
13:45 - 14:00	14p-D3-4	全印刷手法による基板レス有機トランジスタの作製 -剥離層と絶縁 膜の条件探索-	○福田 憲二郎 <sup>1,2,3</sup> , 藤田 知樹 <sup>1</sup> , 熊木 大介 <sup>1,2</sup> , 時任 静士 <sup>1,2</sup>	1.山形大院理工, 2.山形大ROEL, 3.JS さきがけ
14:00 - 14:15	14p-D3-5	オールウェットプロセスによる低電圧駆動可能な有機単結晶トランジスタ	〇境 駭希!, Roger Häusermann!, 伊東 正洁', 金岡 祐介', 山村 祥史!, 松井 弘之', 三津井 親彦', 岡本 敏宏'-4, 宇野 真由美 $^2$ , 竹 谷 純 $^{-12}$	1.東大新領域, 2.阪府産技研, 3.EEJA, 4.JSTさきがけ
14:15 - 14:30	14p-D3-6	めっき法により形成したAuAg Hybrid電極を有する有機トランジス	○伊東 正浩1-2, 宇野 真由美2-3, 竹谷 純一2-3	1.EEJA, 2.東大新領域, 3.阪府産技研
14:30 - 14:45	14p-D3-7	短チャネル塗布型有機トランジスタを用いた有機CMOS回路	○宇野 真由美 <sup>1,2</sup> , 金岡 祐介 <sup>1,2</sup> , 諫早 伸明 <sup>2</sup> , 柳生 慎悟 <sup>2</sup> , 境 駿希 <sup>2</sup> , 山村 祥史 <sup>2</sup> , 松井 弘 之 <sup>2</sup> , 車 溥相 <sup>1</sup> , 中山 健吾 <sup>1</sup> , 三津井 親彦 <sup>2</sup> , 岡本 敏宏 <sup>2,4</sup> , 竹谷 純— <sup>1,2,3</sup>	1.阪府産技研, 2.東大新領域, 3.パイク スタル, 4.JSTさきがけ

12.5	12.5 有機太陽電池 / Organic solar cells					
	3月11日(水)	9:00 - 11:45	5			
	9:00 - 9:15	11a-D15-1	三元プレンド系全高分子型薄膜太陽電池の開発	○辨天 宏明¹, 西田 貴哉¹, 森 大輔¹, 大北 英生¹², 伊藤 紳三郎¹	1.京大院工, 2.JST さきがけ	
	9:15 - 9:30	11a-D15-2	新規ナフトビスオキサジアゾール系ポリマーの太陽電池特性	○川島 和彰1.2, 尾坂 格1.3, 瀧宮 和男1.2	1.理研CEMS, 2.広大院工, 3.JSTさ きがけ	
	9:30 - 9:45	11a-D15-3	有機薄膜太陽電池の高電圧化に寄与するフラーレン誘導体	○辛川 誠¹, 永井 隆文², 足達 健二², 家 裕 隆¹, 安蘇 芳雄¹	1.阪大産研, 2.ダイキン	
	9:45 - 10:00	11a-D15-4	スピロ(チオ)アセタール化フラーレン太陽電池の性能支配因子	○佐伯 昭紀¹, 三木江 翼¹, 伊熊 直彦¹, 小久 保 研¹, 関 修平¹	1.阪大院工	
	10:00 - 10:15	奨 11a-D15-5	置換スピロアセタール化フラーレンの立体異性体構造が有機太陽電 池性能に与える影響	○(DC)三木江 ツバサ¹, 佐伯 昭紀¹, 山崎 優¹, 伊熊 直彦¹, 小久保 研¹, 関 修平¹	1.阪大院工	
	10:15 - 10:30		休憩/Break			
	10:30 - 10:45	11a-D15-6	PTB7:C <sub>70</sub> 複合体を用いた耐熱性のある塗布型有機太陽電池	○多田 和也1	1.兵庫県立大工	
	10:45 - 11:00	11a-D15-7	ジケトビロロビロール骨格を有する光変換半導体材料を用いた塗布 積層型へテロp-i-n太陽電池	〇山口 裕二 $^{1.4}$ , 高平 勝也 $^{1.4}$ , 内永 憲佑 $^2$ , 鈴木 充朗 $^2$ , 山田 容子 $^{2.3}$ , 中山 健 $^{-1.3.4}$	1.山形大院理工, 2.奈良先端大物質, 3.CREST, 4.山形大ROEL	
	11:00 - 11:15	11a-D15-8	一重項分裂を示す非縮合多環系分子の合成と有機薄膜太陽電池 への応用	○(DC)河田 総¹, 夫 勇進¹², 斉藤 彩華¹, 羽 田 真毅²³, 笹部 久宏¹, 城戸 淳二¹	1.山形大院理工, 2.JSTさきがけ, 3.東工 大応セラ研	
	11:15 - 11:30	11a-D15-9	ビフルオレニリデン誘導体の合成と有機薄膜太陽電池での一重項分 裂挙動の検証	○古館 準樹¹, 夫 勇進¹², 木村 拓也¹, 河 田 総¹, 斉藤 彩華¹, 羽田 真毅²³, 笹部 久宏 ¹, 城戸 淳二¹	1.山形大院理工, 2.JSTさきがけ, 3.東工 大応セラ研	
	11:30 - 11:45	11a-D15-10	ベンゾトリアザポルフィリン誘導体の基礎物性とバルクへテロ接合薄 膜太陽電池における光電変換特性	○藤井 彰彦¹, Dao Quang-Duy¹, 大森 雅志¹, 渡辺 光一¹, 井谷 弘道¹², Sosa-Vargas Lydia², 清水 洋², 尾崎 雅則¹	1.阪大院工, 2.産総研ユビキタス	

	3月11日(水	) 13:15 - 18:	00		
招待	13:15 - 13:45	11p-D15-1	「有機分子・バイオエレクトロニクス 分科内招待講演」(30分) 高効率ポリマーブレンド太陽電池の開発	〇大北 英生 <sup>1,2</sup> , 森 大輔 <sup>1</sup> , 辨天 宏明 <sup>1</sup> , 伊 藤 紳三郎 <sup>1</sup>	1.京大院工, 2.JST さきがけ
	13:45 - 14:00	11p-D15-2	2種類のドナーポリマーを積層したバルクヘテロ接合有機太陽電池	○岡田 健¹, 藤田 克彦²	1.九州大総理工, 2.九州大先導研
	14:00 - 14:15	11p-D15-3	高分子ドメイン内のPC <sub>71</sub> BM含有量による太陽電池特性変化	○安田 剛¹, 米澤 宏平², 櫻井 岳暁², 武市泰男³, 菅 大暉¹, 高橋 嘉夫³, 井波 暢人³, 間瀬 一彦³, 小野 寛太³, 守友 浩²	1.物材機構, 2.筑波大, 3.高エネ研, 4.広島大, 5.東大
	14:15 - 14:30	11p-D15-4	PTB7 / $C_{70}$ ヘテロ接合薄膜の電荷ダイナミクス	○米澤 宏平¹, 安田 剛², 守友 浩¹.3	1.筑波大数理, 2.物材機構, 3.筑波大 CiRfSE
	14:30 - 14:45	11p-D15-5	PFNパッファー層を有するPTB7:PC $_{77}$ BM有機薄膜太陽電池の性能に及ぼす PFN膜厚の効果	○落合 鎮康¹, (P) ムルゲサン ヴィジェイス リニバサン¹, 津田 紀生¹, 山田 諄¹	1.愛知工大
	14:45 - 15:00		休憩/Break		
	15:00 - 15:15	11p-D15-6	MoO 陰極バッファーを用いるバルクヘテロ接合型有機薄膜太陽電池の開発	○景山 弘¹, 長谷部 大知¹, 林 翔太郎¹, 梶井博武², 大森 裕², 城田 靖彦²	1.琉球大工, 2.阪大院工
	15:15 - 15:30	11p-D15-7	p-i-n型素子を用いたdonor-acceptor分子における光電圧損失の評価	○大倉 達也¹, 吉田 司¹², 中山 健一¹²	1.山形大院理工, 2.山形大ROEL
	15:30 - 15:45	11p-D15-8	有機共蒸着光電変換層への100 ppmドーピングによる光電流増大	○大橋 知佳 <sup>1,2</sup> , 新村 祐介 <sup>2,3</sup> , 久保 雅之 <sup>2,3</sup> , 平本 昌宏 <sup>1,2,3</sup>	1.総研大, 2.分子研, 3.CREST
	15:45 - 16:00	E 11p-D15-9	Electrodeposited Al-doped ZnO films for Hybrid Solar Cells	○(D)Jennifer DamascoTy¹, Nadine Dannehl², Derck Schlettwein², Yanagi Hisao¹	1.NAIST, 2.JLU Giessen
	16:00 - 16:15	11p-D15-10	表面改質技術を用いた無機有機太陽電池の開発	〇菅野 裕希¹, 佐藤 慶介¹, 深田 直樹², 平 栗 健二¹	1.東京電機大学工, 2.物質·材料研究 機構
	16:15 - 16:30		休憩/Break		
	16:30 - 16:45	E 11p-D15-11	Performance evaluation of PTB7/PC $_{71}\rm BM$ organic solar cells fabricated by spin and spray coating method	OVijaysrinivasan MURUGESAN¹, Shusu- ke Ono¹, Norio Tsuda¹, Jun Yamada¹, Shizuyasu Ochiai¹	1.Aitech
	16:45 - 17:00	11p-D15-12	電気泳動法により製膜した極薄酸化チタンナノシートを電子選択層と した逆構造バルクヘテロ接合型有機薄膜太陽電池の作製	○酒井 翔太¹, 後藤 慶紀¹, 大澤 彰浩¹, 坂 優助¹, 伊東 栄次¹	1.信州大工
	17:00 - 17:15	11p-D15-13	逆構造型バルクヘテロ接合太陽電池のための塗布型極薄電子取り出 し層と電極界面の電位障壁制御に関する検討	○伊東 栄欠¹, 後藤 慶紀¹, 福田 勝利²	1.信州大工, 2.京大
	17:15 - 17:30	11p-D15-14	順構造型有機薄膜太陽電池の耐熱性向上	○森 茂彦¹, 五反田 武志¹, 大岡 青日¹, 中尾 英之¹, 都鳥 顕司¹, 斉藤 三長¹, 細矢 雅弘¹	1.東芝研究開発センター
	17:30 - 17:45	11p-D15-15	モジュール構造が有機薄膜太陽電池の信頼性に与える影響	○森田 秀幸1.2, 宮下 正範2, 増田 淳3	1.太陽光発電技術研究組合, 2.東レ, 3.産総研
	17:45 - 18:00	11p-D15-16	インピーダンス分光とデバイスシミュレーションによるPTB7:P $\mathbf{C}_n$ BM有機薄膜太陽電池の劣化解析	大面 隆範¹, ○村田 憲保¹, 杉山 拓也¹, 中塚 英美¹², 小林 隆史¹³, 永瀬 隆¹³, 内藤 裕義³³4	1.大阪府立大学, 2.三菱化学科学技術研究センター, 3.大阪府立大分子エレクトロニックデバイス研, 4.JST-CREST
	3月12日(木	9:00 - 11:3	0		
招待	9:00 - 9:15	12a-D15-1	「講演奨励賞受賞記念講演」(15分) 結晶性有機薄膜太陽電池における電荷解離ダイナミクス	〇玉井 康成 <sup>1</sup> , 津田 一樹 <sup>1</sup> , 大北 英生 <sup>1,2</sup> , 辨 天 宏明 <sup>1</sup> , 伊藤 紳三郎 <sup>1</sup>	1.京大院工, 2.JSTさきがけ
	9:15 - 9:30	12a-D15-2	有機薄膜太陽電池の乱れた界面における励起子解離の量子過程	○(DC)飯塚 秀行¹, 中山 隆史¹	1.千葉大理
	9:30 - 9:45	12a-D15-3	有機半導体界面での励起子解離過程におけるキャリア-格子相互 作用	○(M1)枡潟 慶充¹, 中山 隆史¹	1.千葉大理
	9:45 - 10:00	12a-D15-4	狭バンドギャップポリマーにおける一重項励起子分裂	○笠井 普文¹, 玉井 康成¹, 大北 英生¹², 辨 天 宏明¹, 伊藤 紳三郎¹	1.京大院工, 2.JST さきがけ
	10:00 - 10:15	12a-D15-5	ローバンドギャップポリマーを用いた有機薄膜太陽電池における正孔 移動度の膜厚依存性	〇成岡 達彦¹, 中塚 英美¹², 小林 隆史¹³, 永 瀬 隆¹³, 内藤 裕義¹³⁴	1.大阪府大工, 2.三菱化学, 3.分子エレク トロニックデバイス研, 4.JST-CREST
	10:15 - 10:30		休憩/Break		
	10:30 - 10:45	12a-D15-6	有機薄膜太陽電池における p 型半導体アルキル鎖長の電荷寿命 への影響	○奥田 浩一¹, 森 正悟²	1.信州大院理工, 2.信州大繊
	10:45 - 11:00	12a-D15-7	赤外分光を用いた位置規則性ポリ(3-ヘキシルチオフェン)(P3HT) :[6,6]-phenyl-C <sub>61</sub> -butyric acid methyl ester (PCBM)混合膜のトラップキャリヤーおよび光化学反応の研究	○古川 行夫¹, 金澤 啓', 吉田 大樹¹	1.早大先進理工
	11:00 - 11:15	12a-D15-8	TiO <sub>、</sub> 電子捕集層を用いた逆型高分子太陽電池における紫外光照射 効果下の電荷蓄積箇所のESR研究	○(D)孫 東鉉¹, 矢野 勝寛², 桑原 貴之², 高 橋 光信², 丸本 一弘¹.3	1.筑波大院数物, 2.金沢大院自然, 3.筑 波大学学際セ
	11:15 - 11:30	12a-D15-9	固体NMR分光法によるバルクヘテロ接合有機薄膜太陽電池への添加剤効果の解析(II)	○緒方 啓典1-2, 河野 紗希1	1.法政大生命科学, 2.法政大マイクロ・ナ ノテクノロジー研

12.5 有機太陽電	電池 / Organic s	olar cells ポスター講演		
3月12日(7	k) 13:30 - 15:	30		
	奨·E 12p-P7-1	Perovskite Morphology and Coverage Ratio Control to $\mathrm{CH_3NH_3PbI_3}$ Solar Cells	○(PC)Binglong Lei¹, Eze Vincent¹, Hideo Furuhashi¹, Tatsuo Mori¹	1.Aichi Inst. Tech.
	奨·E 12p-P7-2	Impact of Homogenous Perovskite Layer in Organometal Halide Perovskite Solar Cells	○(M2C)Vincent Eze¹, Binglong Lei¹, Furuhashi Hideo¹, Mori Tatsuo¹	1.Aichi Institute of Technology
	奨 12p-P7-3	両極性低分子を用いたヘテロ接合型薄膜の電荷ダイナミクス	○高橋 洋輔¹, 米澤 宏平¹, 安田 剛², 守 友 浩¹.³	1.筑波大数理, 2.物材機構, 3.筑波大 CiRfSE
	奨·E 12p-P7-4	Efficiency Enhancement of Organic Solar Cells by Suppressing Recombination at Cathode Interface	○(D)Xia Hao¹, Shenghao Wang¹, Takeaki Sakurai¹, Katsuhiro Akimoto¹	1.Univ. of Tsukuba
	12p-P7-5	フタロシアニン薄膜を用いた擬ショットキー障壁型太陽電池の特性	岡田 香菜¹, 樋口 進哉¹, 宮崎 優¹, 水野 斎¹, ○広光 一郎¹	1.島根大院総合理工
	12p-P7-6	金属/酸化物多層膜を陽極として用いた半透明有機薄膜太陽電池 の作製	○藤井 俊治郎¹, 田中 丈士¹, 片浦 弘道¹	1.産総研ナノシス
	12p-P7-7	キノキサリンイミド骨格を有する新規D-A-D型有機半導体材料の合成 と有機薄膜太陽電池への応用	○松本 英俊¹, 青柳 晃太朗¹, 芦沢 実¹, 鴻 巣 裕一¹	1.東工大院理工
	E 12p-P7-8	Characterizations of Electron Transport Layer in Flexible Organic Thin Films Solar Cell via Spray LBL method	○(D)Atthaporn Ariyarit <sup>1</sup> , Seimei Shiratori <sup>1</sup>	1.Keio Univ.
	12p-P7-9	静電塗布法を用いたPBDTTT-EFT:PC <sub>71</sub> BM有機薄膜太陽電池	○戸田 明日来¹, 鈴木 勝己¹, 福田 武司¹, 鎌田 憲彦¹, 本多 善太郎¹	1.埼玉大工
	12p-P7-10	ベンゾチアジアゾールで架橋されたボルフィリン二量体の合成とその 太陽電池特性	○中川 貴文¹, 岡田 洋史¹, 松尾 豊¹	1.東大院理

12p-P7-11	繊維を基材とした色素増感太陽電池の開発	○嶋田 一裕¹, 豊田 丈紫¹, 広沢 清勝², 加藤 昭彦²	1.石川県工業試験場, 2.倉庫精練株 式会社
12p-P7-12	高電圧印加陽極酸化による酸化チタンナノチューブ光電極の作製	○藤満 新太¹, 岸 直希¹, 曾我 哲夫¹	1.名古屋工大
12p-P7-13	Pt-グラフェン対極を用いた色素増感太陽電池	○星 肇¹, 田中 駿平¹, 三好 崇司¹	1.山口東京理科大工
12p-P7-14	陽極酸化法による酸化チタンナノチューブ成長への電極金属の影響	○(M1)平賀 章浩¹, 川上 亮¹, 佐藤 祐喜¹, 吉門 進三¹	1.同志社大院理工
12p-P7-15	インクジェットプリンター用 ${ m TiO_2}$ インクの開発と評価	○下山 夕貴¹, 植松 弘哉¹, 功刀 義人¹	1.東海大院工
12p-P7-16	非加熱及びスプレー法により形成した色素増感太陽電池の特性	○吉田 博行¹, 明石 和也¹, 森田 廣¹	1.山口東京理大工
12p-P7-17	積層型ペロブスカイト太陽電池における大気暴露の影響	○山本 晃平¹, 古本 嘉和¹, 桑原 貴之¹, 高橋 光信¹, 當摩 哲也¹²	1.金沢大学, 2.JST-さきがけ
12p-P7-18	正孔輸送材のベロブスカイト層への拡散についての考察	○金谷 周朔¹, 西野 仁², 伊藤 省吾¹	1.兵県大工, 2.大阪ガス株式会社
12p-P7-19	ベロブスカイト型太陽電池への銀ナノ粒子添加効果	○森川 弘理¹, 丸山 翔大¹, 片山 大輔¹, 緒 方 啓典¹	1.法政大学院理工
12p-P7-20	真空蒸着法を用いた層状ペロブスカイト化合物の成膜と特性評価	○片山 大輔 <sup>1,2</sup> , 丸山 翔大 <sup>1,2</sup> , 森川 弘理 <sup>1,2</sup> , 緒方 啓典 <sup>1,2</sup>	1.法政大学院理工, 2.法政大マイクロ・ナノテク 研
12p-P7-21	Si/PEDOT:PSS〜テロ接合太陽電池の劣化機構	○武居 雄輝¹, 八木 大地¹, 石川 良¹, 白井 肇¹, 上野 啓司¹	1.埼玉大院理工
12p-P7-22	Si/PEDOT:PSSハイブリッド太陽電池の作製とPEDOT:PSS膜のGIXD測定	○池田 なつみ <sup>1</sup> , 加治屋 大介 <sup>1,2</sup> , 小金澤 智 之 <sup>4</sup> , 齋藤 健一 <sup>1,2,3</sup>	1.広大理, 2.広大自然セ, 3.広大院理, 4.高輝度光科学研究セ
12p-P7-23	霧化塗布法によるテクスチャーSi /PEDOT:PSS接合太陽電池	○大木 達也¹, 市川 浩気¹, 石川 良¹, 上野 啓司¹, 白井 肇¹	1.埼玉大理工
12p-P7-24	FTIR-ATR によるc-Si/PEDOT:PSS 界面化学結合評価と太陽電 池性能	○船田 修司¹, 大木 達也¹, 市川 浩気¹, 石川 良¹, 上野 啓司¹, 白井 肇¹	1.埼大理工研
12p-P7-25	P(VDF-TeFE)強誘電体高分子を挿入したc-Si/PEDOT:PSS 太陽電池	○舛森 建太¹, 劉 奇明¹, 石川 良¹, 上野 啓 司¹, 白井 肇¹	1.埼玉大
E 12p-P7-26	Enhanced BSF of c-Si/PEDOT:PSS heterojunction solar cells	○(M2C)Ramesh Devkota¹, Tatsuya Ohki¹, Koki Ichikawa¹, Ryo Ishikawa¹, Keiji Ueno¹, Hajime Shirai¹	1.Saitama University
12p-P7-27	低分子有機太陽電池のトラップと発電特性	○布村 正太 <sup>1,2</sup> , Che X. <sup>2</sup> , Forrest S. <sup>2</sup>	1.産総研, 2.ミシガン大
12p-P7-28	有機薄膜太陽電池における光劣化挙動の分光学的考察	○(PC)玉井 康成¹, 大北 英生¹, 辨天 宏明¹, 伊藤 紳三郎¹, 宮前 孝行², 山成 敏広³	1.京大院工, 2.産総研, 3.CEREBA
12p-P7-29	インビーダンス分光法による逆構造太陽電池の電子物性解析	大面 隆範!, ○村田 憲保!, 杉山 拓也!, 中塚 英美!², 小林 隆史!³, 永瀬 隆!³, 内藤裕義!³⁴	1.大阪府立大学、2.三菱化学科学技術研究センター、3.大阪府立大分子エレクトロニックデバイス研、4.JST-CREST
12p-P7-30	電界誘起光第2次高調波測定を用いたバルクヘテロ型太陽電池の PEDOT:PSS層への2次ドーピングの評価	○三和 健人¹, 田口 大¹, 間中 孝彰¹, 岩 本 光正¹	1.東工大·理工
12p-P7-31	光誘導吸収測定による有機薄膜太陽電池におけるトラップの観察	○中美 総司 <sup>1,2,3</sup> , 成岡 達彦 <sup>1,2,3</sup> , 砂原 智徳 <sup>1,2,3</sup> , 永瀬 隆 <sup>1,2,3</sup> , 小林 隆史 <sup>1,2,3</sup> , 内藤 裕義 <sup>1,2,3</sup>	1.大阪府大, 2.分子エレクトロニックデバイス研, 3.JST-CREST
12p-P7-32	ITO透明導電性基板上への鉛ベロブスカイト太陽電池の低温プロセス作製	○水田 凱¹, 浦野 年由², 梅山 有和³, 今堀博³4, 伊藤 省吾¹	1.兵県大工, 2.CEREBA, 3.京大工, 4.京 大WPI-iCeMS
12p-P7-33	平滑構造のCH <sub>3</sub> NH <sub>3</sub> PbI <sub>3</sub> / CuSCN太陽電池の作製	○田中 聡一郎¹, 西野 仁², 伊藤 省吾¹	1.兵県大工, 2.大阪ガス株式会社
12p-P7-34	有機鉛ベロブスカイト/結晶シリコンタンデム太陽電池	○(M2)神田 広之¹, ウズム アブドーラ¹, 田 中 聡一郎¹, 梅山 有和², 今堀 博²³, 西野 仁 ⁴, 伊藤 省吾¹	1.兵県大工, 2.京大工, 3.京大WPI- iCeMS, 4.大阪ガス

12.5	有機太陽電流	也 / Organic so	plar cells 口頭講演		
	3月13日(金)	9:00 - 12:00			
	9:00 - 9:15	奨 13a-D15-1	ドナー/アクセプター界面第一層のエネルギー準位が有機薄膜太陽 電池性能に与える影響	○(DC)伊澤 誠一郎 <sup>1,2</sup> , 中野 恭兵 <sup>2</sup> , 鈴木 かおり <sup>2</sup> , 橋本 和仁 <sup>1</sup> , 但馬 敬介 <sup>2,3</sup>	1.東大院工, 2.理研CEMS, 3.さきがけ
	9:15 - 9:30	13a-D15-2	ドナー/アクセプター界面のエネルギー準位と二分子再結合過程	○中野 恭兵¹, 伊澤 誠一郎¹², 真弓 智裕¹², 鈴木 かおり¹, 橋本 和仁², 但馬 敬介¹³	1.理研 CEMS, 2.東大院工, 3.さきがけ
	9:30 - 9:45	奨 13a-D15-3	高感度紫外光電子分光および光電子収量分光によるPTB7:PC <sub>70</sub> BM 混合膜の電子構造観察	○佐藤 友哉¹, 中山 泰生¹, 中村 浩昭³, 石 井 久夫¹.²	1.千葉大融合, 2.千葉大先進, 3.出光 興産
	9:45 - 10:00	奨 13a-D15-4	有機薄膜太陽電池のドナー/アクセプター界面におけるキャリア挙動 の解析	○真弓 智裕 <sup>1,2</sup> , 中野 恭兵 <sup>2</sup> , 橋本 和仁 <sup>1</sup> , 但 馬 敬介 <sup>2,3</sup>	1.東大院工, 2.理研, 3.さきがけ
	10:00 - 10:15	奨 13a-D15-5	ppm極微量ドーピングによる光電流増大効果	○久保 雅之1.2, 菊池 満1.2, 平本 昌宏1.2	1.分子研, 2.CREST/JST
	10:15 - 10:30	奨 13a-D15-6	ソルボサーマル法により合成したモリブデン化合物を正孔捕集層として用いた有機薄膜太陽電池	○濱田 圭祐¹, 村上 大貴¹, 中野 洋人¹, 上村直¹, 村上 直也¹, 横野 照尚¹	1.九工大院工
	10:30 - 10:45		休憩/Break		
	10:45 - 11:00	奨·E 13a-D15-7	Optimization of suitable chloride precursor for better crystal growth of $\mathrm{MAPbI}_3$	○(DC)Vigneshwaran Murugan¹, Terumi Nishimura¹, Yuhei Ogomi¹, Tingli Ma¹, Shyam Pandey¹, Shuzi Hayase¹	1.Kyushu Institute of Technology
	11:00 - 11:15	奨 13a-D15-8	銀コア金シェルナノ粒子を含んだ色素増感太陽電池の特性	○(M1)祖母井 晶¹, 鈴木 仁¹, 高萩 隆行¹, 坂上 弘之¹	1.広島大院 先端研
	11:15 - 11:30	13a-D15-9	Study on plasmon induced electron injection mechanism in $\operatorname{Au-TiO}_2$ nanoparticle system (1)lifetime observation of excited states by fs laser pump-probe PEEM	李 博超¹, 季 博宇¹, 林 景全¹, ○富江 敏尚¹²	1.長春理工大, 2.産総研
	11:30 - 11:45	E 13a-D15-10	Computational Design of Small Phenothiazine Dyes for Dye-Sensitized Solar Cells by Functionalizations Affecting the Thiophene Unit	○Sergei Manzhos¹, Wei Han Tu², Yi Yin Tan³, Omkar Rege⁴	1.Natl Univ Singapore, 2.Anderson Jr College, 3.Raffles Institution, 4.Uni. of Illinois
	11:45 - 12:00	奨 13a-D15-11	ベロブスカイト層の表面処理による太陽電池の高効率化	○(M1)丸山 直輝¹, 西村 秀隆¹, 遠藤 克¹, 若宮 淳志¹², 村田 靖次郎¹	1.京大化研, 2.JST-さきがけ

	3月13日(金)	) 16:30 - 19:0	00		
招待	16:30 - 17:00	13p-D15-1	「有機分子・バイオエレクトロニクス 分科内招待講演」(30分) ペロブスカイト太陽電池の高耐久・高効率化開発における課題と 将来展望	〇宮坂 力¹	1.桐蔭横浜大学院工
	17:00 - 17:15	13p-D15-2	一括塗布による自己組織化中間層を形成したペロプスカイト太陽電池	○(M1)森谷 昌平!, 濱園 康司!, 藤川 直耕!, 尾込 裕平1.4, 沈 青2.4, 吉野 賢二3.4, 豊田 太郎2.4, 早瀬 修二1.4	1.九工大院生命体工, 2.電通大先進理工, 3.宮崎大学工, 4.JST-CREST
	17:15 - 17:30	13p-D15-3	近赤外光電変換可能なスズ系ペロブスカイト太陽電池の特性評価	○尾込 裕平1-4, 松隈 智寛1, 藤原 幸星1, リポレス サンチェス テレサ1, 沈 青 <sup>2,4</sup> , 吉野 賢二 3-4, 豊田 太郎2-4, 早瀬 修二1-4	1.九工大院生命体工, 2.電通大先進理 工, 3.宮崎大工, 4.JST-CREST
	17:30 - 17:45	13p-D15-4	有機無機ペロブスカイトを用いた太陽電池構築のためのヨウ化鉛系 ペロブスカイト蒸着膜作製条件の検討	○黒木 惟¹, 坂口 幸一¹, 江良 正直¹	1.佐大理工
	17:45 - 18:00	13p-D15-5	十面体酸化チタン多孔膜を用いたペロブスカイト太陽電池の特性 評価	○實平 義隆¹, 沼田 陽平¹, 宮坂 力¹	1.桐蔭横浜大院工
	18:00 - 18:15	13p-D15-6	メソポーラスシリカ (MCM-41) 膜上の層状ペロブスカイト化合物の 特性評価 (II)	〇丸山 翔大¹, 片山 大輔¹, 森川 弘理¹, 緒方 啓典¹.²	1.法政大院理工, 2.法政大マイクロ・ナノテク研
	18:15 - 18:30	13p-D15-7	ペロプスカイト太陽電池構造中のTiO₂表面に対するPbI₂パッシペーション効果の観測	○廣谷 太佑¹, 尾込 裕平¹, 藤川 直耕¹, 早瀬 修二¹	1.九工大院生命体工
	18:30 - 18:45	13p-D15-8	ヨウ化錫系有機無機ペロプスカイト蒸着膜の導電率その場測定	○江良 正直¹	1.佐大理工
	18:45 - 19:00	13p-D15-9	酸化物混合体メソポーラス層を用いるペロブスカイト太陽電池におけるJ-V曲線のヒステリシス挙動に関する研究	○沼田 陽平¹, 實平 義隆¹, 宮坂 力¹	1.桐蔭横浜大院工
	3月14日(土)	9:00 - 12:00			
	9:00 - 9:15	14a-D15-1	PbS量子ドット/ZnOナノワイヤアレイ太陽電池の光電変換特性の温 度依存性	王 海濱¹, ○久保 貴哉¹, 中崎 城太郎¹, 瀬 川 浩司¹	1.東大先端研
	9:15 - 9:30	14a-D15-2	過渡吸収法を用いたPbS/CdS複合化量子ドット増感太陽電池の光励 起キャリア移動過程の解明	○(M1)佐藤 光希 <sup>1,2</sup> , 桑原 彰太 <sup>1</sup> , 片山 建二 <sup>1</sup> , 豊田 太郎 <sup>2,3</sup> , 沈 青 <sup>2,3</sup>	1.中大理工, 2.電通大, 3.JST CREST
	9:30 - 9:45	14a-D15-3	ルチル型TiO,単結晶基板に吸着したCdSe量子ドットのイオン化ポテンシャルと光誘起電子移動	○豊田 太郎 <sup>1.5</sup> , インディースク ウィトウーン <sup>1</sup> , 神山 慶太 <sup>2</sup> , 片山 健二 <sup>3</sup> , 早瀬 修二 <sup>4.5</sup> , 沈 青 <sup>1.5</sup>	1.電通大情報理工学, 2.分光計器(株), 3.中央大理工, 4.九工大, 5.CREST
	9:45 - 10:00	14a-D15-4	ZnO単結晶上CdSe量子ドット吸着の面方位依存性一光音響分光法 と光電子収量分光法による評価	○豊田 太郎 <sup>1,4</sup> , インディースク ウィトゥーン <sup>1</sup> , 神山 慶太 <sup>2</sup> , 早瀬 修二 <sup>3,4</sup> , 沈 青 <sup>1,4</sup>	1.電通大情報理工学, 2.分光計器(株), 3.九工大, 4.CREST
	10:00 - 10:15	14a-D15-5	PbS量子ドット薄膜における光励起キャリアダイナミクス -電荷分離の量子ドット問距離依存性-	○久家 佑輝 <sup>1</sup> , 常 進 <sup>1,4</sup> , 豊田 太郎 <sup>1,4</sup> , 尾込 裕平 <sup>2,4</sup> , 早瀬 修二 <sup>2,4</sup> , 吉野 賢二 <sup>3,4</sup> , 沈 青 <sup>1,4</sup>	1.電通大先進理工, 2.九工大生命体工, 3.宮崎大工, 4.JST CREST
	10:15 - 10:30		休憩/Break		
	10:30 - 10:45	14a-D15-6	高起電力タンデムセルに向けたn型及びp型色素増感太陽電池の 作製	○茂木 勇樹¹, 大場 暁海¹, 趙 博文¹, 山 内 博¹, 國吉 繁一¹, 酒井 正俊², 飯塚 正明 ², 工藤 一浩¹	1.千葉大院工, 2.千葉大教
	10:45 - 11:00	E 14a-D15-7	TCO-less Tandem dssc featuring enhanced spectra with new architectures	○(DC)Ajay Baranwal¹, Naotaka Fujikawa¹, Shyam S Pandey¹, Yuhei Ogomi¹, Tingli Ma¹, Shuzi Hayase¹	1.Kyushu Institute of Technology
	11:00 - 11:15	14a-D15-8	多段階陽極酸化法を用いた酸化チタンナノチューブ構造光電極の 作製	○立木 元規¹, 岸 直希¹, 曽我 哲夫¹	1.名工大
	11:15 - 11:30	E 14a-D15-9	Fluorin-Doped Tin Oxide Nanostructured Thin Films by Using Horizontally Spraying Technique	OKenji Murakami², Ajith Bandara¹, Gamini Rajapakse³	1.GSST, Shizuoka Univ., 2.GSE, Shizuoka Univ., 3.Peradeniya Univ.
	11:30 - 11:45	14a-D15-10	電気泳動法による色素増感型太陽電池の負電極上への絶縁層の 形成	○川上 亮¹, 左橋 知也¹, 佐藤 祐喜¹, 森 康維¹, 吉門 進三¹	1.同志社大院理工
	11:45 - 12:00	14a-D15-11	色素増感型太陽電池のための電気泳動法を用いた色素吸着	〇左橋 知也', 川上 亮', 湯浅 拓也', 佐藤 祐喜', 森 康維', 吉門 進三'	1.同志社大院理工
	3月14日(土)	) 13:00 - 15:0	00		
	13:00 - 13:15	14p-D15-1	固体型Sb <sub>2</sub> S <sub>3</sub> 増感太陽電池の各界面における電荷再結合ダイナミクス	○(M1)山崎 康平¹, 佐藤 光希², 豊田 太郎¹⁴, 片山 建二², 尾込 陽平³⁴, 早瀬 修二³⁴, 沈青¹⁴	1.電通大先進理工, 2.中大理工, 3.九工 大生命体工, 4.JST CREST
	13:15 - 13:30	14p-D15-2	インピーダンス分光法によるナノポーラス酸化チタンの電荷移動度 評価	○青野 正規 <sup>1</sup> , 高木 謙一郎 <sup>1</sup> , 永瀬 隆 <sup>1,2</sup> , 小林 隆史 <sup>1,2</sup> , 内藤 裕義 <sup>1,2,3</sup>	1.大阪府大院工, 2.分子エレクトロニック デバイス研, 3.戦略的創造研究推進機構
	13:30 - 13:45	14p-D15-3	鉛ハライドペロプスカイト $\mathrm{CH_sNH_sPbBr_s}$ 単結晶における光キャリア再結合ダイナミクス	○(M1)山田 琢允¹, 山田 泰裕¹, 西村 秀隆¹, 中池 由美¹, 遠藤 克¹, 若宮 淳志¹, 村田 靖 次郎¹, 金光 義彦¹	1.京大化研
	13:45 - 14:00	14p-D15-4	時間分解発光分光によるCH <sub>2</sub> NH <sub>2</sub> PbI <sub>3</sub> ベロブスカイト太陽電池の電荷分離ダイナミクスの研究	○山田 泰裕', 遠藤 克', 若宮 淳志', 金 光 義彦 <sup>1,2</sup>	1.京大化研, 2.JST-CREST
	14:00 - 14:15	14p-D15-5	鉛ハライド系ペロプスカイト太陽電池の電界発光測定による特性評価	○岡野 真人¹, 遠藤 克¹, 若宮 淳志¹, 吉田 正裕²³, 秋山 英文²³, 金光 義彦¹.³	1.京大化研, 2.東大物性研, 3.JST- CREST
	14:15 - 14:30	14p-D15-6	CH <sub>3</sub> NH <sub>3</sub> Sn <sub>2</sub> Pb <sub>1</sub> 、I <sub>3</sub> ベロプスカイトのSn混合比xによる光吸収特性と電荷分離・再結合特性の変化	○沈 青 <sup>1.5</sup> , 尾込 裕平 <sup>2.5</sup> , 豊田 太郎 <sup>1.5</sup> , 藤原幸星 <sup>2</sup> , 山崎 康平 <sup>1</sup> , 佐藤 光希 <sup>1.3</sup> , 片山 建二 <sup>3</sup> , 吉野 賢二 <sup>4.5</sup> , 早瀬 修二 <sup>2.5</sup>	1.電通大先進理工, 2.九工大院生命 体工, 3.中大理工, 4.宮崎大工, 5.JST CREST
	14:30 - 14:45	14p-D15-7	臭素系ベロブスカイト型半導体CH <sub>3</sub> NH <sub>3</sub> PbBr <sub>3</sub> の励起子特性	○佐野 惇郎', 中村 唯我', 松下 智紀' <sup>3</sup> , 橋 本 翼', 清田 裕貴 <sup>2</sup> , 宇田川 洋祐 <sup>2</sup> , 石井 里 歩 <sup>2</sup> , 加賀屋 葉子 <sup>2</sup> , 欅田 英之 <sup>23</sup> , 竹岡 裕子 <sup>23</sup> , 江馬 一弘 <sup>23</sup> , 近藤 高志 <sup>13</sup>	1.東大工, 2.上智大理工, 3.JST-ALCA
	14:45 - 15:00	14p-D15-8	ヨウ化鉛系有機無機ベロブスカイトの基礎光物性	○江良 正直¹, 江馬 一弘², Richard Phillips³	1.佐大理工, 2.上智大理工, 3.ケンブリッジ大学キャベンディッシュ研

1	12.6 ナノバイオテクノロジー / Nanobiotechnology 口頭講演						
	3月11日(水) 9:30 - 11:45						
	9:30 - 9:45	11a-D5-1	吸着ベシクルの開裂機構:吸着領域での欠陥孔形成が関わる機構	○片岡 知歩¹, 山崎 智彦¹	1.物材機構		
	9:45 - 10:00	奨 11a-D5-2	脂質二分子膜の自己展開現象への疎水性の影響	○(M2)大森 悠也¹, 坂上 弘之¹, 高萩 隆行¹, 鈴木 仁¹	1.広島大院先端研		
	10:00 - 10:15	奨 11a-D5-3	固体基板表面による人工脂質膜内分子拡散への非対称性と異方性 の発現	○茂木 俊憲¹, 山崎 憲慈², 荻野 俊郎³, 手 老 龍吾⁴	1.豊技大 EIIRIS, 2.北大院工, 3.横浜大 院工·JST-CREST, 4.豊技大 環境生命		
	10:15 - 10:30	11a-D5-4	グラフェン酸化物上に形成した人工脂質膜の拡散係数測定	○岡本 吉晃¹, 茂木 俊憲², 岩佐 精二¹, サン ドゥー アダルシュ²³, 手老 龍吾¹²	1.豊技大環境・生命, 2.豊技大EIIRIS, 3.豊技大電気・電子		
	10:30 - 10:45		休憩/Break				

10:45 - 11:00	11a-D5-5	金ナノ粒子を含む脂質二重膜の液中におけるAFM評価	○坂口 直駿¹, 横田 圭司¹, 仲山 智明¹, 木村 僚佑¹, 木村 康男²⁴, 平野 愛弓³⁴, 荻野 俊郎¹⁴	1.横国大院工, 2.東京工科大, 3.東北大 院医工, 4.CREST/JST
11:00 - 11:15	奨 11a-D5-6	脂質二重膜上におけるDNA被覆金ナノ粒子のセルフアセンブリに対するイオンの効果	○磯貝 卓巳¹, 赤田 英理¹, 中田 咲子¹, 吉田 直矢¹, 手老 龍吾², 原田 俊太¹, 宇治原 徹 ¹, 田川 美穂¹	1.名大院工, 2.豊橋技科大
11:15 - 11:30	11a-D5-7	人工脂質膜でシールした微小井戸の電気特性評価と構造最適化	○樫村 吉晃¹, フォミチェバ アンナ¹, 大嶋 梓¹, 住友 弘二¹	1.NTT物性基礎研
11:30 - 11:45	奨 11a-D5-8	電子線描画を用いた細胞膜穿孔現象の閾値探索	○吉岡 基¹, 宮廻 裕樹¹, 我妻 玲¹, 満渕 邦 彦¹, 星野 隆行¹	1.東京大学
3月11日(水	) 13:15 - 18:	00		
13:15 - 13:30	11p-D5-1	酸化亜鉛ウィスカー探針による官能基の化学イメージング	○日比野 政裕¹, 菅原 剛¹, 西田 ともみ²	1.室蘭工大, 2.ジェイテクト
13:30 - 13:45	11p-D5-2	液中高分解能FM-AFMを用いた機能性タンパク質表面の水和構造 の観察	○平田 芳樹¹, 小林 圭², 山田 啓文², 田 中 睦生¹	1.産総研, 2.京大工
13:45 - 14:00	11p-D5-3	液中FM-AFMによる左巻きDNAの高分解能観察	○木南 裕陽¹, 小林 圭¹², 山田 啓文¹	1.京大工, 2.京大白眉セ
14:00 - 14:15	11p-D5-4	FM-AFMによるStreptavidin 2次元結晶の液中高分解能観察	○宮本 眞之¹, 木南 裕陽¹, 崔 子鵬¹, 小林 圭¹², 山田 啓文¹	1.京大工, 2.京大白眉セ
14:15 - 14:30	奨 11p-D5-5	液中サブナノ分解能AFM計測のための微小管外側表面モデルの 確立	○高尾 一史¹, 淺川 雅¹, 内橋 貴之¹, 池上 浩司², 瀬藤 光利², 福間 剛士¹.³	1.金大院, 2.浜松医大, 3.ACT-C/JST
14:30 - 14:45	11p-D5-6	走査型アトムプローブによるペプチドの原子レベルでの定性・定量 解析	○西川 治¹, 谷口 昌宏¹	1.金沢工大
14:45 - 15:00		休憩/Break		
15:00 - 15:15	11p-D5-7	バイオセンサへ向けたLiTa $O_3$ 表面における自発分極ドメインの観察	○(B)磯部 亜紀子¹, 仲山 智明¹, 荻野 俊郎¹.²	1.横国大理工, 2.CREST/JST
15:15 - 15:30	11p-D5-8	垂直磁気ドメインを有する強磁性体表面へのタンパク質の吸着	○大和田 永作¹, 横田 圭司¹, 仲山 智明¹, 坂口 直駿¹, 荻野 俊郎¹²	1.横国大院工, 2.CREST/JST
15:30 - 15:45	11p-D5-9	光ピンセットを用いた神経細胞に局在する受容体タンパク質の捕捉・ 集合	○前澤 安代¹, 工藤 卓², 田口 隆久³, 細川 千絵¹	1.産総研 健康工学, 2.関西学院大 理 3.情報機構 脳情報
15:45 - 16:00	奨 11p-D5-10	ヒト血清溶媒リポソームー各種タンパク質問相互作用の誘電分散解析	○吉川 知貴¹, 張 子洋¹, 島内 寿徳², 山下馨¹, 野田 実¹	1.京工繊大, 2.岡山大
16:00 - 16:15	11p-D5-11	レーザー捕捉誘起液液相分離を利用したタンパク結晶化:顕微ラマン 分光測定による局所濃度上昇の可視化	○吉松 泉¹, 三浦 篤志¹², 喜多村 曻¹²	1.北大院総化, 2.北大院理
16:15 - 16:30		休憩/Break		
16:30 - 16:45	11p-D5-12	掃引干渉縞励起蛍光相関分光法のセンシング応用	○服部 峰之1	1.産総研電子光
16:45 - 17:00	11p-D5-13	高密度金ナノ粒子集合体を標識としたバクテリアの光学的検出	○(M2)木下 隆捋¹, 福田 真帆¹, 西野 智昭¹, 椎木 弘¹, 長岡 勉¹	1.阪府大院工
17:00 - 17:15	11p-D5-14	金ナノ粒子サンドイッチアッセイを用いた抗原検出における夾雑物由 来ノイズの低減	○水野 直人¹, 三反畑 輝¹, 江刺家 恵子¹, 斎木 敏治¹	1.慶大院理工
17:15 - 17:30	11p-D5-15	バクテリオロドプシン光センサーのpH緩衝液定量	○(M1)宮下 一馬¹, 田邉 季正¹, 三藤 剛¹, 春山 喜洋², 笠井 克幸², 岡田 佳子¹	1.電通大先進理工, 2.情報通信研究機
17:30 - 17:45	11p-D5-16	バーコーティング法により作製されたバクテリオロドプシン(bR)薄膜を 用いた光応答セルの時間微分型光電流の評価	〇山田 俊樹', 春山 喜洋', 笠井 克幸', 梶 貴博', 富成 征弘', 田中 秀吉', 大友 明'	1.情報通信研究機構
17:45 - 18:00	11p-D5-17	バクテリオロドブシンを用いたオプティカルフローセンシング技術の 開発(2)	○笠井 克幸!, 春山 喜洋!³, 山田 俊樹!, 秋 葉 誠!, 富成 征弘!, 梶 貴博!, 田中 秀吉!, 岡田 佳子², 大友 明!	1.情通機構, 2.電通大情報理工, 3.阪市大院

12.6 ナノ	バイオテクノロジー / N	lanobiotechnology ポスター講演		
3月:	12日(木) 9:30 - 11:3	0		
	E 12a-P10-1	Fabrication of natural material coated on the biodegradable fiber with calcium carbonate for improving hemostatic effect	○(M2)JUNYONG PARK¹, KYUHONG KYUNG¹, SAEHOON KIM², SEIMEI SHIRATORI¹	1.Grad. Sch. Sci. Tech., Keio Univ., 2.Dep. Adv. Ceramic material. Eng., Gangneung-Wonju Univ
	12a-P10-2	AFMを用いたナノスリットに詰まるDNA形状観測	○(B)芝崎 賢作¹, 加藤 佑太¹, 川口 翔平¹, 石田 研太郎¹, 三井 敏之¹	1.青学大理工
	12a-P10-3	モレキュラービーコンを用いた1分子FRET計測系の構築	○和泉 聡志¹, 大久保 幸太朗¹, 櫛田 昂歳¹, 山本 英明², 谷井 孝至¹	1.早大理工, 2.東北大学際研
	12a-P10-4	薄膜干渉基板を用いたラマン分光イムノアッセイのための基礎研究	○安田 充¹, 秋元 卓央², 尾崎 幸洋¹	1.関西学院大院理工, 2.東京工科大応 用生物
	12a-P10-5	薄膜干渉基板を用いた偏光技術に基づく高コントラスト蛍光顕微鏡の 開発とタンパク質分析への応用	○安田 充¹, 秋元 卓央¹	1.東京工科大応用生物
	12a-P10-6	強誘電体基板上でのタンパク質の選択的吸着	○仲山 智明¹, 磯部 亜紀子¹, 荻野 俊郎¹.²	1.横国大院工, 2.CREST/JST
	12a-P10-7	誘電泳動法と細菌鋳型膜による選択的捕捉機構の理論解析	○田村 守 <sup>1,2</sup> , 中田 啓之 <sup>1,3</sup> , 床波 志保 <sup>3</sup> , 飯 田 琢也 <sup>2</sup>	1.大阪府大院工, 2.大阪府大院理, 3.大 阪府大ナノ科学材料セ
	12a-P10-8	プラズマ オン チップ の開発: 気液界面を利用した1細胞へのプラ ズマ照射処理	張 淳堯¹, 鄭 鍾炫¹, 小林 未明², 清水 鉄司³, 佐々木 実¹, ○熊谷 慎也¹	1.豊田工大, 2.奈良先端大, 3.terraplas- ma GmbH

1	12.6 ナノバイオテクノロジー / Nanobiotechnology 口頭講演						
	3月13日(金) 9:30 - 11:45						
	9:30 - 9:45	13a-D5-1	低アスペクト比マイクロポアを用いた浮遊微粒子	の検出	○筒井 真楠¹, 横田 一道¹, 大城 敬人¹, 谷口 正輝¹, 川合 知二¹	1.阪大産研	
	9:45 - 10:00	奨 13a-D5-2	ナノポアトラップ法を用いた微粒子の蛍光-電流同	同時計測	○(DC)有馬 彰秀¹, 筒井 真楠¹, 谷口 正輝¹	1.阪大産研	
	10:00 - 10:15	13a-D5-3	電極組込型ナノポアデバイスにおける電極間クロ	ストーク	○横田 一道¹, 筒井 真楠¹, 大城 敬人¹, 谷口 正輝¹, 川合 知二¹	1.阪大産研	
	10:15 - 10:30	奨 13a-D5-4	電荷差均一化によるナノポアデバイスの絶縁破壊	妻の回避	○松井 一真¹, 柳 至¹, 武田 健一¹	1.目立中研	
	10:30 - 10:45		休憩/Break				

10:45 - 11:	:00 13a-D5-5	複数ナノ間隙デバイスを用いた単分子計測法の開発	○大城 敬人¹, 筒井 真楠¹, 横田 一道¹, 谷 口 正輝¹	1.阪大産研
11:00 - 11:	13a-D5-6	DNAのポア通過前におけるナノポアやナノスリットとの相互作用	○川口 翔平¹, 加藤 祐太¹, 芝崎 賢作¹, 石田研太郎¹, 三井 敏之¹	1.青学大理工
11:15 - 11:	:30 13a-D5-7	電極付加ナノポアのACゲート電位によるDNAの挙動制御	○加藤 佑太¹, 川口 翔平¹, 芝崎 賢作¹, 石田研太郎¹, 三井 敏之¹	1.青学大理工
11:30 - 11:	45 13a-D5-8	正に帯電したナノボアを用いた光学的DNAナノボア通過観察	○山崎 洋人¹, 伊藤 晋太郎¹, アマルビー ユーゴ¹, 江刺家 恵子¹, 斎木 敏治¹	1.慶大院理工
3月13日	(金) 16:30 - 19	:00		
16:30 - 16:	45 13p-D5-1	クラミドモナス非運動性変異株の力学コントロール	八木 俊樹¹, ○西山 雅祥²	1.県立広島大, 2.京大白眉セ
16:45 - 17:	:00 13p-D5-2	フォトニック結晶ナノレーザバイオセンサにおけるセンサ界面の考察	○渡部 工¹, 羽中田 祥司¹, 古田 祐樹¹, 岸 洋次¹, 西島 喜明¹, 馬場 俊彦¹	1.横国大·院工
17:00 - 17:	:15 獎 13p-D5-3	水平円筒流路を用いた血漿分離システムの開発	○黒田 千愛¹, 大木 義路¹², 芦葉 裕樹³, 藤 巻 真³, 粟津 浩一³, 田中 寅彦⁴, 槇島 誠⁴	1.早大先進理工, 2.早大材研, 3.産総研, 4.日大医
17:15 - 17:	:30 獎 13p-D5-4	神経細胞パターンゲルフィルムによるパイオアッセイデバイスの構築	○平田 卓也¹, 岡本 滉平¹, 阿部 結奈¹, 長峯 邦明¹, 梶 弘和¹, 西澤 松彦¹	1.東北大院工
17:30 - 17:	45 獎 13p-D5-5	伸縮可能なバイオ電池の開発	○高井 優樹¹, 加藤 悠人¹, 加藤 孝一郎¹, 小川 雄大¹, 山田 健郎², 畠 賢治², 西澤 松彦¹	1.東北大院工, 2.産総研
17:45 - 18:	:00	休憩/Break		
18:00 - 18:	担 13p-D5-6	酵素発電システムを搭載したイオントフォレシスパッチの開発	○松坂 広太郎¹, 小川 雄大¹, 長峯 邦明¹, 西澤 松彦¹	1.東北大院工
18:15 - 18:	:30 獎 13p-D5-7	アパタイト結晶に対するフラグメント分子軌道法の試み #2	○加藤 幸一郎¹, 福澤 薫²⁴, 望月 祐志³⁴	1.みずほ情報総研, 2.日大松戸歯, 3.立 教大理, 4.東大生産研
18:30 - 18:	45 13p-D5-8	粘菌を利用した金属微粒子配列	○山口 博樹¹, 望月 裕文¹, 渡邉 満洋¹, 近藤 英一¹	1.山梨大
18:45 - 19:	:00 13p-D5-9	三次元構造誘電泳動デバイスを用いた金属ナノ材料の立体形成	○片岡 良介¹, 時田 寛也¹, 内田 諭¹, 佐野 遼², 西川 宏之²	1.首都大学東京, 2.芝浦工業大学

医用上字・ク	バイオチップ /	Biomedical Engineering and Biochips	口頭講演	
3月11日(水	9:00 - 11:4	15		
9:00 - 9:15	奨 11a-D6-1	多点高密度計測のためのノイズキャンセリング回路の設計(集積化脳神経プローブシステムの開発1)	○永藤 弘嵩', 谷 卓治', 長沼 秀樹', 岩 上 卓磨', 川原 岬², 伊藤 圭汰³, 清山 浩司 <sup>4</sup> , 田中 徹 <sup>1,2</sup>	1.東北大院工, 2.東北大院医工, 3.東 大工, 4.長崎総科大
9:15 - 9:30	奨 11a-D6-2	多点高密度計測のためのインピーダンス補正回路の設計(集積化脳神経プローブシステムの開発2)	〇岩上 卓磨', 谷 卓治', 長沼 秀樹', 川 原 岬², 伊藤 圭汰³, 永藤 弘嵩⁴, 清山 浩司 ⁴, 田中 徽¹²	1.東北大院工, 2.東北大院医工, 3.東 大工, 4.長崎総科大
9:30 - 9:45	奨 11a-D6-3	マルチグループシャンクを有する昆虫用In vivoシリコン神経プローブ の作製(集積化脳神経プロープシステムの開発3)	○鈴木 雄策¹, 原島 卓也¹, 木野 久志², 田 中 徹¹³	1.東北大院工, 2.東北大際研, 3.東北大院医工
9:45 - 10:00	奨 11a-D6-4	表層刺激電極を有する網膜下埋植人工網膜チップモジュールの作製	○後藤 大輝¹, 長沼 秀樹², 木野 久志³, 田中 徹¹.²	1.東北大院医工, 2.東北大院工, 3.東北大際研
10:00 - 10:15	11a-D6-5	a-InGaZnO TFT pHセンサの過渡応答特性	〇岩松 新之輔¹, 竹知 和重², 阿部 泰¹, 矢作徽¹, 田邉 浩², 加藤 睦人¹	1.山形県工技セ, 2.NLTテクノロジー
10:15 - 10:30		休憩/Break		
10:30 - 10:45	奨 11a-D6-6	電荷転送読み出し方式を用いた圧力センサの提案とその動作検証	○(M2)岩下 彰宏¹, 岩田 達哉¹, 大石 泰三¹, 高橋 一浩¹, 石田 誠¹, 澤田 和明¹	1.豊橋技科大
10:45 - 11:00	11a-D6-7	イオンの複数同時計測に向けた電流検出型センサの製作	○(BC)水谷 信哉¹, 高橋 聡¹, 河野 顕輝¹², 服部 敏明¹², 石田 誠¹, 澤田 和明¹²	1.豊橋技術科学大学, 2.JST - CRE
11:00 - 11:15	11a-D6-8	センサ感度差を利用した補正技術による参照電極のないイオンイメー ジセンサの提案	○渡邊 愼¹, 太齋 文博¹, 石田 誠¹, 服部 敏明¹, 澤田 和明¹²	1.豊技大, 2.JST-CREST
11:15 - 11:30	奨 11a-D6-9	ポリイオンコンプレックスを用いた非標識ATPイメージセンサの製作	○土井 英生¹, 堀尾 智子¹, 奥村 弘一¹, 服部 敏明¹², 石田 誠¹, 澤田 和明¹²	1.豊橋技科大, 2.科学技術振興機構
11:30 - 11:45	奨 11a-D6-10	イオンイメージセンサを用いたアルツハイマー病原因物質の高速・高 感度検出装置の開発	○(P)奥野 海良人¹, 吉見 立也¹, 奥村 弘一², 澤田 和明², 滝川 修¹	1.国立長寿医療研究セ, 2.豊橋技科
3月11日(水	3) 13:15 - 18	:00		
13:15 - 13:30	奨 11p-D6-1	レンズレスデジタル酵素結合免疫吸着法に向けた高感度 CMOS イメージセンサの設計	○永崎 瑞樹¹, 北口 一樹¹, 竹原 浩成¹, 竹原 宏明¹, 野田 俊彦¹³, 笹川 清隆¹³, 徳田 崇¹³, 野地 博行²³, 太田 淳¹³	1.奈良先端大物質創成, 2.東大院工 3.JST-CREST
13:30 - 13:45	奨 11p-D6-2	生体埋植用自己リセット型CMOSイメージセンサ画素の低消費電力化	〇山口 貴大', 須永 圭紀', 春田 牧人', 竹原 宏明', 野田 俊彦', 笹川 清隆', 徳田 崇', 太田 淳'	1.奈良先端大
13:45 - 14:00	奨 11p-D6-3	埋殖型PWM出力CMOSイメージセンサの低電圧化	○永田 健悟¹, 速水 一¹, 笹川 清隆¹, 竹原 宏明¹, 野田 俊彦¹, 徳田 崇¹, 太田 淳¹	1.奈良先端大
14:00 - 14:15	奨 11p-D6-4	CMOSセンサ搭載生体埋埋め込みグルコースセンサのin vitro長期動作検証	○平井 智大¹, 增田 啓太¹, 河村 敏和¹, 竹原 宏明¹, 野田 俊彦¹, 笹川 清隆¹, 徳田 崇¹, 興 津 輝², 竹内 昌冶², 太田 淳¹	1.奈良先端大, 2.東大
14:15 - 14:30	11p-D6-5	埋植型デバイスによる生体内蛍光イメージングの光学シミュレーション	○竹原 宏明 <sup>1</sup> , 太田 安美 <sup>1</sup> , 元山 真由美 <sup>1</sup> , 春田 牧人 <sup>1</sup> , 野田 俊彦 <sup>1</sup> , 笹川 清隆 <sup>1</sup> , 徳田 崇 <sup>1</sup> , 太田 淳 <sup>1</sup>	1.奈良先端大物質
14:30 - 14:45	奨 11p-D6-6	スマート電極型人工視覚デバイスの刺激電極内蔵用CMOSチップ の設計	○川崎 凌平¹, 藤澤 匠¹, 野田 俊彦¹, 竹原 宏明¹, 笹川 清隆¹, 徳田 崇¹, 太田 淳¹	1.奈良先端大
14:45 - 15:00	11p-D6-7	長さ500 $\mu$ m以上の高アスペクト比Siマイクロワイヤの生体組織への刺入	○八木 智史¹, 山際 翔太¹, 今塩屋 竜也¹, 大井 英夫¹², 久保田 吉博¹, 石田 誠¹², 河 野 剛士¹	1.豊橋技科大 電気・電子情報工学 2.EIIRIS
15:00 - 15:15	11p-D6-8	Pt/SiO2マイクロチューブ神経電極アレイの高空間分解能光刺激への応用	〇松尾 朋幸 <sup>1</sup> , 中邨 友彦 <sup>1</sup> , 山際 翔太 <sup>1</sup> , 澤畑博人 <sup>1</sup> , 石田 誠 <sup>12</sup> , 河野 剛士 <sup>1</sup>	1.豊橋技科大, 2.EIIRIS
15:15 - 15:30	11p-D6-9	完全埋込み神経インターフェースデバイスに向けたフレキシブル基板 上へのフリップチップ実装技術	○Horagodage Prabhath¹, 岡部 謙志¹, 秋田 一平¹, 山際 翔太¹, 河野 剛士¹, 石田 誠¹	1.豊橋技科大
15:30 - 15:45		休憩/Break		

15:45 - 16:00	奨 11p-D6-10	修飾したグラフェンFETとDNAの結合および脱離の電気的検出	○岡野 誠之!, Norhayati Sabani!, Rajiv Verma!, 金井 康!, 大野 恭秀!², 前橋 兼三 ¹³, 井上 恒一¹, 武井 史惠¹, 中谷 和彦¹, 松 本 和彦¹	1.阪大産研, 2.徳島大, 3.農工大
16:00 - 16:15	11p-D6-11	微量生体サンプルを高感度に計測するペーバーゲートトランジスタ の創製	○加治佐 平1, 坂田 利弥1	1.東大院工
16:15 - 16:30	奨 11p-D6-12	抗原-抗体反応計測へのMolecular Charge Contact法の応用	○宮澤 雄弥¹, 坂田 利弥¹	1.東大院工
16:30 - 16:45	11p-D6-13	移植前診断に向けたイオン感応型透明ゲートトランジスタの創製と 評価	○西村 光太郎¹, 宮澤 雄弥¹, 齋藤 暁子¹, 加 治佐 平¹, 坂田 利弥¹	1.東大院工
16:45 - 17:00	11p-D6-14	半導体バイオセンサによる人為的受精能獲得精子とその抑制作用 の評価	○齋藤 暁子¹, 加治佐 平¹, 坂田 利弥¹	1.東大院工
17:00 - 17:15	奨 11p-D6-15	半導体バイオセンサによる再生ヒト軟骨細胞基質産生挙動のin situ モニタリング	〇佐竹 皓宇¹, 齋藤 暁子¹, 加治佐 平¹, 水野 秀一², 坂田 利弥¹	1.東大院工, 2.ハーバード大
17:15 - 17:30	奨 11p-D6-16	嗅上皮細胞トランジスタによるがん関連VOC認識機構の解明	○広瀬 雄一 <sup>1</sup> , 齋藤 暁子 <sup>2</sup> , 加治佐 平 <sup>2</sup> , 坂 田 利弥 <sup>1,2</sup>	1.東大工, 2.東大院工
17:30 - 17:45	奨·E 11p-D6-17	Development of a novel device for allergy test based on semiconductor principle	○Haoyue Yang¹, Akiko Saito¹, Taira Kajisa¹, Yuki Yanase², Toshiya Sakata¹	1.Univ. of Tokyo, 2.Hiroshima Univ.
17:45 - 18:00	11p-D6-18	受精卵質量測定のためのホルダ型ピエゾ抵抗カンチレバの試作と 評価	○曾根 逸人¹, 川上 智之¹, 齋藤 暁子², 須藤 寛文¹, 保坂 純男¹, 坂田 利弥²	1.群馬大院理工, 2.東京大院工

12.7 医用工学・	バイオチップ / E	liomedical Engineering and Biochips	ポスター講演	
3月12日(木	9:30 - 11:30	)		
	12a-P11-1	水晶振動子センサーを用いる癌細胞に対する抗がん剤の影響評価	○アルサリーム アブドッラ¹, 村松 宏¹	1.東京工科大院
	12a-P11-2	小型蛍光偏光度測定装置による微生物遺伝子の計測	○小泉 大和¹, 湯沢 友之、鶴岡 誠¹	1.東京工科大
	12a-P11-3	pH不感応膜としてのPMMA濃厚ブラシの提案	○清水 一輝¹, Baek Sungchul²³, 太斎 文博¹, 石田 誠¹, 辻井 敬亘²³, 澤田 和明¹³	1.豊技大, 2.京大, 3.JST-CREST
	12a-P11-4	糖鎖修飾グラフェンFETを用いたインフルエンザウイルスセンサの 開発	麻植 丈史¹, 生田 昂¹, 林 亮太¹, 金井 康¹, 大野 恭秀¹², ○前橋 兼三¹³, 井上 恒一¹, 松 本 和彦¹, 渡邊 洋平⁴, 河原 敏男⁵, 鈴木 康 夫⁵, 中北 愼一⁴	1.阪大産研, 2.徳島大, 3.農工大, 4.阪大 徽研, 5.中部大, 6.香川大
	12a-P11-5	複素誘電率測定用オンチップインダクタモデルの提案	○外谷 昭洋¹, 北林 翔¹, 升井 義博², 吉 川 公麿³	1.呉工業高等専門学校, 2.広島工業大学, 3.広島大学
	12a-P11-6	LC発振器を応用した複素誘電率測定用回路の提案	○外谷 昭洋¹, 石井 佑樹¹, 升井 義博², 吉川 公麿³	1.呉工業高等専門学校, 2.広島工業大学, 3.広島大学
	12a-P11-7	ミニ遠心機で動作する遠心型マイクロ流体デバイスによる自発的排液 とバイオアッセイへの応用	○浮田 芳昭¹, 内海 裕一², 高村 禅³	1.山梨大学, 2.兵庫県立大学, 3.北陸 先端大
	12a-P11-8	マイクロパターン基板上の単一神経細胞間に形成されるシナプス の解析	○高沖 英里 <sup>1,2</sup> , 山本 英明 <sup>1,2,3</sup> , 松村 亮佑 <sup>1,2</sup> , 桂林 秀太郎 <sup>4</sup> , 平野 愛弓 <sup>1,2</sup> , 庭野 道夫 <sup>1,2,5</sup>	1.東北大院医工, 2.CREST, JST, 3.東北大学際研, 4.福岡大薬, 5.東北大通研
	12a-P11-9	マイクロバターン神経細胞回路の活動様式に関する理論的考察	○千田 雄大1², 山本 英明²³, 平野 愛弓²⁴, 石原 広識⁵, 藤森 壮也⁵, 谷井 孝至⁵, 久保田 繁⁶, 庭野 道夫1²	1.東北大通研, 2.CREST, JST, 3.東北 大学際研, 4.東北大医工, 5.早大理工, 6.山形大理工
	E 12a-P11-10	Gold Nanoparticles Labeled Electrochemical Immunoassay of Human Chorionic Gonadotropin Hormone Detection using Open Circuit Potential	○(M2)Kanokwan Charoenkitamorn¹², Tue Phan Trong¹, Weena Siangproh⁴, Orawon Chailapakul²³, Yuzuru Takamura¹	1.JAIST, 2.Chulalongkorn Univ., 3.Petro. Mat Chula, 4.SWU
	12a-P11-11	分子鋳型ポリマーナノ粒子を用いた慢性ストレス関連ホルモン検出向 けその場検査チップ	○谷口 伸一¹, 村瀬 敦郎², 竹内 俊文²	1.目立横研, 2.神戸大院工
	12a-P11-12	接着性細胞ハンドリングのための導電性シルクゲル薄膜	○手島 哲彦¹, 塚田 信吾¹, 河西 奈保子¹, 佐々木 智¹, 田中 あや¹, 中島 寛¹, 住友 弘二¹	1.NTT物性研
	12a-P11-13	マイクロ流路結合導波モードセンサによる赤血球凝集検出	○芦葉 裕樹¹, 藤巻 真¹, 粟津 浩一¹, 傅 梦 穎², 大木 義路²³, 田中 寅彦⁴, 槇島 誠⁴	1.産総研, 2.早大先進理工, 3.早大材研, 4.日大医
	12a-P11-14	GaInAsP半導体のフォトルミネッセンスを用いたpH / バイオイメージング	○(B)酒本 真衣¹, 岸 洋次¹, 馬場 俊彦¹	1.横国大
	12a-P11-15	フォトニック結晶ナノレーザバイオセンサとリムルス試薬を用いた高速・高感度エンドトキシン検出(II)	○高橋 大智¹, 羽中田 祥司¹, 渡部 工¹, 西島喜明¹, 馬場 俊彦¹	1.横国大院工
	12a-P11-16	POCTに向けた遠心促進熱対流型RT-PCR法の開発	○高橋 和也¹, 桐山 雄一朗¹, 斎藤 真人¹, 民谷 栄一¹	1.阪大工
	E 12a-P11-17	Nano-pillar structured SERS-active substrate based on nano-imprint technology	○Shu Jiang¹, Mizuho Murahashi¹, Masato Saito¹, Eiichi Tamiya¹	1.OSAKA Univ.
	E 12a-P11-18	SERS-based bio-sensing with surface modified aggregates of silver nanoparticles	○(M1)zhengjun shen¹, Yoshikawa Hiroyuki¹, Tamiya Eiichi¹	1.Osaka Univ
	12a-P11-19	差動Siリング光共振器によるショ糖及び前立腺特異抗原検出	○谷口 智哉 <sup>1.2</sup> , 横山 脩平 <sup>1.2</sup> , 雨宮 嘉照 <sup>1</sup> , 池 田 丈 <sup>1.3</sup> , 黒田 章夫 <sup>1.3</sup> , 横山 新 <sup>1.2</sup>	1.広島大ナノデバ研, 2.先端研半導体専攻, 3.分子生命専攻
	12a-P11-20	アクセプタ型フォトニック結晶共振器を用いたバイオセンサーの温度 依存性	○本澤 圭太¹, サナ アムリタ クマル¹, 千日 拓馬¹, 野田 和希¹, 雨宮 嘉照¹, 横山 新¹	1.広島大ナノデバイス
	12a-P11-21	差動Siリング光共振器センサーの温度特性	○横山 脩平¹, 谷口 智哉¹, 雨宮 嘉照¹, 池田 丈¹², 黒田 章夫¹², 横山 新¹	1.広島大ナノデバ、2.広島大分子生命
	12a-P11-22	スポットサイズコンバータの特性評価およびバイオセンサーへの応用	○千日 拓馬¹, 本澤 圭太¹, 雨宮 嘉照¹, 横山 新¹	1.広大ナノデバイス

12.	7 医用工学・/	ヾイオチップ / E	Biomedical Engineering and Biochips	口頭講演				
	3月13日(金) 9:00 - 11:45							
	9:00 - 9:15	奨 13a-D6-1	電子線による高電界生成を用いたナノ空間における物質輸送制御	○(M2)宮廻 裕樹¹, 満渕 邦彦¹, 星野 隆行¹	1.東大院情理			
	9:15 - 9:30	13a-D6-2	送液技術によるオイル封止マイクロウェルを用いた大規模タンパク質 アレイチップの作製	○(M2)福田 拓海¹, 佐藤 秀介¹, 上野 真吾¹, 一木 隆範¹	1.東大院工			
	9:30 - 9:45	13a-D6-3	チップ電気泳動法を用いた高分子ナノ粒子の1粒子ゼータ電位分析	○花村 奈未¹, 赤木 貴則¹, 一木 隆範¹	1.東大院工			
	9:45 - 10:00	奨 13a-D6-4	埋め込み型形状記憶ポリマーマイクロバルブの作製	○(M2)蒋 晨陽¹, 宇都 甲一郎², 荏原 充宏², 青柳 隆夫², 一木 隆範¹	1.東大院工, 2.物材機構			
	10:00 - 10:15	奨・E 13a-D6-5	Microfluidic device-based electrical sensing of Nucleic acid	○(D)Tanzilur Rahman¹, Takanori Ichiki¹	1.University of Tokyo			

10:15 - 10:30		休憩/Break		
10:30 - 10:45	E 13a-D6-6	Microintaglio Printing (μ-IP) of Biomolecules using APTES	○(D)Subhashini RajKumal¹, Hiromi	1.Department of Bioengineering, The
		Functionalized Substrate	Kuramochi <sup>1</sup> , Shingo Ueno <sup>1</sup> , Takanori Ichiki <sup>1</sup>	University of Tokyo
10:45 - 11:00	奨 13a-D6-7	金属アシスト型シリコンスロット導波路におけるセンサ感度の評価	○石坂 雄平¹, 長井 優¹, 藤澤 剛¹, 齊藤 晋聖¹	1.北大情報科学研究科
11:00 - 11:15	奨 13a-D6-8	フォトニック結晶ナノレーザバイオセンサにおける屈折率・電荷同時検 出の可能性(Ⅲ)	○(M2)岸 ヨウジ¹, 酒本 真衣¹, 馬場 俊彦¹	1.横国大·院工
11:15 - 11:30	13a-D6-9	フォトニック結晶ナノレーザによる不純物を含む試料からの前立腺癌 マーカーの高感度検出(II)	○(D)羽中田 祥司¹, 渡部 工¹, 馬場 俊彦¹	1.横国大·院工
11:30 - 11:45	奨 13a-D6-10	カンチレバーバイオセンサを用いたリポソーム脂質膜上でのAβタンバク質動態の経時変化の検討	○(PC)張 子洋¹, 寒川 雅之², 山下 馨¹, 野 田 実¹	1.京都工芸繊維大学, 2.新潟大学
3月13日(金)	16:15 - 19:1	5		
16:15 - 16:30	13p-D6-1	蛍光封入リポソームを用いた蛍光アレイセンサによるターゲット蛋白 質の検出	○今村 亮太¹, 張 子洋¹, 吉川 知貴¹, 島 内 寿徳², 村田 直樹¹, 福澤 理行¹, 山下 馨 ¹, 野田 実¹	1.京工繊大, 2.岡山大
16:30 - 16:45	13p-D6-2	局所光重合反応を利用した高感度バイオマーカー検出	○吉川 裕之¹, 井村 修平¹, 民谷 栄一¹	1.阪大院工
16:45 - 17:00	E 13p-D6-3	Long Term Monitoring of Single and Multiple Cardiomyocytes Trapped in a Centrifugal Microfluidic Chip	○(D)Wilfred Espulgar¹, Wataru Aoki¹, Daiki Mita¹, Masato Saito¹, Jong-Kook Lee¹, Eiichi Tamiya¹	1.Osaka Univ.
17:00 - 17:15	13p-D6-4	遠心促進熱対流型PCR法を利用した食品害虫検出システムの開発	○桐山 雄一朗¹, 齋藤 真人¹, 民谷 栄一¹	1.阪大院工
17:15 - 17:30	13p-D6-5	オンチップ質量分析に向けた熱パルスイオン化法と試料膜形成法	○(D)杉山 清隆¹, 高村 禅¹	1.北陸先端大マテリアル
17:30 - 17:45	13p-D6-6	ハの字型電極を用いた誘電泳動力による細胞輸送システム	○須田 隆夫¹, 濱田 拓也¹, 西元 稜太¹, 井 上 貴仁²	1.鹿児島高専, 2.産総研ナノシステム
17:45 - 18:00		休憩/Break		
18:00 - 18:15	13p-D6-7	背面照射系プラズモニックチップを用いた高感度蛍光検出 —Ag薄膜及びSiO <sub>2</sub> 薄膜の膜厚の検討—	〇中山 拓哉1.2, 金高 健二1, 田和 圭子1.2	1.産総研, 2.関学理工
18:15 - 18:30	13p-D6-8	回折格子結合型表面プラズモン共鳴励起増強蛍光分光(GC-SPFS) を用いた肝細胞癌マーカー(AFP)の免疫測定系の開発	○永江 剛典', 彼谷 高敏', 中村 幸登', 野崎 昭俊', 井出 陽一', 石田 賢治', 須田 美彦', 田和 圭子²	1.コニカミノルタ(株), 2.産総研
18:30 - 18:45	13p-D6-9	特異的高分子リガンド修飾プラズモニックチップを用いたC反応性タン バク質の高感度蛍光検出	〇松浦 亮¹, 北山 雄己哉¹, 田和 圭子², 竹 内 俊文¹	1.神戸大院工, 2.産総研
18:45 - 19:00	13p-D6-10	ブラズモニックチップ上で培養した神経細胞接着分子の光捕捉	○細川 千絵 <sup>1,2</sup> , 宮内 康平 <sup>1,2</sup> , 工藤 卓 <sup>2</sup> , 田口 隆久 <sup>3</sup> , 田和 圭子 <sup>1,2</sup>	1.産総研健康工学, 2.関西学院大理工, 3.情通機構脳情報
19:00 - 19:15	13p-D6-11	Long-range SPR 法を利用した高感度・高深度な生細胞可視化法の開発	○柳瀬 雄輝 <sup>1</sup> , 川口 智子 <sup>1</sup> , 玉田 薫 <sup>2</sup> , 秀 道広 <sup>1</sup>	1.広大医, 2.九大理
3月14日(土)	9:00 - 12:00			
9:00 - 9:15	14a-D6-1	金ナノ粒子プローブよる組織切片のイメージング質量分析	○新留 康郎¹, 藤井 政徳², 中嶋 直敏²³, 新 留 琢郎⁴	1.鹿大院理工, 2.九大院工, 3.I2CNER, JST, 4.熊大院自然
9:15 - 9:30	14a-D6-2	表面プラズモンアンテナ付SOIフォトダイオードを用いた集積化バイオセンサーにおける屈折率測定の性能評価	○佐藤 弘明 <sup>1,2</sup> , 岩田 将平 <sup>2</sup> , 小野 篤史 <sup>1,2</sup> , 猪川 洋 <sup>1,2</sup>	1.静岡大電子研, 2.静岡大院工
9:30 - 9:45	14a-D6-3	量子ドットを蛍光標識としたV溝バイオセンサーの設計	藤巻 真¹, ○芦葉 裕樹¹, 王 暁民¹, 粟津 浩─¹	1.産総研
9:45 - 10:00	14a-D6-4	有機シラン単分子膜パターンへの接着差を用いた癌細胞の選別	○竹内 祐子¹, 柿沼 瑛介¹, 坂本 留実¹, 山本 英明³, 佐藤 裕子²⁴, 谷井 孝至¹²	1.早大理工, 2.早大ナノ機構, 3.東北大学際研, 4.日赤看護大
10:00 - 10:15	14a-D6-5	電気泳動コールター法における精度向上	○清水 俊彰¹, 水木 徹¹, 鵜飼 智文¹, 東 利晃¹, 中島 義賢¹, 花尻 達郎¹	1.東洋大 バイオナノ研
10:15 - 10:30		休憩/Break		
10:30 - 10:45	14a-D6-6	ウェアラブル皮膚アセトン測定の実現に向けたゼオライトの評価	○山田 祐樹¹², 檜山 聡², 豊岡 継泰², 竹内 昌治³, 板橋 慶治¹, 大久保 達也¹, 田畑 仁¹	1.東大工, 2.NTTドコモ, 3.東大生研
10:45 - 11:00	14a-D6-7	ウェーハスケール厚膜ボリマー・マイクロ流路のための感光性接着材	○稗田 克彦¹, 宮崎 智和¹, 窪 寛仁¹, 西村 功¹, Peeters Sara², Van Roosbroeck Ruben²	1.JSR, 2.JSR Micro NV
11:00 - 11:15	14a-D6-8	住環境中ダニアレルゲンのon-site計測のためのSAW免疫センサ	○三木 大輔 <sup>1</sup> , 吉村 直之 <sup>2</sup> , 當麻 浩司 <sup>1</sup> , 宫 島 久美子 <sup>3</sup> , 荒川 貴博 <sup>1</sup> , 谷津田 博美 <sup>4</sup> , 三 林 浩二 <sup>1</sup>	1.医科歯科大, 2.日本無線, 3.学振特研PD, 4.OJ-Bio
11:15 - 11:30	14a-D6-9	リアルタイムマイクロ波マンモグラフィの開発	〇木村 建次郎¹, 向殿 麦¹, 木村 憲明², 三木 万由子³, 高尾 信太郎³	1.神戸大院理, 2.IGI, 3.兵庫県立がん センター
11:30 - 11:45	14a-D6-10	磁気共鳴法によるアスコルビン酸ラジカルの分子イメージング	○伊藤 慎治¹, 兵藤 文紀¹	1.九大レドックスナビ

## 13 半導体 / Semiconductors

## 13.1 Si系基礎物性・表面界面・シミュレーション / Fundamental properties, surface and interface, and simulations of Si related materials 口頭講演

	3月11日(水) 9:00 - 12:30					
招待	9:00 - 9:15	11a-A27-1	「講演奨励賞受賞記念講演」(15分) 半導体プロセスを用いたナノギャップ電極の作製及びその電気特性	〇吉水 康人1, 田中 裕介1, 冨田 寛1	1.東芝	
	9:15 - 9:30	奨 11a-A27-2	回転白金電極を用いるSiC基板の平坦化	○赤井 智喜¹, 今村 健太郎¹, 小林 光¹	1.阪大産研	
	9:30 - 9:45	奨 11a-A27-3	高Ge濃度SiGeにおけるフォノン変形ポテンシャルの導出	○武内 一真¹, 小瀬村 大亮¹, 山本 章太郎¹, 富田 基裕¹³, 臼田 宏治², 小椋 厚志¹	1.明治大理工, 2.産総研 GNC, 3.学振特 別研究員 DC	
	9:45 - 10:00	奨 11a-A27-4	高Ge濃度歪SiGeメサ構造に印加された異方性2軸応力評価	○山本 章太郎¹, 武内 一真¹, 富田 基裕¹³, 小瀬村 大亮¹, 臼田 宏治², 小椋 厚志¹	1.明治大理工, 2.産総研GNC, 3.学振特 別研究員DC	
	10:00 - 10:15	奨 11a-A27-5	EBSP法を用いた微細な全Ge濃度域における歪SiGeメサ構造に生じる応力緩和分布の評価	○(D)富田 基裕¹², 小瀬村 大亮¹, 臼田 宏治³, 小椋 厚志¹	1.明大理工, 2.学振特別研究員DC, 3.産 総研GNC	

	10:15 - 10:30	奨 11a-A27-6	シリコンナノ粒子による水の分解と水素濃度	〇松田 真輔¹, 小林 悠輝¹, 赤井 智喜¹, 今村 健太郎¹, 小林 光¹	1.阪大産研
	10:30 - 10:45		休憩/Break		
	10:45 - 11:00	奨 11a-A27-7	局在プラズモン共鳴を用いたラマン分光法におけるひずみSi表面の Ag粒子被覆率と信号増強の関係	○木嶋 隆浩', 山本 章太郎', 横川 凌', 武 内 一真', 村上 達美', 小瀬村 太亮', 小 椋 厚志'	1.明大理工
	11:00 - 11:15	奨·E 11a-A27-8	Band Bending Model Reproducing Si(111) Hole Subband Levels Measured by ARPES	○Idayu Nur¹, Sakura Nishino Takeda¹, Takeshi J. Inagaki¹, Hiroshi Daimon¹	1.NAIST
	11:15 - 11:30	奨 11a-A27-9	二光子吸収過程を用いたレーザーによるソフトエラーシミュレーションの再現性	○井辻 宏章1.2, 小林 大輔1.2, 廣瀬 和之1.2	1.東大院工, 2.JAXA宇宙研
	11:30 - 11:45	奨 11a-A27-10	トンネルFETのシングルイベント耐性評価	○呉 研¹, 山本 航汰¹, 家城 大輔¹, 高橋 芳浩¹	1.日大理工
	11:45 - 12:00	奨 11a-A27-11	電界効果型マイクロウォール太陽電池の膜厚依存性	○(M1)大木 康平¹, 若宮 彰太¹, 部家 彰¹, 松尾 直人¹	1.兵庫県立大学院工
	12:00 - 12:15	11a-A27-12	Si量子ドット多重集積構造の電界電子放出特性評価	○竹内 大智¹, 牧原 克典¹, 大田 晃生², 池田 弥央³, 宮崎 誠一¹	1.名大院工, 2.名大VBL, 3.広大院先端研
	12:15 - 12:30	11a-A27-13	P添加がGeコアSi量子ドットのPL特性に及ぼす影響	○近藤 圭悟¹, 牧原 克典¹, 宮崎 誠一¹	1.名大院工
	3月12日(木)	10:00 - 12:3	30		
	10:00 - 10:15	12a-A27-1	Si表面平坦化の熱処理雰囲気依存性	○工藤 聡也¹, Atthi Nithi¹, 大見 俊一郎¹	1.東工大
	10:15 - 10:30	12a-A27-2	$NO_2$ を用いたSi系材料の低速ケミカルドライエッチング中の表面反応	○田嶋 聡美¹, 林 俊雄¹, 石川 健治¹, 関根誠¹, 堀 勝¹	1.名大院工
	10:30 - 10:45	12a-A27-3	Cuアシスト無電解エッチングによるSiナノワイヤの作製と評価	○高橋 翔平1, 安達 定雄1	1.群馬大学
	10:45 - 11:00	12a-A27-4	${ m Zr}\ { m L}lpha$ 線源を用いた ${ m AES}$ による ${ m SiO}_2/{ m Si}$ 界面構造の評価	○天野 裕士¹-², 小林 大輔², 野平 博司¹, 廣 瀬 和之²	1.東京都市大工, 2.宇宙研
	11:00 - 11:15	12a-A27-5	純水中極微量金属によるウエーハ汚染	○中津 正人¹	1.三重富士通セミコンダ クター
	11:15 - 11:30		休憩/Break		
	11:30 - 11:45	12a-A27-6	QSSPCライフタイム測定におけるトラッピング効果の補正方法	○中山 明¹, 吉川 博道¹	1.京セラ
	11:45 - 12:00	12a-A27-7	SSRMによる不純物揺らぎ測定の検討	○松沢 一也¹, 板井 翔吾¹, 小野 瑞城¹, 石 原 貴光¹, 張 利¹	1.東芝研究開発センター
	12:00 - 12:15	12a-A27-8	非線形誘電率顕微鏡法による低濃度ドーバントプロファイル評価	○広田 潤¹, 鷹野 正宗¹, 竹野 史郎¹, 赤堀 浩史¹, 茅根 慎通², 長 康雄²	1.東芝S&S社, 2.東北大通研
	12:15 - 12:30	12a-A27-9	深紫外レーザーを用いたレーザー補助3次元アトムプローブの検討	○金野 晃之¹, 大久保 忠勝², 富田 充裕¹, 宝野 和博²	1.東芝研究開発センター, 2.物質・材料 研究機構
	3月12日(木)	14:00 - 18:0	00		
招待	14:00 - 14:15	12p-A27-1	「講演奨励賞受賞記念講演」(15分) 酸化被膜型Siナノワイヤにおける熱伝導率低下の起源に関する原 子論的考察	〇図師 知文 <sup>1,3</sup> , 大毛利 健治 <sup>2</sup> , 山田 啓作 <sup>2</sup> , 渡邉 孝信 <sup>1</sup>	1.早大理工, 2.筑波大, 3.学振特別研究員DC2
	14:15 - 14:30	12p-A27-2	波付きシリコン量子細線における音響フォノンとその熱輸送	○服部 淳一¹, ウラジーミル ポボルチー¹, 多 田 哲也¹	1.産総研
	14:30 - 14:45	E 12p-A27-3	Atomistic phonon study of Hydrogen-terminated extremely thin silicon films	○Manoharan Muruganathan¹, Hiroshi Mizuta <sup>1,2</sup>	1.JAIST, 2.Univ. of Southampton
	14:45 - 15:00	12p-A27-4	BおよびPをドープしたSi量子ドットの電子状態 ~不純物準位のドーパント位置依存性~	○金田 千穂子¹	1.富士通研
	15:00 - 15:15	12p-A27-5	SiO <sub>2</sub> /Si構造中における金属原子の安定性に関する第一原理解析	○(M2)柴田 大生¹	1.岡山県立大学情報工
	15:15 - 15:30	12p-A27-6	金属/Ge界面における点欠陥の理論: MIGSの役割に関する第一原理的検討	○佐々木 奨悟¹, 中山 隆史¹	1.千葉大理
	15:30 - 15:45		休憩/Break		
	15:45 - 16:00	12p-A27-7	次世代TCAD(1) 第一原理計算を用いた4H-SiC中の格子欠陥準位と形成エネルギーの評価	○加藤 信彦¹, 岡崎 一行¹, 小池 秀耀¹	1.(株)アドバンスソフト
	16:00 - 16:15	12p-A27-8	次世代TCAD(2) 3次元デバイスシミュレータによるCMOSインバータ チェーンの一括過渡解析	○原田 昌紀¹, 桑原 匠史¹, 大倉 康幸¹, 山口憲¹, 小池 秀耀¹	1.アドバンストソフト
	16:15 - 16:30	12p-A27-9	次世代TCAD(3) 台形チャネルSi-nMOSFETの耐圧特性解析	○山田 吉宏¹, 大倉 康幸¹, 山口 憲¹, 小 池 秀耀¹	1.アドバンスソフト株式会社
	16:30 - 16:45	12p-A27-10	簡易SBDモデルによるデバイス回路混合シミュレーション	○松沢 一也¹, 阿部 真利¹, 小田 嘉則¹, 小町 潤¹, 伊藤 浩之¹, 秋山 豊¹	1.STARC
	16:45 - 17:00	12p-A27-11	領域分割半導体デバイスシミュレーションの収束ループの検討	○福田 浩一¹, 服部 淳一¹, 越本 浩央¹, 池 上 努¹	1.産総研
	17:00 - 17:15	12p-A27-12	超高速撮像素子におけるアパランシェ増倍効果のシミュレーション 解析	○南谷 夏海¹, Dao Vu Truong Son², 下ノ村 和弘², 江藤 剛治², 鎌倉 良成¹	1.阪大工, 2.立命館理工
	17:15 - 17:30	12p-A27-13	放射線衝突に伴う不揮発メモリのソフトエラーに関するシミュレーション	○脇村 豪¹, 鎌倉 良成¹	1.阪大院工
	17:30 - 17:45	12p-A27-14	SOI-MOSFETにおける重イオン照射誘起寄生バイポーラ効果	○(M1C)山本 航汰¹, 家城 大輔¹, 呉 研¹, 高橋 芳浩¹	1.日大理工

13.1 Si系基礎物性	3.1 Si系基礎物性・表面界面・シミュレーション / Fundamental properties, surface and interface, and simulations of Si related materials ポスター講演						
3月13日(金)	3月13日(金) 16:30 - 18:30						
	13p-P16-1	Al,Nを添加したSiの構造安定性と電子状態	○屋山 巴¹, 知京 豊裕¹	1.物材機構			
	13p-P16-2	アニール条件がGe表面の原子スケールのモフォロジーに与える影響	○森田 行則¹, 太田 裕之¹, 昌原 明植¹, 前 田 辰郎¹	1.産総研			
	13p-P16-3	Ga-In-O薄膜のウェットエッチングプロセス検討	○(B)吉田 邦晃!, 藤岡 秀平!, 後藤 良介¹, 尾沼 猛儀¹², 永井 裕己¹, 山口 智広¹, 本田 徹¹	1.工学院大工, 2.東京高専			

		13p-P16-4	太陽電池用バイパスダイオードに自己バイアスチャネルMOSダイオードを用いた時の電気的特性の検討	○山田 大輔¹, 工藤 嗣友¹, 菅原 文彦²	1.神奈川工大, 2.東北学
13.2	探索的材料特	物性·基礎物性	/ Exploratory Materials, Physical Properties, Devi	ices ポスター講演	寅
	3月12日(木)	13:30 - 15:3	30		
		12p-P8-1	三元系SiクラスレートK <sub>s</sub> Al <sub>z</sub> Si <sub>39</sub> の合成と物性	シンシバクマール¹, ○今井 基晴¹	1.物材機構
		12p-P8-2	$\beta\text{-FeSi}_2(010)//\text{Si}(110)$ エピタキシャル膜における偏光ラマンスペクトル	○(M1C)山口 陽己', 尾方 済人', 塚本 裕明 ¹, 草原 彰吾', 服部 哲', 東 貴彦', 秋山 賢輔', 寺井 慶和'	1.鹿児島大理工, 2.神奈川産技セ
		12p-P8-3	SiGe(111)上への $\beta$ -FeSi <sub>2</sub> エピタキシャル成長とひずみの評価	○塚本 裕明¹, 草原 彰吾¹, 山口 陽己¹, 尾方済人¹, 服部 哲¹, 東 貴彦¹, 寺井 慶和¹	1.鹿児島大理工
		12p-P8-4	スパッタリング法によるβ-FeSi₂多結晶薄膜の伝導型制御	○(M1C)服部 哲', 三村 祐介', 東 貴彦 ', 中山 翔太', 塚本 裕明', 山口 陽己', 寺 井 慶和'	1.鹿児島大理工
		12p-P8-5	単相高マンガンシリサイドの結晶性と熱電特性	○陣場 成行 <sup>1</sup> , 飯岡 優 <sup>1</sup> , 板倉 賢 <sup>2</sup> , 鵜殿 治彦 <sup>1</sup>	1. 茨城大院, 2. 九州大院
		12p-P8-6	簡易合成法で合成したMg <sub>2</sub> Si結晶の成長速度による結晶性への影響	○岡崎 大¹, 山口 桂汰¹, 鵜殿 治彦¹	1. 茨城大院
		12p-P8-7	ウェットエッチングによるメサ型 $\mathrm{Mg_2Si}$ pn接合ダイオードの作製	○秋山 智洋¹, 大徳 健太¹, 堀 信彦¹, 鵜 殿 治彦¹	1.茨城大工
		12p-P8-8	溶液法で合成した単相MnSi <sub>1.75-x</sub> の電気特性評価	飯岡 優¹, ○堀 俊平¹, 陣場 成行¹, 原 嘉昭 ², 鵜殿 治彦¹	1.茨城大, 2.茨城高専
		12p-P8-9	イオンピームスパッタ蒸着法を用いた $\mathrm{Er_2O_3}$ 膜の作製における照射イオン種の効果	○藤田 将弥¹², 山口 憲司², 朝岡 秀人², 毛偉³, 近田 拓未⁴, 鈴木 晶大³, 寺井 隆幸³	1.茨城大理, 2.原子力機構, 3.東京大, 4.静岡大
		12p-P8-10	アモルファス窒化炭素薄膜の作製I	○内島 一哉¹, 佐竹 聖樹², 中村 重之³, 財部 健一⁴, 福井 一俊⁵, 伊藤 國雄¹, 山本 伸一¹	1.龍谷大理工, 2.明石高専, 3.津山高専, 4.岡山理大, 5.福井大学
		12p-P8-11	光デバイスに向けた金属薄膜を用いたZnO多層薄膜の研究	○西羅 涼¹, 山本 伸一¹	1.龍谷大理工
		12p-P8-12	${ m BiVO}_4$ 薄膜における表面状態の評価	○久保 勇翔¹, 山本 伸一¹, 西谷 幹彦²	1.龍谷大理工, 2.大阪大工
		12p-P8-13	コヒーレントフォノン分光法によるカーボンナノチューブ混合溶液のカ イラリティ同定	○(M1)許 人杰¹, 片山 郁文¹, 南 康夫¹, 北 島 正弘¹²², 柳 和宏⁴, 武田 淳¹	1.横国大工, 2.防衛大理工, 3.ルクスレイ 株式会社, 4.首都大学東京理工
		12p-P8-14	金属偏析予測システムSurfSegへの拡散温度予測の追加	○吉武 道子¹	1.物材機構

	3月13日(金	) 9:00 - 12:3	30		
召待	9:00 - 9:15	13a-A25-1	「講演奨励賞受賞記念講演」(15分) Mg2Si pn接合ダイオードのAg拡散係数評価と拡散深さ制御	〇堀 信彦¹, 江坂 文孝², 鵜殿 治彦¹	1.茨城大院, 2.原子力機構
	9:15 - 9:30	13a-A25-2	リング電極 $\mathrm{Mg}_{\mathrm{g}}$ Si フォトダイオードにおけるメサ構造の形成	○大徳 健太¹, 堀 信彦¹, 谷川 俊太郎², 津谷 大樹², 鵜殿 治彦¹	1. 茨城大院, 2. 物材機構
	9:30 - 9:45	13a-A25-3	Mg/Si薄膜積層構造により作製したMg <sub>2</sub> Si膜の物性評価	○長谷川 明紀', 角嶋 邦之², 片岡 好則², 西山 彰², 杉井 信之², 若林 整², 筒井 一生², 名取 研二¹, 岩井 洋¹	1.東工大フロンティア研, 2.東工大総理
	9:45 - 10:00	13a-A25-4	液体封止 $VGF$ 法による $Mg_2Si$ バルク結晶成長	○中川 玲緒¹, 和田 大輝¹, 勝俣 裕¹, 櫻木 史郎², 橋本 哲²	1.明大理工, 2.ユニオンマテリアル(株)
	10:00 - 10:15	13a-A25-5	SPS法で作製したNi-Mg <sub>2</sub> Si界面の断面TEM観察 (2)	○菅原 宏治¹, 山崎 由布紀¹, 中村 新一², 中村 重之³, 森 嘉久⁴, 財部 健一⁴	1.首都大SD, 2.青山学院大, 3.津山高 4.岡山理科大
	10:15 - 10:30	13a-A25-6	Mg_Siの構造欠陥の合成圧力依存性についての考察	○今井 庸二¹, 森 嘉久², 中村 重之³, 財 部 健一²	1.産総研, 2.岡山理大, 3.津山高専
	10:30 - 10:45		休憩/Break		
	10:45 - 11:00	13a-A25-7	AuコートSi上に合成した鉄シリサイドのPL発光特性	○秋山 賢輔1.², 舟窪 浩²	1.神奈川産技セ, 2.東京工業大
	11:00 - 11:15	13a-A25-8	$eta$ -FeSi $_2$ 多結晶薄膜における電気伝導機構の検証	○(M1C)東 貴彦¹, 中山 翔太¹, 服部 哲¹, 三村 祐介¹, 塚本 裕明¹, 山口 陽己¹, 寺井 慶和¹	1.鹿児島大理工
	11:15 - 11:30	13a-A25-9	共スパッタリング法によるアモルファス $Si/\beta$ - $FeSi_2$ 複合薄膜の形成	○(M1)澤田 真志¹, 中沢 公大¹, 勝俣 裕¹	1.明大理工
	11:30 - 11:45	13a-A25-10	リモート水素プラズマ支援によるFeシリサイドナノドットの高密度一括 形成と磁化特性評価	○張 海¹, 牧原 克典¹, 大田 晃生², 壁谷 悠 希¹, 宮崎 誠一¹	1.名大院工, 2.名大VBL
	11:45 - 12:00	13a-A25-11	バルスレーザー堆積法で作製した(Mn,Fe)Si $_{\sim 1.7}$ 薄膜のバンドギャップ	○(B)石井 健太郎¹, 林 慶¹, 宮﨑 讓¹	1.東北大工
	12:00 - 12:15	E 13a-A25-12	Growth of $\operatorname{CaSi}_2$ layers on Si substrates induced by Kirkendall void formation	Xiang Meng¹, Akiko Ueki², Haruo IMAGA- WA², Hiroshi ITAHARA², ○Hirokazu Tatsuoka²	1.Graduate School of Science and Technology, Shizuoka Univ., 2.Toyot Central R&D Labs., Inc., 3.Graduate School of Engineering, Shizuoka University
	12:15 - 12:30	13a-A25-13	キセノンイオンを注入したシリコンのアニールによる構造変化 II	○北川 淳嗣', 藤田 詩織', 羽渕 仁恵', 飯田 民夫', 大橋 史隆², 伴 隆幸², 久米 徹二², 野々村 修一²	1.岐阜高専, 2.岐大工
	3月13日(金	) 16:15 - 19:	15		
	16:15 - 16:30	奨 13p-A25-1	Na-Al-Sn系新規化合物の合成と結晶構造および電気的特性	○(M1)菅野 雅博¹, 山田 高広¹, 山根 久典¹	1.東北大多元研
	16:30 - 16:45	奨 13p-A25-2	Siクラスレート薄膜のNa含有量と結晶歪みのヨウ素処理依存性	○(M1)竹下 博高¹, 境 健太郎², 原口 智宏¹, 鈴木 秀俊¹, 大橋 史隆³, 久米 徹二³, 福山敦彦¹, 野々村 修一³, 碇 哲雄¹	1.宮崎大工, 2.宮崎大産・地連セ, 3.岐 大工
	16:45 - 17:00	13p-A25-3	Na内包II型Siクラスレート前駆体膜作製条件の最適化	○野村 政貴¹, 野口 明宏¹, 阪上 真史¹, 大橋 史隆¹, 久米 徹二¹, 伴 隆幸¹, 野々村 修一¹	1.岐大院工
	17:00 - 17:15	13p-A25-4	II型Siクラスレート薄膜に含まれる不純物の評価および低減	○上原 康暉', 砂場 昭吾', 浦野 和俊', 大橋 史隆', 入米 徹二', 伴 隆幸', 山家 光男¹, 野々村 修一¹	1.岐大院工
	17:15 - 17:30	13p-A25-5	スパッタ膜を用いた透明基板上へのII型Geクラスレート膜の作製	○萬條 宏行¹, 船戸 一平¹, 向井 哲也¹, 大橋 史隆¹, 伴 隆幸¹, 久米 徹二¹, 野々村 修一¹	1.岐大院工
	17:30 - 17:45	13p-A25-6	W内包Siクラスターを凝集したシリサイド半導体薄膜の電気伝導特性	○岡田 直也1.2, 内田 紀行2, 金山 敏彦2	1.JSTさきがけ, 2.産総研

17:45 - 18:00	13p-A25-7	Bi 原子細線をドーパント源とするSi 結晶中へのBi $\delta$ ドーピング法: キャリア輸送特性評価	○三木 一司 <sup>1,2</sup> , 金澤 孝 <sup>1,2</sup> , 村田 晃一 <sup>1,2</sup> , 日 塔 光一 <sup>1</sup>	1.物材機構, 2.筑波大数物
18:00 - 18:15	13p-A25-8	界面ナノ構造を利用したIV族半導体へのMnδドービング:機構解明	村田 晃一1², 〇三木 一司1², 新田 清文³, 金澤 孝1², 坪松 悟史1², 日塔 光一¹, 坂田 修身¹, 寺田 靖子³, 宇留賀 朋哉³	1.物材機構, 2.筑波大数物, 3.JASRI
18:15 - 18:30	奨 13p-A25-9	希薄磁性半導体超格子GaGdAs/GaAsへのSiドーブが及ぼす影響	○大西 吉行', 山野 高史', 行廣 克成', 原田 優', 宮川 勇人', 小柴 俊', 中西 俊介', 橋本 光博', 高橋 敏男°	1.香川大工, 2.東大物性研
18:30 - 18:45	13p-A25-10	$\mathrm{Mn}_{3\mathrm{x}}\mathrm{Co_{x}O_{4}}$ の磁気相図と新奇な物性	○平井 慈人¹, 山田 幾也², 八木 俊介², 神原陽一³, 的場 正憲³	1.高圧先進科研中心, 2.大府大21NRC, 3.慶大理工
18:45 - 19:00	13p-A25-11	ナノアモルファス窒化炭素を用いたRe炭窒化物の高温高圧合成	○安井 望¹, 財部 健一¹, 岡田 卓², 山崎 大輔³, 大藤 弘明⁴, 小島 洋平⁴	1.岡山理大理, 2.東大物性研, 3.岡大地球研, 4.愛媛大GRC
19:00 - 19:15	13p-A25-12	A型希土類構造とC型希土類構造の混晶系のラマン散乱	○知花 優太郎¹, 山中 明生¹	1.千歳科学技術大学
3月14日(土	9:00 - 12:0	0		
9:00 - 9:15	E 14a-A25-1	Formation of MoO3/n-BaSi2 heterojunctions for solar cell applications	○Weijie Du¹, Masakazu Baba¹, Ryota Tak- abe¹, Hiroki Takeuchi¹, Daichi Tsukahara¹, Kaoru Toko¹, Noritaka Usami²³, Takashi Suemasu¹³	1.Univ. of Tsukuba, 2.Nagoya Univ., 3.JST-CREST
9:15 - 9:30	14a-A25-2	MBE法で形成したBaSi $_2$ エビタキシャル膜/酸化膜界面の欠陥準位評価	○武内 大樹¹, Du Weijie¹, 高部 涼太¹, 都甲 薫¹, 原 康祐², 宇佐美 徳隆³⁴, 末益 崇¹.⁴	1.筑波大学院, 2.山梨大学, 3.名古屋大学, 4.JST-CREST
9:30 - 9:45	奨 14a-A25-3	BaSi, domain boundary の最安定構造及び界面特性についての 考察	○馬場 正和', 香山 正徳², 都甲 薫¹, 末 益 崇¹.3	1.筑波大院数理, 2.産総研ユビキタス, 3.JST-CREST
9:45 - 10:00	14a-A25-4	多結晶Si上に成長したBaSi₂薄膜表面のKFM法によるポテンシャル分布評価	○李 云鵬¹, 馬場 正和¹, 沼田 涼平¹, 都甲 薫¹, 宇佐美 徳隆²⁴, 関口 隆史³, 末益 崇¹.⁴	1.筑波大, 2.名大, 3.物材研, 4.JST- CREST
10:00 - 10:15	14a-A25-5	KFM法によるバイアス印加時Si(111)基板上BaSi $_2$ pn接合におけるポテンシャル観察	○塚原 大地¹, 馬場 正和¹, 都甲 薫¹, 渡辺 健太郎¹², 関口 隆史², 末益 崇¹.3	1.筑波大数理, 2.物材機構, 3.JST- CREST
10:15 - 10:30	14a-A25-6	RFスパッタ法により作製したBaSi <sub>z</sub> 薄膜表面の粒界ポテンシャル評価	○(B)横山 展也¹, Nurul A. A. Latiff¹, 馬場 正和¹, 李 云鵬¹, 召田 雅実², 倉持 豪人², 都 甲 薫¹, 末益 崇¹³	1.筑波大院 電子·物理工学専攻, 2.東>一株式会社, 3.JST-CREST
10:30 - 10:45		休憩/Break		
10:45 - 11:00	14a-A25-7	BaSi₂における不純物原子拡散と固溶度の理論検討	○(M1)大須賀 祐喜¹, 中山 隆史¹	1.千葉大理
11:00 - 11:15	14a-A25-8	希少元素フリーSnS/BaSi₂太陽電池の提案と数値シミュレーション	○原 康祐1-2, 末益 崇2-3, 宇佐美 徳隆2-4	1.山梨大クリスタル研, 2.JST-CREST, 3.筑波大院数理物質, 4.名大院工
11:15 - 11:30	14a-A25-9	真空蒸着法による導電性基板上への BaSi₂薄膜の作製	○(B)須原 貴道¹, 原 康祐².³, 末益 崇².⁴, 宇 佐美 徳隆¹.²	1.名古屋大, 2.JST-CREST, 3.山梨大, 4.筑波大
11:30 - 11:45	14a-A25-10	真空蒸着法により作製したBaSi。薄膜の膜厚による影響	○中川 慶彦¹, 原 康祐²³, 末益 崇³.⁴, 宇佐 美 徳隆¹.³	1.名大工, 2.山梨大, 3.JST-CREST, 4.筑波大
11:45 - 12:00	14a-A25-11	SnS/BaSi $_2$ ヘテロ接合太陽電池に向けた真空蒸着法によるSnS薄膜作製	○鈴木 慎太郎¹, 須原 貴道¹, 原 康祐²³, 末 益 崇³⁴, 宇佐美 徳隆¹.³	1.名大工, 2.山梨大クリスタル研, 3.JST CREST, 4.筑波大
3月14日(土	) 13:00 - 14:	00		
13:00 - 13:15	14p-A25-1	アンモニアプロセスを用いたBaSi <sub>2</sub> 薄膜の合成と評価	○関口 隆史 <sup>1,2</sup> , 山根 久典³, 陳 君¹, 渡辺 健 太郎 <sup>1,2</sup> , 末益 崇²	1.物材機構, 2.筑波大数理, 3.東北大 多元研
13:15 - 13:30	14p-A25-2	固相成長テンプレートを用いたGe(111)基板上へのBaSi <sub>2</sub> 膜作製	○高部 涼太¹, 原 康祐², 都甲 薫¹, 宇佐美 徳隆³⁴, 末益 崇¹.⁴	1.筑波大電物, 2.山梨大学, 3.名古屋大学, 4.JST-CREST
13:30 - 13:45	奨·E 14p-A25-3	Fabrication of $\mathrm{Ba(Si,C)}_2$ films on $\mathrm{Si(111)}$ by plasma-assisted molecular beam epitaxy	○(B)JAEJUN LEE¹, HIROKI TAKE- UCHI², RYOTA TAKABE², KAORU TOKO¹², TAKASHI SUEMASU¹.².³	1.Coll. of engineering sciences, Univ. of Tsukuba, 2.Inst. of Applied Physic Univ. of Tsukuba, 3.JST-CREST
13:45 - 14:00	14p-A25-4	Ba <sub>l-x</sub> Sr <sub>x</sub> Si <sub>2</sub> の結晶構造	○今井 基晴¹, 松下 能孝¹	1.物材機構

3月12日(木)	9:30 - 11:30			
	12a-P12-1	MONOS型メモリにおける絶縁膜中の原子欠陥に関する第一原理 計算	○白川 裕規¹, 洗平 昌晃², 神谷 克政³, 白 石 賢二²	1.筑波大院数理, 2.名大院工, 3.神奈 工大
	12a-P12-2	定電流キャリヤ注入法を用いたMONOS構造の正孔捕獲特性の評価	○(M1)田中 伸¹, 内藤 慎二¹, 小林 清輝¹	1.東海大院工
	E 12a-P12-3	Charge retention characteristics of charge trapping nonvolatile memories with silicon carbonitride (SiCN) dielectrics	(D)SheikhRashel Ahmed¹, Shinji Naito², Hironori Shibayama³, Jyunya Nakamura³, Kyoteru Kobayashi¹¹².3	1.GRAD SCH S&T, Tokai Univ, 2.GRAD SCH Eng, Tokai Univ, 3.SCH Eng, Tokai Univ.
	12a-P12-4	酸化剤を変えたALD-Al $_2$ O $_3$ 膜のMOSキャパシタの特性評価	○福井 僚¹, 中村 嘉基¹, 角嶋 邦之², 片岡 好則², 西山 彰², 杉井 信之², 若林 整², 筒井 一生², 名取 研二¹, 岩井 洋¹	1.東工大フロンティア研, 2.東工大総理コ
	12a-P12-5	欠損を含むシリコン酸化膜中のアンモニア分子の透過	○奧 友希¹, 戸塚 正裕¹, 志賀 俊彦¹, 渡 辺 斉¹	1.三菱電機 波光電
	E 12a-P12-6	Improvement of Electrical Properties of InGaAs MOS Interfaces by Inserting La Oxide Interfacial Layers into InGaAs Gate Stacks	(D)ChihYu Chang <sup>1,3</sup> , Osamu Ichikawa <sup>2,3</sup> , Takenori Osada <sup>2,3</sup> , Hisashi Yamada <sup>2,3</sup> , Mitsuru Takenaka <sup>1,3</sup> , Shinichi Takagi <sup>1,3</sup>	1.The Univ. of Tokyo, 2.Sumitomo Chemical, 3.JST-CREST
	12a-P12-7	Radical-Enhanced ALD法によるGe基板上Alジャーマネイトの形成機構に関する検討	横平 知也¹, ○梁池 昂生¹, 柳 炳學², 山 本 千綾², 山中 淳二², 佐藤 哲也², 岡本 浩 ³, 福田 幸夫¹	1.諏訪東京理科大学, 2.山梨大学, 3.弘 前大学

13	13.3 絶縁膜技術 / Insulator technology						
	3月13日(金) 9:00 - 12:30						
	9:00 - 9:15	E 13a-A24-1	Passivation of silicon surfaces by heat treatment in liquid water at $110^{\circ}\text{C}$	○Tomohiko Nakamura¹, Toshiyuki Sameshima¹, Masahiko Hasumi¹, Tomohisa Mizuno²	1.TUAT, 2.Kanagawa Univ.		
	9:15 - 9:30	13a-A24-2	高圧水蒸気中における陽極酸化法により成膜した $\mathrm{SiO}_2$ 膜の特性評	価 ○(M1C)手原 大貴¹, 尾和瀬 智成¹, 呉 研¹, 高橋 芳浩¹	1.日大理工		
	9:30 - 9:45	13a-A24-3	低温 $Kr/O_2$ プラズマ酸化法による $SiO_2/Si$ 構造の作製および評価	○藤川 雄太¹, 岩崎 好孝¹, 上野 智雄¹	1.農工大工		

9:45 - 10:00	13a-A24-4	Multi-Phonon遷移を考慮したSmall-PolaronのVariable Range Hopping	○宝玉 充¹, 谷本 弘吉¹, 青木 伸俊¹, 石 丸 一成¹	1.東芝セミコンダクター&ストレージ社
10:00 - 10:15	13a-A24-5	XANES から推定したSiO <sub>2</sub> /Si 界面の物性評価	○森谷 真帆¹², 小林 大輔², 山本 知之¹, 廣 瀬 和之²	1.早大理工, 2.宇宙科学研究所
10:15 - 10:30	13a-A24-6	SiC MOSキャパシタのTZDB測定時動画撮影による絨毯爆撃状破壊 痕形成メカニズムの解明	○佐藤 創志¹, 廣井 佑紀², 山部 紀久夫², 北 畠 真³, 遠藤 哲郎¹⁴⁵, 丹羽 正昭¹	1.東北大CIES, 2.筑波大院, 3.FUPI 4.東北大CSIS, 5.東北大院工
10:30 - 10:45	E 13a-A24-7	Effectiveness of surface potential fluctuation for representing inversion-layer mobility limited by Coulomb scattering in MOSFETs	(D)Weili Cai <sup>12</sup> , Mitsuru Takenaka <sup>12</sup> , Shinichi Takagi <sup>1,2</sup>	1.Tokyo Univ., 2.JST CREST
10:45 - 11:00		休憩/Break		
11:00 - 11:15	奨 13a-A24-8	水蒸気を用いたプラズマ誘起原子層堆積法によるAl <sub>2</sub> O <sub>3</sub> 膜の絶縁特性改善	○梅原 智明', 堀田 昌宏', 吉嗣 晃治', 石河泰明', 浦岡 行治'	1.奈良先端大
11:15 - 11:30	13a-A24-9	分子動力学法によるhigh-k/SiO₂界面のダイボール形成シミュレーション(2) -酸素密度緩和モデルで説明できないMgO/SiO₂界面ダイボールの再現-	○功刀 遼太¹, 橋口 誠広¹, 志村 昴亮¹, 小椋 厚志³⁵, 佐藤 真一⁴₅, 渡邉 孝信¹²⁵	1.早大理工, 2.早大ナノ機構, 3.明大工, 4.兵庫県立大, 5.JST-CREST
11:30 - 11:45	13a-A24-10	$3$ 次元アトムプローブ法によ $3$ Al $_2$ O $_3$ 膜中の水素分布評価	○清水 康雄¹, 韓 斌¹, 井上 耕治¹, 矢野 史子², 井上 真雄³, 国宗 依信⁴, 島田 康弘⁴, 片山 俊治⁴, 井手 隆⁴, 永井 康介¹	1.東北大金研, 2.東京都市大, 3.ルスス, 4.ルネサスセミコンダクタマニュンクチュアリング
11:45 - 12:00	奨·E 13a-A24-11	Patterning of High-k/metal gate Stack by Neutral Beam Etching Technique for Sub-20 nm CMOS Technology	○YinHsien Su <sup>1,2</sup> , JiaNan Shih <sup>1</sup> , Tomohiro Kubota <sup>2</sup> , WenHsi Lee <sup>1</sup> , YingLang Wang <sup>3</sup> , Seiji Samukawa <sup>2</sup>	1.National Cheng Kung Univ., 2.7 ku Univ., 3.TSMC
12:00 - 12:15	E 13a-A24-12	In-situ Formation of $HfN_{x}$ Gate Stack Structures Utilizing ECR Plasma Sputtering	○Atthi Nithi¹, Shun-ichiro Ohmi¹	1.Tokyo Inst. of Tech.
12:15 - 12:30	13a-A24-13	TiN/HfO₂/TiN構造におけるHfO₂膜の強誘電的特性	○西村 知紀¹, 矢嶋 赳彬¹, 鳥海 明¹	1.東大院工
3月14日(土	9:00 - 12:15	, )		
9:00 - 9:15	14a-A24-1	CVD法を用いたGeO <sub>2</sub> /Ge構造の作製と評価	○小倉 大輝¹, 岩崎 好孝¹, 上野 智雄¹	1.東京農工大工
9:15 - 9:30	14a-A24-2	Hf-Post Metallization AnnealingによるGeO <sub>2</sub> /Ge界面特性の改善効果	○新井田 淳平¹, 岩崎 好孝¹, 上野 智雄¹	1.農工大院工
9:30 - 9:45	14a-A24-3	低温アニールによるGeNx膜質改善	○田中 佑治¹, 岩崎 好孝¹, 上野 智雄¹	1.農工大工
9:45 - 10:00	14a-A24-4	ブラズマ後窒化(100)面及び(110)面SiGe MOS界面の比較	○(D)韓 在勲 <sup>1,2</sup> , 竹中 充 <sup>1,2</sup> , 高木 信一 <sup>1,2</sup>	1.東大院工, 2.JST-CREST
10:00 - 10:15	奨 14a-A24-5	Al <sub>2</sub> O <sub>3</sub> /Ge構造に対する熱酸化にともなうGe表面からのGe原子放 出過程	〇柴山 茂久 <sup>1,2</sup> , 中嶋 薫³, 坂下 満男¹, 中塚理¹, 木村 健二³, 財満 鎭明¹.⁴	1.名大院工, 2.学振特別研究員, 3.5 院工, 4.名大エコトピア
10:15 - 10:30	14a-A24-6	ALDとECRプラズマ酸化による酸化膜固定電荷密度の制御	○永冨 雄太¹, 長岡 裕一¹, 田中 慎太郎¹, 山本 圭介², 王 冬¹, 中島 寬²	1.九大総理工, 2.九大産学連携セン
10:30 - 10:45		休憩/Break		
10:45 - 11:00	奨 14a-A24-7	GaSb表面の純窒化プロセスの検討	○(M2)後藤 高寛¹², 藤川 紗千恵¹, 藤代 博記¹, 小倉 睦郎², 安田 哲二², 前田 辰郎¹²	1.東理大院基礎工, 2.産総研
11:00 - 11:15	奨 14a-A24-8	${ m Ge}$ 上ルチル型 ${ m TiO}_2$ 層へのアクセプタドープによる絶縁性向上の試み	○(B)鈴木 良尚¹, 長田 貴弘², 山下 良之², チナマトゥ バウルサミー², 小橋 和義¹, 生田 目 俊秀², 小椋 厚志¹, 知京 豊裕²	1.明治大学, 2.物質材料研究機構
11:15 - 11:30	14a-A24-9	原子マッチングを利用した結晶性 $\mathrm{La_2O_3}$ high-k/Ge(111)構造の作製	○金島 岳¹, 梶原 康裕¹, 銭高 真人¹, 山田 晋也¹, 浜屋 宏平¹	1.阪大基礎工
11:30 - 11:45	14a-A24-10	結晶性 $\text{La}_2\text{O}_3/\text{Ge}(111)$ における電気特性のアニール効果	○銭高 真人¹, 梶原 康裕¹, 山田 晋也¹, 浜屋 宏平¹, 金島 岳¹	1.阪大基礎工
11:45 - 12:00	E 14a-A24-11	Reliability-aware Germanium Gate Stack Formation by ${\rm GeO}_2$ Network Modification	○Cimang Lu¹², Choong Hyun Lee¹², To- monori Nishimura¹², Kosuke Nagashio¹², Akira Toriumi¹²	1.The Univ. of Tokyo, 2.JST-CRE
12:00 - 12:15	奨·E 14a-A24-12	Design of High-k and Interfacial Layer on Germanium for 0.5 nm EOT	OCimang Lu <sup>1,2</sup> , Choong Hyun Lee <sup>1,2</sup> , To- monori Nishimura <sup>1,2</sup> , Kosuke Nagashio <sup>1,2</sup> , Akira Toriumi <sup>1,2</sup>	1.The Univ. of Tokyo, 2.JST-CRE

13.4	Siプロセス・	配線·MEMS·	集積化技術 / Si wafer processing /MEMS/Integrat	ion technology	口頭講演		
	3月11日(水) 9:00 - 12:30						
	9:00 - 9:15	11a-A29-1	高信頼性ULSI-Cu配線用PVD-Co(W)膜の特性	○百瀬 健¹, 冨田 皓太¹, 角田 隆明², 中川 隆史², 霜垣 幸浩¹	1.東大院工, 2.キヤノンアネルバ		
	9:15 - 9:30	11a-A29-2	超臨界CO₂流体中における金属薄膜のエッチング	○(M1)中村 良輝 <sup>1</sup> , 渡邉 満洋 <sup>1</sup> , 近藤 英一 <sup>1</sup> , ミハイル バクラノフ <sup>2</sup>	1.山梨大, 2.IMEC		
	9:30 - 9:45	11a-A29-3	Auナノチャネルのエレクトロマイグレーションによる質量輸送過程の In-Situ AFM観察	○八木 麻実子¹, 齋藤 孝成¹, 白樫 淳一¹	1.東京農工大学院工		
	9:45 - 10:00	奨 11a-A29-4	ナノシリコン弾道電子源を用いたCu薄膜のブリンティング堆積	○須田 隆太郎¹, 八木 麻実子¹, 小島 明¹, Romain Mentek¹, 白樫 淳一¹, 越田 信義¹	1.農工大・院・工		
	10:00 - 10:15	11a-A29-5	印刷+メッキ法による低抵抗銅配線技術の開発	○徳久 英雄¹, 富田 充¹, 森田 智子¹, 伊勢 翔吾¹, 塚本 志帆¹	1.産総研		
	10:15 - 10:30	11a-A29-6	シリコンフォトニクス光集積回路におけるプロセス課題(I) 高精度加工 及びプロセスモニタリング	○堀川 剛¹², 志村 大輔², 鄭 錫煥², 徳島 正敏², 木下 啓藏², 最上 徹²	1.産総研, 2.PETRA		
	10:30 - 10:45	11a-A29-7	シリコンフォトニクス光集積回路におけるプロセス課題 (II) 光機能素子の集積と実装	○木下 啓藏¹, 堀川 剛¹², 奥村 滋一¹, 竹村 浩一¹, 清水 隆徳¹, 藤方 潤一¹, 最上 徹¹	1.PETRA, 2.産総研		
	10:45 - 11:00		休憩/Break				
	11:00 - 11:15	奨 11a-A29-8	TSV Siアイランドの集積化に向けたDeep-Trenchへの酸化物埋め 込み	○浦岡 泰之¹, 大井 英生², 石田 誠¹², 河 野 剛士¹	1.豊橋技科大 電気·電子情報工学, 2.豊橋技科大 EIIRIS		
	11:15 - 11:30	11a-A29-9	ミニマル装置を用いた連続プロセスでのPZT薄膜形成	○数佐 純子 <sup>1</sup> , 古賀 和博 <sup>1</sup> , 梅山 規男 <sup>1</sup> , 野田 大二 <sup>3</sup> , 扇子 義久 <sup>1,4</sup> , 千葉 貴史 <sup>1,5</sup> , 寺田 昌男 <sup>1,5</sup> , クンプアン ソマワン <sup>1,2</sup> , 原 史郎 <sup>1,2</sup>	1.ミニマルファブ技術研究組合, 2.産総研, 3.マイクロマシンセンター, 4.リソテック, 5.坂口電熱		
	11:30 - 11:45	11a-A29-10	ミニマルBOSCHプロセス	○田中 宏幸 <sup>1</sup> , 清水 禎樹 <sup>12</sup> , 小木曽 久人 <sup>12</sup> , 中野 禅 <sup>12</sup> , 速水 利泰 <sup>3</sup> , 宮崎 後也 <sup>3</sup> , 富 阪 賢一 <sup>3</sup> , 手銭 永充 <sup>3</sup> , クンプアン ソマワン <sup>12</sup> , 原 史朗 <sup>12</sup>	1.ミニマルファブ, 2.産総研, 3.SPPテク ノロジーズ		
	11:45 - 12:00	11a-A29-11	ミニマル装置群によるBGAパッケージングプロセス	○居村 史人¹, 井上 道弘², 猿渡 新水¹², クン プアン ソマワン¹², 原 史朗¹²	1.ミニマルファブ, 2.産総研		

12:00 - 12:15	11a-A29-12	ミニマルダイボンディングプロセス	○寶池 広由 <sup>1</sup> , 居村 史人 <sup>1</sup> , 宮本 清治 <sup>1,2</sup> , クンプアンソマワン <sup>1,3</sup> , 原 史郎 <sup>1,3</sup>	1.ミーマル, 2. 石井工下研先別, 3.座
12:15 - 12:30	11a-A29-13	ミニマル圧縮モールド成形プロセス	○東野 泰英 <sup>1</sup> , 居村 史人 <sup>1</sup> , 小林 一彦 <sup>2</sup> , 井 上 道弘 <sup>3</sup> , 猿渡 新水 <sup>13</sup> , クンプアン ソマワン <sup>13</sup> , 原 史郎 <sup>13</sup>	1.ミニマル, 2.アピックヤマダ, 3.産総
3月11日(水	) 14:00 - 17	:30		
14:00 - 14:15	奨 11p-A29-1	触覚、摩擦、温度センサ集積人工電子皮膚	○原田 真吾¹, 金尾 顕一朗¹, 山本 祐輝¹, 有 江 隆之¹, 秋田 成司¹, 竹井 邦晴¹	1.大阪府大
14:15 - 14:30	奨 11p-A29-2	触覚と曲げに対する高い選択性を有した電子皮膚デバイス	○金尾 顕一朗¹,原田 真吾¹,山本 祐輝¹,本田 航¹,有江 隆之¹,秋田 成司¹,竹井 邦晴¹	1.大阪府大
14:30 - 14:45	11p-A29-3	マイクロ流路を一体化したMEMS Fabry-Perot干渉型表面応力センサの製作	○桝屋 善光¹, 小澤 遼¹, 石田 誠¹, 澤田 和明¹², 髙橋 一浩¹²	1.豊橋技科大, 2.JST-CREST
14:45 - 15:00	11p-A29-4	リング型PZT電極を用いたMEMS共振センサの製作	○高橋 一浩1.2, 石田 誠1, 澤田 和明1.2	1.豊橋技科大, 2.JST-CREST
15:00 - 15:15	11p-A29-5	エネルギーハーベスティングデバイスの検討(5)	○小西 敏文¹, 山根 大輔², 松島 隆明¹, 益 一哉², 年吉 洋³, 町田 克之¹²	1.NTT-AT, 2.東工大, 3.東大
15:15 - 15:30	11p-A29-6	Optical Response of Micromechanical Infrared Thermal Detector	○(PC)Jonghyeon Jeong¹, Shinya Kumagai¹³, Ichiro Yamashita²²³, Yukiharu Uraoka²³, Minoru Sasaki¹³	1.Toyota Technological Institute, 2.Nara Institute of Science and T nology, 3.CREST JST
15:30 - 15:45		休憩/Break		
15:45 - 16:00	奨 11p-A29-7	ビーズを用いたPDMS製細菌捕獲チップの検討III- 各種細菌の蛍光強度特性の時間依存性 -	○西村 祐典!, 林 隆平!, 中澤 寬一!, 石田 誠!, 澤田 和明!, 石井 仁!, 町田 克之², 益 一哉², 王 常楽¹, 飯田 健一郎⁴, 齋藤 光正 ⁴, 吉田 眞一⁴	1.豊橋技科大, 2.東工大, 3.NT- Tアドパンストテウノロジ, 4.九州大学医学研究院
16:00 - 16:15	E 11p-A29-8	Two-Dimensional Redox Imaging Employing Integrated Square Wave Voltammetric Pulse Generator Circuit	(P)BYOUNGHYUN LIM¹, Sou Takahashi¹, Masato Futagawa², Fumihiro Dasai¹.³, Makoto Ishida¹, Kazuaki Sawada¹.³	1.Toyohashi Univ. of Tech., 2.Shi Univ., 3.CREST
16:15 - 16:30	11p-A29-9	容量計測型呼吸センサのための衣服組み込み電極	寺澤 槙恵¹, 熊谷 慎也¹, ○佐々木 実¹	1.豊田工大
16:30 - 16:45	11p-A29-10	波長選択性熱放射による狭空間内における電子デバイス冷却技術	○津田 慎一郎¹, 清水 信¹, 井口 史匡¹, 湯 上 浩雄¹	1.東北大院工
16:45 - 17:00	11p-A29-11	水蒸気酸化によるポーラスシリコンの3次元構造形成	○出野上 真樹¹, 石黒 敬太¹, 青木 画奈¹, 藤井 稔¹	1.神戸大院工
17:00 - 17:15	11p-A29-12	切削平坦化した金バンプを用いたウェハレベル真空封止接合	○平野 栄樹¹, 引地 広介¹, 田中 秀治¹	1.東北大工
17:15 - 17:30	11p-A29-13	高精度薄化研削のための水膜チャックの開発	○吉冨 健一郎¹, 宇根 篤暢¹, 餅田 正秋¹, 坂東 翼², 山本 栄一²	1.防大機械, 2.岡本工作機械
3月12日(木	9:00 - 12:0	00		
9:00 - 9:15	12a-A29-1	青色半導体レーザアニール中のSi膜内光吸収量解析	○岡田 竜弥¹, 神村 盛太¹, 野口 隆¹	1.琉球大工
9:15 - 9:30	12a-A29-2	脱水素無しのアモルファスSi薄膜に対するBLDA低抵抗化	○若杉 智英!, 安次富 卓哉!, 岡田 竜弥 !, 野口 隆!, 西方 靖², 太田 淳², 井上 和久 ³, 山田 一雄³	1.琉球大工, 2.(株)アルバック, 3.プクトサポート社
9:30 - 9:45	12a-A29-3	マイクロ熱プラズマジェット照射によるSi結晶成長の初期膜依存性	○林 将平¹², 森崎 誠司¹, 山本 将悟¹, 中谷 太一¹, 新 良太¹, 東 清一郎¹	1.広大院先端研, 2.学振特別研究員
9:45 - 10:00	12a-A29-4	大気圧マイクロ熱プラズマジェット結晶化によるa-Siパターン内結晶成長のその場観察	○(D)森崎 誠司¹, 林 将平¹, 山本 将悟¹, 中谷 太一¹, 笠原 拓也¹, 東 清一郎¹	1.広大院先端研
10:00 - 10:15	12a-A29-5	金誘起低温層交換法による高Ge組成(≥50%)SiGe/絶縁膜の大粒 径・方位制御成長(≤300℃)	○佐道 泰造¹, パク ジョンヒョク¹², 青木 陸太¹, 宮尾 正信¹	1.九大システム情報, 2.学振
10:15 - 10:30		休憩/Break		
10:30 - 10:45	12a-A29-6	非晶質C12A7 エレクトライド/結晶Si の接合とI-V 特性	○渡邉 俊成¹, 小穴 保久², 戸田 喜丈³, 宮川 直通¹, 古田 薫², 雲見 日出也³, 細野 秀雄³	1.旭硝子, 2.LG Display, 3.東工大
10:45 - 11:00	12a-A29-7	非晶質C12A7エレクトライドのTFT電極への適用	○小穴 保久¹, 渡邊 俊成², 戸田 喜丈³, 宮川 直通², 古田 薫¹, 雲見 日出也³, 細野 秀雄³	1.エルジーディスプレイ, 2.旭硝子, 工大
11:00 - 11:15	12a-A29-8	パネル上高感度フォトセンサ応用へのBLDAによる多層膜構造Si膜 の結晶性向上	Nakao Kota $^1$ , $\bigcirc$ (M2)Koswaththage Charith Jayanada $^1$ , Wakasugi Tomohide $^1$ , Okada Tatsuya $^1$ , Noguchi Takashi $^1$	1.琉球大学
11:15 - 11:30	12a-A29-9	フレキシブル基板上での単結晶シリコンCMOSトランジスタの作製	○酒池 耕平1², 中川 明俊1, 赤澤 宗樹1, 東清一郎1.3	1.広大院 先端研, 2.学振特別研究 PD, 3.広大ナノデバイス・バイオ融合 学研究所
11:30 - 11:45	12a-A29-10	大気圧マイクロ熱プラズマジェット結晶化Ge膜を用いたTFTオフ電流 の結晶化速度依存性	○中谷 太一¹, 林 将平¹, 森崎 誠司¹, 山本 将悟¹, 東 清一郎¹	1.広大院先端研
11:45 - 12:00	12a-A29-11	積層チャネル3D-IC向け極薄Body Poly-Ge p-&n-MISFETsを用いたCMOSインバーターとリング発振器の作製および動作実証	○鎌田 善己¹, 小池 正浩¹, 黒澤 悦男¹, 黒澤 昌志²³, 太田 裕之¹, 中塚 理², 財満 鎭	1.産総研GNC, 2.名大院工, 3.学振

13.4 Siプロセス	·配線·MEMS·	·集積化技術 / Si wafer processing /MEMS/Integra	ation technology	ポスター講演
3月13日(金	<del>2</del> ) 9:30 - 11:3	30		
	奨 13a-P14-1	AuとGeの同時スパッタによるGe薄膜の結晶化(II)	○杉山 貴俊¹, 神子 公男², 弓野 健太郎¹	1.芝浦工業大学, 2.東大生研
	13a-P14-2	二段階Pイオン注入によるメタル/n*Geコンタクト低抵抗化とGe nMOSFETの寄生抵抗低減	○小池 正浩¹, 上牟田 雄一¹, 黒澤 悦男¹, 手塚 勉¹	1.産総研GNC
	E 13a-P14-3	First Trial Fabrication of Poly-Si TFTs using Crystallization-Induction Layers of Yttria-Stabilized Zirconia and Pulsed Laser Annealing Crystallization Methods	○Lien Mai¹, Masayuki Yamano², Tatsuaki Hirata², Shin-Ichiro Kuroki², Susumu Horita¹	1.JAIST, 2.Hiroshima Univ.
	奨 13a-P14-4	ガラス基板上の自己整合四端子平面型メタルダブルゲート低温 poly-Si TFT の制御性	○大澤 弘樹¹, 佐々木 駿¹, 原 明人¹	1.東北学院大工
	13a-P14-5	スパッタ $\mathrm{HfO}_2$ を利用したCLC 低温 $\mathrm{poly} ext{-Si}$ TFTのCMOS化	○目黒 達也¹, 原 明人¹	1.東北学院大工
	奨 13a-P14-6	ガラス基板上の平面型メタルダブルゲート低温poly-Ge TFT	○西村 勇哉¹, 目黒 達也¹, 原 明人¹	1.東北学院大工
	13a-P14-7	AlSi/TiNバンプおよびACPを用いたChip on Chip構造の接合抵抗評価	○秋山 正弘¹, Dali Zhang², Myung-Jae Lee², Edoardo Charbon²	1.長野高専, 2.デルフト工科大学

E 13a-P14-8	Finite element method simulation of three-terminal graphene NEMS switches	(D)Jothiramalingam Kulothungan <sup>1</sup> , Manoharan Muruganathan <sup>1</sup> , Hiroshi Mizuta <sup>1,2</sup>	1.JAIST, 2.Univ. of Southampton
13a-P14-9	スペース赤外線望遠鏡のための極低温可変形鏡の開発	○(M1)高橋 葵¹, 塩谷 圭吾¹, Paul Bi- erden², Steven Cornelissen², Charlie Lam², Michael Feinberg²	1.JAXA宇宙研, 2.BMC
13a-P14-10	プラズモニック素子内包アルギン酸ゲルによるグルコースセンシング	○齋藤 泰登¹, 西山 宏昭¹	1.山形大院理工
奨 13a-P14-11	SAB法によるSi/Si接合の界面特性の評価	○(B)山條 翔二¹, 森本 雅史¹, 梁 剣波¹, 重 川 直輝¹	1.大阪市大工
奨 13a-P14-12	Pb(Zr,Ti)O <sub>3</sub> 薄膜と感光性樹脂の積層構造体作製とその評価	○大久保 昂¹	1.兵庫県立大工
奨 13a-P14-13	ポリイミドを構造体兼接着剤として用いたマイクロ流体デバイスの作 製法	○小宮山 凌平¹, 近藤 正大¹, 宮下 英俊¹, 李 相錫¹	1.鳥取大学
13a-P14-14	レチクルフリー露光装置を用いた不均一伸縮基板対応アライメント方 式の複数回路への対応	○刀根 輝徳¹, 長野 聖央², 久保田 弘¹, 吉岡 昌雄², 小坂 光二³	1.熊大院自, 2.熊大工, 3.TCK

	) 9:00 - 12:0	·集積化技術/Si wafer processing /MEMS/Integrat on		
-,,,	,	-	Ochre M XI data M Mil	a Det I Diagra
9:00 - 9:15	14a-A29-1	光エッチングによる均一層厚を有する極薄SOIの形成	○宮田 優希', 中向 保徳', カッシア チエミ アゼヴェド', 押鐘 寧', 川合 健太郎', 有馬 健太', 森田 瑞穂'	1.阪大院工
9:15 - 9:30	14a-A29-2	IBEを用いたfinミリングによるFinFETの特性ばらつき改善	〇松川 貴¹, 遠藤 和彦¹, 赤坂 洋², 神谷 保志², 池田 真義², 恒川 孝二², 中川 隆史², 柳永勛¹, 昌原 明植¹	1.産総研, 2.キヤノンアネルバ
9:30 - 9:45	14a-A29-3	ブラズマ後処理によって高い仕事関数を有する微結晶窒化チタン膜	○出貝 求¹, 中山 雅則¹, 原田 和宏¹, 芦原 洋司¹, 金山 健司¹	1.(株)日立国際電気
9:45 - 10:00	14a-A29-4	リン酸溶液中レーザドービングにおけるGe基板面方位の効果	○高橋 恒太¹, 黒澤 昌志¹², 池上 浩³, 柴山 茂久¹¹, 坂下 満男¹, 竹内 和歌奈¹, 中塚 理 ¹, 財満 鎭明¹⁵	1.名大院工, 2.学振特別研究員(PC 3.九大院シス情, 4.学振特別研究員 (DC), 5.名大エコトピア
10:00 - 10:15	14a-A29-5	n-ウェルの形成のためのGe基板上へのSb拡散	○米田 亮太¹, 山本 圭介², 中島 寛²	1.九大・総合理工学府, 2.九大・産学 携センター
10:15 - 10:30	奨 14a-A29-6	ゲート絶縁膜耐圧不良のラマン分光法による原因評価	○横川 凌¹, 富田 基裕¹³, 水越 俊和², 平 野 雄大², 草野 健一郎², 佐々木 克弘², 小椋 厚志¹	1.明治大理工, 2.ラピスセミコンダク: 城, 3.学振特別研究員DC
10:30 - 10:45		休憩/Break		
10:45 - 11:00	14a-A29-7	レーザーアニールによる高性能パワー素子のプロセス検討	○陳 訳¹, 野口 隆¹, マッツァムト フルビオ², ヒュエット カリム²	1.琉球大学工, 2.スクリーンセミコンタクタ(株)
11:00 - 11:15	14a-A29-8	Si/SiO₂界面準位密度と製造環境における絶対湿度の相関	○浅野 均¹, 居村 史人¹, 古賀 和博¹, クンプ アンソマワン¹², 原 史朗¹²	1.ミニマルファブ, 2.産総研
11:15 - 11:30	14a-A29-9	ミニマル装置群で作製したpMOSインバータ	○居村 史人¹, 浦 伸吾², 北山 侑司¹, 古賀 和博¹, 浅野 均¹, 中戸 克彦¹, クンプアン ソマ ワン¹³, 原 史朗¹³	1.ミニマルファブ, 2.ロジック・リサー 3.産総研
11:30 - 11:45	14a-A29-10	ミニマル液体ドーバントプロセスによるnMOSFET試作検討	○古賀 和博 <sup>1</sup> , 居村 史人 <sup>1</sup> , 浅野 均 <sup>1</sup> , クンプ アン ソマワン <sup>1,2</sup> , 原 史朗 <sup>1,2</sup>	1.ミニマルファブ技術研究組合, 2.産
11:45 - 12:00	14a-A29-11	ミニマル研削・研磨装置を用いたウェハ再生とそれを用いた MOSFET作製	○梅山 規男 <sup>1</sup> , 谷島 孝 <sup>1</sup> , 浅野 均 <sup>1</sup> , 居村 史 人 <sup>1</sup> , 中戸 克彦 <sup>1</sup> , クンプアン ソマワン <sup>1,2</sup> , 原 史朗 <sup>1,2</sup>	1.ミニマルファブ技術研究組合, 2.産
3月14日(土	) 13:00 - 15	:00		
13:00 - 13:15	14p-A29-1	集光加熱FZ法によるハーフインチ径シリコン結晶成長	○池田 伸一1², 西村 健史³, 小澤 哲也⁴, 長澤 亨³, 高須 誠一³, 原 史朗1²	1.産業技術総合研究所, 2.ミニマルファブ技術研究組合, 3.キヤノンマシナー, 4.リガク
13:15 - 13:30	14p-A29-2	ミニマル集光加熱炉における温度均一性の改善(II)	○三浦 典子 <sup>1</sup> , 相澤 洸 <sup>1</sup> , 山田 武史 <sup>1</sup> , 伊藤 孝宏 <sup>1</sup> 3, 遠江 栄希 <sup>1</sup> , 池田 伸一 <sup>1</sup> 4, 石田 夕起 <sup>1</sup> 4, 三ケ原 孝則 <sup>1</sup> , 大西 康弘 <sup>1</sup> 2, クンプアン ソ マワン <sup>1</sup> 4, 原 史朗 <sup>1,4</sup>	1.ミニマルファブ, 2.米倉製作所, 3.z ンタルモーター, 4.産総研
13:30 - 13:45	14p-A29-3	ミニマル抵抗加熱炉で形成した熱酸化膜の電気的特性(Ⅲ)	○中戸 克彦', 居村 史人', 浅野 均', 鈴木 真之佑' <sup>3</sup> , 松田 祥吾' <sup>3</sup> , 柳沼 綾美 <sup>13</sup> , 森川 清彦 <sup>13</sup> , 服部 昌 <sup>13</sup> , 池田 伸一 <sup>12</sup> , クンプアン ソマワン <sup>12</sup> , 原 史朗 <sup>12</sup>	1.ミニマルファブ技術研究組合, 2.度 術総合研究所, 3.光洋サーモシステ
13:45 - 14:00	14p-A29-4	ミニマルレーザ加熱装置の高速昇降温特性の評価	○佐藤 和重¹, 遠江 栄希¹, 千葉 貴史¹³, 寺田 昌男¹³, 中戸 克彦¹, 三浦 典子¹, 池田 伸一¹², クンプアン ソマワン¹², 原 史朗¹²	1.ミニマルファブ技術研究組合, 2.産 研, 3.坂口電熱
14:00 - 14:15	14p-A29-5	集光型赤外線加熱炉を用いたハーフインチシリコンCVD装置(4)	○李 寧¹, 羽深 等¹, 三ケ原 孝則², 池田 伸 一²³, 石田 夕起²³, 原 史朗²³	1.横国大院工, 2.ミニマルファブ技術 組合, 3.産総研
14:15 - 14:30	14p-A29-6	コーティングカップ内の局所温度制御によるミニマルコーティング特性	○奥田 修史 <sup>1</sup> , 武内 翔 <sup>12</sup> , 扇子 義久 <sup>12</sup> , 伊藤 孝宏 <sup>1,3</sup> , クンプアン ソマワン <sup>1,4</sup> , 原 史朗 <sup>1,4</sup>	1.ミニマルファブ技術研究組合, 2.リ テックジャパン, 3.オリエンタルモータ ー, 4.産総研
14:30 - 14:45	14p-A29-7	ミニマル装置を使用したリソグラフィ工程の変動要因の解析	○北山 侑司¹, 奥田 修史¹, 東野 泰英¹, 寶池 広由¹, クンプアン ソマワン¹², 原 史朗¹²	1.ミニマルファブ技術研究組合, 2.函
14:45 - 15:00	14p-A29-8	局所クリーン化ミニマルPLADエア循環システム(IV)	○谷島 孝¹, 安井 政治¹, クンプアン ソマワン ¹², 前川 仁¹², 原 史朗¹²	1.ミニマルファブ技術研究組合, 2.産

ı	L3.5 デバイス/集積化技術 / Semiconductor devices and related techologies 口頭講演						
	3月11日(水) 9:00 - 12:15						
	9:00 - 9:15	11a-A23-1	FLA法を用いて作製した高性能多結晶Ge tri-gate p-/n-MOSFET の実証	○臼田 宏治¹, 鎌田 善己¹, 上牟田 雄一¹, 森 貴洋¹, 小池 正浩¹, 手塚 勉¹	1.産総研GNC		
	9:15 - 9:30	E 11a-A23-2	Mobility improvement of ultrathin-body Germanium-on-insulator (GeOI) MOSFETs on flipped Smart-Cut GeOI substrates	○(D)Xiao YU <sup>1,2</sup> , Jian KANG <sup>1,2</sup> , Rui ZHANG <sup>1,2</sup> , Mitsuru TAKENAKA <sup>1,2</sup> , Shinichi TAKAGI <sup>1,2</sup>	1.Univ. of Tokyo, 2.JST-CREST		
	9:30 - 9:45	奨 11a-A23-3	表面ラフネス散乱がGeナノワイヤの正孔移動度に与える影響に関する理論的検討	○田中 一¹, 須田 淳¹, 木本 恒暢¹	1.京大院工		
	9:45 - 10:00	11a-A23-4	デバイスシミュレーションによる積層トランジスタ構造の検討	○服部 淳一¹, 福田 浩一¹, 太田 裕之¹, 前 田 辰郎¹	1.産総研		

	10:00 - 10:15	11a-A23-5	Si上フロントゲートInAs/GaSb-OI p-MOSFETの移動度向上	○西 康一 <sup>1,3</sup> ,横山 正史 <sup>1</sup> ,横山 春喜 <sup>2,3</sup> ,星 拓也 <sup>2,3</sup> ,杉山 弘樹 <sup>2,3</sup> ,竹中 充 <sup>1,3</sup> ,高木 信一 <sup>1,3</sup>	1.東大院工, 2.NTT先端集積デバイス研 3.JST CREST
	10:15 - 10:30	奨 11a-A23-6	InGaAs-MOSFET のチャネル長微細化に関する研究	○大澤 一斗¹, 三嶋 裕一¹, 宮本 恭幸¹	1.東工大理工
	10:30 - 10:45		休憩/Break		
	10:45 - 11:00	11a-A23-7	ナノワイヤ型ショットキー障壁トンネルFETのON電流密度増大	○麻田 修平!, 小杉山 洋希!, 橋本 修一郎!, 武井 康平!, ソンセイ!, 張 旭!, 徐 泰宇!, 若 水 昂!, 松川 貴², 昌原 明植²	1.早大理工, 2.産総研
	11:00 - 11:15	11a-A23-8	ひずみSOIトンネルFETの作製と電気的特性	○植田 大貴 <sup>1,2</sup> , 金 閔洙 <sup>1,2</sup> , 竹中 充 <sup>1,2</sup> , 高 木 信一 <sup>1,2</sup>	1.東大, 2.JST CREST
	11:15 - 11:30	奨·E 11a-A23-9	Effects of strain, interface states and back bias on electrical characteristics of Ge-source UTB strained-SOI tunnel FETs	OMinsoo Kim <sup>1,2</sup> , Yuki K. Wakabayashi <sup>1</sup> , Ryosho Nakane <sup>1</sup> , Masafumi Yokoyama <sup>1,2</sup> , Mitsuru Takenaka <sup>1,2</sup> , Shinichi Takagi <sup>1,2</sup>	1.The Univ. of Tokyo, 2.JST-CREST
	11:30 - 11:45	11a-A23-10	高In組成InGaAs量子井戸層の挿入によるプレーナ型InGaAsトンネル FETの性能向上の実証	○(M2)ジ サンミン <sup>1,3</sup> , 市川 磨 <sup>2,3</sup> , 長田 剛規 <sup>2,3</sup> , 山田 永 <sup>2,3</sup> , 竹中 充 <sup>1,3</sup> , 高木 信一 <sup>1,3</sup>	1.東京大工, 2.住友化学, 3.JST CREST
	11:45 - 12:00	11a-A23-11	Si/InGaAsヘテロ接合界面縦型トンネルFETのシェル層歪効果	○冨岡 克広¹², 石坂 文哉¹, 中井 栄治¹, 本 久 順一¹, 福井 孝志¹	1.北大院情報科学および量子集積センタ ー, 2.JSTさきがけ
	12:00 - 12:15	11a-A23-12	電界依存型の誘電率を有するゲート絶縁膜を用いた急峻トランジスタ の可能性とスイッチング性能の検討	○太田 裕之 <sup>1,3</sup> ,右田 真司 <sup>1,3</sup> ,福田 浩一 <sup>1</sup> , 鳥海 明 <sup>2,3</sup>	1.産総研, 2.東大工, 3.JST CREST
	3月11日(水)	14:00 - 17:3			
	14:00 - 14:15	11p-A23-1	数nm-CMOS 素子用二次元Si層の検討(X)水素アニールによる 影響	○鈴木 佑弥¹, 長嶺 由騎¹, 青木 孝¹, 水野智久¹, 前田 辰郎²	1.神奈川大理, 2.産総研
	14:15 - 14:30	11p-A23-2	数nm-MOS素子用二次元Si層検討(XI):C添加による物性変調	○長嶺 由騎¹, 鈴木 佑弥¹, 青木 孝¹, 水 野 智久¹	1.神奈川大理
	14:30 - 14:45	11p-A23-3	バターン依存酸化法を応用した直列三重結合シリコン量子ドットの 作製	〇内田 貴史¹, 吉岡 勇¹, 佐藤 光¹, 福地 厚¹, 有田 正志¹, 藤原 聡², 高橋 庸夫¹	1.北大院情報, 2.NTT物性基礎研
	14:45 - 15:00	11p-A23-4	ゲート制御性を向上したSi-MOS量子ドットデバイスの作製と評価	○本田 拓夢¹, 小寺 哲夫⁴⁵, 米田 淳³, 武田 健太², 樽茶 清悟²ぷ⁵, 小田 俊理¹	1.東工大量子ナノ研, 2.東大, 3.理化学研究所, 4.東工大, 5.東大ナノ量子機構
	15:00 - 15:15	11p-A23-5	低濃度リンドープによるドーバント原子MOSFET	○高須 友貴¹, ダニエル モラル², 水野 武志¹, 田部 道睛¹	1.静大電研, 2.静大院工
	15:15 - 15:30	E 11p-A23-6	First-principle calculations of the interactions between single phosphorus donor and boron acceptor in the P-B co-doped silicon nanostructures	○(P)Le The Anh¹, Daniel Moraru²,	1.JAIST, 2.Shizuoka Univ., 3.Univ. of Southampton
	15:30 - 15:45		休憩/Break		
	15:45 - 16:00	11p-A23-7	コンパクトモデルから見たMOSFETのバリステイック特性の可能性	○名取 研二¹	1.東工大フロンテイア
	16:00 - 16:15	11p-A23-8	単一Si/SiO。界面トラップのチャージボンピング(CP)特性:Pbo センターの電気的直接観測と従来CP理論の原理的改善	○土屋 敏章¹, 小野 行徳²	1.島根大総理工, 2.富山大工
	16:15 - 16:30	奨 11p-A23-9	チャージボンビング電流の実時間計測による電子捕獲過程の解析	○堀 匡寛¹, 渡辺 時暢¹, 土屋 敏章², 小野 行徳¹	1.富山大工, 2.島根大総合理工
	16:30 - 16:45	11p-A23-10	チャージボンビング電流の実時間計測による電子放出、再結合過程 の直接観測	○堀 匡寛¹, 渡辺 時暢¹, 土屋 敏章², 小 野 行徳¹	1.富山大工, 2.島根大総合理工
	16:45 - 17:00	11p-A23-11	短チャネルトンネルトランジスタにおけるAl-Nイオン注入で形成した深い準位を介する単一電子輸送	○大野 圭司¹, 森 貴洋², 森山 悟士³	1.理研, 2.産総研, 3.物材機構
	17:00 - 17:15	11p-A23-12	Si中の等価電複合不純物の電子状態に関する第一原理計算	○(DC)飯塚 将太¹, 中山 隆史¹	1.千葉大理
	17:15 - 17:30	11p-A23-13	シリコンPN接合における再結合電流のEDMR観察	○(M2)古田 慧梧¹, 小野 行徳¹, 西内 祐樹¹, 三谷 太希¹, 堀 匡寛¹	1.富山大工
	3月12日(木)	14:00 - 17:3	80		
招待	14:00 - 14:45	12p-A23-1	「第15回応用物理学会業績賞(研究業績)受賞記念講演 (45分) 大容量メモリ技術の産業展開への貢献と三次元集積化技術の先 駆的研究	〇小柳 光正1	1.東北大学
	14:45 - 15:00	12p-A23-2	浮遊ゲート型三次元FinFETフラッシュメモリ電気特性のチャネル形 状依存性	○柳 永シュン¹, 生田目 俊秀², 松川 貴¹, 遠藤 和彦¹, 大内 真一¹, 塚田 順一¹, 山内 洋美¹, 石川 由紀¹, 水林 亘¹, 森田 行則¹, 右田真司¹, 太田 裕之¹, 知京 豊裕², 昌原 明植¹	1.産総研, 2.物材研
	15:00 - 15:15	奨 12p-A23-3	30nm世代NANDフラッシュメモリにおけるRTNの空間及び統計分布のチャネル不純物依存性	○(M1)富田 季宏¹, 宮地 幸祐¹	1.信州大院
	15:15 - 15:30	12p-A23-4	信頼性を考慮したストレージクラスメモリとNANDフラッシュメモリを 用いたSSDの性能解析	○瀧下 博文¹, 田中丸 周平¹², 保坂 翔吾¹, 上口 光¹, 竹内 健¹	1.中大理工, 2.東大工
	15:30 - 15:45	12p-A23-5	長期保存に向けたSSDの高信頼手法	○山崎 泉樹¹, 田中丸 周平¹², 北村 雄太¹, 竹内 健¹	1.中大理工, 2.東大工
	15:45 - 16:00	12p-A23-6	エンタープライズ向けソリット・ステート・ドライブの高信頼手法	○山崎 泉樹¹, 田中丸 周平¹², 竹内 健¹	1.中大理工, 2.東大工
	16:00 - 16:15		休憩/Break		
	16:15 - 16:30	12p-A23-7	TLC NAND フラッシュメモリ向け高速,高信頼LDPC符号	○徳冨 司¹, 土井 雅史¹, 蜂谷 尚悟¹, 田中丸 周平¹, 竹内 健¹	1.中大理工
	16:30 - 16:45	12p-A23-8	TLCフラッシュメモリ向け読み出し電圧の動的最適化及びデータの 自動回復技術	○小林 惇朗¹, 徳冨 司¹, 土井 雅史¹, 蜂谷 尚悟¹, 田中丸 周平¹, 竹内 健¹	1.中大理工
	16:45 - 17:00	E 12p-A23-9	Measurements and Statistical Comparison of Four Write Stability Metrics in Bulk CMOS SRAM Cells	○(D)Hao Qiu¹, Tomoko Mizutani¹, Takuya Saraya¹, Toshiro Hiramoto¹	1.IIS, Univ. of Tokyo
	17:00 - 17:15	奨·E 12p-A23-10	Statistical Analysis of Four Write Stability Metrics in Fully Depleted Silicon-on-Thin-BOX (SOTB) SRAM Cells at Low Supply Voltage Down to 0.4V	O(D)Hao Qiu¹, Tomoko Mizutani¹, Yoshiki Yamamoto², Hideki Makiyama², Tomohiro Yamashita², Hidekazu Oda², Shiro Kamohara², Nobuyuki Sugii³, Takuya Saraya¹, Masaharu Kobayashi¹, Toshiro Hiramoto¹	1.IIS, Univ. of Tokyo, 2.LEAP
	17:15 - 17:30	12p-A23-11	完全空乏型Silicon-on-Thin-BOX (SOTB) SRAMにおける異常不安定セルの最低動作電圧 $(V_{\min})$ の詳細解	○水谷 朋子¹, 山本 芳樹², 槇山 秀樹², 山 下 朋弘², 尾田 秀一², 蒲原 史朗², 杉井 信 之², 平本 俊郎¹	1.東大生研, 2.LEAP

5 デバイス	/集積化技術/	Semiconductor devices and related techologies	ポスター講演	
3月12日	(木) 9:30 - 11:	30		
	12a-P13-1	SiO₂膜中の単一トラップ生成過程の観察	○与名本 欣樹¹	1.日立横研
	12a-P13-2	n型トンネルトランジスタにおけるPBTI劣化の解析	○水林 亘', 森 貴洋', 福田 浩一', 柳 永勛', 松川 貴', 石川 由紀', 遠藤 和彦', 大内 真 一', 塚田 順一', 山内 洋美', 右田 真司', 森 田 行則', 太田 裕之', 昌原 明植'	1.産総研
	12a-P13-3	ナノワイヤ型ショットキー障壁トンネルFETの動作解析	○徐 泰宇', 小杉山 洋希', 橋本 修一郎', 武 井 康平', ソン セイ', 麻田 修平', 張 旭', 若 水 昂', 松川 貴², 昌原 明植², 渡邉 孝信'	1.早大理工, 2.産総研
	12a-P13-4	極低ドレイン電圧で急峻なサブスレッショルド特性を持つPNボディコンタクト付きSOI MOSFETの測定結果	○蔵本 陽介¹, 森 貴之¹, 井田 次郎¹	1.金沢工業大学
	12a-P13-5	引張 $)$ ひずみSi-on-Insulator (sSOI) 上に形成された圧縮ひずみ Si $_{0.1}$ Ge $_{0.9}$ チャネル $_{\rm P}$ MOSFET における移動度とSS 値の向上	○池田 圭司', 守山 佳彦', 入沢 寿史', 小野瑞城', 上牟田 雄一', 小田 穣', 宮木 智則', 黒澤 悦男', 手塚 勉'	1.産総研GNC
	12a-P13-6	スパッタエピタキシー法を用いたSiGe埋め込みチャネル型p-MOS- FET	○櫻澤 健光¹, 塚本 貴広¹, 広瀬 信光², 笠松章史², 松井 敏明², 三村 高志², 須田 良幸¹	1.東京農工大院工, 2.情報通信研究機
	12a-P13-7	デプレッション型極薄GeSn-pMOSFETs特性のSn濃度依存性	○前田 辰郎¹, Wipakorn Jevasuwan¹, 服部 浩之¹, 内田 紀行¹, 三浦 脩², 田中 正俊², Santos Nuno D. M.³, Vantomme Andre³, Locquet JP.³, Lieten R. R.³ <sup>34,5</sup>	1.産総研, 2.横浜国立大学, 3.KU Lueven, 4.IMEC, 5.Entegris
	12a-P13-8	再成長ソース/ドレインを有するInGaAsマルチゲートMOSFET作製プロセスに関する研究	○(M1)木下 治紀¹, 金澤 徹¹, 袮津 誠晃¹, 三嶋 裕一¹, 宮本 恭幸¹	1.東工大院理工
	12a-P13-9	Si単電子トランジスタにおける電界によるドット内準位の変化	○佐藤 光¹, 内田 貴史¹, 吉岡 勇¹, 福地 厚¹, 有田 正志¹, 藤原 聡², 高橋 庸夫¹	1.北大院情報, 2.NTT物性基礎研
	12a-P13-10	リソグラフィにより形成されたシリコン2重結合量子ドット内の電子スピン状態のバルス測定	○堀部 浩介¹, 小寺 哲夫²³, 小田 俊理¹²	1.東工大量子ナノ研セ, 2.東工大電子 理, 3.東大ナノ量子機構
	12a-P13-11	超平坦Si/Cu同時研削と残留金属低減処理を用いたSi貫通電極露 出工程	○渡辺 直也¹, 青柳 昌宏¹, 片川 大輔², 坂東翼³, 三井 貴彦³, 山本 栄一³	1.産業技術総合研究所, 2.アプリシア クノロジー, 3.岡本工作機械製作所

13.5	デバイス/\$	集積化技術/S	emiconductor devices and related techologies	口頭講演			
	3月13日(金	) 9:00 - 12:3	0				
	9:00 - 9:15	13a-A23-1	バルス光伝導法による非接触テストの開発	○(M1)清水 公志郎', 福田 和樹', 深 純平', 古田 正昭', 吉岡 昌雄', 小林 一博', 久保田弘', 吉永 径一3	1.熊大院自, 2.熊大工, 3.テラプローブ		
	9:15 - 9:30	E 13a-A23-2	Development of amorphous Si / crystalline Si heterojunction strip detector for X-ray/gamma ray imaging	OXiaosong Yan¹, Yang Tian¹, Shimazoe Kenji¹, Fujiwara Takeshi¹, Takahashi Hi- royuki¹, Ishikura Takeshi², Tomita Hideki³	1.Univ. Tokyo, 2.Fuji Electric Co. Ltd 3.Nagoya Univ.		
	9:30 - 9:45	奨·E 13a-A23-3	Thermal analysis on a vertical GaN Gunn diode	○(DC)Wang Ying <sup>1,2</sup> , Lin-An Yang <sup>1</sup> , Jin- Ping Ao <sup>2</sup> , Zhi-Zhe Wang <sup>1</sup> , Yue Hao <sup>1</sup>	1.Xidian Univ., 2.Tokushima Univ.		
	9:45 - 10:00	13a-A23-4	エナジーハーベスト用ショットキーダイオード検討その1	○宮地 晃平 <sup>1</sup> , 松野下 誠 <sup>1</sup> , 長谷川 直輝 <sup>1,2</sup> , 野地 拓匡 <sup>1,3</sup> , 吉田 賢史 <sup>1</sup> , 川﨑 繁男 <sup>1</sup>	1.JAXA宇宙研, 2.京大生存研, 3.首都 大理工		
	10:00 - 10:15	13a-A23-5	SOI MOSFETを用いたアンテナ結合ボロメータの基礎検討	○(M1)植田 剛央², 鈴木 佑弥², 佐藤 弘明 ¹², ティワリ アジェイ¹, 廣本 宣久², 猪川 洋¹²	1.静岡大·電子研, 2.静岡大·工		
	10:15 - 10:30	13a-A23-6	SOIトランジスタの自己加熱による水素センサの低消費電力化	○宮田 耕¹, 竹内 豪¹, 高橋 綱己¹², 内 田 建¹²	1.慶應義塾大学, 2.JST CREST		
	10:30 - 10:45		休憩/Break				
	10:45 - 11:00		第6回シリコンテクノロジー分科会論文賞・研究奨励賞授賞式 / Silicon Technology Division Award Ceremony				
招待	11:00 - 11:30	13a-A23-7	「第6回シリコンテクノロジー分科会論文賞受賞記念講演」(30分) Au/SiO2ハイブリッド接合を用いた3次元集積回路の開発	〇後藤 正英¹, 萩原 啓¹, 井口 義則¹, 大竹浩¹, 更屋 拓哉², 日暮 栄治², 年吉 洋², 平本 俊郎²	1.NHK, 2.東大		
招待	11:30 - 12:00	13a-A23-8	「第6回シリコンテクノロジー分科会論文賞受賞記念講演」(30分) 大口径化可能な貼り合わせ法によるSi上高性能InGaAs-OI MOSFETの作製	〇金 相賢 <sup>1,2,3</sup> , 一宮 佑希 <sup>1,2</sup> , 横山 正史 <sup>1</sup> , 中根 了昌 <sup>1</sup> , Li Jian <sup>4</sup> , Kao Yung-Chung <sup>4</sup> , 竹中 充 <sup>1,2</sup> , 高木 信一 <sup>1,2</sup>	1.東大院工, 2.JST-CREST, 3.Korea Institute of Science and Technolo gy, 4.IntelliEPI, Inc.		
招待	12:00 - 12:15	13a-A23-9	「第6回シリコンテクノロジー分科会研究奨励賞受賞記念講演」 (15分) GeSn多結晶薄膜の進展 ~3D-ICを目指して~	〇黒澤 昌志 <sup>1,2</sup> , 池上 浩 <sup>3</sup> , 田岡 紀之 <sup>1</sup> , 中塚 理 <sup>1</sup> , 財満 鎭明 <sup>1,4</sup>	1.名大院工, 2.学振PD, 3.九大院シス情, 4.名大エコトピア		
招待	12:15 - 12:30	E 13a-A23-10	[Silicon Technology Division Award Speech] (15min.) Si-based Light Emitting Devices with Ge Quantum Dots Embedded in Optical Microcavities	OXuejun Xu¹, Takuya Maruizumi¹, Yasuhiro Shiraki¹	1.Tokyo City Univ.		
	3月13日(金) 16:15 - 19:00						
	16:15 - 16:30	13p-A23-1	大面積MoS₂膜形成に向けたMoの硫化プロセスの検討	○(B)松浦 賢太朗, 大橋 匠!, 山口 晋平 ¹, 須田 耕平², 石原 聖也², 澤本 直美², 角 嶋 邦之¹, 杉井 信之¹, 西山 彰², 片岡 好則', 名取 研二, 筒井 一生¹, 岩井 洋¹, 小椋 厚 志², 若林 整¹	1.東工大, 2.明治大		
	16:30 - 16:45	13p-A23-2	室温におけるNi/InAs間の固体拡散	○眞方山 貴也¹, 堀場 弘司², 組頭 広志², 雲見 日出也³, 細野 秀雄¹.³⁴, 真島 豊¹.³	1.東工大応セラ研, 2.高エネ研PF, 3.東 工大元素センター, 4.東工大フロンティン		
	16:45 - 17:00	13p-A23-3	2層2次元InAs薄膜FETにおけるフローティングゲートメモリ効果	○真方山 貴也¹, 加納 伸也¹, 竹井 邦晴², Steven Chuang², Ali Javey², 雲見 日出也³, 細野 秀雄¹.³⁴, 真島 豊¹.³	1.東工大応セラ研, 2.カリフォルニア大ノ ークレー校, 3.東工大元素センター, 4.東 工大フロンティア		
	17:00 - 17:15	13p-A23-4	TEMその場観察法によるCu/MoO $_{\rm v}/{\rm Al_2O_3}$ 抵抗変化型メモリの特性評価	○平田 周一郎¹, 高橋 謙仁¹, 工藤 昌輝¹, 廣 井 孝弘¹, 中根 明後¹, 福地 厚¹, 有田 正志 ¹, 高橋 庸夫¹	1.北大院情報		
	17:15 - 17:30	13p-A23-5	Cu系CBRAMにおける熱処理の影響	中根 明俊¹, 勝村 玲音¹, 廣井 孝弘¹, 福地厚¹, ○有田 正志¹, 高橋 庸夫¹	1.北大院情報		
	17:30 - 17:45		休憩/Break				
	17:45 - 18:00	13p-A23-6	MOSFET挿入による抵抗変化型メモリの抵抗制御	廣井 孝弘', 中根 明俊', 勝村 玲音', 福地 厚', ○有田 正志', 高橋 庸夫', 浦邊 大史², 安藤 秀幸', 森江 隆'	1.北大院情報, 2.九工大生命体工		

18:00 - 18:15	奨 13p-A23-7	MOSFET上に集積化したCu-MoO <sub>x</sub> -Al抵抗変化型メモリのアナログメモリ動作	○浦邊 大史 <sup>1</sup> , 富崎 和正 <sup>1</sup> , 安藤 秀幸 <sup>1</sup> , 森江 隆 <sup>1</sup> , 廣井 孝弘 <sup>2</sup> , 中根 明俊 <sup>2</sup> , 福地 厚 <sup>2</sup> , 有田 正志 <sup>2</sup> , 高橋 庸夫 <sup>2</sup>	1.九工大生命体工, 2.北大院情報
18:15 - 18:30	13p-A23-8	50 nm $Al_xO_y$ ReRAMアレイの書き換え前後のデータ保持特性	○山沢 裕紀¹, 寧 涉洋¹², Iwasaki Tomoko Ogura¹, 田中丸 周平¹, 上口 光¹, 竹内 健¹	1.中大, 2.東大
18:30 - 18:45	13p-A23-9	抵抗変化型メモリの書き込み特性の評価	○西川 進¹, 寧 涉洋¹², 蜂谷 尚悟¹, 竹内 健¹	1.中大理工, 2.東大工
18:45 - 19:00	13p-A23-10	三次元積層ReRAM/NANDフラッシュメモリハイブリッドSSDの実 装方法	○(M1)石井 智也¹, 上口 光¹, 竹内 健¹	1.中大理工

3月12日(木	9:00 - 12:15	5		
9:00 - 9:15	E 12a-A23-1	Surface potential observation of heavily-doped Si by KPFM	(D)Krzysztof Tyszka <sup>1,2</sup> , Daniel Moraru <sup>1</sup> , Takeshi Mizuno <sup>1</sup> , Ryszard Jablonski <sup>2</sup> , Mihicharu Tabe <sup>1</sup>	1.Shizuoka Univ., 2.Warsaw Univ. o Tech.
9:15 - 9:30	E 12a-A23-2	Development of apparatus supplying hydrogen radical remotely to decompose $\operatorname{SiCl}_4$ source	○(D)Fatima DAHMANI <sup>1</sup> , Yuji OKAMO- TO <sup>1,2</sup> , Daiki TSUTSUMI <sup>1,3</sup> , Takamasa ISHIGAKI <sup>3</sup> , Hideomi KOINUMA <sup>4</sup> , Sumiya MASATOMO <sup>1</sup>	1.NIMS inst., 2.TSUKUBA Univ., 3.Hosei Univ., 4.Tokyo Univ.
9:30 - 9:45	E 12a-A23-3	Interactions of individual dopants and macroscopic quantum dots in weakly-doped nanoscale SOI-FETs	○Daniel Moraru¹, Yuki Takasu², Arup Samanta², Takeshi Mizuno², Michiharu Tabe²	1.Fac. Eng. Shizuoka U, 2.RIE, Shizuoka U
9:45 - 10:00	E 12a-A23-4	Non-destructive Characterization of Oxide/Ge Interface by Photoluminescence Measurement	○Shoichi Kabuyanagi¹.², Tomonori Nishimura¹.², Takeaki Yajima¹.², Akira Toriumi¹.²	1.Tokyo Univ., 2.JST-CREST
10:00 - 10:15	E 12a-A23-5	n°Si/pGe Heterojunctions Fabricated by Narrow Membrane Bonding	○(P)Chi Liu <sup>1,2</sup> , Shoichi Kabuyanagi <sup>1,2</sup> , Tomonori Nishimura <sup>1,2</sup> , Akira Toriumi <sup>1,2</sup>	1.Univ. of Tokyo, 2.JST-CREST
10:15 - 10:30	E 12a-A23-6	Electric-field-assisted formation of an interfacial double-donor molecule in Si nano-transistors	○(PC)Samanta Arup¹, Daniel Moraru², Takeshi Mizuno¹, Michiharu Tabe¹	1.RIE, Shizuoka Univ., 2.DEMS, Shizuoka Univ.
10:30 - 10:45		休憩/Break		
10:45 - 11:00	奨·E 12a-A23-7	Inspection of elastic stress and generated defects in thin Ge film on GeOI wafer	○Toshimitsu Nakamura <sup>1,2</sup> , Tomonori Nishimura <sup>1,2</sup> , Takeaki Yajima <sup>1,2</sup> , Akira Toriumi <sup>1,2</sup>	1.Univ. of Tokyo, 2.JST-CREST
11:00 - 11:15	奨·E 12a-A23-8	Effect of Individual Dopants in Esaki Tunneling Diodes	O(M2)Tan Hoang <sup>1</sup> , D. Moraru <sup>1,2</sup> , R. Unno <sup>1</sup> , A. Sapteka <sup>3</sup> , S. Purwiyanti <sup>3</sup> , L.T. Anh <sup>4</sup> , M. Manoharan <sup>4</sup> , T. Mizuno <sup>1</sup> , H. Mizuta <sup>4,5</sup> , D. Hartanto <sup>3</sup> , M. Tabe <sup>1</sup>	1.RIE,Shizuoka Univ., 2.Shizuoka Univ., 3.Univ. of Indonesia, 4.JAIS 5.Univ. of Southampton
11:15 - 11:30	奨·E 12a-A23-9	Phonon-softening in Germanium by Free Carrier Accumulation -Experimental Distinction between Impurity and Free Carrier Effect-	OShoichi Kabuyanagi <sup>1,2</sup> , Tomonori Nishimura <sup>1,2</sup> , Takeaki Yajima <sup>1,2</sup> , Akira Toriumi <sup>1,2</sup>	1.Tokyo Univ., 2.JST-CREST
11:30 - 11:45	奨·E 12a-A23-10	Catalytic Effect of Substrate-Si on SiO <sub>2</sub> -IL Scavenging in HfO <sub>2</sub> /SiO <sub>2</sub> /Si Stacks	○(DC)Xiuyan Li¹, Takeaki Yajima¹, To- monori Nishimura¹, Akira Toriumi¹	1.Univ. of Tokyo
11:45 - 12:00	奨·E 12a-A23-11	Analytical Model for ${\rm SiO_2}$ -IL Scavenging in ${\rm HfO_2/SiO_2/Si}$ Stacks	○(DC)Xiuyan Li¹, Takeaki Yajima¹, To- monori Nishimura¹, Akira Toriumi¹	1.Univ. of Tokyo
12:00 - 12:15	奨·E 12a-A23-12	2-nm-EOT Y-Si-O Gate Stack Formation on $\mathrm{Si}_{0.5}\mathrm{Ge}_{0.5}$	○CheTsung Chang¹, Tomonori Nishimura¹, Akira Toriumi¹	1.Univ. of Tokyo

3.11	フォトニック	構造・現象, 13.7	7 超薄膜・量子ナノ構造のコードシェアセッション	口頭講演	
	3月12日(木)	9:00 - 12:30	)		
	9:00 - 9:15	奨 12a-A10-1	有機ヒ素を用いたMOVPE法によるフォトニック結晶の埋め込み成長	○河崎 正人 <sup>1,3</sup> , 吉田 昌宏 <sup>1</sup> , 石崎 賢司 <sup>1</sup> , Menaka De Zoysa <sup>1,2</sup> , 北村 恭子 <sup>1,2</sup> , 野田 進 <sup>1</sup>	1.京大院工, 2.京大白眉, 3.三菱電機 先端総研
	9:15 - 9:30	12a-A10-2	$(Sc, Er)_2O_3$ 薄膜におけるサイト選択励起でのエネルギー移動とアップコンバージョン	○川上 欣洋¹, 俵 毅彦²³, 尾身 博雄²³, 鍜治怜奈¹, 足立 智¹	1.北大院工, 2.NTT物性基礎研, 3.NTT ナノフォトニクスセンタ
	9:30 - 9:45	12a-A10-3	(ErSc)2O3 薄膜におけるアップコンバージョン発光とフォトニックバン ドギャップによる抑制	○俵 毅彦¹², Thomas McManus¹³, 川上 欣 洋⁴, 尾身 博雄¹², Adel Najar¹, 鍛治 怜奈⁴, 足立 智⁴, 後藤 秀樹¹	1.NTT物性研, 2.NTTナノフォトニクスセンタ, 3.バース大, 4.北大
	9:45 - 10:00	奨 12a-A10-4	InP(311)B基板上InAs量子ドットからの単一光子発生とその温度特性	○(M2)細井 響子¹, 高熊 亨¹, 黒澤 裕之³, 中島 秀朗³, 赤羽 浩一², 熊野 英和³, 末宗 幾夫³, 早瀬 潤子³	1.慶大理工, 2.情通機構, 3.北大電子研
	10:00 - 10:15	12a-A10-5	(111)A 面上量子ドットにおける励起子微細構造分裂の高精度評価	○中島 秀朗¹, 熊野 英和¹, 劉 祥明², 間野 高明², 黒田 隆², 末宗 幾夫¹	1.北大電子研, 2.物材機構
	10:15 - 10:30	E 12a-A10-6	Entangled photon emission at temperatures up to 60 K from droplet epitaxial quantum dots	○(P)Xiangming Liu¹, Takashi Kuroda¹, Takaaki Mano¹, Hideaki Nakajima², Hide- kazu Kumano², Ikuo Suemune², Yoshiki Sakuma¹, Kazuaki Sakoda¹	1.NIMS, 2.RIES Hokkaido Univ.
	10:30 - 10:45	12a-A10-7	量子ドット-ナノ共振器強結合系における光散逸経路間干渉	〇太田 泰友¹, 太田 竜一², 熊谷 直人¹, 岩本 敏¹², 荒川 泰彦¹²	1.東大ナノ量子機構, 2.東大生研
	10:45 - 11:00	奨 12a-A10-8	走査型電子顕微鏡による量子ドットの位置検出とナノ共振器との結合状態評価	○車 一宏¹, 太田 泰友², 高宮 大策¹, 角田 雅弘², 岩本 敏¹², 荒川 泰彦¹²	1.東大生研, 2.東大ナノ量子機構
	11:00 - 11:15		休憩/Break		
	11:15 - 11:30	12a-A10-9	ウエハ接合界面での光損失を低減した量子ドット結合共振器の作製	○北田 貴弘¹, 原山 千穂¹, 太田 寛人¹, 前川 知久¹, 盧 翔孟¹, 熊谷 直人¹, 井須 俊郎¹	1.徳島大院フロンティア
	11:30 - 11:45	12a-A10-10	一次元フォノニック結晶導波路におけるフォノン伝搬のバンド構造依 存性	○畑中 大樹¹, ドデル アモリ¹, マブーブ イムラン¹, 小野満 恒二¹, 山口 浩司¹	1.NTT物性研
	11:45 - 12:00	奨 12a-A10-11	多モード干渉を利用した表面プラズモンポラリトン交差導波路	○太田 雅¹, 福原 誠史¹, 住村 あさひ¹, 伊藤 基¹, 相原 卓磨¹, 石井 佑弥¹, 福田 光男¹	1.豊技大
	12:00 - 12:15	奨 12a-A10-12	グラフェン装荷型プラズモニクス導波路における光吸収の増強	○(M1)常川 雅人 <sup>1,2</sup> , 小野 真証 <sup>1,3</sup> , 納富 雅 也 <sup>1,2,3</sup>	1.NTT物性研, 2.東工大理工, 3.NT- Tナ/フォトニクスセンタ
	12:15 - 12:30	奨 12a-A10-13	プラズモニック導波路のSi細線導波路への結合	○小野 真証 <sup>1,2</sup> , Hao Xu <sup>1,2</sup> , 倉持 栄一 <sup>1,2</sup> , 野 崎 謙悟 <sup>1,2</sup> , 谷山 秀昭 <sup>1,2</sup> , 常川 雅人 <sup>2,3</sup> , 納 富 雅也 <sup>1,2,3</sup>	1.NTTナノフォトニクスセンタ, 2.NTT物性科学基礎研, 3.東工大理工

3.7			uantum properties and fabrications of nanoscale s	tructures and devices	口頭講演
	3月11日(水	) 9:15 - 12:3	30		
	9:15 - 9:30	11a-A10-1	テーパードセル法を用いたPbS量子ドットの高密度配列	○加納 朋弥¹, 清水 雄大¹, 中嶋 聖介¹², 向 井 剛輝¹	1.横浜国大工学府, 2.理研
	9:30 - 9:45	11a-A10-2	PbS量子ドットのガラスコーティングによる発光特性への影響	○丹羽 慶輔¹, 藤川 裕恭¹, 牟田口 浩明², 田中 智也², 向井 剛輝², 中嶋 聖介².3	1.横浜国大理工, 2.横浜国大院工, 3.理研
	9:45 - 10:00	11a-A10-3	ポリマー薄膜中のコロイドPbS量子ドットにおける励起緩和過程の偏 光異方性	○廣田 舞¹, 芝川 忠慶¹, 原田 幸弘¹, 喜 多 隆¹	1.神戸大院工
	10:00 - 10:15	11a-A10-4	ポリマー/Siハイブリッド型可動式マイクロ光共振器からの量子ドットの発光	○野坂 貴大¹, 中嶋 聖介¹², 向井 剛輝¹	1.横浜国大工学府, 2.理研
	10:15 - 10:30	11a-A10-5	電場のゆらぎによる単一CdSe/ZnSナノ粒子の発光スペクトル拡散 現象	○(M1C)伊吹 博人¹, 井原 章之¹, 金光 義 彦¹	1.京大化研
	10:30 - 10:45		休憩/Break		
辞	10:45 - 11:00	E 11a-A10-6	[Young Scientist Presentation Award Speech] (15min.) Terahertz spectroscopy of sublevel structures in single self-assembled InAs quantum dots	OYa Zhang¹, Kenji Shibata¹, Naomi Nagai¹, Camile Ndebeka-Bandou¹.³, Gerald Bastard¹.³, Kazuhiko Hirakawa¹.²	1.IIS, Univ. of Tokyo, 2.INQIE, University of Tokyo, 3.LPA, Ecole Normale Superieure
	11:00 - 11:15	E 11a-A10-7	Dynamic Nuclear Spin Polarization in the Presence of Multiple Excitonic Complexes in Single InAs/GaAs Quantum Dots at Zero Applied Magnetic Field	OCheeFai Fong <sup>1,2</sup> , Yasutomo Ota <sup>1,2</sup> , Edmund Harbord <sup>1,3</sup> , Satoshi Iwamoto <sup>1,2</sup> , Yasuhiko Arakawa <sup>1,2</sup>	1.NanoQuine, 2.IIS, Univ. of Tokyo 3.Univ. of Bristol
	11:15 - 11:30	11a-A10-8	単一量子リングにおける電子・正孔面内 g 因子評価	○冨永 隆宏¹, 冨井 拓真², 鍜治 怜奈², 呉 祐年³, 鄭 舜仁³, 足立 智²	1.北大工, 2.北大院工, 3.台湾国立交通大
	11:30 - 11:45	11a-A10-9	(113)B GaAs基板上に成長した量子ドットのPLの温度依存性	○盧 翔孟¹, 川口 晃弘¹, 熊谷 直人¹, 北田 貴弘¹, 井須 俊郎¹	1.徳大
	11:45 - 12:00	11a-A10-10	InAs量子ドット積層構造の面内光伝導キャリアの移動度	○熊谷 直人¹, 村雲 圭佑¹, 北田 貴弘¹, 井 須 俊郎¹	1.徳島大院フロンティア
	12:00 - 12:15	11a-A10-11	InGaN/GaN堆積物除去と単一ナノコラム発光	○(B)山本 貴利¹, 前川 未知瑠¹, 今西 佑典¹, 関根 清登¹, 澄川 雄樹¹, 石沢 峻介¹, 中岡俊裕¹, 岸野 克巳¹	1.上智大理工
	12:15 - 12:30	11a-A10-12	Effect of Impurity Correlation on Electron Transport under Nano-Device Structures	○(M2)Muhammad Restu Zulhidza¹, Yuji Kaneno¹, Akiko Ueda¹, Syuta Honda¹, Katsuhisa Yoshida¹, Nobuyuki Sano¹	1.Tsukuba Univ.
	3月12日(木	) 14:00 - 15	:45		
	14:00 - 14:15	12p-A24-1	半導体量子井戸における励起子量子ビートのポンプ光エネルギー 依存性	○小島 磨¹, 喜多 隆¹	1.神戸大院工
	14:15 - 14:30	12p-A24-2	GaAs 量子井戸における正孔スピン重ね合わせ状態の直線偏光分解ポンプローブ測定法による評価	○伊藤 哲¹², 後藤 英樹³, 夫馬 宗一郎¹, 市 田 正夫⁴, 安藤 弘明⁴	1.静岡大電子研, 2.静岡大院工, 3.N' 物性科学基礎研, 4.甲南大理工
	14:30 - 14:45	奨 12p-A24-3	GaAs/AlGaAsトンネル双量子井戸のスピン緩和の温度及び障壁層 幅依存性	○有竹 貴紀¹, 原澤 遼¹, 安江 雄也¹, Wu Hao¹, 武藤 俊一², 竹内 淳¹	1.早大理工, 2.北大院工
	14:45 - 15:00	12p-A24-4	GaAs エピタキシャル構造中のキャリア輸送を利用した超高速光応 答の制御	○長谷川 尊之¹, 竹内 日出雄², 山田 永³, 秦 雅彦³, 中山 正昭²	1.兵庫県大院物質理, 2.阪市大院工, 3.住友化学筑波研
	15:00 - 15:15	12p-A24-5	水素化非晶質Si中に形成された結晶Ge量子井戸構造に関する検討	○貝津 光¹, 磯村 雅夫¹	1.東海大院工
	15:15 - 15:30	12p-A24-6	CaF』/CdF。/CaF、共鳴トンネル量子井戸構造を用いた抵抗スイッチング特性の理論解析	○(DC)須田 慶太¹, 桑田 友哉¹, 渡辺 正裕¹	1.東工大
	15:30 - 15:45	12p-A24-7	金属/Ge界面での偏析によるショットキーバリア変調の第一原理計算	○恩田 由紀子¹, 中山 隆史¹	1.千葉大理

13.7	超薄膜·量子	ポスター講演					
	3月12日(木) 16:00 - 18:00						
		12p-P13-1	量子ドット中V型3準位系集合体における3パルスフォトンエコー	○市川 翔大 <sup>1</sup> , 赤羽 浩一 <sup>2</sup> , 新井 悠人 <sup>1</sup> , 早 瀬 潤子 <sup>1</sup>	1.慶大理工, 2.情通機構		
		12p-P13-2	Si/CaF。共鳴トンネル構造を用いた抵抗スイッチング素子のバルス 応答特性	○桑田 友哉¹, 須田 慶太¹, 渡辺 正裕¹	1.東工大院総理工		

13.8	3 化合物及び	パワー電子ディ	ベイス・プロセス技術 / Compound and power electro	on devices and process technolog	gy     口頭講演	
	3月11日(水) 9:00 - 12:00					
	9:00 - 9:15	11a-A21-1	タンデム太陽電池応用のためのSi/InGaPへテロ接合の電気伝導 特性	○梁 剣波¹, 柴 麗¹, 西田 将太¹, 重川 直輝¹	1.大阪市立大学	
	9:15 - 9:30	11a-A21-2	GaAsSb バックワードダイオードの実測特性の理論解析によるデバイスモデル構築	○小野 孝介¹, 藤田 尚成¹, 伊森 香織¹, 須原理彦¹, 高橋 剛²	1.首都大理工, 2.富士通研	
	9:30 - 9:45	11a-A21-3	InSb HEMT作製におけるプロセスダメージの検討	○前田 章臣', 辻 大介', 竹鶴 達哉', 藤川 紗千恵', 藤代 博記', 渡邊 一世², 山下 良美 ², 遠藤 聡², 原 紳介², 笠松 章史²	1.東理大院基礎工, 2.情報通信研究機構	
	9:45 - 10:00	奨 11a-A21-4	ビスエチルメチルアミノシランを用いた原子層堆積SiO <sub>2</sub> 保護膜を有するAlGaAs/InGaAs HEMTの特性	○鈴木 貴之¹, 滝川 陽介¹, 張 東岩¹, 内藤 志麻子¹, 岩田 直高¹	1.豊田工大	
	10:00 - 10:15	奨 11a-A21-5	SiCN鋳型プロセスを用いた傾斜フィールドプレート構造を持つ InGaAs系HEMTの作製とその特性	○吉田 智洋¹, 畠山 信也¹, 安川 奈那¹, 尾辻 泰一¹, 末光 哲也¹	1.東北大通研	
	10:15 - 10:30		休憩/Break			
	10:30 - 10:45	11a-A21-6	基板転写InP HBTにおけるメタルサプコレクタの熱抵抗低減効果	○白鳥 悠太1², 星 拓也1², 柏尾 典秀1³, 栗 島 賢二1², 日暮 栄治⁴, 松崎 秀昭1²	1.日本電信電話, 2.NTT先端集積 デ パイス研, 3.NTTデ パイスイノペーションセンタ, 4.東大	
	10:45 - 11:00	11a-A21-7	原子拡散接合を用いてSiCウエハ上に作製したInP-DHBT	○渡邉 昌崇¹, 柳沢 昌輝¹, 上坂 勝己¹, 江川 満¹, 小路 元¹	1.住友電工	
	11:00 - 11:15	奨 11a-A21-8	容量測定法によるSiC-PNダイオードの電荷変動機構解析	○松島 宏行¹, 沖野 泰之¹, 望月 和浩¹, 山田 廉一¹	1.目立中研	
	11:15 - 11:30	11a-A21-9	パルスI-V法による4H-SiC MOSFETの界面特性評価	○磯野 弘典¹, 矢野 裕司¹², 冬木 隆¹	1.奈良先端大, 2.筑波大	
	11:30 - 11:45	奨 11a-A21-10	Demonstrate of a Low On-resistance 6.5kV PiN Diode Fabricated on a SiC Substrate with p+ epitaxial layer	○Yuan Bu¹, Norifumi Kameshiro¹, Akio Shima¹, Ren-ichi Yamada¹, Yasuhiro Shimamoto¹	1.Hitachi Ltd.	

11:45 - 12:00	11a-A21-11	GIT双方向スイッチ等価回路モデルの高精度化	○井手 利英¹, 清水 三聡¹, 沈 旭強¹, 森田 竜夫², 大塚 信之², 上田 哲三²	1.産総研先進パワエレ, 2.パナソニック
3月11日(水)	14:00 - 17:1	.5		
4:00 - 14:15	11p-A21-1	Arイオン照射によるダイヤモンド半導体用オーミック電極の形成	○関 裕平¹, 星野 靖¹, 斎藤 保直¹, 中田 穣治¹	1.神奈川大理
4:15 - 14:30	11p-A21-2	(-201), (010) $\mathrm{Ga_2O_3}$ 上における結晶化 $\mathrm{Al_2O_3}$ 層の面方位依存性	○上村 崇史¹, ダイワシガマニ キルシナムル ティ¹, 倉又 朗人², 山腰 茂伸², 東脇 正高¹	1.情通研機構, 2.タムラ製作所
4:30 - 14:45	11p-A21-3	$(010)~{\rm Ga_2O_3}~{\rm LAl_2O_3}$ 結晶化層厚と界面準位密度の相関	○上村 崇史¹, ダイワシガマニ キルシナムル ティ¹, 倉又 朗人², 山腰 茂伸², 東脇 正高¹	1.情通研機構, 2.タムラ製作所
4:45 - 15:00	E 11p-A21-4	Planar Device Isolation for $\beta$ -Ga $_2$ O $_3$ Field Effect Transistors	OManHoi Wong <sup>1</sup> , Kohei Sasaki <sup>2,1</sup> , Akito Kuramata <sup>2</sup> , Shigenobu Yamakoshi <sup>2</sup> , Masa- taka Higashiwaki <sup>1</sup>	1.NICT, 2.Tamura Corp.
15:00 - 15:15	11p-A21-5	中性粒子ビームエッチングとプラズマエッチングにおけるAlGaNのエッチング表面状態の比較	○李 昌勇¹, 肥後 昭男², Thomas Cédric¹, 新村 忠³, 寒川 誠二¹²⁴	1.東北大流体研, 2.東北大学WPI- AIMR, 3.東芝生産技術センター, 4.JST-CREST
5:15 - 15:30	11p-A21-6	中性粒子ビームによるAlGaN/GaN HEMTリセスゲート構造の作製	○李 昌勇¹, 肥後 昭男², 太田 実雄³, 藤岡 洋³-⁴, 寒川 誠二¹-²-⁴	1.東北大流体研, 2.東北大学WPI- AIMR, 3.東京大学生産研, 4.JST- CREST
15:30 - 15:45		休憩/Break		
5:45 - 16:00	11p-A21-7	光照射下におけるn型GaN中プラズマ照射誘起欠陥の挙動の温度 依存性	○折茂 力都¹	1.首都大理工
6:00 - 16:15	11p-A21-8	MOCVD n-GaNで観測されるEv+0.86eV正孔トラップのODLTS 測定	○(M1)宮本 一輝¹, 徳田 豊¹	1.愛知工大
16:15 - 16:30	11p-A21-9	水素雰囲気異方性熱エッチングによる超微細ナノGaN構造の作製	○(M2)喜多 諒¹, 蜂屋 諒¹, 菊池 昭彦¹.²	1.上智大理工, 2.上智大学ナノテクノロジーセンター
6:30 - 16:45	11p-A21-10	段差付き基板上に成長したAlGaN/GaN〜テロ構造の電気的特性	○(DC)樹神 真太郎¹, Asubar Joel¹, 徳田 博邦¹, 中澤 敏志², 石田 昌宏², 上田 哲三 ², 葛原 正明¹	1.福井大院工, 2.バナソニック(株)AIS 社 技術本部
16:45 - 17:00	11p-A21-11	Au-Au熱圧着転写によるAlGaN/GaN HEMTのDC特性の向上	○廣木 正伸¹, 熊倉 一英¹, 山本 秀樹¹	1.NTT物性研
17:00 - 17:15	11p-A21-12	リセスゲート促進障壁層AlGaN/GaN 非対称Open-Gate HFETの 高温特性	○前田 就彦¹², 廣木 正伸², 佐々木 智², 原 田 裕一²	1.東京工科大, 2.NTT研究所
3月12日(木)	9:00 - 12:30		,	
9:00 - 9:15	12a-A21-1	AlTiO/InAlN/AlN/GaN金属-絶縁体-半導体電界効果トランジスタ におけるゲートリーク電流の伝導機構	○梁 吉慶¹, 宇井 利昌¹, HA. Shih¹, 山口 慎也¹, 鈴木 寿一¹	1.北陸先端大
9:15 - 9:30	12a-A21-2	金属ゲート電極材料のAlGaN/GaN HEMT のリーク電流への影響	○大賀 一樹¹, 川那子 高暢², 角嶋 邦之², 片岡 好則², 西山 彰², 杉井 信之², 若林 整², 筒井 一生², 名取 研二¹, 岩井 洋¹	1.東工大フロンティア研, 2.東工大総理
:30 - 9:45	奨 12a-A21-3	界面顕微光応答法を用いたAlGaN/GaN HEMTの劣化過程の2 次元評価	○山本 晋吾¹, 畠山 信也², 末光 哲也², 塩 島 謙次¹	1.福井大院工, 2.東北大学
9:45 - 10:00	12a-A21-4	界面顕微光応答法を用いたイオン注入n - G a N ショットキー接触の 2次元評価	○山本 晋吾¹, 村瀬 真悟¹, 田中 丈士¹², 三 島 友義², 中村 徹³, 塩島 謙次¹	1.福井大院工, 2.日立金属, 3.法政大
0:00 - 10:15	奨 12a-A21-5	自立基板の劈開面に形成したn-GaNショットキー接触の評価	○永縄 萌¹, 青木 俊周¹, 吉田 丈洋², 三島 友義²³, 塩島 謙次¹	1.福井大院工, 2.日立金属(株), 3.法 政大学
0:15 - 10:30	奨 12a-A21-6	GaNショットキーバリアダイオードの順方向特性における アノード電 極端効果	〇吉川 大地 <sup>1</sup> , 山口 裕太郎 <sup>2</sup> , 山中 宏治 <sup>2</sup> , 大石 敏之 <sup>1</sup>	1.佐賀大理工, 2.三菱電機
0:30 - 10:45	奨 12a-A21-7	三端子構造を用いたGaN ショットキーバリアダイオードの寄生抵抗 解析	〇山口 修造 <sup>1</sup> , 山口 裕太郎 <sup>2</sup> , 山中 宏治 <sup>2</sup> , 大石 敏之 <sup>1</sup>	1.佐賀大理工, 2.三菱電機
10:45 - 11:00		休憩/Break		
1:00 - 11:15	12a-A21-8	N極性p形GaNショットキー電極の電気的特性の評価	○青木 俊周 <sup>1</sup> , 谷川 智之 <sup>2</sup> , 片山 竜二 <sup>2</sup> , 松岡 隆志 <sup>2</sup> , 塩島 謙次 <sup>1</sup>	1.福井大院工, 2.東北大金研
11:15 - 11:30	12a-A21-9	走査型非線形誘電率顕微鏡によるAlGaN/GaN構造の2次元電子ガス及び分極の評価	○廣瀬 光太郎¹, 茅根 慎通¹, 長 康雄¹	1.東北大通研
1:30 - 11:45	12a-A21-10	GaN系半導体への局所レーザアニールによる注入Siの活性化	○(M1)永井 昂哉¹, 分島 彰男¹, 江川 孝志¹, 平田 智也², 安藤 聡², 谷 克彦²	1.名工大, 2.ワイエイシイフェトン
11:45 - 12:00	奨 12a-A21-11	放射光光電子分光法によるn-GaN上AI/Tiコンタクトの界面反応分析	○伊藤 丈予!, 淺原 亮平!, 野崎 幹人!, 中澤 敏志², 石田 昌宏², 上田 哲三², 吉越 章 隆², 寺岡 有殿², 細井 卓治!, 志村 考功!, 渡部 平司!	1.阪大院工, 2.バナソニック, 3.原子力 機構
12:00 - 12:15	12a-A21-12	AlGaN/GaN HEMT構造への凹凸AlGaN層導入によるコンタクト 抵抗の低減	○武井 優典¹, 下田 智裕¹, 筒井 一生¹, 齋藤 渉², 角嶋 邦之¹, 若林 整¹, 片岡 好則 ¹, 岩井 洋¹	1.東工大, 2.東芝 セミコンダ クター&ストレージ 社
12:15 - 12:30	12a-A21-13	δドープGaNキャップ/AlGaN/GaN構造のオーミックコンタクト抵抗	○(B)加藤 直樹¹, 安藤 彰浩¹, 分島 彰男¹, 江川 孝志¹, 長田 大和², 上村 隆一郎²	1.名工大, 2.アルバック
3月12日(木)	14:00 - 17:3	30		
14:00 - 14:15	12p-A21-1	超格子キャップ層を用いたAlGaN/GaN MOSFET	○按田 義治¹, 塩崎 奈々子¹, 根来 昇¹, 中澤 敏志¹, 鶴見 直大¹, 石田 昌宏¹, 上田 哲三¹	1.パナソニック
4:15 - 14:30	12p-A21-2	選択再成長を用いたノーマリオフAlGaN/GaN MOSFET	<ul> <li>□ ○中澤 敏志¹, 塩崎 奈々子¹, 根来 昇¹, 鶴見</li> <li>直大¹, 按田 義治¹, 石田 昌宏¹, 上田 哲三¹</li> </ul>	1.パナソニック
4:30 - 14:45	奨 12p-A21-3	酸素雰囲気熱処理プロセスがGaN MOS界面特性に与える影響	○大平 城二¹, 千崎 泰¹, 谷田部 然治¹², 橋 詰 保¹²	1.北大量集センター, 2.JST-CREST
4:45 - 15:00	12p-A21-4	n-GaN MOSキャバシタにおける界面電荷の温度特性	○高島 信也¹, 上野 勝典¹, 江戸 雅晴¹, T.Paul Chow²	1.富士電機, 2.RPI
5:00 - 15:15	奨 12p-A21-5	AlGaN/GaN系PチャネルHFETのMOS構造によるノーマリーオフ化	○久保田 俊介¹, 萱沼 怜¹, 中島 昭³, 西澤 伸一³, 大橋 弘通²³, 筒井 一生¹, 角嶋 邦之¹,	1.東工大総理工, 2.東工大フロンティア 研, 3.産総研
15:15 - 15:30	12p-A21-6	AlGaN上にALD成膜したHfO₂を用いたMIS-HEMTの電気的特性	若林 整¹, 岩井 洋² ○西野 剛介¹, 吉田 雄祐¹, 久保 俊晴¹, 三好 実人¹, 江川 孝志¹	1.名古屋工業大学
15:30 - 15:45		休憩/Break	人八,吐川 丁心	
15:45 - 16:00	奨 12p-A21-7	AlGaN/GaN HEMT 構造のAlGaN層内部の電子トラップ解析	○(M1)馬場 俊之!, 永久 雄一², 川那子 高 暢², 角嶋 邦之², 片岡 好則², 西山 彰², 杉 井 信之², 若林 整², 筒井 一生², 名取 研二 !, 岩井 洋¹	1.東工大フロンティア研, 2.東工大総理

5 12p-A21-8	低周波インビーダンス測定によるGaN HEMTのトラップモデリング	〇山口 裕太郎', 大塚 浩志', 小山 英寿', 加茂 宣卓', 南條 拓真', 山中 宏治', 大石 敏之 <sup>2</sup>	1.三菱電機, 2.佐賀大学
0 12p-A21-9	GaN HEMT Drain-lagのGaN channel層依存性	○鎌田 陽一!, 岡本 直哉!, 佐藤 優!, 山田 敦史!, 小谷 淳二!, 石黒 哲郎!, 多木 俊裕!, 尾崎 史朗!, 新井田 佳孝!, 牧山 剛三!, 渡部 慶二!, 常信 和清!	1.株式会社富士通研究所
5 獎 12p-A21-10	AlGaN/GaN HEMTにおけるオフ状態ストレス後の表面帯電評価	○西口 賢弥¹, 橋詰 保¹²	1.北大量集センター, 2.JST-CREST
0 12p-A21-11	高圧水蒸気処理によるAlGaN/GaN HEMTの電流コラブス抑制	小林 洋平¹, ○Asubar Joel¹, 吉嗣 晃治², 谷 田部 然治³, 徳田 博邦¹, 堀田 昌宏², 浦岡 行治², 橋詰 保³, 葛原 正明¹	1.福井大院工, 2.奈良先端科学技術大学 院大学, 3.北大量集センター
5 12p-A21-12	AlGaN/GaN HEMTにおける発光と電流コラブスの相関	○(M1)大井 慎太郎¹, 坂井田 佳紀¹, Asubar Joel¹, 徳田 博邦¹, 葛原 正明¹	1.福井大院工
0 12p-A21-13	三次元フィールドプレート構造を用いたAlGaN/GaN HEMTの電流 コラプス改善	○鈴木 敦也¹, 秋良 鴻介¹, Joel Asubar¹, 徳 田 博邦¹, 葛原 正明¹	1.福井大院工
3	50 12p-A21-9 15 獎 12p-A21-10 10 12p-A21-11 15 12p-A21-12	12p-A21-9   GaN HEMT Drain-lagのGaN channel層依存性   15   獎 12p-A21-10   AlGaN/GaN HEMTにおけるオフ状態ストレス後の表面帯電評価   12p-A21-11   高圧水蒸気処理によるAlGaN/GaN HEMTの電流コラブス抑制   12p-A21-12   AlGaN/GaN HEMTにおける発光と電流コラブスの相関   12p-A21-13   三次元フィールドプレート構造を用いたAlGaN/GaN HEMTの電流	1, 加茂 宣卓¹, 南條 拓真¹, 山中 宏治¹, 大石 敏之²     2p-A21-9   GaN HEMT Drain-lagのGaN channel層依存性   ○鎌田 陽一¹, 岡本 直哉¹, 佐藤 優¹, 山田 敦史¹, 小谷 淳二¹, 石黒 哲郎', 多木 俊裕', 尾崎 史朗', 新井田 佳孝¹, 牧山 剛三¹, 渡部 慶二¹, 常信 和清¹     5

		ヾイス・プロセス技術 / Compound and power electro	on devices and process teemiolog	gy ポスター講演
3月13日(金)	16:30 - 18:			
	奨 13p-P17-1	高正孔濃度GaAsSbコンタクト層を有するGaAsSb/InGaAsSbベース DHBTのMOCVD成長	○星 拓也¹, 柏尾 典秀², 杉山 弘樹¹, 横山 春喜¹, 栗島 賢二¹, 井田 実¹, 松崎 秀昭¹	1.NTT先端集積デバイス研, 2.NTTテ イスイノベーションセンタ
	13p-P17-2	InAs-PHEMT特性に及ぼす正孔蓄積の効果	〇小松 竜大¹, 西尾 結¹, 佐藤 万里衣¹, 佐藤 宇人¹, 杉山 駿輔¹, 高梨 良文¹	1.東理大
	13p-P17-3	In-Plane Gateデバイスの電流・電圧特性	○坂元 翔¹, 小野満 恒二², 山本 秀樹², 堀越 佳治¹, 牧本 俊樹¹	1.早大理工, 2.NTT BRL
	奨 13p-P17-4	超格子FETに向けたダブルバリアp-i-n接合ダイオード	○行待 篤志¹, 柏野 壮志¹, 宮本 恭幸¹	1.東工大院理工
	13p-P17-5	格子整合系InAIN/ AlGaN HEMT デバイスの試作と評価	○藤田周¹, 三好実¹, 江川 孝志¹	1.名工大
	13p-P17-6	GaN/AIN共鳴トンネルダイオードで生じる双安定性の劣化メカニズム	○永瀬 成範¹, 高橋 言緒¹, 清水 三聡¹	1.産総研
	奨 13p-P17-7	InAIN/GaN HEMTs における傾斜型フィールドプレートによるドレイン空乏領域長への影響	○安川 奈那¹, 畠山 信也¹, 吉田 智洋¹, 尾辻 泰一¹, 末光 哲也¹	1.東北大通研
	13p-P17-8	独立に電圧印加可能なField Plateを有するAlGaN/GaN HEMTの バルスI-V特性	○間瀬 駿¹, 江川 孝志¹, 分島 彰男¹	1.名工大
	13p-P17-9	サファイア基板上GaN PSJ(分極超接合)トランジスタの連続通電特性	〇松本 壮太¹, 平田 祥子¹, 中村 文彦¹, 斎藤 武尊¹, 一丸 敬一¹, 八木 修一¹, 河合 弘治¹	1.パウデック
	13p-P17-10	ノーマリーオフGaN-PSJトランジスタ	〇平田 祥子¹, 松本 壮太¹, 一丸 敬一¹, 斎藤 武尊¹, 八木 修一¹, 中村 文彦¹, 河合 弘治¹	1.株式会社パウデック
	13p-P17-11	GaNバラクタダイオードの製作	高橋 言緒¹, 坂村 祐一¹, 長南 紘志¹, 木内 真希¹, 井手 利英¹, 沈 旭強¹, ○清水 三聡¹, 板谷 太郎¹, 島田 雅夫²	1.産総研, 2.RFデバイステクノロジー
	奨 13p-P17-12	分極接合GaNウエハを用いたパワー集積回路	○萱沼 怜', 久保田 俊介', 中島 昭', 西澤 伸一3, 大橋 弘通 <sup>23</sup> , 筒井 一生 <sup>1</sup> , 角嶋 邦之 <sup>1</sup> , 若林 整', 岩井 洋 <sup>2</sup>	1.東工大総理工, 2.東工大フロンティ研, 3.産業技術総合研究所
	13p-P17-13	鉄ドープMOCVD n-GaNショットキーダイオードのアドミタンス分光	○上田 聖悟¹	1.愛知工大
	13p-P17-14	Ar+イオン照射したMOCVD-GaN:Si膜の電気的評価	〇中野 由崇 <sup>1</sup> , 高木 健司 <sup>1</sup> , 小川 大輔 <sup>1</sup> , 中村 圭二 <sup>1</sup> , 新部 正人 <sup>2</sup> , 川上 烈生 <sup>3</sup>	1.中部大工, 2.兵庫県立大高度研, 3. 島大院工
	13p-P17-15	CF <sub>4</sub> プラズマ処理したAlGaN/GaNヘテロ構造の電気的評価	○中野 由崇¹, 川上 烈生², 新部 正人³, 高木健司¹, 白濱 達夫², 向井 孝志⁴	1.中部大工, 2.徳島大院工, 3.兵庫県 高度研, 4.日亜化学
	13p-P17-16	ドライエッチングがAl <sub>2</sub> O <sub>3</sub> /AlGaN/GaN構造のMOS界面特性に与える影響	○谷田部 然治 <sup>1,2</sup> , 大平 城二 <sup>1</sup> , 佐藤 威友 <sup>1</sup> , 橋詰 保 <sup>1,2</sup>	1.北大量集センター, 2.JST-CREST
	13p-P17-17	${\sf GaN}$ 基板上にプラズマCVDで形成した ${\sf SiO_2}\text{-}{\sf MOS}$ キャパシタの特性	○上野 勝典¹, 高島 信也¹, 松山 秀昭¹, 江戸 雅春¹, 中川 清和²	1.富士電機, 2.山梨大
	13p-P17-18	Al <sub>2</sub> O <sub>3</sub> /InAlN界面特性のプロセス依存性	○千葉 勝仁¹, 赤澤 正道¹	1.北大 量集センター
	13p-P17-19	ノーマリーオフGaN系MOSFETの実現に向けた再成長プロセス	〇井上 恵太¹, 成田 知隆¹, 分島 彰男¹, 江 川 孝志¹	1.名工大
	13p-P17-20	AlGaN/GaN HEMTにおける局所リークへのエピタキシャル層の 影響	○成田 知隆¹, 藤本 祐一¹, 分島 彰男¹, 江 川 孝志¹	1.名古屋工大
	13p-P17-21	GaN基板上AlGaN/GaN HEMT構造の表面モフォロジが耐圧に 与える影響	○田邉 真一¹, 渡邉 則之¹, 内田 昌宏², 松 崎 秀昭¹	1.NTT先端集積デバイス研, 2.NTT-
	奨 13p-P17-22	表面活性化接合によるn+-Si/n-GaNコンタクトの検討	○(B)西村 拓也¹, 梁 剣波¹, 渡邉 則之², 重 川 直輝¹	1.大阪市大工, 2.NTT研究所
	13p-P17-23	Low resistance ohmic contact on AlGaN/GaN heterostructures grown on GaN substrate	ODaryoush H. Zadeh <sup>1</sup> , Shinichi Tanabe <sup>1</sup> , Noriyuki Watanabe <sup>1</sup> , Hideaki Matsuzaki <sup>1</sup>	1.NTT Dev. Tech. Labs.
	13p-P17-24	AlGaN/GaN HEMTへの凹凸AlGaN層導入によるコンタクト抵抗低減効果の凹凸構造パターン依存性	○下田 智裕', 武井 優典', 筒井 一生', 齋 藤 渉', 角嶋 邦之', 若林 整', 片岡 好則 ', 岩井 洋'	1.東工大, 2.東芝セミコンダクター&ストレージ

1	3.9 光物性・発光デバイス / Optical properties and light-emitting devices 口頭講演						
	3月11日(水) 9:30 - 12:15						
	9:30 - 9:45	E 11a-A25-1	Synthesis of ${\rm A_3B_8X_{15}}$ -type new oxynitride phosphors starting from a single crystal composition	○(P)Xiaojun Wang¹, Rong-Jun Xie¹, Naoto Hirosaki¹, Takashi Takeda¹, Shiro Funahashi¹	1.NIMS		
	9:45 - 10:00	E 11a-A25-2	Moisture-induced thermal degradation of red-emitting ${\rm CaAlSiN_3:Eu}$	ORong-Jun Xie <sup>1</sup> , Jie Zhu <sup>1,2</sup> , Yujin Cho <sup>1,3</sup> , Takayuki Suehiro <sup>1</sup> , Takeda Takashi <sup>1</sup> , Naoto Hirosaki <sup>1</sup>	1.NIMS, 2.Nanjin Univ Sci Tech, 3.Uni Tsukuba		
	10:00 - 10:15	11a-A25-3	サイアロン蛍光体ガラス薄膜を用いた固体照明デバイスの特性	〇吉村 健一 <sup>1</sup> , 安念 一規 <sup>1</sup> , 福永 浩史 <sup>1</sup> , 原 田 昌道 <sup>1</sup> , 和泉 真 <sup>1</sup> , 高橋 向星 <sup>2</sup> , 打越 哲郎 <sup>2</sup> , 広崎 尚登 <sup>2</sup>	1.シャープ, 2.物材機構		
	10:15 - 10:30	11a-A25-4	$\rm Ba_3Si_2O_{12}N_2$ :Eu²+蛍光体の2波長励起PL測定-AGEの前照射時間依存性	○高塚 洋右¹, 李 延延¹, 福田 武司¹, 本多善太郎¹, 来島 友幸², 鎌田 憲彦¹	1.埼玉大学, 2.三菱化学		

10:30 - 10:45		休憩/Break		
10:45 - 11:00	11a-A25-5	$A_{_3}M_{_8}X_{_{12}}$ 型新緑色窒化物蛍光体の結晶構造解析	○舟橋 司朗¹, 武田 隆史¹, 広崎 尚登¹, 解 栄軍¹	1.物材機構
11:00 - 11:15	11a-A25-6	$A_3B_8X_1$ 型新緑色窒化物蛍光体の発光特性	○武田 隆史¹, 広崎 尚登¹, 舟橋 司朗¹, 解 栄軍¹	1.物材機構
11:15 - 11:30	11a-A25-7	粉末合成したA <sub>3</sub> B <sub>8</sub> X <sub>12</sub> 型新緑色窒化物蛍光体のカソードルミネッセンス観察	○高橋 向星¹, Yujin Cho¹², 武田 隆史¹, 舟 橋 司朗¹, 解 栄軍¹, 関口 隆史¹², 広崎 尚登¹	1.物材機構, 2.筑波大学
11:30 - 11:45	E 11a-A25-8	Microscopic approach for optimizing the growth conditions of LaAl(Si <sub>6-z</sub> Al <sub>z</sub> )(N <sub>10-z</sub> O <sub>z</sub> )(z~1):Ce <sup>3+</sup> blue phosphor	○(DC)Yujin Cho <sup>1,2</sup> , Kohsei Takahashi <sup>2</sup> , Benjamin Dierre <sup>2</sup> , Rong-Jun Xie <sup>2</sup> , Naoto Hirosaki <sup>2</sup> , Takashi Sekiguchi <sup>1,2</sup>	1.Tsukuba Univ., 2.NIMS
11:45 - 12:00	11a-A25-9	黄色発光蛍光体Sr₂SiှAl₃ON₁₃:Ceの2つのサイトからの発光	○アルベサール 恵子¹, 石田 邦夫¹, 福田 由 美¹, 加藤 雅礼¹	1.東芝研開セ
12:00 - 12:15	11a-A25-10	光励起下での結晶構造解析による $\mathrm{Sr_2Si_7Al_3ON_{13}}$ : $\mathrm{Ce}$ 蛍光体の発光サイトの直接観察	○石田 邦夫¹, 星野 学², 野澤 俊介², 足立伸一², アルペサール 恵子¹, 福田 由美¹, 加藤 雅礼¹	1.東芝研開セ, 2.物構研
3月11日(水	) 13:30 - 17:3	30		
13:30 - 13:45	11p-A25-1	サファイアC面基板上に成膜したZnO:Er膜からの可視PL	○赤沢 方省¹, 篠島 弘幸²	1.NTT DIC, 2.久留米高専
13:45 - 14:00	11p-A25-2	RF-MBE法によるGaAs(100)基板上へのユーロビウム添加立方晶 GaN薄膜の作製	○小山 裕生¹, 弓達 新治¹, 田所 真尚¹, 竹内 一磨¹, 宮田 晃¹, 白方 祥¹	1.愛媛大工
14:00 - 14:15	E 11p-A25-3	Growth and Characterization of GaN/Eu-Doped GaN Nanolayer Structures by Low-Temperature Organometallic Vapor Phase Epitaxy	○Wanxin ZHU¹, Dolf Timmerman¹, Atsushi Koizumi¹, Yasufumi Fujiwara¹	1.Osaka Univ.
14:15 - 14:30	11p-A25-4	Eu,O共添加GaNにおけるトラップ準位のDLTS評価	○重宗 翼¹, 小泉 淳¹, 児島 貴徳¹, 藤原 康文¹	1.阪大院工
14:30 - 14:45	奨 11p-A25-5	Eu添加GaNにおけるEu発光特性の面内圧縮ひずみ依存性	○(M2)稲葉 智宏¹, 児島 貴徳¹, 小泉 淳¹, 藤原 康文¹	1.阪大院工
14:45 - 15:00	11p-A25-6	GaN:Eu赤色LEDの発光効率改善法:パルス駆動による注入電荷 共振	○石井 真史¹, 小泉 淳², 藤原 康文²	1.物材機構, 2.阪大工
15:00 - 15:15	11p-A25-7	「光らなかった」過程から観た希土類添加ガラス:欠陥電荷の局在/ 非局在と消光の関係	○石井 真史¹, 渕 真悟², 竹田 美和³	1.物材機構, 2.青学大, 3.名産研
15:15 - 15:30		休憩/Break		
15:30 - 15:45	奨 11p-A25-8	$Er_x Yb_y Y_{2xy} SiO_5$ 結晶における最大効率 $Yb^{3+}$ 増感作用	○近藤 史哉¹, 一色 秀夫¹	1.電通大院情報理工
15:45 - 16:00	11p-A25-9	$\operatorname{Er}_{\mathbf{x}}\mathbf{Y}_{2\mathbf{x}}\mathbf{S}i\mathbf{O}_{5}$ 結晶中のエネルギー移動による緩和過	○一色 秀夫1	1.電通大院情報理工
16:00 - 16:15	11p-A25-10	硬X線光電子分光によるSi(111)上にMBE成長した( $\text{Er}_z\text{Sc}_{1,x}$ ) $_2\text{O}_z$ 膜のパンド構造の決定	○尾身 博雄 <sup>1,2</sup> , ブラックスタッド ローガン <sup>1</sup> , 俵 毅彦 <sup>1,2</sup>	1.NTT物性研, 2.NTT NPC
16:15 - 16:30	11p-A25-11	Sn添加シリコン酸窒化膜のフォトルミネッセンス特性評価	○(M1C)川俣 明¹, 竹内 寛稀¹, 鈴木 拓也¹, 呉 研¹, 高橋 芳浩¹	1.日大理工
16:30 - 16:45	11p-A25-12	不純物添加がSi量子ドット多重集積構造のEL特性に及ぼす影響	山田 敬久¹, ○牧原 克典¹, 池田 弥央², 宮崎 誠─¹	1.名大院工, 2.広大院先端研
16:45 - 17:00	奨 11p-A25-13	シリコンナノ粒子による吸着分子の発光増強	○前田 譲章¹, 松本 健俊¹, 小林 光¹	1.阪大産研
17:00 - 17:15	11p-A25-14	SOQ MOSFET特性の照射光波長依存性	○西澤 悠佑¹, 山田 辰哉¹, 東 利晃¹, 中島 義賢¹, 花尻 達郎¹	1.東洋大学 バイオナノ研
17:15 - 17:30	E 11p-A25-15	Monitoring Porous Silicon Photo-Dissolution in Hydrofluoric Acid	○Bernard Gelloz¹, Toshifumi Oya², Lianhua Jin²	1.Nagoya Univ., 2.Yamanashi Uni
	9:00 - 12:30			
9:00 - 9:15	12a-A25-1	CuAlS <sub>2</sub> :Mn赤色蛍光体薄膜のポストアニールによる発光特性の改善	○(M1)足立 尚義¹, 川口 英紀¹, 石垣 雅², 大観 光徳¹³	1.鳥大院工, 2.TiFREC, 3.TEDRE
9:15 - 9:30	12a-A25-2	Ga添加による(Y,Ce) <sub>4</sub> (SiS <sub>4</sub> ) <sub>3</sub> 黄色蛍光体の発光波長制御	○(P)七井 靖¹, 大和 樹志¹, 奥野 剛史¹	1.電通大 先進理工
9:30 - 9:45	奨 12a-A25-3	アルカリ土類硫化物蛍光体の発光特性 一第一原理計算と配位子場 理論による電子状態解析—	○中野 博史¹, 大江 昌人¹	1.シャープ
9:45 - 10:00	奨 12a-A25-4	Eu <sup>2+</sup> 付活蛍光体温度消光特性と母体構造の構造活性相関解析	○青木 知也¹, 高羽 洋充¹	1.工学院大学
10:00 - 10:15	12a-A25-5	XPSによる青色蛍光体Sr <sub>3</sub> MgSi <sub>2</sub> O <sub>s</sub> :Eu²+の570nm発光の考察	○(B)郷津 建太¹, 宮川 勇人¹, 曽根 光作¹, 神垣 良昭², 岡本 慎二³, 高橋 尚志⁴	1.香川大工, 2.EBL, 3.東京化研, 4 川大教
10:15 - 10:30	奨 12a-A25-6	$SrAl_2O_4$ ファイバの高感度応力発光特性	○吉田 晃人¹, 松尾 ともみ², 原 陸洋¹, 川崎 悦子¹, 藤尾 侑輝¹, 徐 超男¹²	1.産総研, 2.九大
10:30 - 10:45		休憩/Break		
10:45 - 11:00	12a-A25-7	Ce³-·GAGG結晶における光誘起欠陥の赤外分光	○(B)稲葉 涼太¹, 北浦 守¹, 鎌田 圭², 黒澤 俊介³, 大西 彰正¹, 佐々木 実¹, 原 和彦⁴	1.山形大理, 2.東北大 NICHe, 3.東 金研, 4.静岡大電研
11:00 - 11:15	12a-A25-8	$Ce,Mg$ 共添加 $(La, Gd)_2Si_2O_7$ 単結晶における発光特性の温度依存性	○村上 力輝斗', 黒澤 俊介¹², Vitezslav Jary², 北浦 守¹, 庄子 育宏¹⁵, Ш/井 航平 ¢, 有田 廉º, 横田 有為², Jan Pejchal²³, 大橋 雄二', 鎌田 圭ঽ⁵, 猿ፅ 信房�°, 大西 彰正⁴, Martin Nikl³, 吉川 彰¹²⁵	1.東北大金研, 2.東北大NICHe, 3. コ物理研, 4.山形大理, 5.(株)C&A 大レーザー研
11:15 - 11:30	12a-A25-9	Eu³+をトラップ増感剤とした新規赤色Mn残光蛍光体(Zn <sub>y</sub> Mg <sub>1-y</sub> ) GeO <sub>3</sub> :Mn²+Eu³+の光学特性評価	○家弓 朋広¹, 片山 裕美子¹, 上田 純平¹, 田部 勢津久¹	1.京都大学
11:30 - 11:45	奨 12a-A25-10	LaAlO <sub>3</sub> :Cr³+ペロブスカイト蛍光体の深赤色長残光特性	○(P)片山 裕美子¹, 小林 大晃¹, 田部 勢 津久¹	1.京大院人環
	12a-A25-11	ナノ蛍光体を用いた太陽電池用波長変換膜	○(M1)坂田 陵輔¹, 土井 直紀¹, 石垣 雅², 大観 光徳¹³, 大倉 央⁴	1.鳥大院工, 2.TiFREC, 3.TEDRE 4.メルク(株)
11:45 - 12:00	134113011		人的C /C /C /C /C	10 (10)
11:45 - 12:00 12:00 - 12:15	奨 12a-A25-12	CuInS <sub>2</sub> 及びAgInS <sub>2</sub> /ZnS量子ドットのZnSコーティング回数依存性	○菱沼 賢智', 倉林 智和', 福田 武司', 鎌田 憲彦', 本多 善太郎'	1.埼玉大学

3月12日(木	14:00 - 17	7:00		
14:00 - 14:15	12p-A25-1	Tb <sub>3</sub> Ga <sub>5</sub> O <sub>12</sub> :Eu³+蛍光体の発光特性	○澤田 健士¹, 安達 定雄¹	1.群馬大院理工
14:15 - 14:30	12p-A25-2	CaTiO <sub>3</sub> :Eu³+蛍光体の作製と評価	○(B)折橋 拓也¹, 新井 敬章¹, 安達 定雄¹	1.群馬大院理工
14:30 - 14:45	12p-A25-3	$KCl$ への $(Ce^{3+}, Sn^{2+})$ イオン共賦活効果	○(M1)登坂 優希¹, 安達 定雄¹	1.群馬大院理工
14:45 - 15:00	12p-A25-4	ZnSnF <sub>6</sub> · <u>6</u> H <sub>2</sub> O:Mn <sup>4+</sup> 赤色蛍光体の作製と評価	○(M1)星野 良介¹, 安達 定雄¹	1.群馬大院理工
15:00 - 15:15	12p-A25-5	ZnO薄膜における光波-分極波長距離結合による超高速輻射緩和	○一宮 正義 <sup>1-2</sup> , 馬越 隆之 <sup>2</sup> , 佐伯 昴 <sup>2</sup> , 木 下 岳 <sup>2</sup> , 石原 一 <sup>3</sup> , 川上 将輝 <sup>4</sup> , 中山 正昭 <sup>4</sup> , 芦田 昌明 <sup>2</sup>	1.滋賀県大工, 2.阪大院基礎工, 3.原大院工, 4.阪市大院工
15:15 - 15:30	12p-A25-6	分子線交互供給法によるCdSe量子ドットの作成と光学的評価II	○川崎 泰登¹, 米田 稔¹, 瀬戸 悟², 本田 亮 ³, 谷山 智康⁴	1.岡山理大院理, 2.石川工業高専, 門教育大, 4.東工大応セラ研
15:30 - 15:45		休憩/Break		
15:45 - 16:00	12p-A25-7	バイオテンプレート極限加工によるGaAs量子ナノディスクLEDの試作	○肥後 昭男!, 木場 隆之 <sup>27</sup> , トーマス セドリック <sup>3</sup> , 王 云鵬 <sup>4</sup> , 山下 一郎 <sup>57</sup> , 杉山 正和 <sup>6</sup> , 中野 義昭 <sup>6</sup> , 村山 明宏 <sup>27</sup> , 寒川 誠ニ <sup>1,3,7</sup>	1.東北大学WPI-AIMR, 2.北大情報学, 3.東北大流体研, 4.東大先端研良先端大, 6.東大院工, 7.JST-CRE
16:00 - 16:15	12p-A25-8	$\operatorname{La_2Ti_2O_7:Pr}$ のフォトルミネッセンスおよびエレクトロルミネッセンス特性	○京免 徹¹, 斎藤 志道¹, 花屋 実¹, 高島 浩²	1.群馬大院理工, 2.産総研
16:15 - 16:30	12p-A25-9	$Ca_{a,s}Sr_{a,t}TiO_{3}$ :Prを用いた薄膜型および粉末型EL素子における低電圧発光現象 $2$	○池上 敬一¹, 中川 祐希², 三浦 登², 伯田幸也¹, 高島 浩¹	1.産総研, 2.明大理工
16:30 - 16:45	12p-A25-10	BaTiO <sub>3</sub> ナノ粒子を塗布した無機薄膜エレクトロルミネッセンス素子	○畑山 進也¹, 板垣 悠己¹, 手良向 睛貴¹, 石垣 雅², 大観 光徳¹³	1.鳥大院工, 2.TiFREC, 3.TEDRE
16:45 - 17:00	12p-A25-11	発光側電極にグラフェンを使用した分散型ELの特性	張 栖岩¹, 大久保 貴雅², 奧村 竜二², 市川 洋², ○佐藤 利文¹	1.東京工芸大工メディア, 2.名工大

13.9 光物性・	発光デバイス / O	ptical properties and light-emitting devices	ポスター講演	
3月13日	(金) 16:30 - 18	3:30		
	13p-P18-1	誘導結合プラズマによるEu添加KSrPO $_4$ 蛍光体の還元効果の水素濃度依存性	○高地 満寿雄¹, 山上 紘平¹, 佐々木 徹¹, 菊 池 崇志¹, 加藤 有行¹	1.長岡技科大工
	13p-P18-2	電気泳動堆積によるペロブスカイト酸化物を用いた多層膜無機EL の作製	駒形 大樹¹, ○加藤 有行¹	1.長岡技科大工
	13p-P18-3	白色LED応用に向けたCaY <sub>2</sub> Si <sub>2</sub> S <sub>8</sub> :Ce <sup>3+</sup> , Eu <sup>2+</sup> 蛍光体の発光特性	○田邊 冬夢¹, 加藤 有行¹	1.長岡技科大工
	13p-P18-4	高圧相SrO:Eu青色蛍光体の焼成プロセス	○小松 啓志¹, 中村 淳¹², 大塩 茂夫¹, 齋藤 秀俊¹	1.長岡技科大, 2.中部キレスト
	13p-P18-5	植物栽培用Mn付活蛍光体の合成	○藤田 佳子¹, 國本 崇¹	1.徳文大理工
	13p-P18-6	$Y_4(SiS_4)_3$ :Tb蛍光体へのGe添加による吸収帯の制御	○鈴木 智大¹, 七井 靖¹, 奥野 剛史¹	1.電通大先進理工
	13p-P18-7	赤色硫化物蛍光体La <sub>z</sub> S <sub>3</sub> :Ce <sup>3+</sup> の発光特性	○室崎 祐¹, 七井 靖¹, 奥野 剛史¹	1.電通大先進理工
	13p-P18-8	希土類チオシリケート蛍光体 $(Y_{1:x}Tb_x)_4(SiS_y)_3$ の時間分解フォトルミネッセンス	○鈴木 洋介¹, 七井 靖¹, 奥野 剛史¹	1.電通大先進理工
	13p-P18-9	サイト選択分光法による $(La,Ce,Y)_{a}Si_{a}S_{17}$ 蛍光体のスペクトル分離	○(P)七井 靖¹, 室崎 祐¹, 奥野 剛史¹	1.電通大 先進理工
	13p-P18-10	高強度近赤外応力発光体Sr <sub>3</sub> Sn <sub>2</sub> O <sub>7</sub> : Nd <sup>3+</sup> の開発	○(M1)大城 裕貴 <sup>1,2</sup> , 塗 東 <sup>1,2</sup> , 藤尾 侑輝 <sup>2</sup> , 徐 超男 <sup>1,2,3</sup>	1.九大総理工, 2.産総研, 3.九大 WPI-I2CNER
	13p-P18-11	局在発光中心型酸化物蛍光体における光音響信号とPLの関係	○古川 恵大¹, 深田 晴己¹, 山口 敦史¹	1.金沢工大O.E.D.S. R&Dセンター
	13p-P18-12	MOD法を用いたアップコンバージョン蛍光体の発光特性評価	○久保 孝徳¹, 菖蒲 勇¹, 大山 渓人¹, 野中 俊宏¹, 山本 伸一¹	1.龍谷大理工
	13p-P18-13	LaOF:Yb³+/Er³+アップコンバージョン蛍光体の発光特性評価	○大山 渓人¹, 野中 俊宏¹, 山本 伸一¹	1.龍谷大理工
	13p-P18-14	ホットインジェクション法を用いたCu-In-S/ZnS 量子ドットの作製	〇宮城 拓未¹, 尾川 弘祐¹, 長久保 準基², 永田 智啓², 山本 伸一¹	1.龍谷大理工, 2.(株)アルバック
	13p-P18-15	Cu-In-S/ZnS量子ドットの合成および発光特性評価	○尾川 弘祐¹, 宮城 拓未¹, 長久保 準基², 永田 智啓², 山本 伸一¹	1.龍谷大理工, 2.(株)アルバック
	13p-P18-16	Pドープ $(NH_4)_2$ SiF。微粒子の発光特性評価	○北澤 駿¹, 佐藤 慶介¹, 深田 直樹², 平 栗 健二¹	1.東京電機大学院工, 2.物材機構
	13p-P18-17	引っ張り歪みGOIのCMP薄膜化による発光強度増大	○橋本 秀明¹, 徐 学俊¹, 澤野 憲太郎¹, 丸 泉 琢也¹	1.都市大総研
	13p-P18-18	Eu+イオンをドープしたZnOナノ粒子の発光特性における表面欠陥 の影響	○安藤 俊介¹, 石墨 淳¹, 柳 久雄¹	1.奈良先端大物質
	13p-P18-19	Mn²+ドープコア/シェルCdS/ZnSナノ粒子における発光特性のドープ 濃度及び位置依存性	○柳澤 祐介¹, 石墨 淳¹, 柳 久雄¹	1.奈良先端
	13p-P18-20	${\rm O}_2$ 及びNOガスを用いて作製したEu,O共添加GaNの表面モフォロジーとEu発光特性	○高津 潤一¹, 松田 将明¹, 児島 貴徳¹, 小泉淳¹, 藤原 康文¹	1.大阪大工
	13p-P18-21	InPの2光子吸収係数βの偏光方向依存性シミュレーション	○李 修平¹, 坂東 弘之¹, 大石 真樹¹, 松 末 俊夫¹	1.千葉大院融合

13.	10 化合物太陽	陽電池, 15.2 Ⅱ-V	/l族結晶および多元系結晶のコードシェアセッション	口頭講演			
	3月12日(木) 13:30 - 17:45						
	13:30 - 13:45	12p-A26-1	ZnTe基板上へのClドープCdTe薄膜のMBE成長	○(M1)寺沢 俊貴¹, 田中 徹¹, 斉藤 勝彦¹, 郭 其新¹, 西尾 光弘¹	1.佐賀大院工		
	13:45 - 14:00	12p-A26-2	MBEによる高不整合材料ZnCdTeO薄膜の成長	○(B)岡野 友紀¹, 溝口 耕輔¹, 寺沢 俊貴¹, 田中 徽¹, 斉藤 勝彦¹, 郭 其新¹, 西尾 光弘¹	1.佐賀大学		
	14:00 - 14:15	奨 12p-A26-3	PLD法による透明p型導電性BaCuSF膜の作製とCdTe太陽電池への応用	○川邉 利幸¹, 榊間 博¹, 小川 洋平², 細野 藍響², 岡本 保², 和田 隆博¹	1.龍谷大理工, 2.木更津高専		
	14:15 - 14:30	12p-A26-4	グラフェン透明導電膜の薄膜化合物太陽電池応用	〇石川 亮佑¹, 大矢 智也¹, 野本 隆宏¹, 坪井 望¹	1.新潟大工		
	14:30 - 14:45	12p-A26-5	Se蒸気圧制御によるCZTSナノ粒子薄膜のSe化	○梅嶋 悠人¹, 井狩 華奈美¹, 上村 一生¹, 張 険峰², 小林 正和¹.³	1.早大先進理工, 2.早大ICSEP, 3.早 大材研		

	14:45 - 15:00	12p-A26-6	ゾルゲル硫化法による $\mathrm{Cu_2ZnSnS_4}$ 薄膜の作製における $\mathrm{UV/O_3}$ 処理 の効果 $\mathrm{II}$	○宮沢 勇斗¹, 田中 久仁彦¹, 打木 久雄¹	1.長岡技大
	15:00 - 15:15	12p-A26-7	ミスト CVD 法による $\mathrm{Cu_2ZnSnS_4}$ 薄膜の作製と評価	○渡辺 勇一郎¹, 池之上 卓己¹, 三宅 正男¹, 平藤 哲司¹	1.京大院エネ科
	15:15 - 15:30	奨 12p-A26-8	ナフテン酸銅,ナフテン酸亜鉛およびオクチル酸スズとジメチルセレンを用いたCu <sub>z</sub> ZnSnSe <sub>i</sub> 薄膜の作製	○山田 諒太¹, 田橋 正浩¹, 高橋 誠¹, 吉野 賢二², 後藤 英雄¹	1.中部大学, 2.宮崎大学
	15:30 - 15:45		休憩/Break		
	15:45 - 16:00	12p-A26-9	$\mathrm{Cu_2ZnSnS_4}$ ナノ粒子の液相合成における $\mathrm{Cu^{2+}}$ 還元過程	○(M1)森下 一喜¹, 須藤 裕之¹, 神谷 格¹	1.豊田工大
	16:00 - 16:15	12p-A26-10	$\mathrm{Cu_2ZnSnS_4}$ ナノ粒子を用いた塗布型太陽電池の作製	○杉本 寛太¹, 桑名 潤¹, 後藤 仁憲¹, 陶山 直樹¹, 張 毅聞², 黒川 康良¹, 山田 明¹.3	1.東工大院理工, 2.凸版印刷, 3.東工 大PVREC
	16:15 - 16:30	12p-A26-11	HAXPESによる窓層/CdS層/CZTS層界面のバンド構造評価	○田島 伸¹, 片岡 恵太¹, 梅原 密太郎¹, 高橋 直子¹, 木本 康司¹, 北住 幸介¹, 磯村 典武¹	1.豊田中研
	16:30 - 16:45	12p-A26-12	Zn <sub>1-x</sub> Mg <sub>x</sub> O/Cu <sub>2</sub> ZnSn(S, Se) <sub>4</sub> 界面のバンド接続の in-situ 評価	○諏訪原 裕貴¹	1.鹿児島大
	16:45 - 17:00	E 12p-A26-13	Photocarrier dynamics in $\text{Cu}_z\text{ZnSn}(S_x\text{Se}_{1:x})_4$ single crystals: Composition dependence	○(PC)Le Quang Phuong¹², Makoto Okano¹, Genki Yamashita³, Masaya Nagai³, Masaaki Ashida³, Akira Nagaoka¹⁴, Kenji Yoshino⁴, Yoshihiko Kanemitsu¹²	1.Kyoto Univ., 2.JST-CREST, 3.Osaka Univ., 4.Univ. of Miyazaki
	17:00 - 17:15	E 12p-A26-14	Suppression of nonradiative recombination centers in $\mathrm{Cu_2ZnSnS_4}$ single crystals by sodium doping	○(PC)Le Quang Phuong¹², Makoto Okano¹, Genki Yamashita³, Masaya Nagai³, Masaaki Ashida³, Akira Nagaoka¹.⁴, Kenji Yoshino⁴, Yoshihiko Kanemitsu¹²²	1.Kyoto Univ., 2.JST-CREST, 3.Osaka Univ., 4.Univ. of Miyazaki
	17:15 - 17:30	12p-A26-15	電子線照射による $\mathrm{Cu_2ZnSnS_4}$ 太陽電池の電気的・光学的特性への影響	○相原 理¹, 坂倉 秀徳¹, 片桐 裕則², 杉 山 睦¹	1.東京理科大 理工/総研, 2.長岡高専
	17:30 - 17:45	奨 12p-A26-16	ケステライト化合物Cu $_{\!$	○永岡 章 <sup>1.5</sup> , Scarpulla Michael <sup>2</sup> , 柿本 浩一 <sup>3</sup> , 吉野 賢二 <sup>4</sup> , 野瀬 嘉太郎 <sup>1</sup>	1.京大院工, 2.米ユタ大, 3.九大応力研, 4.宮崎大工, 5.学振特別研究員PD
	3月13日(金	9:00 - 12:1	5		
	9:00 - 9:15	奨 13a-A17-1	近接昇華法を用いたサファイア基板上のAg(Ga,Al)Te <sub>2</sub> 混晶作製	○宇留野 彩¹, 薄井 綾香¹, 竹田 裕二¹, 井上 朋大¹, 小林 正和¹²	1.早大先進理工, 2.早大材研
	9:15 - 9:30	13a-A17-2	CuInSe <sub>2</sub> -In <sub>2</sub> Se <sub>3</sub> 系化合物の結晶構造と光学的性質	○(PC)前田 毅¹, 宮 イゲン¹, 和田 隆博¹	1.龍谷大理工
	9:30 - 9:45	奨 13a-A17-3	CuGaSe₂-ZnSe系化合物の結晶構造と光学的性質	〇山田 悠斗 <sup>1</sup> , 前田 毅 <sup>1</sup> , 竹井 康二 <sup>1</sup> , 和 田 隆博 <sup>1</sup>	1.龍谷大理工
	9:45 - 10:00	13a-A17-4	Znのサイト選択ドービングによるp形CIGS薄膜の作製	○白方 祥¹, 吉田 正吾¹, 岸田 貴志¹, 弓達 新治¹, 宮田 晃¹	1.愛媛大 工
	10:00 - 10:15	13a-A17-5	CIGS薄膜のその場PL測定	○深井 尋史¹, 池村 賢一郎², 井口 和也², エルリカオ ザッカーリ¹, カトリイズール¹, 松山 勇¹, 山口 博¹, 中田 時夫¹	1.東京理科大総研, 2.浜松ホトニクス
	10:15 - 10:30	13a-A17-6	$\mathrm{CuIn}_{1-x}\mathrm{Ga}_{x}\mathrm{Se}_{2}$ における光キャリアの緩和及び拡散ダイナミクス	○岡野 真人¹, 櫻井 岳晓², 秋本 克洋², 柴田 肇³, 仁木 栄³, 金光 義彦¹.⁴	1.京大化研, 2.筑波大数物研, 3.産 総研・太陽光発電工学研究・センター, 4.JST-CREST
	10:30 - 10:45	E 13a-A17-7	Microstructure Characteristics of $\mathrm{Cu}(\mathrm{In},\mathrm{Ga})\mathrm{Se}_2$ Thin Films Investigated by TEM	○(PC)HyungSeok Kim <sup>1,4</sup> , T. Ohkubo <sup>1</sup> , K. Hono <sup>1</sup> , K. Yoshida <sup>2</sup> , T. Nakada <sup>3</sup>	1.NIMS, 2.Osaka Univ., 3.Tokyo Univ. of Sci., 4.LG Electronics
	10:45 - 11:00	13a-A17-8	Lift-off法を用いたsuperstrate型Cu(In,Ga)Se $_2$ 溥膜太陽電池におけるPEDOT:PSS裏面電極の検討	○新澤 雄高¹, 新井 裕之¹, 廣庭 大輔¹, 峯 元 高志¹	1.立命館大学
	11:00 - 11:15	13a-A17-9	裏面バッシベーション効果を利用したCIGS太陽電池特性	○崔 誠佑¹, 上川 由紀子¹, 西永 慈郎¹, 山田昭政¹, 柴田 肇¹, 仁木 栄¹	1.産総研
	11:15 - 11:30	E 13a-A17-10	Effect of KF-PDT on MBE-Grown $Cu(In_{1:x}Ga_x)Se_2$ Thin Film	○(PC)Ishwor Khatri¹, Hirofumi Fukai¹, Isamu Matsuyama¹, Hiroshi Yamaguchi¹, Tokio Nakada¹	1.Tokyo University of Science
	11:30 - 11:45	13a-A17-11	Photovoltages and Their Dependence on Incident Light Wavelengths on CIGS Solar Cells Investigated by P-KFM	○(D)Hyeondeuk Yong¹, Takashi Minemoto³, Takuji Takahashi¹.²	1.IIS, The Univ. of Tokyo, 2.INQIE, The Univ. of Tokyo, 3.Coll. of Sci. and Eng., Ritsumeikan Univ.
	11:45 - 12:00	13a-A17-12	CIGS上でのケルビンプローブフォース顕微鏡及び静電引力顕微鏡による表面電位分布と静電引力スペクトルの観測	○石井 智章¹, 峯元 高志³, 高橋 琢二1.2	1.東大生研, 2.東大ナノ量子機構, 3.立命館大理工
招待	12:00 - 12:15	13a-A17-13	「講演奨励賞受賞記念講演」(15分) Cu(In,Ga)Se2薄膜太陽電池の 価電子帯制御による界面再結合抑 制効果の理論的及び実験的検証	〇西村 昂人 <sup>1</sup> , 平井 義晃 <sup>1</sup> , 黒川 康良 <sup>1</sup> , 山田 明 <sup>1,2</sup>	1.東工大院理工, 2.太陽光発電システム 研究センター

0 化合物太陽	情電池, 15.2 II-	VI族結晶および多元系結晶のコードシェアセッション	ポスター講演	
3月13日(金)	16:30 - 18:	30		
	13p-P19-1	電着法によるFeSe薄膜の作製と物性評価II	○(M1)長屋 智紀¹, 高橋 誠¹, 鈴木 崇也¹, 田橋 正浩¹, 大木戸 貞夫¹	1.中部大学
	13p-P19-2	酸性溶液中で硫黄源の仕込み量がSnS膜に与える影響	○石川 佑¹, 宮崎 尚¹, 岡本 庸一¹, 守本 純¹	1.防衛大材料
	13p-P19-3	硫化法を用いたSnS薄膜における組成比が電気特性に与える影響	○三上 俊太郎¹, 横井 翼¹, 鷲見 浩貴¹, 相原理¹, 永易 京¹, 久富 一真¹, 杉山 睦¹	1.東京理科大学理工学部/総合研
	奨 13p-P19-4	$\operatorname{GeS}_2$ とS蒸気反応を用いた $\operatorname{Cu}_2\operatorname{GeS}_3$ 薄膜太陽電池の作製	○知野 広太郎¹, 豊永 詞¹, 金井 綾香¹, 荒木 秀明¹²	1.長岡高専, 2.科学技術振興機構 さきがけ
	13p-P19-5	スプレー熱分解法による $Cu_2ZnSnS_4$ 薄膜太陽電池の作製	○(B)藤川 祥太朗', ヒエップ グエン ティ', ウィルマン セプティナ', 原田 隆史', 池田 茂', 松村 道雄'	1.阪大太陽エネルギー化学研セ
	13p-P19-6	2段階同時蒸着法による $Cu_{_2}ZnSnSe_{_4}$ 溥膜作製の検討	○村上 秀憲¹, 大塚 健介¹, 弓達 新治¹, 宮田 晃¹, 白方 祥¹	1.愛媛大工
	13p-P19-7	Cu <sub>2</sub> ZnSn(S,Se) <sub>4</sub> ナノ粒子を用いた塗布薄膜の焼成条件による影響	○鈴木 俊正¹, 鈴木 吏², 堀 茂雄², 野々村 修一²	1.JFCC, 2.岐阜大学
	13p-P19-8	時間の経過による三次元構造Cu <sub>2</sub> ZnSnS <sub>4</sub> 太陽電池の特性変化	○田中 久仁彦¹, 長橋 由樹¹, 石山 貴道¹, 森谷 克彦², 打木 久雄¹	1.長岡技大, 2.鶴岡高専
	13p-P19-9	分子線エピタキシー法による $\mathrm{CuGaS}_2$ 薄膜の作製と評価 $\sim$ (NH, $_4$ ) $_2$ S,による過剰 $\mathrm{Cu}_s$ Sのエッチング~	○倉掛 真弥¹, 岡 優貴¹, 松下 将也¹, 山田 秀明¹, 阿部 友紀¹, 市野 邦男¹	1.鳥大院工
	13p-P19-10	MEE法を用いて成長したGaAs(001)基板上CIS-CGS構造の評価	○豊田 康揮¹, 佐藤 知嵩¹, 谷口 龍希¹, サティア バマ¹, 堀越 佳治¹, 牧本 俊樹¹	1.早稲田大学
	13p-P19-11	大気中におけるCIGS太陽電池の効率劣化の検証	○西永 慈郎¹, 上川 由紀子¹, 崔 誠佑¹, 柴 田 肇¹, 仁木 栄¹	1.産総研

13p-		二波長蛍光分光法および光容量分光法を用いた鉛ハライド系ペロブ スカイト太陽電池の欠陥準位評価	○中澤 紀祥 <sup>1</sup> , 櫻井 岳暁 <sup>1</sup> , M.M. Islam <sup>1</sup> , 秋本 克洋 <sup>1</sup> , 尾込 裕平 <sup>2</sup> , 早瀬 修二 <sup>2</sup>	1.筑波大, 2.九工大
13p-		ベロブスカイト太陽電池に用いる多孔質酸化チタン層の昇温脱離 分析	○(B)宝山 修士¹, ハシーヤ カリマ アディ リ¹, 原田 隆史¹, 池田 茂¹, 伊藤 省吾², 松 村 道雄¹	1.大阪大基礎工, 2.兵庫県立大工
13p-		量子ドット増感型太陽電池の量子ドット生成法に対するフォトキャリア 取り出し効率の比較	○家山 昂¹, 尾崎 信彦¹, 大渕 隆文², 福田直晃², 加藤 美奈子³, 滝谷 俊夫³	1.和歌山大シス工, 2.京都大, 3.日立 造船(株)
13p-	-P19-15	AR膜によるInGaP/GaAs/Si 3接合セル中サブセル特性の制御	○重川 直輝¹, 梁 剣波¹	1.大阪市大工
13p-	-P19-16	多接合太陽電池応用に向けたGaAs/Ge表面活性化接合技術の検討	○山下 大之¹, 河野 元紀¹, 渡辺 健太郎¹, 杉山 正和¹, 須賀 唯知¹, 中野 義昭¹	1.東大工
13p-	-P19-17	GaAs:N δドーブ超格子を有する太陽電池の二段階光吸収	〇鈴木 智也¹, 八木 修平¹, 土方 泰斗¹, 岡田 至崇², 矢口 裕之¹	1.埼玉大理工, 2.東大先端研
E 13		GaNAs quantum structures embedded in GaAs p-i-n for Intermediate Band Solar Cell with zero valance band offset	⊙Martin Elborg¹, Takeshi Noda¹, Liyuan Han¹	1.NIMS, Tsukuba
13p-1	-P19-19	面内高密度InAs量子ドット層における光伝導特性	○(B)秋元 直己¹, 内田 俊介¹, 山口 浩一¹	1.電通大
13p-		ECRプラズマ作製によるCu/Cu $_2$ O型PVセルの特性に与える水素プラズマ前処理の効果	○奈良 拓馬¹, 菊地 悠介¹, 佐藤 直幸¹, 池 畑 隆¹	1.茨城大院理工
13p-	-P19-21	ECRプラズマ作製によるCu/Cu <sub>2</sub> O型PVセルの大気曝露特性	○長谷川 基輝¹, 菊地 悠介¹, 佐藤 直幸¹, 池畑 隆¹	1. 茨城大院理工
13p-		Free-standing InP Nanowire Array and Their Optical Properties Toward Resource-Saving Solar Cells	○(M1)muyi Chen¹, Eiji Nakai¹, katsuhiro Tomioka¹², takashi Fukui¹	1.Graduate school of IST and RCIQE Hokkaido Univ.,, 2.JST-PRESTO

		ound solar cells 口頭講演		
3月12日(木	) 10:00 - 12:	00		
10:00 - 10:15	12a-A26-1	電気化学堆積硫化鉄薄膜の硫黄アニール処理とZnOとのヘテロ接 合への応用	○梶間 崇宏¹, 川井 正一², 市村 正也¹	1.名工大, 2.デンソー
10:15 - 10:30	12a-A26-2	電気化学法よる $Cu_2O/\alpha$ - $Fe_2O_3$ 〜テロ接合太陽電池の作製	○(M1)張 朝龍¹, 市村 正也¹	1.名工大
10:30 - 10:45	12a-A26-3	SnプレカーサへのS添加がSnS薄膜の硫化成長に与える影響	○横井 翼¹, 三上 俊太郎¹, 鷲見 浩貴¹, 相原理¹, 永易 京¹, 久富 一真¹, 杉山 睦¹	1.東京理科大学理工学部/総合研
10:45 - 11:00	奨 12a-A26-4	硫化物 / $\mathbf{ZnSnP}_2$ ヘテロ接合界面におけるバンドオフセット評価	$\bigcirc(D)$ 中塚 滋¹, 中元 宏¹, 野瀬 嘉太郎¹, 池 田 茂², 白井 泰治¹	1.京大院工, 2.阪大太陽エネ研セ
11:00 - 11:15	12a-A26-5	硫化成膜した $Cu_2SnS_3$ 薄膜とプレカーサの $Cu/Sn$ 組成比との相関	○鷲見 浩貴¹, 佐藤 宗一¹, 史 冠男¹, 杉 山 睦¹	1.東京理科大学理工学部/総合 究機構
11:15 - 11:30	奨 12a-A26-6	Na添加プリカーサを用いた硫化法による $Cu_2SnS_3$ 薄膜の作製	○中嶋 崇喜¹, 藤本 純弥¹, 山口 利幸¹	1.和歌山高専
11:30 - 11:45	12a-A26-7	$Cu_2SnS_3$ 薄膜におけるドナーアクセプター対再結合発光	○粟飯原 直也¹, 田中 久仁彦¹, 打木 久雄¹, 金井 綾香², 荒木 秀明².³	1.長岡技大, 2.長岡高専, 3.JST-さ
11:45 - 12:00	12a-A26-8	第一原理計算による $\mathrm{Cu_2SnS_3}$ 太陽電池材料の空格子欠陥の評価	○西原 弘訓¹, 前田 毅¹, 繁實 章夫¹, 和 田 隆博¹	1.龍谷大理工
3月13日(金	9:30 - 12:1	5		
9:30 - 9:45	13a-A26-1	可視光励起光電子分光法を用いた半導体超格子における伝導電子 のエネルギー分布測定	○(DC)市橋 史朗', 西谷 健治', 董 鑫宇', 川口 昂彦', 桑原 真人', 原田 俊太', 田川 美穂', 伊藤 孝寛', 宇治原 徹'	1.名大院工, 2.名大VBL
9:45 - 10:00	奨·E 13a-A26-2	Carrier Collection Efficiency for Multiple Quantum Well Solar Cells under High Sunlight Concentration	(D)Warakorn Yanwachirakul <sup>1</sup> , Hiromasa Fujii <sup>1</sup> , Kasidit Toprasartpong <sup>1</sup> , Hassanet Sodabunlu <sup>1</sup> , Kentaroh Watanabe <sup>2</sup> , Masaka- zu Sugiyama <sup>1</sup> , Yoshiaki Nakano <sup>1</sup>	1.Univ. of Tokyo, 2.RCAST
10:00 - 10:15	奨 13a-A26-3	InAs/GaAs量子ドット超格子太陽電池における超高速過渡光電流 応答	○谷渕 泰三¹, 加田 智之¹, 笠松 直史¹, 松村 拓哉¹, 朝日 重雄¹, 喜多 隆¹	1.神戸大院工
10:15 - 10:30	E 13a-A26-4	Design and Simulation of Grating-Shaped Nano-Wall Structures for Light Absorption Enhancement in Quantum Dot Solar Cells	○(M2)Cyril Digiola <sup>1,2</sup> , Satoshi Iwamoto <sup>1,2</sup> , Yasuhiko Arakawa <sup>1,2</sup>	1.NanoQuine, 2.IIS, Univ. of To
10:30 - 10:45	13a-A26-5	Siドープ量子ドット太陽電池の集光特性評価	○(DC)内藤 駿弥 <sup>1,2</sup> , 宮下 直也 <sup>2</sup> , 下村 北斗 <sup>1,2</sup> , 玉置 亮 <sup>2</sup> , 星井 拓也 <sup>1,2</sup> , 岡田 至崇 <sup>1,2</sup>	1.東大院工, 2.東大先端研
10:45 - 11:00		休憩/Break		
11:00 - 11:15	13a-A26-6	Si ドープしたInAs 量子ドット太陽電池における2 段階光吸収過程	〇下村 北斗¹, 玉置 亮², 内藤 駿弥¹, 岡田 至崇¹²	1.東大院工, 2.東大先端研
11:15 - 11:30	奨 13a-A26-7	フォトフィリング効果を考慮した2段階光吸収の定量評価	○玉置 亮¹, 庄司 靖¹, 岡田 至崇¹, 宮野 健 次郎¹	1.東大先端研
11:30 - 11:45	奨 13a-A26-8	単一量子ドット中における2段階光吸収電流の波長依存性	○野澤 朋宏 <sup>1,3</sup> , 都木 宏之 <sup>1,2</sup> , 渡邉 克之 <sup>1</sup> , 荒 川 泰彦 <sup>1,2</sup>	1.東大ナノ量子, 2.東大生研, 3.シ
11:45 - 12:00	E 13a-A26-9	Negative two-step two-photon-absorption photocurrent induced by infrared photons in quantum dots: dot density dependence	○(PC)David Tex <sup>1,2</sup> , Kouichi Akahane³, Yoshihiko Kanemitsu <sup>1,2</sup>	1.ICR Kyoto Univ., 2.JST-CRES 3.NICT
12:00 - 12:15	13a-A26-10	量子ドット中間バンド型太陽電池の2段階光電流の励起光強度依存性	○(DC)朝日 重雄¹, 寺西 陽之¹, 笠松 直史¹, 加田 智之¹, 海津 利行¹, 喜多 隆¹	1.神戸大院工
3月14日(土	9:30 - 12:0	0		
9:30 - 9:45	14a-A26-1	分極を制御したGa極性而上III族窒化物太陽電池の新規構造	○中村 亮裕¹, 藤井 克司², 杉山 正和¹, 中野 義昭¹	1.東大工, 2.GS+I
9:45 - 10:00	14a-A26-2	スマートスタック構造における接合界面の詳細分析	○水野 英範¹, 牧田 紀久夫¹, 穂積 康雄¹, 菅谷 武芳¹, 松原 浩司¹, 高遠 秀尚¹	1.産総研
10:00 - 10:15	E 14a-A26-3	Reduction in Optical Reflection Loss at Intermediate Adhesive Layer for Mechanical Stacked Multi-Junction Solar Cells	OShunsuke Kimura <sup>1</sup> , Tomohiko Nakamura <sup>1</sup> , Shinya Yoshidomi <sup>1</sup> , Masahiko Hasumi <sup>1</sup> , Toshiyuki Sameshima <sup>1</sup>	1.TUAT
10:15 - 10:30	E 14a-A26-4	Contribution of absorption and recombination losses in subcell photocurrent-spectra determined by wavelength-dependent time-resolved photoluminescence	○(PC)David Tex¹.⁴, Hidefumi Akiyama²⁴, Mitsuru Imaizumi³, Yoshihiko Kanemitsu¹.⁴	1.ICR Kyoto Univ., 2.ISSP Toky Univ., 3.JAXA, 4.JST-CREST
10:30 - 10:45	14a-A26-5	3接合タンデム太陽電池から放射されるテラヘルツ波特性	○濱内 翔太¹, 酒井 裕司¹, 梅垣 俊仁¹, 伊藤 明², 中西 英俊², 川山 巌¹, 村上 博成¹, 斗内 政吉¹	1.阪大レーザー研, 2.SCREEN ホディングス
10:45 - 11:00		休憩/Break		

11:00 - 11:15	14a-A26-6	多接合太陽電池のエレクトロルミネッセンス絶対光量画像計測	○吉田 正裕', 朱 琳', 金 昌秀', 秋山 英文 ¹, 陳 少強², 望月 敏光³, 久保田 英博⁴, 中村 徹哉³, 今泉 充⁵, 金光 義彦⁵	1.東大物性研, 2.華東師範大, 3.産総研, 4.アトー(株), 5.JAXA, 6.京大化研
11:15 - 11:30	14a-A26-7	InGaAs/GaAsP超格子の太陽電池における波状構造の影響	○(B)加藤 巧¹, 藤井 宏昌', ソダーバンル ハッサネット², 渡辺 健太郎², 杉山 正和¹, 中野 義昭¹	1.東大工, 2.東大先端研
11:30 - 11:45	E 14a-A26-8	Lattice-matched III-V/Ge triple junction solar cell with InGaAs/GaAsP superlattice middle cell	○Hassanet Sodabanlu¹, Hiromasa Fujii², Kentaroh Watanabe¹, Masakazu Sugiyama², Yoshiaki Nakano¹²	1.RCAST, The Univ. of Tokyo, 2.School of Engineering, The Univ. of Tokyo
11:45 - 12:00	14a-A26-9	高効率格子整合4接合太陽電池に向けた実効バンドギャップ1.15 eV のInGaAs/GaAsP歪補償量子井戸	○トーブラサートポン カシディット¹, 藤井 宏昌¹, Thomas Tomos³, Führer Markus³, Alonso-Álvarez Diego³, Farrell Daniel J.³, 渡辺 健太郎², 岡田 至崇², Ekins-Daukes Nicholas J.³, 杉山 正和¹, 中野 義昭¹	1.東大工, 2.東大先端研, 3.インペリア ルカレッジ

## 15 結晶工学 / Crystal Engineering

3月12日(木	3) 9:30 - 11:4	15		
9:30 - 9:45	E 12a-D13-1	Properties of InGaSb crystals grown under $\mu G$ at International Space Station and 1G conditions	ONirmalKumar Velu¹, Arivanandhan Mukannan¹, Rajesh Govindasamy¹, Tadanobu Koyama¹, Yoshimi Momo- se¹, Yuko Inatomi², Kaoruho Sakata², Takehiko Ishikawa², Masahiro Takayanagi², Shinnichi Yoda², Shigeki Kamigaichi², Tetsuo Ozawa², Yasunori Okano⁴, Yasuhiro Hayakawa¹	1.RIE, Shizuoka Univ., 2.JAXA, 3.Shi zuoka Insti Sci., 4.Osaka Univ.
9:45 - 10:00	12a-D13-2	宇宙環境を利用した均一組成SiGe結晶育成実験	○荒井 康智¹, 木下 恭一¹, 稲富 祐光¹, 塚田 隆夫², 阿部 敬太², 住岡 沙羅², 久保 正樹²	1.宇宙機構, 2.東北大院工
10:00 - 10:15	12a-D13-3	CaSi₂多結晶の育成及びCaSi₂組成近傍のCa-Si 2元系状態図	○八百川 律子¹, 中野 秀之¹²	1.豊田中研, 2.さきがけ
10:15 - 10:30	12a-D13-4	マイクロ引き下げ法による難加工性Ir合金細線作製技術の開発	○横田 有為¹, 中村 宗樹², 田中 邦弘², 坂 入 弘一², 黒澤 俊介¹³, 大橋 雄二³, 鎌田 圭 ¹⁴, 吉川 彰¹³₄	1.東北大NICHe, 2.田中貴金属工業, 3.東北大金研, 4.C&A
10:30 - 10:45	12a-D13-5	直線集束ビーム超音波材料解析システムによる ${f Ca_3Ta(Ga_{0.5}Al_{0.5})}$ ${}_3{f Si_2O_{14}}$ 単結晶の均質性評価法	○大橋 雄二¹, 工藤 哲男¹, 横田 有為², 庄子育宏³, 黒澤 俊介¹², 鎌田 圭²³, 吉川 彰¹²₃	1.東北大金研, 2.東北大NICHe, 3.C&
10:45 - 11:00	E 12a-D13-6	Congruency and Liquid Immiscibility in Langasite-type Crystal with Four Elements	○(DC)Hengyu Zhao¹, Jun Nozawa¹, Haruhiko Koizumi¹, Kozo Fujiwara¹, Satoshi Uda¹	1.IMR, Tohoku Univ.,
11:00 - 11:15	12a-D13-7	コングルエント・ニオブ酸リチウム単結晶成長における酸素挙動	○宇田 聡¹	1.東北大金研
11:15 - 11:30	12a-D13-8	Ar雰囲気下での熱処理による不純物添加したニオブ酸リチウムの酸素欠陥の形成	○小山 千尋¹, 野澤 純¹, 藤原 航三¹, 宇 田 聡¹	1.東北大金研
11:30 - 11:45	12a-D13-9	マイクロ引き下げ法を用いたCeBr <sub>3</sub> 結晶の育成における育成条件の 改善とPr添加効果	○伊藤 友樹¹, 横田 有為², 黒澤 俊介¹², Pejchal Jan²⁴, 大橋 雄二¹, 鎌田 圭²³, 吉 川 彰¹.²³	1.東北大金研, 2.東北大NICHe, 3.(杉 C&A, 4.チェコ物理研

15.1	15.1 バルク結晶成長 / Bulk crystal growth ポスター講演					
	3月12日(木) 16:00 - 18:00					
		E 12p-P14-1	Thermoelectric properties of compositionally homogeneous p an n-type SiGe bulk crystals	d Omprakash Muthusamy¹, Arivanandhan Mukannan¹, Tadanobu Koyama¹, Yoshimi Momose¹, Hiroya Ikeda¹, Hirokazu Tatsuoka¹, Yasunori Okano², Tetsuo Ozawa³, Yuko Inatomi⁴, Bhattacharya Shovit⁵, Aswal Dinesh⁵, MoorthyBabu Sridharan⁶, Yasuhiro Hayakawa¹	1.RIE Shizuoka Univ, 2.Osaka Univ, 3.Shizuoka Insti Sci., 4.JAXA, 5.BARC, 6.Anna Univ	
		12p-P14-2	$RuO_2$ 単結晶の合成とその特性評価	○八巻 和宏¹, 番場 幸大¹, 入江 晃亘¹	1.宇都宮大工	
		12p-P14-3	高品質 $AgGaSe_2$ 単結晶育成に向けた $Se添加効果の検討$ (II)	○須崎 昌己¹	1.大阪府立大学高専	

15.1 バルク結晶原	成長 / Bulk cr	rystal growth 口頭講演		
3月14日(土)	) 10:00 - 12	:00		
10:00 - 10:15	14a-D13-1	VBサファイア結晶中のWインクルージョンの形成機構の検討	○杉本 圭¹, 太子 敏則², 干川 圭吾¹	1.信州大工, 2.信州大環境エネ研
10:15 - 10:30	14a-D13-2	垂直ブリッジマン法により育成したAl <sub>2</sub> O <sub>3</sub> /YAG:Ce-MGCの微細組織	○山田 聖也¹, 大葉 悦子¹, 太子 敏則², 干川 圭吾¹, 吉村 正文¹³, 坂田 信一³	1.信州大工, 2.信州大環境エネ研, 3.宇部興産
10:30 - 10:45	E 14a-D13-3	Modeling basal plane dislocations in single-crystal sapphire by Alexander-Haasen model	○Bing Gao¹, Koichi Kakimoto¹	1.RIAM, Kyushu Univ.
10:45 - 11:00	E 14a-D13-4	Correlation study on heating profile and carbon contamination during the melting process of Czochralski silicon crystal growth	○(P)Xin Liu¹, Bing Gao¹, Satoshi Na- kano¹, Koichi Kakimoto¹	1.RIAM, Kyushu Univ.
11:00 - 11:15	14a-D13-5	交流電場印加による高品質タンパク質結晶の育成機構の解明 I	○小泉 晴比古¹, 宇田 聡¹, 藤原 航三¹, 橘 勝², 小島 謙一³, 野澤 純¹	1.東北大・金研, 2.横市大・院生命ナノ, 3.創英大・教育
11:15 - 11:30	14a-D13-6	荷電コロイド系結晶成長における不純物分配挙動	○野澤 純¹, 胡 素梦¹, 小泉 晴比古¹, 藤原 航三¹, 宇田 聡¹	1.東北大金研
11:30 - 11:45	E 14a-D13-7	Impurity Partitioning of Grain Boundary during Polycrystalline Colloidal	○Sumeng Hu¹, Jun Nozawa¹, Koizumi Haruhiko¹, Fujiwara Kozo¹, Uda Satohi¹	1.IMR. Tohoku Univ.
11:45 - 12:00	14a-D13-8	重力沈降によって生成したシリカコロイド結晶の構造観察(II)	○大木 芳正¹, 中野 勇二¹, 川中 智司¹, 内 田 文生¹	1.富士化学㈱

13.1	0 化合物太陽	陽電池, 15.2 Ⅱ-\	川族結晶および多元系結晶のコードシェアセッション	口頭講演	
	3月12日(木)	13:30 - 17:4	15		
	13:30 - 13:45	12p-A26-1	ZnTe基板上へのClドープCdTe薄膜のMBE成長	○(M1)寺沢 俊貴¹, 田中 徹¹, 斉藤 勝彦¹, 郭 其新¹, 西尾 光弘¹	1.佐賀大院工
	13:45 - 14:00	12p-A26-2	MBEによる高不整合材料ZnCdTeO薄膜の成長	○(B)岡野 友紀¹, 溝口 耕輔¹, 寺沢 俊貴¹, 田中 徹¹, 斉藤 勝彦¹, 郭 其新¹, 西尾 光弘¹	1.佐賀大学
	14:00 - 14:15	奨 12p-A26-3	PLD法による透明p型導電性BaCuSF膜の作製とCdTe太陽電池への応用	○川邉 利幸¹, 榊間 博¹, 小川 洋平², 細野 藍響², 岡本 保², 和田 隆博¹	1.龍谷大理工, 2.木更津高専
	14:15 - 14:30	12p-A26-4	グラフェン透明導電膜の薄膜化合物太陽電池応用	○石川 亮佑¹, 大矢 智也¹, 野本 隆宏¹, 坪井 望¹	1.新潟大工
	14:30 - 14:45	12p-A26-5	Se蒸気圧制御によるCZTSナノ粒子薄膜のSe化	○梅嶋 悠人¹, 井狩 華奈美¹, 上村 一生¹, 張 険峰², 小林 正和¹.³	1.早大先進理工, 2.早大ICSEP, 3.早 大材研
	14:45 - 15:00	12p-A26-6	ゾルゲル硫化法による $\mathrm{Cu}_2\mathrm{ZnSnS}_4$ 薄膜の作製における $\mathrm{UV/O}_3$ 処理の効果 II	○宮沢 勇斗¹, 田中 久仁彦¹, 打木 久雄¹	1.長岡技大
	15:00 - 15:15	12p-A26-7	ミスト CVD 法による Cu <sub>2</sub> ZnSnS <sub>4</sub> 薄膜の作製と評価	○渡辺 勇一郎¹, 池之上 卓己¹, 三宅 正男¹, 平藤 哲司¹	1.京大院エネ科
	15:15 - 15:30	奨 12p-A26-8	ナフテン酸銅, ナフテン酸亜鉛およびオクチル酸スズとジメチルセレンを用いたCu <sub>z</sub> ZnSnSe <sub>4</sub> 薄膜の作製	○山田 諒太¹, 田橋 正浩¹, 高橋 誠¹, 吉野 賢二², 後藤 英雄¹	1.中部大学, 2.宮崎大学
	15:30 - 15:45		休憩/Break		
	15:45 - 16:00	12p-A26-9	Cu₂ZnSnS₄ナノ粒子の液相合成におけるCu²-還元過程	○(M1)森下 一喜¹, 須藤 裕之¹, 神谷 格¹	1.豊田工大
	16:00 - 16:15	12p-A26-10	Cu <sub>z</sub> ZnSnS <sub>4</sub> ナノ粒子を用いた塗布型太陽電池の作製	○杉本 寛太¹, 桑名 潤¹, 後藤 仁憲¹, 陶山 直樹¹, 張 毅聞², 黒川 康良¹, 山田 明¹³	1.東工大院理工, 2.凸版印刷, 3.東工 大PVREC
	16:15 - 16:30	12p-A26-11	HAXPESによる窓層/CdS層/CZTS層界面のバンド構造評価	○田島 伸¹, 片岡 恵太¹, 梅原 密太郎¹, 高橋 直子¹, 木本 康司¹, 北住 幸介¹, 磯村 典武¹	1.豊田中研
	16:30 - 16:45	12p-A26-12	$Zn_{1.x}Mg_xO/Cu_2ZnSn(S, Se)_4$ 界面のパンド接続の in-situ 評価	○諏訪原 裕貴¹	1.鹿児島大
	16:45 - 17:00	E 12p-A26-13	Photocarrier dynamics in $\text{Cu}_2\text{ZnSn}(S_x\text{Se}_{1:x})_4$ single crystals: Composition dependence	○(PC)Le Quang Phuong¹², Makoto Okano¹, Genki Yamashita³, Masaya Nagai³, Masaaki Ashida³, Akira Nagaoka¹⁴, Kenji Yoshino⁴, Yoshihiko Kanemitsu¹²	1.Kyoto Univ., 2.JST-CREST, 3.Osaka Univ., 4.Univ. of Miyazaki
	17:00 - 17:15	E 12p-A26-14	Suppression of nonradiative recombination centers in $\mathrm{Cu_2ZnSnS_4}$ single crystals by sodium doping	○(PC)Le Quang Phuong¹², Makoto Okano¹, Genki Yamashita³, Masaya Nagai³, Masaaki Ashida³, Akira Nagaoka¹⁴, Kenji Yoshino⁴, Yoshihiko Kanemitsu¹²	1.Kyoto Univ., 2.JST-CREST, 3.Osaka Univ., 4.Univ. of Miyazaki
	17:15 - 17:30	12p-A26-15	電子線照射による $Cu_zZnSnS_a$ 太陽電池の電気的・光学的特性への影響	○相原 理¹, 坂倉 秀徳¹, 片桐 裕則², 杉 山 睦¹	1.東京理科大 理工/総研, 2.長岡高専
	17:30 - 17:45	奨 12p-A26-16	ケステライト化合物 $\mathrm{Cu_2ZnSn(S_x,Se_{1:x^1_4}}$ 単結晶中の固有散乱メカニズム	○永岡 章 <sup>1.5</sup> , Scarpulla Michael², 柿本 浩一 ³, 吉野 賢二⁴, 野瀬 嘉太郎¹	1.京大院工, 2.米ユタ大, 3.九大応力研, 4.宮崎大工, 5.学振特別研究員PD
	3月13日(金)	9:00 - 12:15	5		
	9:00 - 9:15	奨 13a-A17-1	近接昇華法を用いたサファイア基板上のAg(Ga,Al)Te <sub>2</sub> 混晶作製	○宇留野 彩¹, 薄井 綾香¹, 竹田 裕二¹, 井上 朋大¹, 小林 正和¹²	1.早大先進理工, 2.早大材研
	9:15 - 9:30	13a-A17-2	CuInSe <sub>2</sub> -In <sub>2</sub> Se <sub>3</sub> 系化合物の結晶構造と光学的性質	○(PC)前田 毅¹, 宮 イゲン¹, 和田 隆博¹	1.龍谷大理工
	9:30 - 9:45	奨 13a-A17-3	CuGaSe <sub>2</sub> -ZnSe系化合物の結晶構造と光学的性質	○山田 悠斗¹, 前田 毅¹, 竹井 康二¹, 和 田 隆博¹	1.龍谷大理工
	9:45 - 10:00	13a-A17-4	Znのサイト選択ドービングによるp形CIGS薄膜の作製	○白方 祥¹, 吉田 正吾¹, 岸田 貴志¹, 弓達 新治¹, 宮田 晃¹	1.愛媛大 工
	10:00 - 10:15	13a-A17-5	CIGS薄膜のその場PL測定	○深井 尋史¹, 池村 賢一郎², 井口 和也², エルリカオ ザッカーリ¹, カトリイズール¹, 松山 勇¹, 山口 博¹, 中田 時夫¹	1.東京理科大総研, 2.浜松ホトニクス
	10:15 - 10:30	13a-A17-6	$\mathrm{CuIn}_{1_{-x}}\mathrm{Ga}_{x}\mathrm{Se}_{2}$ における光キャリアの緩和及び拡散ダイナミクス	○岡野 真人¹, 櫻井 岳晓², 秋本 克洋², 柴田 肇³, 仁木 栄³, 金光 義彦¹⁴	1.京大化研, 2.筑波大数物研, 3.産 総研・太陽光発電工学研究センター, 4.JST-CREST
	10:30 - 10:45	E 13a-A17-7	Microstructure Characteristics of Cu(In, Ga)Se $_2$ Thin Films Investigated by TEM	○(PC)HyungSeok Kim <sup>1,4</sup> , T. Ohkubo <sup>1</sup> , K. Hono <sup>1</sup> , K. Yoshida <sup>2</sup> , T. Nakada <sup>3</sup>	1.NIMS, 2.Osaka Univ., 3.Tokyo Univ. of Sci., 4.LG Electronics
	10:45 - 11:00	13a-A17-8	Lift-off法を用いたsuperstrate型Cu(In,Ga)Se₂薄膜太陽電池におけるPEDOT:PSS裏面電極の検討	○新澤 雄高¹, 新井 裕之¹, 廣庭 大輔¹, 峯 元 高志¹	1.立命館大学
	11:00 - 11:15	13a-A17-9	裏面パッシベーション効果を利用したCIGS太陽電池特性	○崔 誠佑¹, 上川 由紀子¹, 西永 慈郎¹, 山田昭政¹, 柴田 肇¹, 仁木 栄¹	1.産総研
	11:15 - 11:30	E 13a-A17-10	Effect of KF-PDT on MBE-Grown $\mathrm{Cu}(\mathrm{In}_{\mathrm{1-x'}}\mathrm{Ga_x'}\mathrm{Se_2}$ Thin Film	○(PC)Ishwor Khatri¹, Hirofumi Fukai¹, Isamu Matsuyama¹, Hiroshi Yamaguchi¹, Tokio Nakada¹	1.Tokyo University of Science
	11:30 - 11:45	13a-A17-11	Photovoltages and Their Dependence on Incident Light Wavelengths on CIGS Solar Cells Investigated by P-KFM	○(D)Hyeondeuk Yong¹, Takashi Minemoto³, Takuji Takahashi¹.²	1.IIS, The Univ. of Tokyo, 2.INQIE, The Univ. of Tokyo, 3.Coll. of Sci. and Eng., Ritsumeikan Univ.
	11:45 - 12:00	13a-A17-12	CIGS上でのケルビンプローブフォース顕微鏡及び静電引力顕微鏡による表面電位分布と静電引力スペクトルの観測	○石井 智章¹, 峯元 高志³, 高橋 琢二1.2	1.東大生研, 2.東大ナノ量子機構, 3.立命館大理工
招待	12:00 - 12:15	13a-A17-13	「講演奨励賞受賞記念講演」(15分) Cu(In,Ga)Se2薄膜太陽電池の 価電子帯制御による界面再結合抑 制効果の理論的及び実験的検証	〇西村 昂人 <sup>1</sup> , 平井 義晃 <sup>1</sup> , 黒川 康良 <sup>1</sup> , 山 田 明 <sup>1,2</sup>	1.東工大院理工, 2.太陽光発電システム 研究センター

13.10 化合物太	陽電池, 15.2 II-	VI族結晶および多元系結晶のコードシェアセッション	ポスター講演				
3月13日(金	3月13日(金) 16:30 - 18:30						
	13p-P19-1	電着法によるFeSe薄膜の作製と物性評価II	○(M1)長屋 智紀¹, 高橋 誠¹, 鈴木 崇也¹, 田橋 正浩¹, 大木戸 貞夫¹	1.中部大学			
	13p-P19-2	酸性溶液中で硫黄源の仕込み量がSnS膜に与える影響	○石川 佑¹, 宮﨑 尚¹, 岡本 庸一¹, 守本 純¹	1.防衛大材料			
	13p-P19-3	硫化法を用いたSnS薄膜における組成比が電気特性に与える影響	○三上 俊太郎¹, 横井 翼¹, 鷲見 浩貴¹, 相原理¹, 永易 京¹, 久富 一真¹, 杉山 睦¹	1.東京理科大学理工学部/総合研究機構			
	奨 13p-P19-4	$GeS_2$ と $S$ 蒸気反応を用いた $Cu_2GeS_3$ 薄膜太陽電池の作製	○知野 広太郎¹, 豊永 詞¹, 金井 綾香¹, 荒 木 秀明¹.²	1.長岡高専, 2.科学技術振興機構, さきがけ			

13p-P19-5	スプレー熱分解法による $Cu_2ZnSnS_4$ 薄膜太陽電池の作製	(B)藤川 祥太朗', ヒエップ グエン ティ <sup>1</sup> , ウィルマン セプティナ <sup>1</sup> , 原田 隆史 <sup>1</sup> , 池田 茂 <sup>1</sup> , 松村 道雄 <sup>1</sup>	1.阪大太陽エネルギー化学研セ
13p-P19-6	2段階同時蒸着法による $Cu_2ZnSnSe_4$ 薄膜作製の検討	○村上 秀憲¹, 大塚 健介¹, 弓達 新治¹, 宮田 晃¹, 白方 祥¹	1.愛媛大工
13p-P19-7	$Cu_2ZnSn(S,Se)_4$ ナノ粒子を用いた塗布薄膜の焼成条件による影響	○鈴木 俊正¹, 鈴木 吏², 堀 茂雄², 野々村 修一²	1.JFCC, 2.岐阜大学
13p-P19-8	時間の経過による三次元構造 $Cu_z Zn Sn S_4$ 太陽電池の特性変化	○田中 久仁彦¹, 長橋 由樹¹, 石山 貴道¹, 森谷 克彦², 打木 久雄¹	1.長岡技大, 2.鶴岡高専
13p-P19-9	分子線エピタキシー法によるCuGaS₂薄膜の作製と評価 ~(NH₄)₂Sҳによる過剰CuҳSのエッチング~	○倉掛 真弥¹, 岡 優貴¹, 松下 将也¹, 山田 秀明¹, 阿部 友紀¹, 市野 邦男¹	1.鳥大院工
13p-P19-10	MEE法を用いて成長したGaAs(001)基板上CIS-CGS構造の評価	○豊田 康揮¹, 佐藤 知嵩¹, 谷口 龍希¹, サティア バマ¹, 堀越 佳治¹, 牧本 俊樹¹	1.早稲田大学
13p-P19-11	大気中におけるCIGS太陽電池の効率劣化の検証	○西永 慈郎¹, 上川 由紀子¹, 崔 誠佑¹, 柴 田 肇¹, 仁木 栄¹	1.産総研
13p-P19-12	二波長蛍光分光法および光容量分光法を用いた鉛ハライド系ペロプ スカイト太陽電池の欠陥準位評価	○中澤 紀祥¹, 櫻井 岳暁¹, M.M. Islam¹, 秋本 克洋¹, 尾込 裕平², 早瀬 修二²	1.筑波大, 2.九工大
13p-P19-13	ベロブスカイト太陽電池に用いる多孔質酸化チタン層の昇温脱離 分析	○(B)宝山 修士¹, ハシーヤ カリマ アディ リ¹, 原田 隆史¹, 池田 茂¹, 伊藤 省吾², 松 村 道雄¹	1.大阪大基礎工, 2.兵庫県立大工
13p-P19-14	量子ドット増感型太陽電池の量子ドット生成法に対するフォトキャリア 取り出し効率の比較	○家山 昂¹, 尾崎 信彦¹, 大渕 隆文², 福田 直晃², 加藤 美奈子³, 滝谷 俊夫³	1.和歌山大シス工, 2.京都大, 3.日立 造船(株)
13p-P19-15	AR膜によるInGaP/GaAs/Si 3接合セル中サブセル特性の制御	○重川 直輝¹, 梁 剣波¹	1.大阪市大工
13p-P19-16	多接合太陽電池応用に向けたGaAs/Ge表面活性化接合技術の検討	〇山下 大之¹, 河野 元紀¹, 渡辺 健太郎¹, 杉山 正和¹, 須賀 唯知¹, 中野 義昭¹	1.東大工
13p-P19-17	GaAs:N δドーブ超格子を有する太陽電池の二段階光吸収	○鈴木 智也¹, 八木 修平¹, 土方 泰斗¹, 岡田 至崇², 矢口 裕之¹	1.埼玉大理工, 2.東大先端研
E 13p-P19-18	GaNAs quantum structures embedded in GaAs p-i-n for Intermediate Band Solar Cell with zero valance band offset	⊙Martin Elborg¹, Takeshi Noda¹, Liyuan Han¹	1.NIMS, Tsukuba
13p-P19-19	面内高密度InAs量子ドット層における光伝導特性	○(B)秋元 直己¹, 内田 俊介¹, 山口 浩一¹	1.電通大
13p-P19-20	ECRプラズマ作製によるCu/Cu $_2$ O型PVセルの特性に与える水素プラズマ前処理の効果	○奈良 拓馬¹, 菊地 悠介¹, 佐藤 直幸¹, 池畑 隆¹	1.茨城大院理工
13p-P19-21	$ECR$ プラズマ作製による $Cu/Cu_2$ O型PVセルの大気曝露特性	○長谷川 基輝¹, 菊地 悠介¹, 佐藤 直幸¹, 池畑 隆¹	1.茨城大院理工
13p-P19-22	Free-standing InP Nanowire Array and Their Optical Properties Toward Resource-Saving Solar Cells	○(M1)muyi Chen¹, Eiji Nakai¹, katsuhiro Tomioka¹², takashi Fukui¹	1.Graduate school of IST and RCIQE Hokkaido Univ.,, 2.JST-PRESTO

15.2 II-VI族結晶 #	15.2 II-VI族結晶および多元系結晶 / II-VI and related compounds ポスター講演							
3月12日(木) 16:00 - 18:00								
	12p-P15-1	分子線エピタキシー法によるGaP基板上のZnSTe成長層の構造的 評価	○樫山 翔太¹, 難波 直¹, 長谷川 浩康¹, 阿部友紀¹, 市野 邦男¹	1.鳥取大工				
	12p-P15-2	GaAs(001)基板への(Zn,Ga,Sn)As₂薄膜の結晶成長と評価	○寺内 達也¹, 井上 寛明¹, 豊田 英之¹, 内 富 直隆¹	1.長岡技術科学大学				
	12p-P15-3	水素イオン注入ZnOバルク単結晶中の水素の挙動: 弾性反跳分析 評価	○(B)西片 直樹¹, 甲斐田 卓也¹, 上岡 一馬¹, 西村 智明¹, 栗山 一男¹, 串田 一雅²	1.法政大理工, 2.大阪教育大				
	12p-P15-4	新規Cuドービング法で作製した多結晶CdTe膜のPL評価	○瀬戸 悟¹, 小川 洋平², 細野 藍響², 岡本 保²	1.石川高専, 2.木更津高専				
	12p-P15-5	ZnTe(100)面上への(Cd,Cr)Te自己形成ドットの作製と磁気光学特性	○(M2)中澤 文生¹, 内海 駿人¹, 金澤 研¹, 黒田 眞司¹	1.筑波大院数理物質				

5.2 II-VI族結晶	および多元系統	晶/II-VI and related compounds	口頭講演		
3月13日(金) 16:15 - 19:15					
16:15 - 16:30	13p-A17-1	高温ZnTeバッファ層導入によるZnTe薄膜のドメイン構造の改善	〇相場 貴之', 中須 大蔵', 山下 聡太郎', 服部 翔太', 木津健', 孫 惟哲', 田栗 光祐', 風見 蕗乃', 橋本 勇輝', 小崎 峻', 小林 正和'², 朝日 聡明³	1.早大先進理工, 2.早大材研, 3.JX日鉱 日石金属	
16:30 - 16:45	13p-A17-2	サファイア基板表面のステップ構造がZnTe薄膜成長にもたらす効果	○木津健',中質大蔵',山下聡太郎',相場 貴之',服部翔太',孫惟哲',田栗光祐',風 見蕗乃',小崎峻',橋本勇輝',小林正和 ¹²,朝日聡明³	1.早大先進理工, 2.早大材研, 3.JX日鉱日石金属	
16:45 - 17:00	13p-A17-3	オフ角を持つサファイアa面基板のステップ構造によるZnTeドメイン 構造の改善	〇山下 聡太郎', 中須 大蔵', 木津 健', 相場 貫之', 服部 翔太', 孫 惟哲', 田栗 光祐', 風 見 蕗乃', 橋本 勇輝', 小崎 峻', 小林 正和 1², 朝日 聡明 <sup>3</sup>	1.早大先進理工, 2.早大材研, 3.JX日鉱日石金属	
17:00 - 17:15	奨 13p-A17-4	S面サファイア基板上ZnTe薄膜の作製と成長方位関係の解析	○中須 大蔵', 山下 聡太郎', 相場 貴之', 木津 健', 服部 翔太', 孫 惟哲', 田栗 光祐', 風見 蕗乃', 小崎 峻', 橋本 勇輝', 小林 正和'², 朝日 聡明³	1.早大先進理工, 2.早大材研, 3.JX日鉱日石金属	
17:15 - 17:30	13p-A17-5	格子不整合がZnMgTe/ZnTe光導波路の表面形状に与える影響	○風見 蕗乃¹, 孫 惟哲¹, 田栗 光祐¹, 中須 太蔵; 相場 貴之¹, 山下 聡太郎¹, 服部 翔太 ¹, 木津 健¹, 小崎 峻¹, 橋本 勇輝¹, 小林 正 和¹², 朝日 聡明³	1.早大先進理工, 2.早大材研, 3.JX日鉱 日石金属	
17:30 - 17:45	奨·E 13p-A17-6	The electro-optic signal improvement by ZnMgTe/ZnTe waveguide structures	○WeiChe Sun¹, Kosuke Taguri¹, Fukino Kazami¹, Taizo Nakasu¹, Sotaro Yamash- ita¹, Takayuki Aiba¹, Takeru Kizu¹, Shota Hattori¹, Shun Ozaki¹, Yuki Hashimoto¹, Masakazu Kobayashi¹², Toshiaki Asahi³	1.Waseda Univ. Dept. of Elec. Eng. & Biosci., 2.Waseda Univ. Lab. for Mat. Sci. & Tech, 3.JX Nippon Mining & Metals Corp.	
17:45 - 18:00		休憩/Break			
18:00 - 18:15	13p-A17-7	InP基板上II-VI族半導体レーザに向けたpクラッド層材料の検討	○(B)小林 亮平', 野村 一郎', 高松 眞吾', 白石 智裕', 福島 浩二', 岸野 克巳'	1.上智大理工	
18:15 - 18:30	13p-A17-8	InP基板上II-VI族半導体レーザのための酸化インジウムスズpクラッド層の検討	○(B)福島 浩二¹, 野村 一郎¹, 白石 智裕¹, 高松 眞吾¹, 小林 亮平¹, 岸野 克己¹	1.上智大理工	

18:30 - 18:45	E 13p-A17-9	Preparation of Ag-Er-TiO $_{\! 2}$ nanocomposites and photo-catalytic activity	OPrakash Natarajan <sup>1</sup> , Karthikeyan Rajan <sup>1</sup> , Thangaraju Dheivasigamani <sup>1</sup> , Navaneethan Mani <sup>1</sup> , Arivanandhan Mukannan <sup>1</sup> , Tadano- bu Koyama <sup>1</sup> , Yasuhiro Hayakawa <sup>1</sup>	1.Shizuoka Univ.
18:45 - 19:00	13p-A17-10	ZnSnN₂結晶の作製と評価(1) −パルク結晶合成−	○川村 史朗¹, 谷口 尚¹, 山田 直臣²	1.物質·材料研究機構, 2.中部大工
19:00 - 19:15	13p-A17-11	ZnSnN₂結晶の作製と評価(2) -スパッタ多結晶膜-	竹内 智之¹, 曹 祥¹, 川村 史朗², ○山田 直臣¹	1.中部大工, 2.物材機構

15.3 III-V族エピ	15.3 III-V族エピタキシャル結晶 / III-V-group epitaxial crystals 口頭講演						
3月13日(金	3月13日(金) 16:15 - 19:00						
16:15 - 16:30	13p-D4-1	(111)面InP基板上のMBE成長InAlAs層の特性	○春元 雅貴¹	1.阪府大院工			
16:30 - 16:45	13p-D4-2	表面窒化により成長したGaAsN混晶の発光特性	〇浦上 法之¹, 山根 啓輔¹, 関口 寛人¹, 岡田 浩¹², 若原 昭浩¹	1.豊橋技科大工, 2.EIIRIS			
16:45 - 17:00	13p-D4-3	GaAs中のエピタキシャル二次元窒素膜におけるアニール効果	○原田 幸弘¹, 小川 泰弘¹, 馬場 健¹, 海津 利行¹, 喜多 隆¹	1.神戸大院工			
17:00 - 17:15	13p-D4-4	Si基板上格子整合系GaAsPN混晶の高品質化	○麦倉 俊¹, 浦上 法之¹, 山根 啓輔¹, 関口 寛人¹, 岡田 浩¹², 若原 昭浩¹	1.豊橋技科大院・工, 2.豊橋技科大 EIIRIS			
17:15 - 17:30	13p-D4-5	Si基板上へのGaN/Ga(N)Asヘテロ構造のMBE成長	○(M2)加太 俊¹, 中井 裕子¹, 山崎 健平¹, 田中 康弘¹, 高橋 尚志¹, 橋本 光博², 高橋 敏男², 秋山 英文², 小柴 俊¹	1.香大, 2.東大物性研			
17:30 - 17:45	13p-D4-6	MOVPE 法を用いたSi 基板上Ge バッファおよびInGaAs/GaAs MQW層の成長	○中尾 亮 <sup>1,2</sup> , 荒井 昌和 <sup>1,2</sup> , 山本 剛 <sup>1</sup> , 松 尾 慎治 <sup>1,2</sup>	1.NTT先端集積デバイス研, 2.ナノフォトニクスセンタ			
17:45 - 18:00	13p-D4-7	微細トレンチへの選択MOCVD成長における三元系化合物半導体 の局所組成分析	○大場 大輔¹, 近藤 佳幸¹, 軍司 勲男¹, 飯塚 洋二¹, 杉山 正和², 保坂 重敏¹	1.東京エレクトロン、2.東大院工			
18:00 - 18:15	13p-D4-8	MOVPE法によるGaN基板上のウルツ鉱構造AlInP成長	○平谷 佳大¹, 石坂 文哉¹, 冨岡 克広¹², 福井 孝志¹	1.北大院情報科学および量子集積センタ ー, 2.JSTさきがけ			
18:15 - 18:30	13p-D4-9	低温成長In <sub>x</sub> Ga <sub>1x</sub> Asの結晶構造の成長温度依存性	○富永 依里子¹, 廣瀬 伸悟¹, 角屋 豊¹	1.広大院先端研			
18:30 - 18:45	13p-D4-10	GaSb基板の熱処理条件最適化	○横山 春喜 <sup>1.3</sup> , 星 拓哉 <sup>1.3</sup> , 杉山 弘樹 <sup>1.3</sup> , 西 康一 <sup>2.3</sup> , 竹中 充 <sup>2.3</sup> , 高木 信一 <sup>2.3</sup>	1.日本電信電話株式会社, 2.東大, 3.JST CREST			
18:45 - 19:00	奨 13p-D4-11	Thermal annealing of Thin Film InSb on Mica and Glass Substrate	(M2)Koswaththage Charith Jayanada <sup>1</sup> , Noguchi Takashi <sup>1</sup> , Taniguchi Shinichi <sup>2</sup> , Yoshitome Shokichi <sup>2</sup>	1.Univ. of the Ryukyus, 2.e-tec INC.			

15.3	15.3 III-V族エピタキシャル結晶 / III-V-group epitaxial crystals ポスター講演							
	3月13日(金) 9:30 - 11:30							
		13a-P15-1	希薄窒化物半導体の電子状態記述のための有効ハミルトニアンの 方法	○森藤 正人¹, 山下 純貴¹, 近藤 正彦¹, 石 川 史太郎²	1.阪大院工, 2.愛媛大院工			
		13a-P15-2	第一原理計算によるInAsN混晶のバンド構造に関する研究	○(M1)宮崎 貴史¹, 八木 修平¹, 土方 泰斗¹, 矢口 裕之¹	1.埼玉大院理工			
		奨·E 13a-P15-3	H-related acceptor state associated with residual carriers in p-type GaAsN grown by chemical beam epitaxy	Omar Elleuch¹, Li Wang¹, Kan Hua Lee¹, Koshiro Demizu¹, Kazuma Ikeda¹, Nobuaki Kojima¹, Yoshio Ohshita¹, Mas- afumi Yamaguchi¹	1.Toyota Tech. Inst.			
		13a-P15-4	Ge(111)基板上へのGaSb <sub>x</sub> As <sub>1-x</sub> のMBE成長	○孫 一博¹, 早瀬 久貴¹, 市場 太国¹, 森 涼介¹, 梶川 靖友¹	1.島根大総合理工			
		E 13a-P15-5	Molecualr beam epitaxial growth of MnAs/InAs/GaAs(111)B heterostructure	Cong Thanh Nguyen¹, Md. Earul Islam¹, ○Masashi Akabori¹	1.CNMT, JAIST			
		13a-P15-6	GaSb/GaAs量子ドットの光学異方性における後熱処理の効果	○川津 琢也¹, 野田 武司¹, 佐久間 芳樹¹, 榊 裕之¹²	1.物材機構, 2.豊田工大			
		13a-P15-7	面内高密度InAs量子ドット層の発光特性のInAs成長量依存性	○(M2)佐藤 祐介¹, 秋元 直己¹, 内田 俊介¹, 山口 浩一¹	1.電通大			

15.3	15.3 III-V族エピタキシャル結晶 / III-V-group epitaxial crystals 口頭講演						
	3月14日(土) 9:00 - 11:30						
	9:00 - 9:15	奨·E 14a-D4-1	GaAsBi/GaAs growth on (100) and (411)A GaAs Substrates by Molecular Beam Epitaxy	O(D)Pallavi Patil¹, Masataka Tatebe¹, Yuh Nabara¹, Koh-ichiroh Higaki¹, Nobutaka Nishi¹, Eric Eugenio², Saburo Tanaka¹, Satoshi Shimomura¹	1.Ehime University, 2.CIACyT UASLP		
	9:15 - 9:30	14a-D4-2	(100)面 GaAs基板上のGaAs/GaAsBi量子井戸のMBE成長	○西井 寅貴¹, 檜垣 興一郎¹, Patil Pallavi¹, 石川 史太郎¹, 下村 哲¹	1.愛媛大院理工		
	9:30 - 9:45	14a-D4-3	(100)A面 GaAs基板上のGaAs/GaAsBi超格子のBi組成プロファイルの解析	○檜垣 興一郎¹, 西井 寅貴¹, パラビ パティル¹, 石川 史太郎¹, 下村 哲¹	1.愛媛大院理工		
	9:45 - 10:00	14a-D4-4	GaAs傾斜基板上InGaP量子細線状構造の自己形成における積層 数の影響	○満原 学¹, 渡邉 則之¹, 横山 春喜¹, 重 川 直輝²	1.日本電信電話(株), 2.大阪市大		
	10:00 - 10:15	14a-D4-5	GaAsキャップ層成長温度によるInAs/GaAs量子ドットの広帯域発光 波長制御	松村 拓哉¹, ○海津 利行¹², 喜多 隆¹	1.神戸大院工, 2.神戸大研究基盤セ		
	10:15 - 10:30	14a-D4-6	GaAs(001)上のInAs量子ドットの1.55 µm以上での発光(2)	○下村 憲一¹, 神谷 格¹	1.豊田工大		
	10:30 - 10:45	14a-D4-7	InP(311)B基板上におけるデジタル埋め込みInAs量子ドットの時間 分解PL測定	○赤羽 浩一¹, 山本 直克¹, 川西 哲也¹, 田中健浩², 中村 新一², 外林 秀之²	1.情通機構, 2.青学大		
	10:45 - 11:00	14a-D4-8	GaP歪補償InAs/GaAs量子ドット積層構造の成長とLD高温動作	○影山 健生¹, 渡邉 克之², ヴォクオック フィ², 武政 敬三³, 菅原 充³, 岩本 敏¹², 荒川 泰彦¹²	1.東大ナノ量子機構, 2.東大生研, 3.QD レーザ		
	11:00 - 11:15	奨 14a-D4-9	MBE法におけるin-situ 熱拡散法によるGaAsPナノワイヤの自己形成と量子ドットによる斥力効果	○VO QUOC HUY¹, 渡邉 克之¹, 影山 健 生², 岩本 敏¹², 荒川 泰彦¹²	1.東大生研, 2.東大ナノ量子機構		
	11:15 - 11:30	E 14a-D4-10	Optimization of Growth Temperature of GaAs Nucleation Layer in InAs/GaAs Quantum Dots on Ge/Si substrate by MOCVD	○Mohan Rajesh¹, Masao Nishioka¹, Yasuhiko Arakawa¹	1.NanoQuine, The Univ. of Tokyo		

3月14日(土) 13:00 - 14:15					
13:00 - 13:15	14p-D4-1	キャップされたInAs量子ドットの表面モホロジーの観測 ~キャップ層成長温度依存性~	○角田 雅弘¹, 車 一宏², 權 晋寬², 太田 泰 友¹, 渡邉 克之¹², 岩本 敏¹², 荒川 泰彦¹²	1.東大ナノ量子, 2.東大生研	
13:15 - 13:30	E 14p-D4-2	MBE Growth and Analysis of InAs QDs on $\left(411\right)$ and $\left(221\right)$ GaAs substrates.	○(D)Eric Eugenio-Lopez <sup>1,2</sup> , Victor Hugo Mendez-Garcia <sup>1</sup> , Satoshi Shimomura <sup>2</sup>	1.CIACyT UASLP, 2.Ehime University	
13:30 - 13:45	14p-D4-3	InAsSb層上への面内超高密度InAs量子ドット(10½ cm²)の自己形成(3)	○(M1)鮫島 一樹¹, 山口 浩一¹	1.電通大	
13:45 - 14:00	奨 14p-D4-4	ステップ成長によるInP(311)B面基板上低密度InAs量子ドットの作製	○(M2)高熊 亨¹, 細井 響子¹, 赤羽 浩一², 早瀬 潤子¹	1.慶大理工, 2.情通機構	
14:00 - 14:15	14p-D4-5	ポーラスアルミナマスクにより作製したGaAsバターン基板上へのInAs量子ドットのMBE成長	○山崎 剛典¹, 十亀 真依¹, 森下 義隆¹	1.農工大工	

15.4	III-V族窒化物	物結晶 / III-V-	group nitride crystals      口頭講演		
	3月11日(水)	8:30 - 11:4	5		
	8:30 - 8:45	11a-B1-1	立方晶窒化ホウ素(c-BN)薄膜のMBE成長におけるイオン照射の効果	○平間 一行¹, 谷保 芳孝¹, 狩元 慎一¹, 山本 秀樹¹	1.NTT物性研
	8:45 - 9:00	11a-B1-2	MBE法で作製したScN薄膜のⅢ/Vフラックス比依存性	○大垣 武¹, 坂口 勲¹, 大橋 直樹¹, 羽田 肇¹	1.物材機構
	9:00 - 9:15	11a-B1-3	RF-MBE法で作製したSm添加GaN薄膜の構造・光学的特性の評価	○(M1)出原 健太郎¹, 長谷川 繁彦¹	1.阪大産研
	9:15 - 9:30	11a-B1-4	RFプラズマ支援分子線エピタキシー法を用いたGaNの選択成長	○(M1)薗田 彬人¹	1.北大
	9:30 - 9:45	11a-B1-5	$(-201)$ $Ga_2O_3$ 基板上へのAIN薄膜のRF-MBE成長	○東脇 正高¹, 中田 義昭¹, 倉又 朗人², 山腰 茂伸²	1.情通研機構, 2.タムラ製作所
	9:45 - 10:00		休憩/Break		
	10:00 - 10:15	奨 11a-B1-6	(InN) <sub>1</sub> /(GaN) <sub>4</sub> 短周期超格子の擬似混晶化	○今井 大地 <sup>1,2,3</sup> , 草部 一秀 <sup>1,2</sup> , 王 科 <sup>1,2</sup> , 吉 川 明彦 <sup>1,2,4</sup>	1.千葉大 SMART GIR, 2.JST-ALCA 3.JSPS PD, 4.工学院大学
	10:15 - 10:30	E 11a-B1-7	High indium content (InN)m/(GaN)n SPSs on relaxed InGaN templates	OKE WANG¹, Kazuhide Kusakabe¹, Daichi Imai¹, Akihiko Yoshikawa¹.²	1.Chiba Univ., 2.Kogakuin Univ.
	10:30 - 10:45	11a-B1-8	PSD法により成長したp型GaNに対する接触抵抗の評価	○野口 英成¹, 荒川 靖章¹, 上野 耕平¹, 太田 実雄¹, 藤岡 洋¹²³	1.東大生研, 2.JST-CREST, 3.JST-AC CEL
	10:45 - 11:00	E 11a-B1-9	GaN growth on Hf foils using nearly lattice-matched HfN barriers by pulsed sputtering deposition	○(D)Hyeryun Kim¹, Jitsuo Ohta¹, Atsushi Kobayashi¹, Kohei Ueno¹, Hiroshi Fujioka¹²²³	1.The Univ. of Tokyo, 2.JST-CREST 3.JST-ACCEL
	11:00 - 11:15	11a-B1-10	PSD法による高In組成InGaN結晶成長と太陽電池の作製	○荒川 靖章¹	1.東大生研
	11:15 - 11:30	11a-B1-11	反応性バルスDCスバッタ法により作製されたAIN膜の結晶性および 表面構造に及ぼすスバッタ電力の影響	竹内 洋仁¹, ○大塚 誠¹, 福山 博之¹	1.東北大学多元研
	11:30 - 11:45	奨 11a-B1-12	指向性スパッタリングAIN中間層を用いた Si(001)基板上単結晶 (1013)GaN成長	○光成 正1, 本田 善央1, 天野 浩12	1.名大院工, 2.赤﨑記念研究センター
	3月11日(水)	13:15 - 18:	45		
	13:15 - 13:30	11p-B1-1	UHVスパッタエピタキシー法によるAlInN層の成長	○(M1)神田 赳志¹, 多田 暁由¹, 小橋 勇希¹, 福井 迪¹, 水野 愛¹, 篠田 宏之¹, 六倉 信喜¹	1.東京電機大工
	13:30 - 13:45	11p-B1-2	スパッタ法AINテンプレート基板を用いたAINのHVPE成長	〇安井 大貴¹, 三宅 秀人¹, 平松 和政¹, 岩谷 素顕², 赤崎 勇², 天野 浩³	1.三重大院工, 2.名城大学, 3.名古屋 大学
	13:45 - 14:00	11p-B1-3	OVPE法を用いたGaNの-c面高温成長	○合山 雄紀', 高津 啓彰', 重田 真実', 隅 智亮', 北本 啓', 今出 完', 吉村 政志', 伊勢 村 雅士', 森 勇介'	1.阪大, 2.伊藤忠プラスチックス
	14:00 - 14:15	11p-B1-4	ハイドライド気相成長における $\mathrm{SiO}_2$ マスクの品質が $\mathrm{GaN}$ の選択横方向成長に及ぼす影響	○河原 慎¹, 山本 健志¹, 稲垣 卓志¹, 岡田 成仁¹, 只友 一行¹, 山根 啓輔²	1.山口大理工, 2.豊橋技科大電電
	14:15 - 14:30	11p-B1-5	ハイドライド気相成長法を用いて堆積させたSiNx中間層上への厚膜 GaN成長	○稲垣 卓志¹, 岡村 泰仁¹, 山根 啓輔², 岡田 成仁¹, 只友 一行¹	1.山口大院理工, 2.豊橋技術科学大
	14:30 - 14:45	11p-B1-6	ハイドライド気相成長法を用いた両面成長によるGaNテンプレート の反り低減	○山本 健志¹, 井原 洋¹, 山根 啓輔², 岡田 成仁¹, 只友 一行¹	1.山口大院理工, 2.豊橋技術科学大
	14:45 - 15:00		休憩/Break		
	15:00 - 15:15	奨 11p-B1-7	Naフラックス結合成長法で作製したGaNバルク結晶における成長初期界面の欠陥構造解析	○(M2)浅津 宏伝¹, 竹内 正太郎¹, 今西 正幸², 中村 芳明¹, 今出 完², 森 勇介², 酒井 朗¹	1.阪大院基礎工, 2.阪大院工
	15:15 - 15:30	11p-B1-8	高Ga組成Naフラックス法における結晶表面モルフォロジーの炭素 濃度依存性	〇小川 翔悟', 今西 正幸', 轟 夕摩', 村 上 航介', 今林 弘毅', 松尾 大輔', 高澤 秀 生', 丸山 美帆子', 今出 完', 吉村 政志 ', 森 勇介'	1.阪大工
	15:30 - 15:45	11p-B1-9	C添加Na-Ga融液中のCNイオンの形成・分解に関する研究	○河村 貴宏¹², 今林 弘毅², 丸山 美帆子², 今出 完², 吉村 政志², 森 勇介², 森川 良忠²	1.三重大院工, 2.阪大院工
	15:45 - 16:00	11p-B1-10	GaN単結晶を用いた柱状すべり面における転位増殖のモデル化	○中野 智¹, 高 冰¹, 柿本 浩一¹	1.九大応力研
	16:00 - 16:15	奨 11p-B1-11	静滴法を用いた窒化サファイア基板のGa-Al融液に対する濡れ角 測定	○安達 正芳¹, 安武 晃佑², 齊藤 敬高², 中島 邦彦², 杉山 正史³, 飯田 潤二³, 福山 博之¹	1.東北大多元研, 2.九大院工, 3.住友 金属鉱山
	16:15 - 16:30	奨 11p-B1-12	AIN溶液成長における熱力学計算を用いた成長速度の向上	○渡邉 将太¹, 永冶 仁¹, 陳 鳴宇¹, 竹内 幸久', 青柳 健大¹, 原田 俊太¹, 田川 美穂', 宇治原 徹¹	1.名大院工
	16:30 - 16:45		休憩/Break		
召待	16:45 - 17:00	11p-B1-13	「講演奨励賞受賞記念講演」(15分) 温度上昇に伴うAlGaN系半導体の支配的な非輻射再結合経路の 変化	〇市川 修平 <sup>1</sup> , 船戸 充 <sup>1</sup> , 岩崎 洋介 <sup>2</sup> , 川 上 養一 <sup>1</sup>	1.京大院工, 2.JFEミネラル株式会社
	17:00 - 17:15	11p-B1-14	GaNにおけるキャリア・励起子エネルギー緩和過程の励起条件依存 に関する数値解析	○馬 ベイ¹, 森田 健¹, 石谷 善博¹	1.千葉大工
	17:15 - 17:30	11p-B1-15	無極性m而AlGaN/GaN量子井戸サブバンド間吸収のドービング濃度依存性	○小谷 晃央1.2.3, 有田 宗貴1, 荒川 泰彦1.2	1.東大ナノ量子, 2.東大生研, 3.シャー
	17:30 - 17:45	11p-B1-16	AlGaN量子井戸における励起子分子結合エネルギーの井戸幅依存性	福野 智規¹, 中村 豪仁¹, 和泉 平¹, 倉井 聡¹, 三宅 秀人², 平松 和政², ○山田 陽一¹	1.山口大院理工, 2.三重大院工
	17:45 - 18:00	11p-B1-17	Eu, Mg共添加GaNのEu濃度が発光サイトに及ぼす影響	○(M1)鎌田 拓歩¹, 関口 寛人¹, 山根 啓輔¹, 岡田 浩¹², 若原 昭浩¹	1.豊橋技科大, 2.エレクトロニクス先端 合研究所(EIIRIS)

13:45 - 14:00   12p-B1-2   MOVPE法によるAIN成長における面サファイア微頓斜角度の影響						
19.5 19.00   19.01   19.02		18:00 - 18:15	11p-B1-18	Eu, Mg共添加AlGaNのAl組成が発光サイトに与える影響		1.豊橋技科大工, 2.EIIRIS
おおか		18:15 - 18:30	11p-B1-19	自立GaN基板上m面Al <sub>1×</sub> In <sub>x</sub> N エピタキシャル薄膜の発光特性(III)	○小島 一信¹, 池田 宏隆², 藤戸 健史², 秩	1.東北大多元研, 2.三菱化学(株)
3月上2日(大) 8:30 - 1145   22-01-1   7116-679919		18:30 - 18:45	奨 11p-B1-20	m面Al <sub>1-x</sub> In <sub>x</sub> N薄膜の分光エリプソメトリーによる評価	○(B)加賀谷 大樹¹, 山崎 芳樹¹, 池田 宏隆²,	1.東北大多元研, 2.三菱化学(株)
2.1.1 株 12.1		3月12日(木)	8:30 - 11:4!	5	(M) (E) (C) (C) (C) (C) (C) (C) (C) (C) (C) (C	
143 - 148		8:30 - 8:45	12a-B1-1	THzエリプソメトリーによるGaN単結晶の評価	之1, 長島 健2, 岩本 敏志3, 佐藤 幸徳3, 森田	
#4. 4m PRA 2019 12-21-14		8:45 - 9:00	奨 12a-B1-2	ホモエビタキシャル成長n型GaNのホール効果測定	○澤田 直暉¹, 成田 哲生², 加地 徹², 上杉	1.京大工, 2.豊田中研, 3.京大院工
2-50 - 4-85   12-81-5   別述でお担望性を用いてGNの別位アメイナセフの解析   日本語で 第2-5 年 第2 月 日本 1   1-2 日本語で 1   1-2		9:00 - 9:15	12a-B1-3	GaNダイオードの放射線検出特性評価	康平2, 本田 善央2, 天野 浩23, 三村 秀典4,	
1899 - 1809   12-931-6   12-931-6   12-931-6   13-931-7   13-9		9:15 - 9:30	12a-B1-4	赤外反射分光によるGaNのキャリヤ密度深さ分布解析	○上條 隆明¹, 馬 蓓¹, 森田 健¹, 石谷 善博¹	1.千葉大工
1980   1980   12a 81-6   異常報音を記載的ないの名文を対した良くでは響		9:30 - 9:45	12a-B1-5	励起子励起準位を用いたGaNの励起子ダイナミクスの解析		1.千葉大院工, 2.三重大院工
18-15-10-29   12-81-17   MOVPESEL 2-5n-19 成立 [LG_n,NS-0-35 ※ 位元 2-5 ※ 1 を		9:45 - 10:00	12a-B1-6	貫通転位がEu添加GaNの発光特性に及ぼす影響	○田原 浩行¹, 関口 寛人¹, 山根 啓輔¹, 岡田	1.豊橋技科大工, 2.EIIRIS
10:38 - 10:45   別上型		10:00 - 10:15		休憩/Break		
物語   11-19   対 12-81-19   対		10:15 - 10:30	12a-B1-7	MOVPE法によるn $^+$ -p構造 $\operatorname{In}_{_x}\operatorname{Ga}_{1,_x}\operatorname{N}(x{\sim}0.3)$ 光起電力素子の作製		1.福井大, 2.JST-CREST, 3.大阪市立大
1303-1315   12+81-10   契制規列はGNAディアラムにおけるダンルゲーク発売の温報食件的		10:30 - 10:45	奨 12a-B1-8	規則配列GaNナノコラム上InGaN単一量子井戸の発光機構		1.上智大理工, 2.上智大ナノテク
11:5 - 11:20   12-11-12   12-11-12   12-11-12   12-11-12   12-11-12   13-		10:45 - 11:00	奨 12a-B1-9	規則配列InGaN/GaNナノコラム細線化(直径35 nm)と発光特性		1.上智大理工, 2.上智ナノテク
13-39 - 11-35   12-p B1-1   22-p B1-2		11:00 - 11:15	12a-B1-10	規則配列InGaN系ナノコラムにおけるダブルビーク発光の温度依存性		1.上智大理工, 2.上智大ナノテク
13:30 - 11:45   12:0 H 2		11:15 - 11:30	12a-B1-11			1.山口大院理工
13-15 - 13-16   12-p-B1-1		11:30 - 11:45	12a-B1-12			1.山口大院理工
1845 - 1440   12p-B1-2   MOVPEBLELS ANNE KELEDIS GAME PT PT PREMISHAGE PT PT PREMISH PT PT PT PREMISH PT		3月12日(木)	13:15 - 19:4	45		
### 14:00 - 14:15   12p-B1-3   MOVPE法によるAIN成長におけるci面ナファイフ表面の影響	招待	13:15 - 13:45	12p-B1-1	念講演」(30分)	〇出浦 桃子1	1.東北大学
### 14:15 - 14:30  ### 12p-B1-5  ### 2ft.  #		13:45 - 14:00	12p-B1-2	MOVPE法によるAIN成長におけるc面サファイア微傾斜角度の影響		1.三重大院工, 2.東北大金工
14:30 - 14:45   12p-B1-5   クェットエッチングによるサファイア表面加工基板(PSS)を用いた開帯 外LEDI用高高質AINアンプレートの作製 外LEDI用高高質AINアンプレートの作業 外LEDI用高高質AINアンプレートの作業 外LEDI用高高質AINアンプレートの作業 外LEDI用高高質AINアンプレートの作業 外に作 生まり 大田 事学、表面 男工 和 東北大金属 東部 18年 大田 東北 大田 野 18年 古田 東北 18年 大田 東北 大田 野 18年 大田 東北 大田 野 18年 大田 東部 18年 大田 東北 大田 野 18年 大田 東北 18年 大田 東北 大田 野 18年 大田 東北 大田 田 東北 大田 田 野 18年 大田 東北 大田 田 東北 大田 田 東北 大田 田 田 北田 田 田 北田 田 田 北田 田 田 北田 田 田 田 田		14:00 - 14:15	12p-B1-3	MOVPE法によるAIN成長におけるc面サファイア表面の影響		1.三重大院工
#田 憲念: 農場 行創・松油 恵田子、協会 京北 (大郎 大田 大郎		14:15 - 14:30	奨 12p-B1-4	窒化a面サファイア基板上へのc面AINの有機金属気相成長	○柴岡 真実¹, 船戸 充¹, 川上 養一¹	1.京大院工
15:00 - 15:15   12p-B1-7		14:30 - 14:45	12p-B1-5		鎌田 憲彦², 鹿嶋 行雄³, 松浦 恵里子³, 嶋谷 聡⁴, 小久保 光典⁵, 田代 貴晴⁵, 大川 貴史⁵,	
「		14:45 - 15:00	E 12p-B1-6			1.NIMS
15:15 - 15:30   休憩/Break   日5:30 - 15:45   12p-B1-8   AIN(11 元2)面における表面構造および成長初期過程に関する量子 施 智徳   1.三重大院工 施 智徳   1.三重大院工 施 育徳   1.三重大院工		15:00 - 15:15	12p-B1-7		○呉 ペイツエン¹, 船戸 充¹, 川上 養一¹	1.京大院工
15:45 - 16:00   12p-B1-9   AlGaN MQWP3井戸層組成傾斜による電子線励起深葉外発行強   ○大橋 隆定*, 鳥羽 隆   1.東北大院環境科学   度の向上   1.東北大院環境科学   1. 東北大院環境科学   1. 東東・谷保 万孝・山本 秀樹・   1. 下打物性基礎研   1. 「東北大院環境科学   2. 東朝・1. 日本 新聞・1. 「東北 大陸、東東・谷保 万孝・山本 秀樹・   1. 下打物性基礎研   1. 「東北大学・大学・大学・大学・大学・大学・大学・大学・大学・大学・大学・大学・大学・大		15:15 - 15:30				
15:45 - 16:00   12p-B1-9   AlGan MQWi内非戸層組成傾斜による電子線励起深葉外発行強度の向上   1.東北大院環境科学   1.東北大院環境科学   1.東北大院環境科学   1. 1.東北大院環境科学   1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1.		15:30 - 15:45	12p-B1-8			1.三重大院工
16:00 - 16:15   獎 12p-B1-10   MOVPE法によるSiC基板上の無極性面高AI組成AIGaN成長   ○奥村 宏典、谷保 芳孝、山本 秀樹   1.NTT物性基礎研   16:15 - 16:30   獎 12p-B1-11   高キャリア濃度n型AIGaNの電気的特性   ○武田 邦宏、森 一喜、山田 知明、岩谷 素卵、竹内 哲也、上山 智、赤崎 勇立   2 をンター   16:30 - 16:45   12p-B1-12   Ga,O, (-201)基板上AIGaN (0001)エビタキシャル膜の成長   0森島 嘉史、平山 秀樹・山下 住忠、飯塚 和幸・食文 取人、山腰 友仲   1株式会社タムラ製作所、2.理化学研 変形   16:45 - 17:00   12p-B1-13   深紫外LEDに向けた窒化物半導体トンネル接合の検討   ○高新賀 大貴、南川 大智、井野 匡貴・竹乃 哲也、岩谷 素鉀、上山 智、天野 音、赤崎 勇立   1.名城大理工、2.名古屋大院工、3.名大・赤崎記念研究センター   17:00 - 17:15   獎 12p-B1-14   トンネル接合を用いたモノリシック型白色LEDの検討   0加藤 貴久、飯田 大輔・河台 俊介、上山 智・大野 音 記念研究センター   1.名城大理工、2.東京理夫、3.名大・赤崎記念研究センター   17:15 - 17:30   休憩/Break   「講演奨励賞受費記念講演」(15分)   MOVPE成果N極性(0001)InGaN多重量子井戸構造と発光ダイオードの構造・光学特性   17:45 - 18:00   類 12p-B1-15   InGaN海膜表面に形成されたピットのCLと不純物との相関   0角谷 正女・豊満 直樹・王 剣字、原 日 善之・大阪工、2.赤崎記念研究センター   1.名大院工、2.赤崎記念研究センター   1.名太大理工、2.名古屋大学・赤崎記念研究センター   2.25 本郷、竹内 哲也・上山 智、赤崎 勇立   1.名太大理工、2.名古屋大学・赤崎記念研究センター   2.25 本郷、竹内 哲也・上山 智・赤崎 勇立   1.名太大理工、2.名古屋大学・赤崎記念研究センター   2.25 本郷、竹内 哲也・上山 智・赤崎 勇立   1.25 表別、 1.25 表別を記述、 1.25 表別、 1.		15:45 - 16:00	12p-B1-9	AlGaN MQW内井戸層組成傾斜による電子線励起深紫外発行強		1.東北大院環境科学
16:30 - 16:45   12p-B1-12   Ga <sub>2</sub> O <sub>3</sub> (-201)基板上AlGaN (0001)エピタキシャル膜の成長   2歳 高京、平山 秀樹 月 <sup>12</sup>   2次 例人、山腰 茂仲   2元		16:00 - 16:15	奨 12p-B1-10		○奥村 宏典¹, 谷保 芳孝¹, 山本 秀樹¹	1.NTT物性基礎研
16:30 - 16:45   12p-B1-12   Ga <sub>2</sub> O <sub>3</sub> (-201)基板上AIGaN (0001)エピタキシャル膜の成長 和幸, 倉文 朝人, 山腰 茂仲   元 秀樹: 山下 佳弘:, 飯塚 和幸, 倉文 朝人, 山腰 茂仲   元 秀樹: 山下 佳弘:, 飯塚 元序 , 倉文 朝人, 山腰 茂仲   元 秀樹: 山下 佳弘:, 飯塚 元序 , 名 大 元 新 秀山   12p-B1-13   深紫外LEDに向けた窒化物半導体トンネル接合の検討   一 八 百也   元 子帝 素顕: 上山 智:, 天野 浩 - 北 赤崎 勇 <sup>13</sup>   九 名城大理工, 2.名古屋大院工, 3.名大・赤崎 勇 <sup>13</sup>   17:00 - 17:15   奨 12p-B1-14   トンネル接合を用いたモノリシック型白色LEDの検討   一 加藤 貴久:, 飯田 大輔: 河合 後介:, 上山 智:, 大野 浩 - 北 赤崎 勇 - 北 元 新 元 十 下 の 横遠・光学特性   17:30 - 17:45   12p-B1-15   「講演奨励賞受賞記念講演」(15分)		16:15 - 16:30	奨 12p-B1-11	高キャリア濃度n型AlGaNの電気的特性		
16:45 - 17:00   12p-B1-13   深紫外LEDに向けた窒化物半導体トンネル接合の検討		16:30 - 16:45	12p-B1-12	$\mathrm{Ga_2O_3}$ (-201) 基板上AlGaN (0001) エピタキシャル膜の成長	○森島 嘉克¹, 平山 秀樹², 山下 佳弘¹, 飯塚	
17:00 - 17:15   奨 12p-B1-14   トンネル接合を用いたモノリシック型白色LEDの検討   〇加藤 貴久!、飯田 大輔:、河合 俊介!、上山 智!、竹内 哲也!、岩谷 素顕!、赤崎 勇!3   記念研究センター   17:15 - 17:30   休憩/Break   日7:30 - 17:45   12p-B1-15   「講演奨励賞受賞記念講演」(15分)		16:45 - 17:00	12p-B1-13	深紫外LEDに向けた窒化物半導体トンネル接合の検討	〇高須賀 大貴', 南川 大智', 井野 匡貴', 竹内 哲也', 岩谷 素顕', 上山 智', 天野 浩	1.名城大理工, 2.名古屋大院工, 3.名大・
17:15 - 17:30   休憩/Break   17:30 - 17:45   12p-B1-15   「講演奨励賞受賞記念講演』(15分)		17:00 - 17:15	奨 12p-B1-14	トンネル接合を用いたモノリシック型白色LEDの検討	○加藤 貴久¹, 飯田 大輔², 河合 俊介¹, 上山	
MOVPE成長N極性(0001)InGaN多重量子井戸構造と発光ダイオ		17:15 - 17:30		休憩/Break		
17:45 - 18:00 獎 12p-B1-16 加圧MOVPE法を用いた(0001)面GaN上InGaN/GaN多重量子井 戸の成長 いた(0001)面GaN上InGaN/GaN多重量子井 戸の成長 いた(0001)面GaN上InGaN/GaN多重量子井 戸の成長 い角谷 正友 <sup>1,4</sup> 、豊満 直樹 <sup>1,2</sup> 、王 剣字 <sup>1</sup> 、原 田 善之 <sup>3</sup> 、Sang Liwen <sup>1</sup> 、関口 隆史 <sup>1</sup> 、山口 智 広 <sup>2</sup> 、本田 徹 <sup>2</sup> 18:15 - 18:30 12p-B1-18 GaN上に作製したGaInN単膜およびGaInN/GaN超格子のX線そ の場観察測定 におっている場でである。 日本 「元本 大学・未崎記念研究センター 「元本 大学・大崎記念研究センター」 18:30 - 18:45 12p-B1-19 デジタル混晶SMART (InN) <sub>1</sub> /(GaN) <sub>4</sub> の低NH <sub>3</sub> 分圧MOVPEプロ で 「京がタル混晶SMART (InN) <sub>1</sub> /(GaN) <sub>4</sub> の低NH <sub>3</sub> 分圧MOVPEプロ で 「京がタル混晶SMART (InN) <sub>1</sub> /(GaN) <sub>4</sub> の低NH <sub>3</sub> 分圧MOVPEプロ で 「全本 「発力・計画をは、 「企業 一大で、 大学、 大学、 大学、 大学、 大学、 大学、 大学、 大学、 大学、 大学	招待	17:30 - 17:45	12p-B1-15	MOVPE成長N極性(0001)InGaN多重量子井戸構造と発光ダイオ	村 健司1.2, 窪谷 茂幸1, 花田 貴1.2, 片山 竜二	1.東北大金研, 2.JST, CREST
18:00 - 18:15   12p-B1-17   InGaN薄膜表面に形成されたビットのCLと不純物との相関		17:45 - 18:00	奨 12p-B1-16	加圧MOVPE法を用いた(0001)面GaN上InGaN/GaN多重量子井	○田村 彰¹, 山本 哲也¹, 本田 善央¹, 天	1.名大院工, 2.赤﨑記念研究センター
18:15 - 18:30 12p-B1-18		18:00 - 18:15	12p-B1-17		○角谷 正友 <sup>1,4</sup> , 豊満 直樹 <sup>1,2</sup> , 王 剣宇 <sup>1</sup> , 原 田 善之 <sup>3</sup> , Sang Liwen <sup>1</sup> , 関口 隆史 <sup>1</sup> , 山口 智	
18:30 - 18:45 12p-B1-19 デジタル混晶SMART $(InN)_1/(GaN)_4$ の低NH $_3$ 分圧MOVPEプロセス 0草部 一秀 $^1$ 、吉川 明彦 $^{12}$ 1.千葉大C-SGIR, 2.工学院大18:45 - 19:00 契 12p-B1-20 N極性 $(000\overline{1})$ GaNのMOVPE選択成長における貫通転位密度の低減 7途坂 崇 $^1$ 、谷川 智之 $^{12}$ 、木村 健司 $^{12}$ 、正直花奈子 $^1$ 、窪谷 茂幸 $^{12}$ 、片山 竜二 $^{12}$ 、大院工大党に		18:15 - 18:30	12p-B1-18		○(B)大角 純也¹, 石原 耕史¹, 山本 泰司¹,	
18:45 - 19:00 奨 12p-B1-20 N極性(000Ī)GaNのMOVPE選択成長における貫通転位密度の低減 ○逢坂 崇!, 谷川 智之 <sup>12</sup> , 木村 健司 <sup>12</sup> , 正直 花奈子!, 窪谷 茂幸 <sup>12</sup> , 片山 竜二 <sup>12</sup> , 松岡 隆 大院エ		18:30 - 18:45	12p-B1-19	デジタル混晶SMART (InN) <sub>1</sub> /(GaN) <sub>4</sub> の低NH <sub>3</sub> 分圧MOVPEプロ		
		18:45 - 19:00	奨 12p-B1-20		花奈子1, 窪谷 茂幸1.2, 片山 竜二1.2, 松岡 隆	

19:00 - 19:15	12p-B1-21	±c面GaNの表面熱的安定性に関する研究	○岡田 俊祐¹, 三宅 秀人¹, 平松 和政¹, 逢坂崇², 谷川 智之², 松岡 隆志²	1.三重大院·工, 2.東北大·金研
19:15 - 19:30	12p-B1-22	サファイア基板上に低温成長したGaNバッファ層のTEM評価	○松原 徹 <sup>1.2</sup> , 杉本 浩平¹, 岡田 成仁¹, 只 友 一行¹	1.山口大院理工, 2.UBE科学分析センター
19:30 - 19:45	12p-B1-23	減圧CVDで成長した六方晶窒化ホウ素薄膜の深紫外発光特性の 向上	○梅原 直己¹, 增田 敦¹, 清水 乙生², 光野 徹也¹, 小南 裕子¹, 原 和彦³.⁴	1.静岡大院工, 2.静岡大工, 3.静岡大創 造大院, 4.静岡大電子研

月12日	(木) 16:00 - 18:0	00		
	12p-P16-1	六角形状GaNマイクロディスクからのレーザ光放射特性の検討	○光野 徹也¹, 鈴木 翔¹, 酒井 優², 岸野 克 巳³, 原 和彦¹	1.静岡大学, 2.山梨大学, 3.上智
	12p-P16-2	準安定相窒化ホウ素(w-BN)の電子状態計算	○太田 優一¹, 時田 幸一¹, 渡辺 洋人¹	1.都産技研
	12p-P16-3	GaN両極性同時成長におけるV/III比依存性の検討	○久瀬 健太¹, 井上 翼¹, 中野 貴之¹	1.静大院工
	12p-P16-4	MOCVDによるGaN基板上への低C不純物濃度のGaN単膜成長	〇朴 冠錫 <sup>12</sup> , 池永 和正 <sup>1</sup> , 矢野 良樹 <sup>1</sup> , 德 永 裕樹 <sup>1</sup> , 三嶋 晃 <sup>2</sup> , 伴 雄三郎 <sup>2</sup> , 田渕 俊也 <sup>1</sup> , 松本 功 <sup>1</sup>	1.大陽日酸(株), 2.大陽日酸CSE
	奨·E 12p-P16-5	Low-Temperature Growth of InN Films on Si(111) Substrates by Radical-Enhanced Metal-Organic Chemical Vapor Deposition	○(PC)Yi Lu¹, Osamu Oda¹, Kazuki Iwamoto¹, Hiroki Kondo¹, Kenji Ishikawa¹, Makoto Sekine¹, Masaru Hori¹	1.Nagoya University
	12p-P16-6	GaN(0001)面上の高In組成InGaN成長のレーザその場観察	○(B)山本 哲也 <sup>1,2</sup> , 田村 彰 <sup>1,2</sup> , 本田 善央 <sup>1,2</sup> , 天野 浩 <sup>1,2</sup>	1.名大工, 2.赤崎記念センター
	12p-P16-7	RF-MBE法を用いてAIONバッファー層上に成長したAINの転位密度	○畑 泰希¹, 山﨑 隆弘¹, 山根 悠介¹, 前田 理也¹, 熊倉 一英², 山本 秀樹², 牧本 俊樹¹	1.早大先進理工, 2.NTT物性基
	12p-P16-8	RF-MBE法による窒化サファイア基板上アルミニウム薄膜成長	○(B)星川 侑也¹, 大澤 真弥¹, 松本 雄大¹, 山口 智広¹, 尾沼 猛儀¹², 本田 徹¹	1.工学院大, 2.東京高専
	12p-P16-9	4H-SiC(0001)微傾斜基板を用いたInNドット配列の自己形成	○森 誠也¹, 高宮 健吾¹, 折原 操¹, 八木 修 平¹, 土方 泰人¹, 矢口 裕之¹	1.埼玉大院理工
	12p-P16-10	膜厚制御メサ加工基板を用いた電流制御型液相成長によるGaN横 方向成長	〇岩川 宗樹!, 高倉 宏幸!, 冨田 将史!, 神林 大介!, 安井 亮太!, 水野 陽介', 丸山 隆浩!, 成塚 重弥!	1.名城大理工
	12p-P16-11	GaNの水素雰囲気熱エッチングにより作製したAlGaNベースマイクロディスク微小光共振器	○鈴木 翔¹, 光野 徹也¹, 菊池 昭彦², 酒井 優³, 岸野 克巳², 原 和彦¹	1.静岡大工, 2.上智大理工, 3.山 医工
	12p-P16-12	GaN-SBDの定常状態における高分解光容量測定	○出来 真斗¹, 大内 朋也¹, 本田 善央¹, 天 野 浩¹	1.名古屋大
	12p-P16-13	InGaN 薄膜の分光CL マッピング像の温度依存性評価	○倉井 聡¹, 若松 歩¹, 山田 陽一¹	1.山口大院·理工
	12p-P16-14	バイアス印加光電流およびバイアス印加PL測定によるLED評価	○(M1)宇佐美 茂佳¹², 天野 浩¹², 本田 善 央¹²	1.名大院工, 2.赤﨑記念研究セン
	12p-P16-15	焼結法による炭化タンタル被覆黒鉛材 ~バルク成長・エビ成膜用の 高耐久・高信頼性保護コーティング~	○中村 大輔¹, 鈴村 彰敏¹, 重藤 啓輔¹	1.豊田中研
	12p-P16-16	深紫外LEDにおける超格子p型AlGaN透明コンタクト層のホール拡 散効果	○前田 哲利¹, 定 昌史¹, 平山 秀樹¹	1.理研
	12p-P16-17	スパッタ法によるZnOテンプレート上へのInN層の成長	○(M2)多田 晓由!, 小橋 勇希!, 福井 迪¹, 神田 赳志', 水野 愛!, 篠田 宏之!, 六倉 信喜¹	1.東京電機大工
	12p-P16-18	スパッタ法によるGaNテンプレート上へのInN層の成長	○(M2)福井 迪¹, 小橋 勇希¹, 多田 暁由 ¹, 神田 赳志¹, 水野 愛¹, 篠田 宏之¹, 六 倉 信喜¹	1.東京電機大工
	12p-P16-19	反応性プラズマ支援成膜法により形成したBN 膜の粘弾性と密着性	○野間 正男¹, 山下 満², 江利口 浩二³, 長谷川 繁彦⁴	1.神港精機株式会社, 2.兵庫県立 術センター, 3.京大院工, 4.阪大阪

15.4	III-V族窒化	物結晶 / III-V-	group nitride crystals		
	3月13日(金	) 8:30 - 13:0	0		
	8:30 - 8:45	奨 13a-B1-1	GaNの欠陥によるレーザー誘起THz放射振幅の増強	○酒井 裕司¹, 川山 巌¹, 中西 英俊², 斗 内 政吉¹	1.阪大レーザー研, 2.SCREENホール ディングス
	8:45 - 9:00	13a-B1-2	表面プラズモン共鳴のナノ構造と屈折率の依存性の検討	○丹羽 一将¹, 加藤 貴久¹, 河合 俊介¹, 飯田 大輔², 上山 智¹, 竹內 哲也¹, 岩谷 素顕¹, 赤崎 勇¹³	1.名城大理工, 2.東京理大, 3.名大・赤崎 記念研究センター
	9:00 - 9:15	奨 13a-B1-3	フリップチップ加工による低熱抵抗規則配列ナノコラムLED	○林 宏晓¹, 福島 大史¹, 野間 友博¹, 水野真¹, 今野 裕太¹, 岸野 克巳¹	1.上智大
	9:15 - 9:30	13a-B1-4	スパッタAIN上規則配列ナノコラムLEDのフリップチップ加工	○野間 友博¹, 林 宏暁¹, 福島 大史¹, 野村一郎¹, 岸野 克巳¹	1.上智大理工
	9:30 - 9:45	E 13a-B1-5	Nitrogen Excess Pressure Annealing of Gallium Nitride using a Novel Heat-Beam Method	○(M1)NADIA NURSYAFIQAH¹, YUJI AWANO¹	1.KEIO UNIV.
	9:45 - 10:00	奨 13a-B1-6	高AI組成のn-AIGaNにおけるV系電極のコンタクト特性	○森 一喜', 武田 邦宏', 草深 敏匡', 岩谷 素顕', 上山 智', 竹内 哲也', 赤崎 勇 1², 天野 浩³	1.名城大理工, 2.赤崎記念研究センター, 3.名古屋大院工
	10:00 - 10:15	13a-B1-7	高性能近紫外LEDの作製に関する検討	○弦間 彩花¹, 河合 俊介¹, 岩谷 素顕¹, 竹内 哲也¹, 上山 智¹, 赤崎 勇¹²	1.名城大理工, 2.名大赤崎研究記念センター
	10:15 - 10:30	奨 13a-B1-8	SiO <sub>3</sub> ナノ周期構造を有する基板上に作製した窒化物系青色LEDの 発光特性	○花井 駿¹, 北野 司¹, 岩谷 素顕¹, 竹内 哲也¹, 上山 智¹, 赤崎 勇¹²	1.名城大学 理工, 2.名古屋大学赤崎記 念研究センター
	10:30 - 10:45		休憩/Break		
招待	10:45 - 11:00	13a-B1-9	「講演奨励賞受賞記念講演」(15分) (001)Si基板上(1-101)InGaNストライプ光共振器の誘導放出特	〇久志本 真希1, 本田 善央1, 天野 浩1,2	1.名大院工, 2.赤崎記念研究センター
	11:00 - 11:15	13a-B1-10	Si / SiO <sub>2</sub> / GaN系LED基板上への微小LEDの作製	○土山 和晃¹, 宇都宮 脩¹, 山根 啓補¹, 関口 寛人¹, 岡田 浩¹², 若原 昭浩¹	1.豊技大工, 2.豊技大エレクトロニクス先 端融合研究所
	11:15 - 11:30	13a-B1-11	InGaN光電極を用いた水からの水素生成	○植竹 勇介¹, 荻田 太郎¹, 飯田 大輔¹, パト リック ジネ², 大川 和宏¹	1.東京理科大理, 2.エア・リキード・ラボ ラトリーズ
	11:30 - 11:45	13a-B1-12	InGaN量子井戸を用いた青色発光トランジスタの電気的・光学的特性	○西中 淳一¹, 熊倉 一英¹, 山本 秀樹¹	1.NTT物性研

	11:45 - 12:00	13a-B1-13	窒化物半導体発光トランジスタの光出力周波数特性	○熊倉 一英¹, 西中 淳一¹, 山本 秀樹¹	1.NTT物性研
	12:00 - 12:15	奨 13a-B1-14	フーリエ分光法による位置制御GaNナノワイヤ量子ドットにおけるスペクトル拡散の評価	○HOLMES Mark¹, 加古 敏², 崔 琦鉉¹, 有 田 宗貴¹, 荒川 泰彦¹²	1.東大ナノ量子機構, 2.東大生研
	12:15 - 12:30	13a-B1-15	GaN/AlGaN界面ゆらぎ量子ドットの構造評価	○有田 宗貴¹, 壹岐 太一², 荒川 泰彦¹.²	1.東大ナノ量子機構, 2.東大生産研
	12:30 - 12:45	E 13a-B1-16	High-Q AlGaN photonic crystal nanocavities for coupling with fluctuation GaN QDs	OSylvain Sergent¹, Munetaka Arita¹, Satoshi Kako², Taichi Iki¹, Satoshi Iwamoto¹², Yasuhiko Arakawa¹²	1.Nanoquine, Univ. of Tokyo, 2.IIS, Univ. of Tokyo
	12:45 - 13:00	13a-B1-17	AlGaN 薄膜中における局在中心の励起子分子発光の観測	○壹岐 太一 <sup>1</sup> , 有田 宗貴 <sup>2</sup> , 加古 敏 <sup>1,2</sup> , 荒 川 泰彦 <sup>1,2</sup>	1.東大生研, 2.東大ナノ量子
	3月13日(金)	16:15 - 18:	00		
招待	16:15 - 16:30	13p-B1-1	「講演奨励賞受賞記念講演」(15分) 位置制御GaNナノワイヤ量子ドットの巨大励起子分子束縛エネル ギー	Oチェ ギヒョン <sup>1</sup> , ホームズ マーク <sup>1</sup> , 加古 敏 <sup>2</sup> , 有田 宗貴 <sup>1</sup> , 荒川 泰彦 <sup>1,2</sup>	1.東大ナノ量子機構, 2.東大生研
	16:30 - 16:45	E 13p-B1-2	Momentum Space Spectroscopy of AlGaN/Air DBR Microcavities	ORenchun Tao <sup>1</sup> , Munetaka Arita <sup>2</sup> , Satoshi Kako <sup>1</sup> , Kenji Kamide <sup>2</sup> , Yasuhiko Arakawa <sup>1,2</sup>	1.IIS., Univ. of Tokyo, 2.NanoQuine., Univ. of Tokyo
	16:45 - 17:00	13p-B1-3	グラフェンを用いた窒化物ナノコラムの結晶成長	○今野 裕太¹, 林 宏暁¹, 岸野 克己¹	1.上智大理工
	17:00 - 17:15	奨 13p-B1-4	水素雰囲気異方性熱エッチング(HEATE)法によるInGaN/GaN多重量子井戸ナノ構造の作製	○水谷 友哉¹, 蜂屋 諒¹, 古橋 洋樹¹, 喜多諒¹, 菊池 昭彦¹²	1.上智大, 2.上智ナノテクセンター
	17:15 - 17:30	13p-B1-5	窒化物半導体における貫通転位近傍での原子偏析に関する理論 的研究	○坂口 涼平¹, 秋山 亨¹, 中村 浩次¹, 伊藤 智徳¹	1.三重大院工
	17:30 - 17:45	13p-B1-6	X線マイクロビームによるGaN基板上InGaN系デバイスの評価	○横川 俊哉¹, 栫 拓也¹, 今井 康彦², 木 村 滋²	1.山口大工, 2.JASRI
	17:45 - 18:00	奨 13p-B1-7	Siサブ波長回折格子/SiO₂膜/LED構造を有する窒化物系偏光LED	○高島 祐介¹, 田邉 聖人¹, 清水 亮¹, 原口 雅宣¹², 直井 美貴¹²	1.徳島大ATS, 2.徳島大STS

		Group IV crystals and alloys	<b>万</b> 万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万	
3月11日(水		-		
9:00 - 9:15	奨 11a-D7-1	GGA+U 法による Si <sub>1-x</sub> Sn <sub>x</sub> 材料物性の精密予測	○長江 祐樹¹, 黒澤 昌志¹², 加藤 元太¹, 柴 山 茂久¹³, 中塚 理¹, 財満 鎭明¹⁴	1.名大院工, 2.学振PD, 3.学振DC, 4. 大エコトピア
9:15 - 9:30	11a-D7-2	太陽電池用GeSnC混晶系の原子配置に関する第一原理解析	○(M2)松谷 亮¹, 末岡 浩治¹, 神山 栄治¹², 泉妻 宏治², 鹿島 一日児², 中塚 理³	1.岡山県大院情報系工, 2.グローバル! ェーハズ, 3.名大院工
9:30 - 9:45	11a-D7-3	太陽電池用GeSiSn混晶系のバンドギャップに関する第一原理計算	○(M2)須和 亮¹, 末岡 浩治¹, 神山 栄治¹², 泉妻 宏治², 鹿島 一日児², 中塚 理³	1.岡山県大院情報系工, 2.グローバル・ ェーハズジャパン, 3.名大院工
9:45 - 10:00	奨 11a-D7-4	$\mathrm{Ge}_{\mathrm{1}_{\mathrm{xsy}}}\mathrm{Si}_{\mathrm{x}}\mathrm{Sn}_{\mathrm{y}}/\mathrm{Ge}$ 个テロ構造におけるエネルギーバンド構造の解明	○山羽 隆¹, 加藤 公彦¹, 柴山 茂久¹², 浅野 孝典¹², 坂下 満男¹, 中塚 理¹, 財満 鎭明¹³	1.名大院工, 2.学振特別研究員, 3.名プエコトピア
10:00 - 10:15	11a-D7-5	GeSn薄膜形成におけるSn析出の挙動	○塚本 貴広¹, 広瀬 信光², 笠松 章史², 三村 高志², 松井 敏明², 須田 良幸¹	1.東京農工大院工, 2.情報通信研究機
10:15 - 10:30	11a-D7-6	固相成長法による高SnC組成 $Ge_{1-xy}$ Sn $_xC_y$ 三元混晶薄膜の形成および結晶構造評価	○小田 裕貴¹, 山羽 隆¹, 黒澤 昌志¹², 竹内 和歌奈¹, 坂下 満男¹, 中塚 理¹, 財満 鎖明¹³	1.名大院工, 2.学振特別研究員, 3.名フェコトピア
10:30 - 10:45		休憩/Break		
10:45 - 11:00	奨 11a-D7-7	MOCVD法によるGe基板上でのGe $_{1,2}$ Sn $_x$ エビタキシャル成長 (2)	○須田 耕平¹, 木嶋 隆浩¹, 石原 聖也¹, 澤本 直美¹, 町田 英明², 石川 真人², 須藤 弘², 大 下 祥雄³, 小椋 厚志¹	1.明治大, 2.気相成長, 3.豊田工大
11:00 - 11:15	11a-D7-8	$\mathrm{Ge}_{\mathrm{l}_x}\mathrm{Sn}_{\mathrm{x}}$ エビタキシャル層中の電気的活性な欠陥の挙動	○竹內 和歌奈¹, 浅野 孝典¹², 坂下 満男¹, 中塚 理¹, 財満 鎖明¹.³	1.名大院工, 2.学振特別研究員, 3.名フェコトピア
11:15 - 11:30	11a-D7-9	原子状水素供給が $Ge_{l-x}Sn_x$ エピタキシャル層の結晶性に及ぼす効果	○藤浪 俊介¹, 浅野 孝典¹², 保崎 航也¹, 小山 剛史¹, 中塚 理¹, 岸田 英夫¹, 財満 鎭明¹³	1.名古屋大院工, 2.学振(DC), 3.名古 大エコトピア
11:30 - 11:45	奨 11a-D7-10	$Ge_{l_{-x}}Sn_x$ エピタキシャル層中の欠陥の電気的特性	○浅野 孝典 <sup>1,2</sup> , 柴山 茂久 <sup>1,2</sup> , 竹内 和歌奈 <sup>1</sup> , 坂下 満男 <sup>1</sup> , 中塚 理 <sup>1</sup> , 財満 鎭明 <sup>1,3</sup>	1.名大院工, 2.学振DC, 3.エコトピア科 学研究所
11:45 - 12:00	11a-D7-11	熱電素子応用を目指したGeSn単結晶薄膜の熱物性評価	○黒澤 昌志1², 福田 雅大¹, 高橋 恒太¹, 坂 下 満男¹, 中塚 理¹, 財満 鎖明1³	1.名大院工, 2.学振PD, 3.名大エコト
3月11日(水	3) 13:30 - 17	:15		
13:30 - 13:45	11p-D7-1	絶縁基板上におけるGeSnの極低温固相成長 -高Sn濃度GeSnの 形成-	○松村 亮¹², 佐々木 雅也¹, 知北 大典¹, 甲 斐 友樹¹, 佐道 泰造¹, 宮尾 正信¹	1.九大院システム情報, 2.学振特別研 究員
13:45 - 14:00	11p-D7-2	GeSn/ 絶縁基板の極低温種付け横方向固相成長法(1)-種付け効果に与えるアイランド構造の影響 -	○甲斐 友樹¹, 知北 大典¹, 松村 亮¹², 佐道 泰造¹, 宮尾 正信¹	1.九大院システム情報, 2.学振特別研 究員
14:00 - 14:15	奨 11p-D7-3	GeSn/ 絶縁基板の極低温種付け横方向固相成長法 (2) -Sn 濃度の横方向 分布 -	○甲斐 友樹¹, 知北 大典¹, 松村 亮¹², 佐道 泰造¹, 宮尾 正信¹	1.九大院システム情報, 2.学振特別研 究員
14:15 - 14:30	11p-D7-4	GeSn/絶縁基板の極低温種付け横方向固相成長法(3) - パルスレーザーアニール・シーディングの検討-	○松村 亮¹², 知北 大典¹, 佐道 泰造¹, 池上 浩¹, 宮尾 正信¹	1.九大院システム情報, 2.学振特別研 究員
14:30 - 14:45	奨 11p-D7-5	非晶質基板上ゲルマニウム薄膜の(111)面配向結晶化におけるレーザーアニール条件の検討	○高尾 透¹, 堀田 昌宏¹, 仁枝 嘉昭¹, 石河 泰明¹, 浦岡 行治¹	1.奈良先端大
14:45 - 15:00	奨 11p-D7-6	レーザーアニールによるGe薄膜結晶化の熱拡散シミュレーション	○仁枝 嘉昭', 堀田 昌宏', 高尾 透', 石河 泰明', 浦岡 行治'	1.奈良先端大
15:00 - 15:15	11p-D7-7	非晶質SiおよびGe膜のFLA結晶化時の原子の振る舞いの差異	○松尾 直人¹, 平野 翔大¹, 部家 彰¹, 中村 祥章², 横森 岳彦², 吉岡 正樹²	1.兵庫県立大工, 2.ウシオ電機(株)
15:15 - 15:30		休憩/Break		
15:30 - 15:45	11p-D7-8	フレキシブル基板上への擬似単結晶Ge薄膜の形成	○東 英実¹, 笠原 健司², 工藤 康平³, 岡本 隼人³, 茂藤 健太³, バク ジョンヒョク², 山 田 晋也¹, 金島 岳¹, 宮尾 正信², 角田 功³, 浜屋 宏平¹	1.阪大基礎工, 2.九大シス情, 3.熊本高専
15:45 - 16:00	11p-D7-9	金誘起層交換成長法で作成した擬似単結晶Geの電気伝導特性		1.阪大基礎工, 2.九大シス情
16:00 - 16:15	11p-D7-10	300°C以下プロセスで作製した結晶性GeチャネルTFT	○笠原 健司¹, 永冨 雄太², 山本 圭介², 東 英実³, 中野 茉莉央', 山田 晋也³, 金島 岳³, 中島 寛², 浜屋 宏平³	1.九大シス情, 2.九大産学連携センタ 3.阪大基礎工
16:15 - 16:30	11p-D7-11	ガラス上Ge薄膜のAl誘起成長におけるSn添加効果	○(M1)大谷 直生¹, 都甲 薫¹, 末益 崇¹	1.筑波大院数理物質
16:30 - 16:45	11p-D7-12	Ge(111)薄膜を利用したガラス上Geナノワイヤの均一合成	○(B)中田 充紀¹, 都甲 薫¹, Jevasuwan Wipakorn², 深田 直樹², 末益 崇¹	1.筑波大院 数理物質, 2.物材機構

16:45 - 17:00	11p-D7-13	非晶質Ge薄膜のAu誘起成長に及ぼす熱処理温度の影響	○工藤 康平 <sup>1</sup> , 野満 建至 <sup>1</sup> , 岡本 隼人 <sup>1</sup> , 高倉 健一郎 <sup>1</sup> , 角田 功 <sup>1</sup>	1.熊本高等専門学校
17:00 - 17:15	11p-D7-14	圧縮応力を印加した非晶質Ge薄膜のAu誘起成長	○工藤 和樹', 酒井 崇嗣', 草野 欽太', 本山 慎一², 楠田 豊², 古田 真浩², 中 庸行³, 沼田 朋子³, 高倉 健一郎', 角田 功'	1.熊本高等専門学校, 2.サムコ, 3.堀 場製作所
3月12日(木)	10:00 - 12:0	00		
10:00 - 10:15	12a-D5-1	アモルファスGe上のサブ原子層カーボンの熱処理を用いたSi(100)基板上のGe薄膜形成	○青山 拓磨¹, 伊藤 友樹², 畠山 真慈², 川島 知之¹², 鷲尾 勝由¹²	1.東北大工, 2.東北大院工
10:15 - 10:30	奨 12a-D5-2	C/Ge/Si(100)構造におけるサブ原子層カーボンとGe成長温度のGe 薄膜形成への影響	○(M2)伊藤 友樹¹, 畠山 真慈¹, 川島 知之¹, 鷲尾 勝由¹	1.東北大院工
10:30 - 10:45	12a-D5-3	サブ原子層カーボンを用いたGeドットのSi-C結合形成温度依存性に 関する検討	〇佐藤 佑紀¹, 伊藤 友樹¹, 川島 知之¹, 鷲 尾 勝由¹	1.東北大院工
10:45 - 11:00	12a-D5-4	$Ar$ イオン注入法を用いた圧縮歪み $Si$ /緩和 $Si_{1x}C_x$ へテロ構造の作製	○有澤 洋 <sup>1</sup> , 星 裕介 <sup>1</sup> , 藤原 幸亮 <sup>2</sup> , 山中 淳 二 <sup>2</sup> , 有元 圭介 <sup>2</sup> , 中川 清和 <sup>2</sup> , 澤野 憲太郎 <sup>3</sup> , 字佐美 徳隆 <sup>1</sup>	1.名大院工, 2.山梨大クリスタル研, 3.都 市大総研
11:00 - 11:15	奨 12a-D5-5	n-GeへのPデルタドービングにおけるSi挿入によるその偏析抑制効果	○山田 道洋¹, 澤野 憲太郎², 植松 真司¹, 伊藤 公平¹	1.慶大理工, 2.都市大
11:15 - 11:30	12a-D5-6	MBEを用いたSi(100)上2段階Ge薄膜成長における表面平坦化条件の検討	○早瀬 凌¹, 伊藤 友樹¹, 川島 知之¹, 鷲 尾 勝由¹	1.東北大院工
11:30 - 11:45	12a-D5-7	2段階成長単結晶Ge層の結晶性及び光学特性評価	〇小田 克矢¹, 奥村 忠嗣¹, 葛西 淳一¹, 井 $\overline{P}$ 立身¹	1.日立中研
11:45 - 12:00	12a-D5-8	極薄Al <sub>2</sub> O <sub>2</sub> /SiO <sub>2</sub> BOX層を有する貼り合わせGeOI基板の熱処理による電気特性改善	○吉田 啓資¹, 中村 芳明¹, 竹内 正太郎¹, 守山 佳彦¹², 手塚 勉², 酒井 朗¹	1.阪大院基礎工, 2.産総研グリーンナノエ レクトロニクスセンター

15.5 IV族結晶	ı, IV-IV族混晶 /	Group IV crystals and alloys ポスタ	!一講演					
3月12日	3月12日(木) 16:00 - 18:00							
	12p-P17-1	金内包キノコ型ナノ構造ゲルマニウム	○青野 祐美¹, 阿部 洋¹, 宮﨑 尚¹	1.防大材料				
	12p-P17-2	高空間分解能HXPESとXPSによる歪み及び組成がSiGe価電子帯に 与える影響の検出	○山堀 俊太¹, 笹子 知弥¹, 米倉 瑛介¹, 澤野 憲太郎¹, 池永 英司², 野平 博司¹	1.東京都市大工, 2.高輝度光科学研究センター				
	12p-P17-3	イオン注入成長法で作製した圧縮歪みSi/Si $_{1x}$ C $_x$ /Si(001)構造MOSFETの電気特性評価	○中込 諒', 酒井 翔一朗', 藤原 幸亮', 有元 圭介', 山中 淳二', 中川 清和', 宇佐美 徳隆 ², 星 裕介², 澤野 憲太郎³	1.山梨大クリスタル研, 2.名古屋大学, 3.東京都市大総研				
	12p-P17-4	伸張歪みSi/緩和SiGe/Si(110)の表面モフォロジーへの成長速度の影響	○宇津山 直人¹, 佐藤 圭¹, 有元 圭介¹, 山中 淳二¹, 中川 清和¹, 宇佐美 徳隆², 澤野 憲太郎³	1.山梨大クリスタル研, 2.名古屋大, 3.東京都市大総研				
	12p-P17-5	歪みSi/Si1-xCx/Si(001)ヘテロ構造の結晶性と不純物活性化過程 との関係	○藤原 幸亮!, 酒井 翔一朗!, 小林 昭太!, 有元 圭介!, 山中 淳二!, 中川 清和!, 宇佐美徳隆², 星 裕介², 澤野 憲太郎³	1.山梨大学クリスタル研, 2.名古屋大学, 3.東京都市大総研				
	12p-P17-6	RFマグネトロンスパッタリング法により作製した $Si_xC_{1x}$ 混晶薄膜の光学的・構造的特性	○(M1)楠木 厚毅¹, 原 広紀¹, 勝俣 裕¹	1.明大理工				
	12p-P17-7	Pのin-situドーピングにより作製したn型GOIの電気伝導特性	○勝俣 洋典¹, 長嶋 智典¹, 浜屋 宏平², 澤野 憲太郎¹	1.東京都市大工, 2.阪大基礎工				

15.6 IV族	系化合物 / Group IV	Compound Semiconductors ポスタ	ター講演	
3月1	11日(水) 13:30 - 15:	30		
	11p-P2-1	溶剤添加SiC溶液成長における炭素溶解度測定と溶剤混入量の評価	○日根 賢人¹, 太子 敏則²	1.信大工, 2.信大環境エネ研
	11p-P2-2	SiC溶液成長における自発形成二次元核の4H多形安定性	花房 絢乃¹, 樋口 雅之¹, ○芦田 晃嗣¹, 久津間 保徳¹, 金子 忠昭¹	1. 関学大理工
	11p-P2-3	SiC単結晶成長における溶液ドリフトと結晶形態	○(M1)加藤 貴士¹, 亀井 一人¹², 楠 一彦², 関 和明²	1.東北大院, 2.新日鐵住金
	11p-P2-4	自然酸化膜付Si基板上へのモノメチルシランを用いたSiC薄膜高速成長(II)	○山田 晋平¹, 成田 克¹, 中島 健介¹, 内藤 正路², 末光 眞希³	1.山形大工, 2.九工大院生命体工, 3.東 北大通研
	11p-P2-5	レーザーアブレーションによるSiCナノ微粒子の作製	○椿山 亮太¹, 黒葛原 愛美¹, 宮島 顕祐¹	1.東理大理
	11p-P2-6	ミラー電子顕微鏡およびSEM,FIB-STEMによるナノヒロック対構造 の観察	○一色 俊之 <sup>1</sup> , 生頼 義久 <sup>2</sup> , 佐藤 高広 <sup>2</sup> , 福井 宗利 <sup>2</sup>	1.京都工繊大, 2.日立ハイテク
	11p-P2-7	4H-SiCの拡張転位の電子顕微鏡解析	○佐藤 高広¹, 大津 喜宏², 生頼 義久¹, 一色 俊之³, 福井 宗利¹	1.日立ハイテクノロジーズ, 2.日立ハイ テクマニファクチャ&サービス, 3.京都工 芸繊維大学
	11p-P2-8	原子ステップ誘起による自己組織化単分子膜の規則配列	○田中 弥生¹, 神田 隆生², 江龍 修¹	1.名工大院, 2.ポバール興業㈱
	11p-P2-9	SiC/SiO <sub>2</sub> 界面における窒素化学状態の結晶面方位依存性	○森 大輔¹, 井上 慧¹, 寺西 秀明¹, 瀧川 亜 樹¹, 広瀬 隆之¹	1.富士電機株式会社
	11p-P2-10	4H-SiC熱酸化膜への水分子吸着の影響	○佐藤 旦¹, 黒木 伸一郎¹, 石川 誠治², 前田 知徳², 瀬崎 洋², 吉川 公麿¹	1.広島大学ナノデバイス, 2.フェニテッ クセミコン
	11p-P2-11	高温下ガンマ線照射したSiC MOSFETの耐放射線性評価	〇松田 拓磨 <sup>1,2</sup> , 横関 貴史 <sup>1,2</sup> , 三友 啓 <sup>1,2</sup> , 村田 航一 <sup>1,2</sup> , 牧野 高紘 <sup>2</sup> , 阿部 浩之 <sup>2</sup> , 小野田 忍 <sup>2</sup> , 大久保 秀一 <sup>3</sup> , 田中 雄季 <sup>3</sup> , 神取 幹郎 <sup>3</sup> , 吉江 徹 <sup>3</sup> , 大島 武 <sup>2</sup> , 土方 泰斗 <sup>1</sup>	1.埼玉大学, 2.日本原子力機構, 3.サンケン電気
	11p-P2-12	SiC-MOSFETへのガンマ線照射効果の酸化膜作製プロセスによる違い	○三友 啓 <sup>12</sup> , 松田 拓磨 <sup>12</sup> , 村田 航一 <sup>12</sup> , 横 関 貴史 <sup>12</sup> , 牧野 高紘 <sup>2</sup> , 阿部 浩之 <sup>2</sup> , 小野田 忍 <sup>2</sup> , 大島 武 <sup>2</sup> , 大久保 秀一 <sup>3</sup> , 田中 雄季 <sup>3</sup> , 神 取 幹朗 <sup>3</sup> , 吉江 徹 <sup>3</sup> , 土方 泰斗 <sup>1</sup>	1.埼玉大学, 2.日本原子力機構, 3.サンケン電気
	11p-P2-13	部分的アモルファス化によるSiC/金属オーミック抵抗の低減とそのメ カニズム	○(M2)ミランタ デシルワ¹, 黒木 伸一郎¹, 石川 誠治¹², 前田 知徳¹², 瀬崎 洋¹², 吉川 公麿¹	1.広大 RNBS, 2.フェニテック
	11p-P2-14	レーザアニールを用いたp型4H-SiCへのオーミックコンタクト形成	○中西 洋介¹, 岡部 博明¹, 中村 勇¹, 田口健介¹, 須賀原 和之¹, 冨田 信之¹, 山川 聡¹	1.三菱電機 先端総研
	奨 11p-P2-15	SAB法による4H-SiC/Si HBT構造における少数キャリア注入特性	○(B)清水 彩絵¹, 西田 将太¹, 梁 剣波¹, 森 本 雅史¹, 重川 直輝¹, 新井 学²	1.大阪市大工, 2.新日本無線(株)

3月12日(太)	9:00 - 11:4	.5		
9:00 - 9:15	12a-B4-1	4H-SiC溶液成長におけるSiCrAl溶媒へのSn微量添加効果	○小松 直佳¹, 三谷 武志¹², 高橋 徹夫¹², 加藤 智久¹², 宇治原 徹³, 松本 祐司³, 藏重 和央¹³, 奧村 元¹²	1.FUPET, 2.AIST, 3.名古屋大学, 4.東 北大学, 5.日立化成
9:15 - 9:30	12a-B4-2	SiC溶液成長における貫通転位変換と成長表面のマクロステップの 関係	○原田 俊太¹, 肖 世玉¹, 青柳 健大¹, 村山 健太¹, 酒井 武信¹, 田川 美穂¹, 宇治原 徹¹	1.名大院工
9:30 - 9:45	12a-B4-3	横型CVD装置を用いたSiCエビ膜成長における界面転位の発生と 抑制	○工藤 千秋 <sup>1,2</sup> , 升本 恵子 <sup>1,5</sup> , 浅水 啓州 <sup>1,3</sup> , 田村 謙太郎 <sup>1,3</sup> , 西尾 譲司 <sup>1,4</sup> , 児島 一聡 <sup>1,5</sup> , 大野 俊之 <sup>1,6</sup>	1.FUPET, 2.バナソニック, 3.ローム, 4. 芝, 5.産総研, 6.日立
9:45 - 10:00	12a-B4-4	微傾斜4H-SiC(0001)表面ナノ構造の周期化距離のオフ角度依存性	○福間 洸平¹, 高崎 友也¹, 梶原 隆司¹, アントン ビシコフスキー¹, 田中 悟¹	1.九大院工
10:00 - 10:15	12a-B4-5	低温成長による3C-SiC(111)自立基板の結晶性評価	○浅村 英俊¹, 大内 澄人¹, 生川 満久¹, 稲垣 徹¹, 川村 啓介¹	1.エア・ウォーター総研
10:15 - 10:30		休憩/Break		
10:30 - 10:45	奨 12a-B4-6	12 mA/W の光電流を示す水分解用 SiC	○市川 尚澄1	1.名工大
10:45 - 11:00	12a-B4-7	4H-SiC表面再結合速度における温度依存性の解析	○(B)小濱 公洋¹, 森 祐人¹, 加藤 正史¹, 市村 正也¹	1.名工大
11:00 - 11:15	奨 12a-B4-8	様々なドーピング密度を有するp型4H-SiCのホール効果の温度依存性	○浅田 聡志¹, 奥田 貴史¹, 木本 恒暢¹, 須 田 淳¹	1.京大院工
11:15 - 11:30	12a-B4-9	4H-SiC中の空孔欠陥と水素の反応と、水素複合欠陥のESR評価	○棚井 創基¹, 村上 功樹¹, 奥田 貴史², 須 田 淳², 木本 恒暢², 小杉 亮治³, 大島 武⁴, 梅田 享英¹	1.筑波大, 2.京大, 3.産総研, 4.原研
11:30 - 11:45	奨 12a-B4-10	超高次非線形誘電率顕微鏡法を用いた交流バイアス印加による SiC-DMOSFET断面におけるキャリア分布のゲート電圧依存性の 解析	○茅根 慎通¹, 長 康雄¹	1.東北大
3月13日(金)	9:00 - 11:4			
9:00 - 9:15	13a-B4-1	SiC表面における酸化初期での反応過程に関する理論的検討	○伊藤 綾子¹, 秋山 亨¹, 中村 浩次¹, 伊藤 智徳¹, 影島 博之², 植松 真司³, 白石 賢二⁴	1.三重大院工, 2.島根大院理工, 3.慶 理工, 4.名大院工
9:15 - 9:30	13a-B4-2	4H-SiC/SiO $_2$ 界面における酸化反応過程に関する理論的検討	○秋山 亨¹, 伊藤 綾子¹, 中村 浩次¹, 伊藤 智徳¹, 影島 博之², 植松 真司³, 白石 賢二⁴	1.三重大院工, 2.島根大院理工, 3.慶 理工, 4.名大院工
9:30 - 9:45	13a-B4-3	4H-SiC酸化の第一原理/古典的分子動力学シミュレーション	○山崎 隆浩 <sup>1,2</sup> , 田島 暢夫 <sup>1,2</sup> , 金子 智昭 <sup>1,2</sup> , 西川 宜孝 <sup>3</sup> , 清水 達雄 <sup>4</sup> , 加藤 弘一 <sup>4</sup> , 大野 隆央 <sup>1,2,5</sup>	1.物材機構, 2.高効率電デバコンソ, 3 ずほ情報総研, 4.東芝研究開発センタ 5.東大生産研
9:45 - 10:00	13a-B4-4	光電子収率分光法によるSiO <sub>2</sub> /SiC構造の電子状態計測(2)	○大田 晃生¹, 渡邉 浩成², グェンスァン チュン², 牧原 克典², 宮崎 誠─²	1.名大VBL, 2.名大院工
10:00 - 10:15	13a-B4-5	リモート $H_2$ プラズマ処理した4H-SiC表面の化学構造および電子状態分析	○グェンスァン チュン¹, 大田 晃生², 竹内 大智¹, 張 海¹, 牧原 克典¹, 宮崎 誠一¹	1.名大院工, 2.名大VBL
10:15 - 10:30		休憩/Break		
10:30 - 10:45	13a-B4-6	X線反射率法によるSiO <sub>2</sub> /SiC構造解析	○先崎 純寿¹, 下里 淳¹, 吉田 貞史¹	1.産総研
10:45 - 11:00	奨 13a-B4-7	カソードルミネッセンス法による熱酸化SiOg/SiC界面欠陥の検出	<ul><li>○福島 悠太¹, チャンタパン アタウット¹, 永井 大介¹. 細井 卓治¹, 志村 考功¹, 渡部 平司¹</li></ul>	1.阪大院工
11:00 - 11:15	13a-B4-8	容量検出型電子スピン共鳴分光法による4H-SiC MOSFET中の結晶欠陥の測定	○(M1)鹿児山 陽平¹, 岡本 光央², 小杉 亮治², 原田 信介², 牧野 高紘³, 大島 武³, 梅田 享英¹	1.筑波大数物, 2.産総研, 3.日本原研
11:15 - 11:30	E 13a-B4-9	Electrically Detected Magnetic Resonance (EDMR) Study on Interface Defects in C-face 4H-SiC Metal-Oxide-Semi-conductor Field Effect Transistors	○(B)GEONWOO KIM¹, Shijie Ma¹, Ryo Arai¹, Mitsuo Okamoto², Shinsuke Hara- da², Takahiro Makino³, Takeshi Ohshima³, Takahide Umeda¹	1.Univ. of Tsukuba, 2.AIST, 3.JAEA
11:30 - 11:45	13a-B4-10	SiO <sub>z</sub> /SiC MOS 構造における伝導帯端近傍の界面特性II	○竹内 和歌奈¹, 山本 建策², 坂下 満男¹, 金村 髙司², 中塚 理¹, 財満 鎖明¹.3	1.名大院工, 2.(株)デンソー, 3.名大エコトピア
3月13日(金)	16:15 - 18:	30		
16:15 - 16:30	奨 13p-B4-1	種々の温度における容量の過渡応答(C-t特性)に基づくSiC MOS界 面近傍の膜中トラップ密度の定量化	○藤野 雄貴 <sup>1</sup> , 菊地 リチャード平八郎 <sup>1</sup> , 喜 多 浩之 <sup>1,2</sup>	1.東大院工, 2.JSTさきがけ
16:30 - 16:45	奨 13p-B4-2	低温酸素アニールによる $\mathrm{SiO}_{\mathrm{z}}/4\mathrm{H}$ - $\mathrm{SiC}(0001)$ 界面準位密度の増減機構の理解と制御	○菊地 平八郎¹, 喜多 浩之²	1.東大院工, 2.JST さきがけ
16:45 - 17:00	奨 13p-B4-3	4H-SiC面内MOSFET上のdry酸化界面における電界効果移動度と 実効移動度の乖離	○平井 悠久¹, 喜多 浩之¹²	1.東大院工, 2.JSTさきがけ
17:00 - 17:15	13p-B4-4	4H-SiC MOSFETにおけるチャネル移動度の面方位及びチャネル方向に対する異方性の系統的評価	○有吉 恵子 <sup>1.2</sup> , 飯島 良介², 原田 信介¹³, 児 島 一聡¹³, 先崎 純寿¹³, 田中 保宣¹³, 高尾 和人², 四戸 孝¹²	1.FUPET, 2.東芝, 3.産総研
17:15 - 17:30	13p-B4-5	SiCのTDDB理論	○南 眞嗣¹	1.フェニテック
17:30 - 17:45	奨 13p-B4-6	4H-SiC MOSFETの高温ドレインバイアス試験における故障メカニズム解析	○内田 光亮¹, 日吉 透¹, 西口 太郎¹, 山 本 裕史¹, 松川 真治¹, 古米 正樹¹, 御神 村 泰樹¹	1.住友電気工業
17:45 - 18:00	奨 13p-B4-7	NOアニールを施したSiC MOSデバイスのフラットバンド電圧安定性	○勝 義仁¹, 細井 卓治¹, 南園 悠一郎², 木本 恒暢², 志村 考功¹, 渡部 平司¹	1.阪大院工, 2.京大院工
18:00 - 18:15	13p-B4-8	I-V特性から見たSiC-MOSFETストレス劣化の特徴	○村上 英一¹, 清水 宥喜¹, 米村 望努¹, 原 陽平¹	1.九産大工
18:15 - 18:30	13p-B4-9	ゲートバイアス印加を伴うSiC MOSFETへのガンマ線照射効果	○村田 航一1², 三友 啓1², 松田 拓磨1², 横 関 貴史1², 牧野 高紘², 阿部 浩之², 小野田 忍², 大久保 秀一³, 田中 雄季³, 神取 幹郎³, 吉江 徹°, 大島 武², 土方 泰斗¹	1.埼玉大学, 2.日本原子力機構, 3.サンプン電気
3月14日(土)	9:00 - 12:3	30	日正 186,八四 以, 上刀 宋平。	
9:00 - 9:15	奨 14a-B4-1	量子分子動力学シミュレーションによるSiCエッチングプロセスにおける化学反応ダイナミクスの解明	○(D)伊藤 寿¹, 桑原 卓哉¹, 樋口 祐次¹, 尾澤 仲樹¹, 久保 百司¹	1.東北大院工
9:15 - 9:30	奨 14a-B4-2	4H-SiCの電気化学エッチングにおけるサイドエッチングの異方性	○山下 尚人¹, 佐藤 孝亮², 木本 恒暢², 須 田 淳²	1.京大工, 2.京大院工

9:45 - 10:00	14a-B4-4	大気圧熱プラズマジェット照射急速熱処理の冷却速度制御による 4H-SiC中Pの高効率活性化	○(M2)丸山 佳祐¹, 花房 宏明¹, 林 将平¹, 村上 秀樹¹, 東 清一郎¹	1.広大院 先端研
10:00 - 10:15	14a-B4-5	表面に堆積したAI薄膜へのレーザ照射による4H-SiCへのp型ドービング	○池田 晃裕¹, 角名 陸歩¹, 池上 浩¹, 浅 野 種正¹	1.九州大学
10:15 - 10:30	14a-B4-6	液体窒素中でのSiC基板へのレーザー照射	○宮川 鈴衣奈¹, 中川 崇寛¹, 江龍 修¹	1.名工大
10:30 - 10:45	14a-B4-7	Ti電極とTiC電極のSiCショットキーダイオードの電気特性評価	〇(B)鈴木 智之 <sup>1</sup> , 岡本 真里 <sup>2</sup> , 宗清 修 <sup>2</sup> , 角 嶋 邦之 <sup>2</sup> , 片岡 好則 <sup>2</sup> , 西山 彰 <sup>2</sup> , 杉井 信之 <sup>2</sup> , 若林 整 <sup>2</sup> , 筒井 一生 <sup>2</sup> , 名取 研二 <sup>1</sup> , 岩井 洋 <sup>1</sup>	1.東工大フロンティア研, 2.東工大総理工
10:45 - 11:00		休憩/Break		
11:00 - 11:15	14a-B4-8	SiO <sub>2</sub> 注入マスクを用いた6インチ基板上の高エネルギーイオン注入 技術開発	○堀井 拓¹, 久保田 良輔¹, 和田 圭司¹, 田中 聡¹, 関口 剛¹, 御神村 泰樹¹	1.住友電気工業(株)
11:15 - 11:30	14a-B4-9	3.3 kV 4H-SiC MOSFETの作製と特性評価	○酒井 光彦¹, 内田 光亮¹, 日吉 透¹, 和田 圭司¹, 古米 正樹¹, 築野 孝¹, 御神村 泰樹¹	1.住友電気工業
11:30 - 11:45	奨 14a-B4-10	Investigation of SiC MOSFETs with 3C/4H Different Poly-Type Junctions	○Munetaka Noguchi¹, Toshiaki Iwamat- su¹, Naruhisa Miura¹, Shuhei Nakata¹, Satoshi Yamakawa¹	1.Mitsubishi Electric Corp.
11:45 - 12:00	14a-B4-11	3.3 kV級SiC-MOSFETに適用するFLR型終端構造	○海老原 洪平 <sup>12</sup> , 富永 貴亮 <sup>12</sup> , 濱田 憲治 <sup>1</sup> , 日野 史郎 <sup>12</sup> , 渡邊 寛 <sup>12</sup> , 三浦 成久 <sup>1</sup> , 中田 修平 <sup>12</sup> , 山川 聡 <sup>12</sup>	1.三菱電機, 2.FUPET
12:00 - 12:15	奨 14a-B4-12	超高耐圧4H-SiCパワーデバイスを目指した衝突イオン化係数の決定	○(DC)丹羽 弘樹¹, 須田 淳¹, 木本 恒暢¹	1.京大院工
12:15 - 12:30	14a-B4-13	新しいユニポーラ動作SiCダイオード	〇谷本 智¹, 上岡 健一¹, 藤田 高弥¹, 児島 一聡², 牧野 俊春³, 山崎 聡³	1.日産アーク・要素解析、2.産総研・先進パワエレ、3.産総研・エネ部門

15.7 エピ	タキシーの基礎 / Fund	damentals of epitaxy	ポスター講演	Į.	
3月13日(金) 9:30 - 11:30					
	13a-P16-1	ミストCVDによるα-(AlGa)₂O₃混晶成長の基礎検討 較したα-Al₂O₃の成長速度の検討ー	ーα-Ga <sub>2</sub> O <sub>3</sub> と比	○(B)高橋 幹夫¹, 畠山 匠¹, 尾沼 猛儀¹², 山 口 智広¹, 本田 徹¹	1.工学院大工, 2.東京高専
	13a-P16-2	GaAs MCEにおけるらせんステップ源による法線成 カニズム	長速度決定メ	○水野 陽介¹, 冨田 将史¹, 高倉 宏幸¹, 岩川 宗樹¹, 神林 大介¹, 丸山 隆浩¹, 成塚 重弥¹	1.名城大理工

15.7 エピタキシーの基礎 / Fundamentals of epitaxy 口頭講演						
3月14日(土) 14:15 - 15:00						
	14:15 - 14:30	14p-D4-6	GaAs中Mn不純物状態のSTM観察		○津久井 雅之¹, 加来 滋¹, 吉野 淳二¹	1.東工大院理工
	14:30 - 14:45	14p-D4-7	In断続供給によるInAs量子ドット形成のSTMBE観察		○東條 孝志¹², 山口 浩一², 塚本 史郎¹	1.阿南高専, 2.電通大
	14:45 - 15:00	14p-D4-8	InAs(001)-(8x3)ぬれ層表面の不安定性に関する検討	ŧ	○伊藤 智徳¹, 秋山 亨¹, 中村 浩次¹	1.三重大院工

5.8 結晶評価, 7	下純物・結晶欠	陥 / Crystal evaluation, impurities and crystal defe	cts     口頭講演	
3月12日(木	14:00 - 19:	00		
14:00 - 14:15	E 12p-A18-1	Formation of polycrystalline Silicon Layer on Quartz substrate by Aluminium-induced Crystallization	○(M1)Joko Suwardy¹², Wipakorn Jevasuwan¹, Kaoru Toko², Takashi Suemasu², Naoki Fukata¹²	1.National Institute for Materials Science, 2.Univ. of Tsukuba
14:15 - 14:30	奨 12p-A18-2	高濃度Si結晶のフォトルミネッセンススペクトルの系統的変化	○中川 啓 <sup>1,2</sup> , 田島 道夫 <sup>1,2</sup> , 豊田 裕之 <sup>2</sup> , 小 椋 厚志 <sup>1</sup>	1.明治大, 2.JAXA宇宙研
14:30 - 14:45	12p-A18-3	Si結晶中の低濃度炭素の赤外吸収測定 (VI) 5x10 <sup>14</sup> cm <sup>-3</sup> までの SIMS測定と標準試料	〇井上 直久 <sup>1.7</sup> , 渡邉 香², 後藤 安則³, 大渕 真澄⁴, 関 洋文⁵, 鵜野 浩行 <sup>6</sup> , 河村 裕一 <sup>7</sup>	1.東京農工大工, 2.システムズエンジニ アリング, 3.トヨタ自動車, 4.ナノサイエ ンス, 5.東レリサーチ, 6.住重試験検査, 7.大阪府大
14:45 - 15:00	12p-A18-4	SiC結晶の赤外吸収(3)反射吸収	○井上 直久¹, 渡邉 香², 関 章憲³, 河村 裕一⁴	1.東京農工大工, 2.システムズエンジニア リング, 3.トヨタ自動車, 4.大阪府大
15:00 - 15:15	12p-A18-5	融液からの炭素の蒸発を利用したCZ-Siの極低炭素化技術	○永井 勇太¹, 鹿島 一日兒¹, 中川 聰子¹, 日笠 光朗¹	1.グローバルウェーハズ・ジャパン
15:15 - 15:30	12p-A18-6	MCZシリコン単結晶のバルクライフタイムに対する低炭素化の効果 (2)	○日笠 光朗¹, 中川 聰子¹, 鹿島 一日兒¹, 永井 勇太¹	1.グローバルウェーハズ・ジャパン
15:30 - 15:45		休憩/Break		
15:45 - 16:00	12p-A18-7	固液界面近傍の熱応力がSi単結晶の臨界v/G値に与える影響(II)	○末岡 浩治¹, 神山 栄治¹, 中村 浩三¹	1.岡山県大情報工
16:00 - 16:15	12p-A18-8	自己拡散や成長欠陥研究から求められたシリコン中の点欠陥の性質	○末澤 正志¹, 飯島 嘉明¹, 深田 直樹², 米 永 一郎¹	1.東北大金研, 2.物材機構
16:15 - 16:30	12p-A18-9	シリコン中の空孔濃度に及ぼす不純物効果の検討 (II)	○中村 浩三¹, 末岡 浩治¹, 神山 栄治¹	1.岡山県大情報工
16:30 - 16:45	奨 12p-A18-10	水素ドナー及び格子間Si対形成に対する熱処理温度の影響	○清井 明¹, 田中 政幸¹, 川上 剛史¹, 鶴田明三¹, 谷村 純二¹, 湊 忠玄², 多留谷 政良²	1.三菱電機先端総研, 2.三菱電機パワ電
16:45 - 17:00	奨 12p-A18-11	シリコンウェーハ中の酸素析出物を起因とするSlip転位発生の臨界 応力	○藤瀬 淳¹, 高 奉均¹, 鳥越 和尚¹, 小野 敏昭¹	1.株式会社SUMCO
17:00 - 17:15	奨 12p-A18-12	n型シリコンウェーハ中のFe関連準位の低温熱処理挙動	○大仲 亜由美¹, 門野 武¹, 三次 伯知¹, 栗 田 一成¹	1.SUMCO
17:15 - 17:30		休憩/Break		
17:30 - 17:45	12p-A18-13	炭素クラスターイオン照射によるSiウェーハの近接ゲッタリング(1) -CMOSイメージセンサのデバイス特性にゲッタリングが与える効果-	○栗田 一成¹, 門野 武¹, 李 伸², 朴 在勤²	1.株式会社SUMCO, 2.漢陽大学校
17:45 - 18:00	奨 12p-A18-14	炭素クラスターイオン照射によるSiウェーハの近接ゲッタリング(2) -エ ピタキシャル成長後の水素の熱処理・拡散挙動-	○奥山 亮輔', 廣瀬 諒', 門野 武', 岩永 卓朗', 古賀 祥泰', 奥田 秀彦', 栗田 一成'	1.株式会社SUMCO
18:00 - 18:15	12p-A18-15	炭素クラスターイオン照射によるSiウェーハの近接ゲッタリング(3) -エビ成長後の酸素の熱処理・拡散挙動-	○奥田 秀彦¹, 奥山 亮輔¹, 岩永 卓朗¹, 門野武¹, 廣瀬 諒¹, 古賀 祥泰¹, 栗田 一成¹	1.株式会社SUMCO
18:15 - 18:30	奨 12p-A18-16	炭素クラスターイオン照射によるSiウェーハの近接ゲッタリング(4) -低温クラスター照射が照射欠陥の形成に与える影響-	○廣瀬 諒¹, 奥山 亮輔¹, 門野 武¹, 岩永 卓 朗¹, 古賀 祥泰¹, 奥田 秀彦¹, 栗田 一成¹	1.株式会社SUMCO

18:30 - 18:45	12p-A18-17	第一原理計算によるSi単結晶中のゲッタリングサイトの探索	○白澤 涉¹, 末岡 浩治¹, 前川 和義², 山 口 直²	1.岡山県大院情報系工, 2.ルネサスエレクトロニクス
18:45 - 19:00	12p-A18-18	IV族半導体結晶におけるクラスタや混晶系の対称性を考慮した原子 配置作成プログラムとその適用	○末岡 浩治¹, 松谷 亮¹, 白澤 涉¹, 神山 栄 治¹², 泉妻 宏治², 鹿島 一日児², 中塚 理³	1.岡山県大情報工, 2.グローバルウェー ハズ, 3.名大院工

15.8	15.8 結晶評価, 不純物・結晶欠陥 / Crystal evaluation, impurities and crystal defects ポスター講演						
	3月13日(金) 9:30 - 11:30						
		13a-P17-1	融液からの切り離しによるCZ Si結晶内の引き上げ速度に依存した点 欠陥分布の観察	○阿部 孝夫¹, 高橋 徹¹, 白井 光雲²	1.信越半導体磯部研究所, 2.阪大産研		
		13a-P17-2	斜入射トポグラフィーと局所ロッキングカーブ法によるAlイオン注入SiC 基板の歪状態の観察	○高橋 由美子¹, 平野 馨一¹, 吉村 順一¹, 山下 良樹¹, 志村 考功², 長町 信治³	1.KEK-PF, 2.大阪院工, 3.(株)長町サ イエンスラボ		

品質・微	が結晶 / Amornho	us and Microcrystalline Materials	ポスター講演	
	(水) 16:00 - 18	· ·	3.27.7. HI2124	
o,,,==,	11p-P6-1	酸化亜鉛及び硫化亜鉛の遠紫外スペクトル測定	○山田 庸介¹	1.関学大理工
	11p-P6-2	ラマン分光法による酸化物ガラスのレーザー誘起構造変化の解析	○内田 翔平¹, 寺門 信明¹, 高橋 儀宏¹, 藤原 巧¹	1.東北大院工
	11p-P6-3	合成粉溶融シリカガラスのArFエキシマレーザー誘起光吸収帯の熱 処理特性	○(M1)丹羽 祥平¹, 野城 慎也¹, 葛生 伸¹, 山本 剛貴¹, 堀越 秀春²	1.福井大工, 2.東ソー・エスジーエム
	11p-P6-4	接合したシリカガラス間のOH 基の拡散	○佐藤 直哉¹, 山本 剛貴¹, 葛生 伸¹, 堀越 秀春², 丹羽 祥平¹	1.福井大工, 2.東ソー・エスジーエム
	11p-P6-5	反応雰囲気気体がシリカガラスの失透に及ぼす影響(II)	○堀井 直宏¹, 桑名 秀太¹, 高野 直也¹, 葛 生 伸², 池田 昌弘¹, 安仁屋 勝³, 青山 義弘 ¹, 野村 保之¹	1.福井高専, 2.福井大院工, 3.熊本大院自然
	11p-P6-6	水垢構造を脆弱化させる表面濡れ性の研究	○中目 万理¹, 石川 綾子¹, 松本 勘¹, 光 橋 義陽¹	1.TOTO(株)
	11p-P6-7	潜熱蓄熱に向けたガラスー結晶複合材料の開発	○村本 圭¹, 藤原 巧¹, 高橋 儀宏¹, 寺門 信明¹	1.東北大工
	11p-P6-8	微結晶シリコン薄膜を発電層に用いたヘテロ接合型太陽電池の試作	○大住 祐矢¹, 端 純平¹, 北田 和寛¹, 吉田 憲充¹², 野々村 修一¹²	1.岐大院工, 2.岐阜大CIPS
	11p-P6-9	選択的 Si 酸化を用いた c-Si/a-Si ヘテロ接合界面(1 in)における漏れ電流抑制技術の開発	○太田 昂貴¹, 三和 寛之¹, 西田 哲¹, 牟田 浩司¹, 栗林 志頭眞¹	1.岐大院工
	11p-P6-10	裏面コンタクト型ヘテロ接合Si結晶セルにおける裏面構造の幾何寸 法設計指針の検討	○(PC)神岡 武文¹, 林 豊¹, 中村 京太郎², 大下 祥雄¹	1.豊田工大, 2.明治大
	11p-P6-11	a-Si:Hパッシベーション膜の高品質化プロセスの検討	〇山本 翔太¹, 岡田 祐希¹, 三和 寛之¹, 西田哲¹, 松木 伸行¹, 牟田 浩司¹, 栗林 志頭眞¹	1.岐阜大学院工
	11p-P6-12	TMAHによるテクスチャ付シリコン基板のライフタイム改善	○寺澤 良平¹, 兼松 雅斗¹, 武藤 芳樹¹, 西田哲¹, 牟田 浩司¹, 栗林 志頭眞¹	1.岐阜大院工
	11p-P6-13	結晶シリコン太陽電池のパッシベーション用アルミナ薄膜のスピンコ ーティング製膜	○野口 卓馬¹, ウズム アブドゥラ¹, 神田 広之¹, 伊藤 省吾¹	1.兵県大工
	11p-P6-14	結晶シリコン太陽電池用のスピンコート・リン拡散剤の調製	○望月 脩平¹, ウズム アブドゥラ¹, 神田 広之¹, 伊藤 省吾¹	1.兵県大工
	11p-P6-15	フラッシュランプアニールにより形成したpoly-Si膜のa-Si膜による表面 バッシベーションの効果	○野澤 尚樹¹, 渡邊 大貴¹, 大平 圭介¹	1.北陸先端大
	11p-P6-16	ポリビニルアルコールを用いたシリコン太陽電池用アルミニウムペーストの作製	○足利 泰紀 <sup>1</sup> , 野口 卓馬 <sup>1</sup> , ウズム アブドー ラ <sup>1</sup> , 松岡 敏文 <sup>2</sup> , 中西 暢 <sup>3</sup> , 福井 英人 <sup>4</sup> , 原田 富太郎 <sup>4</sup> , 伊藤 省吾 <sup>1</sup>	1.兵県大工, 2.日本酢ビ・ポバール株式 会社, 3.信越化学工業株式会社, 4.大和 産業株式会社
	11p-P6-17	${ m TiO_2}$ ナノ粒子/ ${ m SiO_2}$ コンポジット膜を用いた太陽電池裏面反射構造 ${ m II}$	○室岡 拓也¹, 永吉 浩¹	1.東京高専
	11p-P6-18	シリカ粒子および液体ガラスを用いた高散乱性透明導電基板の作製	○井上 将成¹, 三浦 修平², 鈴木 一鋭², 野田 真一², 村上 功一¹, 野々村 修一¹.²	1.岐大工, 2.岐大院工
	11p-P6-19	スピンコート法による結晶Si太陽電池用光反射防止膜の作製	○栗山 捋¹, ウズム アブドーラ¹, 伊藤 省吾¹	1.兵県大工
	11p-P6-20	Siナノワイヤー太陽電池の光劣化と $Al_2O_3$ によるパッシベーション効果	〇宮澤 遼太', 小路 智也', 角嶋 邦之', 片岡 好則', 西山 彰', 杉井 信之', 若林 整', 筒井 一生', 大橋 弘通', 名取 研二', 岩井 洋'	1.東工大フロンティア研, 2.東工大総理工
	E 11p-P6-21	The effects of Nickel additive on solar grade silica reduction process	○(DC)ABDELLAOUI IMANE¹, Kenji Itaka², Abd Erahmane Boucetta², Rabie Benioub², Takuya Ogasawara²	1.Tsukuba Univ., 2.Hirosaki Univ.
	11p-P6-22	異なるFermi準位を有するSi中Fe不純物のメスパウア分光	○伊野 裕司¹, 田中 清高¹, 坂田 和正¹, 吉田 豊¹	1.静岡理工科大
	11p-P6-23	マルチシードキャスト法により導入した小傾角粒界における再結合速度の温度特性	○(D)小島 拓人¹, 立花 福久¹, 大下 祥雄¹, Prakash Ronit²³, 関口 隆史²³, 山口 真史¹	1.豊田工大, 2.物材機構, 3.筑波大
	11p-P6-24	50cm角seed cast法によるSiインゴットの育成と特性評価 (III)	宮村 佳児¹, 原田 博文¹², イプトナー カロリン¹, ブラカシュ ロニト¹, 陳 君¹, 中野 智², 柿本 浩一², ○関口 隆史¹	1.物材機構, 2.九大応力研

16	16.1 基礎物性·評価 / Fundamental properties and their evaluation in disordered materials 口頭講演							
	3月12日(木) 9:15 - 12:30							
	9:15 - 9:30	12a-A28-1	Ag微粒子を配置したGeTeにおける抵抗スイッチ現象	○今西 佑典¹, 木田 士文¹, 宮邉 徹¹, 中岡 俊裕¹	1.上智大理工			
	9:30 - 9:45	12a-A28-2	硫化銅薄膜のギャップ内準位評価	○後藤 民浩¹	1.群馬大院理工			
	9:45 - 10:00	12a-A28-3	硫黄ガス熱処理によるSnS薄膜の特性変化	○矢澤 広祐¹	1.群大理工			
	10:00 - 10:15	奨 12a-A28-4	減衰全反射型遠紫外分光装置による金属酸化物半導体粉末の測定	○田邉 一郎¹, 尾崎 幸洋¹	1.関西学院大理工			
	10:15 - 10:30	12a-A28-5	非晶質InGaZnO $_{\!\!\!4}$ とInSnZnO $_{\!\!\!4}$ のバンド吸収端酸素化及び水素化特性評価	○(M1)張 帥澤¹, 大野 祐樹¹, 清水 耕作¹	1.日大生産工			

10:30 - 10:45	12a-A28-6	反射CPM法を用いた非晶質酸化物半導体薄膜トランジスタの特性 不安定性解析	○竹山 裕貴¹, 大野 祐樹¹, 清水 耕作¹	1.日大
10:45 - 11:00		休憩/Break		
11:00 - 11:15	12a-A28-7	原子状水素供給スパッタ法による非晶質シリコン膜の作製と変調アド ミタンス法によるp-i/i-n界面の評価	○大江 和顕¹, 岩崎 真宝¹, 清水 耕作¹	1.日本大生産
11:15 - 11:30	12a-A28-8	$Si$ 及び $SiO_2$ 上に製膜した非晶質 $Ge$ 膜の固相結晶成長に関する検討	○黒岩 杏太¹, 磯村 雅夫¹	1.東海大院工
11:30 - 11:45	12a-A28-9	テルライト系ガラスを用いた超高速一括波長変換の研究 一紫外光ポーリング条件の最適化ー	○山寺 雄太¹, 平野 拓也¹, 三田地 成幸¹	1.東京工科大
11:45 - 12:00	12a-A28-10	レーザー照射によるガラス表面へのBiFeO <sub>3</sub> 形成	○熊谷 彰恵¹, 高橋 哲平¹, 高橋 儀宏¹, 寺門 信明¹, 藤原 巧¹	1.東北大院工
12:00 - 12:15	12a-A28-11	TiO <sub>2</sub> 結晶化ガラスにおける光触媒活性の組成及び熱処理温度依存性	○高橋 寛¹, 吉田 和貴¹, 正井 博和², 高橋 儀宏¹, 寺門 信明¹, 藤原 巧¹	1.東北大院工, 2.京大化研
12:15 - 12:30	12a-A28-12	結晶化ガラスに対する欠陥導入と光触媒活性への影響	○吉田 和貴¹, 正井 博和², 寺門 信明¹, 高橋 儀宏¹, 藤原 巧¹, 加藤 英樹³, 垣花 眞人³	1.東北大院工, 2.京大化研, 3.東北大 多元研
3月12日(木	14:00 - 17	:15		
14:00 - 14:15	奨 12p-A28-1	集熱・排熱デバイスへの応用に向けた $\operatorname{SrCuO}_2$ スパッタ膜の作製	○高橋 良輔¹, 寺門 信明¹, 高橋 儀宏¹, 藤原 巧¹	1.東北大院工
14:15 - 14:30	12p-A28-2	$(NH_{+})_{2}SiF_{c}$ 微粒子へのリン添加-構造・発光特性-	○常盤 葵¹, 佐藤 慶介¹, 深田 直樹², 平 栗 健二¹	1.東京電機大学, 2.物質·材料研究
14:30 - 14:45	奨 12p-A28-3	Mn⁴+ ドープSrGe₄O₅相の赤色発光におけるSi置換効果	○鈴木 理恵¹, 寺門 信明¹, 高橋 儀宏¹, 藤原 巧¹	1.東北大院工
14:45 - 15:00	奨 12p-A28-4	$Mn添加Li_2O-ZnO-GeO_2$ 系結晶化ガラスにおける発光挙動の結晶 化温度依存性	○星野 愛信¹, 高橋 儀宏¹, 寺門 信明¹, 藤 原 巧¹	1.東北大院工
15:00 - 15:15	12p-A28-5	異なる冷却過程で作製した $\mathrm{SrO-B_2O_3}$ ガラス中の $\mathrm{Sn^{2+}}$ 中心の発光	○正井 博和¹, 是枝 聡肇², 大窪 貴洋³	1.京大化研, 2.立命館大, 3.千葉大
15:15 - 15:30	12p-A28-6	$\mathrm{Eu}^{\scriptscriptstyle{3+}}$ 添加 $\mathrm{GdF_3\text{-}SiO_2}$ 透明結晶化ガラスのゾルゲル合成と発光特性	○早川 知克¹, 古田 眞人¹	1.名古屋工大大学院
15:30 - 15:45		休憩/Break		
15:45 - 16:00	奨 12p-A28-7	浮遊法を用いた長残光 $\operatorname{SrAl}_2\operatorname{O}_4$ 結晶化ガラスの合成	○篠崎 健二¹, Affatigato Mario², 本間 剛¹, 小松 高行¹	1.長岡技科大, 2.コー大学
16:00 - 16:15	12p-A28-8	リン酸鉄ナトリウムガラスのナトリウム電池用正極としての機能性	仲田 諭史¹, ○本間 剛¹, 篠崎 健二¹, 小 松 高行¹	1.長岡技科大
16:15 - 16:30	12p-A28-9	亜鉛ビスマスリン酸塩ガラスの真空紫外反射スペクトル	○北村 直之¹, 福味 幸平¹	1.産総研
16:30 - 16:45	12p-A28-10	シリカ超微粒子集合体の空隙サイズの温度依存性	○小林 立人¹, 斎藤 文修¹	1.東大総合文化
16:45 - 17:00	12p-A28-11	仮想温度の異なるSiO $_2$ ガラスにおける弾性評価および構造解析	○正井 博和¹, 是枝 聡肇², 藤井 康裕², 斎藤 和也³, 関谷 エジソン³, 小原 真司⁴	1.京大化研, 2.立命館大, 3.豊田工; 4.JASRI/SPring-8
17:00 - 17:15	12p-A28-12	SiO。中の酸素欠陥の7.6eV光吸収帯の不均一広がりとピークシフト	○梶原 浩一¹, Skuja Linrads², 細野 秀雄³	1.首都大, 2.Latvia大, 3.東工大

16.3	シリコン系太	、陽電池 / Bulk	, thin-film and other silicon-based solar cells	口頭講演	
	3月11日(水)	9:00 - 12:30			
	9:00 - 9:15	11a-C2-1	変調表面テクスチャにおける光閉じ込め効果の理論的検討	○太野垣 健¹, 岸本 裕子¹, 星 裕介², 宇佐 美 徳隆²	1.京大化研, 2.名大工
	9:15 - 9:30	11a-C2-2	コロイダルリソグラフィを利用したテクスチャSi基板表面へのナノ構造 形成とその太陽電池特性	○星 裕介¹, 平井 悠司², 宇佐美 徳隆¹	1.名大院工, 2.千歳科技大
	9:30 - 9:45	11a-C2-3	液体ガラスを用いた反射防止膜の形成	○村上 功一¹, 三浦 修平¹, 鈴木 一鋭¹, 野田 真一¹, 井上 将成¹, 野々村 修一¹	1.岐大院工
	9:45 - 10:00	11a-C2-4	球状シリカ粒子および液体ガラスを用いた凹凸構造付き透明導電 膜基板	○野田 真一¹, 三浦 修平¹, 鈴木 一鋭¹, 井上 将成¹, 村上 功一¹, 野々村 修一¹	1.岐大院工
	10:00 - 10:15	11a-C2-5	液体Siを用いて製膜したa-Siバッシベーション膜の耐熱性	○(M1C)過 程¹, 大平 圭介¹, 高岸 秀行², 下田 達也¹	1.北陸先端大, 2.福島大
	10:15 - 10:30	奨 11a-C2-6	反応支援型ミストCVD法により低温成長した酸化アルミニウム(AIO <sub>x</sub> ) 薄膜のパッシベーション応用特性	○内田 貴之¹, 川原村 敏幸², 藤田 静雄¹, 平松 孝浩³, 織田 容征³	1.京大院工, 2.高知工大 総研, 3.東芝三 菱電機産業システム
	10:30 - 10:45	11a-C2-7	新規アルミニウム源による酸化アルミニウム膜の形成と太陽電池応用	○高橋 清¹, 轟 宗一郎², 宮島 晋介²	1.日本アルキルアルミ、2.東工大院理工
	10:45 - 11:00	11a-C2-8	a-Si:H/c-Siへテロ界面におけるボイド構造 $-$ 陽電子消滅データに基づく光学的評価法の適用 $-$	○松木 伸行¹, 上殿 明良², ブライアン オローク³, 大島 永康³	1.岐阜大, 2.筑波大, 3.産総研
	11:00 - 11:15		休憩/Break		
	11:15 - 11:30	11a-C2-9	Cat-doping法によるa-Si膜への低温ドーピング	○瀬戸 純一1	1.北陸先端大
	11:30 - 11:45	11a-C2-10	低界面再結合速度を実現するCat-CVD SiN <sub>x</sub> /a-Si積層保護膜の光 学特性	○小山 晃一¹, 寺嶋 茂樹¹, 大平 圭介¹, 松 村 英樹¹	1.北陸先端大
	11:45 - 12:00	11a-C2-11	低表面再結合速度を実現したCat-CVD SiNx/a-Si積層膜の化学 耐性	○寺嶋 茂樹¹, 小山 晃一¹, 大平 圭介¹, 松 村 英樹¹	1.北陸先端大
	12:00 - 12:15	E 11a-C2-12	Defect termination at the interfaces of Cat-CVD $SiN_x/c$ -Si and $SiN_x/P$ Cat-doped layer/c-Si structures	○(D)Cham Trinh <sup>1,2</sup> , Koichi Koyama <sup>1,2</sup> , Keisuke Ohdaira <sup>1,2</sup> , Hideki Matsumura <sup>1,2</sup>	1.JAIST, 2.JST CREST
	12:15 - 12:30	11a-C2-13	Improvement in the passivation quality of Cat-CVD a-Si/c-Si hetero-junction interface for Si(111) and Si(100) by the formation of ultra-thin oxide layers	○(M2)Takafumi Oikawa¹, Keisuke Ohdaira¹², Koichi Higashimine¹², Hideki Matsumura¹²	1.JAIST, 2.JST CREST
	3月11日(水)	14:00 - 15:4	5		
	14:00 - 14:15	奨 11p-C2-1	シリコン窒化膜製膜時に導入される結晶欠陥層のライフタイムの算出	$\bigcirc$ (P)立花 福久¹, 小島 拓人¹, 高井 大輔¹, 小椋 厚志², 大下 祥雄¹	1.豊田工大, 2.明治大学
	14:15 - 14:30	11p-C2-2	硝酸酸化 $SiO_2$ 膜と加熱処理による $Si$ 表面のパッシベーション	〇中島 寛記¹, 入鹿 大地¹, 野中 啓章¹, 今村健太郎¹, 松本 健俊¹, 小林 光¹	1.阪大産研
	14:30 - 14:45	奨 11p-C2-3	結晶Si太陽電池表面パッシベーションにおける積層構造の検討	○(D)池野 成裕 <sup>1.5</sup> , 勝又 隆晶 <sup>1.24</sup> , 山下 祥 弘¹, 佐藤 真— <sup>3.4</sup> , 吉田 晴彦 <sup>3.4</sup> , 新船 幸二 <sup>3.4</sup> , 知京 豊裕 <sup>2.4</sup> , 小椋 厚志 <sup>1.4</sup>	1.明治大学, 2.物質·材料研究機構, 3.兵庫県立大学, 4.JST-CREST, 5.学振特別研究員DC
	14:45 - 15:00	奨 11p-C2-4	金属Alの熱酸化で形成したAlOx/Si界面状態および固定電荷密度	○(D)池野 成裕 <sup>1,3</sup> , 山下 祥弘 <sup>1</sup> , 勝又 隆晶 <sup>1,2,4</sup> , 知京 豊裕 <sup>2</sup> , 小椋 厚志 <sup>1,4</sup>	1.明治大学, 2.物材機構, 3.学振特別研究員DC, 4.JST-CREST

	15:00 - 15:15	11p-C2-5	Siヘテロ接合(SHJ)太陽電池におけるケルビンプローブ顕微鏡を用いた仕事関数測定の定量性検討	○(PC)山田 郁彦¹, 高林 紘¹, 神岡 武文 ¹, 立花 福久¹, 中村 京太郎¹, 大下 祥雄 ¹, 神谷 格¹	1.豊田工大
	15:15 - 15:30	11p-C2-6	n/i層とp/i層が部分的に重なった裏面電極型ヘテロ接合Si太陽電池 における界面欠陥密度の影響	○野毛 宏¹, 齊藤 公彦¹, 佐藤 愛子¹, 金子 哲也², 近藤 道雄¹.3	1.福島大, 2.東海大工, 3.産総研
	15:30 - 15:45	奨·E 11p-C2-7	C-Si/PEDOT:PSS heterojunction solar cells with a TiO <sub>2</sub> AR coating	(D)Qiming Liu <sup>1</sup> , Tatsuya Ohki <sup>1</sup> , Ryo Ishikawa <sup>1</sup> , Keiji Ueno <sup>1</sup> , Hajime Shirai <sup>1</sup>	1.Saitama University
	3月12日(木	9:00 - 12:3		ionnama, resp. cono, raspine omina	
	9:00 - 9:15	12a-A18-1	エレクトロルミネッセンス定量画像測定による太陽電池の開放電圧	○望月 敏光¹, 金 昌秀²³, 朱 琳²³, 陳 少強	1.産総研, 2.東大物性研, 3.JST-CREST
	0.45	10.110.0	評価	4, 吉田 正裕 <sup>2,3</sup> , 高遠 秀尚 <sup>1</sup> , 秋山 英文 <sup>2,3</sup> , 金 光 義彦 <sup>3,5</sup>	4.華東師範大, 5.京大化研
	9:15 - 9:30	12a-A18-2	絶対EL画像測定による太陽電池の開放電圧マッピング	○金 昌秀 <sup>1,2</sup> , 望月 敏光³, 朱 琳¹², 陳 少強 ⁴, 吉田 正裕¹², 高遠 秀尚³, 秋山 英文¹², 金 光 義彦 <sup>2,5</sup>	1.東大物性研, 2.JST-CREST, 3.産総研, 4.華東師範大, 5.京大化研
	9:30 - 9:45	奨 12a-A18-3	Siナノクリスタル層形成による極低反射化と多結晶Si太陽電池への 応用	○入鹿 大地1.2, 今村 健太郎1.2, 小林 光1.2	1.阪大産研, 2.JST-CREST
	9:45 - 10:00	E 12a-A18-4	The Impact of Boron Diffusion Profile on n-type Silicon Solar Cells	○(PC)SIMAYI SHALAMUJIANG¹, yasuhiro Kida¹, Katsuhiko Shirasawa¹, Hidetaka Takato¹	1.National Institute of Advanced Industrial Science and Technology
	10:00 - 10:15	12a-A18-5	固定ダイヤモンドワイヤーで加工した単結晶シリコンウエハの表面 評価	○福田 哲生¹, 鈴木 信隆¹, 森谷 正昭¹, 白澤 勝彦¹, 高遠 秀尚¹	1.(独)産総研
	10:15 - 10:30	12a-A18-6	切断ワイヤの摩耗と単結晶シリコンウエハの破壊強度	○小野 裕道¹, 本田 和夫¹, 福田 哲生², 鈴木 信隆², 白澤 勝彦², 高遠 秀尚²	1.福島県ハイテクプラザ, 2.(独)産総研 島再生可能エネルギー研究所
	10:30 - 10:45	12a-A18-7	Ne雰囲気スパッタSi膜(500 nm厚)への青色レーザによる結晶化	○具志堅 貴也¹, 若杉 智英¹, 岡田 竜弥¹, 野口 隆¹, 河本 直哉²	1.琉球大学, 2.山口大学
	10:45 - 11:00		休憩/Break		
	11:00 - 11:15	奨 12a-A18-8	太陽電池用モノライクSi中の転位発生抑制のための応力解析	○杉岡 翔太¹, 沓掛 健太朗¹², 出浦 桃子¹, 大野 裕¹, 米永 一郎¹	1.東北大金研, 2.JSTさきがけ
	11:15 - 11:30	12a-A18-9	実用サイズシリコンインゴットの組織制御による転位発生抑制	○高橋 勲¹, Supawan Joonwichien¹, 平松 巧也¹, 岩田 大将¹, 松島 悟¹, 宇佐美 徳隆¹	1.名大院工
	11:30 - 11:45	12a-A18-10	シードキャスト法における結晶Siの粒界と転位発生との関	○岩田 大将¹, 高橋 勲¹, Joonwichien Supawan¹, 宇佐美 徳隆¹	1.名大工
	11:45 - 12:00	E 12a-A18-11	Three-dimensional analysis of dislocation multiplication in single-crystal silicon under accurate control of cooling history of temperature	OBing Gao <sup>1</sup> , Karolin Jiptner <sup>2</sup> , Satoshi Nakano <sup>1</sup> , Hirofumi Harada <sup>2</sup> , Yoshiji Miyamura <sup>2</sup> , Takashi Sekiguchi <sup>2</sup> , Koichi Kakimoto <sup>1</sup>	1.RIAM, Kyushu Univ., 2.NIMS
	12:00 - 12:15	奨 12a-A18-12	太陽電池用多結晶Si中のサーマルドナー関連欠陥に起因する深い準 位のフォトルミネッセンス	○樋口 史仁 <sup>1,2</sup> , 佐藤 邦孝 <sup>1,3</sup> , 加藤 言 <sup>1,2</sup> , 田 島 道夫 <sup>1,2</sup> , 小野 春彦 <sup>1,3</sup> , 小椋 厚志 <sup>1</sup>	1.明治大, 2.JAXA 宇宙研, 3.神奈川 県産技セ
	12:15 - 12:30	12a-A18-13	硫黄を過飽和ドーブしたSi単結晶の中赤外光吸収スペクトルの結晶 構造依存性	○中井 達也¹, 内藤 宗幸¹, 小林 勇輝¹, 長尾 克紀¹, 青木 珠緒¹, 杉村 陽¹, 梅津 郁朗¹	1.甲南大理工
	3月12日(木	) 13:45 - 19:	00		
	13:45 - 14:00	12p-C2-1	サプストレート型微結晶シリコン太陽電池における透明導電酸化物 膜の影響	○齋 均!, 前島 圭剛², 片山 博貴³, 鯉田 崇 ·, 松井 卓矢¹, 近藤 道雄¹, 竹内 良昭⁴, 吉 田 功²	1.産総研, 2.PVTEC, 3.Panasonic, 4.三 菱重工
	14:00 - 14:15	奨 12p-C2-2	セリウムをドープした酸化インジウム膜におけるセリウム価電子状態お よび電気特性への水素同時ドーピング効果	○小林 英治¹, 渡部 嘉¹, 山本 哲也²	1.長州産業, 2.高知工科大
	14:15 - 14:30	12p-C2-3	ナノ構造体・結晶シリコン融合構造におけるGeドット積層構造とフォトニックナノ構造の独立形状制御	○(M1C)青沼 理¹, 星 裕介¹, 太野垣 健², 宇 佐美 徳隆¹	1.名大院工, 2.京大化研
	14:30 - 14:45	12p-C2-4	フォトニック結晶を有する極薄μc-Si太陽電池の光吸収の解析 -Ag電 極プラズモン吸収の検討 -	○田中 良典¹, 石崎 賢司¹, De Zoysa Menaka¹², 川本 洋輔¹, 梅田 尚実¹, 藤田 奨 也¹, 元平 暉人¹, 野田 進¹	1.京大院工, 2.京大白眉
	14:45 - 15:00	12p-C2-5	フォトニック結晶による極薄μc-Si太陽電池の変換効率向上 -Ag電極 プラズモン吸収の抑制-	○石崎 賢司¹, De Zoysa Menaka¹², 田中 良典¹, 梅田 尚実¹, 川本 洋輔¹, 藤田 奨也 ¹, 野田 進¹	1.京大院工, 2.京大白眉
	15:00 - 15:15	奨 12p-C2-6	ビラミッド構造への化学的転写法による極低反射Si表面と光閉じ込め	○今村 健太郎 <sup>1,2</sup> , 入鹿 大地 <sup>1,2</sup> , 野中 啓章 <sup>1,2</sup> , 小林 光 <sup>1,2</sup>	1.阪大産研, 2.CREST-JST
	15:15 - 15:30		休憩/Break		
召待	15:30 - 15:45	12p-C2-7	「講演奨励賞受賞記念講演」(15分) 走査型非線形誘電率顕微鏡によるアモルファスシリコン太陽電池の	〇廣瀬 光太郎1, 茅根 慎通1, 長 康雄1	1.東北大通研
	15:45 - 16:00	奨 12p-C2-8	<b>pin接合の可視化</b> プラズマCVDプロセスにおけるa-Si <sub>1-x</sub> C <sub>x</sub> :HのChemical-Orderの発現 に関する量子分子動力学計算	○(D)桑原 卓哉¹, 伊藤 寿¹, 樋口 祐次¹, 尾澤 伸樹¹, 久保 百司¹	1.東北大院工
	16:00 - 16:15	12p-C2-9	一		1.阪大院基礎工, 2.JST-CREST
	16:15 - 16:30	12p-C2-10	薄膜シリコン太陽電池における欠陥密度決定プロセス(II) -pin型、nip型 太陽電池における発電特性の差異 -	○傍島 靖1², 松田 彰久1², 岡本 博明1²	1.阪大院基礎工, 2.JST-CREST
	16:30 - 16:45	12p-C2-11	薄膜シリコン太陽電池における欠陥密度決定プロセス(III) -nip 太陽電池における発電特性の改善 -	○傍島 靖1², 松田 彰久1², 岡本 博明1²	1.阪大院基礎工, 2.JST-CREST
	16:45 - 17:00	12p-C2-12	Conductive-AFMによる多結晶SiGe薄膜の欠陥分布の評価	○澤 祐基¹, 磯村 雅夫¹	1.東海大院工
	17:00 - 17:15		休憩/Break		
	17:15 - 17:30	12p-C2-13	a-Si:H太陽電池における光劣化の製膜速度依存性	○松井 卓矢¹, Bidiville Adrien¹, 前島 圭剛², 齋 均¹, 鯉田 崇¹, 末崎 崇²², 松本 光弘²⁴, 斉 藤 公彦²⁵, 吉田 功², 近藤 道雄¹	1.産総研, 2.PVTEC, 3.カネカ, 4.パナンニック, 5.福島大
	17:30 - 17:45	12p-C2-14	太陽光励起レーザーと組み合わせるためのシリコン光電変換素子 (II)	○竹田 康彦¹, 伊藤 忠¹	1.豊田中研
	17:45 - 18:00	12p-C2-15	「FLAによるテクスチャ化ガラス上へのpoly-Si薄膜形成	○(M2)渡邊 大貴¹, 大平 圭介¹	1.北陸先端大
	18:00 - 18:15	E 12p-C2-16	Optical modelling and simulation of Cone Shaped Si-NWs p-i-n structure for Solar Cell Application	○(P)M Khan¹, Y Ishikawa¹³, I Kita³, Y Kurokawa¹², Y Ichikawa¹, M Konagai¹²	1.Japan Science and Technology Agency, 2.Department of Physical Electronics, Tokyo Institute of Tech- nology, 3.Nara Institute of Science an Technology
	18:15 - 18:30	E 12p-C2-17	Effects of surface modification on the photovoltaic performance of nanocrystalline silicon membrane cells - II	○(P)Romain Mentek¹, Daihei Hippo¹, Nobuyoshi Koshida¹	1.Tokyo Univ. of Agri. and Tech.

18:30 - 18:45	12p-C2-18	Siナノウォールセルの特性	○平井 政和¹, 吉葉 修平¹, 市川 幸美¹, 小 長井 誠¹²	1.科学技術振興機構, 2.東工大院理工
18:45 - 19:00	12p-C2-19	エネルギー障壁を制御したショットキー型Siナノワイヤ太陽電池の発電特性	○伊藤 勇磨¹, 角嶋 邦之¹, 筒井 一生¹, 若林整¹, 片岡 好則¹, 西山 彰¹, 杉井 信之¹, 名取研二², 岩井 洋²	1.東工大総理工, 2.東工大フロンティア研
3月13日(金	9:00 - 11:0	0		
9:00 - 9:15	13a-C2-1	結晶Si 太陽電池モジュールにおけるインターコネクターのふるい分け試験の検討	○鈴木 聡¹², 棚橋 紀悟², 土井 卓也³, 増 田 淳³	1.PVTEC, 2.エスペック, 3.産総研
9:15 - 9:30	13a-C2-2	レーザーテラヘルツエミッション顕微鏡とEL/LBIC法による多結晶Si 太陽電池イメージの比較評価(II)	中西 英俊¹, ○伊藤 明¹, 川山 巌², 村上 博成², 斗内 政吉²	1.SCREEN, 2.阪大レーザー研
9:30 - 9:45	13a-C2-3	レーザーテラヘルツエミッション顕微鏡による太陽電池検査実証機 開発	〇中西 英俊 $^1$ , 水端 稔 $^1$ , 伊藤 明 $^1$ , 川山 巌 $^2$ , 村上 博成 $^2$ , 斗内 政吉 $^2$	1.SCREEN, 2.阪大レーザー研
9:45 - 10:00	13a-C2-4	結晶シリコン太陽電池モジュールにおける PID 現象と Na の拡散 の関係	○城内 紗千子¹, 原 浩二郎¹, 増田 淳¹	1.産総研
10:00 - 10:15	13a-C2-5	結晶シリコン太陽電池における事前逆電圧印加によるPIDの抑制 効果	○原 由希子¹, 増田 淳¹	1.産総研
10:15 - 10:30	奨 13a-C2-6	複合加速試験における太陽電池モジュールへのUV曝露の影響	○Ngo Thi Hong Trang¹, 辺田 祐志¹, 土井 卓也², 増田 淳²	1.太陽光発電技術研究組合, 2.産総研
10:30 - 10:45	13a-C2-7	高精度屋外太陽電池評価技術	○深堀 明博¹, 武内 貴和¹, 松田 洋治¹, 菱川 善博¹	1.産総研 太陽光発電工学研究センター
10:45 - 11:00	奨 13a-C2-8	ナノ構造pHセンサーによる太陽電池モジュール内の微量酢酸検出	○(D)浅香 孝!, 板山 知広¹, 長崎 秀昭', 岩 見 健太郎', 山本 千津子², 原 由希子², 増田 淳², 梅田 倫弘¹	1.東京農工大, 2.産総研

	/ Nanoc	carbon Technology		
-ノカーボン /	Nanocarbor	n Technology ポスター講演		
3月11日(水)	9:30 - 11:3	30		
	11a-P6-1	IJP法で形成したCoMo触媒を用いた垂直CNTの低圧CVD成長	○林 潤一¹, 中村 基訓¹, 篁 耕司¹	1.旭川高専
	11a-P6-2	薄膜触媒のバターニングによる高純度なカーボンナノコイルの合成	○郷原 丈弘¹, 竹井 邦晴¹, 有江 隆之¹, 秋 田 成司¹	1.大阪府大工
	11a-P6-3	無電解めっきNiB 触媒を用いた熱CVD によるナノカーボンの形成	○青笹 明彦¹, 富田 貢丞¹, 松本 勇士¹, 西出 大亮², 佐久間 尚志², 梶田 明広², 酒井 忠司 ², 上野 和良¹³	1.芝浦工大, 2.超低電圧デバイス技 究組合, 3.SITグリーンイノベーショ 究センター
	11a-P6-4	アルコールCVD法を用いた絶縁体基板上へのナノカーボンの生成	○辻本 茉里奈¹, 森迫 詩陽¹, 橘 勝¹	1.横浜市大
	11a-P6-5	塗布を用いた絶縁基板上への直接成長グラファイト薄膜 II	○加藤 幹大¹, 西村 未来¹, 趙 新為¹	1.東理大理
	11a-P6-6	${\rm Ir}(111)/\alpha\text{-Al}_2{\rm O}_3(0001)$ 基板を用いたグラフェンのLP-CVD成長	○(M1)齋藤 祐太¹, 島田 諒人¹, 児玉 英之¹, 澤邊 厚仁¹, 黄 晋二¹	1.青山学院大理工
	奨 11a-P6-7	水分導入による銅触媒の結晶方位とグラフェン成長への影響	○井上 雅文¹, 安野 裕貴¹, 竹内 雅人¹, 竹井 邦晴¹, 松岡 雅也¹, 秋田 成司¹, 有江 隆之¹	1.阪府大工
	11a-P6-8	Cu キャップ層を持つCo 触媒からの固相析出による多層グラフェン形成	〇佐野 翔太¹, 北村 啓太¹, 松本 勇士¹, 酒井 忠司², 上野 和良¹³	1.芝浦工大, 2.超低電圧デバイス 究組合, 3.SIT グリーンイノベーシ 究センター
	11a-P6-9	二軸方向電界印加状態での酸化グラフェン還元によるグラフェン作製	○(B)煙山 史人¹, 山内 繁², 小宮山 崇夫¹, 長南 安紀¹, 山口 博之¹, 青山 隆¹	1.秋田県大システム科学技術, 2.私 大木材高度加工研究所
	11a-P6-10	赤外照射プラズマCVD法によるグラフェン膜作成法の検討	○森 成樹¹, 山内 繁², 小宮山 崇夫¹, 長南 安紀¹, 山口 博之¹, 青山 隆¹	1.秋田県大システム, 2.秋田県大ス
	11a-P6-11	有機物を用いた新しいグラフェンの作製方法 その2	○西村 未来¹, 加藤 幹大¹, 趙 新為¹	1.東理大理
	11a-P6-12	2段階アニール析出法による高品質多層グラフェンの合成	〇上田 悠貴¹, 鈴木 学¹, 山田 純平¹, 成塚 重弥¹, 丸山 隆浩¹	1.名城大理工
	奨 11a-P6-13	酸化ニッケルを触媒とした絶縁基板上へのグラフェン直接合成	○大林 克未¹, 竹井 邦晴¹, 秋田 成司¹, 有 江 隆之¹	1.大阪府大工
	11a-P6-14	固相反応を用いた絶縁基板上へのグラフェン直接合成(Ⅲ)	○杉浦 孝俊¹, 若松 裕司¹, Golap Kalita¹, 種村 眞幸¹	1.名工大院工
	11a-P6-15	${ m Al}_2{ m O}_3$ バリア層、 ${ m Au}$ キャップ層を用いた析出法における 高品質多層 グラフェン生成に与えるアニール時間の効果	○山田 純平¹, 鈴木 学¹, 上田 悠貴¹, 丸山 隆浩¹, 成塚 重弥¹	1.名城大理工
	11a-P6-16	金属融解によるCVDグラフェンの絶縁性基板上への直接転写	○井上 凌介¹, 真庭 豊¹, 宮田 耕充¹²	1.首都大理工, 2.JSTさきがけ
	11a-P6-17	Ni凝集を利用した転写フリープロセスによるグラフェントランジスタ 作製	○水野 正也¹, 久保 俊晴¹, 三好 実人¹, 江川 孝志¹, 曽我 哲夫¹	1.名古屋工業大学
	11a-P6-18	グラフェンー金属カルコゲナイドの面内へテロ原子薄膜	○白土 喜博¹, 遠藤 寛子², 辻 正治¹², 吾 郷 浩樹¹.².³	1.九大院総理工, 2.九大先導研, 3 さきがけ
	11a-P6-19	$WS_2/MoS_2$ 〜テロ構造の2段階成長と評価	○森 勝平¹, 真庭 豊¹, 宮田 耕充¹²	1.首都大理工, 2.JSTさきがけ
	11a-P6-20	${ m MoS}_2$ 合成における基板結晶性の影響	○林 賢二郎¹, 岩井 大介¹, 佐藤 信太郎¹	1.富士通研
	奨 11a-P6-21	単層h-BN膜のCVD成長と $\mathrm{MoS}_2$ とのヘテロ積層膜の創製	○祝迫 佑¹, 内田 勇気¹, 辻 正治¹², 吾郷 浩樹¹²³	1.九大院総理工, 2.九大先導研, 3 さきがけ
	奨 11a-P6-22	CVDにより成膜した単層MoS <sub>2</sub> の結晶性評価	○倉林 空¹, 長汐 晃輔¹²	1.東大工, 2.JST-さきがけ
	11a-P6-23	$\mathrm{MoS}_2$ 原子層膜の共鳴ラマン評価	南野 達哉¹, 村上 俊也², ○木曽田 賢治¹, 伊東 千尋²	1.和歌山大教育, 2.和歌山大シス
	11a-P6-24	前駆体溶液塗布膜からの $\operatorname{MoS}_{\scriptscriptstyle 2}$ 薄膜作製及 $\operatorname{UH}_{\scriptscriptstyle 2}$ アニールによる特性変化	○黒崎 祐太郎¹, 上野 啓司¹	1.埼玉大院理工
	11a-P6-25	エビタキシャル成長した $\mathrm{MoSe}_{z}$ 超薄膜のラマン分光	○小野満 恒二¹, Krajewska Aleksandra¹, Neufeld Ryan¹, 前田 文彦¹, 熊倉 一英¹, 山 本 秀樹¹	1.NTT物性研
	11a-P6-26	リチウムをインターカレートしたMoS2の作製と吸湿過程	○(PC)三枝 栄子¹, 阿澄 玲子², 鳥田 悟², 田 中 深幸³, 清水 哲夫³, 安藤 淳¹	1.産総研ナノエレクトロニクス研究 2.産総研電子光技術研究部門, 3 ナノシステム研究部門
	11a-P6-27	機械的剥離法を用いたHfS <sub>2</sub> 原子薄膜の作製と基礎物性の評価	○石川 篤 <sup>1,2</sup> , 金澤 徹³, 雨宮 智宏 <sup>2,3</sup> , 鶴田 健二 <sup>1</sup> , 田中 拓男 <sup>2,4</sup> , 宮本 恭幸 <sup>3</sup>	1.岡山大院自然, 2.理研, 3.東エラ 工, 4.北大電子研

11a-P6-28	単層カーボンナノチューブにおけるX線照射欠陥のAFMラマン評価	○村上 俊也¹, 木曽田 賢治², 伊東 千尋¹	1.和大シス工, 2.和大教育
11a-P6-29	ナノカーボン材料の電子ビーム加工の分子シミュレーション(IX)	○木田 昌吾¹, 山本 真也¹, 安田 雅昭¹, 多田和広², 川田 博昭¹, 平井 義彦¹	1.大阪府大工, 2.富山高専
11a-P6-30	バターン形成可能なイオンゲルの作製	○関根 佳明¹, 古川 一暁¹, 鈴木 哲¹, 日比 野 浩樹¹	1.NTT物性基礎研
11a-P6-31	ゲート制御型グラフェン光酸化に対するグラフェン形状とジュール熱 の効果	○松本 守広¹, 野内 亮¹	1.大阪府大N2RC
奨 11a-P6-32	酸化グラフェンの VUV 光マイクロ還元とその電気特性評価	○(M2)屠 宇迪¹, 宇都宮 徹¹, 一井 崇¹, 杉 村 博之¹	1.京大院工
11a-P6-33	真空紫外光照射により還元された酸化グラフェンのSTM観察	○(M1)中元 宏¹, 屠 宇迪¹, 楽満 啓亮², Om P. Khatri³, 一井 崇¹, 宇都宮 徹¹, 杉村 博之¹	1.京大院工, 2.京大工, 3.IIP
奨 11a-P6-34	熱電変換を志向したカーボンナノチューブのn型分子ドーピング	○野々口 斐之¹, 中野 元博¹, 河合 壯¹	1.奈良先端大物質
11a-P6-35	電気二重層キャリア注入により極性制御された半導体型単層カーボン ナノチューブ熱電デバイスの作製	○北村 典雅¹, 大島 侑己¹, 神田 翔平¹, 河合 英輝¹, 柳 和宏¹	1.首都大理工
奨 11a-P6-36	単一構造単層カーボンナノチューブ光学異性体の高純度的分離及 び光学特性	○魏 小均¹,都築 真由美¹,平川 琢也¹,蓬 田 陽平¹,平野 篤¹,藤井 俊治郎¹,田中 丈士¹,片浦 弘道¹	1.産総研ナノシス
11a-P6-37	カーボンナノチューブ-アゾベンゼン複合系の作製と光学応答	○笠松 大輝¹, 小山 剛史¹, 岸田 英夫¹	1.名大院工
奨 11a-P6-38	Raman分光法によるカーボンナノチューブフォレストの深さごとの構造評価	○(M1)石本 光輝¹, 小路 紘史¹, 関家 一樹¹, 古田 寛¹², 八田 章光¹²	1.高知工科大院, 2.高知工科大総研ナ ノテク
11a-P6-39	グラフェンのフェムト秒キャリアダイナミクスに及ぼす基板効果	○玉井 尚登¹, 山田 淳史¹, 重政 英史¹, 久津 間 保徳¹, 金子 忠昭¹	1. 関学大理工
11a-P6-40	SiC(000-1)C面上の島状グラフェンのラマンスペクトル解析	○田中 嘉人¹, 上村 獎平¹, Sanpon Vanta- sin¹, 久津間 保徳¹, 金子 忠昭¹, 尾崎 幸洋¹	1.関西学院大理工
11a-P6-41	接触抵抗改善によるグラフェンFETの高性能化	○(BC)小岩 匡¹, 岡 謙吾¹, 末光 哲也², 尾辻 泰一², 内野 俊¹	1.東北工大, 2.東北大通研
11a-P6-42	酸化グラフェン/シリコーン樹脂複合体の調製と物性評価	○(M1C)高橋 英史¹, 堂浦 剛², 林 靖彦¹, 仁 科 勇太¹.3	1.岡山大学, 2.星和電機, 3.JSTさきがけ
11a-P6-43	MoS <sub>2</sub> /Grapheneヘテロ構造の作製と特性評価	○佐藤 雄太¹, 大井 皓平¹, 何 柏寬¹, 田畑博史¹, 久保 理¹, 片山 光浩¹	1.阪大院工
11a-P6-44	金属ナノインクによるカーボンナノチューブ紡績糸の高導電率化	○上杉 祐生¹, 大饗 俊弘¹, 楠 拓真¹, 運天 政貴¹, 吉田 弥伸¹, 西川 亘¹, 山下 善文¹, 飯 島 徽¹, 林 靖彦¹	1.岡山大院自然
11a-P6-45	カーボンナノチューブ複合糸を用いた糸トランジスタの構造検討	○(M1)吉田 将俊¹, 大矢 剛嗣¹	1.横国大院工
11a-P6-46	電気物性が分離されたカーボンナノチューブを用いる酵素センサの動 作機構の解明	野脇 航平¹, 星野 達也², ○六車 仁志¹	1.芝浦工大院理工, 2.㈱ガステック
11a-P6-47	カーボンナノチューブ透明導電膜のヘイズ率測定	○小野田 侑太¹, 岸 直希¹, 斎藤 毅², 曽 我 哲夫¹	1.名工大, 2.産総研
11a-P6-48	カーボンナノチューブ自立膜を用いた軽量熱機関の創製	○生野 孝¹, 深野 達雄¹, 樋口 和夫¹	1.豊田中央研究所
11a-P6-49	グラフェンによる擬似的八木・宇田アンテナ(1)	○鈴木 哲¹, 日比野 浩樹¹	1.NTT物性基礎研
11a-P6-50	グラフェン黒体放射発光素子を用いた光通信	○天坂 裕也¹, 横井 智哉¹, 牧 英之¹	1.慶大理工
11a-P6-51	グラフェン高速広波長域光検出器開発と波長依存性	○石田 一樹¹, 牧 英之¹	1.慶應義塾大学理工学部物理情報 工学科
11a-P6-52	ヘリウムイオンビームを用いたサスペンデッドグラフェンの微細加工	○(M1)武市 旺大¹, 兼竹 望¹, ムルガナタ ン マノハラン¹, 八坂 行人¹², シュミット マレ ク¹, 水田 博¹³	1.北陸先端大, 2.日立ハイテクサイエンス, 3.サザンプトン大
奨 11a-P6-53	水素インターカレーションによるグラフェンナノリボンFETへのSiO $_{\!\!2}$ 基板の影響の除去	○(D)岩崎 拓哉¹, スン ジアン¹, 兼竹 望¹, 筑 葉 拓生¹, 赤堀 誠志¹, ムルガナタン マノハラ ン¹, 水田 博¹²	1.北陸先端大, 2.サザンプトン大
奨·E 11a-P6-54	Tuning the electronic properties of graphene nanoribbons by chemical functionalization	○(PC)Pablo Solis-Fernandez¹, Masaharu Tsuji¹, Hiroki Ago¹.²	1.IMCE, Kyushu Univ., 2.PRESTO - JST
11a-P6-55	有機強誘電体ゲートMoS <sub>2</sub> -FET構造の作製	広瀬 宗一郎¹, 小林 択平¹, 中嶋 宇史², 新家 義裕³, ○川江 健³, 森本 章治³	1.金沢大院自然, 2.東京理科大, 3.金 沢大理工
11a-P6-56	ナノシートCa <sub>2</sub> Nb <sub>3</sub> O <sub>10</sub> をゲート絶縁膜としたMoS <sub>2</sub> -FET構造の作製	〇小林 拓平¹, 広瀬 宗一郎¹, 内田 寛², 新家 義裕¹, 川江 健¹, 森本 章治¹	1.金沢大, 2.上智大

17.1	1 成長技術 /	Growth techn	ology       口頭講演					
	3月12日(木) 10:15 - 11:45							
	10:15 - 10:30	12a-D6-5	真空一貫プロセスによるCNT成長用Coナノ粒子形成法の研究	○桑田 大輔¹, 竹山 隆之介¹, 中野 博貴¹, 知 念 優弥¹, 星野 靖¹, 斎藤 保直¹, 中田 穣治¹	1.神奈川大理			
	10:30 - 10:45	12a-D6-6	ナノダイヤモンドからのカーボンナノチューブ成長における成長核粒子 径とCNT径の相関解析	○林 明生¹, 椎名 諒¹, 有福 達治², 清柳 典子², 小林 慶裕¹	1.大阪大工, 2.日本化薬			
	10:45 - 11:00	奨 12a-D6-7	無触媒CVD成長したカーポンナノチューブの評価	○(B)平野 優', 稲葉 優文', 渋谷 恵', 鈴木 和真', 李 智宇', 明道 三穂', 平岩 篤', 乗松 航², 楠 美智子², 川原田 洋¹	1.早大理工, 2.名大エコトピア研			
	11:00 - 11:15	12a-D6-8	アルコールガスソース法によるRh触媒からの単層カーボンナノチュ ープ成長	○(M1)小澤 顕成¹, 才田 隆広¹, 成塚 重弥 ¹, 丸山 隆浩¹	1.名城大理工			
	11:15 - 11:30	12a-D6-9	コバルトと鉄の積層膜を触媒とした熱フィラメントCVD法による単層カーボンナノチューブの低温成長の試み	鈴木 智貴¹, 金 時蒼¹, 川井田 雄介¹, 花山 友基¹, 丸山 一樹¹, 三木 敦史¹, ○石川 豊¹	1.日本工大工			
	11:30 - 11:45	12a-D6-10	多層カーボンナ/チューブと多層カーボンナ/コイルの合成のための 触媒担持材の検討	○飯田 哲生¹, 須田 善行¹, 滝川 浩史¹, 植仁志², 清水 一樹³, 梅田 良人⁴	1.豊橋技術科学大学, 2.東海カーボン, 3.湘南合成樹脂製作所, 4.東邦ガス			

		) 13:15 - 19:0			
寺	13:15 - 13:30	12p-D7-1	「講演奨励賞受賞記念講演」(15分) CVD成長MoS2薄膜を用いたグラフェン/MoS2/Si太陽電池の光 電変換特性	〇壷井 佑夏¹, 王 飛久¹, 小澤 大知¹, 宮内 雄平¹, 毛利 真一郎¹, 松田 一成¹	1.京大工ネ研
	13:30 - 13:45	12p-D7-2	SiC高指数面ファセット上に現れるグラフェン擬1次元構造	○林 真吾', 森田 康平', 梶原 隆司', ビシコフスキー アントン', 飯盛 拓嗣', 小森 文夫', 田中 宏和', 神田 昌申', 田中 悟'	1.九大院工, 2.東大物性研, 3.筑波大数理物質
	13:45 - 14:00	12p-D7-3	SiC上グラフェン成長とステップバンチングの関係	○(M2)安井 理¹, 乗松 航¹, 楠 美智子¹	1.名古屋大工
	14:00 - 14:15	12p-D7-4	Buffer-layer-free graphene on SiC(0001) by quenching menthod	○(P)Jianfeng Bao¹, Hiroshi Iwata², Wata- ru Norimatsu², Michiko Kusunoki¹	1.EcoTopia Science Institute. Nago University, 2.Department of Applie Chemistry. Graduate School of Eng neering. Nagoya University
	14:15 - 14:30	奨 12p-D7-5	Si基板上エピタキシャルグラフェンのNi援用低温形成とリアルタイム/ 角度分解光電子分光によるグラフェン化機構評価	〇長谷川 美佳!, 須藤 亮太!, 菅原 健太!, 三本菅 正太!, 原本 直樹!, 寺岡 有殿º, 吉越章隆², 吹留 博一 <sup>1</sup> , 末光 眞希 <sup>1,3</sup>	1.東北大通研, 2.原子力機構, 3.JST- CREST
	14:30 - 14:45	奨 12p-D7-6	レーザー誘起成長により形成されたSiC(0001)上グラフェンの成長 過程観察	○(M1)服部 正和', 池上 浩', 中村 大輔 ', 岡田 龍雄', 古川 一暁', 高村 真琴', 日 比野 浩樹'	1.九大, 2.NTT物性基礎研
	14:45 - 15:00	12p-D7-7	コンダクティブAFMによるSiC上に形成されたグラフェンの空間分布 評価	○稲本 拓朗¹, 佐藤 まり子¹, 藤井 健志¹	1.富士電機
	15:00 - 15:15	12p-D7-8	SiC単結晶薄膜ハイブリッドデバイス基板による高品質グラフェン成長	○吹留 博一 <sup>1</sup> , 秋山 昌次 <sup>2</sup> , 田島 圭一郎 <sup>1</sup> , 舩窪 一智 <sup>1</sup> , 未光 眞希 <sup>1</sup> , 小西 繁 <sup>2</sup> , 炭木 弘 <sup>2</sup> , 川合 信 <sup>2</sup> , 久保田 芳宏 <sup>2</sup> , 堀場 弘司 <sup>3</sup> , 組 頭 広志 <sup>3</sup>	1.東北大通研, 2.信越化学工業, 3.高エネ研
	15:15 - 15:30	奨 12p-D7-9	CVD法を用いた液体ガリウム触媒界面におけるグラフェン合成	○(M1)檜山 卓希 <sup>1,2</sup> , 村上 勝久 <sup>1,2</sup> , 藤田 淳 一 <sup>1,2</sup>	1.筑波大数理, 2.TIMS
	15:30 - 15:45	12p-D7-10	ガリウム蒸気触媒CVDによる絶縁基板上への大面積グラフェン合成	○村上 勝久¹², 田中 駿丞¹, 蛭川 彩夏¹, 檜山 卓希¹², 狩野 絵美¹³, 竹口 雅樹³, 藤田 淳一¹.²	1.筑波大数理, 2.TIMS, 3.NIMS
	15:45 - 16:00	奨 12p-D7-11	銅ナノ粒子表面におけるグラファイト化反応過程のその場観察	○伊藤 直人¹, 村上 勝久¹, 狩野 絵美¹², 竹口 雅樹², 藤田 淳一¹	1.筑波大数理, 2.物質·材料研究機構
	16:00 - 16:15		休憩/Break		
	16:15 - 16:30	12p-D7-12	原料分子形状が窒素ドーブグラフェン構造に与える影響	○加藤 時穂¹, 今村 岳¹, 小幡 誠司¹, 斉 木 幸一朗¹	1.東大院新領域
	16:30 - 16:45	12p-D7-13	グラフェンCVD成長における酸素分圧の影響	○(DC)寺澤 知潮¹, 斉木 幸一朗¹²	1.東大院理, 2.東大院新領域
	16:45 - 17:00	E 12p-D7-14	Visualizing Copper Assisted Transformation of Amorphous Carbon into Graphene by Current-Induced Annealing.	○(D)Mohamad Saufi Rosmi¹², Mohd Zamri Mohd Yusop¹³, Golap Kalita¹, Yazid Yaakob¹⁴, Chisato Takahashi¹, Masaki Tanemura¹	1.Nagoya Inst. of Tech., 2.Univ. P Sultan Idris, 3.Univ. Tech. Malays 4.Univ. Putra Malaysia
	17:00 - 17:15	E 12p-D7-15	A novel nanometer-level amorphous carbon coating method by direct pyrolysis of coronene without solvent and its application to the ${\rm LiFePO_4}$ cathode for ${\rm Li-ion}$ battery	○(P)ShuJun Ye¹, Akira Hasegawa¹, Hiroaki Kumakura¹, Eiki Yasakawa¹, Akihiro Nomura¹, Yoshimi kubo¹	1.NIMS
	17:15 - 17:30	奨 12p-D7-16	ボトムアップ・グラフェンナノリボンのエッチングフリー転写	○(PC)大伴 真名歩¹, 関根 佳明¹, 日比野 浩樹¹	1.NTT物性基礎研
	17:30 - 17:45	奨·E 12p-D7-17	Chemical vapor deposition growth of graphene with millimeter-scale grain size	OSHENGNAN WANG <sup>1</sup> , SATORU SUZUKI <sup>1</sup> , MAKOTO TAKAMURA <sup>1</sup> , HIROKI HIBINO <sup>1</sup>	1.NTT Basic Research Laboratorie
	17:45 - 18:00	12p-D7-18	酸化グラフェンのブラズマ還元による絶縁基板上へのグラフェン直 接成長	○佐藤 稔¹, 赤田 圭史¹, 寺澤 知潮², 小幡 誠司¹, 斉木 幸一朗¹.²	1.東大新領域, 2.東大院理
	18:00 - 18:15	12p-D7-19	太陽炉を用いた超高温・反応性雰囲気での酸化グラフェン処理による 高結晶性グラフェン形成	○石田 俊¹, 宮田 雄一郎¹, 篠田 佳彦², 小 林 慶裕¹	1.阪大院工, 2.若狭湾エネ研
	18:15 - 18:30	12p-D7-20	マイクロ波表面波プラズマCVDによる多数層グラフェン合成と紫外光 カットによる高品質化	○市村 進 <sup>1,2</sup> , 内田 秀雄 <sup>1</sup> , 脇田 紘一 <sup>1</sup> , 林 靖 彦 <sup>2</sup> , 梅野 正義 <sup>1</sup>	1.中部大, 2.岡山大院
	18:30 - 18:45	奨 12p-D7-21	プラステックフレキシブル基板上でのグラフェン直接合成	〇石橋 祐輔¹, 金井 康¹, 大野 恭秀¹², 前橋 兼三¹³, 井上 恒一¹, 松本 和彦¹	1.阪大産研, 2.徳島大, 3.東京農工
	18:45 - 19:00	奨 12p-D7-22	量産に向けたプラズマCVDグラフェンの成長初期過程観察	○加藤 隆一¹, 南 聡史¹, 沖川 侑揮¹², 石原 正統¹², 山田 貴壽¹², 長谷川 雅考¹²	1.TASC, 2.産総研ナノチューブ応用
	3月14日(土)	14:30 - 15:1	15		
	14:30 - 14:45	14p-D7-7	BaF₂基板上のアルコールCVD グラファイティックカーボン成長	○(M1)曇 艶¹, 中村 篤志¹, 久保野 敦史¹	1.静大院工
	14:45 - 15:00	奨 14p-D7-8	WドープNbS <sub>2</sub> 原子層の成長と評価	○佐々木 将悟¹, 真庭 豊¹, 宮田 耕充¹²	1.首都大理工, 2.JST さきがけ
	15:00 - 15:15	14p-D7-9	ミストアニールによる二硫化モリブデン(MoS2)層状膜作製への挑戦	○(B)佐藤 翔太¹, 川原村 敏幸¹.², 古田 守².3	1.高知工大シス工, 2.総研, 3.環境理

17	17.2 構造制御・プロセス / Structure control and process 口頭講演							
	3月12日(木) 9:00 - 11:45							
	9:00 - 9:15	12a-D7-1	Cu基板表面の酸化に伴うCVD合成されたグラフェン結晶の構造変化	○Golap Kalita¹, Sharma Subash¹, Papon Remi¹, 種村 真幸¹	1.名工大			
	9:15 - 9:30	奨 12a-D7-2	グラフェンの亀裂におけるジグザグ端の選択的な形成	○(D)藤原 美帆¹, 井上 凌介², 真庭 豊², 篠 原 久典¹, 宮田 耕充²³	1.名大院理, 2.首都大理工, 3.JSTさ きがけ			
	9:30 - 9:45	12a-D7-3	Free-standingグラフェン膜のラマン分光とTEMによる層数評価	○山崎 憲慈!, 前原 洋祐!, 中川 佐知子!, 田中 由紀子!, 河田 周二郎!, 木村 浩一朗!, 内田 努¹, 郷原 一寿¹	1.北大工			
	9:45 - 10:00	12a-D7-4	バイオセンサー応用に向けたグラフェン上ピレン吸着密度制御の検討	○松井 祐司¹, 根岸 良太¹, 小林 慶裕¹	1.阪大院工			
	10:00 - 10:15	12a-D7-5	窒素中性粒子ビームによる窒素ドープグラフェンの構造制御	○岡田健¹, 寒川 誠二¹²	1.東北大流体研, 2.東北大WPI-AIMR			
	10:15 - 10:30	12a-D7-6	ヘリウムイオンビームによるグラフェンへのナノ構造直描	○内藤 裕一¹, 飯島 智彦¹, 小川 真一¹	1.産総研ナノエレクロトニクス研究部門			
	10:30 - 10:45	E 12a-D7-7	Observing graphene and graphite by nitrogen ion beam microscopy	○(P)Marek Schmidt¹, Anto Yasaka²¹, Hiroshi Mizuta¹.³	1.JAIST, 2.Hitachi High-Tech Science, 3.Univ. of Southampton			
	10:45 - 11:00	12a-D7-8	HSQ塗布によるSiC上グラフェンのキャリア濃度変化	○(M2)小田 達也¹, 小林 慶祐¹, 有月 琢哉¹, 青木 翔¹, 永濱 拓也¹, 永瀬 雅夫¹	1.徳島大学			

	11:00 - 11:15	12a-D7-9	グラフェン/SiC界面のSiインターカレーションにおける界面構造と電子状態	○(M2)木本 真一¹, 飯盛 拓嗣², Anton Visikovskiy¹, 梶原 隆司¹, 小森 文夫², 田 中 悟¹	1.九大院工, 2.東大物性研
	11:15 - 11:30	12a-D7-10	UV/O <sub>3</sub> 処理による酸化グラフェンシートのエッチング	○清水 亮宏¹, 小幡 誠司², 斉木 幸一朗¹²	1.東大院理, 2.東大院新領域
	11:30 - 11:45	12a-D7-11	加熱金属メッシュで生成した原子状水素による酸化グラフェンの還元	○部家 彰¹, 松尾 直人¹	1.兵庫県立大工
	3月12日(木)	9:15 - 10:15	5		
招待	9:15 - 9:30	12a-D6-1	「講演奨励賞受賞記念講演」(15分) 混合界面活性剤を用いたカーボンナノチューブの単一構造分離	〇蓬田 陽平¹, 都築 真由美¹, 魏 小均¹, 平野 篤¹, 藤井 俊治郎¹, 田中 丈士¹, 片浦 弘道¹	1.産総研ナノシステム
	9:30 - 9:45	12a-D6-2	湿式ジェットミル法を用いたカーボンナノチューブ分散液の作製およ び評価	○(M2)あるもわっらい あなす¹, 庄 善之¹	1.東海大工
	9:45 - 10:00	12a-D6-3	単層カーボンナノチューブのアンジップ経時変化	○福森 稔¹, 田中 啓文², 田中 大輔¹, 小 川 琢冶¹	1.阪大院理, 2.九工大院生命体
	10:00 - 10:15	E 12a-D6-4	Self-Assembly of Graphene- and Carbon-Nanotubes-Based Structures from Rice Husks using Microwave Plasma Irradiation	OZhipeng Wang¹, Hironori Ogata², Shingo Morimoto¹, Josue Ortiz-Medina¹, Masatsugu Fujishige¹, Kenji Takeuchi¹, Hiroyuki Muramatsu¹, Takuya Hayashi¹, Mauricio Terrones², Yoshio Hashimoto¹, Morinobu Endo¹	1.Shinshu Univ, 2.Hosei Univ, 3.The Pennsylvania State Univ
	3月13日(金)	18:30 - 19:0	00		
	18:30 - 18:45	13p-D8-10	電流計測AFMによる水素終端化シリコン基板上に固定した酸化グラフェンの局所電気特性評価	○(M1)國府 翔¹, 屠 宇迪¹, 一井 崇¹, 宇都 宮 徹¹, 杉村 博之¹	1.京大院工
	18:45 - 19:00	13p-D8-11	金(111)表面上スマネン分子のSTM計測	○藤井 慎太郎¹, Ziatdinov Maxim¹, 木口 学¹, 東林 修平², 櫻井 英博³	1.東工大院理, 2.分子研, 3.阪大院工

<b>新機能探索</b>	・基礎物性評価	${\mathbb E}$ / Exploration of new functions and evaluation of	basic properties	口頭講演
3月11日(水)	16:45 - 18	:00		
16:45 - 17:00	11p-D8-1	グラフェンナノ構造における光学特性のサイズ依存性評価	○石田 周太郎¹, 田中 隆介¹, 笹木 敬司¹	1.北大電子研
17:00 - 17:15	11p-D8-2	テラヘルツ時間領域分光法によるグラフェン光学伝導度の基板及び 温度依存性	○川野 慎也¹, 大城 誠¹, Nicole Moody², 川 山 巌¹, Minjie Wang², 河野 淳一郎², Rob- ert Vajtai², Pulickel Ajayan², 斗內 政吉¹	1.阪大レーザー研, 2.ライス大学
17:15 - 17:30	11p-D8-3	窒素ドープグラフェン上の酸素還元反応	○(M2)市川 諒英 <sup>1,2</sup> , 赤石 暁 <sup>1,2</sup> , 中村 淳 <sup>1,2</sup>	1.電通大院先進理工, 2.JST-CRES
17:30 - 17:45	11p-D8-4	単層酸化グラフェンに吸着したセシウムイオンの電子状態	○圓谷 志郎¹, 本田 充紀², 下山 巌², 岡本 芳浩², 楢本 洋¹, 矢板 毅², 境 誠司¹	1.原子力機構先端基礎, 2.原子力 量子ビーム
17:45 - 18:00	11p-D8-5	フォノン制御したグラフェンのゼーベック係数	○安野 裕貴¹, 竹井 邦晴¹, 秋田 成司¹, 有 江 隆之¹	1.大阪府大院工
3月13日(金)	9:00 - 11:4	ļ5		
9:00 - 9:15	13a-D8-1	電極接合に起因する二層グラフェンのバンドギャップ	○野内 亮¹	1.大阪府立大
9:15 - 9:30	13a-D8-2	グラフェン電界効果トランジスタにおける電極接続の影響の軽減	片倉 健太¹, 伊藤 優¹, 田中 宏和¹, 平出 璃音可¹, 大塚 洋一¹, 友利 ひかり¹², ○神田 晶申¹	1.筑波大, 2.JSTさきがけ
9:30 - 9:45	奨 13a-D8-3	コンダクタンス法による2層グラフェンのギャップ内準位解析	○金山 薫¹, 長汐 晃輔¹²	1.東大マテリアル, 2.JST-さきがけ
9:45 - 10:00	13a-D8-4	グラフェン層成長により形成した多層グラフェンナノリボンの電気伝 導特性	○北川 治樹¹, 根岸 良太¹, 田中 啓文³, 福森 稔², 小川 琢治², 小林 慶裕¹	1.阪大院工, 2.阪大院理, 3.九工大
10:00 - 10:15	13a-D8-5	レジスト熱収縮を用いたグラフェンへの歪み印加	○高村 真琴¹, 日比野 浩樹¹	1.NTT物性基礎研
10:15 - 10:30	奨 13a-D8-6	グラフェン上ALD-Y $_2$ O $_3$ 推積におけるバッファー層への高圧酸素アニールによる容量向上	○高橋 伸尭¹, 長汐 晃輔¹²	1.東大院工, 2.JST-さきがけ
10:30 - 10:45	13a-D8-7	SiC上成長擬似フリースタンディンググラフェンのconductive AFM 測定	○高瀬 恵子¹, Tran Minh Tien¹², 古川 一 暁¹, 高村 真琴¹, 日比野 浩樹¹	1.NTT物性基礎研, 2.長岡技科大
10:45 - 11:00	奨 13a-D8-8	AFMを用いたナノスケールでのグラフェンの弾性力評価	○猪狩 智彦¹², 村上 勝久¹², 藤田 淳一¹.²	1.筑波大数理, 2.TIMS
11:00 - 11:15	奨 13a-D8-9	加熱/冷却系を用いたh-BN上へのグラフェンのPMMA乾式転写	○ウワンノー ティーラユット <sup>1</sup> , 谷口 尚 <sup>2</sup> , 渡邊 賢司 <sup>2</sup> , 長汐 晃輔 <sup>1,3</sup>	1.東大, 2.NIMS, 3.JST-さきがけ
11:15 - 11:30	奨 13a-D8-10	ジグザグエッジ導入グラフェンの電気化学的物性	○田村 直貴¹, 笘居 高明¹, 本間 格¹	1.東北大多元研
11:30 - 11:45	奨 13a-D8-11	グラフェン電界効果トランジスタの光メモリ効果	○石田 昌平¹, 安野 裕貴¹, 有江 隆之¹, 竹井 邦晴¹, 竹内 雅人¹, 松岡 雅也¹, 秋田 成司¹	1.大阪府大工
3月13日(金)	9:30 - 11:4	15		
9:30 - 9:45	13a-D7-1	ホウ素ドープ最密充填カーボンナノチューブ膜の電気伝導測定	○乗松 航¹, 小田 晃司¹, 藤田 隼人¹, 楠 美智子²	1.名大院工, 2.名大エコ研
9:45 - 10:00	13a-D7-2	半導体SWNT分散薄膜のガスセンシングメカニズム	○田畑 博史¹, 松竹 直斗¹, 久保 理¹, 片 山 光浩¹	1.阪大工
10:00 - 10:15	13a-D7-3	SWCNTフィルムの熱電物性:半導体型・金属型混合の効果	○林 大介¹, 中井 祐介¹, 客野 遥¹, 柳 和宏¹, 宮田 耕充¹², 真庭 豊¹, 山本 貴博³	1.首都大理工, 2.JSTさきがけ, 3.東 理科大学
10:15 - 10:30	13a-D7-4	カーボンナノコイルの温度依存による物性評価	○高木 昭宏¹, 北川 淳嗣¹, 北村 翔¹, 飯田 民夫¹, 中村 康史², 須田 善行²	1.岐阜高専, 2.豊橋技科大
10:30 - 10:45	13a-D7-5	単一のカーボンナノコイルを対象とした電気特性測定系の構築と電気 特性に与える黒鉛化処理の影響	○中村 康史!, 須田 善行!, 滝川 浩史!, 植仁志², 清水 一樹³, 梅田 良人⁴, 島 弘幸⁵	1.豊技大工, 2.東海カーボン, 3.湘南樹脂製作所, 4.東邦ガス, 5.山梨大
10:45 - 11:00	13a-D7-6	(5,4)(6,4)(6,5)(8,6)カーボンナノチューブ酸化過程の第一原理計算	○大淵 真理¹	1.富士通研
11:00 - 11:15	13a-D7-7	乾燥下におけるセルロース分散カーボンナノチューブの光学遷移	○伊藤 雅浩¹, 川田 康平¹, 矢島 博文¹, 本間 芳和¹	1.東理大理
11:15 - 11:30	奨 13a-D7-8	単層カーポンナノチューブを用いた室温・通信波長帯域でのフォトンア ンチバンチング測定	○遠藤 匠¹, 早瀬 潤子¹, 牧 英之¹	1.慶大理工
11:30 - 11:45	13a-D7-9	大気イオンに曝された単層ナノチューブの光学特性	○稲葉 工¹, 本間 芳和¹	1.東理大理

16:15 - 16:30	13p-D8-1	単層WSe <sub>2</sub> 膜を用いた電気二重層発光ダイオード	○(M1)藤本 太陽 <sup>1</sup> , 蒲 江 <sup>1</sup> , Jing-Kai Huang <sup>2</sup> , Lain-Jong Li <sup>2</sup> , 坂上 知 <sup>1</sup> , 竹延 大 志 <sup>1,3</sup>	1.早大先進, 2.Academia Sinica, 3.早 大材研
16:30 - 16:45	E 13p-D8-2	Measuring Photo-oxidation Effect in $\mathrm{WS}_2$ Nanosheets using Laser Terahertz Emission Spectroscopy	○Jofferson Gonzales¹, F.R. Bagsican¹, Iwao Kawayama¹, Hironaru Murakami¹, A. Winchester², S. Ghosh², S. Talapatra², Masayoshi Tonouchi¹	1.Osaka Univ., 2.SIU-Carbondale
16:45 - 17:00	13p-D8-3	単原子層遷移金属ダイカルコゲナイドへテロ構造における発光特性	○(PC)毛利 真一郎¹, 小澤 大知¹, 宮内 雄平¹, 江田 剛輝², 松田 一成¹	1.京大エネ研, 2.シンガポール国立大
17:00 - 17:15	奨 13p-D8-4	原子層ヘテロ構造における光キャリアの電荷分離と緩和機構	○(DC)小澤 大知¹, Ivan Verzhbitskiy², Alexandra Carvalho², A. H. Castro Neto², 松田 一成¹, 江田 剛輝²	1.京都大エネ研, 2.シンガポール国立大
17:15 - 17:30	13p-D8-5	グラフェン/MoSe <sub>2</sub> van der Waalsヘテロ構造における電流変調	○佐田 洋太¹, 守谷 頼¹, 矢吹 直人¹, 増渕 覚¹², 町田 友樹¹²	1.東大生産研, 2.東大ナノ量子機構
17:30 - 17:45	13p-D8-6	グラフェン/MoS』全属〜テロ構造の面直伝導におけるグラフェンの 状態密度の効果	○守谷 賴¹, 山口 健洋¹, 井上 義久¹, 佐田 洋太¹, 森川 生¹, 増渕 覚¹², 町田 友樹¹²	1.東大生産研, 2.東大ナノ量子機構
17:45 - 18:00	13p-D8-7	層状カルコゲナイド ${ m WS}_2$ トンネルバリアの特性	○守谷 頼¹, 山口 健洋¹, 井上 義久¹, 森川 生¹, 増渕 覚¹², 渡邊 賢司³, 谷口 尚³, 町 田 友樹¹²	1.東大生産研, 2.東大ナノ量子機構, 3.4 材機構
18:00 - 18:15	奨 13p-D8-8	h-BNのLayer-by-Layer絶縁破壊	○服部 吉晃¹, 谷口 尚², 渡邊 賢司², 長 汐 晃輔¹.³	1.東大マテ, 2.物材機構, 3.JST-さきがり
18:15 - 18:30	13p-D8-9	hBN 基板中の空孔のグラフェンの伝導への影響の第一原理解析	○金子 智昭1.2, 大野 隆央1.2.3	1.物質・材料研究機構, 2.高効率電デバコンソ, 3.東大生産研

アハイス心)	用 / Device ap <sub>l</sub>	plications		
3月12日(木	13:15 - 16:4	45		
13:15 - 13:30	12p-D6-1	電気二重層キャパシタ活性炭電極へのカーボンオニオン添加の効果	○石井 湧太¹, 青野 祐子¹, 平田 敦¹	1.東工大院
13:30 - 13:45	奨 12p-D6-2	SiC上カーボンナノチューブフォレストのパターニング形成のための耐超高温ZnO/Cマスク	○稲葉 優文¹, 李 智宇¹, 鈴木 和真¹, 渋谷 恵¹, 明道 三穂¹, 平野 優¹, 乗松 航², 楠 美 智子², 川原田 洋¹	1.早大先進理工, 2.名大エコトビ
3:45 - 14:00	奨 12p-D6-3	カーボンナノチューブ機械振動子の支持強度の振動への影響	○猪谷 健志¹, 安田 正明¹, 有江 隆之¹, 竹井 邦晴¹, 秋田 成司¹	1.阪府大工
14:00 - 14:15	12p-D6-4	相補型ペーパートランジスタの開発	○(B)松井 洸樹¹, 浜名 良樹¹, 大矢 剛嗣¹	1.横国大理工
14:15 - 14:30	奨 12p-D6-5	イオン液体による電気二重層ゲートを用いたカーボンナノチューブ単電子トランジスタの量子状態の制御	○(B)鎌田 果歩¹, 清家 康平¹, 金井 康¹, 大 野 恭秀¹², 前橋 兼三¹³, 井上 恒一¹, 松 本 和彦¹	1.阪大産研, 2.徳島大, 3.東京農
4:30 - 14:45	奨 12p-D6-6	異種無機材料集積によるフレキシブルCMOS回路	○本田 航¹, 有江 隆之¹, 秋田 成司¹, 竹 井 邦晴¹	1.大阪府大
4:45 - 15:00	12p-D6-7	カーポンナノチューブ複合紙による熱電発電デバイスの開発	○(B)稲垣 忠光¹, 大矢 剛嗣¹	1.横国大理工
15:00 - 15:15		休憩/Break		
15:15 - 15:30	12p-D6-8	ナノダイヤモンドから成長したカーボンナノチューブ薄膜の密度・長さ 制御とそのバイオセンサ応用	○加瀬 寛人¹, 根岸 良太¹, 有福 達治², 清柳 典子², 小林 慶裕¹	1.阪大院工, 2.日本化薬(株)
5:30 - 15:45	奨 12p-D6-9	帯電電荷によるカーボンナノチューブ機械共振の高Q値化	○安田 正明¹, 竹井 邦晴¹, 有江 隆之¹, 秋 田 成司¹	1.大阪府大工
5:45 - 16:00	奨·E 12p-D6-10	Highly Efficient and Flexible Organic Solar Cells Using Single-Walled Carbon Nanotube Films Doped with Strong and Safe ${\rm MoO}_{_{\chi}}$ Dopant	○(D)Il Jeon¹, Kehang Cui¹, Takaaki Chi- ba¹, Albert Nasibulin², Esko Kauppinen², Shigeo Maruyama¹, Yutaka Matsuo¹	1.Univ. of Tokyo, 2.Aalto Univ
6:00 - 16:15	12p-D6-11	カーボンナノチューブ塗料による塗工型色素増感太陽電池の高効 率化	○(B)松永 悠樹¹, 大矢 剛嗣¹	1.横国大理工
6:15 - 16:30	12p-D6-12	One-step電着法によるナノカーボン材料へのPt-Ruナノ粒子の担持状態および電極触媒特性評価	○吉竹 晴彦¹, 早瀬 勝平¹, 王 志朋², 緒 方 啓典¹	1.法政大院理工, 2.信州大工
6:30 - 16:45	12p-D6-13	イオン照射によるナノカーボン材料の欠陥構造の制御およびOne-step 電着法によるPtナノ粒子の担持状態の解析	○早瀬 勝平¹, 吉竹 晴彦¹, 西村 智朗², 王 志朋³, 緒方 啓典¹⁴	1.法政大院, 2.法政大イオン研, 大, 4.法政大学マイクロ・ナノテク研
3月14日(土	) 9:00 - 12:00	0		
9:00 - 9:15	14a-D7-1	高品質エピタキシャルグラフェンを用いたGFETの特性評価	○須藤 亮太¹, 舘野 泰範², 吹留 博一¹, 末 光 眞希¹	1.東北大通研, 2.住友電工伝デ
9:15 - 9:30	奨 14a-D7-2	SiNゲートスタックによる高キャリア移動度グラフェンチャネルFET	○玉虫 元¹, 菅原 健太¹, Mastura binti Hus- sin¹, 未光 哲也!, 須藤 亮太¹, 吹留 博一¹, 末 光 眞希¹, 尾辻 泰一¹	1.東北大 通研
9:30 - 9:45	14a-D7-3	グラフェン/シリコンショットキー接合太陽電池	○アディカリスディープ¹, 内田 秀雄¹, 安林 幹翁¹, 河原 敏男¹, 梅野 正義¹	1.中部大
9:45 - 10:00	奨 14a-D7-4	グラフェン光検出器の高感度化に向けた構造検討	〇嶋谷 政彰¹, 小川 新平¹, 藤澤 大介¹, 金井康², 大野 恭秀², 前橋 兼三², 松本 和彦²	1.三菱電機, 2.阪大産研
0:00 - 10:15	14a-D7-5	グラフェンによる擬似的八木・宇田アンテナ(2)	○鈴木 哲¹, 日比野 浩樹¹	1.NTT物性基礎研
0:15 - 10:30	14a-D7-6	グラフェントンネルトランジスタの第一原理解析	○(M1C)鈴木 俊英¹, ハマム アーメド¹, ムル ガナタン マノハラン¹, 水田 博¹²	1.北陸先端大, 2.サザンプトン大
0:30 - 10:45	14a-D7-7	トップゲート型サスペンデッドグラフェンNEMSスイッチの特性評価	○(M2)筑葉 拓生¹, ムルガナタン マノハラン¹, 水田 博¹²	1.北陸先端大, 2.サザンプトン大
0:45 - 11:00	14a-D7-8	グラフェンカンチレバー型NEMSスイッチの作製と評価	○(M2)兼竹 望 <sup>1,2</sup> , ムルガナタン マノハラン <sup>1,2</sup> , 水田 博 <sup>1,2</sup>	1.北陸先端大, 2.サザンプトン大
1:00 - 11:15	奨 14a-D7-9	三脚構造分子をリンカーとしたアプタマー修飾グラフェンFETを用いたIgE検出	○(8)林 亮太', 麻植 丈史', 生田 昂', 金井康', 大野 恭秀'², 前橋 兼三'³, 井上恒一', 田代 彩', 家 裕隆', 安蘇 芳雄', 松本 和彦'	1.阪大産研, 2.徳島大, 3.農工大
1:15 - 11:30	14a-D7-10	グラフェン電界効果トランジスターにおけるフェリチン吸着の効果	○Mulyana Yana¹, 上沼 睦典¹, 岡本 尚文¹, 石河 泰明¹, 山下 一郎¹, 浦岡 行治¹	1.奈良先端大
1:30 - 11:45	E 14a-D7-11	Role of the electric field in the carbon dioxide molecule adsorption on graphene: Density functional theory simulation	○Manoharan Muruganathan¹, Hiroshi Mizuta¹.²	1.JAIST, 2.Univ. of Southampt
1:45 - 12:00	14a-D7-12	Pdナノドットで修飾したグラフェンナノリボンを用いた水素センサ	○竹内 豪¹, 星野 伸介¹, 宮田 耕¹, 高橋 綱 己¹², 内田 建¹²	1.慶應大理工 電子工, 2.JST C

3月14日(土) 13:00 - 14:30						
13:00 - 13:15	14p-D7-1	酸処理法によるシリコン酸化膜上グラフェンの歪とドービング除去	増田 祥也¹, ○佐野 正人¹	1.山形大院理工		
13:15 - 13:30	14p-D7-2	グラフェン/金属電極複合構造の電気伝導特性	○實宝 秀幸1.2, 岡田 晋2, 大淵 真理1	1.富士通研, 2.筑波大		
13:30 - 13:45	奨 14p-D7-3	Au/Cr/MoS2 系におけるCr 薄膜化によるコンタクト抵抗特性の改善	○佐野 宏亮¹, 高橋 綱己¹², 内田 建¹²	1.慶應大理工 電子工, 2.JST CREST		
13:45 - 14:00	14p-D7-4	$\mathrm{HfO}_{2}$ 絶縁膜を用いた $\mathrm{MoS}_{2}$ FETにおける実効移動度の評価	○二之宮 成樹',森 貴洋',内田 紀行',久保 利隆',渡辺 英一郎',津谷 大樹',森山 悟士 ³,田中 正俊',安藤 淳'	1.横国大院工, 2.産総研, 3.物材機構		
14:00 - 14:15	14p-D7-5	${ m MoS_2}$ チャネルに対する水分子吸着の影響	〇小林 拓平¹, 広瀬 宗一郎¹, 新家 義裕¹, 川 江 健¹, 森本 章治¹	1.金沢大		
14:15 - 14:30	14p-D7-6	薄膜HfS $_2$ FET	○金澤 徹¹, 雨宮 智宏¹³, 石川 篤²³, 鶴田 健二², 田中 拓男³⁴, 宮本 恭幸¹	1.東工大院理工, 2.岡山大院自然, 3.理 研, 4.北大電子研		

セッションK	ワイドギャップ	酸化物半導体材料・デバイス / Joint Session K	ポスター講演	
	9:30 - 11:3		итлух	
	13a-P18-1	触媒反応生成高エネルギーH <sub>2</sub> O ビームのエネルギー状態	〇叶内 慎吾¹, 中村 友紀¹, 玉山 泰宏¹, 安 井 寛治¹	1.長岡技科大工
	13a-P18-2	MnドービングがZnOホモエビタキシャル薄膜成長過程に与える影響	〇岩崎 裕徳¹, 野瀬 幸則¹, 吉村 武¹, 芦田淳¹, 藤村 紀文¹	1.大阪府立大院工
	13a-P18-3	水素導入による酸化亜鉛の電気特性変化	伊藤 弘樹¹, ○安部 功二¹	1.名古屋工業大
	13a-P18-4	ZnOサブミクロンロッドの光学的特性	○鈴木 聡¹, 木田 正紀¹, 古川 俊介¹, 星野 慧一¹	1.木更津高専
	E 13a-P18-5	Physical Property Evaluation of ZnO Thin Film Fabricated by Low-temperature process for Flexible Transparent Devices	O(M2)Hiraku Watanabe¹, Adie Bin Mohd Khafe¹, Hiroshi Yamuchi¹, Shigekazu Kuni- yoshi¹, Masatoshi Sakai¹, Masaaki Iizuka², Kazuhiro Kudo¹	1.Grad. Sch. Chiba. Univ., 2.Cl Univ.
	13a-P18-6	マルチプラズマイオンプレーティングに向けた低シート抵抗ZnO透明 導電膜の連続合成装置の開発	○佐藤 直幸¹, 大木 浩², 根矢 和次², 佐藤 達志²	1.茨城大院理工, 2.株式会社ビー
	13a-P18-7	スパッタリング法によるAZO膜の電気特性に与える投入電力の影響	○正力 幹也¹, 井上 創太¹, 菊池 大樹¹, 杉浦怜¹, 舩木 修平¹, 山田 容士¹	1.島大総理工
	13a-P18-8	高密度Zn-O₂混合プラズマ中におけるZnO導電膜の透明度遷移領域の観察	〇野中 翔太¹, 竹田 直樹¹, 佐藤 直幸¹, 池 畑 隆¹	1. 茨城大院理工
	奨 13a-P18-9	塗布法による酸化亜鉛ナノ粒子層pn接合の作製と評価	○糸原 大貴¹, 篠原 風人¹, 吉田 俊幸¹, 藤田 恭久¹	1.島根大院総理工
	奨 13a-P18-10	n型酸化亜鉛発光層を用いた酸化亜鉛ナノ粒子塗布型紫外線発光ダイオードの作製	○清山 拓史¹, 平儀野 雄斗¹, 阿部 耕介 ², 橋本 英樹³, リン ジェイ³, 吉田 俊幸¹, 藤 田 恭久¹	1.島根大院総理, 2.島根大総理, 大戦略的研究C
	13a-P18-11	ガリウムアセチルアセトナートを用いた酸化ガリウムのMOCVD成長	高橋 映成¹, ○安田 隆¹, 中込 真二¹, 國 分 義弘¹	1.石巻専修大理工
	13a-P18-12	ミストエピタキシー法によるα型酸化ガリウムの横方向選択成長(ELO)	〇高塚 章夫¹, 織田 真也¹, 金子 健太郎², 藤田 静雄², 人羅 俊実¹	1.株式会社FLOSFIA, 2.京大院
	13a-P18-13	ワイドギャップ半導体 $\beta$ -Ga $_2$ O $_3$ 単結晶のテラヘルツ波反射測定によるキャリア密度評価	○齋藤 伸吾', 尾沼 猛儀1 <sup>2,3</sup> , 佐々木 公平 <sup>1,4</sup> , 倉又 朗人 <sup>4</sup> , 関根 徳彦 <sup>1</sup> , 笠松 章史 <sup>1</sup> , 東 脇 正高 <sup>1</sup>	1.情通機構, 2.東京高専, 3.工学 4.タムラ製作所
	13a-P18-14	ミストCVDによって作製したコランダム型酸化インジウム $(\alpha$ -In $_2$ O $_3$ )の 特性評価	○(B)須和 祐太¹, 川原村 敏幸¹, 小島 一信 ², 秩父 重英²	1.高知工大シス工, 2.東北大多元
	13a-P18-15	サファイア上にミストCVD成長させた $\alpha$ -Fe $_2$ O $_3$ (0001)薄膜のCAICISSによる表面構造解析	○尾坂 駿¹, 丹波 大樹¹, 高橋 一暉¹, 織田 真也²², 金子 健太郎², 田畑 博史¹, 久保 理¹, 藤田 静雄², 片山 光浩¹	1.阪大院工, 2.京大院工, 3.FLO(株)
	13a-P18-16	GaとH <sub>2</sub> Oを原料とする大気圧化学気相堆積法による $\beta$ -Ga <sub>2</sub> O <sub>3</sub> 薄膜及びナノ構造の成長	○寺迫 智昭 <sup>1</sup> , 一ノ谷 光 <sup>2</sup> , 宮田 晃 <sup>2</sup> , 矢 木 正和 <sup>3</sup>	1.愛媛大院理工, 2.愛媛大工, 3. 高専
	13a-P18-17	ヘテロ接合を用いたDLTS法によるIGZO薄膜のトラップ準位の評価(2)	○小坂 修司¹, 横田 嘉宏¹, 岡田 廣¹	1.コベルコ科研
	奨 13a-P18-18	滴下法により形成したZnOナノ粒子層のMES-FET応用のための基 礎的検討	○篠原 風人¹, 糸原 大貴¹, 吉田 俊幸¹, 藤 田 恭久¹	1.島根大院総理
	13a-P18-19	SiN:Fゲート絶縁膜を用いた高信頼性a-InGaZnO薄膜トランジスタの 界面における結合状態の解析	○(DC)山崎 はるか¹, 石河 泰明¹, 藤井 茉美¹, 高橋 英治², 安東 靖典², 浦岡 行治¹	1.奈良先端大, 2.日新電機
	13a-P18-20	In-Ga-Zn-O薄膜トランジスタにおけるバッシベーション膜の効果 〜フッ素含有酸化シリコン・酸化シリコン/窒化シリコン積層バッシベ ーション〜	○辰岡 玄悟¹, Jingxin Jiang¹, Dapeng Wang¹², 古田 守¹²	1.高知工大環境理工, 2.高知工力
	13a-P18-21	ブラズマ処理によるIGZO TFTのソース・ドレイン領域形成 〜ガス種と基板バイアスが抵抗率およびその熱的安定性に及ぼす効果〜	○曲 勇作¹, Dapeng Wang¹², 古田 守¹.²	1.高知工大環境, 2.高知工大総研
	13a-P18-22	In-Ga-Zn-O薄膜トランジスタにおけるソース・ドレイン電極プラズマエッチングダメージと実効チャネル長への影響	○是友 大地¹, 戸田 達也¹, ワン ダーパン 1², 古田 守¹.²	1.高知工大環境理工, 2.高知工力

•	合同セッションK	ワイドギャップ	プ酸化物半導体材料・デバイス / Joint Session K	口頭講演				
	3月11日(水) 9:30 - 11:45							
	9:30 - 9:45	11a-D1-1	酸化亜鉛透明導電膜を感ガス材とした高速高出力電流水素センサー	○山本 哲也¹, 野本 淳一¹, 牧野 久雄¹, 岸 本 誠一²	1.高知工科大総研, 2.高知高専機械 工学科			
	9:45 - 10:00	11a-D1-2	2段階アニールによるNb:Ti $O_2$ 透明導電膜作製プロセスウィンドウの拡大	○中尾 祥一郎 <sup>1,2</sup> , 廣瀬 靖 <sup>1,2,3</sup> , 長谷川 哲也 <sup>1,2,3</sup>	1.KAST, 2.CREST, 3.東大理			
	10:00 - 10:15	11a-D1-3	ポリカーボネート基板上V添加ZnO薄膜の低温成膜と評価	○鈴木 智也¹, 千葉 博², 安倍 大², 川島 知 之¹², 鷲尾 勝由¹²	1.東北大工, 2.東北大院工			
	10:15 - 10:30	11a-D1-4	AZO透明導電膜における表面テクスチャ構造の制御と最適化	○山中 俊憲¹, 宇於崎 涼介¹, 宮田 俊弘 ¹, 南 内嗣¹	1.金沢工大 OEDS R&D センター			
	10:30 - 10:45		休憩/Break					
	10:45 - 11:00	11a-D1-5	多結晶AZO透明導電膜のキャリア輸送現象に対する結晶粒界の影響	○宇於崎 涼介¹, 山中 俊憲¹, 宮田 俊弘¹, 南 内嗣¹	1.金沢工大 OEDS R&D センター			

	11:00 - 11:15	11a-D1-6	ZnO膜中にドープしたEuトナーと水素の働き	○赤沢 方省1	1.NTT DIC
	11:15 - 11:30	11a-D1-0		○ 森田 晋也¹, 伊藤 寿², 樋口 祐次², 尾澤	1.(株)神戸製鋼所, 2.東北大工
	11:15 - 11:50		Tight-Binding量子分子動力学法を用いたアモルファスIGZOの構造計算	伸樹², 久保 百司²	
	11:30 - 11:45	11a-D1-8	ESRを用いたIGZO薄膜の評価	○野中 裕介', 黒澤 陽一', 小松 良寛', 石原 典隆', 太田 特志', 中島 基', 廣橋 拓也', 高 橋 正弘', 生內 俊光 <sup>2</sup> , 保坂 泰靖 <sup>2</sup> , 肥塚 純 一 <sup>2</sup> , 山崎 舜平 <sup>1</sup>	1.半エネ研, 2.AFD Inc.
	3月11日(水)	13:15 - 17:4	15		
招待	13:15 - 13:30	11p-D1-1	「講演奨励賞受賞記念講演」(15分) クリティカルレイヤーを用いたスパッタAI添加ZnO透明電導電膜の キャリア輸送制御(II)	〇野本 淳一¹, 牧野 久雄¹, 山本 哲也¹	1.高知工科大総研
	13:30 - 13:45	11p-D1-2	c軸配向結晶性IGZO FETの微細化に伴うフォノン散乱の影響	○松田 慎平¹, 菊地 彫¹, 山根 靖正¹, 岡崎 豊¹, 山崎 舜平¹	1.半工ネ研
	13:45 - 14:00	11p-D1-3	窒素添加InGaZnO膜の熱処理に対する電気特性評価	○中野 慎太郎¹, 前田 雄也¹, 大黒 達也², 百 瀬 寿代², 諸岡 哲², 神例 信貴³, 鈴木 幸治¹	1.(株) 東芝 研究開発センター, 2.(株) 東芝 セミコンダクター&ストレージ社, 3.( 株) 東芝 生産技術センター, 4.東芝リサ ーチコンサルティング(株)
	14:00 - 14:15	奨 11p-D1-4	IGZO薄膜中の酸素空孔によるPLとドナー準位	○(M1C)陳 東京¹, 森本 貴明¹², 福田 伸子³, 大木 義路¹⁴	1.早大先進理工, 2.学振DC2, 3.産総研FLEC, 4.早大材研
	14:15 - 14:30	11p-D1-5	酸化物半導体を低温溶液プロセスで作製する際のマイクロ波及び真 空紫外光照射効果の確認	○(PC)鄭 恵貞¹, 小倉 晋太郎¹, 吉田 学¹, 牛島 洋史¹, 福田 伸子¹, 植村 聖¹	1.産総研
	14:30 - 14:45	11p-D1-6	光ゾル-ゲルプロセスによるIZO半導体薄膜の作製とTFT特性	○小笹 健仁¹, 鄭 恵貞¹, 植村 聖¹, 吉田 学¹, 星野 聡¹	1.産総研FLEC
	14:45 - 15:00	奨 11p-D1-7	溶液プロセスによる非晶質InZnO薄膜トランジスタ特性に対する湿式酸素アニールの影響	○長田 至弘¹, 石河 泰明¹, 藤井 茉美¹, 浦 岡 行治¹	1.奈良先端大
	15:00 - 15:15	奨 11p-D1-8	塗布型a-InZnO薄膜トランジスタに向けた銀ナノベーストの印刷適性	○(DC)浦川 哲¹, 石河 泰明¹, 長田 至弘¹, 藤井 茉実¹, 堀田 昌宏¹, 浦岡 行治¹	1.奈良先端大
	15:15 - 15:30		休憩/Break		
	15:30 - 15:45	11p-D1-9	水素の影響による酸化亜鉛スズ(ZnSnO:ZTO)薄膜トランジスタの 電気特性変化	○(M1C)竹之内 良太¹, 戸田 達也¹, 石井 林 太郎³, 高橋 広己³, 王 大鵬¹², 古田 守¹²	1.高知工大, 2.総研, 3.三井金属鉱業株式会社
	15:45 - 16:00	奨 11p-D1-10	ゾルゲル成膜した酸化亜鉛薄膜の乾燥温度依存性とTFT特性	○川上 祐貴¹, 大東 隆文¹, 尾形 健一¹, 前元 利彦¹, 佐々 誠彦¹	1.大工大ナノ材研センタ
	16:00 - 16:15	11p-D1-11	酸化亜鉛系電界効果トランジスターを用いたグルコースセンサーの 作製と評価	○(M1)池谷 謙¹, 小池 一歩¹, 広藤 裕一¹, 前元 利彦¹, 佐々 誠彦¹, 矢野 満明¹	1.大阪工大ナノ材研センタ
	16:15 - 16:30	11p-D1-12	アモルファスInWO TFTの微量Zn添加効果	○(P)木津 たきお¹, 宮永 美紀², 粟田 英章², 生田目 俊秀¹, 塚越 一仁¹	1.物材機構, 2.住友電気工業
	16:30 - 16:45	11p-D1-13	アモルファス酸化インジウム薄膜トランジスタにおける電荷密度および 移動度の添加元素依存性	○三苫 伸彦¹, 相川 慎也¹, 欧阳 威¹, 高 旭¹, 木津 たきお¹, 林 孟芳¹, 藤原 明比古², 生田 目 俊秀¹, 塚越 一仁¹	1.物材機構 WPI-MANA, 2.SPring-8
	16:45 - 17:00	11p-D1-14	大型スパッタカソードにおけるIGZO 膜の均一性向上	○大久保 裕夫¹, 磯部 辰徳¹, 新井 真¹, 清田淳也¹, 齋藤 一也¹	1.アルバック
	17:00 - 17:15	奨 11p-D1-15	非晶質InGaZnO抵抗変化メモリにおける電極材料依存性	○門 圭佑¹, 山内 祥光¹, 鍋坂 恭平¹, 藤井 茉美¹, 石河 泰明¹, 浦岡 行治¹	1.奈良先端大
	17:15 - 17:30	奨·E 11p-D1-16	Analysis of Oxygen vacancies in the Interface of amorphous InGaZnO / Siloxane passivation film by X-ray photoelectron spectroscopy	○(M2)Chaiyanan Kulchaisit¹, Haruka Yamazaki¹, Juan Paolo Bermundo¹, Mami Fujii¹, Masahiro Horita¹, Yasuaki Ishikawa¹, Yukiharu Uraoka¹	1.Nara Inst. of Sci. and Tech.
	17:30 - 17:45	奨·E 11p-D1-17	Low temperature excimer laser annealing of a-InGaZnO thin-film transistors passivated by hybrid organic-inorganic passivation layer	○(D)Juan Paolo Bermundo¹, Yasuaki Ishikawa¹, Mami Fujii¹, Michiel van der Zwan², Hiroshi Ikenoue³, Ryoichi Ishiha- ra², Toshiaki Nonaka⁴, Yukiharu Uraoka¹	1.Nara Inst. of Sci. and Tech., 2.Delft Univ. of Tech., 3.Kyushu Univ., 4.AZ Elect. Mat.
		9:00 - 12:15			
	9:00 - 9:15	12a-D1-1	高速回転式ミストCVD法により形成したZnO薄膜	○田之上 博信!, 和田 祥平!, 横山 裕太郎!, 谷口 卓矢!, 山本 真也!, 中村 昭平!, 中 良 弘¹³, 永岡 昭二²³, 中村 有水¹³	1.熊大工, 2.熊本県産技センター, 3.熊本 有機センター
	9:15 - 9:30	奨 12a-D1-2	高周波熱プラズマ法による窒素ドープ酸化亜鉛ナノ粒子の生成	○(DC)平儀野 雄斗¹, 田中 暁巳², 竹内 浩², 竹内 啓², 藤田 恭久¹	1.島根大院総理, 2.竹内電機
	9:30 - 9:45	奨 12a-D1-3	MOCVD法を用いて成長したNドープZnO膜のアニール効果	〇中浦 柘也 <sup>13</sup> ,原田 善之³,王 剣宇¹,長田 貴弘¹,関口 隆史¹,知京 豊裕¹,鈴木 摂²,石 垣 隆正³,角谷 正友¹	1.NIMS., 2.COMMET, 3.法政大
	9:45 - 10:00	12a-D1-4	反応性プラズマ蒸着法によって作製したGa添加ZnO薄膜における構造特性への酸素ガス流量及びGa添加量の効果	○寺追 智昭¹, 野本 淳一², 牧野 久雄², 白方 祥¹, 山本 哲也²	1.愛媛大院理工, 2.高知工科大総研
	10:00 - 10:15	12a-D1-5	c面サファイア上V添加ZnO極薄膜配向性の成膜温度依存性	○渡部 晃弘¹, 千葉 博², 川島 知之¹², 鷲 尾 勝由¹²	1.東北大工, 2.東北大院工
	10:15 - 10:30	12a-D1-6	c面とa面サファイア基板上V添加ZnO薄膜配向性の成膜温度依存性	〇千葉 博¹, 渡部 晃弘², 川島 知之¹, 鷲尾 勝由¹	1.東北大院工, 2.東北大工
	10:30 - 10:45		休憩/Break		
	10:45 - 11:00	12a-D1-7	UHVスパッタ法により成長したZnO層の大気アニール処理	○(M1)松久 健司¹, 佐久間 大樹¹, 三好 佑弥¹, 水野 愛¹, 篠田 宏之¹, 六倉 信喜¹	1.東京電機大工
	11:00 - 11:15	12a-D1-8	窒素添加結晶化法によるc面サファイア基板上へのZnO膜の作製: 歪み緩和におけるバッファー層結晶粒密度の影響	井手 智章¹, 松島 宏一¹, 清水 僚太¹, 山下 大輔¹, 徐 鉉雄¹, 古閑 一憲¹, 白谷 正治¹, ○ 板垣 奈穂¹²	1.九州大学, 2.JSTさきがけ
	11:15 - 11:30	奨 12a-D1-9	水熱合成ZnOターゲットを用いたZnO薄膜のヘリコン波励起プラズマスバッタエビタキシー(3):浅い不純物に関する考察	○山崎 芳樹¹, 古澤 健太郎¹, 岩橋 咲弥¹, 小島 一信¹, 秩父 重英¹	1.東北大多元研
	11:30 - 11:45	奨 12a-D1-10	水熱合成ZnOターゲットを用いたZnO薄膜のヘリコン波励起プラズマスバッタエピタキシー(4):遷移金属不純物に関する考察	○(B)岩橋 咲弥¹, 山崎 芳樹¹, 小島 一信¹, 古澤 健太郎¹, 上殿 明良², 秩父 重英¹	1.東北大多元研, 2.筑波大物理工
	11:45 - 12:00	奨 12a-D1-11	Mg、Zn <sub>1</sub> 、O/ZnOヘテロ構造における面内Mg分布の評価と制御	○打田 正輝!, ジョセフ フォルソン¹, 瀬川 勇三郎², 小塚 裕介¹, 塚崎 敦³⁴, 川崎 雅司¹²	1.東大院工, 2.理研CEMS, 3.東北大金 研, 4.JSTさきがけ
	12:00 - 12:15	12a-D1-12	Pt/Mg <sub>x</sub> Zn <sub>1-x</sub> O/n*-ZnOショットキーフォトダイオードの分光感度特性	○遠藤 治之¹, 佐藤 秀幸², Belmoubarik Mohamed², 高橋 強¹, 野崎 友大², 佐橋 政 司², 柏葉 安兵衞"	1.岩手県工技センタ, 2.東北大工, 3.岩 手大

16.15 16.20	12- D1 1	- C- O ジョカ畄牡目の佐制も掛生証体	○ △ ス - は上前12 - 徳田 - 古山12 - 藤田 - 松-14	1.京大院工, 2.株式会社FLOSFIA
16:15 - 16:30	13p-D1-1	α-Ga <sub>2</sub> O <sub>3</sub> バルク単結晶の作製と構造評価	○金子 健太郎 <sup>1,2</sup> , 織田 真也 <sup>1,2</sup> , 藤田 静雄 <sup>1</sup> , 人羅 俊実 <sup>2</sup>	1.泉大阮上, 2.株式会在FLOSFIA
16:30 - 16:45	奨 13p-D1-2	水素・窒素気流中における $\beta$ - $Ga_2O_3$ の熱的安定性の熱力学的検討	○富樫 理恵', 野村 一城', 江口 千尋', 蕗澤 孝紘', 後藤 健², 村上 尚', 熊谷 義直', 倉又 朗人², 山腰 茂伸², 纐纈 明伯'	1.東京農工大院工, 2.タムラ製作所
16:45 - 17:00	13p-D1-3	β-Ga <sub>2</sub> O <sub>3</sub> 基板の結晶欠陥評価(2)	○永井 哲也¹, 野網 健悟¹, 中居 克彦¹, 二 木 登史郎¹	1.日鉄住金テクノロジー
17:00 - 17:15	奨 13p-D1-4	ミストCVD法により成長した $Sn$ ドープ $Ga_2O_3$ 薄膜の電気特性評価	○赤岩 和明¹, 李 三東¹, 金子 健太郎¹, 藤 田 静雄¹	1.京大院工
17:15 - 17:30	13p-D1-5	大気圧プラズマCVD法を用いた(-201) $\beta$ -Ga $_2$ O $_3$ 薄膜のホモエビタキシャル成長	○木口 拓也¹, 野瀬 幸則¹, 上原 剛², 藤 村 紀文¹	1.大阪府立 大学院, 2.積水インテグレ テッドリサーチ
17:30 - 17:45		休憩/Break		
17:45 - 18:00	奨 13p-D1-6	ハライド気相成長法による $\beta$ -Ga $_{2}$ O $_{3}$ 基板上ホモエビタキシャル成長	○野村 一城¹, 後藤 健², 佐々木 公平²³, 河原 克明¹, ティユクァントゥ¹, 富樫 理恵¹, 村上尚¹, 熊谷 義直¹, 東脇 正高³, 倉又 朗人², 山腰 茂伸², Bo Monemar¹⁵, 纐纈 明伯¹	1.東京農工大院工, 2.タムラ製作所, 3 報通信研究機構, 4.東京農工大GIRO 5.Linköping Univ.
18:00 - 18:15	奨 13p-D1-7	酸素ラジカル支援PLD法による酸化ガリウム系混晶薄膜の成長	〇若林 諒', 服部 真依', 大島 孝仁', 佐々木公平², 增井 建和², 倉又 朗人², 山腰 茂伸², 吉松 公平¹, 大友 明¹³	1.東工大院理工, 2.タムラ製作所, 3.5素戦略
18:15 - 18:30	奨 13p-D1-8	$eta$ -( $Al_xGa_{1,x}$ ) $_2O_y/eta$ - $Ga_2O_3$ ヘテロ接合のバンドオフセット評価	○服部 真依!, 若林 諒, 大島 孝仁!, 佐々木 公平², 增井 建和², 倉又 朗人², 山腰 茂伸², 堀場 弘司³⁴, 組頭 広志³⁴, 吉松 公平¹, 大友 明¹⁴	1.東工大院理工, 2.タムラ製作所, 3.高ネ研, 4.東工大元素戦略
18:30 - 18:45	奨 13p-D1-9	PLD法を用いた $\beta$ -Ga <sub>2</sub> O <sub>3</sub> エビタキシャル薄膜成長のNiOバッファー層 導入による低温化	○福田 大二¹, 塩尻 大士¹, 山内 涼輔¹, 土嶺 信男², 金子 智¹³, 松田 晃史¹, 吉本 護¹	1.東工大, 2.(株)豊島製作所, 3.神奈 県産技センター
18:45 - 19:00	13p-D1-10	$\beta$ -Ga $_2$ O $_3$ 薄膜を用いたMFIS構造の作製	○近藤 勇樹¹, 尾澤 秋弘¹, 野村 圭介¹, 川江健¹, 森本 章治¹	1.金沢大学
19:00 - 19:15	13p-D1-11	$\beta\text{-Ga}_2\text{O}_3$ のMBE成長における積層欠陥発生の面方位依存性	○佐々木 公平¹, 倉又 朗人¹, 山腰 茂伸¹	1.タムラ製作所
3月14日(土	) 9:00 - 11:3	30		
9:00 - 9:15	14a-D1-1	極性ZnO単結晶表面の偏光依存硬X線光電子分光	○大澤 健男¹, 上田 茂典¹, 鈴木 基寬², 大 橋 直樹¹	1.物材機構, 2.JASRI/SPring-8
9:15 - 9:30	奨 14a-D1-2	高周波マグネトロンスパッタリング法によるZnO薄膜の極性制御	○(M1)角田 啓 <sup>1,2</sup> , 大澤 健男 <sup>2</sup> , 大橋 直樹 <sup>2</sup> , 石垣 隆正 <sup>1</sup>	1.法政大学大学院, 2.物質·材料研究 機構
9:30 - 9:45	14a-D1-3	ZnOの結晶対称性の破れと偏光励起の相関	○松井 裕章¹, 蓮池 紀幸², 播磨 弘², 田 畑 仁¹	1.東大工, 2.京都工繊大
9:45 - 10:00	14a-D1-4	雰囲気の違いによるZnO単結晶基板の光導電特性	○阿部 貴美!, 鎌田 修平!, 高橋 修三!, 中川 玲!, 千葉 鉄也!, 中川 美智子!, 千葉 茂樹 ¹, 柏葉 安宏², 大坊 真洋!, 新倉 郁生¹, 柏葉 安兵衛¹, 長田 洋¹	1.岩手大学, 2.仙台高専
10:00 - 10:15		休憩/Break		
10:15 - 10:30	14a-D1-5	r 面サファイア基板を用いたWO $_{_3}$ 薄膜のMBE 成長	○松尾 昌幸¹, 村山 喬之¹, 原田 義之¹, 小 池 一歩¹, 佐々 誠彦¹, 矢野 満明¹, 稲葉 克彦 ², 小林 信太郎²	1.大阪工大ナノ材研センタ, 2.リガク 2線研究所
10:30 - 10:45	14a-D1-6	ゾルーゲル法により成長したNiOエピタキシャル膜の格子歪	○國分 義弘¹, 目黒 康裕¹, 中込 真二¹	1.石巻専修大理工
10:45 - 11:00	14a-D1-7	MOCVD法によるc面サファイア基板上 $\mathrm{Cu_2O}$ 溥篪の結晶成長-二段 階成長の検討-	○寺村 瑞樹¹, 谷口 凱¹, 田口 健太朗¹, 藤原 一樹¹, 石川 博康¹	1.芝浦工大
11:00 - 11:15	14a-D1-8	分子プレカーサー水溶液を用いたミストCVD法によるZnO薄膜製作	○(M1)後藤 良介¹, 澁木 勇人¹, 田沼 圭亮¹, 畠山 匠¹, 永井 裕己¹, 山口 智広¹, 佐藤 光 史¹, 本田 徹¹	1.工学院大学
11:15 - 11:30	14a-D1-9	ミストCVD法におけるZnS薄膜の成長機構	山崎 佑一郎¹, ○宇野 和行¹, 田中 一郎¹	1.和大システム工

## コードシェアセッション / Code-sharing session

3.5	3.5 レーザー装置・材料, 3.14 光制御デバイス・光ファイバーのコードシェアセッション 口頭講演							
	3月13日(金) 9:00 - 11:15							
招待	9:00 - 9:15	13a-A13-1	「講演奨励賞受賞記念講演」(15分) 中赤外(9-12μm)光渦レーザーにおける符号制御	〇堀川 マイケル知樹 <sup>1</sup> , 尾川 あずさ <sup>1</sup> , 古城健司 <sup>1</sup> , 宮本 克彦 <sup>1</sup> , 尾松 孝茂 <sup>1,2</sup>	1.千葉大融合, 2.JST-CREST			
	9:15 - 9:30	奨·E 13a-A13-2	Widely tunable optical vortex parametric laser	O(D)ABULIKEMU AIZITIAILI¹, Taximaiti Yusufu¹², Katsuhiko Miyamoto¹, Takashige Omatsu¹²	1.Chiba Univ, 2.JST-CREST			
	9:30 - 9:45	13a-A13-3	マイクロチップレーザー励起中赤外光パラメトリック発生の検討	○石月 秀貴¹, 平等 拓範¹	1.分子研			
	9:45 - 10:00	奨 13a-A13-4	CsLiB6O10結晶を用いた非同軸位相整合方式の高効率 355nm 紫 外光発生	○(D)曲 晨¹, 吉村 政志¹, 高橋 義典¹, 森 勇介¹	1.阪大院工			
	10:00 - 10:15	奨 13a-A13-5	金属/液体電極を用いた電圧印加によるMgO:LiNbO。周期分極反転 構造の作製と緑色光第二高調波発生	○沖野 行佑¹, 栖原 敏明¹	1.阪大院工			
	10:15 - 10:30	奨 13a-A13-6	接合イオンスライスLiNbO、結晶におけるプロトン交換増速エッチング によるリッジ光導波路の作製	○田中 圭祐¹, 栖原 敏明¹	1.阪大院工			
	10:30 - 10:45	奨 13a-A13-7	MgO(8mol%)添加c-LiTaO <sub>3</sub> アニールプロトン交換導波路の作製	○岡 寿治¹, 栖原 敏明¹	1.阪大院工			
	10:45 - 11:00	13a-A13-8	AlGaAs/AlOx 高屈折率差U字導波路における第二高調波発生の 位相整合特性	○中村 勇貴¹, 松下 智紀¹, 近藤 高志¹	1.東大工			
	11:00 - 11:15	奨 13a-A13-9	周期空間反転AlGaAsのAs₂を用いたMBE成長	○楢崎 亮太¹, 松下 智紀¹, 近藤 高志¹	1.東大工			

しフォトニック	構造·現象, 13.	.7 超薄膜・量子ナノ構造のコードシェアセッション	口頭講演	
3月12日(木)	9:00 - 12:3	0		
9:00 - 9:15	奨 12a-A10-1	有機ヒ素を用いたMOVPE法によるフォトニック結晶の埋め込み成長	○河崎 正人 <sup>1,3</sup> , 吉田 昌宏 <sup>1</sup> , 石崎 賢司 <sup>1</sup> , Menaka De Zoysa <sup>1,2</sup> , 北村 恭子 <sup>1,2</sup> , 野田 進 <sup>1</sup>	1.京大院工, 2.京大白眉, 3.三菱電機 先端総研
9:15 - 9:30	12a-A10-2	$(Sc, Er)_2O_3$ 薄膜におけるサイト選択励起でのエネルギー移動とアップコンバージョン	○川上 欣洋¹, 俵 毅彦²³, 尾身 博雄²³, 鍜治怜奈¹, 足立 智¹	1.北大院工, 2.NTT物性基礎研, 3.NT ナノフォトニクスセンタ
9:30 - 9:45	12a-A10-3	(ErSc)2O3 薄膜におけるアップコンバージョン発光とフォトニックバン ドギャップによる抑制	○俵 毅彦¹², Thomas McManus¹³, 川上 欣 洋⁴, 尾身 博雄¹², Adel Najar¹, 鍛治 怜奈⁴, 足立 智⁴, 後藤 秀樹¹	1.NTT物性研, 2.NTTナノフォトニクス ンタ, 3.バース大, 4.北大
9:45 - 10:00	奨 12a-A10-4	InP(311)B基板上InAs量子ドットからの単一光子発生とその温度特性	○(M2)細井 響子¹, 高熊 亨¹, 黒澤 裕之³, 中島 秀朗³, 赤羽 浩一², 熊野 英和³, 末宗 幾夫³, 早瀬 潤子³	1.慶大理工, 2.情通機構, 3.北大電子
10:00 - 10:15	12a-A10-5	(111)A 面上量子ドットにおける励起子微細構造分裂の高精度評価	○中島 秀朗¹, 熊野 英和¹, 劉 祥明², 間野 高明², 黒田 隆², 末宗 幾夫¹	1.北大電子研, 2.物材機構
10:15 - 10:30	E 12a-A10-6	Entangled photon emission at temperatures up to 60 K from droplet epitaxial quantum dots	○(P)Xiangming Liu¹, Takashi Kuroda¹, Takaaki Mano¹, Hideaki Nakajima², Hide- kazu Kumano², Ikuo Suemune², Yoshiki Sakuma¹, Kazuaki Sakoda¹	1.NIMS, 2.RIES Hokkaido Univ.
10:30 - 10:45	12a-A10-7	量子ドット-ナノ共振器強結合系における光散逸経路間干渉	〇太田 泰友¹, 太田 竜一², 熊谷 直人¹, 岩本 敏¹², 荒川 泰彦¹.²	1.東大ナノ量子機構, 2.東大生研
10:45 - 11:00	奨 12a-A10-8	走査型電子顕微鏡による量子ドットの位置検出とナノ共振器との結 合状態評価	○車 一宏¹, 太田 泰友², 高宮 大策¹, 角田 雅弘², 岩本 敏¹², 荒川 泰彦¹²	1.東大生研, 2.東大ナノ量子機構
11:00 - 11:15		休憩/Break		
11:15 - 11:30	12a-A10-9	ウエハ接合界面での光損失を低減した量子ドット結合共振器の作製	〇北田 貴弘¹, 原山 千穂¹, 太田 寛人¹, 前川 知久¹, 盧 翔孟¹, 熊谷 直人¹, 井須 俊郎¹	1.徳島大院フロンティア
11:30 - 11:45	12a-A10-10	一次元フォノニック結晶導波路におけるフォノン伝搬のバンド構造依 存性	○畑中 大樹¹, ドデル アモリ¹, マブーブ イムラン¹, 小野満 恒二¹, 山口 浩司¹	1.NTT物性研
11:45 - 12:00	奨 12a-A10-11	多モード干渉を利用した表面プラズモンポラリトン交差導波路	○太田 雅¹, 福原 誠史¹, 住村 あさひ¹, 伊藤 基¹, 相原 卓磨¹, 石井 佑弥¹, 福田 光男¹	1.豊技大
12:00 - 12:15	奨 12a-A10-12	グラフェン装荷型プラズモニクス導波路における光吸収の増強	○(M1)常川 雅人 <sup>1,2</sup> , 小野 真証 <sup>1,3</sup> , 納富 雅 也 <sup>1,2,3</sup>	1.NTT物性研, 2.東工大理工, 3.NT- Tナ/フォト=クスセンタ
12:15 - 12:30	奨 12a-A10-13	プラズモニック導波路のSi細線導波路への結合	○小野 真証 <sup>1,2</sup> , Hao Xu <sup>1,2</sup> , 倉持 栄一 <sup>1,2</sup> , 野 崎 謙悟 <sup>1,2</sup> , 谷山 秀昭 <sup>1,2</sup> , 常川 雅人 <sup>2,3</sup> , 納 富 雅也 <sup>1,2,3</sup>	1.NTTナノフォトニクスセンタ, 2.NTT 性科学基礎研, 3.東工大理工

6.6	プローブ顕微	対鏡, 12.2 評価・	基礎物性のコードシェアセッション	口頭講演	
	3月13日(金	) 9:00 - 12:0	0		
	9:00 - 9:15	奨 13a-D14-1	多段階光強度のLM-STSによるP3HT:PCBM系有機薄膜太陽電池 の局所測定	○落合 貴大¹², 安田 剛³, 加藤 洋和¹, 小林 祐貴¹, 吉田 昭二¹, 武内 修¹, 重川 秀実¹	1.筑波大数理物質, 2.タカノ(株), 3.物質・材料研究機構
	9:15 - 9:30	奨 13a-D14-2	動作中の有機トランジスタにおける過渡的キャリア分布のナノスケー ル可視化	○山岸 裕史¹, 木村 知玄¹, 小林 圭¹², 野田 啓³, 山田 啓文¹	1.京大院工, 2.京大白眉セ, 3.慶應大 理工
	9:30 - 9:45	13a-D14-3	時間分解静電気力顕微鏡による有機半導体グレインへの電荷注入・ 排出過程の可視化	○木村 知玄¹, 山岸 裕史¹, 小林 圭¹², 山 田 啓文¹	1.京大工, 2.京大白眉セ
	9:45 - 10:00	奨 13a-D14-4	探針増強ラマン散乱分光測定における金属探針の温度評価と熱拡 散手法	○(DC)望月 誠仁¹, 小口 真弘¹, 角井 杏帆¹, 矢野 隆章¹, 原 正彦¹, 林 智広¹	1.東工大総理工
	10:00 - 10:15	13a-D14-5	液中FM-AFMによる免疫グロブリンM(IgM)の抗原結合評価	○黄 雲飛 <sup>1</sup> , 木南 裕陽 <sup>1</sup> , 小林 圭 <sup>1,2</sup> , 山 田 啓文 <sup>1</sup>	1.京大工, 2.京大白眉セ
	10:15 - 10:30	奨 13a-D14-6	自己検知型カンチレバーを用いた液中における単一吸着細胞の剥 離力測定	○橋本 重孝¹, 安達 誠¹, 岩田 太¹.²	1.静岡大院工, 2.静岡大電研
	10:30 - 10:45		休憩/Break		
招待	10:45 - 11:00	13a-D14-7	「講演奨励賞受賞記念講演」(15分) ポルフィリン-TbIIIダブルデッカー型単分子磁石のSTMによるパター ニングと近藤状態の評価	〇猪瀬 朋子 <sup>1</sup> , 田中 大輔 <sup>1</sup> , Liu Jie <sup>2</sup> , 梶原 美珠 <sup>2</sup> , 米田 忠弘 <sup>2</sup> , 小川 琢治 <sup>1</sup>	1.阪大院理, 2.東北大多元研
	11:00 - 11:15	奨 13a-D14-8	単一分子伝導における分子形状効果の3次元計測	○片山 智貴¹, 中村 美紀¹, 吉田 昭二¹, 武内修¹, 重川 秀実¹	1.筑波大数理
	11:15 - 11:30	奨 13a-D14-9	CuPc追加蒸着によるPCBMの配列構造の変化	○(M1)桝井 茜¹, 坂上 弘之¹, 高萩 隆行¹, 鈴木 仁¹	1.広島大院先端研
	11:30 - 11:45	奨 13a-D14-10	力検出による近接場光の高分解能観測	○山西 絢介¹, 徳山 貴士¹, 内藤 賀公¹, 李 艶君¹, 菅原 康弘¹	1.阪大院工
	11:45 - 12:00	13a-D14-11	電気化学FM-AFMを用いたイオン液体/ルブレン(001)界面における 探針誘起ナノリソグラフィー	○坂東 賢一 <sup>1</sup> , 原 援又 <sup>1</sup> , 森野 裕介 <sup>1</sup> , 岡田 悠悟 <sup>2</sup> , 今西 哲士 <sup>1</sup> , 横田 泰之 <sup>1</sup> , 植村 隆文 <sup>2</sup> , 竹谷 純一 <sup>2</sup> , 福井 賢一 <sup>1</sup>	1.阪大院基礎工, 2.東大院新領域

13.10 化合	物太陽電池, 15.2	II-VI族結晶および多元系結晶のコードシェアセッション	/ 口頭講演				
3月12	3月12日(木) 13:30 - 17:45						
13:30 -	13:45 12p-A26-1	ZnTe基板上へのClドープCdTe薄膜のMBE成長	○(M1)寺沢 俊貴¹, 田中 徹¹, 斉藤 勝彦¹, 郭 其新¹, 西尾 光弘¹	1.佐賀大院工			
13:45 -	14:00 12p-A26-2	MBEによる高不整合材料ZnCdTeO薄膜の成長	○(B)岡野 友紀¹, 溝口 耕輔¹, 寺沢 俊貴¹, 田中 徹¹, 斉藤 勝彦¹, 郭 其新¹, 西尾 光弘¹	1.佐賀大学			
14:00 -	14:15 獎 12p-A26-3	PLD法による透明p型導電性BaCuSF膜の作製とCdTe太陽電池への応用	○川邉 利幸¹, 榊間 博¹, 小川 洋平², 細野藍響², 岡本 保², 和田 隆博¹	1.龍谷大理工, 2.木更津高専			
14:15 -	14:30 12p-A26-4	グラフェン透明導電膜の薄膜化合物太陽電池応用	○石川 亮佑¹, 大矢 智也¹, 野本 隆宏¹, 坪井 望¹	1.新潟大工			
14:30 -	14:45 12p-A26-5	Se蒸気圧制御によるCZTSナノ粒子薄膜のSe化	○梅嶋 悠人¹, 井狩 華奈美¹, 上村 一生¹, 張 険峰², 小林 正和¹.³	1.早大先進理工, 2.早大ICSEP, 3.早 大材研			
14:45 -	15:00 12p-A26-6	ゾルゲル硫化法による $\mathrm{Cu}_{z}\mathrm{ZnSnS}_{4}$ 薄膜の作製における $\mathrm{UV/O}_{3}$ 処理 の効果 $\mathrm{II}$	○宮沢 勇斗¹, 田中 久仁彦¹, 打木 久雄¹	1.長岡技大			
15:00 -	15:15 12p-A26-7	ミスト CVD 法による $Cu_2ZnSnS_4$ 薄膜の作製と評価	○渡辺 勇一郎¹, 池之上 卓己¹, 三宅 正男¹, 平藤 哲司¹	1.京大院エネ科			

	15:15 - 15:30	奨 12p-A26-8	ナフテン酸銅, ナフテン酸亜鉛およびオクチル酸スズとジメチルセレンを用いたCu,ZnSnSe, 薄膜の作製	○山田 諒太¹, 田橋 正浩¹, 高橋 誠¹, 吉野 賢二², 後藤 英雄¹	1.中部大学, 2.宮崎大学
	15:30 - 15:45		休憩/Break		
	15:45 - 16:00	12p-A26-9	Cu <sub>2</sub> ZnSnS <sub>4</sub> ナノ粒子の液相合成におけるCu <sup>2+</sup> 還元過程	○(M1)森下 一喜¹, 須藤 裕之¹, 神谷 格¹	1.豊田工大
	16:00 - 16:15	12p-A26-10	Cu <sub>2</sub> ZnSnS <sub>4</sub> ナノ粒子を用いた塗布型太陽電池の作製	○杉本 寛太¹, 桑名 潤¹, 後藤 仁憲¹, 陶山 直樹¹, 張 毅聞², 黒川 康良¹, 山田 明¹ぷ	1.東工大院理工, 2.凸版印刷, 3.東工 大PVREC
	16:15 - 16:30	12p-A26-11	HAXPESによる窓層/CdS層/CZTS層界面のバンド構造評価	○田島 伸¹, 片岡 恵太¹, 梅原 密太郎¹, 高橋 直子¹, 木本 康司¹, 北住 幸介¹, 磯村 典武¹	1.豊田中研
	16:30 - 16:45	12p-A26-12	Zn <sub>1-x</sub> Mg <sub>x</sub> O/Cu <sub>2</sub> ZnSn(S, Se) <sub>4</sub> 界面のバンド接続の in-situ 評価	○諏訪原 裕貴¹	1.鹿児島大
	16:45 - 17:00	E 12p-A26-13	Photocarrier dynamics in $\text{Cu}_2\text{ZnSn}(S_x\text{Se}_{1-x})_4$ single crystals: Composition dependence	○(PC)Le Quang Phuong¹², Makoto Okano¹, Genki Yamashita³, Masaya Nagai³, Masaaki Ashida³, Akira Nagaoka¹⁴, Kenji Yoshino⁴, Yoshihiko Kanemitsu¹²	1.Kyoto Univ., 2.JST-CREST, 3.Osaka Univ., 4.Univ. of Miyazaki
	17:00 - 17:15	E 12p-A26-14	Suppression of nonradiative recombination centers in $\mathrm{Cu_2ZnSnS_4}$ single crystals by sodium doping	○(PC)Le Quang Phuong¹², Makoto Okano¹, Genki Yamashita³, Masaya Nagai³, Masaaki Ashida³, Akira Nagaoka¹⁴, Kenji Yoshino⁴, Yoshihiko Kanemitsu¹²	1.Kyoto Univ., 2.JST-CREST, 3.Osaka Univ., 4.Univ. of Miyazaki
	17:15 - 17:30	12p-A26-15	電子線照射による $\mathrm{Cu_2ZnSnS_4}$ 太陽電池の電気的・光学的特性への影響	○相原 理¹, 坂倉 秀徳¹, 片桐 裕則², 杉 山 睦¹	1.東京理科大 理工/総研, 2.長岡高専
	17:30 - 17:45	奨 12p-A26-16	ケステライト化合物Cu $_{z}$ ZnSn(S $_{z'}$ Se $_{1:x}$ )。単結晶中の固有散乱メカニズム	○永岡 章 <sup>1,5</sup> , Scarpulla Michael <sup>2</sup> , 柿本 浩一 <sup>3</sup> , 吉野 賢二 <sup>4</sup> , 野瀬 嘉太郎 <sup>1</sup>	1.京大院工, 2.米ユタ大, 3.九大応力研, 4.宮崎大工, 5.学振特別研究員PD
	3月13日(金	9:00 - 12:1	5		
	9:00 - 9:15	奨 13a-A17-1	近接昇華法を用いたサファイア基板上のAg(Ga,Al)Te <sub>2</sub> 混晶作製	○宇留野 彩¹, 薄井 綾香¹, 竹田 裕二¹, 井上 朋大¹, 小林 正和¹²	1.早大先進理工, 2.早大材研
	9:15 - 9:30	13a-A17-2	CuInSe₂-In₂Se₃系化合物の結晶構造と光学的性質	○(PC)前田 毅¹, 宮 イゲン¹, 和田 隆博¹	1.龍谷大理工
	9:30 - 9:45	奨 13a-A17-3	CuGaSe <sub>2</sub> -ZnSe系化合物の結晶構造と光学的性質	〇山田 悠斗', 前田 毅', 竹井 康二', 和 田 隆博 <sup>1</sup>	1.龍谷大理工
	9:45 - 10:00	13a-A17-4	Znのサイト選択ドービングによるp形CIGS薄膜の作製	○白方 祥¹, 吉田 正吾¹, 岸田 貴志¹, 弓達 新治¹, 宮田 晃¹	1.愛媛大 工
	10:00 - 10:15	13a-A17-5	CIGS薄膜のその場PL測定	○深井 尋史!, 池村 賢一郎², 井口 和也², エルリカオ ザッカーリ¹, カトリイズール¹, 松山 勇¹, 山口 博², 中田 時夫¹	1.東京理科大総研, 2.浜松ホトニクス
	10:15 - 10:30	13a-A17-6	$\operatorname{CuIn}_{1-x}\operatorname{Ga}_x\operatorname{Se}_2$ における光キャリアの緩和及び拡散ダイナミクス	○岡野 真人¹, 櫻井 岳晓², 秋本 克洋², 柴田 肇³, 仁木 栄³, 金光 義彦¹.⁴	1.京大化研, 2.筑波大数物研, 3.産 総研・太陽光発電工学研究センター, 4.JST-CREST
	10:30 - 10:45	E 13a-A17-7	Microstructure Characteristics of $Cu(In, Ga)Se_2$ Thin Films Investigated by TEM	○(PC)HyungSeok Kim <sup>1,4</sup> , T. Ohkubo <sup>1</sup> , K. Hono <sup>1</sup> , K. Yoshida <sup>2</sup> , T. Nakada <sup>3</sup>	1.NIMS, 2.Osaka Univ., 3.Tokyo Univ. of Sci., 4.LG Electronics
	10:45 - 11:00	13a-A17-8	Lift-off法を用いたsuperstrate型Cu(In,Ga)Se₂薄膜太陽電池におけるPEDOT:PSS裏面電極の検討	○新澤 雄高¹, 新井 裕之¹, 廣庭 大輔¹, 峯 元 高志¹	1.立命館大学
	11:00 - 11:15	13a-A17-9	裏面パッシベーション効果を利用したCIGS太陽電池特性	○崔 誠佑¹, 上川 由紀子¹, 西永 慈郎¹, 山田昭政¹, 柴田 肇¹, 仁木 栄¹	1.産総研
	11:15 - 11:30	E 13a-A17-10	Effect of KF-PDT on MBE-Grown $Cu(In_{1:x}Ga_x)Se_2$ Thin Film	○(PC)Ishwor Khatri¹, Hirofumi Fukai¹, Isamu Matsuyama¹, Hiroshi Yamaguchi¹, Tokio Nakada¹	1.Tokyo University of Science
	11:30 - 11:45	13a-A17-11	Photovoltages and Their Dependence on Incident Light Wavelengths on CIGS Solar Cells Investigated by P-KFM	(D)Hyeondeuk Yong <sup>1</sup> , Takashi Minemoto <sup>3</sup> , Takuji Takahashi <sup>1,2</sup>	1.IIS, The Univ. of Tokyo, 2.INQIE, The Univ. of Tokyo, 3.Coll. of Sci. and Eng., Ritsumeikan Univ.
	11:45 - 12:00	13a-A17-12	CIGS上でのケルビンブローブフォース顕微鏡及び静電引力顕微鏡による表面電位分布と静電引力スペクトルの観測	○石井 智章¹, 峯元 高志³, 高橋 琢二¹²	1.東大生研, 2.東大ナノ量子機構, 3.立命館大理工
招待	12:00 - 12:15	13a-A17-13	「講演奨励賞受賞記念講演」(15分) Cu(In,Ga)Se2薄膜太陽電池の 価電子帯制御による界面再結合抑 制効果の理論的及び実験的検証	〇西村 昂人 <sup>1</sup> , 平井 義晃 <sup>1</sup> , 黒川 康良 <sup>1</sup> , 山田 明 <sup>1,2</sup>	1.東工大院理工, 2.太陽光発電システム 研究センター

13.10 化合物太陽	景電池, 15.2 Ⅱ-V	/l族結晶および多元系結晶のコードシェアセッション	ポスター講演		
3月13日(金) 16:30 - 18:30					
	13p-P19-1	電着法によるFeSe薄膜の作製と物性評価II	○(M1)長屋 智紀¹, 高橋 誠¹, 鈴木 崇也¹, 田橋 正浩¹, 大木戸 貞夫¹	1.中部大学	
	13p-P19-2	酸性溶液中で硫黄源の仕込み量がSnS膜に与える影響	○石川 佑¹, 宮崎 尚¹, 岡本 庸一¹, 守本 純¹	1.防衛大材料	
	13p-P19-3	硫化法を用いたSnS薄膜における組成比が電気特性に与える影響	〇三上 俊太郎¹, 横井 翼¹, 鷲見 浩貴¹, 相原理¹, 永易 京¹, 久富 一真¹, 杉山 睦¹	1.東京理科大学理工学部/総合研究機構	
	奨 13p-P19-4	$GeS_2$ と $S蒸気反応を用いたCu_2GeS_3$ 薄膜太陽電池の作製	○知野 広太郎¹, 豊永 詞¹, 金井 綾香¹, 荒 木 秀明¹.²	1.長岡高専, 2.科学技術振興機構, さきがけ	
	13p-P19-5	スプレー熱分解法によるCu <sub>2</sub> ZnSnS <sub>4</sub> 薄膜太陽電池の作製	○(B)藤川 祥太朗¹, ヒエップ グエン ティ¹, ウィルマン セプティナ¹, 原田 隆史¹, 池田 茂¹, 松村 道雄¹	1.阪大太陽エネルギー化学研セ	
	13p-P19-6	2段階同時蒸着法によるCu <sub>z</sub> ZnSnSe <sub>4</sub> 薄膜作製の検討	○村上 秀憲¹, 大塚 健介¹, 弓達 新治¹, 宮田 晃¹, 白方 祥¹	1.愛媛大工	
	13p-P19-7	Cu <sub>2</sub> ZnSn(S,Se) <sub>4</sub> ナノ粒子を用いた塗布薄膜の焼成条件による影響	○鈴木 俊正¹, 鈴木 吏², 堀 茂雄², 野々村 修一²	1.JFCC, 2.岐阜大学	
	13p-P19-8	時間の経過による三次元構造Cu₂ZnSnS₄太陽電池の特性変化	○田中 久仁彦¹, 長橋 由樹¹, 石山 貴道¹, 森 谷 克彦², 打木 久雄¹	1.長岡技大, 2.鶴岡高専	
	13p-P19-9	分子線エピタキシー法によるCuGaS₂薄膜の作製と評価 ~(NH₄)₂Sҳによる過剰CuҳSのエッチング~	○倉掛 真弥¹, 岡 優貴¹, 松下 将也¹, 山田 秀明¹, 阿部 友紀¹, 市野 邦男¹	1.鳥大院工	
	13p-P19-10	MEE法を用いて成長したGaAs(001)基板上CIS-CGS構造の評価	○豊田 康揮¹, 佐藤 知嵩¹, 谷口 龍希¹, サティア バマ¹, 堀越 佳治¹, 牧本 俊樹¹	1.早稲田大学	
	13p-P19-11	大気中におけるCIGS太陽電池の効率劣化の検証	○西永 慈郎¹, 上川 由紀子¹, 崔 誠佑¹, 柴 田 肇¹, 仁木 栄¹	1.産総研	
	13p-P19-12	二波長蛍光分光法および光容量分光法を用いた鉛ハライド系ペロプスカイト太陽電池の欠陥準位評価	○中澤 紀祥¹, 櫻井 岳暁¹, M.M. Islam¹, 秋 本 克洋¹, 尾込 裕平², 早瀬 修二²	1.筑波大, 2.九工大	

13p-P19-13	ベロブスカイト太陽電池に用いる多孔質酸化チタン層の昇温脱離 分析	○(B)宝山 修士!, ハシーヤ カリマ アディ リ¹, 原田 隆史¹, 池田 茂¹, 伊藤 省吾², 松 村 道雄!	1.大阪大基礎工, 2.兵庫県立大工
13p-P19-14	量子ドット増感型太陽電池の量子ドット生成法に対するフォトキャリア 取り出し効率の比較	○家山 昂¹, 尾崎 信彦¹, 大渕 隆文², 福田 直晃², 加藤 美奈子³, 滝谷 俊夫³	1.和歌山大シス工, 2.京都大, 3.日立 造船(株)
13p-P19-15	AR膜によるInGaP/GaAs/Si 3接合セル中サブセル特性の制御	○重川 直輝¹, 梁 剣波¹	1.大阪市大工
13p-P19-16	多接合太陽電池応用に向けたGaAs/Ge表面活性化接合技術の検討	○山下 大之¹, 河野 元紀¹, 渡辺 健太郎¹, 杉山 正和¹, 須賀 唯知¹, 中野 義昭¹	1.東大工
13p-P19-17	GaAs:N δドープ超格子を有する太陽電池の二段階光吸収	○鈴木 智也¹, 八木 修平¹, 土方 泰斗¹, 岡田 至崇², 矢口 裕之¹	1.埼玉大理工, 2.東大先端研
E 13p-P19-18	GaNAs quantum structures embedded in GaAs p-i-n for Intermediate Band Solar Cell with zero valance band offset	⊙Martin Elborg¹, Takeshi Noda¹, Liyuan Han¹	1.NIMS, Tsukuba
13p-P19-19	面内高密度InAs量子ドット層における光伝導特性	○(B)秋元 直己¹, 内田 俊介¹, 山口 浩一¹	1.電通大
13p-P19-20	$\rm ECR \mathcal{T}$ ラズマ作製による $\rm Cu/Cu_{_2}O \mathbb{Z}PV$ セルの特性に与える水素プラズマ前処理の効果	○奈良 拓馬¹, 菊地 悠介¹, 佐藤 直幸¹, 池畑 隆¹	1.茨城大院理工
13p-P19-21	ECRプラズマ作製による $\mathrm{Cu/Cu_2OPPV}$ セルの大気曝露特性	○長谷川 基輝¹, 菊地 悠介¹, 佐藤 直幸¹, 池畑 隆¹	1.茨城大院理工
13p-P19-22	Free-standing InP Nanowire Array and Their Optical Properties Toward Resource-Saving Solar Cells	○(M1)muyi Chen¹, Eiji Nakai¹, katsuhiro Tomioka¹², takashi Fukui¹	1.Graduate school of IST and RCIQE Hokkaido Univ.,, 2.JST-PRESTO